Campus Map



講演会当日のお問合せはこちらへ
大会本部直通ＴＥＬ　0463-59-8303

2015年応用物理学会春季学術講演会企画にあたって

応用物理学会講演会企画運営委員長
民谷　栄一



2015年第62回応用物理学会春季学術講演会は，東海大学湘南キャンパスにて開催されます．今回，14の大分類分科，合同セッションにおいて3,909件の発表（うち口頭講演2,947件，ポスター発表962件）が行われます．これに加えて，3月13日（金）には，ノーベル物理学賞を受賞された赤﨑先生，天野先生，中村先生の3名による，ノーベル物理学賞受賞記念講演が開催されます．他にも，特別シンポジウムが5件，シンポジウムが25件，チュートリアルが3件開催され，今春の講演会はイベントが盛りだくさんとなっています．また，ポスター会場には，180以上の企業・団体が出展する展示会も併設いたします．

また本会に関わる受賞記念講演として，応用物理学会業績賞，講演奨励賞の受賞記念講演が予定されています．恒例の「応物キャリア相談会」も開催致します．

講演プログラム及び講演会場，展示企業及び展示ブースなどは昨年同様，iPhone とiPad 及びAndroidのアプリで提供されていますので是非ご活用ください．これを使えば，講演会場の号館や展示会のブースの場所がスマートフォンの表示画面でキャンパス地図から案内される他，講演者や講演タイトル，講演時間なども簡単に検索できます．従来に引き続いて，託児室の設置も行っていますので，ご利用ください．学会としては非公式ではありますが，FacebookやTwitterなどでもニュースやイベントの紹介をしております．

展示会場（JSAP EXPO Spring 2015）では，JSAP フォトコンテスト(Science as Art) の開催や，恒例のスタンプラリー等も企画されていますので，奮ってご参加ください．また，展示会出展社によるランチョンセミナーを今回も開催いたします．

参加者にとって活力を生み出す有意義な学術講演会になるよう願っております．最後になりましたが，講演会場をご提供いただいた東海大学と現地実行委員の先生方に深く感謝いたします．

― 春季講演会トピックス ―

◇ノーベル物理学賞受賞記念講演
3月13日（金） 14:00～16:00
2号館大ホール（2S-101）
講演者：赤﨑 勇終身教授(名城大学)
天野 浩教授(名古屋大学)
中村 修二教授(カリフォルニア大学)

◇懇親会
3月11日（水） 19:00～20:30
キャンパス内カフェテリア「コム・スクエア」
会費：社会人3000円，学生1000円
申込：ウェブまたは当日会場にて申込可能です．
会費は当日17時までに，Registrationの
「懇親会受付」にてお支払ください．

◇応物キャリア相談会
3月13日（金） 11:30～13:45/16:15～18:30
展示会場（総合体育館）

◇特別シンポジウム「かながわ発！スマートエネルギー革命」
3月12日（木） 13:00～16:50
松前記念館講堂

◇特別シンポジウム「日本のモノづくり再生に向けた産学官共鳴場の創成を目指して」
3月12日（木） 13:30～17:30
B2会場（6号館6B-102）

◇特別シンポジウム「応用物理学会分野で活躍する女性たち～第3回バイオエレクトロニクス編～」
3月13日（金） 9:00～12:00
B3会場（6号館 6B-103）

◇特別シンポジウム「世界一行きたい科学広場」
3月14日（土） 9:50～15:30
2N-101/松前記念館講堂

◇特別シンポジウム「フォノンエンジニアリング：ナノスケール熱制御のための新しい材料科学，理論・シミュレーション，計測技術，およびこれによるデバイス革新」
3月14日（土） 8:45～15:00
B2会場（6号館6B-102）

第62回応用物理学会春季学術講演会 特別企画

ノーベル物理学賞受賞記念講演

3月13日（金） 14：00～16：00
東海大学 湘南キャンパス
2号館大ホール（2S-101教室）

応用物理学会の名誉会員である赤﨑 勇先生，天野 浩先生，中村 修二先生が2014年ノーベル物理学賞を受賞されたことを記念して，受賞記念講演会を開催いたします．



赤﨑勇 終身教授
（名城大学）



天野浩 教授
（名古屋大学）



中村修二 教授
（カリフォルニア大学）

プログラム
14：00　開演
14：05　応用物理学会 会長祝辞
14：15　赤﨑 勇 先生　ご講演
14：45　天野 浩 先生　ご講演
15：15　中村 修二 先生　ご講演

参加費

無料 ※講演会の他の講演を聴講される場合は，別途参加申込み，参加費が必要となります．

お申し込み方法

1. 事前ウェブ申込（どなたでもお申込みいただけます） 2月13日（金）正午締切
   詳細は大会公式ウェブサイト(http://meeting.jsap.or.jp/)をご覧ください．
2. 当日整理券配布（講演会参加費をお支払済みの方のみ）
   3月１３日（金）８：00より，東海大学湘南キャンパス１７号館Registrationにて，整理券（1300枚）を先着順で配布いたします．

※当日は講演会場にてライブ配信も予定しております．ライブ配信は十分な席数をご用意しております．

■第15回応用物理学会業績賞(教育業績)

業績の名称：インターネット・書籍等を通じた応用物性分野の教育・普及活動への貢献
受賞者：佐藤勝昭(科学技術振興機構)
日時：3月11日(水) 14：30−15：15
会場：E1会場(松前記念館講堂)

佐藤勝昭氏は，長年にわたり，インターネットや書籍等を通じて応用物理学に関わる科学技術をわかりやすく解説することにより，広く若手研究者・技術者の育成と社会における普及活動を行い，応用物理分野に多大な貢献を果たしてきた．
2000年にインターネットのWEBサイト「物性なんでもQ＆A」を開設し，半導体・金属・光・磁性・結晶工学などを中心とした応用物性に関する質問を幅広く受け，わかりやすく適切な回答を迅速に掲載し，小中高生，大学・大学院生，企業研究者・技術者などからの1300件余りの質問に回答してきた．それらのQ＆Aには索引がつけられ，キーワードを調べることで，容易に目的とする項目にたどりつけるようにしている．これらの活動により，若手研究開発者や応用物理学に興味をもつ青少年や一般人の知的基盤の底上げに貢献してきた．閲覧数も多く，2007年以降でも60万件を超えている．インターネット時代の理工系教育に対してまさに先鞭をつけた業績である．さらに，学協会での招待講演，大学での講義や市民講座などで用いたパワーポイントファイルをWeb公開するほか，e−ラーニングに積極的に取り組むなどインターネットをフルに活用した教育活動を行ってきた．また，書籍出版に関しても，数多くの一般・初学研究者向けの書籍を執筆し，科学知識の普及に努めてきた．
学会活動の一環として，「物性なんでもQ＆A」をコンパクトにまとめた連載記事は応用物理学会結晶工学分科会の会誌『Crystal Letters』に毎回掲載され，2014年9月号の最終回までに22回を数えた．
以上のように「インターネット・書籍等を通じた応用物性分野の教育・普及活動への貢献」に関する同氏の業績は，学生・若手研究開発者の育成・啓発，科学技術に関する青少年・一般人への啓発に大きく貢献する卓越したものであるといえ，応用物理学会業績賞（教育業績）として誠に相応しいものである．当日は「ネット時代の応物コミュニケーション」の題目で講演いただく．

■第15回応用物理学会業績賞(研究業績)

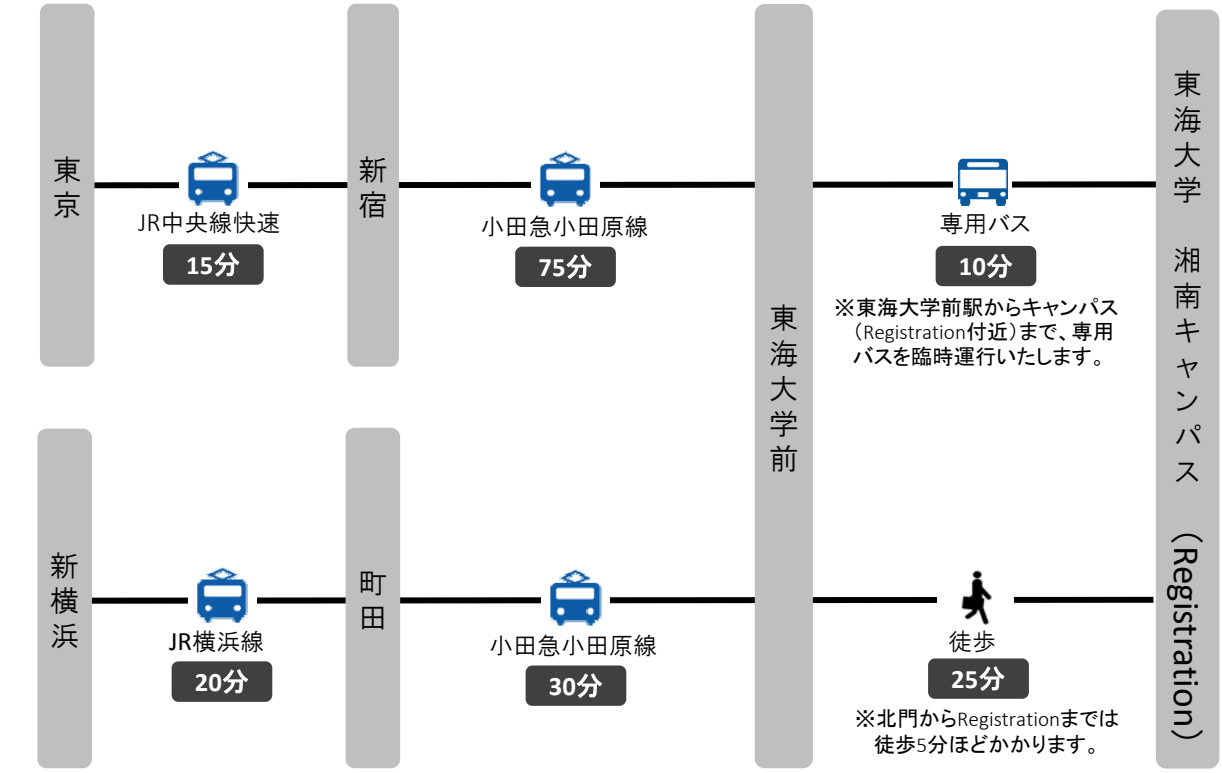
業績の名称：大容量メモリ技術の産業展開への貢献と三次元集積化技術の先駆的研究
受賞者：小柳光正(東北大学)
日時：3月12日(木) 14：00−14：45
会場：A23会場(6A−216)

小柳光正氏は，大容量半導体メモリの基本構造を世界に先駆けて提唱し，半導体産業の発展に大きく寄与すると共に，三次元集積回路に関する重要な技術を確立して，シリコン集積回路の高性能化と高機能化に卓越した貢献をなした．
小柳氏は，1978年にMOS（Metal−Oxide−Semiconductor）トランジスタを形成したシリコン基板の上に積層してメモリ用キャパシタを設ける三次元スタックドキャパシタ型メモリセルを提案，試作し，その基本特性を実証した．このセル構造は微細化に適し，かつ製造歩留まりに優れたメモリの基本構造として，現在では，ほぼ世界中の汎用DRAM（Dynamic Random Access Memory：再生動作が必要な随時書き込み・読み出しメモリ）に採用され，半導体産業の発展に大きく貢献した．この技術が半導体メモリ分野に与えた学術的，産業的インパクトは極めて大きいといえる．
また，小柳氏は実現が困難とされていた三次元集積回路に関する多くの基本技術を提案，実証し，シリコン集積回路の高機能・高性能化に向けて大きな貢献をなした．具体的には，基板貫通配線（TSV: Through−Silicon−Via）による三次元集積化を多結晶シリコンTSVを用いて世界にさきがけ実証した．また，液体の表面張力を巧みに活用することにより，半導体メモリ，センサー，化合物半導体素子などの異種チップを自己整合的に三次元集積化するという画期的な手法を提案し，従来のシリコン集積回路単体では達成できない高機能化に成功した．小柳氏の業績は，単なる集積化技術の提案に留まらず，応用も含めたシステムレベルで研究開発を主導してきた点が特筆される．
以上のように，小柳氏は高集積化に適したDRAMの基本構造を提案し，半導体産業の発展に卓越した貢献をなすと共に，一貫して三次元集積回路の研究開発を牽引し，数多くの独創的かつ重要な基本技術を確立して，集積回路の高機能化に大きく寄与した．応用物理学，および産業発展の両面において小柳氏の果たした貢献は極めて顕著であり，応用物理学会業績賞（研究業績）として誠に相応しいものである．当日は「大容量メモリ技術の産業展開への貢献と三次元集積化技術の先駆的研究」の題目で講演いただく．

業績の名称：フォトニック結晶工学に関する先駆的研究
受賞者：野田進（京都大学）
日時：3月12日(木) 16：00−16：45
会場：A10会場(6A−115)

野田進氏は，世界初となる光波長帯での完全3次元フォトニック結晶の実現，2次元フォトニック結晶における上下方向の光閉じ込めの概念の提案・実証と世界最大のQ値をもつ光ナノ共振器の実現，さらには，2次元結晶のバンド端共振効果を用いた大面積コヒーレントレーザの概念の創出・実証・実用化など，フォトニック結晶工学の創出・発展において卓越した貢献をなした．
自在な光制御が期待される完全3次元結晶の実現のためには，光の波長程度の周期をもつ3次元光ナノ構造の形成が不可欠であるが，当初は，光波長域では結晶そのものが存在しなかった．野田氏は，3次元結晶の設計と作製に果敢に挑戦し，独自の精緻なロッド積み上げ法を開発して，光波長帯（光通信帯）において，完全バンドギャップをもつ3次元結晶の実現に世界で初めて成功した．さらに，この結晶に発光体を導入し，自然放出制御にも初めて成功した．野田氏のこの研究は，結晶そのものの実現はもとより，それによる自然放出制御の理論予測をも実証したという点で，象徴的かつ美しい科学的成果として世界中から高く評価されている．
一方，作製の観点からは，2次元結晶が魅力的であるが，上下方向の光閉じ込めが不完全で，光制御が困難であると考えられていた．野田氏らは，上下方向の強い閉じ込めが2次元面内での格子の精密調整によって得られることを発見して世界を驚かせた．また，2次元結晶にナノ共振器・導波路を導入することで，面内を伝搬する光を面垂直方向にも取り出せることをも示した．これらの発見により，2次元結晶における光制御（特に，高Q値共振器）の競争が国内外で激化したが，野田氏は持ち前の科学的洞察力と実行力でトップ集団を牽引し，今では1000万にも迫る驚異的な高Q値を得ることに成功している．最近，半導体物理学の分野では励起子やポラリトンを用いた原子光学的研究が脚光を集めているが，このような基礎研究の実施においても野田氏らが提示してきた2次元結晶の設計・作製指針が不可欠なものとなっている．
さらに野田氏は，2次元結晶の産業応用に向けた研究においても世界をリードする成果を挙げている．特筆すべきは，高ビーム品質をもつワット級半導体レーザの実現である．従来の半導体レーザでは，光出力を増大しようとして，出射面積を大きくすると出射端でレーザ光の波面が変形してビーム品質が著しく劣化するという問題があった．一方，フォトニック結晶のバンド端共振効果を利用する野田氏の発明では，出射面で一様な波面が得られるため，出射面積を大きくしてもビーム品質が劣化せず，増大した出力を一点に集光できることとなる．この画期的な半導体レーザは，極最近，産学共同により，実用化が決定するに至っている．
これら野田氏の卓越した多くの業績は応用物理学会業績賞（研究業績）として誠に相応しいものである．当日は「フォトニック結晶工学の進展と今後の展望」の題目で講演いただく．

交通アクセス



東海大学構内に駐車場はございません。**自家用車は御利用いただけません。**ご注意ください。

専用バス発着場所

東海大学前駅南口からキャンパス内（Registration付近）まで専用バスを臨時運行いたします。

料金　**片道250円、往復400円**　**料金は学内乗降時にお支払ください。**
往復でご利用の方にはその際帰りの切符をお渡しします。

※お支払いは現金のみになります。ICカードはご利用になれません。お釣銭のないようにご協力お願い致します。
※専用バス切符売場はキャンパス内バス発着場所付近にございます。
（東海大学前駅南口にはございません。）
※ピーク時は混雑が予想されます。あらかじめご了承ください。
※路線バスは東海大学前駅南口から東海大学北門まで運行しております。（片道 180円）

東海大学前駅（南口）



東海大学 湘南キャンパス



駅からのアクセス

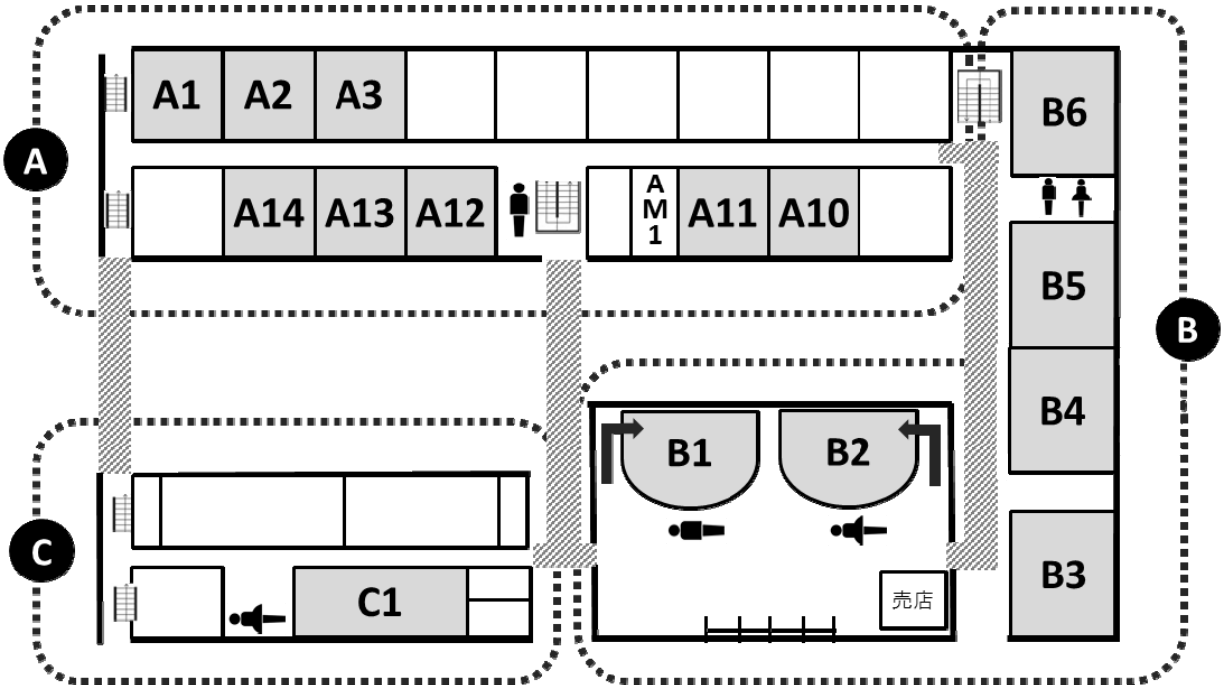

東海大学前駅
小田急小田原線
ファミリーマート
グルメシティ・大根店
不動産屋
横浜銀行
パチンコ
東海大学
近道商店街
秦野厚生病院
横浜銀行を過ぎて
最初の角を右折して，
川を越えてください．
駅から北門まで
徒歩約20分
通称「定年坂」
（階段（のぼり））
喫茶店（ボルボ）
TSUTAYA
北門
ノーベル物理学賞
受賞記念講演
ノーベル物理学賞
受賞記念講演へはこちら
講演会場へはこちら
北門から
Registrationまで
徒歩約5分
テニスコート
陸上競技場、サッカー場
ドトールコーヒー
ラグビー場
ポスター会場、展示場
Registration
食堂
シャトルバス発着場所
食堂
講演会場（D）
講演会場（A,B,C）

フロアマップ

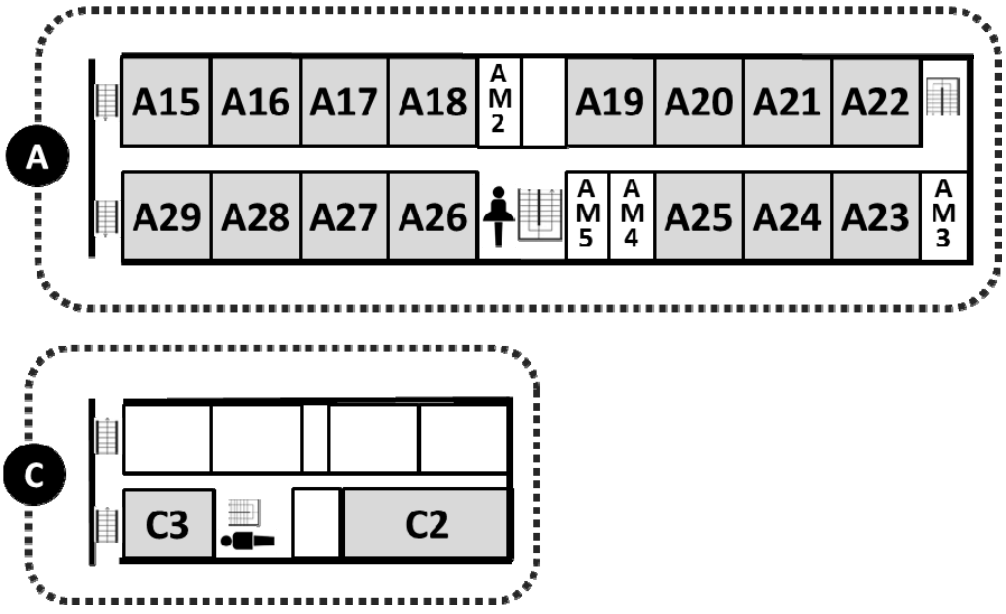
1F

の部分は屋根のある廊下でつながっています。

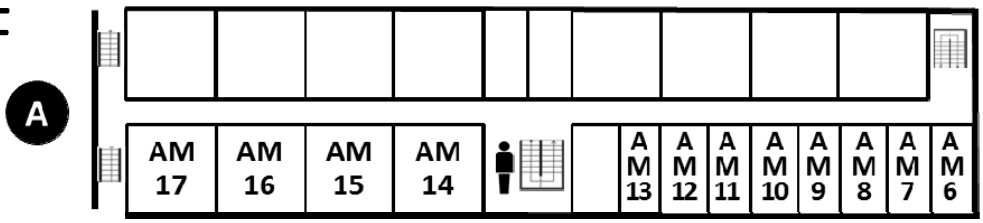
6号館



2F



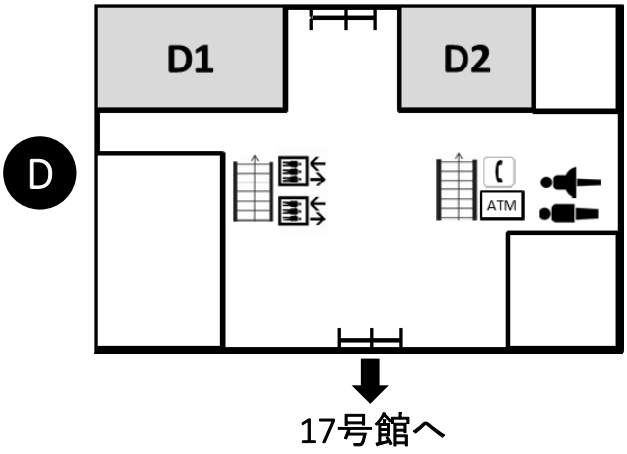
3F



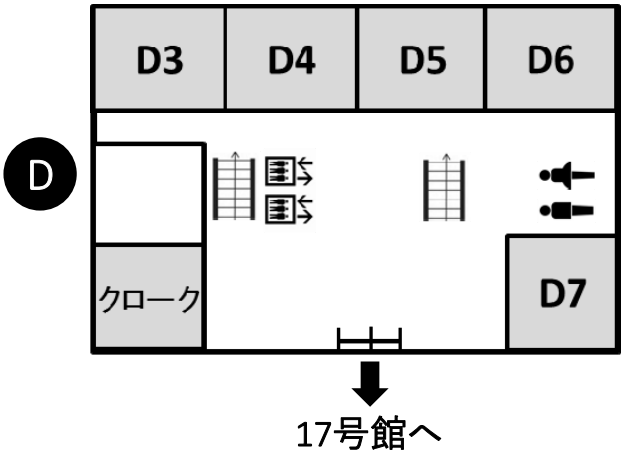
フロアマップ

16号館

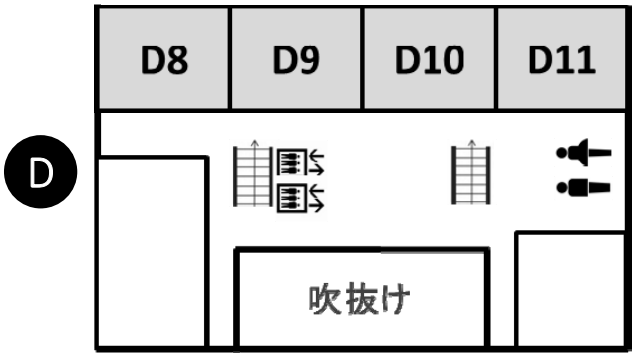
1F



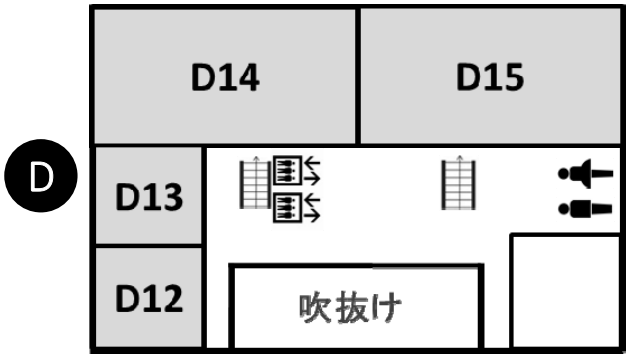
2F



3F

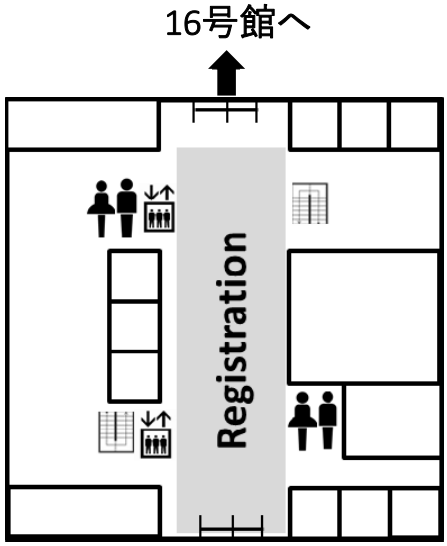


5F

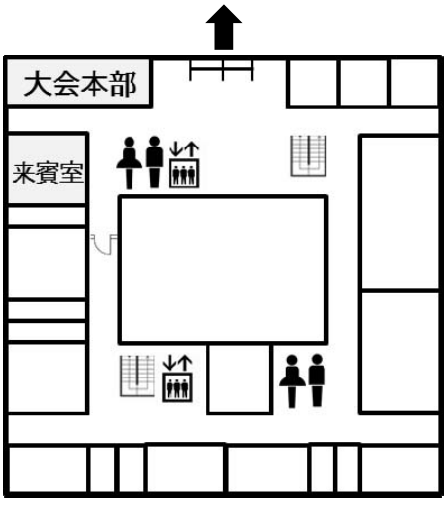


17号館

1F



2F



■ご案内

本部行事

日 付 2015年3月11日(水)
会 場 E1会場 松前記念館講堂

●第37回応用物理学会「講演奨励賞」贈呈式(公開)11:00～12:00
●応用物理学会業績賞授賞式 15:15～15:45
●応用物理学会研究分野業績賞授賞式 16:00～17:15
●名誉会員贈呈式 17:30～18:30

参加費について

学術講演会に出席される方は参加費(当日価格)をRegistrationにてお支払いください. 参加費をお支払いいただいた方には予稿集DVD・公式ガイドブック・参加票をお渡しいたします.なお,参加費(予稿集DVD・公式ガイドブック・参加票含む)を事前予約されている方は,当日参加票を首から下げて直接講演会場へお越しください.

内容	種別	予約価格	当日価格
講演会参加費 [事前送付] ・予稿集DVD ・参加票 [当日引換] ・公式ガイドブック	一般会員・準会員	8,000円	12,000円
	学生(会員・非会員)	3,000円	5,000円
	シニア会員*	4,000円	7,000円
	協定学会会員**	8,000円	12,000円
	非会員	15,000円	20,000円
予稿集DVDのみ購入	従来の0,1,2,3分冊の内容を全て収録	8,000円	
公式ガイドブックのみ購入	プログラム・登壇者索引	2,000円	

＊ 常勤として勤務に就かれていない60歳以上の会員.一般会員からの種別変更が必要です.
** 協定学会:APS(American Physical Society), EOS (European Optical Society), EPS(European Physical Society), IOP(Institute of Physics), KPS(Korean Physical Society), OSA(Optical Society of America), OSK(Optical Society of Korea), PESJ (日本物理教育学会), PSROC(The Physical Society of Republic of China), SFP (Société Française de Physique), SPIE (International Society for Optica Engineering), TPS(Taiwan Photonics Society)
●講演会参加費は,**一般会員および学生は不課税,非会員は内税**です.
●事前予約されている方は当日, 参加票を首から下げて直接講演会場へお越しください.
※ガイドブックが不要の方はRegistrationにお立ち寄りいただく必要はございません.
●講演会参加を予約されなかった方は, 当日早目にRegistration内「当日受付(On-site Registration)」ブースにてお手続きください.
●会場内では, 必ず「参加票」を首からさげて下さい.

サービスについて

●ネットワークサービスについて
学術講演会の開催期間中に, ポスター発表, JSAP EXPOの会場であるP会場で, 無線LANを利用したインターネット接続が無料で利用できます. 利用するコンピュータはご自身にてご準備ください. なお, ウイルス対策を十分に講じたコンピュータをお使い下さいますよう, お願いします.

●参加者用クローク(手荷物一時預かり)サービスについて
クロークサービス(有料)を以下にて実施しますのでご利用ください.

受付場所:D棟(16号館) 2階
預かり料:荷物1個につき300円

預かり時間:
3/11(水) は,8:00～19:00(当日限り)
3/12(木)～13(金) は,8:00～19:30(当日限り)
3/14(土) は,8:00～16:00(当日限り)

その他:スペースに限りがあり, お預かりできない場合もございます. 貴重品はお預かりできません.

●バリアフリー対応について
講演会場の建物は基本的にバリアフリーですが, 一部の対応していない会場があります. 詳細に関しては, 事前に事務局(03-5802-0864)にお問い合わせください.

●公共交通機関利用のお願い
会場周辺には, 駐車ができる施設・設備はありません. 電車およびバス等の公共交通機関をご利用下さい.

●営利目的の宣伝活動について
事前申請された事業者以外の展示営業活動はご遠慮ください.

●撮影, 録音について
講演発表の撮影, 録音はできません. ポスターも撮影禁止です.

●マスコミ取材について
事前に許可が必要です. 学会事務局または現地大会本部にご連絡ください.

■口頭講演のご案内

1.PCプロジェクタ使用に関して

全ての講演会場で，PCプレゼンテーションを実施します．講演会場には，ノートパソコンと液晶プロジェクタを設置しています．以下の注意事項参考に，発表の準備をしていただきますようお願いします．

1.会場設置のノートパソコンを使用する場合

講演者は，USBメモリ又はCD-ROMでパワーポイント(PPT)のファイルを会場に持参し，発表することができます．動作環境は以下のとおりです．

1-1)ハードウェア

・CPUとクロック周波数はIntelCorei3/2.1GHz以上です．
・メインメモリは2GB以上です．
・USB2.0ポートは3～4個付いています．ただし，1ポートはマウスにて使用されます．

1-2)ソフトウェア

・OSはWindows7Proです．
・プレゼンテーションソフトは**MicrosoftPowerPoint(PPT)2013**です．
・動画再生ソフトは，WindowsMediaPlayerVer.10です．特殊な形式・コーデックには対応していませんので，標準的なものをご使用ください．QuickTime，RealPlayerやAdobeReaderなど，他の再生ソフトはインストールされていません．
・ウイルスセキュリティーソフトはインストールされていますが，複数の方がUSBメモリーを介して同じPCを使用するため，ウイルス感染の危険性がないわけではありません．USBメモリーはライトプロテクトスイッチ(書き込み防止機能)の付いたUSBメモリーをご使用ください．

1-3)発表用ファイル

・PPTファイルを作成する場合，Windows7が標準で提供しているフォントを使用してください．例えば，日本語と英語：MS明朝，MSゴシック，英語：Arial，TimesNewRoman等があります．標準でないフォントを使用すると，デザインされたとおりには表示されません．
・ファイルサイズがあまり大きくならないようご注意ください．メインメモリの容量が限られていますので，サイズの大きなファイルを操作するとパソコンが不調になることがあります．
・PPTファイルにファイル名を付けてください．ファイル名は，半角英数字の講演番号と発表者のお名前をアンダースコア(アンダーバー)で結んで表記してください．　**ファイル名の例：11a-A1-10 yamada.ppt**
・ウィルスを感染させることが無いよう，ファイルの管理には十分注意して下さい．

1-4)発表会場

・セッション開始前の休憩中に，USBメモリ又はCD-ROMのデータをノートパソコンのデスクトップにコピーして，発表に備えてください．
この場合，セッション終了後にアルバイターがノートパソコンにコピーされたファイルを閲覧できない状態に削除します．
・講演会終了後にソフトウェアによるデーター消去は行いますが，完全消去には対応しておりませんので，ノートパソコンのハードディスクにデータが残ることを気になさる方は，USBメモリ又はCD-ROMを直接アクセスして投影を行ってください．
・ノートパソコンへのコピーと投影チェックは，セキュリティ上，座長あるいは会場担当のアルバイター立会いで行ってください．
コピーは原則アルバイターが行います．アルバイターは，休憩時間には常駐しますが，昼休みは午後の講演開始時間の20分前まで不在となりますので，ご協力願います．

2.ノートパソコンを持ち込まれる際のご注意

講演者が持参したノートパソコンを使って，発表することができます．以下の点にご留意いただき，発表を行ってください．

2-1)パソコンの操作

・発表開始前にパソコンの電源を入れ，投影の準備をしておいてください．
・講演者は，画面を外部出力可能にしておいてください．

2-2)講演時の注意事項

・接続に要する時間も講演時間に含みますので，速やかな発表に向けてのご準備にご配慮ください．

2-3)接続ケーブル

・右の画像のケーブルを準備してあります．一部のノートパソコンでは付属のコネクタが必要な場合がありますので，お忘れなくご持参ください．



2.講演時間について

一般講演の講演時間は15分（講演10分，質疑応答5分）です．会場係が経過時間をお知らせするベルを鳴らします．

●**第１鈴**：講演予定時間終了の5分前

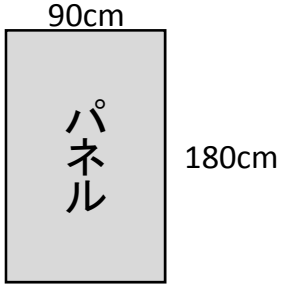
●**第２鈴**：講演予定時間終了
※第2鈴がなったときただちに講演を中止していただきます．

●**第３鈴**：質疑（討論）時間終了

■ポスター講演のご案内

1.展示方法

・1講演につき，たて180cm，よこ90cmのパネルが
用意されています．



・パネルに各自用意したポスター，図表，写真などを
適宜レイアウトして掲示してください．
・ポスターの大きさ，形式は問いません．パネルに収まるように
ポスターを作成してください．
・すべての掲示は本部で用意したピンで行ってください．
糊の使用はご遠慮ください．

2.講演時間について

	am	pm前半	pm後半
準備	9:10～9:30	13:10～13:30	15:40～16:00
説明・討論	**9:30～11:30**	**13:30～15:30**	**16:00～18:00**
撤収	11:30～11:40	15:30～15:40	18:00～18:10

**※3/13(金)のpm後半のみ16:30～18:30となります．
ご注意ください．**

コアタイムは講演番号の順番が
奇数の方は最初の1時間，偶数の方は後半の1時間
です．その時間帯はポスターの前から離れないでください．

※例えば
11a-P1-3であれば3番なので奇数
12p-P2-6であれば6番なので偶数
となります．

3.ショートプレゼンテーション付きポスター講演

口頭講演会場で1講演2分間のショートプレゼンテーションを行い，引き続きポスター講演会場にてポスター講演を行います．
ショートプレゼンテーションの日時・会場，およびポスター講演の日時・会場を必ずご確認ください．
ショートプレゼンテーションでは質疑応答はございませんので，終了のベルが鳴ったら直ちに講演を中止してください．

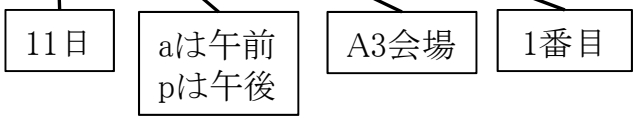
Poster Award規程

1.この規程は,公益社団法人応用物理学会（以下「本会」という.）が本会会員に対して行なうPoster Awardに関して定めたものである.
2.Poster Awardは,本会の応用物理学会春季学術講演会および応用物理学会秋季学術講演会（以下「講演会」という.）において,
応用物理学の発展に貢献しうる優秀なポスター講演を行った会員を表彰し,その成果を称えることを目的とする.
3.表彰対象は,本会の講演会で発表された,応用物理学の発展に貢献しうる優秀なポスター講演で,以下(1)～(2)の条件を
全て満たす著者を表彰する.
(1)ポスター講演を行った時点で本会会員であること
(2)講演申し込み時に,登録された著者であること
4.ポスター講演の著者で,会員外(分科会A会員,相互協定を締結した学協会の会員及び非会員)の者は表彰対象としない.
5.Poster Awardの選考手順は,別途内規で定める.
6.表彰の対象となるポスターは,ポスター講演総数の概ね2%以内とする.
7.受賞者には本会会長名の賞状を授与する.
8.表彰は表彰時点における本会会長名により行う.
9.受賞ポスターは,講演会会期中,会場に掲示する.
10.表彰されたポスターについては,講演会企画運営委員会及び理事会に報告する.
11.本規程の改正は総務委員長が承認し理事会へ報告する.

付 則
1.この規程は平成25年2月15日理事会にて決定.
2.この規程は平成25年2月15日より施行する.

■講演番号について

(例) 11 a - A3 – 1

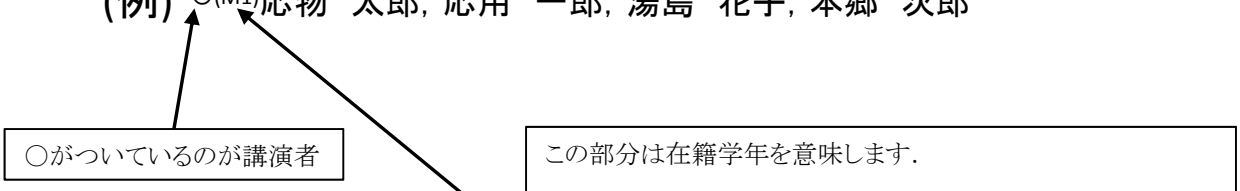


講演番号の横にある印の意味は以下の通りです.

E 英語による講演
奨 講演奨励賞エントリーの講演

■講演者名の表記について

(例) ○(M1)応物 太郎, 応用 一郎, 湯島 花子, 本郷 次郎



(M1)→(M1C), (D)→(DC), (P)→(PC)と表示されている場合

求職中であることを意味します.

講演者が求職中であることを明示できるよう, キャリアエクスプローラーマークがございます.
詳しくは以下URLをご覧ください.
http://www.jsap.or.jp/activities/annualmeetings/CEmark.html

■チラシについて

講演会場でチラシやパンフレットを置いたり配布したりすることは禁止されております. 見つけた場合にはただちに撤去させていただきます. 応用物理学会の協賛または共催の学会, 会合等で, チラシに応用物理学会の名前またはロゴが入っているものに限り, Registration内指定のチラシ置場を準備してありますので, ご自身にてRegistrationにお持ちください. また, お持込いただいたチラシは最終日の12時までにご自身にて撤去をお願いいたします.

■駐車場について

会場内には, 来場者用の駐車場はありませんので, 車では来場しないでください(公共交通機関をご利用下さい). また近隣への迷惑になりますので, 路上駐車は絶対に行わないでください.
無断で大学内に車で入構したのを発見した場合は, 講演取消等の重い処分が下される場合がございますので, ご注意ください.

■懇親会のご案内

今大会の懇親会は東海大学　湘南キャンパス内にある「コムスクエア」で行います．
お手頃な参加費になっておりますので，ぜひお誘いあわせのうえ，ご参加ください．

日　時　2015年3月11日(水)　19:00～
会　場　東海大学　湘南キャンパス　「コムスクエア」(神奈川県平塚市北金目4-1-1)

参加費

社会人	3,000円(税込)
学生(会員・非会員)	1,000円(税込)

以下の方々は懇親会は無料招待となります．

・名誉会員
・功労会員
・第37回講演奨励賞受賞者
・第15回業績賞受賞者



お申込方法

●ウェブからのお申込み
ページ下の「参加申込」のURLにアクセスしてお申込みください．
参加費は，当日17:00までにRegistrationの「懇親会受付」にてお支払いください．(現金のみ)

●会場でのお申込み
Registrationの「懇親会受付」にてお申込みいただき，参加費をお支払いください．(現金のみ)

懇親会参加予約締切：　2015年3月1日(日)

懇親会参加申込URL
http://meeting.jsap.or.jp/socialgathering.html

■託児室のご案内

応用物理学会学術講演会参加者のための臨時託児室を設置いたします．
利用料は無料となっておりますので，ぜひご利用ください．

設置期間：2015年3月11日(水)～14日(土)
開室時間：8時30分～19時30分(最終日は16時まで)

利用には事前の申し込みが必要となりますのでご注意下さい．


2011年秋の様子

託児室利用申込締切：　2015年3月2日(月)

託児室利用申込URL
http://meeting.jsap.or.jp/nursery.html

講演分科日程表(分科別) I

東海大学 湘南キャンパス

大分類分科名	3月11日(水)		3月12日(木)		3月13日(金)		3月14日(土)	
中分類分科名	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
1 応用物理学一般								
1.1 応用物理一般・学際領域				P1 13:30 - 15:30		D12 16:30 - 19:00		
1.2 教育						P1 16:30 - 18:30		
1.3 新技術・複合新領域		D13 # 13:15 - 17:00		P2 13:30 - 15:30				
1.4 エネルギー変換・貯蔵	P1 9:30 - 11:30		D12 9:00 - 12:45					
1.5 資源・環境	D12 10:00 - 11:30			P3 13:30 - 15:30				
1.6 計測技術・計測標準					P1 9:30 - 11:30		D12 9:00 - 11:15	D12 13:00 - 14:15
1.7 超音波	P2 9:30 - 11:30	D12 13:15 - 17:15						
2 放射線								
2.1 放射線物理一般・検出器基礎			P1 9:30 - 11:30		A19 9:00 - 12:15	A19 14:00 - 16:00		
2.2 検出器開発		A19 16:15 - 18:00	P2 9:30 - 11:30			A19 # 16:15 - 19:00	A19 9:00 - 12:15	
2.3 放射線応用・発生装置・新技術	A19 9:00 - 11:45	A19 14:00 - 16:00	P3 9:30 - 11:30					
3 光・フォトニクス ※ コードシェアセッションあり 3.5 と 3.14, 3.11 と 13.7(表の末尾, コードシェアセッション を参照)								
3.0 Optics and Photonics English Session					A15 9:00 - 11:15			
3.1 光学基礎・光学新領域					P2 9:30 - 11:30		A12 9:00 - 12:00	A12 13:00 - 14:15
3.2 材料・機器光学				A13 14:00 - 17:15	P3 9:30 - 11:30			
3.3 情報フォトニクス・画像工学					P4 9:30 - 11:30	A11 16:30 - 17:30	A11 9:00 - 12:15	A11 13:15 - 14:30
3.4 生体・医用光学			P4 9:30 - 11:30				A10 9:30 - 11:45	A10 13:00 - 14:30
3.5 レーザー装置・材料			P5 9:30 - 11:30			A13 16:30 - 18:45	A13 9:30 - 12:00	
3.6 超高速・高強度レーザー			A15 # 9:45 - 12:30	A15 14:00 - 17:45	P5 9:30 - 11:30	A15 16:30 - 19:00	A15 9:15 - 12:00	A15 * 13:00 - 15:00
3.7 レーザープロセシング	A11 9:30 - 12:30	A11 14:00 - 18:00	A11 ## 9:30 - 11:30		A11 9:30 - 12:30	P2 16:30 - 18:30		
3.8 光計測技術・機器	A14 9:00 - 12:30	A14 14:00 - 18:00			P6 9:30 - 11:30		A14 9:00 - 11:30	A14 13:00 - 15:00
3.9 テラヘルツ全般		P1 16:00 - 18:00	A14 9:15 - 12:15	A14 13:30 - 17:00	A14 9:00 - 12:15	A14 16:15 - 19:00		
3.10 光量子物理・技術	A17 9:15 - 12:00	A17 14:00 - 16:45	P6 9:30 - 11:30					
3.11 フォトニック構造・現象	P3 9:30 - 11:30			A10 ※ 14:00 - 18:45	A10 9:00 - 12:15	A10 ※※ 16:30 - 18:45		
3.12 ナノ領域光科学・近接場光学	A12 9:00 - 12:30	A12 14:00 - 18:00	A12 9:00 - 12:15		A12 9:00 - 12:30	P3 16:30 - 18:30		
3.13 半導体光デバイス			A17 9:00 - 13:00	A17 14:00 - 19:00		P4 16:30 - 18:30		
3.14 光制御デバイス・光ファイバー	A13 9:15 - 12:30	A13 14:00 - 16:45	A13 9:00 - 11:45		P7 9:30 - 11:30			
3.15 シリコンフォトニクス		A16 14:00 - 17:00	A16 9:30 - 12:30	A16 14:00 - 17:30	P8 9:30 - 11:30			
6 薄膜・表面 ※ コードシェアセッションあり 6.6 と 12.2(表の末尾, コードシェアセッション を参照)								
6.1 強誘電体薄膜		P3 16:00 - 18:00			A21 9:00 - 12:30	A21 16:15 - 18:30	A21 9:00 - 12:00	
6.2 カーボン系薄膜	P4 9:30 - 11:30	C1 13:15 - 18:00	C1 9:00 - 11:45	C1 # 13:15 - 19:00				
6.3 酸化物エレクトロニクス	D10 9:00 - 11:45	D10 13:15 - 17:45	D10 9:00 - 11:45		D10 9:00 - 11:45	P5 16:30 - 18:30 D10 16:30 - 19:00	D10 9:30 - 11:45	D10 13:00 - 14:45
6.4 薄膜新材料	D8 9:00 - 11:45		D8 9:00 - 11:45	D8 # 13:15 - 18:30		P6 16:30 - 18:30		
6.5 表面物理・真空	D9 9:00 - 12:00			D13 13:15 - 17:00		P7 16:30 - 18:30		
6.6 プローブ顕微鏡			D9 10:00 - 11:45	P4 13:30 - 15:30		D9 16:30 - 19:30	D9 9:00 - 12:00	D9 13:00 - 15:00

会場名のアルファベットは建物名を表します.
(例:A1 は A棟にあります. B2 は B棟にあります)

<建物略称>
A:6号館A
B:6号館B
C:6号館C
D:16号館
E:松前記念館講堂
P:体育館

分科内招待講演あり
##Invited lecture of overseas researcherあり
* 光・量子エレクトロニクス業績賞(宅間宏賞)受賞記念講演あり
※ 応用物理学会業績賞(研究業績)受賞記念講演あり
※※ 女性研究者研究業績・人材育成賞(小舘香椎子賞)受賞記念講演

講演分科日程表について

(例)

3月11日(水)		3月12日(木)		3月13日(金)		3月14日(土)	
午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
P3 9:30 - 11:30			A10 14:00 - 18:45	B1 9:00 - 12:15	B2 16:30 - 18:45	D9 9:00 - 12:00	D9 13:00 - 15:00
ポスター セッション のみ			場所の記号 (A10会場)	講演時間			

講演分科日程表(分科別) II

東海大学 湘南キャンパス

大分類分科名	3月11日(水)		3月12日(木)		3月13日(金)		3月14日(土)	
中分類分科名	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
7 ビーム応用								
7.1 X線技術	P5 9:30 - 11:30	A26 13:15 - 17:30						
7.2 電子ビーム応用			P7 9:30 - 11:30	A11 13:30 - 19:00				
7.3 微細パターン・微細構造形成技術	B2 9:00 - 11:45	B2 # 13:15 - 16:30	P8 9:30 - 11:30					
7.4 量子ビーム界面構造計測						P8 16:30 - 18:30	A16 9:00 - 12:00	
7.5 原子・分子線およびビーム関連新技術					A16 # 10:30 - 12:00	P9 16:30 - 18:30		
7.6 イオンビーム一般						P10 16:30 - 18:30	C1 9:00 - 12:00	C1 13:00 - 15:00
8 プラズマエレクトロニクス								
8.0 Plasma Electronics English Session			D14 9:00 - 10:45		P9 9:30 - 11:30			
8.1 プラズマ生成・制御				P9 16:00 - 18:00		A28 16:30 - 19:00	A28 9:00 - 11:45	
8.2 プラズマ診断・計測		A27 14:00 - 18:00			P10 9:30 - 11:30			
8.3 プラズマ成膜・表面処理				P10 16:00 - 18:00	A27 9:00 - 12:30			
8.4 プラズマエッチング					P11 9:30 - 11:30		A27 9:00 - 13:00	
8.5 プラズマナノテクノロジー					P12 9:30 - 11:30	A27 16:30 - 18:45		
8.6 プラズマライフサイエンス				P11 16:00 - 18:00	A28 9:00 - 12:15			
8.7 プラズマ現象・新応用・融合分野		A28 14:00 - 18:00				P11 16:30 - 18:30		
8.8 プラズマエレクトロニクス分科内招待講演			D14 # 11:00 - 11:30					
プラズマエレクトロニクス賞授賞式			D14 11:30 - 11:45					
9 応用物性								
9.1 誘電材料・誘電体		P4 16:00 - 18:00	B5 9:00 - 12:30					
9.2 ナノワイヤ・ナノ粒子			A20 9:30 - 12:15	A20 14:00 - 18:30		P12 16:30 - 18:30		
9.3 ナノエレクトロニクス						P13 16:30 - 18:30	A20 9:00 - 11:45	A20 13:00 - 14:45
9.4 熱電変換			A22 9:00 - 12:30	A22 14:00 - 18:00	A22 9:00 - 12:30	P14 16:30 - 18:30		
9.5 新機能材料・新物性	A20 10:00 - 11:45	A20 14:00 - 16:30		P5 13:30 - 15:30				
10 スピントロニクス・マグネティクス								
10.1 新物質創成(酸化物・ホイスラー・金属磁性体等)		D11 15:45 - 18:30	D11 9:00 - 11:45					
		P5 13:30 - 15:30						
10.2 スピントルク・スピン流・回路・測定技術				D11 13:15 - 18:30				
10.3 GMR・TMR・磁気記録技術						D11 16:15 - 18:15		D11 ※※ 13:00 - 15:00
10.4 半導体・有機・光・量子スピントロニクス							D2 ** 9:00 - 12:00	D2 13:00 - 15:00
10.5 磁場応用							D11 9:00 - 12:00	
11 超伝導								
11.1 基礎物性		A2 14:00 - 16:45	P9 9:30 - 11:30	A2 13:30 - 18:00				
11.2 薄膜, 厚膜, テープ作製プロセスおよび結晶成長				A1 14:00 - 17:30		A1 12:00 - 19:00		
11.3 臨界電流, 超伝導パワー応用		A1 14:00 - 18:00						
11.4 アナログ応用および関連技術				A3 14:00 - 17:00			A3 9:00 - 12:00	
11.5 接合, 回路作製プロセスおよびデジタル応用						A2 16:15 - 17:30	A2 9:00 - 12:00	
12 有機分子・バイオエレクトロニクス ※ コードシェアセッションあり 6.6 と 12.2(表の末尾, コードシェアセッション を参照)								
12.1 作製・構造制御	D2 9:00 - 12:00	D2 13:15 - 18:00	D2 9:00 - 11:30		P13 9:30 - 11:30			
12.2 評価・基礎物性				P6 13:30 - 15:30		D14 16:30 - 19:00	D14 9:00 - 12:00	D14 13:00 - 15:00
12.3 機能材料・萌芽的デバイス	D4 9:00 - 11:45	D4 13:15 - 17:45	D4 9:00 - 11:30	D4 13:15 - 17:45	D4 # 9:00 - 11:00	P15 16:30 - 18:30		
12.4 有機EL・トランジスタ	D3 9:30 - 11:45	D3 13:15 - 18:00	D3 9:00 - 11:45	P12 16:00 - 18:00	D3 9:00 - 11:45		D3 9:15 - 12:00	D3 13:00 - 15:00
12.5 有機太陽電池	D15 9:00 - 11:45	D15 # 13:15 - 18:00	D15 9:00 - 11:30	P7 13:30 - 15:30	D15 9:00 - 12:00	D15 # 16:30 - 19:00	D15 9:00 - 12:00	D15 13:00 - 15:00
12.6 ナノバイオテクノロジー	D5 9:30 - 11:45	D5 13:15 - 18:00	P10 9:30 - 11:30		D5 9:30 - 11:45	D5 16:30 - 19:00		
12.7 医用工学・バイオチップ	D6 9:00 - 11:45	D6 13:15 - 18:00	P11 9:30 - 11:30		D6 9:00 - 11:45	D6 16:15 - 19:15	D6 9:00 - 12:00	

会場名のアルファベットは建物名を表します.
(例:A1 は A棟にあります. B2 は B棟にあります)

<建物略称>
A:6号館A
B:6号館B
C:6号館C
D:16号館
E:松前記念館講堂
P:体育館

分科内招待講演あり
** 化合物半導体エレクトロニクス業績賞(赤﨑勇賞)受賞記念講演あり
※※ 女性研究者研究業績・人材育成賞(小舘香椎子賞)受賞記念講演

講演分科日程表(分科別)III

東海大学 湘南キャンパス

大分類分科名	3月11日(水)		3月12日(木)		3月13日(金)		3月14日(土)	
中分類分科名	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
13 半導体　※ コードシェアセッションあり　3.11 と 13.7, 13.10 と 15.2(表の末尾, コードシェアセッション を参照)								
13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション	A27 9:00 - 12:30		A27 10:00 - 12:30	A27 14:00 - 18:00		P16 16:30 - 18:30		
13.2 探索的材料物性・基礎物性				P8 13:30 - 15:30	A25 9:00 - 12:30	A25 16:15 - 19:15	A25 9:00 - 12:00	A25 13:00 - 14:00
13.3 絶縁膜技術			P12 9:30 - 11:30		A24 9:00 - 12:30		A24 9:00 - 12:15	
13.4 Siプロセス・配線・MEMS・集積化技術	A29 9:00 - 12:30	A29 14:00 - 17:30	A29 9:00 - 12:00		P14 9:30 - 11:30		A29 9:00 - 12:00	A29 13:00 - 15:00
13.5 デバイス／集積化技術	A23 9:00 - 12:15	A23 14:00 - 17:30	P13 9:30 - 11:30	A23　※ 14:00 - 17:30	A23 9:00 - 12:30	A23 16:15 - 19:00		
13.6 Semiconductor English Session			A23 9:00 - 12:15					
13.7 超薄膜・量子ナノ構造	A10 9:15 - 12:30			A24 14:00 - 15:45 P13 16:00 - 18:00				
13.8 化合物及びパワー電子デバイス・プロセス技術	A21 9:00 - 12:00	A21 14:00 - 17:15	A21 9:00 - 12:30	A21 14:00 - 17:30		P17 16:30 - 18:30		
13.9 光物性・発光デバイス	A25 9:30 - 12:15	A25 13:30 - 17:30	A25 9:00 - 12:30	A25 14:00 - 17:00		P18 16:30 - 18:30		
13.10 化合物太陽電池			A26 10:00 - 12:00		A26 9:30 - 12:15		A26 9:30 - 12:00	
15 結晶工学　※ コードシェアセッションあり　13.10 と 15.2(表の末尾, コードシェアセッション を参照)								
15.1 バルク結晶成長			D13 9:30 - 11:45	P14 16:00 - 18:00			D13 10:00 - 12:00	
15.2 II-VI族結晶および多元系結晶				P15 16:00 - 18:00		A17 16:15 - 19:15		
15.3 III-V族エピタキシャル結晶					P15 9:30 - 11:30	D4 16:15 - 19:00	D4 9:00 - 11:30	D4 13:00 - 14:15
15.4 III-V族窒化物結晶	B1 8:30 - 11:45	B1 13:15 - 18:45	B1 8:30 - 11:45	B1　※※ 13:15 - 19:45 P16 16:00 - 18:00	B1 8:30 - 13:00	B1 16:15 - 18:00		
15.5 IV族結晶, IV-IV族混晶	D7 9:00 - 12:00	D7 13:30 - 17:15	D5 10:00 - 12:00	P17 16:00 - 18:00				
15.6 IV族系化合物		P2 13:30 - 15:30	B4 9:00 - 11:45		B4 9:00 - 11:45	B4 16:15 - 18:30	B4 9:00 - 12:30	
15.7 エピタキシーの基礎					P16 9:30 - 11:30			D4 14:15 - 15:00
15.8 結晶評価, 不純物・結晶欠陥				A18 14:00 - 19:00	P17 9:30 - 11:30			
16 非晶質・微結晶								
16.1 基礎物性・評価		P6 16:00 - 18:00	A28 9:15 - 12:30	A28 14:00 - 17:15				
16.3 シリコン系太陽電池	C2 9:00 - 12:30	C2 14:00 - 15:45 P6 16:00 - 18:00	A18 9:00 - 12:30	C2 13:45 - 19:00	C2 9:00 - 11:00			
17 ナノカーボン								
17.1 成長技術	P6 9:30 - 11:30		D6 10:15 - 11:45	D7 13:15 - 19:00				D7 14:30 - 15:15
17.2 構造制御・プロセス			D7 9:00 - 11:45 D6 9:15 - 10:15			D8 18:30 - 19:00		
17.3 新機能探索・基礎物性評価		D8 16:45 - 18:00			D8 9:00 - 11:45 D7 9:30 - 11:45	D8 16:15 - 18:30		
17.4 デバイス応用				D6 13:15 - 16:45			D7 9:00 - 12:00	D7 13:00 - 14:30
合同セッションK ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス								
合同セッションK ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス	D1 9:30 - 11:45	D1 13:15 - 17:45	D1 9:00 - 12:15		P18 9:30 - 11:30	D1 16:15 - 19:15	D1 9:00 - 11:30	

会場名のアルファベットは建物名を表します.
(例:A1 は A棟にあります. B2 は B棟にあります)

<建物略称>
A:6号館A
B:6号館B
C:6号館C
D:16号館
E:松前記念館講堂
P:体育館

分科内招待講演あり
※ 応用物理学会業績賞(研究業績)受賞記念講演あり
※※ 女性研究者研究業績・人材育成賞(小舘香椎子賞)受賞記念講演

講演分科日程表(分科別)IV

東海大学 湘南キャンパス

大分類分科名	3月11日(水)		3月12日(木)		3月13日(金)		3月14日(土)	
中分類分科名	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
特別シンポジウム								
応用物理分野で活躍する女性達 -第3回バイオエレクトロニクス編-					B3 9:00 - 12:00			
フォノンエンジニアリング:ナノスケール熱制御のための新しい材料科学、理論・シミュレーション、計測技術、およびこれによるデバイス革新							B2 8:45 - 15:00	
世界行きたい科学広場in 東海大学湘南キャンパス 第一部:シンポジウム							F1 9:00 - 10:50	
世界行きたい科学広場in 東海大学湘南キャンパス 第二部:科学広場と科学ショー							E1 11:00 - 15:00	
かながわ発! スマートエネルギー革命				E1 13:00 - 16:45				
産学協働研究会設立シンポジウム-日本のモノづくり再生に向けた産学官共鳴場の創成を目指して-				B2 13:30 - 17:30				
シンポジウム								
フォトニクスと量子情報技術の融合へ向けて		B4 13:30 - 17:15						
斜め蒸着法, GLAD, STF等, シャドウイングによるナノ形態の制御と評価		D9 13:15 - 17:00						
最先端CMOS技術とその将来展望		B5 13:15 - 17:30						
放射線オプティクス				A19 14:00 - 17:15				
レーザーによる3次元造形技術の最先端から実用まで				B6 13:30 - 18:00				
光量子を自在に操る分極反転光デバイス				D2 13:15 - 17:00				
散逸ゆらぎ制御ナノ電子フォトン系の理論とデバイス構築				A12 14:00 - 17:45				
宇宙観測・地球観測で活用される光センシング技術				B3 13:30 - 16:15				
次世代強誘電体材料の開発指針				B5 13:30 - 17:30				
スピン-軌道相互作用が生み出す酸化物の新しい機能性				D10 13:15 - 18:30				
二酸化チタンの最近の動向				D9 13:15 - 17:30				
リソグラフィ技術の最新動向				C3 13:15 - 15:30				
微粒子合成法とその応用最前線				D14 13:30 - 18:45				
バイオインターフェースの可視化・実用技術の新展開				D5 13:15 - 17:15				
未来を担う若手科学者の在り方　～集積化技術の新たな価値創造を目指して～				A29 13:00 - 17:00				
クルマ社会の未来を支えるセンシング技術　～自動運転システムの展望と課題～				D15 14:00 - 17:15				
酸化物半導体における価電子メタモルフォロジ				D1 13:15 - 18:30				
進化するパワー半導体・・・シリコンからワイドバンドギャップへ				B4 13:15 - 18:15				
衝撃および重力場応用の物理の最前線					D13 9:00 - 13:00			
スピントロニクスの将来ビジョン ～スピントロニクスはこれから何をするのか?～					B6 9:00 - 12:30			
巨匠が教えてくれた高温超伝導とその未来～北澤宏一先生・前田弘先生追悼シンポジウム～					B2 9:00 - 11:45	B2 16:15 - 18:45		
太陽電池用バルク結晶シリコンの成長と評価						C2 13:15 - 18:15		
窒化物半導体特異構造の科学　～成長・プロセスとエレクトロニクス展開～							B1 8:30 - 11:45	B1 12:45 - 15:00
最先端の電子・集束イオンビーム装置技術		B3 13:15 - 17:15						
化合物薄膜とペロブスカイト太陽電池融合の可能性	B6 9:00 - 11:45	B6 13:15 - 17:00						
コードシェアセッション								
3.5 レーザー装置・材料, 3.14 光制御デバイス・光ファイバーのコードシェアセッション					A13 9:00 - 11:15			
3.11 フォトニック構造・現象, 13.7 超薄膜・量子ナノ構造のコードシェアセッション			A10 9:00 - 12:30					
6.6 プローブ顕微鏡, 12.2 評価・基礎物性のコードシェアセッション					D14 9:00 - 12:00			
13.10 化合物太陽電池, 15.2 II-VI族結晶および多元系結晶のコードシェアセッション				A26 13:30 - 17:45	A17 9:00 - 12:15	P19 16:30 - 18:30		

会場名のアルファベットは建物名を表します.
(例:A1 は A棟にあります. B2 は B棟にあります)

<建物略称>
A:6号館A　D:16号館
B:6号館B　E:松前記念館講堂
C:6号館C　P:体育館

日程表(会場別)1

東海大学 湘南キャンパス

会場名		収容人数	3月11日(水)		3月12日(木)		3月13日(金)		3月14日(土)	
			午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
A(6号館A)	A1 6A-105	114		11.3 臨界電流, 超伝導パワー応用		11.2 薄膜, 厚膜, テープ作製プロセスおよび結晶成長		11.2 薄膜, 厚膜, テープ作製プロセスおよび結晶成長		
	A2 6A-106	114		11.1 基礎物性		11.1 基礎物性		11.5 接合, 回路作製プロセスおよびデジタル応用	11.5 接合, 回路作製プロセスおよびデジタル応用	
	A3 6A-107	114				11.4 アナログ応用および関連技術			11.4 アナログ応用および関連技術	
	A10 6A-115	105	13.7 超薄膜・量子ナノ構造		3.11 フォトニック構造・現象, 13.7 超薄膜・量子ナノ構造のコードシェアセッション	3.11 フォトニック構造・現象	3.11 フォトニック構造・現象	3.11 フォトニック構造・現象	3.4 生体・医用光学	3.4 生体・医用光学
	A11 6A-116	105	3.7 レーザープロセシング	3.7 レーザープロセシング	3.7 レーザープロセシング	7.2 電子ビーム応用	3.7 レーザープロセシング	3.3 情報フォトニクス・画像工学	3.3 情報フォトニクス・画像工学	3.3 情報フォトニクス・画像工学
	A12 6A-101	105	3.12 ナノ領域光科学・近接場光学	3.12 ナノ領域光科学・近接場光学	3.12 ナノ領域光科学・近接場光学	散逸ゆらぎ制御ナノ電子フォトン系の理論とデバイス構築	3.12 ナノ領域光科学・近接場光学		3.1 光学基礎・光学新領域	3.1 光学基礎・光学新領域
	A13 6A-102	105	3.14 光制御デバイス・光ファイバー	3.14 光制御デバイス・光ファイバー	3.14 光制御デバイス・光ファイバー	3.2 材料・機器光学	3.5 レーザー装置・材料, 3.14 光制御デバイス・光ファイバーのコードシェアセッション	3.5 レーザー装置・材料	3.5 レーザー装置・材料	
	A14 6A-103	105	3.8 光計測技術・機器	3.8 光計測技術・機器	3.9 テラヘルツ全般	3.9 テラヘルツ全般	3.9 テラヘルツ全般	3.9 テラヘルツ全般	3.8 光計測技術・機器	3.8 光計測技術・機器
	A15 6A-205	114			3.6 超高速・高強度レーザー	3.6 超高速・高強度レーザー	3.0 Optics and Photonics English Session	3.6 超高速・高強度レーザー	3.6 超高速・高強度レーザー	3.6 超高速・高強度レーザー
	A16 6A-206	114		3.15 シリコンフォトニクス	3.15 シリコンフォトニクス	3.15 シリコンフォトニクス	7.5 原子・分子線およびビーム関連新技術		7.4 量子ビーム界面構造計測	
	A17 6A-207	114	3.10 光量子物理・技術	3.10 光量子物理・技術	3.13 半導体光デバイス	3.13 半導体光デバイス	13.10 化合物太陽電池, 15.2 II-VI族結晶および多元系結晶のコードシェアセッション	15.2 II-VI族結晶および多元系結晶		
	A18 6A-208	114			16.3 シリコン系太陽電池	15.8 結晶評価, 不純物・結晶欠陥				
	A19 6A-211	114	2.3 放射線応用・発生装置・新技術 2.2 検出器開発	2.3 放射線応用・発生装置・新技術 2.2 検出器開発		放射線オプティクス	2.1 放射線物理一般・検出器基礎	2.1 放射線物理一般・検出器基礎 2.2 検出器開発	2.2 検出器開発	
	A20 6A-212	114	9.5 新機能材料・新物性	9.5 新機能材料・新物性	9.2 ナノワイヤ・ナノ粒子	9.2 ナノワイヤ・ナノ粒子			9.3 ナノエレクトロニクス	9.3 ナノエレクトロニクス
	A21 6A-213	114	13.8 化合物及びパワー電子デバイス・プロセス技術	13.8 化合物及びパワー電子デバイス・プロセス技術	13.8 化合物及びパワー電子デバイス・プロセス技術	13.8 化合物及びパワー電子デバイス・プロセス技術	6.1 強誘電体薄膜	6.1 強誘電体薄膜	6.1 強誘電体薄膜	
	A22 6A-214	114			9.4 熱電変換	9.4 熱電変換	9.4 熱電変換			
	A23 6A-216	105	13.5 デバイス／集積化技術	13.5 デバイス／集積化技術	13.6 Semiconductor English Session	13.5 デバイス／集積化技術	13.5 デバイス／集積化技術	13.5 デバイス／集積化技術		
	A24 6A-217	105				13.7 超薄膜・量子ナノ構造	13.3 絶縁膜技術		13.3 絶縁膜技術	
	A25 6A-218	105	13.9 光物性・発光デバイス	13.9 光物性・発光デバイス	13.9 光物性・発光デバイス	13.9 光物性・発光デバイス	13.2 探索的材料物性・基礎物性	13.2 探索的材料物性・基礎物性	13.2 探索的材料物性・基礎物性	13.2 探索的材料物性・基礎物性
	A26 6A-201	105		7.1 X線技術	13.10 化合物太陽電池	13.10 化合物太陽電池, 15.2 II-VI族結晶および多元系結晶のコードシェアセッション	13.10 化合物太陽電池		13.10 化合物太陽電池	
	A27 6A-202	105	13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション	8.2 プラズマ診断・計測	13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション	13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション	8.3 プラズマ成膜・表面処理	8.5 プラズマナノテクノロジー	8.4 プラズマエッチング	
	A28 6A-203	105		8.7 プラズマ現象・新応用・融合分野	16.1 基礎物性・評価	16.1 基礎物性・評価	8.6 プラズマライフサイエンス	8.1 プラズマ生成・制御	8.1 プラズマ生成・制御	
	A29 6A-204	105	13.4 Siプロセス・配線・MEMS・集積化技術	13.4 Siプロセス・配線・MEMS・集積化技術	13.4 Siプロセス・配線・MEMS・集積化技術	未来を担う若手科学者の在り方　～集積化技術の新たな価値創造を目指して～			13.4 Siプロセス・配線・MEMS・集積化技術	13.4 Siプロセス・配線・MEMS・集積化技術
B(6号館B)	B1 6B-101	340	15.4 III-V族窒化物結晶	15.4 III-V族窒化物結晶	15.4 III-V族窒化物結晶	15.4 III-V族窒化物結晶	15.4 III-V族窒化物結晶	15.4 III-V族窒化物結晶	窒化物半導体特異構造の科学　～成長・プロセスとエレクトロニクス展開～	窒化物半導体特異構造の科学　～成長・プロセスとエレクトロニクス展開～
	B2 6B-102	340	7.3 微細パターン・微細構造形成技術	7.3 微細パターン・微細構造形成技術		産学協働研究会設立シンポジウム-日本のモノづくり再生に向けた産学官共鳴場の創成を目指して-	巨匠が教えてくれた高温超伝導とその未来～北澤宏一先生・前田弘先生追悼シンポジウム～	巨匠が教えてくれた高温超伝導とその未来～北澤宏一先生・前田弘先生追悼シンポジウム～	フォノンエンジニアリング:ナノスケール熱制御のための新しい材料科学、理論・シミュレーション、計測技術、およびこれによるデバイス革新	
	B3 6B-103	190		最先端の電子・集束イオンビーム装置技術		宇宙観測・地球観測で活用される光センシング技術	応用物理分野で活躍する女性達 -第3回バイオエレクトロニクス編-			
	B4 6B-104	190		フォトニクスと量子情報技術の融合へ向けて	15.6 IV族系化合物	進化するパワー半導体・・・シリコンからワイドバンドギャップへ	15.6 IV族系化合物	15.6 IV族系化合物	15.6 IV族系化合物	
	B5 6B-105	190		最先端CMOS技術とその将来展望	9.1 誘電材料・誘電体	次世代強誘電体材料の開発指針				
	B6 6B-106	190	化合物薄膜とペロブスカイト太陽電池融合の可能性	化合物薄膜とペロブスカイト太陽電池融合の可能性		レーザーによる3次元造形技術の最先端から実用まで	スピントロニクスの将来ビジョン ～スピントロニクスはこれから何をするのか?～			

日程表(会場別)2

東海大学 湘南キャンパス

会場名		収容人数	3月11日(水)		3月12日(木)		3月13日(金)		3月14日(土)	
			午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
C(6号館C)	C1 6C-104	180		6.2 カーボン系薄膜	6.2 カーボン系薄膜	6.2 カーボン系薄膜			7.6 イオンビーム一般	7.6 イオンビーム一般
	C2 6C-207	171	16.3 シリコン系太陽電池	16.3 シリコン系太陽電池		16.3 シリコン系太陽電池	16.3 シリコン系太陽電池	太陽電池用バルク結晶シリコンの成長と評価		
	C3 6C-201	117				リソグラフィ技術の最新動向				
D(16号館D)	D1 16-101	165	合同セッションK ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス	合同セッションK ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス	合同セッションK ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス	酸化物半導体における価電子メタモルフォロジ		合同セッションK ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス	合同セッションK ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス	
	D2 16-102	121	12.1 作製・構造制御	12.1 作製・構造制御	12.1 作製・構造制御	光量子を自在に操る分極反転光デバイス			10.4 半導体・有機・光・量子スピントロニクス	10.4 半導体・有機・光・量子スピントロニクス
	D3 16-203	121	12.4 有機EL・トランジスタ	12.4 有機EL・トランジスタ	12.4 有機EL・トランジスタ		12.4 有機EL・トランジスタ		12.4 有機EL・トランジスタ	12.4 有機EL・トランジスタ
	D4 16-204	121	12.3 機能材料・萌芽的デバイス	12.3 機能材料・萌芽的デバイス	12.3 機能材料・萌芽的デバイス	12.3 機能材料・萌芽的デバイス	12.3 機能材料・萌芽的デバイス	15.3 III-V族エピタキシャル結晶	15.3 III-V族エピタキシャル結晶	15.3 III-V族エピタキシャル結晶 15.7 エピタキシーの基礎
	D5 16-205	121	12.6 ナノバイオテクノロジー	12.6 ナノバイオテクノロジー	15.5 IV族結晶, IV-IV族混晶	バイオインターフェースの可視化・実用技術の新展開	12.6 ナノバイオテクノロジー	12.6 ナノバイオテクノロジー		
	D6 16-206	121	12.7 医用工学・バイオチップ	12.7 医用工学・バイオチップ	17.2 構造制御・プロセス 17.1 成長技術	17.4 デバイス応用	12.7 医用工学・バイオチップ	12.7 医用工学・バイオチップ	12.7 医用工学・バイオチップ	
	D7 16-207	121	15.5 IV族結晶, IV-IV族混晶	15.5 IV族結晶, IV-IV族混晶	17.2 構造制御・プロセス	17.1 成長技術	17.3 新機能探索・基礎物性評価		17.4 デバイス応用	17.4 デバイス応用 17.1 成長技術
	D8 16-303	121	6.4 薄膜新材料	チュートリアル 17.3 新機能探索・基礎物性評価	6.4 薄膜新材料	6.4 薄膜新材料	17.3 新機能探索・基礎物性評価	17.3 新機能探索・基礎物性評価 17.2 構造制御・プロセス		
	D9 16-304	121	6.5 表面物理・真空	斜め蒸着法, GLAD, STF等, シャドウイングによるナノ形態の制御と評価	6.6 プローブ顕微鏡	二酸化チタンの最近の動向		6.6 プローブ顕微鏡	6.6 プローブ顕微鏡	6.6 プローブ顕微鏡
	D10 16-305	121	6.3 酸化物エレクトロニクス	6.3 酸化物エレクトロニクス	6.3 酸化物エレクトロニクス	スピン-軌道相互作用が生み出す酸化物の新しい機能性	6.3 酸化物エレクトロニクス	6.3 酸化物エレクトロニクス	6.3 酸化物エレクトロニクス	6.3 酸化物エレクトロニクス
	D11 16-306	121	チュートリアル	10.1 新物質創成(酸化物・ホイスラー・金属磁性体等)	10.1 新物質創成(酸化物・ホイスラー・金属磁性体等)	10.2 スピントルク・スピン流・回路・測定技術		10.3 GMR・TMR・磁気記録技術	10.5 磁場応用	10.3 GMR・TMR・磁気記録技術
	D12 16-501	77	1.5 資源・環境	1.7 超音波	1.4 エネルギー変換・貯蔵			1.1 応用物理一般・学際領域	1.6 計測技術・計測標準	1.6 計測技術・計測標準
	D13 16-502	99		1.3 新技術・複合新領域	15.1 バルク結晶成長	6.5 表面物理・真空	衝撃および重力場応用の物理の最前線		15.1 バルク結晶成長	
	D14 16-503	286	チュートリアル		8.0 Plasma Electronics English Session 8.8 プラズマエレクトロニクス分科内招待講演 プラズマエレクトロニクス賞授賞式	微粒子合成法とその応用最前線	6.6 プローブ顕微鏡, 12.2 評価・基礎物性のコードシェアセッション	12.2 評価・基礎物性	12.2 評価・基礎物性	12.2 評価・基礎物性
	D15 16-504	286	12.5 有機太陽電池	12.5 有機太陽電池	12.5 有機太陽電池	クルマ社会の未来を支えるセンシング技術　～自動運転システムの展望と課題～	12.5 有機太陽電池	12.5 有機太陽電池	12.5 有機太陽電池	12.5 有機太陽電池
E	E1 松前記念館講堂	490	奨励賞贈呈式	第15回応用物理学会業績賞受賞記念講演 業績賞授賞式 名誉会員贈呈式		かながわ発! スマートエネルギー革命			世界行きたい科学広場in 東海大学湘南キャンパス 第二部:科学広場と科学ショー	
F	F1 2N-101	1000							世界行きたい科学広場in 東海大学湘南キャンパス 第一部:シンポジウム	
P(体育館)	P1 ～ P19	ポスターセッション	1.4 エネルギー変換・貯蔵 1.7 超音波 3.11 フォトニック構造・現象 6.2 カーボン系薄膜 7.1 X線技術 17 ナノカーボン	[前半] 10 スピントロニクス・マグネティクス 15.6 IV族系化合物 [後半] 3.9 テラヘルツ全般 6.1 強誘電体薄膜 9.1 誘電材料・誘電体 16 非晶質・微結晶	2.1 放射線物理一般・検出器基礎 2.2 検出器開発 2.3 放射線応用・発生装置・新技術 3.4 生体・医用光学 3.5 レーザー装置・材料 3.10 光量子物理・技術 7.2 電子ビーム応用 7.3 微細パターン・微細構造形成技術 11 超伝導 12.6 ナノバイオテクノロジー 12.7 医用工学・バイオチップ 13.3 絶縁膜技術 13.5 デバイス／集積化技術	[前半] 1.1 応用物理一般・学際領域 1.3 新技術・複合新領域 1.5 資源・環境 6.6 プローブ顕微鏡 9.5 新機能材料・新物性 12.2 評価・基礎物性 12.5 有機太陽電池 13.2 探索的材料物性・基礎物性 [後半] 8.1 プラズマ生成・制御 8.3 プラズマ成膜・表面処理 8.6 プラズマライフサイエンス 12.4 有機EL・トランジスタ 13.7 超薄膜・量子ナノ構造 15.1 バルク結晶成長 15.2 II-VI族結晶および多元系結晶 15.4 III-V族窒化物結晶 15.5 IV族結晶, IV-IV族混晶	1.6 計測技術・計測標準 3.1 光学基礎・光学新領域 3.2 材料・機器光学 3.3 情報フォトニクス・画像工学 3.6 超高速・高強度レーザー 3.8 光計測技術・機器 3.14 光制御デバイス・光ファイバー 3.15 シリコンフォトニクス 8.0 Plasma Electronics English Session 8.2 プラズマ診断・計測 8.4 プラズマエッチング 8.5 プラズマナノテクノロジー 12.1 作製・構造制御 13.4 Siプロセス・配線・MEMS・集積化技術 15.3 III-V族エピタキシャル結晶 15.7 エピタキシーの基礎 15.8 結晶評価, 不純物・結晶欠陥 合同セッションK ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス	[後半] 1.2 教育 3.7 レーザープロセシング 3.12 ナノ領域光科学・近接場光学 3.13 半導体光デバイス 6.3 酸化物エレクトロニクス 6.4 薄膜新材料 6.5 表面物理・真空 7.4 量子ビーム界面構造計測 7.5 原子・分子線およびビーム関連新技術 7.6 イオンビーム一般 8.7 プラズマ現象・新応用・融合分野 9.2 ナノワイヤ・ナノ粒子 9.3 ナノエレクトロニクス 9.4 熱電変換 12.3 機能材料・萌芽的デバイス 13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション 13.8 化合物及びパワー電子デバイス・プロセス技術 13.9 光物性・発光デバイス 13.10 化合物太陽電池, 15.2 II-VI族結晶および多元系結晶のコードシェアセッション		・1 講演につき, たて180cm, よこ90cmのパネルが用意されています. 予め講演番号, 講演題目, 所属, 氏名を記入した用紙(たて15cm, よこ85cm) を各自が用意し, これをパネル上部に取り付けてください. ・次にパネルに, 各自が用意したポスター, 図表, 写真などを, 適宜レイアウト(例えば研究目的, 研究方法, 研究成果といった順に)して掲示してください. ・ポスターの大きさ, 形式は問いませんが, できるだけ見やすく, 大きく書いてください. その際ポスターがパネルにうまく収まるように, 予めポスターの割り付けを検討しておくと便利です. ・すべての掲示は本部で用意したピンで行ってください. 糊の使用はご遠慮ください.

■チュートリアル（ショートコース）一覧

開催日：2015年3月11日（水）

題目：講義内容	講師略歴	講師名	所属	講義時間	会場
グラフェンの電子状態と電気伝導 最近，グラファイトの単原子層からなるグラフェンが注目されている．グラフェンのフェルミエネルギー付近のバンドは，等方的な線形分散をもつ．そのため，電子の速度は運動量に依らず一定であり，電子は決して止まらずに，光のように常に同じ速さで動く．この性質はたった1枚の原子層からなるこの物質に高い導電性をもたらすだけではなく，さまざまな不思議な性質を示す．この講演ではこのようなグラフェンの電子状態について解説するとともに，電気伝導を中心として興味深い性質や特異性について紹介する． 1. はじめに 2. 単層グラフェンの電子状態 3. 単層グラフェンの磁気的性質 4. 単層グラフェンの光学的性質 5. 単層グラフェンの電気伝導 6. 単層グラフェンにおける電子-フォノン相互作用 7. 2層グラフェン 8. 多層グラフェン 9. 最近の話題から	1968 東京大学理学部物理学科卒業 1973 東京大学大学院理学系研究科博士課程修了 1973 東京大学理学部助手 1979 筑波大学物理工学系助教授 1983 東京大学物性研究所助教授 1990 東京大学物性研究所教授 2002 東京工業大学理工学研究科教授 2011 東京工業大学理工学研究科特命教授 2012 日本物理学会JPSJ編集長併任	安藤恒也	東京工業大学	13:15～16:15	D8
発光分光計測法によるプロセスプラズマの実践的計測の基礎と応用 第1部　基礎～「電子温度・密度、ガス温度、ラジカル密度の測定」 第1部では衝突輻射モデルに基づいて、発光分光計測結果から電子温度・密度を導出するための基礎・方法を述べ、次に分子性気体放電のバンドスペクトル分光解析結果からガス温度の近似値としての回転温度を求める方法を述べ、最後にアクチノメトリー法を用いた分子気体放電プラズマ中の原子状ラジカルの測定方法を説明する。 第2部　応用～「プロセスモニタリングへの適用」 第2部では、プロセスプラズマへの適用例を紹介する。太陽電池用途のプラズマプロセスを取り上げ、発光分光計測に基づくプロセスモニタリングとプロセスの最適化手法について解説する。	第1部　赤塚　洋 1987 京都大学大学院工学研究科修士課程修了 1987 日本電気(株) レーザ・ミリ波開発部 1991 東京工業大学原子炉工学研究所助手 1995 博士（工学） 同年　東京工業大学原子炉工学研究所助教授、現在に至る。発光分光計測を中心とするプラズマ計測、プラズマ内の原子分子過程の基礎研究に従事。 第2部　布村正太 1999 名古屋大学大学院工学研究科 博士課程修了 1999 アイオワ大学 ポスドク研究員 2002 マックスプランク研究所 ポスドク研究員 2003 九州大学 ポスドク研究員 2005 産業技術総合研究所 研究員 2011 産業技術総合研究所 主任研究員 2013 ミシガン大学 客員研究員 プラズマプロセス、太陽電池の研究開発に従事。	第1部 赤塚　洋 第2部 布村正太	東京工業大学 原子炉工学研究所 エネルギー工学部門 産業技術総合研究所 太陽光発電工学研究センター	第1部 9:00～11:00 休憩 11:00～11:10 第2部 11:10～12:10	D14
スピントロニクスの基礎 A. 磁気の基礎 1. 磁気の単位 2. 磁化曲線，磁気異方性 B. スピントロニクスの基礎 1. 薄膜（人工格子）作製・評価法，垂直磁化 2. 巨大磁気抵抗効果，トンネル磁気抵抗効果 3. スピントロニクスの諸現象（スピン注入，スピントルク，etc.） 4. スピン流	1981　東京大学理学部卒業 1986　東京大学大学院理学系研究科（博士課程）修了 東北大学金属材料研究所助手 1994　同助教授 （1994-1995　アレクサンダー・フォン・フンボルト客員研究員としてドイツ・ユーリヒ研究センターに滞在） 2000　東北大学金属材料研究所教授（～現在） 2009　同副所長 2014　同所長（～現在）	高梨弘毅	東北大学	9:00～12:10 （休憩10分）	D11

※会場名のアルファベットは建物名を表します．以下をご参照ください．たとえば「A1」はA棟にございます．場所は表紙の「建物配置図」でご確認ください．
<建物略称>　A：6号館A　B：6号館B　C：6号館C　D：16号館

チュートリアル受講希望の方は，以下URLより事前予約申し込みを行ってください．

事前予約申込締切：2015年3月4日（水）

http://meeting.jsap.or.jp/tutorial.html

残席がある場合に限り，当日受付を行います．満席の場合は入場できませんので予めご了承ください．

チュートリアルは以下の受講料を頂戴します．当日，Registration の「チュートリアル受付」で受講料をお支払ください．
お支払後，資料をお受け取りになり，会場へとお進みください．

＜チュートリアル受講料＞（税込）
一般会員：4,000円　学生：2,000円　非会員：6,000円
受講料支払場所：Registration 「チュートリアル受付」

■受賞記念講演

■第15回応用物理学会業績賞(教育業績)受賞記念講演

開催日	時間	会場	講演タイトル	講演者	所属
3月11日	14:30-15:15	E1	ネット時代の応物コミュニケーション	佐藤勝昭	JST

■第15回応用物理学会業績賞(研究業績)受賞記念講演

開催日	時間	会場	講演タイトル	講演者	所属
3月12日	16:00-16:45	A10	フォトニック結晶工学の進展と今後の展望	野田進	京都大
3月12日	14:00-14:45	A23	大容量メモリ技術の産業展開への貢献と三次元集積化技術の先駆的研究	小柳光正	東北大

■第16回光・量子エレクトロニクス業績賞(宅間宏賞)受賞記念講演

開催日	時間	会場	講演タイトル	講演者	所属
3月14日	13:00-13:30	A15	コンパクトSASE型X線自由電子レーザーSACLAの開発	石川哲也	理化学研究所

■第5回化合物半導体エレクトロニクス業績賞(赤﨑勇賞)受賞記念講演

開催日	時間	会場	講演タイトル	講演者	所属
3月14日	9:00-9:30	D2	AlInAs/GaInAsから強磁性半導体GaMnAsまで	大野英男	東北大

■第5回女性研究者研究業績・人材育成賞(小舘香椎子賞)受賞記念講演

開催日	時間	会場	講演タイトル	講演者	所属
3月13日	16:30-17:00	A10	フォトニック結晶レーザによる新奇集光ビームの生成とその応用	北村恭子	京都大
3月14日	13:00-13:30	D11	垂直通電型巨大磁気抵抗効果増大の開発 ～スピントロニクス産業へ向けて～	湯浅裕美	東芝
3月12日	13:15-13:45	B1	化合物半導体を中心とした混晶薄膜ヘテロ構造の結晶成長	出浦桃子	東北大

※会場名のアルファベットは建物名を表します．以下をご参照ください．たとえば「A1」はA棟にございます．場所は表紙の「建物配置図」でご確認ください．
<建物略称> A:6号館A B:6号館B C:6号館C D:16号館

■特別シンポジウム

開催日	時間	会場	シンポジウムタイトル
3月12日	13:00～16:50	松前記念館講堂	かながわ発！スマートエネルギー革命
3月12日	13:30～17:30	B2	日本のモノづくり再生に向けた産学官共　鳴場の創成を目指して
3月13日	9:00～12:00	B3	応用物理学会分野で活躍する女性たち～第3回バイオエレクトロニクス編～
3月14日	9:50～15:30	2N-101/松前記念館講堂	世界一行きたい科学広場
3月14日	8:45～15:00	B2	フォノンエンジニアリング：ナノスケール熱制御のための新しい材料科学、理論・シミュレーション、計測技術、およびこれによるデバイス革新

※会場名のアルファベットは建物名を表します．以下をご参照ください．たとえば「A1」はA棟にございます．場所は表紙の「建物配置図」でご確認ください．
<建物略称> A:6号館A B:6号館B C:6号館C D:16号館

参加票用シールの使い方





・I speak Englishのシールを目安に、英語話者の人同士のコミュニケーションが円滑に図れると良いな。
・研究仲間や今夜の飲み仲間が見つかれば良いな。
・講演会参加者の会話のきっかけになってほしい。



・・・という意図で、今回、初の試みとして、参加票に貼るシールを作成しました。
従来のChairシール、Speakerシールに加え、多数のシールをご用意したので、ご自身に該当するシールを、参加票の印の箇所に、自由に貼ってください。

■第37回(2014年秋季)応用物理学会講演奨励賞　賞状・記念品の贈呈式

標記贈呈式を以下により公開で行います．ふるってご参加ください．
日時：　3月11日(水)　11:00～12:00
会場：　東海大学　湘南キャンパス　E1会場(松前記念館講堂)

講演奨励賞受賞者 (講演時の所属)	講演題目 (受賞者以外の共著者の所属：共著者)	講演奨励賞受賞者 (講演時の所属)	講演題目 (受賞者以外の共著者の所属：共著者)
長久保 白 (阪大基礎工)	極低温ピコ秒超音波法を用いたGaNのキャリアダイナミクスの観測と圧電定数計測 (阪大基礎工：石原達也，荻博次，中村暢伴，平尾雅彦)	藤岡 正弥 (物材機構)	高フッ素濃度単結晶$SmFeAsO_{1-x}F_x$の微細加工技術を用いた超伝導特性評価 (物材機構[1]，筑波大[2]：Saleem Denholme[1]，田中将嗣[1]，鈴木皓司[1,2]，原裕[1,2]，山本拓馬[1,2]，山下愛智[1,2]，山口尚秀[1]，竹屋浩幸[1]，高野義彦[1,2])
手島 駿 (千歳科技大)	学生プロジェクトによる理科実験授業におけるタブレット端末の活用 (千歳科技大：長谷川誠)	玉井 康成 (京大院工)	有機薄膜太陽電池における結晶性と自由電荷生成 (京大院工[1]，JSTさきがけ[2]：津田一樹[1]，大北英生[1,2]，辨天宏明[1]，伊藤紳三郎[1])
古場 裕介 (放医研)	シンチレーティングGlass GEMの炭素線に対する応答(3) (放医研[1]，東大[2]：藤原健[2]，松藤成弘[1]，高橋浩之[2])	猪瀬 朋子 (阪大院理)	Au(111)上オクタエチルポルフィリンダブルデッカー型単分子磁石のSTMを用いた単一分子操作 (阪大院理[1]，東北大多元研[2]，九工大[3]：田中大輔[1]，Jie Liu[2]，田中啓文[1,3]，米田忠弘[2]，小川琢治[1])
草 史野 (農工大工)	中赤外超短パルスを用いた金ナノロッドからの光電界電子放出 (農工大工[1]，東大生研[2]，ゲッティンゲン大[3]：芦原聡[1,2]，Katharina Echternkamp[3]，Claus Ropers[3])	田畑 顕一 (筑波大数理物質)	発光性共振器としての自己集合化共役高分子マイクロ球体 (筑波大数理物質[1]，デュイスブルグ-エッセン大[2]，筑波大TIMS[3]：Braam Daniel[2]，櫛田創[1]，童亮[1]，桑原純平[1]，神原貴樹[1]，Lorke Axcel[2]，山本洋平[1,3])
松本 歩 (京大院工)	電析皮膜の液中レーザーアブレーション放出種に対するパルス幅の効果 (京大院工：田村文香，天野健一，深見一弘，西直哉，作花哲夫)	野田 祐樹 (産総研FLEC)	異種ミクロ液滴の特異な混合メカニズムと高度印刷薄膜製造技術への応用 (産総研FLEC[1]，東大工[2]：峯廻洋美[1]，山田寿一[1]，長谷川達生[1,2])
川端 祐斗 (東大院工)	InP/InGaAsPモノリシック偏波変調器の提案と実証 (東大院工：財津優，種村拓夫，中野義昭)	稲田 なつみ (金大院)	吸着抑制能を有するSAM/水界面の3次元相互作用力分布の直接計測 (金大院[1]，金大バイオAFMセ[2]，JST ACT-C[3]：淺川雅[2]，宮澤佳甫[1]，福間剛士[1,2,3])
鴻池 遼太郎 (京大院工)	離れた光ナノ共振器間での断熱的光転送の実証 (京大院工：中川遥之，浅野卓，田中良典，野田進)	吉水 康人 (東芝)	半導体プロセスを用いたナノギャップ電極の作製 (東芝：田中裕介，冨田寛)
羽田 真毅 (東工大応セラ研/JST-さきがけ)	フェムト秒時間分解電子線回折法の開発 (東工大応セラ研[1]，JST-さきがけ[2]，東工大院理工[3]，JST-CREST[4]：恩田健[2,3]，腰原伸也[3,4]，中村一隆[1,4])	図師 知文 (早大理工/学振特別研究員DC2)	酸化被膜型Siナノワイヤにおける熱伝導率低下の起源に関する考察 (早大理工[1]，筑波大[2]：大毛利健治[2]，山田啓作[2]，渡邉孝信[1])
向井 佑 (京大院理)	スプリットリング共振器の高強度テラヘルツ近接磁場による非線形スピン波励起 (京大院理[1]，京大iCeMS[2]，CREST JST[3]，京大院工[4]：廣理英基[2,3]，山本隆文[4]，陰山洋[2,4]，田中耕一郎[1,2,3])	張 亜 (東大生研)	Terahertz intersublevel transitions in single self-assembled InAs quantum dots with variable electron numbers (東大生研[1]，東大INQIE[2]，LPA，Ecole Normale Superieure[3]：柴田憲治[1]，長井奈緒美[1]，G. Bastard[1,3]，C. Ndebeka-Bandou[1,3]，平川一彦[1,2])
堀川マイケル知樹 (千葉大)	同軸位相整合差周波光発生による中赤外(6.3-12.0 μm)光渦 (千葉大[1]，JST-CREST[2]：古城健司[1]，尾川あずさ[1]，宮本克彦[1]，尾松孝茂[1,2])	西村 昂人 (東工大院理工)	Cu(In,Ga)Se_2太陽電池へのCu(In,Ga)$_3Se_5$導入による界面再結合の抑制 (東工大院理工[1]，太陽光発電システム研究センター[2]：平井義晃[1]，黒川康良[1]，山田明[1,2])
Kyoko Namura (Kyoto Univ./JSPS Research Fellow)	Microfluidic control by temporally modulated thermoplasmonics (Kyoto Univ.：Kaoru Nakajima，Kenji Kimura，Motofumi Suzuki)	堀 信彦 (茨城大院)	スパッタエッチングによるMg_2Si結晶中のAg熱拡散深さの評価 (茨城大院[1]，原子力機構[2]：江坂文孝[2]，鵜殿治彦[1])
清水 荘雄 (東工大元素)	斜方晶構造を持つエピタキシャルHfO_2系薄膜の作製と評価 (東工大元素[1]，東工大総理工[2]：舟窪浩[1,2])	正直 花奈子 (東北大金研)	サファイア基板上MOVPE成長N極性面(0001)InGaNを用いた赤・緑・青色発光ダイオードの作製 (東北大金研[1]，JST，CREST[2]：崔正熙[1]，谷川智之[1,2]，窪谷茂幸[1]，花田貴[1,2]，片山竜二[1,2]，松岡隆志[1,2])
藤田 貴啓 (東大院工)	パイロクロア型イリジウム酸化物ヘテロ接合における磁気ドメイン境界の制御と界面伝導の観測 (東大院工[1]，東北大金研[2]，JSTさきがけ[3]，東大新領域[4]，理研CEMS[5]：佐野航[1]，打田正輝[1]，小塚裕介[1]，塚﨑敦[2,3]，有馬孝尚[4,5]，川﨑雅司[1,5])	市川 修平 (京大院工)	CLマッピング測定を用いたAlGaN系半導体における支配的な非輻射再結合経路の直接観察 (京大院工[1]，JFEミネラル[2]：船戸充[1]，岩崎洋介[2]，川上養一[1])
狩野 絵美 (筑波大数理、NIMS)	グラフェン上の金属原子のその場TEM観察 (筑波大数理[1]，NIMS[2]：橋本綾子[1,2]，竹口雅樹[1,2])	チェ ギヒョン (東大ナノ量子機構)	GaNナノワイヤ量子ドットからの最大励起子分子束縛エネルギーの観測 (東大ナノ量子機構[1]，東大生研[2]：Mark Holmes[1]，加古敏[2]，有田宗貴[1]，荒川泰彦[1,2])
Yi Ding (Titech)	Effect of crystallinity on optical, electrical and photovoltaic properties of silicon nanoparticles synthesized by non-thermal (Titech：Shu Zhou, Michihiro Sugaya, Tomohiro Nozaki)	久志本 真希 (名大院工)	(001)Si基板上半極性面InGaN光共振器の誘導放出特性 (名大院工[1]，赤崎研究センター[2]：本田善央[1]，天野浩[1,2])
佐々木 渉太 (東北大院工)	遺伝子細胞膜透過性に対するプラズマ照射起因電気的ストレスと酸化ストレスの効果 (東北大院工[1]，東北大院医工[2]：神崎展[2]，金子俊郎[1])	廣瀬 光太郎 (東北大通研)	走査型非線形誘電率顕微鏡によるアモルファスシリコン太陽電池のpin接合の可視化 (東北大通研：茅根慎通，長康雄)
金原 一樹 (東工大院理工)	遠赤外エリプソメータを用いた$BaTiO_3$単結晶のフォノン解析 (東工大院理工：保科拓也，武田博明，鶴見敬章)	壷井 佑夏 (京大エネ研)	CVD成長によるMoS_2薄膜の合成と光電変換デバイスへ応用 (京大エネ研[1]，名大院理[2]，JST-PRESTO[3]：王飛久[1]，小澤大知[1]，宮内雄平[1,2,3]，毛利真一郎[1]，松田一成[1])
稲垣 卓弘 (NTT物性研)	KTN結晶の電界誘起相転移を用いた低電圧駆動の光位相変調 (NTT物性研[1]，NTTフォトニクス研[2]：今井欽之[2]，宮津純[2]，武居弘樹[1]，小林潤也[2])	蓬田 陽平 (産総研)	段階溶出による単層カーボンナノチューブの大量構造分離 (産総研：都築真由美，魏小均，平野篤，藤井俊治郎，田中丈士，片浦弘道)
Duc Anh Le (東大院工)	Enhancement of ferromagnetism by manipulating the wavefunctions in n-type ferromagnetic semiconductor (In,Fe)As quantum wells (東大院工：Nam Hai Pham，笠原裕一，岩佐義宏，田中雅明)	Yasuaki Kumamoto (RIKEN)	Indium for deep-UV plasmonics: Surface-enhanced Raman scattering (RIKEN[1]，Osaka Univ.[2]：Yuika Saito[2]，Atsushi Taguchi[1,2]，Mitsuhiro Honda[1]，Koichi Watanabe[1]，Satoshi Kawata[1,2])
竹内 尚輝 (情通機構)	ラッチ回路を用いた断熱磁束量子パラメトロン回路の高速動作実証 (横国大：山梨裕希，吉川信行)	野本 淳一 (高知工科大総研)	クリティカルレイヤーを用いたスパッタAl添加ZnO透明導電膜キャリア輸送制御 (高知工科大総研：牧野久雄，山本哲也)

■第37回(2014年秋季)応用物理学会講演奨励賞受賞記念講演

開催日	時間	会場	中分類分科名・講演タイトル・所属・著者
3/11 (水)	13:15～13:30	D12	1.7 超音波 極低温ピコ秒超音波法を用いた異なるキャリア密度のGaNに対するキャリアダイナミクスの観測 1.阪大基礎工　○長久保 白1 石原 達也1 荻 博次1 中村 暢伴1 平尾 雅彦1
	14:00～14:15	A11	3.7 レーザープロセシング 水中レーザー誘起ブレークダウン分光法における蒸発速度差を考慮した組成比の補正 1.京大院工　○松本 歩1 田村 文香1 天野 健一1 深見 一弘1 西 直哉1 作花 哲夫1
	09:00～09:15	A12	3.12 ナノ領域光科学・近接場光学 金ナノロッドによる中赤外超短パルス電場の共鳴増強と光電界放出 1.農工大院工、2.東大生研、3.ゲッティンゲン大　○草 史野1, 2 エヒテルンカンプ カタリナ3 ロパース クラウス3 芦原 聡2
	14:00～14:15	A12	3.12 ナノ領域光科学・近接場光学 深紫外プラズモニクスにおけるインジウムとアルミニウムの利用 1.理研、2.阪大院工　○熊本 康昭1 齊藤 結花2 田口 敦清2 本田 光裕2 河田 聡1, 2
	13:15～13:30	D10	6.3 酸化物エレクトロニクス パイロクロア型Ir酸化物の磁気ドメイン境界における磁気輸送現象 1.東大院工、2.東北大金研、3.JSTさきがけ、4.東大新領域、5.理研CEMS　○藤田 貴啓1 佐野 航1 打田 正輝1 小塚 裕介1 塚崎 敦2, 3 有馬 孝尚4, 5 川﨑 雅司1, 5
	10:45～11:00	D2	12.1 作製・構造制御 インクジェット塗布された異種ミクロ液滴の混合挙動の制御と高度印刷薄膜製造技術への応用 1.産総研 FLEC、2.東大工　○野田 祐樹1 峯廻 洋美1 山田 寿一1 長谷川 達生1, 2
	09:00～09:15	A27	13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション 半導体プロセスを用いたナノギャップ電極の作製及びその電気特性 1.東芝　○吉水 康人1 田中 裕介1 冨田 寛1
	10:45～11:00	A10	13.7 超薄膜・量子ナノ構造 Terahertz spectroscopy of sublevel structures in single self-assembled InAs quantum dots 1.IIS, Univ. of Tokyo,2.INQIE, University of Tokyo,3.LPA, Ecole Normale Superieure ○Ya Zhang1 Kenji Shibata1 Naomi Nagai1 Camile Ndebeka-Bandou1, 3 Gerald Bastard1, 3 Kazuhiko Hirakawa1, 2
	16:45～17:00	B1	15.4 III-V族窒化物結晶 温度上昇に伴うAlGaN系半導体の支配的な非輻射再結合経路の変化 1.京大院工、2.JFEミネラル株式会社　○市川 修平1 船戸 充1 岩﨑 洋介2 川上 養一1
	13:15～13:30	D1	合同セッションK ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス クリティカルレイヤーを用いたスパッタAl添加ZnO透明電導電膜のキャリア輸送制御(II) 1.高知工科大総研　○野本 淳一1 牧野 久雄1 山本 哲也1
3/12 (木)	10:30～10:45	A14	3.9 テラヘルツ全般 スプリットリング共振器の高強度テラヘルツ近接磁場による非線形反強磁性共鳴励起 1.京大院理、2.京大iCeMS、3.JST-PRESTO、4.JST-CREST、5.京大院工　○向井 佑1 廣理 英基2, 3, 4 山本 隆文5 陰山 洋2, 5 田中 耕一郎1, 2, 4
	14:00～14:15	A17	3.13 半導体光デバイス ハーフリッジ型導波路構造を用いたInPモノリシック偏波変調器の試作と実証 1.東大院工　○川端 祐斗1 財津 優1 種村 拓夫1 中野 義昭1
	13:15～13:30	D8	6.4 薄膜新材料 Thermoplasmonic control of Marangoni flow around a micro bubble 1.Kyoto Univ.,2.J S P S Research Fellow　○Kyoko Namura1, 2 Kaoru Nakajima1 Kenji Kimura1 Motofumi Suzuki1
	13:30～13:45	A11	7.2 電子ビーム応用 グラフェンのステップ成長のその場TEM観察 1.筑波大数理、2.NIMS　○狩野 絵美1, 2 橋本 綾子1, 2 竹口 雅樹1, 2
	10:30～10:45	D14	8.0 Plasma Electronics English Session Non-thermal plasma synthesis of silicon nanoparticles and its optical, electrical and photovoltaic properties 1.Titech　○Yi Ding1 Shu Zhou1 Sugaya Michihiro1 Nozaki Tomohiro1
	11:00～11:15	B5	9.1 誘電材料・誘電体 遠赤外分光エリプソメータを用いた相転移現象の観測 1.東工大院　○金原 一樹1 保科 拓也1 武田 博明1 鶴見 敬章1
	11:15～11:30	B5	9.1 誘電材料・誘電体 KTN結晶の電界誘起相転移を用いた光制御 1.NTT物性研、2.NTTデバイスイノベーションセンタ　○稲垣 卓弘1 今井 欽之2 宮津 純2 武居 弘樹1 小林 潤也2
	13:30～13:45	A2	11.1 基礎物性 高フッ素濃度単結晶$SmFeAsO_{1-x}F_x$の合成とFIB を用いた微小結晶への4端子電極作製プロセス 1.物材機構、2.筑波大学　○藤岡 正弥1 Denholme Saleem1 田中 将嗣1 鈴木 皓司1, 2 原 裕1, 2 山木 拓馬1, 2 山下 愛智1, 2 山口 尚秀1 竹屋 浩幸1 高野 義彦1, 2
	15:00～15:15	D4	12.3 機能材料・萌芽的デバイス 自己組織化π共役高分子マイクロ球体からのWGM発光 1.筑波大数理物質、2.デュイスブルグ-エッセン大学物理、3.筑波大TIMS　○田畑 顕一1 Daniel Braam2 櫛田 創1 童 亮1 桑原 純平1 神原 貴樹1 Axel Lorke2 山本 洋平1, 3
	09:00～09:15	D15	12.5 有機太陽電池 結晶性有機薄膜太陽電池における電荷解離ダイナミクス 1.京大院工、2.JSTさきがけ　○玉井 康成1 津田 一樹1 大北 英生1, 2 辨天 宏明1 伊藤 紳三郎1
	14:00～14:15	A27	13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション 酸化被膜型Siナノワイヤにおける熱伝導率低下の起源に関する原子論的考察 1.早大理工、2.筑波大、3.学振特別研究員DC2　○図師 知文1, 3 大毛利 健治2 山田 啓作2 渡邉 孝信1
	17:30～17:45	B1	15.4 III-V族窒化物結晶 MOVPE成長N極性(0001)InGaN多重量子井戸構造と発光ダイオードの構造・光学特性 1.東北大金研、2.JST, CREST　○正直 花奈子1 崔 正君1 谷川 智之1, 2 木村 健司1, 2 窪谷 茂幸1 花田 貴1, 2 片山 竜二1, 2 松岡 隆志1, 2
	15:30～15:45	C2	16.3 シリコン系太陽電池 走査型非線形誘電率顕微鏡によるアモルファスシリコン太陽電池のpin接合の可視化 1.東北大通研　○廣瀬 光太郎1 茅根 慎通1 長 康雄1
	13:15～13:30	D7	17.1 成長技術 CVD成長MoS_2薄膜を用いたグラフェン/MoS_2/Si太陽電池の光電変換特性 1.京大エネ研　○壷井 佑夏1 王 飛久1 小澤 大知1 宮内 雄平1 毛利 真一郎1 松田 一成1
	09:15～09:30	D6	17.2 構造制御・プロセス 混合界面活性剤を用いたカーボンナノチューブの単一構造分離 1.産総研ナノシステム　○蓬田 陽平1 都築 真由美1 魏 小均1 平野 篤1 藤井 俊治郎1 田中 丈士1 片浦 弘道1
	15:45～16:00	B5	シンポジウム：次世代強誘電体材料の開発指針 HfO_2基エピタキシャル薄膜の強誘電性 1.東工大元素、2.東工大総理工　○清水 荘雄1 片山 きりは2 舟窪 浩1, 2
	16:30～16:45	D5	シンポジウム：バイオインターフェースの可視化・実用技術の新展開 吸着抑制能を有するオリゴエチレングリコール末端SAMの液中3D-SFM計測 1.金大院、2.金大バイオAFMセ、3.JST ACT-C　○稲田 なつみ1 淺川 雅2 宮澤 佳甫1 福間 剛士1, 2, 3

※会場名のアルファベットは建物名を表します．以下をご参照ください．たとえば「A1」はA棟にございます．場所は表紙の「建物配置図」でご確認ください．
<建物略称>　A:6号館A　B:6号館B　C:6号館C　D:16号館

■第37回(2014年秋季)応用物理学会講演奨励賞受賞記念講演

開催日	時間	会場	中分類分科名・講演タイトル・所属・著者
3/13 (金)	16:30～16:45	D12	1.1 応用物理一般・学際領域 学生プロジェクトによる理科実験授業におけるタブレット端末の活用方法に関する検討 1.千歳科技大　○手島 駿1 長谷川 誠1
	16:45～17:00	A19	2.2 検出器開発 シンチレーティングGlass GEM の炭素線に対する応答 1.放医研、2.東大工　○古場 裕介1 藤原 健2 松藤 成弘1 高橋 浩之2
	09:00～09:15	A13	3.5 レーザー装置・材料, 3.14 光制御デバイス・光ファイバー コードシェアセッション 中赤外(9-12 μ m)光渦レーザーにおける符号制御 1.千葉大融合、2.JST-CREST　○堀川 マイケル知樹1 尾川 あずさ1 古城 健司1 宮本 克彦1 尾松 孝茂1, 2
	09:00～09:15	A10	3.11 フォトニック構造・現象 離れた光ナノ共振器間の任意タイミングでの断熱的光転送の実現 1.京大院工　○鴻池 遼太郎1 中川 遥之1 浅野 卓1 田中 良典1 野田 進1
	10:45～11:00	D14	6.6 プローブ顕微鏡, 12.2 評価・基礎物性 コードシェアセッション ポルフィリン-Tb^{III}ダブルデッカー型単分子磁石のSTMによるパターニングと近藤状態の評価 1.阪大院理、2.東北大多元研　○猪瀬 朋子1 田中 大輔1 Liu Jie2 梶原 美珠2 米田 忠弘2 小川 琢治1
	10:45～11:00	A28	8.6 プラズマライフサイエンス 大気圧プラズマ照射による水溶性高分子の細胞膜透過性促進 1.東北大院工、2.東北大院医工　○佐々木 渉太1 保苅 雄太郎1 神崎 展2 金子 俊郎1
	09:00～09:15	A25	13.2 探索的材料物性・基礎物性 Mg_2Si pn接合ダイオードのAg拡散係数評価と拡散深さ制御 1.茨城大院、2.原子力機構　○堀 信彦1 江坂 文孝2 鵜殿 治彦1
	12:00～12:15	A17	13.10 化合物太陽電池, 15.2 II-VI族結晶および多元系結晶 コードシェアセッション Cu(In,Ga)Se_2薄膜太陽電池の 価電子帯制御による界面再結合抑制効果の理論的及び実験的検証 1.東工大院理工、2.太陽光発電システム研究センター　○西村 昂人1 平井 義晃1 黒川 康良1 山田 明1, 2
	10:45～11:00	B1	15.4 III-V族窒化物結晶 (001)Si基板上(1-101)InGaNストライプ光共振器の誘導放出特 1.名大院工、2.赤崎記念研究センター　○久志本 真希1 本田 善央1 天野 浩1, 2
	16:15～16:30	B1	15.4 III-V族窒化物結晶 位置制御GaNナノワイヤ量子ドットの巨大励起子分子束縛エネルギー 1.東大ナノ量子機構、2.東大生研　○チェ ギヒョン1 ホームズ マーク1 加古 敏2 有田 宗貴1 荒川 泰彦1, 2
3/14 (土)	11:00～11:15	A15	3.6 超高速・高強度レーザー フェムト秒時間分解電子線回折法の開発:トポロジカル絶縁体の光誘起構造ダイナミクスの観測 1.東工大応セラ研、2.JST-さきがけ、3.JST-CREST、4.東工大理工、5.マックス・プランク研、6.トロント大 ○羽田 真毅1, 2 則松 桂1, 3 田中 誠一4 Keskin Sercan5 鶴田 哲也1, 3 五十嵐 九四朗1 石川 忠彦4 萱沼 洋輔1, 3 Miller R. J. Dwayne5, 6 笹川 崇男1 恩田 健2, 4 腰原 伸也3, 4 中村 一隆1, 3
	09:30～09:45	D2	10.4 半導体・有機・光・量子スピントロニクス Electrical modulation of ferromagnetism via controlling the wavefunction in n-type ferromagnetic semiconductor (In,Fe)As quantum wells 1.The University of Tokyo,2.Tokyo Institute of Technology,3.Kyoto University,4.RIKEN Center for Emergent Matter Science ○Duc Anh Le1 Nam Hai Pham1, 2 Yuichi Kasahara1, 3 Yoshihiro Iwasa1, 4 Masaaki Tanaka1
	09:00～09:15	A2	11.5 接合, 回路作製プロセスおよびデジタル応用 磁束量子ラッチを用いたXORゲートの提案と動作実証 1.横浜国大　○竹内 尚輝1 山梨 裕希1 吉川 信行1

※会場名のアルファベットは建物名を表します．以下をご参照ください．たとえば「A1」はA棟にございます．場所は表紙の「建物配置図」でご確認ください．
<建物略称>　A:6号館A　B:6号館B　C:6号館C　D:16号館

Notes

■分科企画シンポジウム

開催日	時間	会場	シンポジウム名	世話人（所属）
3/11(水)	13:30～17:15	B4	3. 光・フォトニクス フォトニクスと量子情報技術の融合へ向けて Quantum Photonics: Toward a new paradigm of quantum information technology	岩本 敏 東大 早瀬 潤子 慶応大 根本 香絵 国立情報学研究所 小坂 英男 横国大 行方 直人 日本大
	13:15～17:00	D9	6. 薄膜・表面 斜め蒸着法, GLAD, STF等, シャドウイングによるナノ形態の制御と評価 Fabrication and characterization of nano-structures prepared with advanced shadowing deposition systems	佐々木 正洋 筑波大 土佐 正弘 物材機構 山田 洋一 筑波大
	13:15～17:30	B5	13. 半導体 最先端CMOS技術とその将来展望 Advanced CMOS Technology and Its Future Scope	最上 徹 PETRA 木下 啓藏 PETRA 上野 智雄 農工大 一木 隆範 東大
3/12(木)	14:00～17:15	A19	2. 放射線 放射線オプティクス Ionizing radiation optics	柳田 健之 九工大 島添 健次 東大 越水 正典 東北大 人見 啓太郎 東北大
	13:30～18:00	B6	3. 光・フォトニクス レーザーによる3次元造形技術の最先端から実用まで Advanced and Practical 3D Fabrication Techniques Using Lasers	佐藤 正健 産総研 細川 陽一郎 奈良先端大
	13:15～17:00	D2	3. 光・フォトニクス 光量子を自在に操る分極反転光デバイス Polarity-reversed optical device handling quantum photons	栗村 直 物材機構 石月 秀貴 分子科学研究所
	14:00～17:45	A12	3. 光・フォトニクス 散逸ゆらぎ制御ナノ電子フォトン系の理論とデバイス構築 Theory and Practice of Nanoelectron-photon Interaction via Dissipation and Fluctuations	成瀬 誠 情通機構 信定 克幸 分子科学研究所 八井 崇 東大 岩見 健太郎 農工大
	13:30～16:15	B3	3. 光・フォトニクス 宇宙観測・地球観測で活用される光センシング技術 Optical sensing utilized in space and earth observations	中村健太郎 東京工業大学 石井勝弘 光産業創成大学院大学 和田 篤 防衛大学校
	13:30～17:30	B5	6. 薄膜・表面 9. 応用物性 （「6.1 強誘電体薄膜」と「9.1誘電材料・誘電体」の合同） 次世代強誘電体材料の開発指針 Guidelines for Development of Ferroelectric Materials in the Following Generation	塚田 真也 島根大 三浦 薫 キヤノン 坂本 渉 名大
	13:15～18:30	D10	6. 薄膜・表面 スピン-軌道相互作用が生み出す酸化物の新しい機能性 New functionality of oxides generated by spin-orbit interaction	松野 丈夫 理研 浅沼 周太郎 産総研 神吉 輝夫 阪大 廣瀬 靖 東大 組頭 広志 高エネルギー加速器研究機構 田中 秀和 阪大 秋永 広幸 産総研
	13:15～17:30	D9	6. 薄膜・表面 二酸化チタンの最近の動向 Recent development of titanium dioxide	坂間 弘 上智大 佐々木 正洋 筑波大 山田 豊和 千葉大
	13:15～15:30	C3	7. ビーム応用 リソグラフィ技術の最新動向 The latest trend of the lithography technology	藤井 清 ﾙﾈｻｽｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀﾏﾆｭﾌｧｸﾁｭｱﾘﾝｸﾞ 須賀 治 EUVL基盤開発センター 岡崎 信次 ギガフォトン
	13:30～18:45	D14	8. プラズマエレクトロニクス 微粒子合成法とその応用最前線 Synthesizing methods for fine particles and their latest applications	伊藤 昌文 名城大 杤久保 文嘉 首都大 佐藤 孝紀 室蘭工大
	13:15～17:15	D5	12. 有機分子・バイオエレクトロニクス バイオインターフェースの可視化・実用技術の新展開 Visualization and application of biointerfaces	手老 龍吾 豊橋技科大 住友 弘二 NTT物性基礎研究所 大城 敬人 阪大 柳瀬 雄輝 広島大
	13:00～17:00	A29	13. 半導体 未来を担う若手科学者の在り方　～集積化技術の新たな価値創造を目指して～ Session directed by Students and Young-Researchers on Silicon Integration Technologies (tentative)	若林 整 東工大 角嶋 邦之 東工大 高橋 庸夫 北大 藤原 聡 NTT
	14:00～17:15	D15	13. 半導体 クルマ社会の未来を支えるセンシング技術　～自動運転システムの展望と課題～ Sensing Technologies for the Future of Automobile Society ～The Prospect and Challenge of Autonomous Driving System～	町田 克之 NTT-AT 有本 和民 岡山県立大 松浦 正純 ルネサスエレクトロニクス 土屋 智由 京大 佐々木 実 豊田工大 年吉 洋 東大 森村 浩季 NTT
	13:15～18:15	B4	15. 結晶工学 進化するパワー半導体・・・シリコンからワイドバンドギャップへ Progress of power semiconductors, toward wide band-gap materials beyond silicon	上野 勝典 富士電機 大谷 昇 関西学院大 矢野 裕司 筑波大
	13:15～18:30	D1	合同セッションK 酸化物半導体における価電子メタモルフォロジ Valence-electron metamorphology in oxide semiconductors	川原村 敏幸 高知工大 阿部 友紀 鳥取大 宇野 和行 和歌山大
3/13(金)	9:00～12:30	B6	10. スピントロニクス・マグネティクス スピントロニクスの将来ビジョン ～スピントロニクスはこれから何をするのか？～ A vision of future spintronics ~What is the next in spintronics?	千葉 大地 東大 関 剛斎 東北大 好田 誠 東北大 新田 淳作 東北大
	9:30～13:00	D13	1. 応用物理学一般 衝撃および重力場応用の物理の最前線 Research forefront of shock wave and high & micro-gravity application science	松谷 晃宏 東工大 松本 仁 防衛大 真下 茂 熊本大
	9:00～11:45 16:15～18:45	B2	11. 超伝導 巨匠が教えてくれた高温超伝導とその未来～北澤宏一先生・前田弘先生追悼シンポジウム～ Memorial Symposium for Prof. K. Kitazawa and Prof. H. Maeda	小田部 荘司 九工大 下山 淳一 東大 筑本 知子 中部大 松本 要 九工大 堀井 滋 京大 川山 巌 阪大 斉藤 志郎 NTT
	13:15～18:15	C2	15. 結晶工学 16. 非晶質・微結晶 太陽電池用バルク結晶シリコンの成長と評価 Growth and characterization of bulk crystalline silicon for photovoltaic application	大平 圭介 北陸先端大 沓掛 健太朗 東北大 石河 泰明 奈良先端大
3/14(土)	8:30～11:45 12:45～15:00	B1	15. 結晶工学 窒化物半導体特異構造の科学　～成長・プロセスとエレクトロニクス展開～ Materials science of singularity in nitride semiconductors-Growth, processing and electronic application-	三宅 秀人 三重大 熊谷 義直 農工大 片山 竜二 東北大

■シンポジウム

開催日	時間	会場	シンポジウム名	世話人(所属)
3/11(水)	13:15～17:15	B3	7. ビーム応用 最先端の電子・集束イオンビーム装置技術 State of the art technology in electron and focused-ion-beam apparatuses	高岡 義寛 京大
	9:00～11:45 13:15～17:00	B6	13. 半導体 化合物薄膜とペロブスカイト太陽電池融合の可能性 Feasibility of integration of perovskite semiconductors into multinary compounds solar cells	櫻井 岳暁 筑波大学 今泉 充 宇宙航空研究開発機構 仁木 栄 産総研

■分科内招待講演

■1.応用物理学一般

開催日	時間	会場	タイトル	講演者名 (所属)
03/11(水)	13:15～13:45	D13	MOD法により製作したVOxマイクロボロメータ素子の検出特性	内田 貴司 (防衛大)

■2.放射線

開催日	時間	会場	タイトル	講演者名 (所属)
03/13(金)	16:15～16:45	A19	原子核乾板自動解析技術の開発とその応用	森島 邦博 (名大)

■3.光・フォトニクス

開催日	時間	会場	タイトル	講演者名 (所属)
3/12(木)	11:15～11:30	A15	12 GHzフェムト秒モード同期レーザーを用いた光パルスフーリエ合成	遠藤 護 (東大)

■6.薄膜・表面

開催日	時間	会場	タイトル	講演者名 (所属)
3/12(木)	16:45～17:45	C1	DLC膜の現在と将来展望	大竹 尚登 (東工大)
3/12(木)	15:30～15:45	D8	透明強磁性鉄薄膜	千原 真志 (名大)

■7.ビーム応用

開催日	時間	会場	タイトル	講演者名 (所属)
3/11(水)	13:15～13:45	B2	易液化ガスPFPを用いたナノインプリント	廣島 洋 (産総研)
3/13(金)	10:30～11:15	A16	ナノクラスタービーム技術の新展開	中嶋 敦 (慶應大)

■8.プラズマエレクトロニクス

開催日	時間	会場	タイトル	講演者名 (所属)
3/12(木)	11:00～11:30	D14	プラズマを学び科学・技術の最先端に挑戦する	石井 彰三 (東工大)

■12.有機分子・バイオエレクトロニクス

開催日	時間	会場	タイトル	講演者名 (所属)
3/13(金)	10:15～11:00	D4	分子回路工学をめざした分子グリッド配線技術	彌田 智一 (東工大)
3/11(水)	13:15～13:45	D15	高効率ポリマーブレンド太陽電池の開発	大北 英生 (京大)
3/13(金)	16:30～17:00	D15	ペロブスカイト太陽電池の高耐久・高効率化開発における課題と将来展望	宮坂 力 (横浜桐蔭大)

■海外研究者招待講演

開催日	時間	会場	タイトル	講演者名 (所属)
3/12(木)	11:00～11:30	A11	Intracellular molecular manipulation by femtosecond laser triggering	Hao He (Shanghai Jiaotong University)

※会場名のアルファベットは建物名を表します. 以下をご参照ください. たとえば「A1」はA棟にございます. 場所は表紙の「建物配置図」でご確認ください.
<建物略称> A:6号館A B:6号館B C:6号館C D:16号館

■大分類意見交換会一覧

	開催日	時間	会場	人数	食事	備考
1 応用物理学一般	3/12(木)	12:15～13:15	AM4	7	折詰	
2 放射線	3/12(木)	11:30～12:00	AM14	35	折詰	放射線分科会幹事会と同時開催
3 光・フォトニクス3	3/12(木)	12:30～13:30	AM5	25	折詰	
6 薄膜・表面	3/12(木)	11:45～13:00	AM6	15	折詰	
7 ビーム応用	3/11(水)	12:00～13:00	AM2	8	折詰	
8 プラズマエレクトロニクス	3/12(木)	11:45～12:15	D14	80	折詰	プラズマエレクトロニクス分科会ミーティングと同時開催
9 応用物性	3/13(金)	12:45～13:30	AM2	6	折詰	
10 スピントロニクス・マグネティクス	3/13(金)	17:30～19:00	AM2	30	折詰	スピントロニクス研究会幹事会と同時開催
11 超伝導	3/12(木)	11:45～12:00	AM16	30	折詰	超伝導分科幹事会と同時開催
12 有機分子・バイオエレクトロニクス	3/12(木)	12:00～13:00	AM7	25	折詰	
13 半導体	3/11(水)	12:30～13:30	AM16	40	折詰	
15 結晶工学	3/12(木)	12:00～12:45	AM1	16	折詰	
16 非晶質・微結晶	3/11(水)	12:45～13:45	AM2	11	折詰	
17 ナノカーボン	3/13(金)	12:00～13:00	AM6	15	折詰	

■English Session のご案内

以下のセッションでは英語による講演が予定されています.

3.0	Optics and Photonics English Session			
	3/13(金)	9:00～11:15	口頭講演	A15会場
8.0	Plasma Electronics English Session			
	3/12(木)	9:00～10:45	口頭講演	D14会場
	3/13(金)	9:30～11:30	ポスター講演	P会場
10	スピントロニクス・マグネティクス			
	3/11(水)	13:30～15:30	ポスター講演	P会場
10.1	新物質創成(酸化物・ホイスラー・金属磁性体等)			
	3/11(水)	15:45～18:30	口頭講演	D11会場
	3/12 (木)	9:00～11:45	口頭講演	D11会場
10.2	スピントルク・スピン流・回路・測定技術			
	3/12(木)	13:15～18:30	口頭講演	D11会場
10.3	GMR・TMR・磁気記録技術			
	3/13 (金)	16:15～18:15	口頭講演	D11会場
	3/14(土)	13:00～15:00	口頭講演	D11会場
10.4	半導体・有機・光・量子スピントロニクス			
	3/14(土)	9:00～15:00	口頭講演	D2会場
10.5	磁場応用			
	3/14(土)	9:00～12:00	口頭講演	D11会場
13.6	Semiconductor English Session			
	3/12(木)	9:00～12:15	口頭講演	A23会場

※会場名のアルファベットは建物名を表します. 以下をご参照ください. たとえば「A1」はA棟にございます. 場所は表紙の「建物配置図」でご確認ください.
<建物略称> A:6号館A B:6号館B C:6号館C D:16号館

■会合一覧

会合については講演会運営上，本部と会合世話人との間で右のように責任分担範囲を定めて実施したいと思いますので，各位のご協力をお願いします。

＜本部担当＞会場確保，割付
＜世話人担当＞会場準備，後片付け，支払他一切

開催日	開始時間	終了時間	会場	会合名	人数	食事	世話人	世話人所属
3/11（水）	13:00	15:00	AM1	教育企画委員会インフォーマルミーティング	20	－	原　一広	九大
	15:30	17:30	A10	学生研究者交流会	80	－	応用物理学会本部	
3/12（木）	11:00	14:00	AM16	超伝導分科会幹事会	30	折詰	淡路　智	東北大
	11:30	12:00	AM14	放射線大分類意見交換会	35	折詰	伏見　賢一	徳島大
	12:00	13:30	AM14	放射線分科会幹事会	0	－	河原林　順	名大
	12:00	13:00	AM2	第18回集積化MEMS技術研究会委員会	25	折詰	森村　浩季	NTT
	12:00	13:30	A24	JJAP特集号編集委員会議	70	折詰	近藤　高志	東大
	12:00	13:30	AM15	薄膜・表面物理分科会 第43期第6回，第44期第1回幹事会	45	折詰	佐々木正洋	筑波大
	12:15	13:00	AM3	応用物理学会中国四国支部貢献賞選考委員会	5	折詰	浅田　裕法	山口大
	12:15	13:15	D14	プラズマエレクトロニクス分科会ミーティング	60	－	本村　大成	産総研
							寺本　慶之	産総研
	17:30	19:30	AM14	北陸・信越支部及びEM-NANO2015組織委員・プログラム委員合同IM	25	折詰	伊東　栄次	信州大
							加藤　景三	新潟大
	17:30	19:30	AM15	シリコンテクノロジー分科会幹事会	50	折詰	藤原　聡	NTT
							品田　高広	東北大
	17:30	19:30	AM2	応用電子物性分科会幹事会	24	折詰	伏見　浩	オプトランス
	18:15	19:30	AM3	先進パワー半導体分科会幹事会	26	折詰	佐野　泰久	阪大
	18:00	19:30	AM16	第2回ICCGE18/ISSCG16合同実行委員会	35	折詰	田畑　睦美	第18回結晶成長国際会議（ICCGE-18）事務局
	18:00	19:30	AM5	APNFO10組織委員会	16	折詰	斎木　敏治	慶応大
3/13（金）	10:00	12:00	AM1	応用物理教育分科会 幹事会	20	－	鈴木　芳文	九州工業大
							本田　亮	鳴門教育大
	12:00	13:00	AM14	応用物理学会女子会IM	50	折詰	応用物理学会本部	
	12:00	13:30	AM3	応用物理学会中国四国支部2014年度第3回役員会	35	折詰	浅田　裕法	山口大
	12:30	13:30	AM5	テラヘルツ電磁波技術研究会インフォーマルミーティング	5	折詰	山下　将嗣	理研
	12:45	14:00	AM4	シリサイド系半導体と関連物質研究会　幹事会	20	－	寺井　慶和	鹿児島大
	16:15	17:30	AM6	EMS34第2回運営・実行合同委員会	30	-	光野　徹也	静岡大
	17:00	19:30	AM7	フォトニクス分科会	10	－	応用物理学会本部	
	16:00	18:00	AM14	CSW2016合同委員会	50	－	後藤　秀樹	NTT
	17:30	19:00	AM3	応用物理学会中国四国支部研究会企画委員会	9	－	牧野　久雄	高知工科大
	17:30	19:30	AM15	有機分子・バイオエレクトロニクス分科会インフォーマルミーティング	58	折詰	中　茂樹	富山大
	17:30	19:30	AM2	スピントロニクス研究会 幹事会	30	折詰	三輪　真嗣	阪大
	18:00	19:30	AM16	ISGN6合同実行委員会	50	折詰	谷川　智之	東北大
	18:30	19:30	AM1	応用物理教育分科会 インフォーマルミーティング	30	－	本田　亮	鳴門教育大
							鈴木　芳文	九州工業大
3/14（土）	11:30	13:30	AM2	磁場応用IM	20	－	山登　正文	首都大
							山本　勲	横国大
	11:45	12:45	AM14	ナイトライド基金運営委員会　総会	50	折詰	三宅　秀人	三重大
	12:00	14:00	A17	埋もれた界面のX線・中性子解析研究会	12	折詰	桜井　健次	物材機構
	12:00	14:00	AM1	日本光学会　情報フォトニクス研究グループ幹事会	11	折詰	鈴木　裕之	東工大

※会場名のアルファベットは建物名を表します．以下をご参照ください．たとえば「A1」はA棟にございます．場所は表紙の「建物配置図」でご確認ください．
<建物略称>　A:6号館A　B:6号館B　C:6号館C　D:16号館

展示会のご案内

展示会(JSAP EXPO Spring)を開催します。研究・開発に役立つ様々な製品が展示されます。是非、ご来場ください!

日　　時: 2015年3月11日(水)～12日(木) 10:00～18:00
2015年3月13日(金) 10:00～18:30 ※最終日の3月14日(土)は12:00まで
会　　場: 東海大学　体育館(P会場)
展示内容: ・一般機器展示
・出版書籍展示
展示規模: 180社　210小間(予定)

☆ **ドリンクバー**(ドリンクチケットor展示会招待券をお持ちください!!)



ドリンクチケット→

☆ **展示会場内にて無線LANが使用できます。**

☆ **第5回JSAP Photo Contest**
優秀作品の投票をしていただいた方に抽選にて景品を進呈します。

☆ **無料プリントサービスコーナー**
予稿集DVDのプリントアウトができます。

☆ **スタンプラリー開催!**(空くじナシ)
豪華景品をゲット!

先着3千名様

☆ **来場された方に、「BUYERS GUIDE」をプレゼント!**
展示会場に出展している企業の製品が検索できます。

☆ **ソーラーカー展示**　☆**TOYOTA 燃料電池車 MIRAI展示**

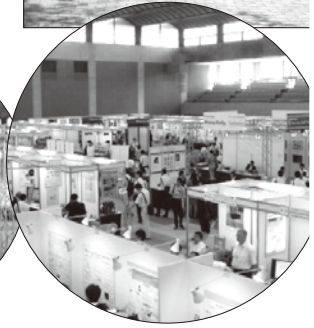
出展企業(2015年1月30日現在)

㈱アートレイ
㈱アールデック
アイアールシー㈱ / 中古機械買取販売㈱
IOP英国物理学会出版局
㈱アイリン真空
アサヒ・テクノソリューションズ㈱
朝日分光㈱
アステック㈱
アドバンスソフト㈱
㈱アドバンテスト
㈱アポロウエーブ
アメリカ物理学会出版局
アリオス㈱
アルバック・クライオ㈱
㈱アローズ
ALDジャパン㈱
エア・ウォーター㈱
㈱エイエルエステクノロジー
㈱エイコー/ ㈱エイコー・エンジニアリング
㈱エイチ・ティー・エル
㈲エーピーエフ
㈱エヌエフ回路設計ブロック
エバンスアナリティカルグループ ナノサイエンス㈱
㈱エピクエスト
㈱エピテック
㈱エムオー産業
(公社)応用物理学会
㈱オーエステック
㈱大阪真空機械製作所
オーシャンフォトニクス㈱
大塚電子㈱
㈱オキサイド
オックスフォード・インストゥルメンツ㈱
㈱オフィールジャパン
㈱オプティマ
㈱オプトサイエンス
オプトシリウス㈱
㈱科学技術振興機構
樫山工業㈱
カンタムエレクトロニクス㈱
キーサイト・テクノロジー(同)
北野精機㈱
㈱キッツエスシーティー
㈱紀伊國屋書店
㈱金門光波
㈱グリーンテック
㈱クリスタル光学
㈱クレステック
クロスライトソフトウェアインク日本支社
計測エンジニアリングシステム㈱
ケニックス㈱
㈱光学技研
興研㈱
㈱高純度化学研究所
神津精機㈱
コーンズテクノロジー㈱
㈱小坂研究所
コヒレント・ジャパン㈱
㈱コメット
㈱サーモ理工
SCIVAX㈱
サイバネットシステム㈱
(一財)材料科学技術振興財団
サエス・ゲッターズ・エス・ピー・エー 日本支店
坂口電熱㈱
㈱彪半導体
㈱サムウエイ
サムコ㈱
㈱三啓
サンユー電子㈱
JSWアフティ㈱
ジェー・エー・ウーラム・ジャパン㈱
㈱ジェック東理社
シグマ アルドリッチ ジャパン(同)
シグマテック㈱
㈱システムズエンジニアリング
㈱システムハウス・サンライズ
㈱システムブレイン
ジャパンハイテック㈱
シュプリンガー・ジャパン㈱
シュレーディンガー㈱
翔栄システム㈱
㈱菅製作所
㈱スプリード
スペクトラ・クエスト・ラボ㈱
㈲スペクトルデザイン
㈱西部技研
セティ㈱
㈱相馬光学
ソルビー工業㈱
大亜真空㈱
泰榮電器㈱
大陽日酸㈱
田中貴金属グループ
㈱タムラ製作所
Zurich Instruments Ltd
TNSシステムズ(同)
㈱ディジタルデータマネジメント
テガサイエンス㈱
㈲テク
テクノハンズ㈱
㈱テクノポート
テクノロジーリンク㈱
デフトップ㈱
テルモセラ・ジャパン㈱
㈱東京インスツルメンツ
㈱東陽テクニカ
㈱豊島製作所
巴工業㈱
㈱トヤマ
ナガセテクノエンジニアリング㈱
㈱ナノファクター
ナノフォトン㈱
㈱ナノシステムソリューションズ
ナノメトリクス・ジャパン㈱
ナプソン㈱
㈱日本ローパー
日本エクシード㈱
日本オートマティック・コントロール㈱
日本カンタム・デザイン㈱
日本高周波(株)
(株)日本シード研究所
日本セミラボ㈱
日本電子㈱
日本分光㈱
㈱日本レーザー
ネオアーク㈱
パーク・システムズ・ジャパン㈱
バイクリスタル㈱
ハイソル㈱
伯東㈱
㈱バスカル
パナリティカル
浜松ホトニクス㈱
ピーアンドシー㈱
㈱ピーエムティー
WITec㈱
㈱ビームセンス
㈱ビームトロン / ㈱リッチモアインターナショナル
㈱ヒューリンクス
㈱VICインターナショナル
VAT㈱
VGシエンタ㈱
フィルジェン㈱
㈱フォーサイトテクノ
㈱フォトンデザイン
富士通㈱
富士フイルムグローバルグラフィックシステムズ㈱
プネウム㈱
ブルカー・エイエックスエス㈱
㈱プロリンクス
分光計器(株)
ベクターセミコン㈱
(独)放射線医学総合研究所
㈱堀場製作所
㈱マイクロサポート
武蔵エンジニアリング㈱
ムサシノ電子㈱
㈱睦コーポレーション
㈱明電舎
㈱メック
モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン(同)
文部科学省ナノテクノロジープラットフォームセンター
㈱ユニソク
㈱ライトストーン
㈱リガク
理研計器㈱
理工貿易㈱ / マイクロテク㈱
㈱リンテック
ルフト㈲
レイチャーシステムズ㈱
レーザーテック㈱
ロックゲート㈱
ワッティー㈱











■講演募集分科名・プログラム編集委員

大分類分科名 Category	中分類分科名		Section	委員(所属) 下線は大分類分科代表又は合同セッション代表
1 応用物理学一般 Applied Physics in General	1.1	応用物理一般・学際領域	Interdisciplinary and general physics	面谷信（東海大）
	1.2	教育	Education	鈴木芳文（九工大）
	1.3	新技術・複合新領域	Novel technologies and interdisciplinary engineering	松谷晃宏（東工大）
	1.4	エネルギー変換・貯蔵	Energy conversion and storage	小栗和也（東海大）
	1.5	資源・環境	Resources and environment	小栗和也（東海大）
	1.6	計測技術・計測標準	Instrumentation, measurement and metrology	寺崎正（産総研）
	1.7	超音波	Ultrasonic	近藤淳（静岡大）
2 放射線 Ionizing Radiation	2.1	放射線物理一般・検出器基礎	Radiation physics and Detector fundamentals	伏見賢一（徳島大），越水正典（東北大），人見啓太朗（東北大）
	2.2	検出器開発	Detection systems	
	2.3	放射線応用・発生装置・新技術	Application, radiation generators, new technology	
3 光・フォトニクス Optics and Photonics **2014年秋に従来の大分類3，4，5が統合・再編され、1つの大分類になっております。**	3	Optics and Photonics English Session	Optics and Photonics English Session	未定
	3.1	光学基礎・光学新領域	Basic optics and frontier of optics	居波渉（静岡大）
	3.2	材料・機器光学	Equipment optics and materials	石飛秀和（阪大），望月博孝（産総研），畔野靖行（キヤノン），片山龍一（福岡工大）
	3.3	情報フォトニクス・画像工学	Information photonics and image engineering	的場修（神戸大），片山龍一（福岡工大）
	3.4	生体・医用光学	Biomedical optics	松浦祐司（東北大），西舘泉（農工大）
	3.5	レーザー装置・材料	Laser system and materials	興雄司（九大），時田茂樹（阪大），宮本克彦（千葉大）
	3.6	超高速・高強度レーザー	Ultrashort-pulse and high-intensity lasers	石川顕一（東大），石澤淳（NTT）
	3.7	レーザープロセシング	Laser processing	細川陽一郎（奈良先端大），佐藤正健（産総研）
	3.8	光計測技術・機器	Optical measurement, instrumentation, and sensor	平井亜紀子（産総研），塩田達俊（埼玉大），柴田泰邦（首都大）
	3.9	テラヘルツ全般	THz technology	河野行雄（東工大），山下将嗣（理研）
	3.10	光量子物理・技術	Optical quantum physics and technologies	行方直人（日大）
	3.11	フォトニック構造・現象	Photonic structures and phenomena	新家昭彦（NTT），浅野卓（京大）
	3.12	ナノ領域光科学・近接場光学	Nanoscale optical science and near-field optics	酒井優（山梨大），岩見健太郎（農工大）
	3.13	半導体光デバイス	Semiconductor optical devices	下村和彦（上智大），中村滋（NEC），荒川太郎（横国大）
	3.14	光制御デバイス・光ファイバー	Optical control devices and optical fiber	石月秀貴（NINS），渡辺俊夫（NTT），和田篤（防衛大）
	3.15	シリコンフォトニクス	Silicon photonics	森雅彦（産総研）
6 薄膜・表面 Thin Films and Surfaces	6.1	強誘電体薄膜	Ferroelectric thin films	坂本渉（名大），三浦薫（キヤノン）
	6.2	カーボン系薄膜	Carbon-based thin films	神田一浩（兵庫県立大），小倉政彦（産総研）
	6.3	酸化物エレクトロニクス	Oxide electronics	廣瀬靖（東大），神吉輝夫（阪大）
	6.4	薄膜新材料	Thin films and New materials	中村吉伸（東大），土屋哲男（産総研）
	6.5	表面物理・真空	Surface Physics, Vacuum	高見知秀（広島大），山田洋一（筑波大）
	6.6	プローブ顕微鏡	Probe Microscopy	福間剛士（金沢大），山田豊和（千葉大）
7 ビーム応用 Beam Technology and Nanofabrication	7.1	X線技術	X-ray technologies	寺岡有殿（原子力機構），江島丈雄（東北大）
	7.2	電子ビーム応用	Applications and technologies of electron beams	川崎忠寛（JFCC），根尾陽一郎（静岡大）
	7.3	微細パターン・微細構造形成技術	Micro/Nano patterning and fabrication	山崎謙治（NTT），須賀治（EIDEC），横尾篤（NTT）
	7.4	量子ビーム界面構造計測	Buried interface sciences with quantum beam	桜井健次（NIMS）
	7.5	原子・分子線およびビーム関連新技術	Atomic/molecular beams and beam-related new technologies	田川雅人（神戸大）
	7.6	イオンビーム一般	Ion beams	種村眞幸（名古屋工大）
8 プラズマエレクトロニクス Plasma Electronics	8.0	Plasma Electronics English Session	Plasma Electronics English Session	佐藤孝紀（室蘭工大）
	8.1	プラズマ生成・制御	Plasma production and control	柳生義人（佐世保高専）
	8.2	プラズマ診断・計測	Plasma measurements and diagnostics	伊藤剛仁（阪大）
	8.3	プラズマ成膜・表面処理	Plasma deposition of thin film and surface treatment	太田貴之（名城大）
	8.4	プラズマエッチング	Plasma etching	前田賢治（日立）
	8.5	プラズマナノテクノロジー	Plasma nanotechnology	佐藤孝紀（室蘭工大），金子俊郎（東北大）
	8.6	プラズマライフサイエンス	Plasma life sciences	山田英明（産総研）
	8.7	プラズマ現象・新応用・融合分野	Plasma phenomena, emerging area of plasmas and their new applications	小田昭紀（千葉工大）
	8.8	プラズマエレクトロニクス分科内招待講演	プラズマエレクトロニクス分科内招待講演	佐藤孝紀（室蘭工大）
9 応用物性 Applied Materials Science	9.1	誘電材料・誘電体	Dielectrics, ferroelectrics	塚田真也（島根大）
	9.2	ナノワイヤ・ナノ粒子	Nanowires and Nanoparticles	原嘉二郎（北大），古藤誠（キヤノン）
	9.3	ナノエレクトロニクス	Nanoelectronics	島田宏（電通大）
	9.4	熱電変換	Thermoelectric conversion	中津川博（横国大），竹内恒博（豊田工大）
	9.5	新機能材料・新物性	New functional materials and new physical properties	高瀬浩一（日大）
10 スピントロニクス・マグネティクス Spintronics and Magnetics	10.1	新物質創成（酸化物・ホイスラー・金属磁性体等）	Emerging materials in spintronics and magnetics (excluding semiconductors)	近藤剛（東芝）
	10.2	スピントルク・スピン流・回路・測定技術	Spin torque, spin current, circuits, and measurement technologies	大兼幹彦（東北大）
	10.3	GMR・TMR・磁気記録技術	Giant magnetoresistance (GMR), tunnel magnetoresistance (TMR) and magnetic recording technologies	三輪真嗣（阪大）
	10.4	半導体・有機・光・量子スピントロニクス	Semiconductors, organic, optical, and quantum spintronics	好田誠（東北大）
	10.5	磁場応用	Application of magnetic field	山本勲（横国大）
11 超伝導 Superconductivity	11.1	基礎物性	Fundamental properties	山本秀樹（NTT），入江晃亘（宇都宮大）
	11.2	薄膜，厚膜，テープ作製プロセスおよび結晶成長	Thin and thick superconducting films, coated conductors and film crystal growth	一野祐亮（名大）
	11.3	臨界電流，超伝導パワー応用	Critical Current, Superconducting Power Applications	小田部荘司（九工大）
	11.4	アナログ応用および関連技術	Analog applications and their related technologies	紀和利彦（岡山大）
	11.5	接合，回路作製プロセスおよびデジタル応用	Junction and circuit fabrication processs, digital applications	山梨裕希（横国大）
12 有機分子・バイオエレクトロニクス Organic Molecules and Bioelectronics **2014年春に中分類が再編されておりますので，ご確認のうえご投稿ください.**	12.1	作製・構造制御	Fabrications and Structure Controls	三崎雅裕（神戸大），三浦康弘（桐蔭横浜大），松井淳（山形大）
	12.2	評価・基礎物性	Characterization and Materials Physics	古川一暁（NTT），解良聡（NINS），久保野敦史（静岡大）
	12.3	機能材料・萌芽的デバイス	Functional Materials and Novel Devices	福田武司（埼玉大），山下兼一（京都工繊大），永野修作(名大)，尾崎良太郎(愛媛大)，奥崎秀典（山梨大）
	12.4	有機EL・トランジスタ	Organic light-emitting devices and organic transistors	横山大輔（山形大），永瀬隆(大阪府大)，坂上知（早大），深川弘彦（NHK）
	12.5	有機太陽電池	Organic solar cells	久保貴哉(東大)，嘉治寿彦（農工大），尾坂格（理研）
	12.6	ナノバイオテクノロジー	Nanobiotechnology	住友弘二(NTT)，熊谷慎也(豊田工大)
	12.7	医用工学・バイオチップ	Biomedical Engineering and Biochips	柳瀬雄輝（広島大），笹川清隆（奈良先端大），宮本浩一郎（東北大）

■講演募集分科名・プログラム編集委員

大分類分科名 Category	中分類分科名		Section	委員(所属) 下線は大分類分科代表又は合同セッション代表
13 半導体 Semiconductors **本講演会より，従来の大分類13，14が統合・再編され，1つの大分類になっております．**	13. 1	Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション	Fundamental properties, surface and interface, and simulations of Si related materials	上野智雄（農工大），嶺峨幸一郎（ソニー），森伸也(阪大)
	13. 2	探索的材料物性・基礎物性	Exploratory Materials, Physical Properties, Devices	寺井慶和(鹿児島大)，末益崇(筑波大)
	13. 3	絶縁膜技術	Insulator technology	石田猛(日立)，小山正人(東芝)
	13. 4	Siプロセス・配線・MEMS・集積化技術	Si wafer processing /MEMS/Integration technology	小川真一(産総研)，中村友二(富士通)，上野和良(芝浦工大)，河本直哉(山口大)，角嶋邦之(東工大)，町田克之(NTT-AT)，佐々木実(豊田工大)，石井仁(豊橋技科大)，永瀬雅夫(徳島大)
	13. 5	デバイス／集積化技術	Semiconductor devices and related techologies	右田真司(産総研)，入沢寿史(東芝)
	13. 6	Semiconductor English Session	Semiconductor English Session	未定
	13. 7	超薄膜・量子ナノ構造	Quantum properties and fabrications of nanoscale structures and devices	宮澤俊之(東大)，依羅彦(NTT)，早瀬潤子(慶大)，尾崎信彦(和歌山大)
	13. 8	化合物及びパワー電子デバイス・プロセス技術	Compound and power electron devices and process technology	中村成志(首都大)，塩島謙次(福井大)，牧山剛三(富士通研)，末光哲也(東北大)
	13. 9	光物性・発光デバイス	Optical properties and light-emitting devices	小泉淳(阪大)，國本崇(徳島文理大)，深田晴己(金沢工大)，今北健二(神戸大)
	13. 10	化合物太陽電池	Compound solar cells	杉山睦(東理大)，八木修平(埼玉大)
15 結晶工学 Crystal Engineering	15. 1	バルク結晶成長	Bulk crystal growth	荻野拓（東大）
	15. 2	II-VI族結晶および多元系結晶	II-VI and related compounds	阿部友紀（鳥取大)，宇野和行（和歌山大)，田橋正浩（中部大）
	15. 3	III-V族エピタキシャル結晶	III-V-group epitaxial crystals	杉山正和(東大)，荒井昌和(NTT)
	15. 4	III-V族窒化物結晶	III-V-group nitride crystals	片山竜二（東北大)，高橋邦方（パナソニック)，大矢昌輝（エルシード)，山口智広（工学院大)，村上尚（農工大）
	15. 5	IV族結晶，IV-IV族混晶	Group IV crystals and alloys	澤野憲太郎（東京都市大）
	15. 6	IV族系化合物	Group IV Compound Semiconductors	矢野裕司（筑波大）
	15. 7	エピタキシーの基礎	Fundamentals of epitaxy	杉山正和(東大)
	15. 8	結晶評価，不純物・結晶欠陥	Crystal evaluation, impurities and crystal defects	深田直樹（物材機構)，沓掛健太朗(東北大)
16 非晶質・微結晶 Amorphous and Microcrystalline Materials	16. 1	基礎物性・評価	Fundamental properties and their evaluation in disordered materials	吉田憲充(岐阜大)，梶原浩一（首都大）
	16. 2	プロセス技術・デバイス	Processing technologies and devices	大平圭介（北陸先端大)，傍島靖（阪大）
	16. 3	シリコン系太陽電池	Bulk, thin-film and other silicon-based solar cells	小出直城（シャープ)，寺川朗（パナソニック)，石河泰明（奈良先端大）
17 ナノカーボン Nanocarbon Technology	17. 1	成長技術	Growth technology	佐藤信太郎（富士通研)，野内亮（大阪府立大)，吹留博一（東北大)，長汐晃輔（東大)，前橋兼三(農工大)，神田晶申（筑波大)，田中丈士（産総研)，千足昇平（東大)，藤井健志（富士電機）
	17. 2	構造制御・プロセス	Structural control and process	
	17. 3	新機能探索・基礎物性評価	Exploration of new functions and evaluation of basic properties	
	17. 4	デバイス応用	Device applications	
合同セッションK 「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」 Joint Session K "Wide bandgap oxide semiconductor materials and	薄膜・表面の6. 3酸化物エレクトロニクス，6. 4薄膜新材料，および結晶工学15. 2 II-VI族結晶および多元系結晶で企画した合同セッションです.		This is a joint session of 6.3 Oxide-based electronics, 6.4 New thin film materials in 6. Thin Films and Surfaces and 15.2 II-VI-group crystals and multicomponent crystals in 15. Crystal Engineering.	廣瀬靖(東大)，神吉輝夫（阪大)，中村吉伸（東大)，土屋哲男（産総研)，阿部友紀（鳥取大)，田橋正浩（中部大)，川原村敏幸（高知工科大）

2015年秋季学術講演会のご案内

応用物理学会　第76回秋季学術講演会

期間：2015年9月13日（日）～9月16日（水）
場所：名古屋国際会議場
（名古屋市熱田区熱田西町1番1号）

応物初の国際会議場利用！

登壇申込、参加申込の受付開始は5月中頃を予定しております。
登壇申込締切は6月中頃を予定しております。
随時、最新情報を掲載いたしますので、詳しくは応用物理学会ホームページをご覧ください。

応用物理学会　講演会ホームページ：https://www.jsap.or.jp/activities/annualmeetings/index.html
お問い合わせ先　：meeting@jsap.or.jp（応用物理学会講演会担当）

■ 講 演 会 運 営 関 係

本部(応用物理学会)

会長	河田 聡 (阪大)	
副会長	保立 和夫 (東大)	益 一哉 (東工大)
	久間 和生 (内閣府)	
講演会企画運営委員長	民谷 栄一 (阪大)	
講演会企画運営副委員長	馬場 俊彦 (横国大)	

現地実行委員(東海大学)

顧問	松前 達郎 (総長)	松前 義昭 (理事長・副総長)
	髙野 二郎 (副総長)	山田 清志 (学長)
	川上 哲太朗 (副学長・教学部長)	平野 葉一 (副学長・学長室長)
	山下 泰裕 (副学長)	吉田 一也 (副学長・工学部長)
アドバイザー	内田 裕久 (工学部・第49回実行委員長)	内田 晴久 (教養学部・教育支援センター所長・第57回実行委員長)
	利根川 昭 (理学部・学長室次長)	山口 滋 (大学院総合理工学研究科長)
	石原 良美 (理学部長・大学院理学研究科長)	磯村 雅夫 (大学院工学研究科長)
	安達 建夫 (事務部長)	島貫 憲夫 (事務部次長・業務管理課長)
	石丸 明弘 (研究推進部次長)	久保田 美明 (総合情報センター次長)
	薩野 耕治 (事務課長)	有松 重雄 (ファシリティ課長)
	中村 直人 (教学部湘南教務課長)	緒方 友一 (事務課会計担当課長)
実行委員長	木村 英樹 (工学部・チャレンジセンター所長)	
実行副委員長	庄 善之 (工学部)	
総務	淺香 隆 (工学部)	秋山 泰伸 (工学部)
	樋口 昌史 (工学部)	藤川 知栄美 (工学部)
	佐藤 正志 (工学部)	遊部 雅生 (工学部)
会計	桑畑 周司 (工学部)	小林 清輝 (工学部)
会場	松村 義人 (工学部)	千葉 雅史 (理学部)
	小栗 和也 (教養学部)	葛巻 徹 (工学部)
	岡田 工 (チャレンジセンター)	安森 偉郎 (教育研)
シンポジウム	内田 晴久 (教養学部)	四方 周輔 (理学部)
	木村 英樹 (工学部)	岡田 工 (チャレンジセンター)
展示会・ポスター	室谷 裕志 (工学部)	渋谷 猛久 (工学部)
懇親会	功刀 義人 (工学部・キャリア支援センター次長)	沖村 邦雄 (工学部)

応用物理学会特別シンポジウム

入場無料

世界一行きたい科学広場





in ***東海大学湘南キャンパス 2015***

第一部　シンポジウム (9:50-10:50) 会場　2N-101教室
1：開会の言葉 （東海大学　岡田工、内田晴久）
2：今回のシンポジウムについて （福井大学大学院　葛生伸）
3：学生による子ども向けの体験実験教室（東海大学　四方周輔）
4：これからのリフレッシュ理科教室について
―フェーズチェンジの試み―（福岡大学　平松信康）
5：これからの理科教育が抱える課題 （東海大学　滝川洋二）
第二部　科学広場と科学ショー (11:00-15:00) 会場：松前記念館講堂
質疑討論（15:00-15:30））

東海大学教授
滝川洋二先生



実験セット
プレゼント

実におもしろい実験ショー
(12:00-13:00)

2015. 3. 14 (土)

時間：　11：00～15：00
主催：　応用物理学会
共催：　東海大学
　　応用物理学会応用物理教育分科会
　　応用物理学会人材育成委員会
会場：　東海大学湘南キャンパス
　　松前記念館講堂
対象：　幼児（保護者同伴）～小・中・高校生、一般

文部科学省
地(知)の拠点

東海大学

駐車場はございませんので、公共交通機関をご利用ください。

応用物理学会特別シンポジウム

世界一行きたい科学広場 in 東海大学湘南キャンパス　2015

主催：　応用物理学会
共催：　東海大学
　　応用物理学会応用物理教育分科会
　　応用物理学会人材育成委員会

実験セット プレゼント

東海大学教授 滝川洋二先生の
実におもしろい科学ショー



滝川洋二先生　プロフィール

東海大学教授。NPO法人ガリレオ工房理事長、NPO法人理科カリキュラムを考える会理事長。科学の楽しさを広める研究をしており、各地の科学イベントを手掛ける。TVドラマ「ガリレオ」や映画「容疑者Xの献身」の実験の監修のほか、日本テレビ系列「世界一受けたい授業」など、テレビ出演も増えています。滝川編『理科読をはじめよう』岩波書店2010年3月　滝川他編『発展コラム式中学理科の教科書』講談社ブルーバックス2008年3月他など著書多数。2005年文部科学大臣表彰（科学技術賞・理解増進部門）



東海大学湘南キャンパスへの交通アクセス詳細
小田急線(新宿より快速急行約60分、小田原より約25分)「東海大学前」駅下車徒歩約15分、
またはJR東海道線「平塚」駅下車「東海大学行き」または「秦野駅行き」バス(約30分)で「東海大学正門前」下車徒歩約5分



お問い合わせ

世界一行きたい科学広場in東海大学湘南キャンパス事務局（東海大学内）
担当：チャレンジセンター　岡田(TEL 0463-58-1211)

文部科学省 地(知)の拠点

東海大学

（公社）応用物理学会　特別シンポジウム

かながわ発！
スマートエネルギー革命

主宰：　公益社団法人 応用物理学会
共催：　応用物理学会エネルギーシステム研究会●神奈川県●東海大学

3月12日（木）　13:00-16:50
東海大学 湘南校舎 松前記念館講堂

参加無料

シンポジウム開催イントロダクトリートーク
東海大工学部・チャレンジセンター ● 木村英樹

スマートエネルギー社会へ！　かながわの挑戦
神奈川県産業労働局エネルギー部 ● 松浦治美

太陽電池が拓くスマート社会
パナソニックグループ エコソリューションズ社 ● 羽賀孝裕

水素がもたらすスマート社会の未来
水素エネルギー製品研究試験センター ● 中村　博

FCEVとEV開発の最前線
日産自動車株式会社総合研究所 ● 荒井孝之

水素エネルギーの大規模貯蔵運搬技術
千代田化工建設株式会社 ● 岡田佳巳

水素エネルギーの普及で動き出す
スマート社会とエネルギー革命
東海大学工学部 ● 内田裕久

総合討論・質疑応答・クロージングリマーク
東京大学工学部・応用物理学会エネルギーシステム研究会 ● 杉山正和

大会期間中、最新型のソーラーカーおよび FCV「MIRAI」 を展示会会場にて展示予定！

会場アクセス：　http://www.u-tokai.ac.jp/info/traffic_map/shared/pdf/shonan_campus.pdf
※）駐車場はありませんので、公共交通機関をご利用ください。
問い合わせ：　応用物理学会・エネルギーシステム研究会　email：　uchida@tokai.ac.jp

To-Collabo
Tokai university Community linking laboratory
文部科学省 地（知）の拠点

第62回応用物理学会春季学術講演会　特別シンポジウム

日本のモノづくり再生に向けた産学官共鳴場の創成を目指して

－産学協働研究会設立シンポジウム－

期日：2015年3月12日（木）13：30～17：30
会場：東海大学湘南キャンパス　6号館6B-102教室（応物学会講演会場）
参加費：無料（事前登録不要）

いま危機に瀕している応物学会産学協働の復活のために、本気と本音で議論します。

プログラム：

- 開催挨拶　保立和夫（東京大学、応用物理学会副会長）
- 産学協働研究会設立の経緯と構想
  末光眞希（東北大学、産学協働研究会運営副委員長）
- 日本のサイエンス・イノベーション・ファンド政策の根本的な誤り
  山口栄一（京都大学）
- 国家財政と科学技術イノベーション　－産学連携の観点から－
  片山健太郎（財務省）
- 産学連携の政策的意義　坂本修一（文部科学省）
- 半導体産業ビジネス現場から見た産学連携への一考察
  －化合物半導体デバイスにおける日米比較から学ぶ－
  乙木洋平（日立金属）
- 集積エレクトロニクス領域における産学連携拠点の現状とチャレンジ
  遠藤哲郎（東北大学）
- パネルディスカッション　テーマ「産学連携とファンド」　（全員）
- 閉会の挨拶　堂免　恵（湧志創造、産学協働研究会運営委員長）

主催：応用物理学会人材育成委員会（世話人　堂免恵）
問い合わせ先：
公益社団法人　応用物理学会事務局　苅米義弘
〒113-0034 東京都文京区湯島2-31-22 湯島アーバンビル7F
Tel:03-5802-0861，Fax:03-5802-6250，email:karigome@jsap.or.jp

応用物理学会　特別シンポジウム

応用物理分野で活躍する女性達

ー第3回　バイオエレクトロニクス編ー

女性研究者のキャリアパスは，ロールモデルの欠如や様々なライフステージにおける不安などのため，なかなか将来を見通すことが難しく，また相談できる研究者が近くにいないため　孤立しやすいといった様々な課題を個々の研究者が抱えています．本シンポジウムは，科学・技術研究における多様性やリーダーシップの重要性について多角的に考え，また女性研究者とのコミュニケーションの機会を提供することで，応用物理研究コミュニティーが直面する様々な障壁へのヒントとなることを願って企画するものです．

日時　2015年 3月13日（金） 9:00〜12:00

会場　東海大学　湘南キャンパス（春季学術講演会　B3会場）

プログラム

9:00- 9:05	**趣旨説明**	**高井 まどか**（東大）
9:05- 9:10	**会長あいさつ**	**河田 聡**（応用物理学会会長／阪大）
9:10- 9:30	**金属微粒子二次元シートによるバイオインターフェイスの高分解能蛍光観察**	**玉田 薫**（九州大）
9:30- 9:50	**プラズモニックチップを用いた高感度蛍光検出法のバイオイメージングとバイオセンシングへの応用**	**田和 圭子**（産総研）
9:50-10:00	**休　憩**	
10:00-10:40	**基調講演　我が国の科学技術イノベーション政策〜若手・女性活躍によるイノベーション創出〜**	**久間 和生**（総合科学技術・イノベーション会議 議員 ）
10:40-11:00	**神経細胞の機能計測とナノテクノロジ**	**河西 奈保子**（ＮＴＴ）
11:00-11:20	**シリコン微細加工で創る脂質二分子膜イオンチャネルチップ**	**平野 愛弓**（東北大）
11:20-11:30	**休　憩**	
11:30-12:00	**パネル討論**	

パネラー：**永松 愛子**（JAXA），**南谷 英美**（東大），**住友 弘二**（NTT），**山田 明**（東工大）

参加費無料

お問合せ先

公益社団法人　応用物理学会
担当：苅米　karigome@jsap.or.jp

The Japan Society of Applied Physics

The Japan Society of Applied Physics

第62回応用物理学会春季学術講演会 特別シンポジウム
（後援：JST研究開発戦略センター）

フォノンエンジニアリング
ナノスケール熱制御のための新しい材料科学、理論・シミュレーション、計測技術、およびこれによるデバイス革新

日時：　2015年 3月 14日 (土) 8:45～15:00
会場：　第62回　応用物理学会春季学術講演会
東海大湘南キャンパス(神奈川県平塚市北金目4-1-1)
B2会場　(6B-102教室)
世話人　粟野祐二(慶大理工)、丸山茂夫(東大工)、竹内恒博(豊田工大工)

プログラム

1. はじめに	粟野 祐二（慶大理工）
2. ナノ構造や界面によるフォノン輸送制御	塩見 淳一郎（東大工, JSTさきがけ）
3. 最低熱伝導率の観点に基づく低熱伝導率材料の候補物質	桂 ゆかり[1]，高木 英典[1,2]，押山 淳[1]（[1]東大工 [2]MPI 固体研）
4. フォノンの波動性を利用した熱伝導制御	野村 政宏（東大生研, 東大ナノ量子機構）
5. 摂動分子動力学法による複雑結晶構造酸化物の格子熱伝導の数値解析	吉矢 真人[1,2]，藤井 進[1]，宮内 洋平[1]，多田 昌浩[1]，柳樂 知也[1]，安田 秀幸[1,3]（[1]大阪大工, [2]ファインセラミックスセンター，[3]京都大工）
6. ポーラス Si 薄膜の熱伝導	宮崎 康次（九州工大工）
7. パルス光加熱サーモリフレクタンス法でみる薄膜および界面での熱伝導	八木 貴志，竹歳 尚之，馬場 哲也（産総研）
8. 材料の観点から、熱電材料	森　孝雄（物材機構，筑波大学）
9. NEMS技術とフォノンエンジニアリング	水田 博[1,2]，Manoharan Muruganathan[1]，小矢野 幹夫[1]，土屋 良重[2]（[1]北陸先端大，[2]サザンプトン大）
<<昼　食　12:15～13:00>>	
10. ナノスケール熱制御によるデバイス革新	馬場　寿夫（JST-CRDS）
11. 抵抗変化メモリ ReRAM におけるナノスケール熱制御	秋永 広幸，島 久（産総研）
12. 表面プラズモンを利用した熱アシスト磁気記録	中川 活二，芦澤 好人，塚本 新（日大理工）
13. 熱配慮設計によるデバイス高性能化・高機能化戦略	内田 建，高橋 綱己（慶大理工, JST-CREST）
14. フォノンエンジニアリングの電子機器実装への応用	畠山　友行，石塚　勝（富山県立大工）
15. まとめ	丸山　茂夫（東大工）

参加費 ： 無料（応用物理学会の非会員の方でも 、どなたでもご参加可能）
※本シンポジウム以外の講演会を聴講される際は、講演会総合受付にて
参加費のお支払いをお願い致します。
申 込 ： 事前登録不要(当日直接会場へお越し下さい)
問い合わせ先: 応用物理学会講演会担当 meeting@jsap.or.jp

ランチョンセミナー

昼食無料

企業・団体によるランチョンセミナーが開催されます.
ランチョンセミナー参加者には先着順で昼食を無料でお配りいたします.

開催日	時間	会場	定員	主催企業・団体
3/11 (水)	12:15-13:00	B1	200	応用物理学会（APEX/JJAP）
		B3	100	クレステック
3/12 (木)		B3	100	エリオニクス
		B4	100	WITec
		B1	100	シュプリンガー・ジャパン
		B6	100	物質・材料研究機構（NIMS）
3/13 (金)		B5	100	サーモ理工 / アステック

各セミナーの詳細につきましては，**次ページ以降のご案内** をご覧ください.

参加方法

ランチョンセミナー参加ご希望の方はRegistration内の「ランチョンセミナー参加受付」で参加票をご提示ください. その場で「整理券」をお渡しします.
その整理券に**お名前，ご所属，メールアドレスをご記入の上**，昼12時10分までにランチョンセミナー会場へお越しください.

整理券の配布

参加票をご提示いただき，整理券を配布いたします.
◆ 配布場所：Registration内 「ランチョンセミナー参加受付」
◆ 配布時間：各日　8:00～11:00
※先着順.　整理券が無くなり次第，受付を終了いたします.

注意事項

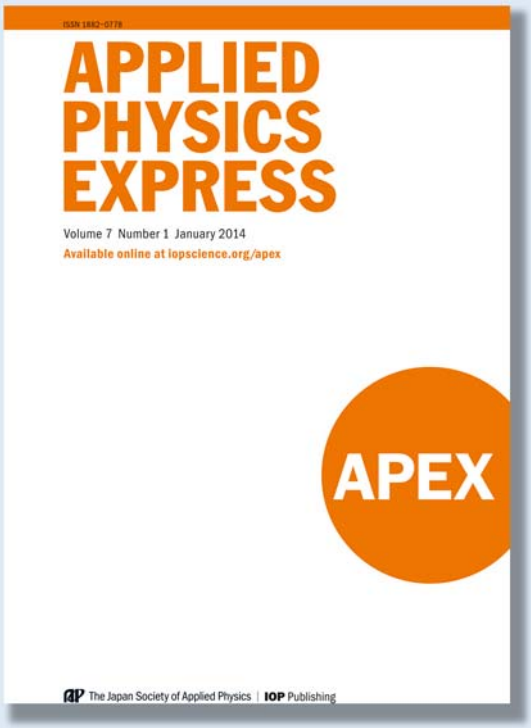
「整理券」をお持ちの方は，お昼の12時10分までに各セミナー会場で昼食と引き換えてください.
12時10分を過ぎると「整理券」は無効になり，「整理券」をお持ちでないセミナー参加者へ昼食をお配りいたします.

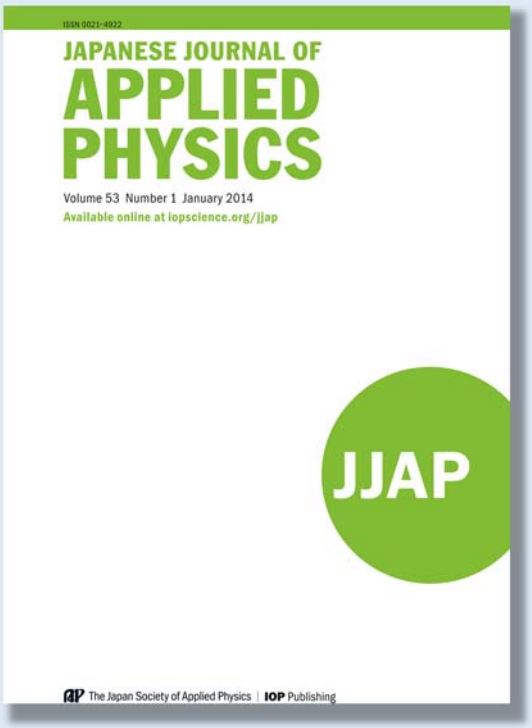
整理券をお持ちでない方

12時10分までに各セミナー会場に直接お越しください.
昼食の残りがある場合に限り，先着順で昼食をお配りいたします.
昼食が無くなった場合でも，ご入場いただきセミナーに
参加していただけます.









APEX/JJAP
Luncheon Seminar

日時: 2015年3月11日（水）12:15 - 13:00
会場: B1（6B-101 / 6号館1階）

「英語論文の書き方と国際出版の必要性」

サンドゥー・アダルシュ（Adarsh SANDHU）
豊橋技術科学大学・教授

＜講演内容＞
なぜ論文を投稿し、出版したいのか／テンスに悩まない技／IMRAD式による論文の書き方をご説明します。
高品質なカバーレターの重要性／出版された論文は引用されますか？引用率向上の技。

Dr. Matthew Salter
IOP Publishing, Publishing Manager Asia-Pacific

Journals sites **at iopscience.org/apex** and **iopscience.org/jjap**

Published in partnership with
The Japan Society of Applied Physics

CRESTEC

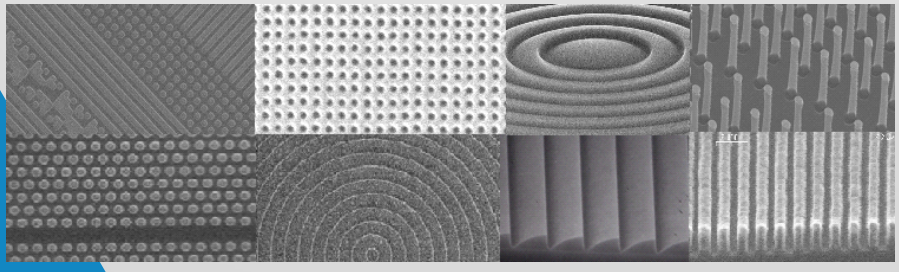
株式会社クレステックの
応用物理学会ランチョンセミナー

■ 会場: B3 （6B-103）
■ 日時: 3月11日（水）12:15～13:00



講演内容：

・電子線描画装置について
・EB描画の受託加工
・学会発表でうまく話すコツ



Action for innovation ELIONIX

第 62 回応用物理学会春季学術講演会

エリオニクス
ランチョンセミナーのご案内

日　時

2015年 3月12日(木) 12:15～13:00

会　場

B3　6B-103

演　目

極表面の計測分析セミナー
～表面性状、表面力、ナノ硬さ～

http://www.elionix.co.jp

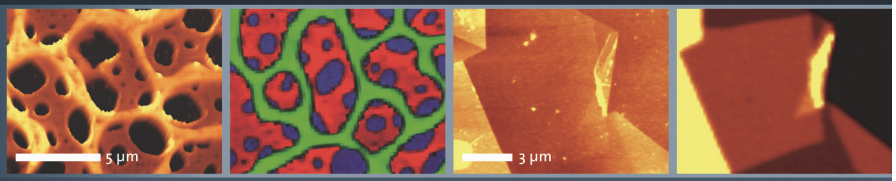
株式会社 エリオニクス

[本社・工場・ショールーム] 〒192-0063 東京都八王子市元横山町3-7-6　TEL.042-626-0611　FAX.042-626-6136
[ナノテクシステムセンター] 〒192-0012 東京都八王子市左入町279　TEL.042-692-0610　FAX.042-692-0690
[西 日 本 営 業 所] 〒563-0025 大阪府池田市城南1丁目9-22グリーンプラザ2F　TEL.072-754-6999　FAX.072-754-6990

WITec
focus innovations

AFM/共焦点ラマン顕微鏡
alpha300AR





ガラス基板上のブレンドポリマー　左：AFM凹凸像　右：共焦点ラマン像

Si基板上のグラフェンフレーク　左：AFM凹凸像　右：共焦点ラマン像

WITecランチョンセミナーのご案内

日　時　2015年3月12日（木）12:15～13:00

会　場　B4 (6B-104)

演　題　「AFM/SEM+ラマン」という提案
～表面形状と化学特性から拡がる試料評価

PITTCON® Editors' GOLD AWARD　R&D 100 2011　Microscopy TODAY INNOVATION AWARD　PRISM AWARDS

WITec Headquaters
WITec GmbH Lise-Meitner-Str. 6,89081 Ulm, Germany

WITec株式会社
〒213-0012　神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP西713B
TEL 044-819-7773 info@witec-instruments.biz

www.witec.de

Springer

springer.com

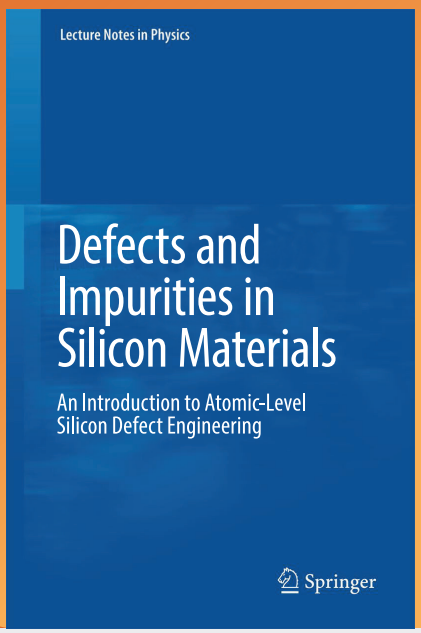
2015年 第62回 応用物理学会春季学術講演会

Springer ランチョンセミナー

Your Partner in Publishing

日時: 3月12日(木)12:15～13:00

会場: 東海大学 湘南キャンパス 6号館1階 B1会場(6B-101)



テーマ

英文書籍の執筆

静岡理工科大学 吉田 豊 先生



書籍は、長年の研究の集大成として世に広める役割を果たします。それが英文であることで読者層は世界へ広がります。さらに書籍の電子化による世界への普及の速さは、研究発信にとっても魅力的な一面になりつつあります。
本セミナーでは、英文書籍を執筆することの利点やプロセス、どのようなアイデアや業績が書籍をまとめるのに役に立つか、Springerの著者が豊富な経験を共有します。

シュプリンガー・ジャパン株式会社 マーケティング部 ● **所在地:** 〒101-0065 東京都千代田区西神田3-8-1 千代田ファーストビル東館
● **電話:** 03-6831-7013 ● **ファックス:** 03-6831-7006 ● **電子メール:** market@springer.jp ● **グローバル・サイト:** springer.com ● **ローカル・サイト:** springer.jp
● **Twitter:** twitter.com/SpringerJapan ● **Facebook:** facebook.com/SpringerJapan ● **YouTube:** youtube.com/SpringerJapanVideos

OPEN ACCESS JOURNAL

STAM Science and Technology of Advanced Materials

第 62 回応用物理学会春季学術講演会 ランチョンセミナー：STAM 誌が注目する研究領域

マテリアルズゲノム―世界動向と日本

日　時　3 月 12 日（木）12:15 - 13:00

会　場　B6（6B-106, 東海大学 6 号館 1 階）

主　催　独立行政法人 物質・材料研究機構 National Institute for Materials Science　EMPA　IOP Publishing

参加方法等詳細は▶ http://meeting.jsap.or.jp/luncheon.html

2011 年 6 月に発表された米国大統領イニシアチブの一つ「マテリアルズゲノムイニシアチブ」では、材料開発のスピードアップを達成すべく、材料研究開発に用いられる、計算機シミュレーション、実験的手法、およびデータをツールとしてそれらの高度化をはかることが一つの目標となっている．このことを背景とし、ハイスループット第一原理計算、ハイスループット材料合成・分析、マルチスケールモデリング、材料データベースなどの活動に注目が集まっている．これらの研究活動は、コンピュータによる系統的かつ高速な情報処理によって、多種多様かつ大量のデータを効果的に利用する「データ活用型研究」を包含することが特徴であり、また狙い所でもある．講演では、こうした研究活動の俯瞰の試みについて報告し、将来の可能性について議論したい．

司 会：目 義雄／ STAM 編集副委員長／物質・材料研究機構先端材料プロセスユニット長

12:15	編集委員長挨拶（吉田 豊信／物質・材料研究機構フェロー）
12:20	STAM Updates（山口 周／ STAM 編集副委員長／東京大学教授）
12:25	講演『マテリアルズゲノム―世界動向と日本』 （門平 卓也／物質・材料研究機構調査分析室）
12:50	質疑応答

講演者／門平 卓也

独立行政法人物質・材料研究機構調査分析室主任エンジニア．
2007 年 2 月に NIMS 入所後、研究企画業務に従事．近年、米国マテリアルズゲノムイニシアチブを端緒として活発化するデータを活用する材料研究に関して、海外動向調査を継続的に進めている．NIMS で連続開催された理事長主催勉強会シリーズ「マテリアルズ・インフォマティクス」の世話人．



iopscience.org/stam

第 62 回 応用物理学会春季学術講演会

㈱サーモ理工／アステック㈱

ランチョンセミナーのご案内

日　時

2015 年 3 月 13 日（金）　12：15～13：00

会　場

B５　　６号館　　１階　（6B-105）

演　目

◆　赤外線加熱と応用例　　㈱サーモ理工

◆　プラズマ中ガス質量分析、最新二次イオン質量分析計　　アステック㈱

http://www.kagaku.com/thermo/

熱と共に歩む
株式会社サーモ理工

〒181-0013
東京都三鷹市下連雀8-7-3三鷹ハイテクセンター
TEL 0422-76-2511　　FAX 0422-76-2514
E-mail：sekigai@thermo-r.co.jp

http://www.astechcorp.co.jp

アステック株式会社

〒169-0075
東京都新宿区高田馬場4-39-7　高田馬場21ビル
TEL03-3366-0818　　FAX 03-3366-3710
E-mail：science@astechcorp.co.jp

応用物理学会関係サイト一覧

＜2015年第62回応用物理学会春季学術講演会に関するサイト＞



第62回応用物理学会春季学術講演会ホームページ
2015年第62回応用物理学会春季学術講演会に関する全ての情報がまとまっています.
http://meeting.jsap.or.jp/

講演会プログラムホームページ (Confit)


講演会のプログラムをパソコンで確認する場合はこちらをご参照ください.
https://confit.atlas.jp/jsap2015s

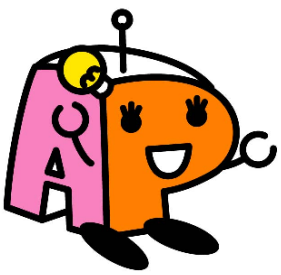
プログラムHP

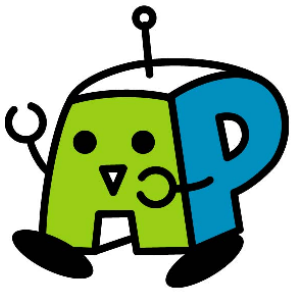
＜応用物理学会全体に関するサイト＞

応用物理学会ホームページ
応用物理学会に関する全ての情報がまとまっています.
http://www.jsap.or.jp

応用物理学会Facebook
講演会期間中は，講演会に関する情報をいち早く確認することができます．是非ご覧ください.
https://www.facebook.com/OYOBUTURI

応用物理学会Twitter
講演会期間中は，講演会に関する情報をいち早く確認することができます．是非ご覧ください.
https://twitter.com/JSAPmeeting





第15回応用物理学会業績賞受賞記念講演 / 15th JSAP Outstanding Achievement Award Lecture

第15回応用物理学会業績賞受賞記念講演 / 15th JSAP Outstanding Achievement Award Lecture　口頭講演

	3月11日(水)　14:30 - 15:15				
招待	14:30 - 15:15	11p-E1-1	「第15回応用物理学会業績賞(教育業績)受賞記念講演」(45分) ネット時代の応物コミュニケーション	○佐藤 勝昭[1]	1.科学技術振興機構
	3月12日(木)　14:00 - 14:45				
招待	14:00 - 14:45	12p-A23-1	「第15回応用物理学会業績賞(研究業績)受賞記念講演」(45分) 大容量メモリ技術の産業展開への貢献と三次元集積化技術の先駆的研究	○小柳 光正[1]	1.東北大学
	3月12日(木)　16:00 - 16:45				
招待	16:00 - 16:45	12p-A10-8	「第15回応用物理学会業績賞(研究業績)受賞記念講演」(45分) フォトニック結晶工学の進展と今後の展望	○野田 進[1]	1.京大

特別シンポジウム

応用物理分野で活躍する女性達　−第3回バイオエレクトロニクス編− / Women in Applied Physics - Part III: Bioelectronics -

	3月13日(金)　9:00 - 12:00				
	9:00 - 9:05	13a-B3-1	趣旨説明	○高井 まどか[1]	1.東京大学
	9:05 - 9:10	13a-B3-2	会長挨拶	○河田 聡[1]	1.大阪大学
	9:10 - 9:30	13a-B3-3	金属微粒子二次元シートによるバイオインターフェイスの高分解能蛍光観察	○玉田 薫[1]	1.九州大学
	9:30 - 9:50	13a-B3-4	プラズモニックチップを用いた高感度蛍光検出法のバイオイメージングとバイオセンシングへの応用	○田和 圭子[1]	1.産業技術総合研究所
	9:50 - 10:00	13a-B3-4.1	休憩		
	10:00 - 10:40	13a-B3-5	我が国の科学技術イノベーション政策　～若手・女性活躍によるイノベーション創出～	○久間 和生[1]	1.総合科学技術・イノベーション会議
	10:40 - 11:00	13a-B3-6	神経細胞の機能計測とナノテクノロジ	○河西 奈保子[1]	1.NTT
	11:00 - 11:20	13a-B3-7	シリコン微細加工で創る脂質二分子膜イオンチャネルチップ	○平野 愛弓[1]	1.東北大学
	11:20 - 11:30	13a-B3-7.1	休憩		
	11:30 - 12:00	13a-B3-8	パネル討論	○高井 まどか[1], 永松 愛子[2], 南谷 英美[2], 住友 弘二[2], 山田 明[4]	1.東京大学, 2.宇宙航空研究開発機構, 3.NTT, 4.東京工業大学

フォノンエンジニアリング：ナノスケール熱制御のための新しい材料科学、理論・シミュレーション、計測技術、およびこれによるデバイス革新 / PHONON ENGINEERING: material science, theory/simulation and measurement technologies for Nano-scale thermal management and device innovation

	3月14日(土)　8:45 - 15:00				
	8:45 - 8:55	14a-B2-1	はじめに	○粟野 祐二[1]	1.慶大理工
	8:55 - 9:20	14a-B2-2	ナノ構造や界面によるフォノン輸送制御	○塩見 淳一郎[1,2]	1.東大工, 2.JSTさきがけ
	9:20 - 9:45	14a-B2-3	最低熱伝導率の観点に基づく低熱伝導率材料の候補物質	○桂 ゆかり[1], 高木 英典[1,2], 押山 淳[1]	1.東大工, 2.MPI 固体研
	9:45 - 10:10	14a-B2-4	フォノンの波動性を利用した熱伝導制御	○野村 政宏[1,2]	1.東大生研, 2.東大ナノ量子機構
	10:10 - 10:35	14a-B2-5	摂動分子動力学法による複雑結晶構造酸化物の格子熱伝導の数値解析	○吉矢 真人[1,2], 藤井 進[1], 宮内 洋平[1], 多田 昌浩[1], 柳樂 知也[1], 安田 秀幸[1,3]	1.大阪大工, 2.ファインセラミックスセンター, 3.京都大工
	10:35 - 11:00	14a-B2-6	ポーラス Si 薄膜の熱伝導	○宮崎 康次[1]	1.九州工大工
	11:00 - 11:25	14a-B2-7	パルス光加熱サーモリフレクタンス法でみる薄膜および界面での熱伝導	○八木 貴志[1], 竹歳 尚之[1], 馬場 哲也[1]	1.産総研
	11:25 - 11:50	14a-B2-8	材料の観点から、熱電材料	○森 孝雄[1,2]	1.物材機構, 2.筑波大学
	11:50 - 12:15	14a-B2-9	NEMS技術とフォノンエンジニアリング	○水田 博[1,2], Manoharan Muruganathan[1], 小矢野 幹夫[1], 土屋 良重[2]	1.北陸先端大, 2.サザンプトン大
	12:15 - 13:00	14a-B2-9.1	昼食		
	13:00 - 13:10	14a-B2-10	ナノスケール熱制御によるデバイス革新	○馬場 寿夫[1]	1.JST-CRDS
	13:10 - 13:35	14a-B2-11	抵抗変化メモリ ReRAM におけるナノスケール熱制御	○秋永 広幸[1], 島 久[1]	1.産総研
	13:35 - 14:00	14a-B2-12	表面プラズモンを利用した熱アシスト磁気記録	○中川 活二[1], 芦澤 好人[1], 塚本 新[1]	1.日大理工
	14:00 - 14:25	14a-B2-13	熱配慮設計によるデバイス高性能化・高機能化戦略	○内田 建[1,2], 高橋 綱己[1,2]	1.慶大理工, 2.JST-CREST
	14:25 - 14:50	14a-B2-14	フォノンエンジニアリングの電子機器実装への応用	○畠山 友行[1], 石塚 勝[1]	1.富山県立大工
	14:50 - 15:00	14a-B2-15	まとめ	○丸山 茂夫[1]	1.東大工

世界行きたい科学広場in 東海大学湘南キャンパス　第一部：シンポジウム / Science Square in Shonan Campus of Tokai University　Part 1 symposium

3月14日(土)　9:00 - 10:50

	9:50 - 9:55	14a-F1-1	開会の言葉	○岡田 工[1], 内田 晴久[1]	1.東海大
	9:55 - 10:05	14a-F1-2	今回のシンポジウムについて	○葛生 伸[1]	1.福井大院工
	10:05 - 10:20	14a-F1-3	学生による子ども向けの体験実験教室	○四方 周輔[1]	1.東海大理
	10:20 - 10:35	14a-F1-4	これからのリフレッシュ理科教室について?フェーズチェンジの試みー	○平松 信康[1]	1.福岡大
	10:35 - 10:50	14a-F1-5	これからの理科教育が抱える課題	○滝川 洋二[1]	1.東海大

世界行きたい科学広場in 東海大学湘南キャンパス　第二部：科学広場と科学ショー / Science Square in Shonan Campus of Tokai University　Part 2 Science Square and Science Shows

3月14日(土)　11:00 - 15:00

	11:00	14a-E1-1	科学広場開場		
	12:00 - 13:00	14a-E1-2	「実に面白い実験ショー」青色発光ダイオードの ひみつ～青色LEDとノーベル賞～	○滝川 洋二[1]	1.東海大
	15:00	14a-E1-3	閉場		
	15:00 - 15:30	14a-E1-4	質疑討論		

かながわ発！　スマートエネルギー革命 / Smart Energy Revolution form KANAGAWA

3月12日(木)　13:00 - 16:45

	13:00 - 13:10	12a-E1-1	シンポジウム開催イントロダクトリートーク	○木村 英樹[1]	1.東海大工学部・チャレンジセンター
	13:10 - 13:40	12a-E1-2	スマートエネルギー社会へ！　かながわの挑戦	○松浦 治美[1]	1.神奈川県産業労働局エネルギー部
	13:40 - 14:10	12a-E1-3	太陽電池が拓くスマート社会	○羽賀 孝裕[1]	1.パナソニックグループ エコソリューションズ社
	14:10 - 14:40	12a-E1-4	水素がもたらすスマート社会の未来	○中村 博[1]	1.水素エネルギー製品研究試験センター
	14:40 - 14:55	12a-E1-4.1	休憩		
	14:55 - 15:25	12a-E1-5	FCEVとEV開発の最前線	○荒井 孝之[1]	1.日産自動車株式会社総合研究所
	15:25 - 15:55	12a-E1-6	水素エネルギーの大規模貯蔵運搬技術	○岡田 佳巳[1]	1.千代田化工建設株式会社
	15:55 - 16:25	12a-E1-7	水素エネルギーの普及で動き出すスマート社会とエネルギー革命	○内田 裕久[1]	1.東海大学工学部
	16:25 - 16:45	12a-E1-8	総合討論・質疑応答・クロージングリマーク	○杉山 正和[1]	1.東京大学工学部・応用物理学会エネルギーシステム研究会

産学協働研究会設立シンポジウム-日本のモノづくり再生に向けた産学官共鳴場の創成を目指して- / Kickoff Symposium for Group of Research and Joint-Effort on Industry-Academia Partnership

3月12日(木)　13:30 - 17:30

	13:30 - 13:35	12p-B2-1	開会挨拶	○保立 和夫[1]	1.東京大学
	13:35 - 13:50	12p-B2-2	産学協働研究会設立の経緯と構想	○末光 眞希[1]	1.東北大学
	13:50 - 14:30	12p-B2-3	日本のサイエンス・イノベーション・ファンド政策の根本的な誤り	○山口 栄一[1]	1.京都大学大学院総合生存学館
	14:30 - 14:50	12p-B2-4	国家財政と科学技術イノベーション－産学連携の観点から－	○片山 健太郎[1]	1.財務省主計局文部科学第四係主査
	14:50 - 15:10	12p-B2-5	産学連携の政策的意義	○坂本 修一[1]	1.文部科学省産業連携地域支援課長
	15:10 - 15:25	12p-B2-5.1	休憩		
	15:25 - 15:55	12p-B2-6	半導体産業ビジネス現場から見た産学連携への一考察―化合物半導体デバイスにおける日米比較から学ぶー	○乙木 洋平[1]	1.日立金属
	15:55 - 16:25	12p-B2-7	集積エレクトロニクス領域における産学連携拠点の現状とチャレンジ	○遠藤 哲郎[1]	1.東北大学 国際集積エレクトロニクス研究開発センター センター長
	16:30 - 17:20	12p-B2-8	パネルディスカッション テーマ「産学連携とファンド」		
	17:20 - 17:30	12p-B2-9	閉会の挨拶	○堂免 恵[1]	1.湧志創造

分科企画シンポジウム / Symposium

3 光・フォトニクス

フォトニクスと量子情報技術の融合へ向けて / Quantum Photonics: Toward a new paradigm of quantum information technology

3月11日(水)　13:30 - 17:15

招待	13:30 - 13:45	11p-B4-1	**オープニング**	**○根本 香絵[1]**	**1.国立情報学研究所**
招待	13:45 - 14:15	11p-B4-2	**量子ドットを用いた量子情報素子の現状と期待**	**○荒川 泰彦[1,2]**	**1.東大ナノ量子機構, 2.東大生研**
招待	14:15 - 14:45	11p-B4-3	**光子を用いた量子計測**	**○竹内 繁樹[1]**	**1.京大工**
招待	14:45 - 15:15	11p-B4-4	**量子鍵配送システムとそれを実現するフォトニクス技術**	**○南部 芳弘[1]**	**1.NECスマエネ研**

	15:15 - 15:30		休憩/Break		
招待	15:30 - 16:00	11p-B4-5	**半導体量子ドットによる単一光子および量子もつれ光源**	**○熊野 英和[1], 中島 秀朗[1], 末宗 幾夫[1]**	**1.北大電子研**
	16:00 - 16:15	奨 11p-B4-6	超伝導磁束量子ビットに結合したNV中心の磁場印加による寿命の改善	○松崎 雄一郎[1], シャオボ ズー[1], 角柳 孝輔[1], 樋田 啓[1], 下岡 孝明[2], 水落 憲和[2], 根本 香絵[3], 仙場 浩一[4], ムンロー ウィリアム[1], 山口 浩司[1], 齊藤 志郎[1]	1.NTT 物性基礎研, 2.阪大基礎工, 3.国立情報学研究所, 4.情報通信研究機構
	16:15 - 16:30	奨 11p-B4-7	ダイヤモンドスピン縮退キュービットの任意状態生成	○三島 将太[1], 田中 統太[1], 幸村 雄介[1], 関口 雄平[1], 新倉 菜恵子[1], 小坂 英男[1]	1.横国大院工
招待	16:30 - 17:00	11p-B4-8	**ナノエミッタ-ナノフォトニクス結合系における光物質相互作用増強**	**○納富 雅也[1,2]**	**1.NTTナノフォトニクスセンタ, 2.NTT物性科学基礎研**
招待	17:00 - 17:15	11p-B4-9	**クロージング**	**○岩本 敏[1]**	**1.東大生研・ナノ量子機構**

6 薄膜・表面

斜め蒸着法, GLAD, STF等, シャドウイングによるナノ形態の制御と評価 / Fabrication and characterization of nano-structures prepared with advanced shadowing deposition systems

3月11日(水)　13:15 - 17:00

招待	13:15 - 14:00	11p-D9-1	**シャドウイングによるナノ形態制御技術の進展と課題**	**○鈴木 基史[1]**	**1.京大院・工**
招待	14:00 - 14:30	11p-D9-2	**3次元ナノテンプレートPLD法による遷移金属酸化物微細構造体創製**	**○服部 梓[1], 田中 秀和[1]**	**1.阪大産研**
	14:30 - 14:45	11p-D9-3	雰囲気ガスによる表面拡散の制御法の開発と明瞭なAgナノコラム形成への応用	○伊東 孝将[1], 中嶋 薫[1], 木村 健二[1], 鈴木 基史[1]	1.京大院工
招待	14:45 - 15:15	11p-D9-4	**反応性環境下での斜め堆積による化合物薄膜の離散的ナノ柱状構造形成**	**○井上 泰志[1], 高井 治[2]**	**1.千葉工大工, 2.関東学院大**
	15:15 - 15:30		休憩/Break		
招待	15:30 - 16:00	11p-D9-5	**異材界面に挿入したナノ要素集合薄膜の破壊基準**	**○澄川 貴志[1], 北村 隆行[1]**	**1.京大工**
招待	16:00 - 16:30	11p-D9-6	**斜め蒸着法を用いた無機光学素子**	**○高田 昭夫[1], 小池 伸幸[1], 高橋 英司[1]**	**1.デクセリアルズ(株)**
招待	16:30 - 17:00	E 11p-D9-7	**WO_3-NRs/$BiVO_4$ core-shell nanostructure for enhanced photocatalytic H_2 production**	**○Yuriy Pihosh[1], Kazuma Mawatari[1], Masahiro Tosa[2], Takehiko Kitamori[1]**	**1.University of Tokyo, 2.NIMS**

13 半導体

最先端CMOS技術とその将来展望 / Advanced CMOS Technology and Its Future Scope

3月11日(水)　13:15 - 17:30

	13:15 - 13:30	11p-B5-1	最先端CMOS技術とその将来展望	○最上 徹[1]	1.PETRA
招待	13:30 - 14:00	11p-B5-2	**3次元構造デバイスにおけるプラズマダメージ層形成モデル**	**○江利口 浩二[1], 斧 高一[1]**	**1.京大院工**
招待	14:00 - 14:30	11p-B5-3	**最先端CMOS加工におけるダメージの予測・制御技術**	**○久保井 信行[1], 深沢 正永[1], 辰巳 哲也[1]**	**1.ソニー(株)**
	14:30 - 14:45	11p-B5-4	先端電子デバイスエッチング技術とその将来展望	○田中 基裕[1], 安井 尚輝[1], 森本 未知数[1], 伊澤 勝[1]	1.日立ハイテク
	14:45 - 15:00		休憩/Break		
招待	15:00 - 15:30	11p-B5-5	**FinFETにおける特性ばらつきと低周波ノイズの抑制技術**	**○松川 貴[1], 福田 浩一[1], 柳 永勛[1], 塚田 順一[1], 山内 洋美[1], 遠藤 和彦[1], 大内 真一[1], 右田 真司[1], 水林 亘[1], 森田 行則[1], 太田 裕之[1], 昌原 明植[1]**	**1.産総研**
招待	15:30 - 16:00	11p-B5-6	**AC performance improvement by RMG module for 14nm FinFETs and beyond**	**○Mitsuhiro Togo[1], M. Joshi[1], H. V. Meer[1], C. Yong[1], B. Liu[1], X. He[1], X. Wu[1], S. Y. Mun[1], X. Zhang[1], D. Konduparthi[1], J. Lian[1], G. Bohra[1], W. H. Tong[1], C. Y. Xiao[1], D. Triyoso[1], E. Banghart[1], S. M. Pandey[1], A. Wei[1], R. Pal[1], R. Carter[1], M. H. Nam[1], M. Eller[1], S. Samavedam[1]**	**1.GLOBALFOUNDRIES**
招待	16:00 - 16:30	11p-B5-7	**シリコントライゲートナノワイヤトランジスタにおける特性ばらつき・電流ノイズ・閾値電圧シフトの系統的理解**	**○齋藤 真澄[1], 太田 健介[1], 田中 千加[1], 松下 大介[1], 沼田 敏典[1]**	**1.東芝研開セ**
招待	16:30 - 17:00	11p-B5-8	**次世代High-k メタルゲートプロセス**	**○吉田 尚美[1], アダム ブランド[1]**	**1.アプライドマテリアルズ**
招待	17:00 - 17:30	11p-B5-9	**Geチャネル High-k/メタルゲートMOSFET向けパッシベーションスキーム**	**○中村 源志[1], Kandabara Tapily[2], Robert Clark[2], David O'Meara[2], Steve Consiglio[2], Richard Gaylord[2], Cory Wajda[2], Gert Leusink[2], Tat Ngai[3], Dmitry Veksler[3], Chris Hobbs[3], Ken Matthews[3], David Gilmer[3], Paul Kirsch[3]**	**1.東京エレクトロン(株), 2.TEL Technology Center, America, LLC, 3.SEMATECH**

2 放射線

放射線オプティクス / Ionizing radiation optics

3月12日(木)　14:00 - 17:15

招待	14:00 - 14:30	12p-A19-1	**宇宙X線観測用望遠鏡**	**○松本 浩典[1]**	**1.名大KMI**
招待	14:30 - 15:00	12p-A19-2	**回折格子を用いたX線顕微法の開発**	**○矢代 航[1]**	**1.東北大多元研**
招待	15:00 - 15:30	12p-A19-3	**放射光X線ナノ集光技術の現状と将来展望**	**○山内 和人[1]**	**1.大阪大学**
	15:30 - 15:45		休憩/Break		
招待	15:45 - 16:15	12p-A19-4	**フレネルゾーンプレートを用いたX線顕微イメージング技術の開発**	**○竹内 晃久[1], 鈴木 芳生[1], 上杉 健太朗[1], 小田 政利[2]**	**1.JASRI / SPring-8, 2.NTT-AT**
招待	16:15 - 16:45	12p-A19-5	**中性子反射光学素子の開発とその応用**	**○日野 正裕[1]**	**1.京大原子炉**
招待	16:45 - 17:15	12p-A19-6	**X線天文・探査衛星に向けたマイクロマシン技術を用いた超軽量X線望遠鏡**	**○江副 祐一郎[1]**	**1.首都大理工物理**

3 光・フォトニクス

レーザーによる3次元造形技術の最先端から実用まで / Advanced and Practical 3D Fabrication Techniques Using Lasers

3月12日(木)　13:30 - 18:00

招待	13:30 - 14:30	12p-B6-1	光造形法の創作時顛末（発明想到経緯・当時の評価・特許4失策）	○小玉 秀男[1]	1.快友国際特許事務所
招待	14:30 - 15:00	12p-B6-2	マイクロ光造形・鋳型技術の進展と応用	○丸尾 昭二[1]	1.横国大院工
	15:00 - 15:15		休憩/Break		
招待	15:15 - 15:45	12p-B6-3	3Dプリンターで注目される粉末床溶融結合技術	○早野 誠治[1]	1.株式会社アスペクト
招待	15:45 - 16:15	12p-B6-4	フェムト秒レーザーを用いた透明固体内部加工	○松尾 繁樹[1]	1.芝浦工大工
招待	16:15 - 16:45	12p-B6-5	除去・付加複合フェムト秒レーザー3次元加工	○杉岡 幸次[1], Wu Dong[1], Xu Jian[1], Sima Felix[1], 緑川 克美[1]	1.理研光量子工学研究領域
	16:45 - 17:00		休憩/Break		
	17:00 - 17:15	E 12p-B6-6	Flexible electrode patterning in glass microchannels using hybrid femtosecond laser microfabrication for 3D controllable electro-orientation of microorganisms	○Jian Xu[1], Hiroyuki Kawano[1], Dong Wu[1], Katsumi Midorikawa[1], Koji Sugioka[1]	1.RIKEN
	17:15 - 17:30	奨 12p-B6-7	フェムト秒レーザを用いたNi微細構造の還元パターニング特性	○田村 健紀[1], 溝尻 瑞枝[2], 櫻井 淳平[2], 秦 誠一[2]	1.名大工, 2.名大院工
	17:30 - 17:45	12p-B6-8	レーザー支援エッチングによる多成分ガラス基板への貫通孔形成	○米村 正寿[1], 加藤 覚[1], 長谷川 和男[1], 高橋 秀知[2]	1.豊田中研, 2.アイシン精機
	17:45 - 18:00	12p-B6-9	配向を制御したカーボンナノチューブ/ポリマーコンポジット3次元マイクロ構造のレーザー形成	○庄司 暁[1], 牛場 翔太[2], 増井 恭子[2], 河田 聡[2]	1.電通大先進理工, 2.阪大院工

3 光・フォトニクス

光量子を自在に操る分極反転光デバイス / Polarity-reversed optical device handling quantum photons

3月12日(木)　13:15 - 17:00

招待	13:15 - 13:45	12p-D2-1	分極反転デバイスによるもつれ光子対発生	○岸本 直[1], 曹 博[2], 陳 切春[2], 上野 若菜[2], 薮野 正裕[2], 三森 康義[2], 荒平 慎[1], 村井 仁[1], 枝松 圭一[2]	1.沖電気工業, 2.東北大通研
招待	13:45 - 14:15	12p-D2-2	帯域拡大分極反転デバイスによる量子もつれ光子対	○田中 陽[1,2], 岡本 亮[1,2,3], Lim Hwang-Hong[4], 栗村 直[4], 竹内 繁樹[1,2,3]	1.北大電子研, 2.阪大産研, 3.京大工, 4.物材機構
招待	14:15 - 14:45	12p-D2-3	低複屈折分極反転デバイスによる量子もつれ光子生成	○清水 亮介[1]	1.電通大先端セ
招待	14:45 - 15:15	E 12p-D2-4	Spontaneous parametric down conversion in adhered slab waveguide based on periodically poled lithium tantalate	○Hwan Hong Lim[1], Sunao Kurimura[1], Kazufumi Fujii[1], Masayuki Okano[2], Shigeki Takeuchi[2,3,4]	1.NIMS, 2.Kyoto Univ., 3.Hokkaido Univ., 4.Osaka Univ.
	15:15 - 15:30		休憩/Break		
招待	15:30 - 16:00	12p-D2-5	超短パルス発生・制御からみた分極反転デバイスへの期待	○藤 貴夫[1]	1.分子研
招待	16:00 - 16:30	12p-D2-6	広帯域分極反転MgO:LNを用いた緑色レーザ発生	○正田 史生[1], 秋野 陽介[1], 山本 修平[1], 柳澤 隆行[1], 平野 嘉仁[1]	1.三菱電機
招待	16:30 - 17:00	12p-D2-7	紫外光発生用新結晶 LBGO	○廣橋 淳二[1], 谷内 哲夫[2], 今井 浩一[1], 坂入 光佳[1], 竹川 俊二[1], 松倉 誠[1], 宮澤 信太郎[1,3], 古川 保典[1]	1.オキサイド, 2.東北大学際研, 3.早大材研

3 光・フォトニクス

散逸ゆらぎ制御ナノ電子フォトン系の理論とデバイス構築 / Theory and Practice of Nanoelectron-photon Interaction via Dissipation and Fluctuations

3月12日(木)　14:00 - 17:45

招待	14:00 - 14:30	12p-A12-1	スピンゆらぎの物理基盤とデバイス構築	○田畑 仁[1]	1.東大院工
招待	14:30 - 15:00	12p-A12-2	ナノ環境における揺らぎの下での光誘起ダイナミクスの理論と応用	○飯田 琢也[1], 床波 志保[2], 伊都 将司[3]	1.大阪府大院理, 2.大阪府大ナノ科学・材料セ, 3.阪大院基礎工
招待	15:00 - 15:30	12p-A12-3	ナノ電子フォトン系における機能の基本構造と圏論に基づく描像	○堀 裕和[1]	1.山梨大院総研
招待	15:30 - 16:00	12p-A12-4	天然光合成PSIIに学ぶ水の酸化反応	○中村 振一郎[1]	1.理化学研究所
	16:00 - 16:15		休憩/Break		
招待	16:15 - 16:45	12p-A12-5	フォトクロミック分子材料の最前線	○入江 正浩[1]	1.立教大学未来分子センター
招待	16:45 - 17:15	12p-A12-6	揺律場の科学に向けて	○原 正彦[1,2]	1.東工大総理工, 2.理研
招待	17:15 - 17:45	12p-A12-7	綱引きボムベ：全体最適な意思決定器「知的ナノ構造体」に向けて	○金 成主[1], 青野 真士[2,3], 成瀬 誠[4]	1.物材機構, 2.東工大, 3.JST, 4.情通機構

3 光・フォトニクス

宇宙観測・地球観測で活用される光センシング技術 / Optical sensing utilized in space and earth observations

3月12日(木)　13:30 - 16:15

招待	13:30 - 14:00	12p-B3-1	系外惑星直接観測のための高コントラスト撮像光学系	○西川 淳[1,2]	1.国立天文台, 2.総研大物
招待	14:00 - 14:30	12p-B3-2	系外惑星探査のための近赤外ドップラー分光と光周波数コム	○黒川 隆志[1,2], 柏木 謙[2], 小谷 隆行[1], 西川 淳[1,4], 田村 元秀[1,3]	1.国立天文台, 2.東京農工大, 3.東大, 4.総研大
招待	14:30 - 15:00	12p-B3-3	大型低温重力波望遠鏡KAGRAとレーザー干渉計技術	○安東 正樹[1,2]	1.東大理, 2.国立天文台
	15:00 - 15:15		休憩/Break		
招待	15:15 - 15:45	12p-B3-4	超小型衛星ほどよし3, 4号における光学系とその成果	○青柳 賢英[1], 中須賀 真一[1]	1.東大工
招待	15:45 - 16:15	12p-B3-5	人工衛星用光ファイバジャイロ:高精度化のためのキー技術	○巳谷 真司[1], 水谷 忠均[1], 篠崎 慶亮[1], 佐々木 善信[1]	1.JAXA

6 薄膜・表面　9 応用物性

次世代強誘電体材料の開発指針 / Guidelines for Development of Ferroelectric Materials in the Following Generation

3月12日(木)　13:30 - 17:30

招待	13:30 - 14:00	12p-B5-1	チタン酸バリウム系強誘電体の開拓を振り返って	○秋重 幸邦[1]	1.島根大教育
招待	14:00 - 14:30	12p-B5-2	強誘電体エレクトロニクス材料の研究開発動向	○安藤 陽[1]	1.村田製作所
招待	14:30 - 15:00	12p-B5-3	強誘電体プローブデータストレージ	○平永 良臣[1], 青木 朋徳[1], 陳 一桐[1], 長 康雄[1]	1.東北大通研
招待	15:00 - 15:30	12p-B5-4	強誘電体薄膜の圧電MEMS への応用	○小林 健[1], 牧本 なつみ[1], 岡田 浩尚[1], 高松 誠一[1], 鈴木 靖弘[1], 伊藤 寿浩[1], 前田 龍太郎[1]	1.産総研
	15:30 - 15:45		休憩/Break		
招待	15:45 - 16:00	12p-B5-5	「講演奨励賞受賞記念講演」(15分) HfO2基エピタキシャル薄膜の強誘電性	○清水 荘雄[1], 片山 きりは[2], 舟窪 浩[1,2]	1.東工大元素, 2.東工大総理工
招待	16:00 - 16:30	12p-B5-6	エネルギー変換応用を指向した非鉛強誘電体薄膜の開発	○吉村 武[1], 藤村 紀文[1]	1.阪府大院工
招待	16:30 - 17:00	12p-B5-7	KNN非鉛圧電薄膜の開発	○堀切 文正[1], 渡辺 和俊[1], 柴田 憲治[1]	1.日立金属
招待	17:00 - 17:30	12p-B5-8	酸化物エレクトロニクスと強誘電体 ―過去、現在、未来―	○田畑 仁[1]	1.東大院工

6 薄膜・表面

スピン-軌道相互作用が生み出す酸化物の新しい機能性 / New functionality of oxides generated by spin-orbit interaction

3月12日(木)　13:15 - 18:30

招待	13:15 - 14:15	12p-D10-1	トポロジカル量子現象の視点とトポロジカル超伝導	○前野 悦輝[1]	1.京大院理
招待	14:15 - 15:00	12p-D10-2	カルコゲナイド系トポロジカル絶縁体の実験研究	○瀬川 耕司[1]	1.阪大産研
招待	15:00 - 15:45	12p-D10-3	トポロジカル絶縁体設計に向けたイリジウム酸化物(111)超格子の実現	○平井 大悟郎[1]	1.東大理物
	15:45 - 16:00		休憩/Break		
招待	16:00 - 16:45	12p-D10-4	ペロブスカイトハーフメタル/強誘電体ヘテロ構造のマルチフェロイック特性	○浅野 秀文[1], 蘇 ジョンミン[1], 許 方舟[1], 伊東 和徳[1], 羽尻 哲也[1], 植田 研二[1]	1.名古屋大院工
招待	16:45 - 17:30	12p-D10-5	マルチフェロイックにおけるエレクトロマグノンの電気磁気共鳴	○高橋 陽太郎[1,2,3]	1.東大工, 2.理研 CEMS, 3.PRESTO JST
	17:30 - 17:45	12p-D10-6	垂直磁気異方性を誘起したMn酸化物薄膜における異常ホール効果	○中村 優男[1], 森川 大輔[1], 于 秀珍[1], 有馬 孝尚[1,2], 川﨑 雅司[1,2], 十倉 好紀[1,2]	1.理研 CEMS, 2.東大院工
招待	17:45 - 18:30	12p-D10-7	ナノスケール磁気渦―スキルミオンの直接観察	○于 秀珍[1]	1.理研創発

6 薄膜・表面

二酸化チタンの最近の動向 / Recent development of titanium dioxide

3月12日(木)　13:15 - 17:30

招待	13:15 - 13:30	12p-D9-1	二酸化チタンの最近の動向	○坂間 弘[1]	1.上智大理工
招待	13:30 - 14:00	12p-D9-2	Overview：結晶多形および表面・界面	○大西 洋[1]	1.神戸大院理
招待	14:00 - 14:30	12p-D9-3	二酸化チタン表面の光励起キャリア寿命―光触媒活性を向上させるためのヒント―	○小澤 健一[1]	1.東工大院理工
招待	14:30 - 15:00	12p-D9-4	色素増感太陽電池における二酸化チタン光電極の役割	○荒川 裕則[1]	1.東理大工
招待	15:00 - 15:30	12p-D9-5	抵抗変化メモリ -メモリ材料としての二酸化チタン-	○木下 健太郎[1,2]	1.鳥取大工, 2.TiFREC
	15:30 - 15:45		休憩/Break		
招待	15:45 - 16:15	12p-D9-6	TiO_2系透明導電体の新進展	○長谷川 哲也[1,2,3]	1.東大院理, 2.KAST, 3.JST-CREST
招待	16:15 - 16:45	12p-D9-7	酸化チタン・ナノチューブ複合体の形成とデバイス応用	○庭野 道夫[1]	1.東北大通研
招待	16:45 - 17:15	12p-D9-8	球状多孔質金属酸化物ナノ粒子の一段階合成とその応用	大谷 政孝[1], ○小廣 和哉[1]	1.高知工科大環境理工
招待	17:15 - 17:30	12p-D9-9	二酸化チタンへの期待	○佐々木 正洋[1]	1.筑波大数物

7 ビーム応用

リソグラフィ技術の最新動向 / The latest trend of the lithography technology

3月12日(木)　13:15 - 15:30

招待	13:15 - 14:00	12p-C3-1	リソグラフィ技術の発展とEUVリソグラフィの最新動向	○岡崎 信次[1]	1.ギガフォトン(株)
招待	14:00 - 14:30	12p-C3-2	マルチパターニングによる微細加工の可能性	○八重樫 英民[1], 小山 賢一[1], 山内 祥平[1], 原 亜梨沙[1], 名執 桜子[1], 大和 雅俊[1], 岡部 憲明[1], 小池 恭平[1]	1.東京エレクトロン
招待	14:30 - 15:00	12p-C3-3	ジブロックコポリマーを用いた誘導自己組織化プロセスのモデリングと最適化	○吉元 健治[1], 深渡瀬 健[1], 堀 義宗[1], 銭谷 優佑[1], 大嶋 正裕[1]	1.京大
招待	15:00 - 15:30	12p-C3-4	Nanoimprint systems for high volume semiconductor manufacturing	○岩本 和徳[1], 酒井 啓太[1], 岩永 武彦[1], 高林 幸夫[1]	1.キヤノン株式会社

8 プラズマエレクトロニクス

微粒子合成法とその応用最前線 / Synthesizing methods for fine particles and their latest applications

3月12日(木)　13:30 - 18:45

招待	13:30 - 13:45	12p-D14-1	プラズマによる微粒子合成法の現状と課題	○渡辺 隆行[1]	1.九大工
招待	13:45 - 14:15	12p-D14-2	熱プラズマプロセスによるナノ粒子の合成とその応用	○中村 圭太郎[1], 上原 浩臣[1], 七蔵司 和哉[1]	1.日清製粉グループ本社
招待	14:15 - 14:45	12p-D14-3	プラズマによるナノ粒子の合成と凝集・輸送制御	○白谷 正治[1], 古閑 一憲[1]	1.九大シス情
招待	14:45 - 15:15	12p-D14-4	金超原子および超原子分子:合成と評価	○佃 達哉[1,2]	1.東大院理, 2.京大ESICB
招待	15:15 - 15:45	12p-D14-5	低圧プラズマによる微粒子表面修飾法	○永津 雅章[1]	1.静大創科技院
	15:45 - 16:00	奨 12p-D14-6	間欠スパッタによるFe微粒子高密度形成	○(DC)小路 紘史[1], 本郷 知紀[1], 楠本 雄司[1], 古田 寛[1,2], 八田 章光[1,2]	1.高知工科大院, 2.高知工科大総研ナノテクC

	16:00 - 16:15		休憩/Break		
招待	16:15 - 16:45	12p-D14-7	**コロイド化学的手法によるヘテロ構造ナノ粒子の合成**	**○前之園 信也[1]**	**1.北陸先端大マテリアル**
招待	16:45 - 17:15	12p-D14-8	**超臨界プラズマによるダイヤモンドモイド合成法**	**○寺嶋 和夫[1], シュタウス スベン[1], 占部 継一郎[1], 石井 千佳子[1], 大島 郁人[1], 加藤 智嗣[1]**	**1.東大 新領域**
招待	17:15 - 17:45	12p-D14-9	**液中プラズマを用いるナノ粒子のグリーンな合成と改質**	**○米澤 徹[1]**	**1.北大院工**
	17:45 - 18:00	12p-D14-10	液体電極を用いた大気圧プラズマによる磁性ナノ粒子生成の検討	○白井 直機[1], 吉田 健人[1], 内田 諭[1], 朽久保 文嘉[1]	1.首都大
招待	18:00 - 18:30	12p-D14-11	**微粒子プロセスの高度化による多機能材料の創製**	**○目 義雄[1]**	**1.物材機構**
招待	18:30 - 18:45	12p-D14-12	**まとめと展望**	**○金子 俊郎[1]**	**1.東北大院工**

12 有機分子・バイオエレクトロニクス

バイオインターフェースの可視化・実用技術の新展開 / Visualization and application of biointerfaces

3月12日(木)　13:15 - 17:15

招待	13:15 - 13:45	12p-D5-1	**バイオインタフェース設計とバイオセンサーの高機能化**	**○民谷 栄一[1]**	**1.阪大工**
招待	13:45 - 14:15	12p-D5-2	**FM-AFMおよび3次元フォースマッピング法による生体分子–溶液界面構造の可視化**	**○山田 啓文[1], 小林 圭[1,2]**	**1.京大工, 2.京大白眉センター**
招待	14:15 - 14:45	12p-D5-3	**水溶液-固体界面における無機イオンの振る舞い**	**○赤木 和人[1]**	**1.東北大AIMR**
	14:45 - 15:00	12p-D5-4	分子動力学法に基づくdouble-stranded DNA界面の水とイオン挙動	○前川 侑毅[1], 澁田 靖[1], 加治佐 平[1], 坂田 利弥[1]	1.東大院工
	15:00 - 15:15		休憩/Break		
招待	15:15 - 15:45	12p-D5-5	**表面化学修飾による菌の接着制御**	**○中野 美紀[1], 三宅 晃司[1], 西村 麻里江[2]**	**1.産総研, 2.生物研**
	15:45 - 16:00	12p-D5-6	酸化グラフェン表面に固定したアプタマの分子吸脱着特性	○上野 祐子[1], 古川 一暁[1], 日比野 浩樹[1]	1.NTT物性基礎研
招待	16:00 - 16:30	12p-D5-7	**生体不活性特性と界面水分子**	**○林 智広[1]**	**1.東工大 総理工**
招待	16:30 - 16:45	12p-D5-8	**「講演奨励賞受賞記念講演」(15分) 吸着抑制能を有するオリゴエチレングリコール末端SAMの液中3D-SFM計測**	**○稲田 なつみ[1], 淺川 雅[2], 宮澤 佳甫[1], 福間 剛士[1,2,3]**	**1.金大院, 2.金大バイオAFMセ, 3.JST ACT-C**
招待	16:45 - 17:15	12p-D5-9	**フラグメント分子軌道法でナノ-バイオ界面を見る**	**○望月 祐志[1,2], 福澤 薫[2,3]**	**1.立教大理, 2.東大生産研, 3.日大松戸歯**

13 半導体

未来を担う若手科学者の在り方　～集積化技術の新たな価値創造を目指して～ / How should we behave as future scientists? - Innovative value creation of integration technology by young generations -

3月12日(木)　13:00 - 17:00

招待	13:00 - 13:30	12p-A29-1	**若き科学者たちよ。未来産業創造にむけて沈みゆく船・日本を救え。**	**○山口 栄一[1]**	**1.京大院 総合生存**
招待	13:30 - 14:00	12p-A29-2	**将来の超集積化システムにおける指導原理 ― 学振165委員会の議論から ―**	**○平本 俊郎[1]**	**1.東大生研**
	14:00 - 14:15	12p-A29-3	自己加熱効果の抑制によるFinFET低消費電力化の検討	○高橋 綱己[1,2], 内田 建[1,2]	1.慶應大理工 電子工, 2.JST CREST
	14:15 - 14:30	12p-A29-4	フォーミングガスアニールが$Cr/SiO_2/Si$界面の熱抵抗に与える影響	○熊田 亜理沙[1], 竹内 豪[1], 宮田 耕[1], 高橋 綱己[1,2], 内田 建[1,2]	1.慶應大理工 電子工, 2.JST CREST
	14:30 - 14:45	奨 12p-A29-5	金属/Ge界面への高Sn組成$Ge_{1-x}Sn_x$層挿入によるショットキー障壁高さの低減	○鈴木 陽洋[1], 柴山 茂久[1,2], 坂下 満男[1], 竹内 和歌奈[1], 中塚 理[1], 財満 鎭明[1,3]	1.名大院工, 2.学振DC, 3.名大エコトピア
	14:45 - 15:00	12p-A29-6	$HfO_2/Al_2O_3/In_{0.53}Ga_{0.47}As$界面に対する窒素プラズマクリーニング後の水素アニール効果に関する研究	○祢津 誠晃[1], 金澤 徹[1,2], 宮本 恭幸[1,2]	1.東工大工, 2.東工大院理工
	15:00 - 15:15		休憩/Break		
招待	15:15 - 15:45	12p-A29-7	**3次元集積化技術が拓くDiversificationの未来 - From LSI of scale to LSI of scope -**	**○田中 徹[1]**	**1.東北大院医工**
	15:45 - 16:00	12p-A29-8	三次元集積化における異種材料間の熱膨張係数差がおよぼす影響	○木野 久志[1], 池ヶ谷 俊介[2], 小柳 光正[3], 田中 徹[4]	1.東北大学際研, 2.東北大工, 3.東北大未来研, 4.東北大院医工
招待	16:00 - 16:30	12p-A29-9	**超柔軟有機デバイスによる生体情報計測**	**○染谷 隆夫[1,2]**	**1.東大工, 2.JST/ERATO**
	16:30 - 16:45	12p-A29-10	スパッタ堆積MoS_2膜の下地平坦化による電気特性向上	○大橋 匠[1], 山口 晋平[1], 松浦 賢太朗[1], 須田 耕平[2], 石原 聖也[2], 澤本 直美[2], 角嶋 邦之[1], 杉井 信之[1], 西山 彰[1], 片岡 好則[1], 名取 研二[1], 筒井 一生[1], 岩井 洋[1], 小椋 厚志[2], 若林 整[1]	1.東工大, 2.明治大
	16:45 - 17:00	12p-A29-11	VO_2薄膜における金属・絶縁体転移を用いた電界効果三端子素子の実証	○矢嶋 赳彬[1,2], 西村 知紀[1,2], 鳥海 明[1,2]	1.東大, 2.JST-CREST

13 半導体

クルマ社会の未来を支えるセンシング技術　～自動運転システムの展望と課題～ / Sensing Technologies for the Future of Automobile Society～The Prospect and Challenge of Autonomous Driving System～

3月12日(木)　14:00 - 17:15

招待	14:00 - 14:30	12p-D15-1	**将来のクルマを支えるセンシング技術：MEMS技術に期待！**	**○宮田 博司[1]**	**1.トヨタテクニカルディベロップメント(株)**
招待	14:30 - 15:00	12p-D15-2	**自動運転とADASセンサーがもたらす社会のイノベーション**	**○野辺 継男[1,2]**	**1.インテル, 2.名古屋大学**
	15:00 - 15:15	奨 12p-D15-3	Sub-1Gから20Gまで検知可能な集積化MEMS加速度センサの検討	○山根 大輔[1,4], 小西 敏文[2], 松島 隆明[2], 年吉 洋[3,4], 町田 克之[1,2,4], 益 一哉[1,4]	1.東工大, 2.NTT-AT, 3.東大, 4.JST-CREST
	15:15 - 15:30	12p-D15-4	MEMS3軸加速度センサのマトリックス感度並列計測	○土屋 智由[1], 中野 篤[1], 平井 義和[1], 田畑 修[1], 梅田 章[2]	1.京大工, 2.ベクトルダイナミックス
	15:30 - 15:45		休憩/Break		
招待	15:45 - 16:15	12p-D15-5	**情報通信技術の観点から見た自動車のセキュリティ**	**○黒田 幸明[1]**	**1.サイバー創研**
招待	16:15 - 16:45	12p-D15-6	**自動車運転支援のための画像認識技術**	**○岡田 隆三[1]**	**1.(株)東芝**

	16:45 - 17:00	奨 12p-D15-7	トリリオンセンサ時代に向けた自動ID生成回路	○松永 賢一[1], 大嶋 尚一[1], 美濃谷 直志[2], 近藤 利彦[1], 森村 浩季[1]	1.NTT先デ研, 2.NTTMI研(現NTTテレコン)
	17:00 - 17:15	12p-D15-8	室内CO_2モニタリングのための波長選択赤外光源	○佐々木 実[1], 熊谷 慎也[1]	1.豊田工大

合同セッションK ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス

酸化物半導体における価電子メタモルフォロジ / Valence-electron metamorphology in oxide semiconductors

3月12日(木) 13:15 - 18:30

	13:15 - 13:30	12p-D1-1	酸化物半導体における価電子メタモルフォロジ:Introductory Talk	○川原村 敏幸[1], 阿部 友紀[2], 宇野 和行[3]	1.高知工大, 2.鳥取大, 3.和大
招待	13:30 - 14:00	12p-D1-2	**Stem Technology Initiative for sustainable energy future based on smart chemistry of oxides**	**○鯉沼 秀臣[1]**	**1.東大**
招待	14:00 - 14:30	12p-D1-3	**酸化物半導体における価電子メタモルフォロジの制御**	**○藤田 静雄[1]**	**1.京大院工**
招待	14:30 - 15:00	12p-D1-4	**2価のユウロピウムを含むペロブスカイト型酸化物の磁気的性質**	**○田中 勝久[1], 藤田 晃司[1]**	**1.京大院工**
招待	15:00 - 15:30	12p-D1-5	**可視領域でバンドギャップチューニング可能なZnO系新材料の開発**	**○板垣 奈穂[1,2], 松島 宏一[1], 井出 知章[1], 山下 大輔[1], 徐 鉉雄[1], 古閑 一憲[1], 白谷 正治[1]**	**1.九大シス情, 2.JSTさきがけ**
招待	15:30 - 16:00	12p-D1-6	**鉄系酸化物半導体の価電子制御と光・電気・磁気特性**	**○田畑 仁[1]**	**1.東大院工**
	16:00 - 16:15		休憩/Break		
	16:15 - 16:30	12p-D1-7	β-Ga_2O_3結晶の透過と反射スペクトルの偏光依存性	○尾沼 猛儀[1,2,3], 齋藤 伸吾[3], 佐々木 公平[3,4], 増井 建和[4], 山口 智広[2], 本田 徹[2], 東脇 正高[3]	1.東京高専, 2.工学院大, 3.情通機構, 4.タムラ製作所
	16:30 - 16:45	12p-D1-8	結晶性OS FETのドレイン電流耐性	○馬場 晴之[1], 鈴木 陽夫[1], 小林 由幸[1], 松田 慎平[1], 齋藤 暁[2], 早川 昌彦[2], 山崎 舜平[1,2]	1.半エネ研, 2.AFD Inc
	16:45 - 17:00	奨 12p-D1-9	$Sr_{1-x}La_xSnO_3$透明導電薄膜の作製	○馬場 枝里奈[1], 菅 大介[1], 島川 祐一[1,2]	1.京大化研, 2.JST-CREST
招待	17:00 - 17:30	12p-D1-10	**2次元酸化物ナノシートのメタモルフォロジ**	**○長田 実[1], 佐々木 高義[1]**	**1.物材機構MANA**
招待	17:30 - 18:00	12p-D1-11	**ペロブスカイト酸化物薄膜の電子状態を原子空間分解能で明らかにする**	**○一杉 太郎[1]**	**1.東北大学AIMR**
招待	18:00 - 18:30	12p-D1-12	**ワイドバンドギャップ酸化亜鉛における価電子メタモルフォロジ**	**○山本 哲也[1], 野本 淳一[1], 牧野 久雄[1]**	**1.高知工科大総研**

15 結晶工学

進化するパワー半導体・・・シリコンからワイドバンドギャップへ / Progress of power semiconductors, toward wide band-gap materials beyond silicon

3月12日(木) 13:15 - 18:15

招待	13:15 - 13:30	12p-B4-1	**イントロダクトリー**	**○木本 恒暢[1]**	**1.京大**
招待	13:30 - 14:00	12p-B4-2	**戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)「次世代パワーエレクトロニクス」の取り組み**	**○大森 達夫[1], 田中 保宣[1]**	**1.内閣府**
招待	14:00 - 14:30	12p-B4-3	**パワーデバイスの現状と今後の進展について**	**○齋藤 渉[1]**	**1.東芝**
招待	14:30 - 15:00	12p-B4-4	**パワーデバイス用単結晶の結晶成長**	**○柿本 浩一[1], ガオ ビング[1], リュウ キン[1], 中野 智[1], 西澤 伸一[2], 原田 博文[3], 宮村 佳児[3], 関口 隆史[3], 寒川 義裕[1]**	**1.九大応力研, 2.産総研, 3.物質材料機構**
招待	15:00 - 15:30	12p-B4-5	**結晶評価の立場から見た各種パワー半導体材料**	**○山本 秀和[1]**	**1.千葉工大工**
	15:30 - 15:45		休憩/Break		
招待	15:45 - 16:15	12p-B4-6	**物性から見たパワーデバイス用半導体材料**	**○須田 淳[1]**	**1.京大院工**
招待	16:15 - 16:45	12p-B4-7	**先進パワーデバイスにおける新規ゲート絶縁膜開発**	**○渡部 平司[1], 細井 卓治[1]**	**1.阪大院工**
招待	16:45 - 17:15	12p-B4-8	**イオン注入技術の適用の現状**	**○加地 徹[1]**	**1.豊田中研**
招待	17:15 - 17:45	12p-B4-9	**次世代パワー半導体モジュール技術動向**	**○高橋 良和[1], 中澤 治雄[1], 西村 芳孝[1]**	**1.富士電機**
招待	17:45 - 18:15	12p-B4-10	**パワー半導体デバイスへ要求される特性と現状**	**○原 英則[1]**	**1.安川電機**

1 応用物理学一般

衝撃および重力場応用の物理の最前線 / Research forefront of shock wave and high & micro-gravity application science

3月13日(金) 9:00 - 13:00

招待	9:00 - 9:30	13a-D13-1	**衝撃分野研究の特異性と将来性**	**○三好 仁[1], 酒井 正嗣[1], 吉江 伸二[1]**	**1.衝撃工学研究所**
招待	9:30 - 10:00	13a-D13-2	**X線自由電子レーザーによるレーザー衝撃現象の可視化と将来展望**	**○佐野 雄二[1]**	**1.革新的研究開発推進プログラム**
	10:00 - 10:15	13a-D13-3	国際宇宙ステーションを利用した微小重力実験	○夏井坂 誠[1]	1.宇宙航空研究開発機構
招待	10:15 - 10:45	13a-D13-4	**微小重力環境を利用した均一組成バルク混晶の育成と地上への応用**	**○木下 恭一[1], 荒井 康智[1]**	**1.宇宙航空研究開発機構**
	10:45 - 11:00	13a-D13-5	窒素ガス中ガス銃衝突反応によるアミノ酸含有微粒子合成	○三重野 哲[1], 大河内 一輝[2], 長谷川 直[3], 黒澤 耕介[4]	1.静岡大院創造, 2.静岡大院理, 3.JAXA宇宙研, 4.千葉大惑星セ
	11:00 - 11:15	13a-D13-6	有機物液体中パルス細線放電法による炭化物超微粒子合成	○末松 久幸[1], 菅島 健太[1], 鈴木 和真[1], 鈴木 常生[1], 中山 忠親[1], 新原 晧一[1]	1.長岡技大極限セ
	11:15 - 11:30		休憩/Break		
招待	11:30 - 12:00	13a-D13-7	**高圧合成法による機能性酸化物の探索 —巨大負熱膨張材料 $BiNiO_3$—**	**○東 正樹[1]**	**1.東工大応セラ研**
	12:00 - 12:15	13a-D13-8	衝撃圧縮法によるBi系酸化物超伝導体作製における圧力依存性	○(D)亀谷 崇樹[1], 真下 茂[1], Chen Liliang[1], 富岡 成矢[2], 中村 悟士[2], 中村 峰大[2], 毛塚 博史[2], 鶴岡 誠[2], 吉村 徹三[2], 有沢 俊一[3]	1.熊本大, 2.東京工科大, 3.NIMS
	12:15 - 12:30	13a-D13-9	強い重力場による酸化物の結晶構造変化	○真下 茂[1], 緒方 裕大[1], Bagum Rabaya[1], 杉山 和正[2], 杵鞭 義明[3], 奥部 真樹[4], 速水 和正[5], 富永 昌人[6], 磯部 博志[5], 吉朝 朗[5]	1.熊大パルスパワー, 2.東北大金研, 3.産総研, 4.東工大応セラ研, 5.熊大理, 6.熊大工
	12:30 - 12:45	13a-D13-10	a-Si/Au多層膜の結晶化に対する重力場の影響	○岡本 庸一[1], 緒方 雄大[2], 徳田 誠[2], 宮崎 尚[1], 守本 純[1], 真下 茂[2]	1.防衛大, 2.熊本大

	12:45 - 13:00	13a-D13-11	常磁性状態のGdのバーネット効果	○小野 正雄[1,4], 針井 一哉[1,4], 岡安 悟[1,4], 中堂 博之[1,4], 松尾 衛[1,4], 家田 淳一[1,4], 前川 禎通[1,4], 齊藤 英治[1,2,3,4]	1.原子力機構先端研, 2.WPI-AIMR, 3.東北大金研, 4.JST-ERATO

10 スピントロニクス・マグネティクス

スピントロニクスの将来ビジョン ～スピントロニクスはこれから何をするのか?～ / A vision of future spintronics ~What is the next in spintronics?

3月13日(金) 9:00 - 12:30

招待	9:00 - 9:15	13a-B6-1	**スピントロニクスの現状と将来展望**	**○田中 雅明[1]**	**1.東京大学工学系**
招待	9:15 - 9:45	13a-B6-2	**金属スピントロニクスの応用の現状と将来ビジョン**	**○湯浅 新治[1,3], 薬師寺 啓[1,3], 福島 章雄[1,3], 久保田 均[1,3], 野崎 隆行[1,3], 塩田 陽一[1,3], 甲野藤 真[1,3], 安藤 功兒[1], 三輪 真嗣[2,3], 鈴木 義茂[1,2,3]**	**1.産総研, 2.大阪大, 3.JST**
招待	9:45 - 10:15	13a-B6-3	**ナノスピン変換科学研究で目指すもの**	**○大谷 義近[1,2]**	**1.東大物性研, 2.理研CEMS**
招待	10:15 - 10:45	13a-B6-4	**ホイスラー合金を用いた磁気抵抗素子の課題と展望**	**○宝野 和博[1], 高橋 有紀子[1], 古林 孝夫[1], 桜庭 裕弥[1]**	**1.物質材料研究機構**
	10:45 - 11:00		休憩/Break		
招待	11:00 - 11:30	13a-B6-5	**トポロジカル絶縁体における薄膜化研究の現状と課題**	**○塚﨑 敦[1,2], 吉見 龍太郎[3], ジョセフ チェケルスキー[4], 安田 憲司[3], 小塚 裕介[3,5], ジョセフ ファルソン[3,5], 高橋 圭[6], 永長 直人[3,6], 川﨑 雅司[3,5,6], 十倉 好紀[3,6]**	**1.東北大金研, 2.JSTさきがけ, 3.東大物工, 4.MIT, 5.東大QPEC, 6.理研CEMS**
招待	11:30 - 12:00	13a-B6-6	**磁壁デバイスの展望**	**○小野 輝男[1]**	**1.京大化研**
招待	12:00 - 12:30	13a-B6-7	**光によるスピン制御の展望**	**○宗片 比呂夫[1]**	**1.東工大像情報**

11 超伝導

巨匠が教えてくれた高温超伝導とその未来～北澤宏一先生・前田弘先生追悼シンポジウム～ / Memorial Symposium for Prof. K. Kitazawa and Prof. H. Maeda

3月13日(金) 9:00 - 11:45

招待	9:00 - 9:15	13a-B2-1	**イントロダクトリートーク**	**○下山 淳一[1]**	**1.東大院工**
招待	9:15 - 9:45	13a-B2-2	**高温超伝導の夜明け**	**○岸尾 光二[1]**	**1.東大院工**
招待	9:45 - 10:15	13a-B2-3	**前田弘先生とビスマス系高温超伝導体の発見**	**○戸叶 一正[1]**	**1.物材機構**
招待	10:15 - 10:45	13a-B2-4	**前田弘さんと北澤宏一先生の思い出**	**○佐藤 謙一[1]**	**1.住友電気工業**
招待	10:45 - 11:15	13a-B2-5	**走査型トンネル分光の発展と高温超伝導**	**○花栗 哲郎[1]**	**1.理研CEMS**
招待	11:15 - 11:45	13a-B2-6	**Bi2212固有ジョセフソン接合系によるジョセフソンプラズマ励起とTHz発振(高温超伝導研究の突破口を拓いた2大巨人:北澤宏一・前田弘先生の思い出)**	**○門脇 和男[1]**	**1.筑波大数理物質**

3月13日(金) 16:15 - 18:45

招待	16:15 - 16:45	13p-B2-1	**酸化物超伝導材料の応用として始まった磁気科学研究**	**○廣田 憲之[1]**	**1.物材機構**
招待	16:45 - 17:15	13p-B2-2	**Bi2223超電導材料によるバルク電流リードの開発 -液体ヘリウムフリー超電導マグネットへの適用-**	**○石塚 正之[1], 櫻庭 順二[1], 淡路 智[2], 渡辺 和雄[2]**	**1.住重技研, 2.東北大金研**
招待	17:15 - 17:45	13p-B2-3	**STMと固体物性との出会い～北澤先生の夢へと続く道**	**○長谷川 哲也[1]**	**1.東大院理**
招待	17:45 - 18:15	13p-B2-4	**4K冷凍機を用いた伝導冷却式超電導磁石および高温超電導磁石の開発**	**○栗山 透[1]**	**1.株式会社東芝**
招待	18:15 - 18:45	13p-B2-5	**高温超伝導直流送電と北澤宏一先生**	**○山口 作太郎[1], 筑本 知子[1]**	**1.中部大学超伝導センター**

15 結晶工学 16 非晶質・微結晶

太陽電池用バルク結晶シリコンの成長と評価 / Growth and characterization of bulk crystalline silicon for photovoltaic application

3月13日(金) 13:15 - 18:15

	13:15 - 13:30	13p-C2-1	イントロダクトリートーク ～結晶成長と結晶評価技術の重要性～	○沓掛 健太朗[1], 石河 泰明[2], 大平 圭介[3]	1.東北大金研, 2.奈良先端大, 3.北陸先端大
招待	13:30 - 14:00	13p-C2-2	**Noncontact crucible methodを用いた太陽電池用の直径比の大きなSiインゴット単結晶の研究開発**	**○中嶋 一雄[1], 小野 聖[1], 村井 良多[1], 金子 弦[1]**	**1.科学技術振興機構**
	14:00 - 14:15	奨 13p-C2-3	浮遊キャスト成長法におけるデンドライト結晶を利用した多結晶Siの組織制御と転位密度の低減効果の実証	○(M1C)平松 巧也[1], 高橋 勲[1], 宇佐美 徳隆[1]	1.名大院工
	14:15 - 14:30		休憩/Break		
招待	14:30 - 15:00	13p-C2-4	**シードを用いた太陽電池用シリコンの結晶成長**	**○柿本 浩一[1], ガオ ピング[1], リュウ キン[1], 中野 智[1], 原田 博史[2], 宮村 佳児[2], 関口 隆史[2], 寒川 義裕[1]**	**1.九大応力研, 2.物質材料機構**
招待	15:00 - 15:30	13p-C2-5	**Development of High-quality Multi-crystalline Silicon Ingots for Solar Cells**	**○黄 新明[1,2]**	**1.晶澳太阳能, 2.南京工業大**
	15:30 - 15:45	奨・E 13p-C2-6	Impact of Grain Boundary Interactions on Grain Structure of Multicrystalline Silicon	○(D)Ronit Prakash[1,2], Karolin Jiptner[2], Yoshiji Miyamura[2], Jun Chen[2], Hirofumi Harada[2], Takashi Sekiguchi[1,2]	1.Tsukuba Univ., 2.NIMS
	15:45 - 16:00		休憩/Break		
招待	16:00 - 16:30	13p-C2-7	**フォトルミネッセンスによる太陽電池用Si結晶評価**	**○田島 道夫[1,2], 加藤 言[1,2], 中川 啓[1,2], 豊田 裕之[1], 小椋 厚志[2]**	**1.JAXA 宇宙研, 2.明治大**
	16:30 - 16:45	奨 13p-C2-8	顕微PLイメージング:多結晶シリコンウエハ評価法としての可能性	○二宮 駿也[1], 沓掛 健太朗[1,2], 出浦 桃子[1], 大野 裕[1], 宇佐美 徳隆[3], 米永 一郎[1]	1.東北大 金研, 2.JSTさきがけ, 3.名大院工
	16:45 - 17:00	奨 13p-C2-9	偏光PLイメージングによる太陽電池用多結晶Siの欠陥評価	○加藤 言[1,2], 田島 道夫[1,2], 豊田 裕之[2], 小椋 厚志[1]	1.明治大, 2.JAXA 宇宙研
	17:00 - 17:15		休憩/Break		
招待	17:15 - 17:45	13p-C2-10	**FTIRによるバルク結晶シリコン中の酸素析出の評価**	**○小野 春彦[1,2]**	**1.神奈川県産技セ, 2.明治大**
招待	17:45 - 18:15	13p-C2-11	**PVシリコンのライフタイム評価の進展**	**○渡辺 正晴[1], Korsos F.[2], Wilson M.[3]**	**1.日本セミラボ, 2.セミラボ, 3.Semilab SDI**

15 結晶工学

窒化物半導体特異構造の科学　～成長・プロセスとエレクトロニクス展開～ / Materials science of singularity in nitride semiconductors-Growth, processing and electronic application-

3月14日(土)　8:30 - 11:45

招待	8:30 - 9:00	14a-B1-1	**パルス励起堆積法による特異構造の創製**	**○藤岡 洋[1,2,3], 上野 耕平[1], 小林 篤[1], 太田 実雄[1]**	**1.東大生研, 2.JST-CREST, 3.JST-ACCEL**
招待	9:00 - 9:30	14a-B1-2	**周期トレンチ構造を持つGaNトランジスタ**	**○橋詰 保[1]**	**1.北大量集センター**
	9:30 - 9:45	奨 14a-B1-3	酸性アモノサーマル法によるGaN結晶育成に及ぼす圧力の効果	○栗本 浩平[1,2], 包 全喜[1,2], 斉藤 真[1,3], 富田 大輔[1], 伊藤 みずき[1], 山崎 芳樹[1], 小島 一信[1], 鏡谷 勇二[3], 茅野 林造[2], 石黒 徹[1], 秩父 重英[1]	1.東北大多元研, 2.日本製鋼所, 3.三菱化学
	9:45 - 10:00	奨 14a-B1-4	PAMBE法によるSiC基板上AlN成長層の貫通転位低減における成長初期V/III比の重要性	○金子 光顕[1], 木本 恒暢[1], 須田 淳[1]	1.京大院工
	10:00 - 10:15	14a-B1-5	III族原料流量変調エピタキシによる窒素極性GaN(000-1)薄膜成長機構	○赤坂 哲也[1], 林 家弘[1], 山本 秀樹[1]	1.NTT物性基礎研
	10:15 - 10:30		休憩/Break		
招待	10:30 - 11:00	14a-B1-6	**ナノ構造導入によるLEDの性能向上に関する研究**	**○上山 智[1], 岩谷 素顕[1], 竹内 哲也[1], 赤﨑 勇[1,2]**	**1.名城大理工, 2.名古屋大赤﨑記念研究センター**
	11:00 - 11:15	14a-B1-7	高成長速度AlInN/GaN多層膜反射鏡を用いた面発光レーザのパルス発振	○小塚 祐吾[1], 池山 和希[1], 赤木 孝信[1], 岩山 章[1], 中田 圭祐[1], 竹内 哲也[1], 上山 智[1], 岩谷 素顕[1], 赤﨑 勇[1,2]	1.名城大理工, 2.名大・赤﨑記念研究センター
	11:15 - 11:30	14a-B1-8	AlGaN DBR上InGaN MQWナノコラムフォトニック結晶の光励起発振特性	○(PC)石沢 峻介[1], 本山 界[1], 岸野 克巳[1,2]	1.上智大理工, 2.上智ナノテク
	11:30 - 11:45	奨 14a-B1-9	$ScAlMgO_4$(0001)基板上低歪GaN薄膜を用いたInGaN系可視発光ダイオードの試作	○(D)尾崎 拓也[1], 船戸 充[1], 川上 養一[1]	1.京大院工

3月14日(土)　12:45 - 15:00

招待	12:45 - 13:15	14p-B1-1	**III-Cl・III-Cl_3混在ハライド気相成長によるIII族窒化物特異構造の形成**	**○熊谷 義直[1], 富樫 理恵[1], ティユ クァン トゥ[2], 村上 尚[1], Monemar Bo[2,3], 纐纈 明伯[1]**	**1.東京農工大院工, 2.東京農工大GIRO, 3.Linköping Univ.**
招待	13:15 - 13:45	14p-B1-2	**ボンドエンジニアリングによる特異構造形成へのアプローチ**	**○伊藤 智徳[1]**	**1.三重大院工**
	13:45 - 14:00	14p-B1-3	混晶化合物半導体の電子状態計算:IQB modelの拡張	○篠塚 雄三[1], 小田 将人[1]	1.和歌山大システム工
	14:00 - 14:15	14p-B1-4	時間分解PL測定を用いたAlGaN/AlNヘテロ構造の臨界膜厚評価	○(D)市川 修平[1], 岩田 佳也[1], 船戸 充[1], 川上 養一[1]	1.京大院工
	14:15 - 14:30	14p-B1-5	深紫外LEDの高出力化	○市川 将嗣[1,2], 藤岡 陽[1], 小杉 卓生[1], 遠藤 慎哉[1], 佐川 治信[1], 玉置 寛人[1], 向井 孝志[1], 魚本 幸[2], 島津 武仁[2,3]	1.日亜化学, 2.東北大学際研, 3.東北大通研
招待	14:30 - 15:00	14p-B1-6	**特異構造結晶の導入による高効率深紫外デバイスとTHz-QCLの開発**	**○平山 秀樹[1], 前田 哲利[1], 定 昌史[1], 寺嶋 亘[1], 豊田 史朗[1,2], 鎌田 憲彦[2]**	**1.理研, 2.埼玉大**

公募シンポジウム / Symposium

7 ビーム応用

最先端の電子・集束イオンビーム装置技術 / State of the art technology in electron and focused-ion-beam apparatuses

3月11日(水)　13:15 - 17:15

招待	13:15 - 13:30	11p-B3-1	**イントロダクトリートーク:荷電粒子ビームの工業への応用**	**○高岡 義寛[1]**	**1.京大光・電子理工センター**
招待	13:30 - 14:00	11p-B3-2	**走査電子顕微鏡(SEM)の高分解能化の歴史と最新技術**	**○多持 隆一郎[1]**	**1.日立ハイテク**
招待	14:00 - 14:30	11p-B3-3	**透過型電子顕微鏡(TEM)における最先端技術**	**○奥西 栄治[1], 向井 雅貴[1], 神保 雄[1], 沢田 英敬[1]**	**1.日本電子(株)**
招待	14:30 - 15:00	11p-B3-4	**マスク用電子ビーム描画装置の最新動向**	**○竹越 秀和[1], 上久保 貴司[1], 吉武 俊介[1], 斎藤 賢一[1]**	**1.ニューフレアテクノロジー**
招待	15:00 - 15:30	11p-B3-5	**最先端の電子ビーム(EB)直接描画技術**	**○小澤 寛司[1], 来野 靖久[1], 星 浩利[1], 駒形 正[1]**	**1.日本電子**
	15:30 - 15:45		休憩/Break		
招待	15:45 - 16:15	11p-B3-6	**FIB技術の最新動向**	**○麻畑 達也[1]**	**1.日立ハイテクサイエンス**
招待	16:15 - 16:45	11p-B3-7	**ヘリウムイオン顕微鏡技術による評価と加工**	**○小川 真一[1]**	**1.産総研**
	16:45 - 17:00	11p-B3-8	集束イオンビーム立体ナノ構造形成技術とその高精度化	○米谷 玲皇[1]	1.東大工
	17:00 - 17:15	11p-B3-9	メタルフリー・反応性負イオンFIBへの応用へ向けたイオン液体イオン源の開発と照射効果の検討	○竹内 光明[1], 星出 優輝[1], 龍頭 啓充[1], 高岡 義寛[1]	1.京大光電子理工セ

13 半導体

化合物薄膜とペロブスカイト太陽電池融合の可能性 / Feasibility of integration of perovskite semiconductors into multinary compounds solar cells

3月11日(水)　9:00 - 11:45

	9:00 - 9:15	11a-B6-1	化合物太陽電池の現状・課題とペロブスカイト太陽電池（はじめに）	○今泉 充[1]	1.宇宙機構
招待	9:15 - 9:45	11a-B6-2	**III-V族半導体高効率多接合太陽電池(Overview)**	**○高本 達也[1]**	**1.シャープ**
	9:45 - 10:00	11a-B6-3	スマートスタック法による多接合太陽電池の検討	○牧田 紀久夫[1], 水野 英範[1], 大島 隆治[1], 菅谷 武芳[1]	1.産総研
招待	10:00 - 10:30	11a-B6-4	**CIGS系化合物多接合太陽電池のトップセル開発**	**○山田 明[1,2]**	**1.東工大院理工, 2.東工大PVSEC**
	10:30 - 10:45		休憩/Break		
	10:45 - 11:00	11a-B6-5	CIGS系ボトムセルの開発とペロブスカイト型タンデムセルへの応用の可能性	○中田 時夫[1], エル・リ・カオ ザッカリー[1], カトリ イズール[1], 深井 尋史[1], 松山 勇[1], 山口 博[1]	1.東京理科大総研

	11:00 - 11:15	E 11a-B6-6	Examination of Cu(In,Ga)Se_2 Films Deposited by Multi-Layer Precursor Method Using Optical Deep Level Transient Spectroscopy	○(PC)Jakapan Chantana[1], Daisuke Hironiwa[1], Zeguo Tang[1], Taichi Watanabe[2], Seiki Teraji[2], Takashi Minemoto[1]	1.Ritsumeikan Univ., 2.Nitto Denko Corp.
招待	11:15 - 11:45	11a-B6-7	**ペロブスカイト型太陽電池：材料純度と物性**	**○若宮 淳志[1,2]**	**1.京大化研, 2.JST さきがけ**
	3月11日(水)　13:15 - 17:00				
招待	13:15 - 13:45	11p-B6-1	**種々材料の組み合わせによるペロブスカイト太陽電池の多様化とその耐久性向上の検討**	**○伊藤 省吾[1]**	**1.兵県大工**
招待	13:45 - 14:15	11p-B6-2	**有機・無機ハイブリッド金属ハロゲン化物ペロブスカイトの構造と物性制御**	**○稲辺 保[1], 長谷川 裕之[1]**	**1.北大院理**
	14:15 - 14:30	奨・E 11p-B6-3	Efficient Semi-transparent Perovskite Solar Cells Prepared by the Hybrid Deposition Method	○Shenghao Wang[1], Luis K. Ono[1], Matthew R. Leyden[1], Yuichi Kato[1], Sonia R. Raga[1], Michael V. Lee[1], Yabing Qi[1]	1.Okinawa Inst. Sci. Tech. Graduate Univ.
	14:30 - 14:45	11p-B6-4	ペロブスカイト型複酸化物を用いたダブルレイヤー型色素増感太陽電池の作製	○岡本 裕二[1], 鈴木 義和[1]	1.筑波大数理物質
	14:45 - 15:00		休憩/Break		
招待	15:00 - 15:30	11p-B6-5	**ペロブスカイト太陽電池ー赤外光電変換とPb free ペロブスカイト太陽電池を目指してー**	**○早瀬 修二[1]**	**1.九工大**
招待	15:30 - 16:00	11p-B6-6	**ペロブスカイト太陽電池のデバイスシミュレーション**	**○峯元 高志[1]**	**1.立命館大**
	16:00 - 16:15	奨 11p-B6-7	$Cu_2ZnSn(S,Se)_4$太陽電池におけるハイブリッドバッファ層の検討	○松尾 寿大[1], 廣庭 大輔[1], 酒井 紀行[2], 加藤 拓也[2], 杉本 広紀[2], 峯元 高志[1]	1.立命大, 2.Solar Frontier社
招待	16:15 - 16:45	11p-B6-8	**カルコパイライト系太陽電池の産業化の現状**	**○杉本 広紀[1]**	**1.ソーラーフロンティア㈱**
	16:45 - 17:00	11p-B6-9	化合物薄膜とペロブスカイト太陽電池融合の可能性(おわりに)	○櫻井 岳暁[1]	1.筑波大数理

1 応用物理学一般 / Interdisciplinary Physics and Related Areas of Science and Technology

1.1 応用物理一般・学際領域 / Interdisciplinary and General Physics　ポスター講演

3月12日(木)　13:30 - 15:30

		奨 12p-P1-1	アニーリング法による金ナノ微粒子層作成と真空Plasma処理による影響	○藪田 有希[1], 堀江 莉子[1], 近藤 淳[1]	1.静岡大工
		12p-P1-2	高空間分解能な静電気分布計測のためのセンサアレイの開発	○菊永 和也[1], 江頭 正浩[1], 山下 博史[1], 檜枝 龍美[1], 野中 一洋[1]	1.産総研
		12p-P1-3	粉末状の電極を有する誘電エラストマーアクチュエータの特性	○(B)山内 優幸[1]	1.芝浦工大工
		12p-P1-4	アルゴン雰囲気中ta-C薄膜の深紫外光照射損傷	○神津 知己[1,2], 山口 誠[3], 川口 雅弘[4], 西田 謙[2]	1.レニショー株式会社, 2.防衛大学校, 3.秋田大学, 4.都立産技研センター
		12p-P1-5	回転スクリーンを用いた体積型立体表示－渦巻型スクリーンによるちらつき感の評価－	鈴木 慎之介[1], ○藤川 知栄美[1], 面谷 信[1]	1.東海大工

1.1 応用物理一般・学際領域 / Interdisciplinary and General Physics　口頭講演

3月13日(金)　16:30 - 19:00

招待	16:30 - 16:45	13p-D12-1	**「講演奨励賞受賞記念講演」(15分) 学生プロジェクトによる理科実験授業におけるタブレット端末の活用方法に関する検討**	**○手島 駿[1], 長谷川 誠[1]**	**1.千歳科技大**
	16:45 - 17:00	奨 13p-D12-2	多孔質ガラスとフッ素オイルを用いた固体/液体複合撥水材料の作製とその動的撥水性	○高田 康寛[1], 酒井 宗寿[2], 磯部 敏宏[1], 松下 祥子[1], 中島 章[1]	1.東工大院理工, 2.山口東理大先材研
	17:00 - 17:15	奨 13p-D12-3	固体/液体複合材料における固体表面処理が濡れ性に与える影響	○横山 広大[1], 酒井 宗寿[2], 磯部 敏宏[1], 松下 祥子[1], 中島 章[1]	1.東工大理工, 2.山口東京理科大先材研
	17:15 - 17:30	奨 13p-D12-4	回転分裂法を用いた静電浮遊液滴の粘性係数測定	○(M1)綿引 壮真[1], 松本 聡[2], 金川 哲也[1], 金子 暁子[1], 阿部 豊[1]	1.筑波大, 2.JAXA
	17:30 - 17:45	E 13p-D12-5	Highly Accurate Local Pseudopotentials for Large-Scale Materials Simulations with Orbital FreeDensity Functional Theory	○Sergei Manzhos[1], Fleur Legrain[1]	1.Natl Univ Singapore
	17:45 - 18:00	13p-D12-6	ウコン色素/n-Si/p-Si接合ダイオードの光応答特性	○兼城 千波[1], 内間 大輔[1], 濱田 泰輔[1]	1.沖縄高専
	18:00 - 18:15	奨 13p-D12-7	フレーザー・ウィルコックス錯視のメカニズム検証	○大槻 一博[1], 面谷 信[1]	1.東海大学工
	18:15 - 18:30	13p-D12-8	バーゲン錯視のメカニズム解明	○野原 祐一郎[1], 面谷 信[1]	1.東海大工
	18:30 - 18:45	奨 13p-D12-9	ヘルムホルツ共振器を用いた平面型音響ノッチフィルター素子	○磯崎 瑛宏[1], 高橋 英俊[1], 田村 洋人[1], 高畑 智之[1], 松本 潔[1], 下山 勲[1]	1.東大
	18:45 - 19:00	13p-D12-10	ヴァイオリンの胴体内の空気の温度変化による空気共鳴モードA0周波数のシフト	○松谷 晃宏[1]	1.東工大半導体MEMS

1.2 教育 / Education　ポスター講演

3月13日(金)　16:30 - 18:30

		13p-P1-1	LEDライトを用いたヤングの干渉実験(II)	○大向 隆三[1], 草薙 栄理子[1], 関川 留都[1], 近藤 一史[1]	1.埼玉大教育
		13p-P1-2	フィルター回路を用いた光電効果信号の高感度検出(II)	○大向 隆三[1], 小林 憲治[1], 國料 樹[1]	1.埼玉大教育
		13p-P1-3	ホロカソードランプを用いた光電効果実験(V)	○松本 龍馬[1]	1.埼玉大教育
		13p-P1-4	相対性理論の数学的破綻の証明	○土田 成能[1]	1.ダビンチ研
		13p-P1-5	セルオートマトンを用いた半導体シミュレータ(2)	○大豆生田 利章[1]	1.群馬高専
		13p-P1-6	ArduinoとLabVIEWを用いた偏光計測実験教材の開発	○大久保 進也[1]	1.沼津高専
		13p-P1-7	マイコンのタッチセンサ機能を用いた微小静電容量の測定	○出口 幹雄[1]	1.新居浜高専

		13p-P1-8	演示用の原子吸収スペクトル装置の開発	○塚林 功[1], 関 一[1], 佐藤 杉弥[2]	1.いろは理科工房, 2.日本工大
		13p-P1-9	小型水箱を用いた光の屈折の授業プログラムの研究	○千葉 芳明[1], 西條 敏剛[2], 本田 亮[3]	1.宮城教大, 2.宮城県白石高, 3.鳴門教大
		奨 13p-P1-10	バイポーラ・トランジスタの負性抵抗特性を利用した簡易なLED点滅回路	○(M1)林田 宗志[1], 小山 英樹[1]	1.兵庫教育大院
		13p-P1-11	霧箱中の飛跡で求めるβ線のエネルギー分布	○足利 裕人[1]	1.鳥取環境大学
		13p-P1-12	螺旋プラズマ演示実験装置の開発	○服部 邦彦[1], 塚林 功[1], 佐藤 杉弥[1], 安藤 晃[2]	1.日本工大, 2.東北大工
		13p-P1-13	高校生(SSH)の指導による小学生のための科学教室「屈折望遠鏡」	○鈴木 恒則[1], 中村 春樹[2], 山田 武範[2], 藤城 武彦[1]	1.東海大理, 2.東海大高輪台高校
		13p-P1-14	LED位置センサを利用した力学実験装置の改良	○河野 託也[1], 國光 拓実[1]	1.岐阜高専
		13p-P1-15	永久磁石の直径を小さくした場合のホール効果	○安森 偉郎[1], 岡田 工[2], 崔 一焕[2]	1.東海大教育研, 2.東海大チャレンジセンター
		13p-P1-16	振動発電を使った教材開発(IV)	○木村 花梨[1], 山本 優[1], 川内 つぐみ[1], 八並 愛佳[1], 山田 亜紀[1], 小栗 和也[1]	1.東海大 教養
		13p-P1-17	空気の力と浮力に関する小学生向け科学教室の実践	○葛生 伸[1], 香川 喜一郎[2]	1.福井大院工, 2.ふくい科学学園
		13p-P1-18	幼児に対する科学教育の実践 ～物理分野に興味を持たせる実験教室の考察～	○月僧 秀弥[1], 稲垣 裕介[2], 早武 真理子[2], 葛生 伸[3]	1.坂井市立三国中学校, 2.(公財)日本科学技術振興財団, 3.福井大院工
		奨 13p-P1-19	紫キャベツ色素増感型太陽電池を教材とした科学スクールの開催	○奥村 高史[1], 中野 寛之[1], 佐伯 平二[1], 森 豪[1]	1.愛工大
		13p-P1-20	低コストICTによるリアルタイム教育支援システムの開発	○渡邊 悠[1], 樺澤 匠[1], 湯沢 友之、鶴岡 誠[1]	1.東京工科大
		13p-P1-21	2015物理チャレンジ合宿実験研修の教育的効果	○毛塚 博史[1], 中屋敷 勉[2], 真梶 克彦[3], 興治 文子[4]	1.東京工科大, 2.岡山県立一宮高, 3.筑波大学附属駒場中・高, 4.新潟大教育
		13p-P1-22	シングルボードコンピュータと無線モジュールを利用した物理実験のデータ管理システム	○伊多波 正徳[1]	1.茨城大工
		13p-P1-23	『仮説実験講座』における学生スタッフ体験を通じた理科教職課程履修生のアクティブラーニング	○中村 敏浩[1], 舟橋 春彦[1,2], 宮地 祐司[1,3]	1.大阪電通大工, 2.京大国際高等教育院, 3.NPO楽知ん研究所
		13p-P1-24	中学校理科/技術科教育における電圧電流概念の体験的学習用教材	○改正 清広[1]	1.静大教
		13p-P1-25	工学系人材育成のための学校外/家庭学習用教材の開発	○改正 清広[1]	1.静大教
		13p-P1-26	学生プロジェクトチームによる科学啓発活動の学生教育効果	○長谷川 誠[1], 手島 駿[1]	1.千歳科技大
		奨 13p-P1-27	砂糖水の旋光による白色LED出射光の透過スペクトルの遷移	○徳光 聖茄[1], 浜松 霞[1], 前田 智美[1], 大川七海[1], 長谷川 誠[1]	1.千歳科技大
		13p-P1-28	イベントでの使用を目的とした銀塩ホログラム撮影システム	○平谷 雄二[1]	1.広国大工
		13p-P1-29	小型無線センサーを用いた振動実験教材化II	○鈴木 三男[1], 増田 健二[2]	1.福島高専, 2.静岡大工
		13p-P1-30	風力で動作するホバークラフトの教材としての検討	○山口 静夫[1]	1.九共大総研
		13p-P1-31	プロジェクションマッピングの教材への応用	鈴木 施哉[1], 菅原 詩織[1], ○原田 建治[1]	1.北見工大情報システム
		13p-P1-32	"見えた!" ～驚きをやる気に変える教材の提案～	○菅原 詩織[1], 浅野目 祥[1], 原田 建治[1]	1.北見工大
		13p-P1-33	蛍光偏光度測定装置におけるデータ処理プログラムの開発	○東城 裕樹[1], 渡邊 悠[1], 樺澤 匠、古家 竜之輔[1], 湯沢 友之、鶴岡 誠[1]	1.東京工科大
		13p-P1-34	電気泳動を用いた科目横断教材の開発(2)	○田島 佳奈[1], 伊藤 光平[1], 小林 かおり[1], 小栗 和也[1]	1.東海大 教養
		13p-P1-35	グラスハープを使用した教材開発(III)	○深澤 里菜[1], 斉藤 沙季[1], 大沼 梨菜[1], 藤居奈々[1], 小栗 和也[1]	1.東海大 教養
		13p-P1-36	創造理工学実験における"ものづくり基礎実験教育"用実験テーマの開発	○伊藤 智幹[1], 岡島 茂樹[1], 柴田 祥一[1], 佐藤元泰[1], 伊藤 響[1], 阪田 泉[1], 中山 和也[1], 井筒潤[1], 大嶋 晃敏[1], 上田 洋征[1], 伊藤 幸雄[1]	1.中部大工
		13p-P1-37	米海軍佐世保基地の小学生を対象とした専門英語による理科実験教室	○柳生 義人[1], 西口 廣志[1], 石貫 文子[1], 中尾 充宏[1]	1.佐世保高専
		13p-P1-38	リバースエンジニアリングを活用した教育教材の開発	○林 和彦[1], 幾久 健[1], 石本 辰哉[1]	1.呉高専
		13p-P1-39	Arduinoを利用した物理教材開発	○佐藤 杉弥[1]	1.日本工大
		13p-P1-40	ボルダの振り子における周期の正弦的変化	○近藤 一史[1], 柴崎 健多[1], 石田 卓矢[1], 大向隆三[1], 津田 俊信[1]	1.埼玉大教育

1.3 新技術・複合新領域 / Novel technologies and interdisciplinary engineering　口頭講演

3月11日(水)　13:15 - 17:00

招待	13:15 - 13:45	11p-D13-1	**「応用物理学一般 分科内招待講演」(30分)** **MOD法により製作したVOxマイクロボロメータ素子の検出特性**	**○内田 貴司[1], 立木 隆[1]**	**1.防衛大電気電子**
	13:45 - 14:00	11p-D13-2	マテリアルキュレーション:材料情報の活用による材料探索例3	○吉武 道子[1]	1.物材機構
	14:00 - 14:15	11p-D13-3	ガス浮遊法による酸化物高屈折率ガラスの製造と大型化	○依田 真一[1,2], 今井 良二[3], Won-Seung Cho[4]	1.熊本大学, 2.JAXA, 3.室蘭工大, 4.仁荷大学
	14:15 - 14:30	奨 11p-D13-4	超薄膜Pt/Tiを用いたブリッジ型水素センサの開発	○井並 祥太[1], 牛田 祐貴[2], 武市 修蔵[2], 菅井良祐[2], 堺 健司[2], 紀和 利彦[2], 塚田 啓二[2]	1.岡山大工, 2.岡山大自然
	14:30 - 14:45	11p-D13-5	in-situ電気伝導測定による金触媒の反応機構の解析	○前田 泰[1], 飯塚 泰雄[1], 香山 正憲[1]	1.産総研
	14:45 - 15:00		休憩/Break		
	15:00 - 15:15	11p-D13-6	トップダウン・ボトムアップ統合アプローチによるポリスチレン四重極子の作製	○高橋 毅[1], 松谷 晃宏[2], 庄司 大[2], 西岡 國生[2], 佐藤 美那[2], 磯部 敏宏[1], 中島 章[1], 松下 祥子[1]	1.東工大院理工, 2.東工大半導体MEMS
	15:15 - 15:30	11p-D13-7	磁気配列法による微粒子2次元周期配列構造の形成	○青木 画奈[1], 藤井 稔[1]	1.神戸大工
	15:30 - 15:45	奨 11p-D13-8	光トラップによる気液界面の付着力の評価	○細田 駿介[1], 高澤 曹[1], 山西 陽子[1,2]	1.芝浦工大, 2.JSTさきがけ

	15:45 - 16:00	11p-D13-9	表面処理を利用した高感度光ファイバーセンサーの開発	○木口 崇彦[1], 伊澤 昂汰[2], Li Oi Lun[2,3], 齋藤 永宏[1,2,3,4]	1.名大未来社会, 2.名大院工, 3.JST COI STREAM, 4.名大グリモ
	16:00 - 16:15	11p-D13-10	唾液グルコースのためのマウスガード型バイオセンサに関する研究	○仁田 大輝[1], 黒木 祐輔[1], 當麻 浩司[1], 荒川 貴博[1], 三林 浩二[1]	1.医科歯科大
	16:15 - 16:30	11p-D13-11	血糖値制御のための薬物放出システムにおけるグルコース駆動式減圧機構の高出力化	○栗原 康司[1], 佐藤 怜[1], 松浦 佑樹[1], ムンフジャルガル ムンフバヤル[1], 當麻 浩司[1], 荒川 貴博[1], 齊藤 浩一[2], 三林 浩二[1]	1.医科歯科大, 2.東京高専
	16:30 - 16:45	11p-D13-12	バイオ化学発光を用いた嗅覚カメラによる手掌エタノールガスの可視化計測	○飯谷 健太[1], 佐藤 敏征[1], 當麻 浩司[1], 荒川 貴博[1], 三林 浩二[1]	1.医科歯科大
	16:45 - 17:00	11p-D13-13	シングルビーム原子磁力計におけるゼロ磁場校正	○佐々木 耀一[1], 大坊 真洋[1]	1.岩手大工

1.3 新技術・複合新領域 / Novel technologies and interdisciplinary engineering　ポスター講演

3月12日(木)　13:30 - 15:30

		奨 12p-P2-1	ポリマー製フォトニック結晶共振器の作製・評価	○前野 権一[1], 安藝 翔馬[1], 末吉 健志[1], 久本 秀明[1], 遠藤 達郎[1]	1.阪府大院工
		12p-P2-2	プリンテッドプラズモニック結晶のラマン分光分析への応用	○遠藤 達郎[1], 梶田 浩志[2], 末吉 健志[1], 田中 覚[2], 久本 秀明[1]	1.阪府大院工, 2.SCIVAX株
		12p-P2-3	TiO_2/ポリマーハイブリッド型2次元フォトニック結晶を用いた面発光蛍光増強デバイスの開発	○安藝 翔馬[1], 前野 権一[1], 久本 秀明[1], 末吉 健志[1], 遠藤 達郎[1]	1.阪府大院工
		12p-P2-4	金堆積ナノインプリンテッドプラズモニック結晶の作製と非標識バイオセンサーへの応用	○西口 輝一[1], 末吉 健志[1], 久本 秀明[1], 遠藤 達郎[1]	1.阪府大工
		12p-P2-5	Dee-RIEにより深掘りエッチングされたSiエッチング側面のEDX分析	○佐藤 美那[1], 西岡 國生[1], 庄司 大[1], 松谷 晃宏[1]	1.東工大 半導体MEMSプロセス技術センター
		12p-P2-6	液体定在波を利用した酵母細胞の流路レス凝集パターンの振動周波数による制御	○松谷 晃宏[1], 髙田 綾子[2]	1.東工大半導体MEMS, 2.東工大バイオ技術
		12p-P2-7	小望遠鏡とデジタル一眼レフカメラによる太陽黒点の温度推定における観測波長領域の影響について	○松谷 晃宏[1]	1.東工大半導体MEMS
		12p-P2-8	衝撃圧縮されたポルサイト蛍光体の評価	○(M1)濱田 翔[1], 岸村 浩明[1], 冨永 悠貴[1], 守住 志洋[1], 有賀 敦[1], 松本 仁[1]	1.防大材料
		12p-P2-9	衝撃圧縮法による赤色蛍光体Y_2O_3:Eu^{3+}の改質	○岸村 浩明[1], 濱田 翔[1], 守住 志洋[1], 有賀 敦[1], 松本 仁[1]	1.防衛大材料
		12p-P2-10	衝撃圧縮法によるBi系酸化物超伝導体結晶粒の育成における圧力依存性及びシード効果	○中村 峰大[1], 富岡 成矢[1], 中村 悟士[1], 吉村 徹三[1], 毛塚 博史[1], 亀谷 崇樹[2], Chen Liliang[2], 真下 茂[2], 岸村 浩明[3], 松本 仁[3], 有沢 俊一[4], 遠藤 和弘[5]	1.東京工科大, 2.熊本大, 3.防衛大, 4.物質材料研究機構, 5.金沢工業大
		12p-P2-11	強い重力場による強磁性炭化物の合成	○緒方 裕大[1], 真下 茂[1], 徳田 誠[1], 吉朝 朗[1]	1.熊大

1.4 エネルギー変換・貯蔵 / Energy conversion and storage　ポスター講演

3月11日(水)　9:30 - 11:30

		11a-P1-1	レーザー焼成還元金属ナノペーストを用いた熱電変換素子の開発	○(M1)李 妍楠[1], 佐伯 拓[1], 飯田 幸雄[1]	1.関西大学 システム理工
		11a-P1-2	二酸化炭素励起用中赤外固体レーザーの開発	○佐藤 篤[1], 那須 祥彦[1], 三宅 良宜[1], 丸尾 容子[1]	1.東北工大工
		11a-P1-3	自己集合性ペプチドと有機金属錯体で形成された化学モーターによるマイクロ発電機	○池添 泰弘[1,2], Fang Justin[2], Wasik Tomasz L.[2], 植村 卓[3,4], Zheng Yongtai[3,5], 北川 進[3,5], 松井 宏[2]	1.日工大, 2.NY市大, 3.京大院工, 4.CREST-JST, 5.iCeMS
		11a-P1-4	イオン液体を電解液に用いたリチウムイオン電池における黒鉛負極上の表面皮膜の役割	○岸田 和久[1,2], 中川 清晴[1,2], 小田 廣和[1,2]	1.関大理工, 2.HRC
		11a-P1-5	金属元素を担持した活性炭の水素吸蔵能の評価	○田村 知樹[1], 大竹 尚登[1], 赤坂 大樹[1]	1.東工大
		11a-P1-6	ひずみイメージングによるリチウムイオン二次電池正極材$LiCoO_2$のイオン吸蔵放出の非破壊その場計測	○(B)佛願 建太[1]	1.関大システム理工
		11a-P1-7	高速充放電Liイオン電池に向けた強誘電体－活物質コンポジット正極	○寺西 貴志[1], 吉川 祐未[1], 佐久間 諒[1], 橋本 英樹[1], 林 秀考[1], 藤井 達生[1], 岸本 昭[1]	1.岡山大工
		11a-P1-8	リチウムイオン二次電池のひずみイメージングにおける電圧印加方法の影響	○(B)大坂 隆馬[1]	1.関大システム理工
		11a-P1-9	リチウムイオン二次電池セパレータの熱による構造変化	○松下 友紀[1]	1.関大システム理工
		11a-P1-10	シリコンVLSI技術を用いて試作した100×100 ミクロン平方全固体型リチウムイオン2次電池	○内野 将也[1], 野崎 孝明[1], 栗山 一男[1], 串田 一雅[2]	1.法大理工, 2.大阪教育大
		奨・E 11a-P1-11	Study of time-resolved photoluminescence (TR-PL) in Cu_2Zn-$Sn(S,Se)_4$ thin films with different Cu/Sn ratio.	○Mohammad Abdul Halim[1], Muhammad Monirul Islam[1], Xianjia Luo[1], Takeaki Sakurai[1], Noriyuki Sakai[2], Takuya Kato[2], Hiroki Sugimoto[2], Hitoshi Tampo[3], Hajime Shibata[3], Shigeru Niki[3], Katsuhiro Akimoto[1]	1.University of Tsukuba, 2.Solar Frontier, 3.AIST
		11a-P1-12	熱放射スペクトル制御材料を用いた高効率ソーラー熱光起電力発電	○清水 信[1], 小桧山 朝華[1], 酒井 淳[1], 柳澤 邦彦[1], 井口 史匡[1], 湯上 浩雄[1]	1.東北大院工
		11a-P1-13	バイオマスからエネルギー調達	○(M2)長島 雄志[1]	1.玉川大工
		11a-P1-14	メタンの低温水蒸気改質の実験的研究	○(B)北川 聖[1], 高橋 克己[1], 小原 宏之[1]	1.玉川大学TSCP
		11a-P1-15	CNTを用いた微生物燃料電池の試作	○(M1C)倉嶋 一塁[1], 高橋 克己[1], 小原 宏之[1]	1.玉川大学 TSCP

1.4 エネルギー変換・貯蔵 / Energy conversion and storage　口頭講演

3月12日(木)　9:00 - 12:45

	9:00 - 9:15	奨 12a-D12-1	熱音響機関のためのリニア発電機の設計および評価	○(M1)大西 紘平[1], 長谷川 真也[2], 木村 英樹[2]	1.東海大院工, 2.東海大工
	9:15 - 9:30	E 12a-D12-2	Efficient and Stable Solution-Processed Planar Perovskite Solar Cells	○Chuanjiang Qin[1], Toshinori Matsushima[1], Chiahaya Adachi[1]	1.Kyushu Univ.
	9:30 - 9:45	12a-D12-3	TiO_2上に坦持したAgPd@Pd微粒子を用いた高効率ギ酸分解水素生成	○(PC)服部 真史[1], 永長 久寛[2], 辻 正治[1]	1.九大先導研, 2.九大総理工
	9:45 - 10:00	E 12a-D12-4	Amorphous Carbon Is a Promising Material for Sodium Ion Battery Anodes: a Computational Study	○Sergei Manzhos[1], Fleur Legrain[1], Konstantinos Kotsis[1]	1.Natl Univ Singapore
	10:00 - 10:15	12a-D12-5	マイクロ構造とナノ構造が融合したリチウムイオン電池負極	○山浦 大地[1], 荻野 俊郎[1,2]	1.横浜国大, 2.CREST/JST
	10:15 - 10:30	12a-D12-6	舶用液体水素タンク内部の熱流体解析	○(M2)塚本 博志[1], 武田 実[1]	1.神戸大海事
	10:30 - 10:45	12a-D12-7	酸素分圧の異なる雰囲気における電子線照射が及ぼす$LaNi_{4.6}Al_{0.4}$水素吸蔵合金の電気化学的水素吸収速度への影響	○徳平 真之介[1], 阿部 浩之[2], 内田 裕久[1]	1.東海大応用理学, 2.(独)日本原子力研究開発機構
	10:45 - 11:00	12a-D12-8	液中プラズマ法を用いたCNT表面へのPt触媒の形成とその燃料電池への応用	○(M1)上野 雄太郎[1], 庄 善之[1]	1.東海大工
	11:00 - 11:15		休憩/Break		
	11:15 - 11:30	12a-D12-9	金属触媒ウエットエッチングによる多結晶固定砥粒シリコンウェーハに対するテクスチャー	○北垣内 圭二[1], 熊谷 晃[1]	1.JET
	11:30 - 11:45	奨 12a-D12-10	単色放射に対する太陽電池エネルギー変換効率の波長依存性	○(M1)武澤 港斗[1], 齋藤 輝文[1]	1.東北工大院工
	11:45 - 12:00	12a-D12-11	太陽光発電パネル上積雪の通電加熱による除雪	○齋藤 輝文[1,2], 柴崎 浩一郎[1], 武澤 港斗[2], 二田 祐也[1], 初谷 博[3], 味原 真穂[3], 宍戸 保範[3], 杉山 丞[4]	1.東北工大工, 2.東北工大院工, 3.㈱吉岡, 4.㈱タニタハウジングウェア
	12:00 - 12:15	12a-D12-12	蛍光導波路型ソーラーコレクタにおける変換効率の形状依存性	○(M2)向原 悠香[1], 若木 守明[1], 渋谷 猛久[1], 浅川 久志[2], 名執 洵子[2]	1.東海大工, 2.丸茂電機
	12:15 - 12:30	12a-D12-13	大電力用電気二重層キャパシター型電池の1提案(II)	○川端 啓介	
	12:30 - 12:45	12a-D12-14	ソーラーカーの表面圧力測定に基づく空力性能評価	○(M2)関川 陽[1], 木村 英樹[1], 福田 紘大[1], 春田 憲一[1], 大塚 隆司[1]	1.東海大工

1.5 資源・環境 / Resources and environment　口頭講演

3月11日(水)　10:00 - 11:30

	10:00 - 10:15	11a-D12-1	溶媒浸漬に伴う両極性NIPAゲルの体積の経時変化	○大庭 崇弘[1], 西本 貴士[1], 日高 芳樹[1], 岡部 弘高[1], 原 一広[1]	1.九大院工
	10:15 - 10:30	11a-D12-2	ナノポーラスカーボンの真密度とその分類	○朱 傑[1], 戸田 育民[1], 大塩 茂夫[1], 小松 啓志[1], 津田 欣範[2], 齋藤 秀俊[1]	1.長岡技科大, 2.ヒューズ・テクノネット
	10:30 - 10:45	11a-D12-3	賦活強度が異なる籾殻由来ナノポーラスカーボンの真密度	○朱 傑[1], 戸田 育民[1], 大塩 茂夫[1], 小松 啓志[1], 津田 欣範[2], 齋藤 秀俊[1]	1.長岡技科大, 2.ヒューズ・テクノネット
	10:45 - 11:00	11a-D12-4	ナノポーラスカーボンによるCO_2およびCH_4吸着挙動の温度依存性	○石橋 佳国[1], 李 観成[1], 戸田 育民[1], 小松 啓志[1], 大塩 茂夫[1], 津田 欣範[2], 齋藤 秀俊[1]	1.長岡技科大, 2.ヒューズテクノネット
	11:00 - 11:15	11a-D12-5	グラフェンの紙基板への転写とその特性	○大久保 貴雅[1], 奥村 竜二[1], 張 棲岩[2], 佐藤 利文[2], 市川 洋[1]	1.名古屋工業大学, 2.東京工芸大学
	11:15 - 11:30	11a-D12-6	再利用可能なサファイアフィルタを用いた希少金属の回収	○太子 敏則[1,2]	1.信大環境エネ研, 2.信大COI

1.5 資源・環境 / Resources and environment　ポスター講演

3月12日(木)　13:30 - 15:30

		奨 12p-P3-1	Ti-Cr-Mn系水素吸蔵合金の作製及び水素吸蔵特性の検討	○Zholdayakova Saule[1], 内田 晴久[1]	1.東海大
		12p-P3-2	汎用性に富むクリーン環境CUSP ～ 太陽電池作製プラットフォームから居住空間応用まで	○石橋 晃[1,2], 大橋 美久[2]	1.北大電子研, 2.シーズテック㈱
		12p-P3-3	深紫外LEDを用いたオゾン濃度測定装置の開発	○中村 広隆[1], 武田 有志[1], 菅野 裕靖[2], 阿彦 由美[2], 青柳 克信[3]	1.都産技研, 2.(有)光電鍍工業所, 3.立命館大

1.6 計測技術・計測標準 / Instrumentation, measurement and Metrology　ポスター講演

3月13日(金)　9:30 - 11:30

		13a-P1-1	数値演算による精密な位相雑音と振幅雑音の算出	柳町 真也[1], ○平野 育[1], 池上 健[1], 和田 雅人[1], 萩本 憲[1], 高見澤 昭文[1]	1.産総研
		13a-P1-2	パラジウム添加セラミックスの反応熱を利用した水素ガス検知	○相沢 宏明[1], 勝亦 徹[1], 小室 修二[1]	1.東洋大理工
		13a-P1-3	搬送波位相衛星双方向測定による仲介水素メーザー不要の光時計絶対周波数測定	○藤枝 美穂[1], 井戸 哲也[1], 後藤 忠広[1], 瀧口 博士[1], 早坂 和弘[1], 豊田 健二[2], 米垣 賢治[2], 田中 歌子[2], 占部 伸二[2]	1.情通機構, 2.阪大基礎工
		13a-P1-4	UTCrを用いたUTC(NICT)の高度化	○中川 史丸[1], 花土 ゆう子[1], 今村 國康[1], 伊東 宏之[1]	1.情報通信研究機構

1.6 計測技術・計測標準 / Instrumentation, measurement and Metrology　口頭講演

3月14日(土)　9:00 - 11:15

	9:00 - 9:15	14a-D12-1	振動抑制冷凍機を用いた低温サファイア発振器の周波数安定度の評価	○池上 健[1], 渡部 謙一[1], 柳町 真也[1], 平野 育[1], 萩本 憲[1], 高見澤 昭文[1], ハートネット ジョン[2]	1.産総研, 2.アデレード大
	9:15 - 9:30	14a-D12-2	温度安定型水晶振動子を用いた水素漏洩検知器におけるプリアンプの 温度特性の影響	○鈴木 淳[1], 北條 久男[2], 小林 太吉[3]	1.産総研, 2.パキュームプロダクツ, 3.ブイピイアイ
	9:30 - 9:45	奨 14a-D12-3	熱モードスペクトロスコピーを用いた微小試料に対する新しい熱伝導率計測法の開発	○石原 達也[1], 荻 博次[1], 石田 秀士[1], 平尾 雅彦[1], マリス ハンフリー[2]	1.阪大院基, 2.ブラウン大

	9:45 - 10:00	14a-D12-4	キャビティリングダウン分光法によるガス中微量水分の自動測定システ	○阿部 恒[1], リサク ダニエル[2], シガン アガタ[2], チュレオ ローマン[2]	1.産総研, 2.コペルニクス大学
	10:00 - 10:15	奨 14a-D12-5	アルゴン中微量水分標準の開発	○天野 みなみ[1], 阿部 恒[1]	1.産総研
	10:15 - 10:30	14a-D12-6	スーパーコンティニュアム光を用いた絶対放射温度計の分光感度校正	○山口 祐[1], 山田 善郎[1]	1.産総研
	10:30 - 10:45	14a-D12-7	テラヘルツカロリメータの直線性評価	○飯田 仁志[1], 木下 基[1], 雨宮 邦招[1], 島田 洋蔵[1]	1.産総研
	10:45 - 11:00	奨 14a-D12-8	核四極共鳴信号計測のためのオートチューニングシステム	○佐藤 晋大[1], 赤羽 英夫[1], 糸崎 秀夫[1]	1.阪大院基礎工
	11:00 - 11:15	14a-D12-9	量子電圧雑音源を用いた熱雑音の精密測定によるボルツマン定数の評価	○浦野 千春[1], 吉田 俊介[3], 岡崎 雄馬[1], 山田 隆宏[2], 山澤 一彰[1], 山森 弘毅[2], 福山 康弘[1], 金子 晋久[1], 丸山 道隆[1], 堂前 篤志[1], 丹波 純[1], 桐生 昭吾[3]	1.産総研計測標準, 2.産総研ナノエレ, 3.東京都市大
	3月14日(土) 13:00 - 14:15				
	13:00 - 13:15	14p-D12-1	液中粒子数濃度測定の不確かさ評価と一次標準の開発	○坂口 孝幸[1]	1.産総研
	13:15 - 13:30	14p-D12-2	単一微粒子の形状及び分光分布の解析	○星野 鉄哉[1], 伊藤 雅英[1]	1.筑波大数物
	13:30 - 13:45	14p-D12-3	ウェハ表面パーティクル検査装置校正用の粒子数基準ウェハの開発	○田島 奈穂子[1], 飯田 健次郎[1,2], 榎原 研正[2], クンプアン ソマワン[1,2], 原 史朗[1,2]	1.ミニマルファブ技術研究組合, 2.産総研
	13:45 - 14:00	14p-D12-4	アガロースゲルの誘電特性	岩本 晋司[1], ○飯野 正昭[1]	1.千葉工大工
	14:00 - 14:15	14p-D12-5	応力発光を介した応力履歴記録ペイント	○寺崎 正[1], 徐 超男[1]	1.産業技術総合研究所

1.7 超音波 / Ultrasonic　口頭講演

3月11日(水) 13:15 - 17:15

招待	13:15 - 13:30	11p-D12-1	**「講演奨励賞受賞記念講演」(15分) 極低温ピコ秒超音波法を用いた異なるキャリア密度のGaNに対するキャリアダイナミクスの観測**	**○長久保 白[1], 石原 達也[1], 荻 博次[1], 中村 暢伴[1], 平尾 雅彦[1]**	**1.阪大基礎工**
	13:30 - 13:45	奨 11p-D12-2	180°, 90R散乱配置を用いたBrillouin散乱計測によるGaNの弾性定数測定	○市橋 隼人[1], 柳谷 隆彦[2], 高柳 真司[1], 川部 昌彦[1], 松川 真美[1]	1.同志社大, 2.名工大
	13:45 - 14:00	11p-D12-3	$Ca_3Ta(Ga_{0.5}Al_{0.5})_3Si_2O_{14}$単結晶のAl置換による音響特性への影響の検討	○大橋 雄二[1], 工藤 哲男[1], 横田 有為[2], 庄子 育宏[3], 黒澤 俊介[1,2], 鎌田 圭[2,3], 吉川 彰[1,2,3]	1.東北大金研, 2.東北大NICHe, 3.C&A
	14:00 - 14:15	11p-D12-4	圧電-誘電体周期構造を用いた音響ダイオードの設計	○岩崎 裕平[1], 石川 篤[1], 鶴田 健二[1]	1.岡山大院自然
	14:15 - 14:30	11p-D12-5	骨の超音波誘電磁応答の異方性	○(M1)渡部 翔[1], 山田 尚人[1], 生嶋 健司[1], 新実 信夫[2], 小島 良績[2]	1.農工大院工, 2.日本シグマックス(株)
	14:30 - 14:45	奨 11p-D12-6	骨トランスデューサから放射されるMHz域の超音波測定	○(B)松川 沙弥果[1], 常田 裕子[1], 眞野 功[1], 高柳 真司[1], 松川 真美[1]	1.同志社大
	14:45 - 15:00	奨 11p-D12-7	音響共鳴現象と超音波パルスエコー法を利用したヒトiPS細胞塊の厚さと音速の実測	○齊藤 崇允[1], 松谷 巌[1], 大沼 清[1], 桑原 敬司[1], 近藤 みずき[1], 井原 郁夫[1]	1.長岡技科大工
	15:00 - 15:15	奨 11p-D12-8	超音波速度変化による脂肪肝診断のための組み合わせ型プローブ	○堀 誠[1], 横田 大輝[1], 真野 和音[1], 谷川 昇平[1], 和田 健司[1], 松中 敏行[1], 堀中 博道[1], 森川 浩安[2]	1.阪府大工, 2.阪市大医
	15:15 - 15:30		休憩/Break		
	15:30 - 15:45	奨 11p-D12-9	水銀からのマルチバブルソノルミネセンス	○山中 泰智[1], 崔 博坤[1]	1.明大理工
	15:45 - 16:00	11p-D12-10	広域加熱・局所冷却による閉じたき裂の超音波フェーズドアレイ映像化の定量解析	高橋 恒二[1], 猪 慶弘[1], ○小原 良和[1], 山中 一司[1]	1.東北大学
	16:00 - 16:15	11p-D12-11	高音速薄膜装荷によるリーキー弾性表面波の低損失化	○垣尾 省司[1], 保坂 桂子[1]	1.山梨大院
	16:15 - 16:30	11p-D12-12	宇宙機汚染管理を目的としたQCMアレイセンサの作製と評価	○土屋 佑太[1], 宮崎 英治[1], 美浦 由佳[1], 内田 修[1], 鈴木 浩一[1]	1.宇宙航空研究開発機構
	16:30 - 16:45	11p-D12-13	ゾルゲルSiOx膜を用いたボールSAW微量水分センサの低ガス流量における感度	○辻 俊宏[1], 渡邊 圭[1], 東出 祐介[1], 大泉 透[1], 竹田 宣生[1], 赤尾 慎吾[1], 塚原 祐輔[1], 山中 一司[1]	1.東北大
	16:45 - 17:00	11p-D12-14	アンダーサンプリングを用いた実用的ボールSAWセンサ	○辻 俊宏[1], 大泉 透[1], 竹田 宣生[1], 赤尾 慎吾[1], 塚原 祐輔[1], 山中 一司[1]	1.東北大
	17:00 - 17:15	11p-D12-15	デジタル式マイクロ流体システムを用いた血液凝固測定	大橋 紀之[1], ○近藤 淳[1]	1.静岡大

1.7 超音波 / Ultrasonic　ポスター講演

3月11日(水) 9:30 - 11:30

		奨 11a-P2-1	太陽光を利用した熱音響システムの研究 −円筒管内への光による熱入力−	○渡 健吾[1], 坂本 眞一[2], 渡辺 好章[1]	1.同志社大, 2.滋賀県立大
		奨 11a-P2-2	Ca、CaOHからのソノルミネセンス	○櫻田 浩樹[1], 崔 博坤[1]	1.明大理工
		奨 11a-P2-3	周波数の異なる弾性表面波デバイスを用いた霧化現象の評価	○(M1)杉山 達也[1], 木村 尚史[1], 近藤 淳[1]	1.静岡大
		11a-P2-4	弾性表面波による液滴搬送メカニズムの検討	深谷 智彦[1], ○近藤 淳[1]	1.静岡大

2 放射線 / Ionizing Radiation

2.1 放射線物理一般・検出器基礎 / Radiation physics and Detector fundamentals　ポスター講演

3月12日(木)　9:30 - 11:30

		12a-P1-1	Ce^{3+}を添加したCaB_2O_4結晶の熱蛍光及び輝尽蛍光特性	○藤本 裕[1], 柳田 健之[2], 越水 正典[1], 浅井 圭介[1]	1.東北大, 2.九工大
		12a-P1-2	希土類元素を添加したSiO_2ガラスの放射線応答特性	○藤本 裕[1], 柳田 健之[2], 越水 正典[1], 浅井 圭介[1]	1.東北大, 2.九工大
		12a-P1-3	無添加$LuVO_4$結晶のシンチレーション特性	○藤本 裕[1], 柳田 健之[2], 小島 孝広[3], 越水 正典[1], 浅井 圭介[1]	1.東北大, 2.九工大, 3.オキサイド
		12a-P1-4	Ce:$LiCaAlF_6$におけるシンチレーションの立ち上がり	○越水 正典[1], 柳田 健之[2], 福田 健太郎[3], 藤本 裕[1], 浅井 圭介[1]	1.東北大院工, 2.九工大, 3.トクヤマ
		12a-P1-5	Ce:$Gd_2Si_2O_7$におけるエネルギー移動過程の解析	○越水 正典[1], 柳田 健之[2], 藤本 裕[1], 浅井 圭介[1]	1.東北大院工, 2.九工大
		12a-P1-6	Biドーププラスチックシンチレータの高エネルギーX線検出特性	○越水 正典[1], Bertrand Guillaume[2], Hamel Matthieu[2], 岸本 俊二[3], 春木 理恵[3], 錦戸 文彦[4], 柳田 健之[5], 藤本 裕[1], 浅井 圭介[1]	1.東北大院工, 2.CEA Saclay, 3.KEK, 4.放医研, 5.九工大
		12a-P1-7	高圧合成法を用いたZnOセラミックスのシンチレーション特性	○渡邊 慶[1], 越水 正典[1], 柳田 健之[2], 滝澤 博胤[1], 藤本 裕[1], 浅井 圭介[1]	1.東北大工, 2.九工大
		12a-P1-8	Cs_3BiCl_6及び$Cs_3Bi_2Br_9$単結晶のX線に対する検出特性評価	○清水 真[1], 越水 正典[1], 岸本 俊二[2], 春木 理絵[2], 錦戸 文彦[3], 柳田 健之[4], 藤本 裕[1], 浅井 圭介[1]	1.東北大工, 2.KEK, 3.放医研, 4.九工大
		12a-P1-9	$Cs_3Bi_2Br_9$単結晶のシンチレーション特性及びドーパントによる影響	○清水 真[1], 越水 正典[1], 柳田 健之[2], 藤本 裕[1], 浅井 圭介[1]	1.東北大工, 2.九工大
		12a-P1-10	Hfナノ粒子含有プラスチックシンチレータの高エネルギーX線検出特性評価	○近野 唯[1], 越水 正典[1], 錦戸 文彦[2], 春木 理恵[3], 岸本 俊二[3], 柳田 健之[4], 藤本 裕[1], 孫彦[1], 浅井 圭介[1]	1.東北大, 2.放医研, 3.KEK, 4.九工大
		12a-P1-11	ハフニアナノ粒子含有プラスチックシンチレータのX線検出特性	○(B)平田 智之[1], 野口 多紀郎[1], 越水 正典[1], 岸本 俊二[2], 春木 理恵[2], 錦戸 文彦[3], 柳田 健之[4], 藤本 裕[1], 相田 努[1], 高見 誠一[1], 阿尻 雅文[1], 浅井 圭介[1]	1.東北大学工, 2.KEK, 3.放医研, 4.九工大
		12a-P1-12	中性子検出用Li含有型プラスチックシンチレータの開発	○(B)小田切 泰海[1], 越水 正典[1], 藤本 裕[1], 柳田 健之[2], 浅井 圭介[1]	1.東北大工, 2.九工大
		12a-P1-13	CsClおよびCsBr結晶におけるシンチレーション特性の比較	○佐伯 啓一郎[1], 越水 正典[1], 柳田 健之[2], 藤本 裕[1], 浅井 圭介[1]	1.東北大, 2.九工大
		12a-P1-14	Eu添加CsBr及びCsCl結晶のシンチレーション特性	○佐伯 啓一郎[1], 越水 正典[1], 柳田 健之[2], 藤本 裕[1], 浅井 圭介[1]	1.東北大, 2.九工大
		12a-P1-15	$CsRbZnCl_4$結晶シンチレータのオージェフリー発光特性	○佐伯 啓一郎[1], 越水 正典[1], 柳田 健之[2], 藤本 裕[1], 浅井 圭介[1]	1.東北大, 2.九工大
		12a-P1-16	$YBa_2Cu_3O_\delta$における放射線照射効果の緩和観察	○甲谷 拓也[1], 越水 正典[1], 浅井 圭介[1]	1.東北大工
		12a-P1-17	リン酸塩ガラス中のAg濃度とラジオフォトルミネッセンス特性の相関	○(B)田中 宏典[1], 藤本 裕[1], 越水 正典[1], 柳田 健之[2], 浅井 圭介[1]	1.東北大工, 2.九工大
		12a-P1-18	Cu添加リン酸塩ガラスにおけるラジオフォトルミネッセンス現象の観測	○(B)田中 宏典[1], 藤本 裕[1], 越水 正典[1], 柳田 健之[2], 浅井 圭介[1]	1.東北大工, 2.九工大
		12a-P1-19	シートタイプ蛍光ガラスを用いた放射線量分布の可視化	○宮本 由香[1], 図子 直城[2], 佐藤 文信[2], 飯田 敏行[2], 清水 喜久雄[2], 池口 琢磨[3], 南戸 秀仁[3], 井原 陽平[4], 稲田 禎一[5], 杉山 誠[1], 佐藤 典仁[1], 竹内 宣博[1], 山本 幸佳[1]	1.千代田テクノル, 2.大阪大学, 3.金沢工業大学, 4.EMFジャパン, 5.日立化成
		12a-P1-20	Sn,Mn 共添加ZnO-P_2O_5 ガラスにおけるPL,RL 特性	○正井 博和[1], 日野 祐輔[1], 柳田 健之[2], 藤本 裕[2]	1.京大化研, 2.九工大
		12a-P1-21	重粒子線照射場におけるCsI(Tl)シンチレータの放射化	○(M1)鷲尾 知也[1], 若林 源一郎[2], 納冨 昭弘[3], 眞正 浄光[4], 古場 裕介[5]	1.近大院, 2.近大原研, 3.九大院医, 4.首都大, 5.放医研

2.1 放射線物理一般・検出器基礎 / Radiation physics and Detector fundamentals　口頭講演

3月13日(金)　9:00 - 12:15

	9:00 - 9:15	13a-A19-1	Mg共添加Ce:$Gd_3(Al,Ga)_5O_{12}$シンチレータの大型化とシンチレーション特性評価	○鎌田 圭[1,2], 庄子 育宏[2,3], 名倉 亜耶[3], 黒澤 俊介[1,3], 奥村 聡[4], 山本 誠一[4], V.Kochurikhin Vladimir[5], Pejchal Jan[1,6], 横田 有為[1], 大橋 雄二[3], 吉川 彰[1,2,3]	1.東北大 NICHe, 2.株式会社 C&A, 3.東北大金研, 4.名大院医, 5.General Phys. Inst., 6.Inst.of Phys. AS CR
	9:15 - 9:30	13a-A19-2	SrI2(Eu)単結晶の大口径化とその発光のEu濃度依存性	○桜木 史郎[1], 橋本 哲[1], 河相 武利[2]	1.ユニオンマテリアル, 2.大阪府大
	9:30 - 9:45	13a-A19-3	ArF レーザー励起でのpure SrI_2 及びSrI_2(Eu) 発光特性	○桜木 史郎[1], 橋本 哲[1], 河相 武利[2]	1.ユニオンマテリアル, 2.大阪府大
	9:45 - 10:00	E 13a-A19-4	Wavelength discrimination of Composite ceramic YAG scintillator	○JIANYONG JIANG[1], Kenji Shimazoe[1], Hiroyuki Takahashi[1], Takayuki Yanagida[2]	1.The Univ.of Tokyo, 2.Kyushu Inst.
	10:00 - 10:15	奨 13a-A19-5	$LaBr_3$:Ce シンチレータにおける波形解析を用いたアルファ線自己放射能除去方法の研究開発	○小川原 亮[1], 石川 正純[1]	1.北大医
	10:15 - 10:30	13a-A19-6	$CeBr_3$シンチレーション検出器のγ線応答のモンテカルロシミュレーションによる検討	○松本 政雄[1], 中路 拓[1], 高階 正彰[1], 井原 陽平[2], 隠岐 圭司[2]	1.阪大院医, 2.EMF ジャパン(株)
	10:30 - 10:45		休憩/Break		
	10:45 - 11:00	13a-A19-7	CsIシンチレータの自己放射化にもとづく高感度中性子検出	○納冨 昭弘[1], 有吉 容子[1], 山内 ももこ[1], 木下 博之[1], 本田 宗一郎[1], 若林 源一郎[2], 福永 淳一[3], 赤嶺 寛地[3], 梅津 芳幸[3], 中村 泰彦[3]	1.九大医保, 2.近大原研, 3.九大病院
	11:00 - 11:15	13a-A19-8	TRUST LiCAFと波長シフトファイバを用いた中性子検出器の特性評価	○(M1)山崎 拓弥[1], 杉本 大[1], 渡辺 賢一[1], 山崎 淳[1], 瓜谷 章[1], 井口 哲夫[1], 福田 健太郎[2], 石津 澄人[2], 柳田 健之[3]	1.名大工, 2.トクヤマ, 3.九工大
	11:15 - 11:30	13a-A19-9	Ho添加酸化物結晶の放射線誘起発光特性に関する基礎研究	○熊谷 洋祐[1], 渡辺 賢一[1], 山崎 淳[1], 瓜谷 章[1], 柳田 健之[2]	1.名大工, 2.九工大
	11:30 - 11:45	13a-A19-10	分子内エネルギー移動構造を有する液体シンチレータ用有機色素の開発	○(M1)佐熊 祐大[1], 坂口 幸一[1], 江良 正直[1], 清水 俊彦[2], 猿倉 信彦[2]	1.佐賀大院工, 2.阪大レーザー研
	11:45 - 12:00	13a-A19-11	銀活性リン酸塩ガラスを用いた三次元線量イメージングのための時間分解スペクトル測定	○(B)糸井 駿[1], 柳田(宮本) 由香[2], 黒堀 利夫[1]	1.金沢大自然, 2.千代田テクノル

	12:00 - 12:15	13a-A19-12	銀活性リン酸塩ガラスの飛跡検出器への応用	○小平 聡[1], 宮本 由香[2], 小口 靖弘[2], 四之宮 創[3], 花岡 慶祐[3], 長谷部 信行[3], 川嶋 元[1], 蔵野 美恵子[1], 北村 尚[1], 内堀 幸夫[1], 小倉 紘一[4]	1.放医研, 2.千代田テクノル, 3.早大理工研, 4.日大生産工
	3月13日(金) 14:00 - 16:00				
	14:00 - 14:15	13p-A19-1	TlBr検出器の電子正孔対生成エネルギーの測定II	○人見 啓太朗[1], 小野寺 敏幸[2], 金 聖潤[1], 庄司 忠良[2], 石井 慶造[1]	1.東北大, 2.東北工大
	14:15 - 14:30	13p-A19-2	CdTe系検出器におけるSCP過渡電流波形	○鈴木 和彦[1], 瀬戸 悟[2], 澤田 孝幸[1]	1.北科大工, 2.石川高専
	14:30 - 14:45	13p-A19-3	HBr系エッチング液によるCdTe検出器の表面処理の検討	○神野 悟史[1], 鈴木 悠太[1], 高井 紀明[1], 塚本 雄大[1], 松本 雅彦[1], 伊藤 祐葵[1], 杉本 宗一郎[1], 山崎 大輔[1], 北川 翔三[1], 小島 将弘[1], 安形 保則[1], ニラウラ マダン[1], 安田 和人[1]	1.名工大
	14:45 - 15:00	奨 13p-A19-4	CVD合成ダイヤモンドを用いた高エネルギー重イオン飛跡の検出	○(M1)春山 盛善[1,2], 小野田 忍[2], 寺地 徳之[3], 磯谷 順一[4], 加田 渉[1], 大島 武[2], 花泉 修[1]	1.群大理工, 2.原子力機構, 3.物材機構, 4.筑波大学
	15:00 - 15:15	13p-A19-5	耐放射線性を有するSi-MOSFETの開発	○中田 智成[1], 秋山 周哲[1], 渡辺 温[1], 相沢 淳[2], 大塚 正志[2], 石井 邦尚[2], 吉沢 勝美[2], 持木 幸一[3]	1.パイオニア(株), 2.パイオニアマイクロテクノロジー(株), 3.東京都市大学
	15:15 - 15:30	13p-A19-6	Fe-55によるTESのベンチマーク試験	○佐藤 泰[1], 福田 大治[1], 田中 啓一[2], 神代 暁[1], 平山 文紀[1], 山森 弘毅[1], 永沢 秀一[1], 佐藤 昭[1], 日高 睦夫[1], 畠山 修一[3], 入松川 知也[1,3], 大野 雅史[3], 高橋 浩之[3]	1.産総研, 2.日立ハイテクサイエンス, 3.東大院
	15:30 - 15:45	13p-A19-7	Si吸収体を有する超伝導トンネル接合検出器を用いたkeV領域のイオン計測	○志岐 成友[1], 藤井 剛[1], 浮辺 雅宏[1], 小池 正記[1], 大久保 雅隆[1]	1.産総研
	15:45 - 16:00	13p-A19-8	超伝導転移端検出器アレイのためのマイクロ波読出	○入松川 知也[1], 平山 文紀[2], 佐藤 昭[2], 山森 弘毅[2], 永沢 秀一[2], 福田 大治[2], 日高 睦夫[2], 神代 暁[2], 大野 雅史[1], 高橋 浩之[1]	1.東大工, 2.産総研

2.2 検出器開発 / Detection systems 口頭講演

	3月11日(水) 16:15 - 18:00				
	16:15 - 16:30	11p-A19-9	走査透過型電子顕微鏡搭載用TES型マイクロカロリメータEDSシステムの開発	○前畑 京介[1], 原 徹[2], 満田 和久[3], 日高 睦夫[4], 田中 啓一[5], 山中 良浩[6]	1.九大院工, 2.NIMS, 3.JAXA, 4.産総研, 5.日立ハイテクサイエンス, 6.大陽日酸
	16:30 - 16:45	11p-A19-10	STEM-EDS用64素子TES型X線マイクロカロリメータアレイの開発	○林 佑[1], 永吉 賢一郎[1], 村松 はるか[1], 満田 和久[1], 山崎 典子[1], 本間 敬之[2], 齋藤 美紀子[3], 前畑 京介[4], 原 徹[5]	1.ISAS/JAXA, 2.早大先進理工, 3.早大NTRC, 4.九大工, 5.NIMS
	16:45 - 17:00	11p-A19-11	走査透過型電子顕微鏡搭載のための TES 型 X 線マイクロカロリメータアレイ読み出し系の開発	○千葉 旭[1], 酒井 和広[1], 永吉 賢一郎[1], 山本 亮[1], 林 佑[1], 村松 はるか[1], 満田 和久[1], 山崎 典子[1], 竹井 洋[1], 永沢 秀一[2], 日高 睦夫[2], 前畑 京介[3], 原 徹[4]	1.JAXA, 2.AIST, 3.九大工, 4.NIMS
	17:00 - 17:15	11p-A19-12	走査型電子顕微鏡搭載のためのTES型X 線マイクロカロリメータアレイ実装技術の開発	○永吉 賢一郎[1], 千葉 旭[1], 林 佑[1], 村松 はるか[1], 酒井 和広[1], 山本 亮[1], 満田 和久[1], 山崎 典子[1], 竹井 洋[1], 前畑 京介[2], 原 徹[3]	1.宇宙航空研究開発機構, 2.九大工, 3.物質・材料研究機構
	17:15 - 17:30	11p-A19-13	1keV以下の特性線取得効率向上に向けたTESシステムの開発	○田中 啓一[1], 永田 篤士[1], 中山 哲[1], 茅根 一夫[1], 前畑 京介[2], 満田 和久[3], 原 徹[4]	1.日立ハイテクサイエンス, 2.九大工, 3.JAXA, 4.NIMS
	17:30 - 17:45	11p-A19-14	走査透過型電子顕微鏡 EDS 用ポリキャピラリーのX線伝送特性測定	○高野 彬[1], 前畑 京介[1], 伊豫本 直子[1], 原 徹[2], 満田 和久[3], 山崎 典子[3], 田中 啓一[4]	1.九大工, 2.NIMS, 3.JAXA, 4.日立ハイテクサイエンス
	17:45 - 18:00	11p-A19-15	走査透過型電子顕微鏡搭載用小型無冷媒^{3}He-^{4}He希釈冷凍機の開発	○前畑 京介[1], 山中 良浩[2], 伊藤 琢司[2], 原 徹[3], 満田 和久[4], 田中 啓一[5]	1.九大院工, 2.大陽日酸, 3.NIMS, 4.JAXA, 5.日立ハイテクサイエンス

2.2 検出器開発 / Detection systems ポスター講演

	3月12日(木) 9:30 - 11:30				
		12a-P2-1	TmドープCaF_2蛍光体の光刺激ルミネッセンス	○(M1)中川 涼太[1], 平澤 一樹[1], 竹井 義法[1], 南戸 秀仁[1], 柳田 健之[2], 藤本 裕[3], 宮本 由香[4], 福田 健太郎[5], 黒堀 利夫[6]	1.金沢工大, 2.九州工大, 3.東北大, 4.千代田テクノル, 5.株式会社トクヤマ, 6.金沢大
		12a-P2-2	液相エピタキシャルInSb放射線検出器におけるキャリア捕獲に関する研究	○飯村 隆介[1], 濱口 拓[1], 神野 郁夫[1]	1.京大院工
		12a-P2-3	塗布技術を用いた中性子検出器の試作	○内田 智久[1,3], 池野 正弘[1,3], 身内 賢太郎[2], 島崎 昇一[1,3], 田中 真伸[1,3], 田中 秀治[1]	1.KEK素核研, 2.神戸大理, 3.Open-It
		12a-P2-4	第三世代コンピュータ断層撮影に対応する電流測定・エネルギー分解X線検出器の開発	○(M2)叶井 絵梨[1], 神野 郁夫[1], 山下 良樹[1], 小川 剛史[1], 眞正 浄光[2]	1.京大院工, 2.首都大学東京
		奨 12a-P2-5	エネルギー分解X線コンピュータ断層撮影法による造影剤量低減の可能性	○伊良皆 拓[1], 桑原 潤一[2], 神野 郁夫[1], 伊藤 秋男[1], 中村 光宏[3], 平岡 真寛[3]	1.京大院工, 2.京大病院放射線部, 3.京大院医
		奨 12a-P2-6	熱蛍光素子BeO:Na(UD-170A)のグロー成分解析と線量依存性の検討	○(M2)大坪 圭介[1], 眞正 浄光[1], 古場 裕介[2], 若林 源一郎[3]	1.首都大放, 2.放医研, 3.近大原研
		12a-P2-7	荷電粒子線用グラファイトカロリーメータの開発	○田中 隆宏[1], 清水 森人[1], 森下 雄一郎[1], 黒澤 忠弘[1], 加藤 昌弘[1], 齋藤 則生[1]	1.産総研 計測標準
		奨 12a-P2-8	PET用3次元位置検出器X'tal Cubeの開発:(0.8mm)^{3}分解能への挑戦	○新田 宗孝[1,2], 稲玉 直子[2], 平野 祥之[2], 錦戸 文彦[2], 吉田 英治[2], 田島 英朗[2], 河合 秀幸[1], 山谷 泰賀[2]	1.千葉大学, 2.放医研
		12a-P2-9	TRUST LiCAFと波長シフトファイバを使用した中性子イメージング検出器の開発	○杉本 大[1], 山崎 拓弥[1], 渡辺 賢一[1], 山崎 淳[1], 瓜谷 章[1], 井口 哲夫[1], 福田 健太郎[2], 石津 澄人[2], 柳田 健之[3]	1.名大工, 2.トクヤマ, 3.九工大
		12a-P2-10	健康診断における癌のスクリーニングを目的とした低被ばくX線コンピュータ断層撮影法の開発	○(M2)船引 綾乃[1], 山内 一輝[1], 神野 郁夫[1], 大高 雅彦[2], 橋本 周[2], 荒 邦章[2], 尾鍋 秀明[3]	1.京大院工, 2.原子力機構, 3.レイテック
		12a-P2-11	リバース型アバランシェフォトダイオードのシングルイベント効果のシミュレーション研究	○(M2)荻田 竜平[1], 片寄 祐作[1], 大島 武[2], 小野田 忍[2], 牧野 高紘[2]	1.横国大工, 2.原子力機構
		E 12a-P2-12	Characterization of Cubic SrI_2(Eu) Scintillators for Array Detectors	○Yang Tian[1], Kenji Shimazoe[1], Hiroyuki Takahashi[1], Shiro Sakuragi[2], Yasushi Yamasaki[3]	1.Tokyo Univ., 2.Union Materials, 3.Leading Edge Algorithms

2.2 検出器開発 / Detection systems　口頭講演

3月13日(金)　16:15 - 19:00

招待	**16:15 - 16:45**	**13p-A19-9**	**「放射線 分科内招待講演」(30分) 原子核乾板自動解析技術の開発とその応用**	**○森島 邦博[1]**	**1.名大**
招待	**16:45 - 17:00**	**13p-A19-10**	**「講演奨励賞受賞記念講演」(15分) シンチレーティングGlass GEM の炭素線に対する応答**	**○古場 裕介[1], 藤原 健[2], 松藤 成弘[1], 高橋 浩之[2]**	**1.放医研, 2.東大工**
	17:00 - 17:15	13p-A19-11	極微小シンチレータと光ファイバを用いた透視に映らない診断X線用線量計の開発	○石川 正純[1], 中川 啓治[2], 五十嵐 俊之[2], 古畑 優[3]	1.北大院医, 2.太宝電子㈱, 3.アクロバイオ㈱
	17:15 - 17:30	奨 13p-A19-12	即発OSLによる蛍光強度測定及び線量率線形性の評価	○上野 克宜[1], 富永 和生[1], 田所 孝広[1], 石澤 幸治[2], 高橋 良知[2]	1.日立日研, 2.日立GE
	17:30 - 17:45		休憩/Break		
	17:45 - 18:00	奨 13p-A19-13	Scintillating Glass GEMの開発とその応用	○藤原 健[1], 三津谷 有貴[1], 古場 祐介[2], 高橋 浩之[1], 上坂 充[1]	1.東大工, 2.放医研
	18:00 - 18:15	13p-A19-14	PADC検出器中重イオントラック内に形成されるヒドロキシル基の役割	○楠本 多聞[1], 森 豊[1], 金崎 真聡[1], 小田 啓二[1], 小平 聡[2], 北村 尚[2], 山内 知也[1]	1.神戸大院海事, 2.放医研
	18:15 - 18:30	13p-A19-15	Xeイオン(290 MeV/n), Krイオン(400 MeV/n)を照射したポリイミドの損傷構造	○池永 龍之介[1], 松川 兼也[1], 小田 啓二[1], 山内 知也[1], 小平 聡[2], 北村 尚[2], 小西 輝昭[2]	1.神大院海事, 2.放医研
	18:30 - 18:45	13p-A19-16	高閾値飛跡検出器としてのポリイミド樹脂の研究	○安田 修一郎[1], 松川 兼也[1], 小田 啓二[1], 小平 聡[2], 北村 尚[2], 蔵岡 孝治[1], 山内 知也[1]	1.神大院海事, 2.放医研
	18:45 - 19:00	13p-A19-17	重イオン成分を含む混成場への固体飛跡検出器群の適用	○山内 知也[1], ムハンマド エリワ[1], 楠本 多聞[1], 田尾 陽[1], 池永 龍之介[1], 安田 修一郎[1], 小田 啓二[1], 小平 聡[2], 北村 尚[2], 西内 満美子[3], 榊 泰直[3], 金崎 真聡[3], 福田 裕仁[3], 近藤 公伯[3]	1.神戸大院海事, 2.放医研, 3.原子力機構関西

3月14日(土)　9:00 - 12:15

	9:00 - 9:15	14a-A19-1	腹腔鏡用単眼コンプトンプローブイメージングに関する研究	○(M1)小山 晃広[1], 中村 泰明[1], 島添 健次[1], 高橋 浩之[1]	1.東大工
	9:15 - 9:30	奨 14a-A19-2	無人ヘリ搭載散乱エネルギー認識型高位置分解能ガンマカメラの開発	○島添 健次[1], Jiang Jianyong[1], 高橋 浩之[1], 志風 義明[2], 鳥居 建男[2], 西澤 幸康[2], 吉田 真美[2], 黒澤 俊介[3], 鎌田 圭[3], 吉川 彰[3], 吉野 将生[4], 加藤 翔[4], 伊藤 繁記[4], 遠藤 貴範[4], 堤 浩輔[4], 佐藤 浩樹[4], 薄 善行[4]	1.東大工, 2.原子力機構, 3.東北大, 4.古河機械金属
	9:30 - 9:45	E 14a-A19-3	Electron Track Recognition with SOI sensor for Advanced Compton Imaging	○(M2)Fairuz Atiqah[1], Yuri Yoshihara[1], Kenji Shimazoe[1], Hiroyuki Takahashi[1], Ayaki Takeda[2], Takeshi Tsuru[2], Yasuo Arai[3,4]	1.Univ. of Tokyo, 2.Kyoto Univ., 3.KEK, 4.OIST
	9:45 - 10:00	14a-A19-4	SOI技術を用いた放射線イメージセンサーの最近の進展	○三好 敏喜[1], 新井 康夫[1], 三井 真吾[1], 西村 龍太郎[2]	1.KEK素核研, 2.総研大
	10:00 - 10:15	14a-A19-5	大面積CdTeピクセル検出器開発の現状と今後の計画	○豊川 秀訓[1], 川瀬 守弘[1], 呉 樹奎[1], 佐治 超爾[1], 大端 通[1], 梶原 堅太郎[1], 佐藤 眞直[1], 広野 等子[2], 菖蒲 敬久[3], 城 鮎美[3], 末永 敦士[4], 池田 博一[5]	1.JASRI/SPring-8, 2.ボン大学, 3.原子力機構, 4.豊和産業, 5.ISAS/JAXA
	10:15 - 10:30	奨 14a-A19-6	次世代CTを目指した高精細カラー放射線イメージセンサの開発 (I)	○大島 翼[1], 片岡 淳[1], 岸本 彩[1], 藤田 卓也[1], 呉井 洋太[1], 西山 徹[1], 山本 誠一[2], 尾川 浩一[3]	1.早大理工, 2.名大医, 3.法大理工
	10:30 - 10:45		休憩/Break		
	10:45 - 11:00	14a-A19-7	PMT, APD, MPPCを用いた$SrI_2(Eu)$シンチレータの限界性能評価	○(D)岸本 彩[1], 片岡 淳[1], 櫻木 史郎[2], 山嵜 康司[3]	1.早大理工, 2.ユニオンマテリアル, 3.リーディングエッジアルゴリズム
	11:00 - 11:15	E 14a-A19-8	Effect of Photoluminescence Position in Crystal on the Spectrum of Detected Photons	○Amin Choghadi[1], Kenji Shimazoe[1], Hiroyuki Takahashi[1], Masao Yoshino[2]	1.The Univ. of Tokyo, 2.Furukawa CO LTD
	11:15 - 11:30	奨 14a-A19-9	比例モードSi-APDを用いたX線シンチレーション検出器の開発(2)	○井上 圭介[1], 岸本 俊二[1,2]	1.総研大, 2.高エネ研
	11:30 - 11:45	14a-A19-10	重イオンマイクロビームを利用した4H-SiCショットキーバリアダイオード中の欠陥評価	○(M1C)神林 佑哉[1,2], 安藤 裕士[1], 加田 渉[1], 小野田 忍[2], 牧野 高紘[2], 星乃 紀博[3], 土田 秀一[3], 花泉 修[1], 神谷 富裕[2], 大島 武[2]	1.群馬大, 2.原子力機構, 3.電中研
	11:45 - 12:00	14a-A19-11	荷電粒子誘起電荷解析法を利用したダイヤモンド検出器内部の欠陥準位計測	○加田 渉[1], 神林 佑哉[1,2], 小野田 忍[2], 牧野 高紘[2], 安藤 裕士[1], 梅沢 仁[3], 杢野 由明[3], 鹿田 真一[3], 花泉 修[1], 神谷 富裕[2], 大島 武[2]	1.群馬大, 2.原子力機構, 3.産総研
	12:00 - 12:15	14a-A19-12	Coplanar電極を用いた希ガス電離箱の開発III	○草野 広樹[1], 吉村 亮[1], 川端 修[1], 栗田 光紀[1], 岩崎 健太[1], 宮島 光弘[1], 柴村 英道[1], 長谷部 信行[1]	1.早大理工研

2.3 放射線応用・発生装置・新技術 / Application, radiation generators, new technology　口頭講演

3月11日(水)　9:00 - 11:45

	9:00 - 9:15	11a-A19-1	300keV小型イオンマイクロビーム装置で形成されたビーム径の縮小化	○石井 保行[1], 大久保 猛[1]	1.原子力機構高崎研
	9:15 - 9:30	11a-A19-2	焦電結晶を用いたX線発生器の動作特性(II)	○内藤 雅之[1], 長谷部 信行[1], 草野 広樹[1], 長岡 央[1], 久野 治義[1], 柴村 英道[1], José A. Matias Lopes[2]	1.早稲田大学, 2.Univ. of Coimbra
	9:30 - 9:45	11a-A19-3	慣性静電閉じ込め放電における陰極内部電圧の分光測定	○金岩 潤一郎[1], 大村 航太[1], 友清 彰大[1], 前田 渉吾[1], 青田 英悟[1], 内海 倫明[1], 千葉 雅美[2], 藤井 政俊[3], 進藤 春雄[1]	1.東海大, 2.首都大理工, 3.島根大医
	9:45 - 10:00	11a-A19-4	コンクリート内部を可視化する後方散乱X線装置の開発	○豊川 弘之[1], 平 義隆[1], 萬代 新一[2], 瓜谷 章[3], 渡辺 賢一[3], 藤原 健[4]	1.産総研, 2.(株)BEAMX, 3.名古屋大学, 4.東京大学
	10:00 - 10:15	11a-A19-5	1および2インチ径La-GPS単結晶のシンチレーション特性評価	○黒澤 俊介[1,2], 庄子 育宏[1,3], 村上 力輝斗[1], 山路 晃広[1], Pejchal Jan[2,4], 大橋 雄二[1], 横田 有為[2], 鎌田 圭[2,3], 吉川 彰[1,2,3]	1.東北大金研, 2.東北大NICHe, 3.株式会社C&A, 4.チェコ物理研
	10:15 - 10:30		休憩/Break		
	10:30 - 10:45	11a-A19-6	携帯型コンプトンカメラによる3次元ガンマイメージ再構成	○(D)岸本 彩[1], 片岡 淳[1], 西山 徹[1], 多屋 隆紀[1], 株木 重人[2], 西尾 禎治[3]	1.早大理工, 2.東海大医, 3.国立がん研究センター
	10:45 - 11:00	11a-A19-7	散乱線による放射性物質の3次元深度分布推定法	○(B)岩本 康弘[1], 片岡 淳[1], 岸本 彩[1], 西山 徹[1], 藤田 卓也[1], 多屋 隆紀[1], 大河内 博[1], 緒方 裕子[1]	1.早大理工

	11:00 - 11:15	11a-A19-8	キャビティーリングダウン分光に基づく放射性炭素同位体分析システムの開発	○寺林 稜平[1], 富田 英生[1], Volker Sonnenschein[1], 弘津 嵩大[1], 揺詰 聡士[1], 金 磊[1], 山中 真仁[1], 西澤 典彦[1], 佐藤 淳史[2], 大森 茜[2], 井手野 晃[2], 大原 利成[2], 井口 哲夫[1]	1.名古屋大学, 2.積水メディカル薬物動態研究所
	11:15 - 11:30	11a-A19-9	重粒子線照射野イメージングのための二重リング式OpenPET実証機開発	○山谷 泰賀[1], 吉田 英治[1], 田島 英朗[1], 稲玉 直子[1], 錦戸 文彦[1], 品地 哲弥[1], 新田 宗孝[1], 中島 靖紀[1], Mohammadi Akram[1], 脇坂 秀克[1], M. Ahmed Abdella[1], 稲庭 拓[1], 北川 敦志[1], 増田 圭介[2], 清水 啓司[2]	1.放医研, 2.浜松ホトニクス
	11:30 - 11:45	11a-A19-10	1リング試作機を用いたRFコイル一体型頭部用PET/MRI装置のイメージング性能評価	○錦戸 文彦[1], 田島 英朗[1], 稲玉 直子[1], 清水 浩大[2], 菅 幹生[2], 小畠 隆行[1], 吉田 英治[1], 山谷 泰賀[1]	1.放医研, 2.千葉大
	3月11日(水) 14:00 - 16:00				
	14:00 - 14:15	11p-A19-1	位置有感型比例計数箱PS-TEPCフライトモデルの開発(II)	○岸本 祐二[1], 佐々木 慎一[1], 高橋 一智[1], 齋藤 究[1], 寺沢 和洋[2], 身内 賢太朗[3], 布施 哲人[4], 永松 愛子[4], 勝田 真登[4], 伊藤 裕一[4], 松本 晴久[4], 森 國城[4], 谷森 達[5], 窪 秀利[5], 内堀 幸夫[6], 北村 尚[6], 道家 忠義[7]	1.KEK, 2.慶応大, 3.神戸大, 4.JAXA, 5.京大, 6.放医研, 7.早大
	14:15 - 14:30	11p-A19-2	有人宇宙船内における最適な遮蔽材料と遮蔽厚の検討	○島田 健[1], 永松 愛子[2], 佐藤 達彦[3], 北城 圭一[1], 坂根 小百合[1], 武田 和雄[4], 安田 仲宏[2], 伊藤 剛[2]	1.㈱エイ・イー・エス, 2.宇宙航空研究開発機構, 3.日本原子力研究開発機構, 4.高度情報科学技術研究機構
	14:30 - 14:45	11p-A19-3	放射線治療時のリアルタイム線量モニタ実現に向けた近赤外発光Ti添加ガーネット酸化物シンチレータ結晶の開発	○(DC)山路 晃広[1], 黒澤 俊介[1,2], 北浦 守[3], 村上 力輝斗[1], Pejchal Jan[1], 大橋 雄二[1], 鎌田 圭[2], 横田 有為[2], 大西 彰正[3], 吉川 彰[1,2]	1.東北大金研, 2.東北大NICHe, 3.山形大理
	14:45 - 15:00	11p-A19-4	月周回衛星による月ガンマ線及び中性子の線量空間分布	○林田 陵佑[1], 長岡 央[1], 長谷部 信行[1], 草野 広樹[1], 小平 聡[2]	1.早大理, 2.放医研
	15:00 - 15:15	11p-A19-5	放射性核種の微小部位イメージングに向けたCsレーザー共鳴イオン化スキームの開発	○古田 雄仁[1], 高松 峻英[1], 富田 英生[1], 坂本 哲夫[2], 大石 乾詞[2], 能任 琢真[1], 中村 敦[1], 井口 哲夫[1], クラウス ベント[3]	1.名古屋大工, 2.工学院大工, 3.ヨハネスグーテンベルグ大
	15:15 - 15:30	11p-A19-6	CR-39 を用いたα 線オートラジオグラフィによるMOX 燃料の品質評価への応用	○小平 聡[1], 蔵野 美恵子[1], 細金 達哉[2], 石川 文隆[2], 影山 十三男[2], 佐藤 光弘[2], 茅野 雅志[2], 安田 仲宏[3]	1.放医研, 2.原子力機構, 3.福井大
	15:30 - 15:45	E 11p-A19-7	Lithium silicate crystals for neutron scintillators	○Jan Pejchal[1,2], Alena Beitlerova[2], Shunsuke Kurosawa[3], Yuui Yokota[1,3], Martin Nikl[2], Akira Yoshikawa[1,3]	1.NICHe, Tohoku Univ., 2.Inst. Phys. AS CR, 3.IMR, Tohoku Univ.
	15:45 - 16:00	E 11p-A19-8	Luminescence properties of SrI_2 single crystals doped with s^2-group ions grown by modified micro-pulling-down method	○(P)Robert Kral[1,2], Karel Nitsch[2], Jan Pejchal[2,3], Vitezslav Jary[2], Shunsuke Kurosawa[1], Yuui Yokota[3], Martin Nikl[2], Akira Yoshikawa[1,3]	1.Institute for Materials Research, Tohoku University, 2.Institute of Physics AS CR, Czech Republic, 3.New Industry Creation Hatchery Center, Tohoku University

2.3 放射線応用・発生装置・新技術 / Application, radiation generators, new technology　ポスター講演

	3月12日(木) 9:30 - 11:30				
		12a-P3-1	焦電性結晶を用いたX線発生の強度安定性に及ぼす結晶形状の影響に関する研究	○(M1)小川 友輔[1], 佐藤 祐喜[1], 吉門 進三[1], 伊藤 嘉昭[2]	1.同志社大院理工, 2.京大化研
		12a-P3-2	垂直磁気異方性CoFeB-MgO磁気トンネル接合の高速中性子耐性評価	○成田 克[1], 早尾 貴史[1], 高橋 豊[1], 伊藤 正俊[2], 酒見 泰寛[2], 小林 大輔[3], 廣瀬 和之[3], 石川 慎也[4], Enobio Eli Christopher[4], 佐藤 英夫[5], 池田 正二[5], 遠藤 哲郎[5,6], 大野 英男[4,5,6,7]	1.山形大工, 2.東北大CYRIC, 3.JAXA宇宙研, 4.東北大通研LNS, 5.東北大CIES, 6.東北大CSIS, 7.東北大WPI-AIMR
		12a-P3-3	荷電粒子検出器となる薄膜型単結晶CVDダイヤモンド上での細胞培養の試み	○加田 渉[1], 酒井 真理[2], Pomorski Michal[3], Grilj Veljko[4], Skukan Natko[4], 神林 佑哉[1,5], 牧野 高紘[5], Jakšić Milko[4], 小野田 忍[5], 大島 武[5], 神谷 富裕[5], 花泉 修[1]	1.群馬大, 2.群馬大重粒子, 3.CEA-LIST, 4.RBI, 5.原子力機構

3 光・フォトニクス / Optics and Photonics

3.0 Optics and Photonics English Session　口頭講演

	3月13日(金) 9:00 - 11:15				
	9:00 - 9:15	E 13a-A15-1	Separation of Intermolecular Motions in Liquids with Polarization Dependent Stimulated Raman Spectroscopy	○(P)Stefan Funkner[1], Gudrun Niehues[1], Shun Nakae[1], Takashi Furuya[1], Kohji Yamamoto[1], Masahiko Tani[1]	1.FIR Center, Univ. of Fukui
	9:15 - 9:30	奨・E 13a-A15-2	Low Temperature-Grown GaAs Carrier Lifetime Measurements Using "Double Pump" Terahertz Time-Domain Spectroscopy Setup	○(D)Valynn Magusara[1], Stefan Funkner[1], Gudrun Niehues[1], Elizabeth Ann Prieto[2], Armando Somintac[2], Elmer Estacio[2], Arnel Salvador[2], Kohji Yamamoto[1], Muneaki Hase[3], Masahiko Tani[1]	1.FIR-Univ. of Fukui, 2.NIP Univ. of Phils., 3.Univ. of Tsukuba
	9:30 - 9:45	E 13a-A15-3	Exploring the Fano resonance of dolmen structures in near field by PEEM	○(D)Yu Han[1], Sun Quan[1], Ueno Kosei[1], Matsuo Yasutaka[1], Kubo Atsushi[2], Misawa Hiroaki[1]	1.RIES-Hokkaido Univ., 2.Inst. Phys., Univ. Tsukuba
	9:45 - 10:00	E 13a-A15-4	Design of Perfect Absorber Based on Spiral Architecture Metamaterial for Near-Infrared Spectral Range	○IHAR FANIAYEU[1,2], IGOR SEMCHENKO[2], VYGANTAS MIZEIKIS[1]	1.Shizuoka Univ., 2.Gomel State Univ.
	10:00 - 10:15	E 13a-A15-5	Exciton Quenching of Thermally Activated Delayed Fluorescence Molecules	○(P)SANGARANGE SANDANAYAKA[1], Toshinori Matsushima[1], Chihaya Adachi[1]	1.OPERA Kyushu University, JST ERATO
	10:15 - 10:30	E 13a-A15-6	Light absorption via discrete states in AlGaAs solar cell embedded with Er complex	○(D)ChaoYu Hung[1], Tomah Sogabe[1], Ryo Tamaki[1], Naoya Miyashita[1], Akio Ogura[1], Yoshitaka Okada[1]	1.RCAST, The Univ. of Tokyo
	10:30 - 10:45	E 13a-A15-7	Optical Feedback Sensitivity of InAs/GaAs Quantum Dot Lasers	○(D)Timothy Rae[1], Katsuaki Tanabe[1], Kenichiro Yashiki[2], Kazuhiko Kurata[2], Satoshi Iwamoto[1], Yasuhiko Arakawa[1]	1.NanoQuine, IIS, Univ. Tokyo, 2.PETRA
	10:45 - 11:00	E 13a-A15-8	Experimental Investigation of Four-Wave Mixing Effect in Quantumn-Dot Semiconductor Optical Amplifier Physics	Guo-Wei LU[2], Danshi Wang[3], Cheng Wang[3], Jun Qin[3], ○Takahide Sakamoto[1], Kouichi Akahane[1], Naokatsu Yamamoto[1], Hongxiang Wang[3], Min Zhang[3], Tetsuya Kawanishi[1], Shigeru Yamaguchi[2]	1.NICT, 2.Tokai univ., 3.BUPT

	11:00 - 11:15	E 13a-A15-9	Multiplexed SOI Ring Resonators for Biosensing Applications	○(D)Manuel Mendez-Astudillo[1], Matthias Jager[2], Danny Volkmann[2], Hirochika Nakajima[1]	1.Waseda Univ., 2.TU Berlin

3.1 光学基礎・光学新領域 / Basic optics and frontier of optics　ポスター講演

3月13日(金)　9:30 - 11:30

		13a-P2-1	光渦を用いたレーザートラッピング法によるグリシン結晶成長制御	○パリダン アルキン[1], Lee Jun Hyung[1], 曲澤 学[1], 宮本 克彦[1], 尾松 孝茂[1,2]	1.千葉大, 2.JST_CREST
		13a-P2-2	液晶光学素子による量子化ラゲールガウスビームの生成と伝搬特性(II)	○小川 賀代[1], 齊藤 彩[1], 惟村 百合子[1], 田辺 綾乃[2], 栗原 誠[2], 横山 正史[2], 松本 健志[2], 橋本 信幸[2]	1.日本女子大理, 2.シチズンホールディングス(株)開発部

3.1 光学基礎・光学新領域 / Basic optics and frontier of optics　口頭講演

3月14日(土)　9:00 - 12:00

	9:00 - 9:15	14a-A12-1	フェムト秒ダブルパルストレインによるナノ粒子の光トラッピングおよび放出ダイナミクス(3)粒子アプレーションと放出過程	○村松 正康[1], 沈 則甫[1], 江 威逸[1], Usman Anwar[2], 増原 宏[1]	1.国立交通大理, 2.アブドラ科技大
	9:15 - 9:30	14a-A12-2	ラゲール・ガウスビーム中における粒子の円運動の原理	○茨田 大輔[1,2,4], 川田 重夫[1,2], 谷田貝 豊彦[2], 尾松 孝茂[3,4]	1.宇大院工, 2.宇大CORE, 3.千葉大院融合, 4.JST-CREST
	9:30 - 9:45	14a-A12-3	光渦の散乱力により形成された単結晶シリコンピラー	○高橋 冬都[1], 滝澤 隼[1], 藤原 穂波[1], 宮本 克彦[1], 比田井 洋史[1], 森田 隆二[2,3], 尾松 孝茂[1,3]	1.千葉大院, 2.北大院工, 3.JST-CREST
	9:45 - 10:00	14a-A12-4	テラヘルツベクトルビームの制御II	○若山 俊隆[1], 東口 武史[2,3], 及川 大基[2], 坂上 和之[4], 鷲尾 方一[4], 米村 元喜[1], 吉澤 徹[5], タイヨ スコット[6], 大谷 幸利[3]	1.埼玉医大, 2.宇大, 3.宇大CORE, 4.早大, 5.三次元工学会, 6.アリゾナ大学
	10:00 - 10:15	14a-A12-5	テラヘルツビームの偏光検出：ベクトル渦解析 III	○若山 俊隆[1], 東口 武史[2,3], 及川 大基[2], 坂上 和之[4], 鷲尾 方一[4], 米村 元喜[1], 吉澤 徹[5], タイヨ スコット[6], 大谷 幸利[3]	1.埼玉医大, 2.宇大, 3.宇大CORE, 4.早大, 5.三次元工学会, 6.アリゾナ大学
	10:15 - 10:30	14a-A12-6	高次径偏光ビームのスーパーオシレーション集光	○小澤 祐市[1], 松永 大地[1], 佐藤 俊一[1]	1.東北大多元研
	10:30 - 10:45		休憩/Break		
	10:45 - 11:00	奨 14a-A12-7	高次径偏光ビームのスーパーオシレーション特性による共焦点レーザー顕微鏡の空間分解能の向上	○松永 大地[1], 小澤 祐市[1], 佐藤 俊一[1]	1.東北大多元研
	11:00 - 11:15	14a-A12-8	螺旋型フレネルゾーンプレートによるX線光渦生成と集光点近傍の波面決定	○香村 芳樹[1], 武井 大[1], 鈴木 芳生[2]	1.理研SPring-8センター, 2.JASRI
	11:15 - 11:30	奨 14a-A12-9	タイコグラフィー位相回復法による光渦の波面計測	○齋藤 貴宏[1], 竹尾 陽子[1], 三村 秀和[1]	1.東京大工
	11:30 - 11:45	奨 14a-A12-10	ナノ流体による太陽光の光熱変換	○石井 智[1,2], 長尾 忠昭[1,2]	1.物材機構, 2.JST-CREST
	11:45 - 12:00	奨 14a-A12-11	コアシェル型高屈折率誘電体ナノ構造の可視域電磁場応答制御	○土本 悠太[1], 矢野 隆章[1,2], 林 智広[1,2], 原 正彦[1,2]	1.東工大総理工, 2.理研

3月14日(土)　13:00 - 14:15

	13:00 - 13:15	14p-A12-1	3次元疑似スペクトル時間領域(PSTD)法のGPGPUによる高速化	○水谷 彰夫[1], 菊田 久雄[1]	1.阪府大工
	13:15 - 13:30	14p-A12-2	局在モードを制御した新規ランダムレーザーの発振状態解析	○煮雪 亮[1], 石川 善恵[2], 越崎 直人[3], 辻 剛志[4], 中村 俊博[5], 藤原 英樹[1], 笹木 敬司[1]	1.北大電子研, 2.産総研, 3.北大院工, 4.島大総理工, 5.群馬大院理工
	13:30 - 13:45	14p-A12-3	異方性光学結晶で光完全密閉箱は構成できるか？	○(M2)芝崎 勝也[1], 小林 哲郎[2], 兼松 泰男[2], 岡村 康行[1]	1.阪大基礎工, 2.阪大 e-square
	13:45 - 14:00	14p-A12-4	透過光スペクトルによるナノファイバーセンサーの評価	○山本 和広[1], 山口 堅三[2], 横山 士吉[1], 大友 明[3]	1.九大先導研, 2.香川大, 3.情通機構
	14:00 - 14:15	14p-A12-5	紫外線発光ダイオードとプラスチックターゲットを用いた人工衛星搭載用推進機の開発	○(M1)小山 拓実[1], 山崎 泰史[1], 堀澤 秀之[1]	1.東海大工

3.2 材料・機器光学 / Equipment optics and materials　口頭講演

3月12日(木)　14:00 - 17:15

	14:00 - 14:15	12p-A13-1	赤外イメージングシステムによる塗抹文字検出	○菅原 滋[1]	1.科警研
	14:15 - 14:30	12p-A13-2	液晶レンズの応答特性(I)	○千田 誠[1], 田村 賢介[1], 河村 希典[1], 佐藤 進[2]	1.秋田大院工, 2.液晶レンズ研
	14:30 - 14:45	12p-A13-3	焦点可変液晶レンズを用いたサーモグラフィカメラによる撮像システムの構成	佐藤 翔吾[1], ○河村 希典[1], 佐藤 進[2]	1.秋田大院工, 2.液晶レンズ研
	14:45 - 15:00	12p-A13-4	酸化パナジウムで形成したメゾフレーク膜の光学特性	○垣内田 洋[1], 吉村 和記[1], 田澤 真人[1]	1.産総研
	15:00 - 15:15	12p-A13-5	0.02 以上の屈折率変調を有する有機ナノ微粒子-ポリマーコンポジット体積ホログラフィック格子	○富田 康生[1], 浦野 寛史[1], 西村 直也[2], 大土井 啓祐[2]	1.電通大院先進理工, 2.日産化学工業（株）
	15:15 - 15:30	12p-A13-6	高濃度半導体CdSe 量子ドット分散ポリマーナノコンポジット中における高屈折率変調Bragg 格子の形成	○山上 龍一[1], 秦泉寺 貴章[1], 富田 康生[1]	1.電気通信大
	15:30 - 15:45		休憩/Break		
	15:45 - 16:00	奨 12p-A13-7	動的光重合により作製した回折格子の光学物性	○相沢 美帆[1], 久野 恭平[1], 赤松 範久[1], 宍戸 厚[1,2]	1.東工大資源研, 2.JSTさきがけ
	16:00 - 16:15	奨 12p-A13-8	ブルー相液晶を用いた円偏光選択分波光素子	○アヌチャー コンカノック[1], 河田 優人[1], 田中 秀[1], 吉田 浩之[1], 尾崎 雅則[1]	1.阪大院工
	16:15 - 16:30	奨 12p-A13-9	水中油滴型エマルションを利用した貴金属ナノ粒子自己組織化膜の作製	○(M1)香川 龍恭[1], 武安 伸幸[1], 金田 隆[1]	1.岡大院自然
	16:30 - 16:45	E 12p-A13-10	Low temperature synthesis of mechanoluminescent material	○Kenji Murakami[2], Manoj Ranasinghe[1], Gamini Rajapakse[3], Oliver Illeperuma[3]	1.GSST, Shizuoka Univ., 2.GSE, Shizuoka Univ., 3.Univ. Peradeniya
	16:45 - 17:00	12p-A13-11	高Tgメタクリレート系EOポリマーの長期安定性	○大友 明[1], 青木 勲[1], 山田 千由美[1], 山田 俊樹[1]	1.情通機構
	17:00 - 17:15	12p-A13-12	深紫外光励起によるAlN結晶の吸収スペクトル変化	○(B)久保 雄紀[1]	1.宇大 CORE

3.2 材料・機器光学 / Equipment optics and materials　ポスター講演

3月13日(金)　9:30 - 11:30

		13a-P3-1	偏光板を利用しない液晶レンズの結像におけるノイズ除去	○葉 茂[1], 崔 春暉[1], 包 瑞[1], 郁 樹達[1]	1.超多維
		13a-P3-2	宇宙光通信用小型デュプリケート光学系の汎用化に向けた検討	○中山 朋子[1], 高山 佳久[2], 藤川 知栄美[1], 小舘 香椎子[3]	1.東海大工, 2.情報通信研究機構, 3.電通大
		13a-P3-3	コロナ放電選択堆積によるガラスホログラム	○酒井 大輔[1], 神成 邦弘[1], 氏家 健太郎[1], 原田 建治[1], 原 悠一郎[1], 池田 弘[2], 西井 準治[3]	1.北見工大, 2.九大産学連携センター, 3.北大電子研
		13a-P3-4	液体金属を用いたフレキシブルな反射型回折格子	橋本 拓也[1], ○斉藤 光徳[1], 山田 逸成[2], 西井 準治[3]	1.龍谷大, 2.滋賀県立大, 3.北大
		13a-P3-5	四角形状電極を有する液晶マイクロレンズアレイの3次元液晶分子配向シミュレーション	○河村 希典[1], 中村 剣登[1], 佐藤 進[2]	1.秋田大院工, 2.液晶レンズ研
		13a-P3-6	偏光感受性材料中での偏光選択型バイナリホログラムの記録特性	○宮内 大功[1], 江本 顕雄[1], 大谷 直毅[1], 福田 隆史[2]	1.同志社大理工, 2.産総研
		E 13a-P3-7	Hybrid-aligned dye-doped polymer network liquid crystal showing self-focusing effect	○Jing Wang[1], Yosuke Aihara[1], Motoi Kinoshita[2], Atsushi Shishido[1,3]	1.Tokyo Tech., 2.Saitama Tech., 3.PRESTO, JST
		13a-P3-8	PDMS上でのスチルベン誘導体の結晶形成	○望月 博孝[1], 園田 与理子[1], 佐々木 史雄[1], 阿澄 玲子[1], 周 英[1]	1.産総研電子光
		13a-P3-9	Gd_2O_3: Yb^{3+}, Er^{3+} の下方変換発光におけるエネルギー伝達機構	○植田 史郎[1], 有本 聖吾[1], 佐俣 博章[1], 小澤 忠司[2]	1.神戸大海事, 2.物材機構
		13a-P3-10	Gd_2O_3 : Er^{3+}, Yb^{3+}, Li^{+} のアップコンバージョン特性	○埴岡 正史[1], 有本 聖吾[1], 佐俣 博章[1], 小澤 忠司[2]	1.神戸大海事, 2.物材機構

3.3 情報フォトニクス・画像工学 / Information photonics and image engineering　口頭講演

3月13日(金)　16:30 - 17:30

	16:30 - 16:45	13p-A11-1	事例ベース超解像技術を用いた光学顕微鏡	○石川 慎二[1], 早崎 芳夫[1]	1.宇大オプティクス
	16:45 - 17:00	奨 13p-A11-2	画素限界条件下のDepth-from-defocus における瞳位相変調を用いた奥行き分解能の向上	○新原 隆広[1], 堀崎 遼一[1], 清野 光宏[2], 柳井 謙一[2], 谷田 純[1]	1.阪大院情, 2.デンソー
	17:00 - 17:15	13p-A11-3	タンパク質を用いた受容野型フィルター素子による画像処理	○向井 貴之[1], 本井 拓馬[1], 春山 喜洋[2], 笠井 克幸[2], 岡田 佳子[1]	1.電通大先進理工, 2.情報通信研究機構
	17:15 - 17:30	13p-A11-4	複眼画像システムによるプリンタ画線の偏角多段露光観察	○赤尾 佳則[1], 東川 佳靖[1], 谷田 純[2]	1.科警研, 2.阪大院情報

3.3 情報フォトニクス・画像工学 / Information photonics and image engineering　ポスター講演

3月13日(金)　9:30 - 11:30

		13a-P4-1	ディジタルホログラフィにおけるフレネル領域フィルタリング法に適した物体光条件	○井邊 真俊[1], 野村 孝徳[1], Naughton Thomas J.[2]	1.和歌山大院システム工, 2.アイルランド国立大メイヌース校
		13a-P4-2	ディジタルホログラフィック顕微鏡による血液凝固過程の動的観察	熊谷 泰志[1], ○船水 英希[1], 相津 佳永[1]	1.室工大院
		13a-P4-3	矩形開口シフト法によるディジタルホログラフィの画質向上と合焦位置検出応用の検討	○(D)森 裕[1], 福岡 隆彦[1], 野村 孝徳[1]	1.和歌山大院システム工
		13a-P4-4	スペックル照明を用いたカラーディジタルホログラフィック顕微鏡の分光透過率推定	得能 友太[1], ○船水 英希[1], 相津 佳永[1]	1.室工大院
		奨 13a-P4-5	多色光再生法を用いた偏光ホログラフィックメモリーの再生信号特性	○(B)吉田 竜[1], 志村 努[2], 黒田 和男[1], 藤村 隆史[1]	1.宇大CORE, 2.東大生研
		13a-P4-6	キノフォーム可変焦点レンズを用いた多層記録ホログラフィックメモリ	○(D)信川 輝吉[1], 野村 孝徳[1]	1.和歌山大院システム工
		13a-P4-7	長周期グレーティング装荷SOAによる全光2R再生デバイスにおける縦型と横型方向性結合器による特性比較	○益本 佳奈[1], 徐 イツロク[1], 松島 裕一[1], 宇高 勝之[1]	1.早大理工

3.3 情報フォトニクス・画像工学 / Information photonics and image engineering　口頭講演

3月14日(土)　9:00 - 12:15

	9:00 - 9:15	14a-A11-1	AIRRによる空中LEDスクリーン上での手振り復号型ステガノグラフィー	○高橋 昌史[1], 山本 裕紹[1,2]	1.宇大オプト, 2.JST, CREST
	9:15 - 9:30	14a-A11-2	誤差拡散法に基づく難視認性投影パターンの生成	○生源寺 類[1]	1.静大院工
	9:30 - 9:45	14a-A11-3	車用ヘッドアップディスプレイにおける合わせガラス二重像の精密測定	○富田 保士[1], 久保田 重夫[1]	1.オキサイド
	9:45 - 10:00	14a-A11-4	直交ミラーアレイによって収束された音波の波形	○久次米 亮介[1], 宮本 康平[1], 陶山 史朗[1], 山本 裕紹[1,2]	1.徳島大学, 2.宇都宮大学
	10:00 - 10:15	14a-A11-5	視域走査型全周立体ホログラム表示に用いるホログラム計算法	○井上 達晶[1], 高木 康博[2]	1.農工大工, 2.農工大院工
	10:15 - 10:30	14a-A11-6	波面回転光学系を用いた全水平方向から観測可能なホログラフィック3D ディスプレイの時分割数の削減	○山東 悠介[1,2,3], 茨田 大輔[1,2], 谷田貝 豊彦[1]	1.宇大CORE, 2.宇大院工, 3.大阪府産技研
	10:30 - 10:45		休憩/Break		
	10:45 - 11:00	14a-A11-7	水平走査型カラーホログラフィーに適した誤差拡散法	中島 竜海[1], ○高木 康博[1]	1.農工大院工
	11:00 - 11:15	14a-A11-8	コントラストとDuty比を用いた1次元空間光変調素子によるフルカラーホログラフィックディスプレイの画素構造設計	上野 文華[1], 仁田 功一[1], ○的場 修[1]	1.神戸大院シス情
	11:15 - 11:30	奨 14a-A11-9	ホログラフィック並列光アクセスと多層蛍光スクリーンを用いたボリュームディスプレイ	○熊谷 幸汰[1], 長谷川 智士[1], 早崎 芳夫[1]	1.宇大オプト
	11:30 - 11:45	14a-A11-10	2次元位相格子を用いたホログラフィックメモリのための複素振幅変調技術	○(D)信川 輝吉[1], 野村 孝徳[1]	1.和歌山大院システム工
	11:45 - 12:00	14a-A11-11	複素振幅マスクを用いたバイナリーページデータの高密度化方法	○茨田 大輔[1,2], 川田 重夫[1,2], 谷田貝 豊彦[2]	1.宇大院工, 2.宇大CORE
	12:00 - 12:15	奨 14a-A11-12	位相多値ホログラフィックメモリーにおけるクロストークノイズの解析	○(B)染谷 和希[1], 茨田 大輔[2], 志村 努[3], 藤村 隆史[1]	1.宇大CORE, 2.宇大院工, 3.東大生研

3月14日(土)　13:15 - 14:30					
	13:15 - 13:30	奨 14p-A11-1	16パルス縮退光パラメトリック発振器系を用いたコヒーレント計算機	○高田 健太[1,2,3], Marandi Alireza[2,4], 丸尾 大貴[1,2,3], 坂口 潤将[1,2,3], 宇都宮 聖子[2], 山本 喜久[1,2,3,4]	1.東大情理, 2.国立情報学研, 3.理研, 4.スタンフォード大
	13:30 - 13:45	14p-A11-2	蛍光共鳴エネルギー移動に基づく分子論理回路の光制御	○西村 隆宏[1], 藤井 亮[1], 小倉 裕介[1], 谷田 純[1]	1.阪大院情
	13:45 - 14:00	14p-A11-3	3波長同一パターンを生成する回折光学素子の設計	○柿内 孝介[1], 市川 裕之[1]	1.愛媛大院理工
	14:00 - 14:15	14p-A11-4	全干渉型3次元イメージング分光法のにおける双曲面型体積インターフェログラムの計測の検討	○(D)橋本 哲弥[1], 小笠原 早紀[1], 平井 亜紀子[2], 吉森 久[1]	1.岩大院工, 2.産総研
	14:15 - 14:30	14p-A11-5	統計手法を用いた高速格子パターン投影三次元計測法	○安井 裕紀[1], 吉川 宣一[1]	1.埼玉大学大学院理工学研究科

3.4 生体・医用光学 / Biomedical optics　　ポスター講演

3月12日(木)　9:30 - 11:30					
		12a-P4-1	レーザー光散乱場によるナノ粒子挙動の制御: 数値計算による特性考察	○横井 直倫[1], 相津 佳永[2]	1.旭川高専, 2.室蘭工大院
		12a-P4-2	ハイパースペクトル画像を用いたヒト皮膚PSF の検討	奥塚 太一[1], 稲垣 雄太[1], 船水 英希[1], 前田 貴章[2], ○相津 佳永[1]	1.室工大院, 2.釧路高専
		12a-P4-3	局部変化領域を有するヒト皮膚モデルにおける光線追跡計算	佐々木 瞭[1], 前田 貴章[2], 船水 英希[1], 西舘 泉[3], ○相津 佳永[1]	1.室工大院, 2.釧路高専, 3.東京農工大
		12a-P4-4	9層構造皮膚モデルにおける拡散反射光分布のモンテカルロ解析	吉田 貴之[1], 石山 吉紀[1], 船水 英希[1], 前田 貴章[2], ○相津 佳永[1]	1.室工大院, 2.釧路高専
		12a-P4-5	多波長InAs量子ドットSLD光源を用いたSD-OCTによる植物サンプル断層画像取得	○(M2)柴田 弘[1], 保田 拓磨[1], 尾崎 信彦[1], 大河内 俊介[2], 池田 直樹[3], 大里 啓孝[3], 渡辺 英一郎[3], 杉本 喜正[3], 古城 健司[4], 宮地 邦男[4], Hogg Richard[5]	1.和歌山大シス工, 2.NEC, 3.物材機構, 4.シンクランド(株), 5.シェフィールド大
		奨 12a-P4-6	波長0.8-1.9 um帯におけるOCTイメージングの波長依存性の評価	○川越 寛之[1], 山中 真仁[1], 西澤 典彦[1]	1.名大院工
		12a-P4-7	iPS細胞の多能性評価に向けた非線形分光イメージング	○(M1C)米山 弘亮[1], 瀬川 尋貴[2], 西村 健[3], 福田 綾[3], 久武 幸司[3], 加納 英明[1]	1.筑波大・数理, 2.東大院・理, 3.筑波大・医
		12a-P4-8	生体親和性酸化亜鉛微粒子への金担持と光学特性2	○藤井 政俊[1], 橋本 英樹[2], 藤田 恭久[3]	1.島根大医, 2.島根大戦略研究推進セ, 3.島根大院総合理工
		12a-P4-9	蛍光顕微鏡による珪藻の被殻と細胞骨格の可視化	○堀内 友貴[1], 堀田 純一[1]	1.山形大院理工

3.4 生体・医用光学 / Biomedical optics　　口頭講演

3月14日(土)　9:30 - 11:45					
	9:30 - 9:45	14a-A10-1	差分計測を利用した飽和励起顕微鏡:信号対雑音比の向上	○米丸 泰央[1], スミス ニコラス[2], 河田 聡[1], 藤田 克昌[1]	1.阪大工, 2.阪大iFReC
	9:45 - 10:00	奨 14a-A10-2	近赤外発光・カソードルミネッセンスによるマルチスケール生体観察	○(DC)福島 昌一郎[1], 新岡 宏彦[1], 一宮 正義[2], 三宅 淳[1], 芦田 昌明[1], 荒木 勉[1], 橋本 守[1]	1.阪大基, 2.滋賀県立大
	10:00 - 10:15	奨 14a-A10-3	微小CL光源による非染色細胞の高分解能イメージング	○福田 真大[1], 金森 聡[1], 古川 太一[2], 名和 靖矩[3], 居波 渉[3,4], 林 升[4], 川田 善正[3,4]	1.静大院工, 2.阪大ナノサイエンスデザイン教育センター, 3.静大電子研, 4.JST-CREST
	10:15 - 10:30	14a-A10-4	マルチモーダル多光子顕微鏡を用いたラット眼組織の分子イメージング	○(M1C)秋山 敏宏[1], 瀬川 尋貴[2], 加治 優一[3], 大鹿 哲郎[3], 加納 英明[1]	1.筑波大・数理, 2.東大院・理, 3.筑波大・医
	10:30 - 10:45	E 14a-A10-5	Broadband noise suppression for fiber-laser-based video-rate stimulated Raman scattering spectral microscopy.	○Michio Ishikawa[1], Naoki Kohara[1], Yuki Yonetani[1], Akira Yamamoto[1], Chidane Ouchi[1], Masanobu Hasegawa[1]	1.Canon Inc.
	10:45 - 11:00	14a-A10-6	高感度・高解像フォトサーマル顕微鏡による生体組織の3次元イメージグ	○宮崎 淳[1], 川角 洸史[1], 小林 孝嘉[1]	1.電通大先端レーザー
	11:00 - 11:15	14a-A10-7	ショートマルチモードファイバープローブを用いたFFOCTの基礎特性	○関根 雄樹[1], 高橋 俊博[1], 西舘 泉[2], 佐藤 学[1]	1.山形大, 2.東京農工大
	11:15 - 11:30	14a-A10-8	プラスチック光ファイババンドルを用いた細胞の蛍光イメージング	○櫻井 孝司[1], 夏目 三男[2], 鯉田 孝和[1]	1.豊橋技科大EIIRIS, 2.電興社
	11:30 - 11:45	E 14a-A10-9	Capillary flow reactor synthesis of upconversion colloidal nanoparticles	○Thangaraju Dheivasigaman[1], Mortier Michel[2], Karthikeyan Rajan[1], Prakash Natarajan[1], Tadanobu Koyama[1], Yasuhiro Hayakawa[1]	1.RIE Shizuoka Univ, 2.Chimie ParisTech
3月14日(土)　13:00 - 14:30					
	13:00 - 13:15	14p-A10-1	Continuous and noninvasive characterization of liquid sample based on continuous-wave photoacoustic technique: accuracy improvements with linear fitting.	○Serge Camou[1], Yujiro Tanaka[1], Yuichi Higuchi[1], Hiroshi Koizumi[1]	1.Device Techn. Labs., NTT Corp.
	13:15 - 13:30	奨 14p-A10-2	CW光音響法を応用した非侵襲血糖モニタの高精度化に向けた2次多項式近似アルゴリズム	○田中 雄次郎[1], 樋口 雄一[1], カム セルジュ[1]	1.NTT先デ研
	13:30 - 13:45	14p-A10-3	レーザー走査法による模擬血管の動態観測	○(M1)篠永 直輝[1], 岩井 俊昭[1]	1.東京農工大 BASE
	13:45 - 14:00	14p-A10-4	心臓拍動研究のためのインキュベーター内自動録画システム	○三井 祐司[1]	1.青学大理工
	14:00 - 14:15	14p-A10-5	画像解析を用いた心臓組織片による拍動の伝播と同期化の研究	○(B)新井 晋[1], 高橋 伴典[1], 三井 祐司[1], 石田 研太郎[1], 三井 敏之[1]	1.青学大理工
	14:15 - 14:30	14p-A10-6	心臓組織片による同期化のメカニズムの研究	○高橋 伴典[1], 新井 晋[1], 三井 祐司[1], 石田 研太郎[1], 山崎 将吾[2], 金子 智行[2], 三井 敏之[1]	1.青学大, 2.法政大

3.5 レーザー装置・材料, 3.14 光制御デバイス・光ファイバーのコードシェアセッション　口頭講演

3月13日(金)　9:00 - 11:15

招待	9:00 - 9:15	13a-A13-1	**「講演奨励賞受賞記念講演」(15分) 中赤外(9-12μm)光渦レーザーにおける符号制御**	**○堀川 マイケル知樹[1], 尾川 あずさ[1], 古城 健司[1], 宮本 克彦[1], 尾松 孝茂[1,2]**	**1.千葉大融合, 2.JST-CREST**
	9:15 - 9:30	奨・E 13a-A13-2	Widely tunable optical vortex parametric laser	○(D)ABULIKEMU AIZITIAILI[1], Taximaiti Yusufu[1,2], Katsuhiko Miyamoto[1], Takashige Omatsu[1,2]	1.Chiba Univ, 2.JST-CREST
	9:30 - 9:45	13a-A13-3	マイクロチップレーザー励起中赤外光パラメトリック発生の検討	○石月 秀貴[1], 平等 拓範[1]	1.分子研
	9:45 - 10:00	奨 13a-A13-4	CsLiB6O10結晶を用いた非同軸位相整合方式の高効率 355nm 紫外光発生	○(D)曲 晨[1], 吉村 政志[1], 高橋 義典[1], 森 勇介[1]	1.阪大院工
	10:00 - 10:15	奨 13a-A13-5	金属/液体電極を用いた電圧印加による$MgO:LiNbO_3$周期分極反転構造の作製と緑色光第二高調波発生	○沖野 行佑[1], 栖原 敏明[1]	1.阪大院工
	10:15 - 10:30	奨 13a-A13-6	接合イオンスライス$LiNbO_3$結晶におけるプロトン交換増速エッチングによるリッジ光導波路の作製	○田中 圭祐[1], 栖原 敏明[1]	1.阪大院工
	10:30 - 10:45	奨 13a-A13-7	MgO(8mol%)添加c-$LiTaO_3$アニールプロトン交換導波路の作製	○岡 寿治[1], 栖原 敏明[1]	1.阪大院工
	10:45 - 11:00	13a-A13-8	AlGaAs/AlOx 高屈折率差U字導波路における第二高調波発生の位相整合特性	○中村 勇貴[1], 松下 智紀[1], 近藤 高志[1]	1.東大工
	11:00 - 11:15	奨 13a-A13-9	周期空間反転AlGaAsのAs_2を用いたMBE成長	○楢崎 亮太[1], 松下 智紀[1], 近藤 高志[1]	1.東大工

3.5 レーザー装置・材料 / Laser system and materials　ポスター講演

3月12日(木)　9:30 - 11:30

		12a-P5-1	光アイソレーターを用いた遠赤外レーザー励起用CO_2レーザーの安定化	○中山 和也[1], 岡島 茂樹[1], 秋山 毅志[2], 田中 謙治[2], 川端 一男[2]	1.中部大工, 2.核融合研
		12a-P5-2	青色InGaN半導体レーザ励起可視受動モード同期Pr:YLFレーザ	○狩山 了介[1], 田中 裕樹[1], 飯島 功大[1], 神成 文彦[1]	1.慶大理工
		12a-P5-3	高出力パルス動作Ybファイバーレーザーシステムの開発(7)	○吉田 英次[1], 山村 健[2,4], 椿本 孝治[1], 藤田 尚徳[1], 宮永 憲明[1], 塚本 雅裕[3], 酒川 友一[2,4], ハイク コスロービアン[2,5], 谷口 誠治[2,5], 藤田 雅之[2,5], 井澤 靖和[2,5]	1.阪大レーザー研, 2.ALPROT, 3.阪大接合研, 4.片岡製作所, 5.レーザー総研
		12a-P5-4	重力波検出器KAGRAの発振周波数安定化レーザーシステム	○土井 康平[1], KAGRA コラボレーション	, 1.東大
		12a-P5-5	放電の空間的制御を用いた高繰り返し軸方向放電励起N_2レーザー	○市來 秀平[1], 對馬 弘明[1], 宇野 和行[1], 秋津 哲也[1], 實野 孝久[2]	1.山梨大工, 2.阪大レーザー研
		E 12a-P5-6	Tiled Aperture Coherent Combining of Multiple Beams using Bernoulli Algorithm	○Haik Chosrowjan[1], Toshiyuki Kitamura[2], Mitsuru Musha[2], Masayuki Fujita[1], Yasukazu Izawa[1]	1.ILT, 2.Inst. for Laser Science, Univ. of Electro-Commun.
		12a-P5-7	太陽光励起用Ce/Cr/Nd:YAGセラミックレーザーにおけるNdイオン蛍光寿命の温度依存特性	○(M1)中町 崇人[1], 佐伯 拓[1], 林 考則[1], 藤岡 加奈[2], 古瀬 裕章[3], 本田 能之[2], 本越 伸二[4], 藤本 靖[2], 中塚 正大[2,4], 飯田 幸雄[1]	1.関西大学システム理工, 2.大阪大学レーザーエネルギー学研究センター, 3.北見工業大学, 4.レーザー技術総合研究所

3.5 レーザー装置・材料 / Laser system and materials　口頭講演

3月13日(金)　16:30 - 18:45

	16:30 - 16:45	奨 13p-A13-1	高速スキャナーを用いた利得分布制御による高次Laguerre-Gaussモードビームの直接発振	○佐藤 拓海[1], 小澤 祐市[1], 佐藤 俊一[1]	1.東北大工
	16:45 - 17:00	13p-A13-2	金リングパターンを持つNd:YVO_4レーザー結晶の熱レンズ効果の検討	○角 剛[1], 小澤 祐市[1], 佐藤 俊一[1]	1.東北大多元研
	17:00 - 17:15	13p-A13-3	安定な光混合を目的としたピコ秒パルス光源の開発	○山垣 美恵子[1], 奥山 大輔[1], 澤田 久[1], 折井 庸亮[1], 岡田 穣治[1]	1.スペクトロニクス
	17:15 - 17:30	奨 13p-A13-4	1 μm帯利得スイッチング半導体レーザピコ秒光パルスの光増幅における自然放出光ノイズの入力光パワー依存性	○茶木 智大[1,2], 草間 裕太[2], 房 宜澈[1,2], 山田 博仁[1,2], 横山 弘之[1,2]	1.東北大院工, 2.東北大未来研
	17:30 - 17:45	E 13p-A13-5	Multi-hundreds-kW-peak-power picosecond-light-pulse source based on a 1060-nm-band gain-switched laser diode	○(D)YICHENG FANG[1,2], Tomohiro Chaki[1,2], Kusama Yuta[1], Hirohito Yamada[1,2], Hiroyuki Yokoyama[1,2]	1.NICHe, Tohoku Univ., 2.Grad.School of Eng., Tohoku Univ.
	17:45 - 18:00	13p-A13-6	利得スイッチング半導体レーザに基づく同期制御2波長パルス光源	○草間 裕太[1], 房 宜澈[1], 根本 知己[2], 横山 弘之[1]	1.東北大 未来研, 2.北海道大 電子研
	18:00 - 18:15	13p-A13-7	1.1μm帯量子ドット波長可変レーザの開発	○山野井 俊雄[1], 友松 泰則[1], 遠藤 尚[1], 山本 直克[2], 赤羽 浩一[2], 川西 哲也[2]	1.光伸光学工業(株), 2.情報通信研究機構
	18:15 - 18:30	13p-A13-8	波長可変LDの線幅狭窄化に向けた検討	○原口 英介[1], 望月 敬太[1], 上野 雄鋭[1], 長谷川 清智[1], 安藤 俊行[1]	1.三菱電機(株)
	18:30 - 18:45	13p-A13-9	1 μm帯における広帯域テーパーアンプの開発	○(M1)丸茂 大樹[1]	1.千葉大院理

3月14日(土)　9:30 - 12:00

	9:30 - 9:45	奨 14a-A13-1	共振器内高次高調波発生のためのリング型共振器Yb:YAG Thin Diskモード同期レーザー	○神田 夏輝[1,2], アマニ イランル[1], 今鉾 友洋[3], 住吉 哲実[3], 鍋川 康夫[1], 五神 真[2,4], 緑川 克美[1,4]	1.理研, 2.東大光量子, 3.サイバーレーザー, 4.東大フォトンサイエンス機構
	9:45 - 10:00	奨 14a-A13-2	二周波数注入同期連続発振Ti: Sapphireレーザーの出力安定化	○(M1)吉崎 諒[1], Gavara Trivikramarao[1], 藤村 祐希[1], 桂川 眞幸[1]	1.電通大先進理工
	10:00 - 10:15	14a-A13-3	LD直接励起モード同期Cr^{4+}:YAG単結晶ファイバーレーザー	○石橋 茂雄[1]	1.NTT先端集積デバイス研究所
	10:15 - 10:30	奨 14a-A13-4	サファイアエンドキャップNd:YVO_4スラブバウンス増幅器を用いた 高効率・高出力ピコ秒レーザー	○鴻和 真弥[1], 阿部 将士[1], 宮本 克彦[1], 尾松 孝茂[1,2]	1.千葉大融合, 2.JST CREST
	10:30 - 10:45	奨 14a-A13-5	青色InGaN 半導体レーザ 励起高出力Pr^{3+}:YLF レーザ及び受動Qスイッチ動作	○飯島 功大[1], 狩山 了介[1], 田中 裕樹[1], 神成 文彦[1]	1.慶大理工
	10:45 - 11:00	奨 14a-A13-6	緑色InGaN半導体レーザ2台励起モード同期Ti:sapphireレーザ	○澤田 亮太[1], 田中 裕樹[1], 狩山 了介[1], 神成 文彦[1]	1.慶大理工
	11:00 - 11:15	14a-A13-7	GaN Blue LD励起 Pr^{3+}YLF Laserの赤色2W連続発振	○川瀬 宏海[1], 大内 幹夫[1], 折井 庸亮[2]	1.東京電機大, 2.スペクトロニクス
	11:15 - 11:30	14a-A13-8	常温接合を用いたNd:YAG/ダイヤモンド複合構造レーザーの発振特性	○奥山 洋平[1], 山内 太貴[1], 恩田 友美[1], 庄司 一郎[1]	1.中大理工
	11:30 - 11:45	14a-A13-9	レーザーグレードYb:FAP異方性セラミックスにおける光増幅特性の確認	○佐藤 庸一[1], 秋山 順[1], 平等 拓範[1]	1.分子研

	11:45 - 12:00	14a-A13-10	Sn^{2+}添加リン酸塩ガラス及びホウ酸塩ガラスの可視蛍光飽和特性	○川本 拓也[1,3], 時田 茂樹[1], 正井 博和[2], 田口 俊弘[3], 河仲 準二[1]	1.阪大レーザー研, 2.京大化研, 3.摂南大理工

3.6 超高速・高強度レーザー / Ultrashort-pulse and high-intensity lasers　口頭講演

3月12日(木)　9:45 - 12:30

	9:45 - 10:00	12a-A15-1	フッ化物多層膜鏡による受動共振器利用VUV 高調波のアウトプットカップリング	和久井 健太郎[1], 早坂 和弘[1], ○井戸 哲也[1]	1.情通機構
	10:00 - 10:15	12a-A15-2	プラズマミラーを用いた周波数分解光ゲート法による真空紫外波形計測	○板倉 隆二[1], 熊田 高之[1], 中野 元善[1], 赤木 浩[1]	1.原子力機構・関西研
	10:15 - 10:30	12a-A15-3	多光子イオン化質量分析における深紫外フェムト秒光パルス幅のオンサイト簡易測定	○今坂 智子[1], 濱地 彬文[2], 奥野 智也[2], 今坂 藤太郎[2,3]	1.九大院芸工, 2.九大院工, 3.九大未来化セ
	10:30 - 10:45	12a-A15-4	ガス媒質中でのフィラメンテーションを利用した可視域 6.5 フェムト秒パルスの発生	○金島 圭佑[1], 石井 順久[1], 板谷 治郎[1]	1.東大物性研
	10:45 - 11:00	12a-A15-5	BIBO-OPCPAによるサブ2サイクルミリジュール赤外パルス発生	○石井 順久[1], 金島 圭佑[1], 金井 輝人[1], 渡部 俊太郎[2], 板谷 治郎[1]	1.東大物性研, 2.東理大
	11:00 - 11:15		休憩/Break		
招待	11:15 - 11:30	12a-A15-6	**「光・フォトニクス 分科内招待講演」(15分) 12 GHzフェムト秒モード同期レーザーを用いた光パルスフーリエ合成**	**○(D)遠藤 護[1,2], 谷 峻太郎[1,2], 小林 洋平[1,2]**	**1.東大物性研, 2.JST ERATO**
	11:30 - 11:45	12a-A15-7	広帯域フェムト秒レーザを用いたType-I差周波混合中赤外パルス波形整形	○(M1)伊佐 文宏[1], 藤井 令央[1], 鈴木 敬和[1], 廣澤 賢一[1], 神成 文彦[1]	1.慶大理工
	11:45 - 12:00	12a-A15-8	全ファイバー型自己相似 Er ファイバー増幅システムによる 41 fs パルス発生	○吉富 大[1], 鳥塚 健二[1]	1.産総研
	12:00 - 12:15	12a-A15-9	共振器内フィルタを有する高速波長可変ピコ秒モード同期ファイバレーザ	○(B)田代 大悟[1], 小関 泰之[1]	1.東大工
	12:15 - 12:30	12a-A15-10	1.06-μm帯利得スイッチング駆動DFB-LD光パルスのジッタ低減の検討	○(M1)徳永 京也[1], 房 宜澂[2], 草間 裕太[2], 横山 弘之[2], 小関 泰之[1]	1.東大院工, 2.東北大NICHe

3月12日(木)　14:00 - 17:45

	14:00 - 14:15	奨 12p-A15-1	パルス捕捉現象による非線形光ループミラーを用いた全光サンプリング	○白木 英二[1], 西澤 典彦[2]	1.岐阜高専, 2.名大
	14:15 - 14:30	奨 12p-A15-2	非線形偏波回転とカーボンナノチューブフィルムを用いたハイブリッドモード同期Er添加ファイバーレーザーの特性評価	○(M1)野々部 和樹[1], 金 磊[1], 榊原 陽一[2], 面田 恵美子[2], 片浦 弘道[2], 西澤 典彦[1]	1.名大院工, 2.産総研
	14:30 - 14:45	12p-A15-3	光制御型光コム	○稲場 肇[1], 大久保 章[1], シュラム マルテ[1], 郡司 謙汰[1,2], 洪 鋒雷[3], 保坂 一元[1], 大苗 敦[1]	1.産総研, 2.筑波大, 3.横国大
	14:45 - 15:00	奨 12p-A15-4	2f-3f自己参照干渉計によるCEO周波数の安定性評価	○日達 研一[1], 石澤 淳[1], 忠永 修[2], 増子 拓紀[1], 西川 正[3], 寒川 哲臣[1], 後藤 秀樹[1]	1.NTT物性研, 2.NTT先デ研, 3.東京電機大
	15:00 - 15:15	12p-A15-5	トロイド共振器において発生した光カーコムの時間波形測定及び雑音評価	○岡部 悠介[1], 鈴木 良[1], 陳 哲倫[1], 長野 拓真[1], 小畠 知也[1], 田邉 孝純[1]	1.慶大理工
	15:15 - 15:30	奨 12p-A15-6	シミラリトン増幅器によるオクターブスパンスーパーコンティニューム光のコヒーレンス性の評価	○(M1)野村 佳孝[1], 榊原 陽一[2], 面田 恵美子[2], 片浦 弘道[2], 西澤 典彦[1]	1.名大院工, 2.産総研
	15:30 - 15:45	12p-A15-7	オンチップスーパーコンティニューム光スペクトルとシリコン導波路入射パルス波形の関係	○(M1)後藤 貴大[1,2], 石澤 淳[1], 高 磊[3,4], 土澤 泰[3,4], 松田 信幸[1,3], 日達 研一[1], 西川 正[2], 山田 浩治[3,4], 寒川 哲臣[1], 後藤 秀樹[1]	1.NTT物性研, 2.東京電機大, 3.NTT NPC, 4.NTT先デ研
	15:45 - 16:00		休憩/Break		
	16:00 - 16:15	12p-A15-8	IRドップラー観測用光周波数コムの広帯域化	○森 貴宏[1], 奥山 康志[1], 柏木 謙[1], 田中 洋介[1], 黒川 隆志[1,2], 小谷 隆行[2], 西川 淳[2], 田村 元秀[2,3]	1.東京農工大, 2.国立天文台, 3.東大
	16:15 - 16:30	12p-A15-9	電気光学変調器ベース光周波数コムを用いた低位相雑音ミリ波発生	○石澤 淳[1], 西川 正[2], 後藤 貴大[1,2], 日達 研一[1], 寒川 哲臣[1], 後藤 秀樹[1]	1.NTT物性研, 2.東京電機大
	16:30 - 16:45	奨 12p-A15-10	気体中高強度サブサイクル光パルス発生	○貴田 祐一郎[1], 今坂 藤太郎[1,2]	1.九大院工, 2.九大未来化セ
	16:45 - 17:00	奨 12p-A15-11	チャープパルスアップコンバージョンを用いた中赤外領域の時間分解分光	○(B)畑 秀文[1,2], 中村 亮介[1], 濱田 格雄[1], 神村 共住[2]	1.阪大, 2.大工大
	17:00 - 17:15	奨 12p-A15-12	コヒーレント結合系を用いて生成された超短径偏光パルスの拡張ストークスパラメータによる定量的解析	○(DC)鈴木 雅人[1], 山根 啓作[1,2], 岡 和彦[1], 戸田 泰則[1,2], 森田 隆二[1,2]	1.北大院工, 2.JST CREST
	17:15 - 17:30	12p-A15-13	軸対称偏光ビームの空間位相解析	○山根 啓作[1,2], 横瀬 尚也[1], 鈴木 雅人[1], 戸田 泰則[1,2], 森田 隆二[1,2]	1.北大工, 2.JST-CREST
	17:30 - 17:45	12p-A15-14	光電場再生に基づいた光渦のラゲールガウスモード展開	○山根 啓作[1,2], 中嶌 奨太[1], 鈴木 雅人[1], 戸田 泰則[1,2], 森田 隆二[1,2]	1.北大工, 2.JST-CREST

3月13日(金)　16:30 - 19:00

	16:30 - 16:45	13p-A15-1	X線+近赤外2色レーザー励起による共鳴オージェ過程の光学制御	Chatterjee Souvik[1], ○中嶋 隆[1]	1.京大エネ研
	16:45 - 17:00	13p-A15-2	1,2-ブタジエンにおける超高速緩和ダイナミクスの研究	○(M1)飯窪 亮[1], 藤原 丈久[1], 関川 太郎[1], 原渕 祐[2], 武次 徹也[2], 萱沼 洋輔[3]	1.北大院工, 2.北大院理, 3.東工大応セラ研
	17:00 - 17:15	13p-A15-3	シクロヘキサジエン開環反応における基底状態生成物の観測	○足立 俊輔[1,2], 佐藤 元樹[1], 鈴木 俊法[1,2]	1.京大理, 2.理研
	17:15 - 17:30	13p-A15-4	90nm真空紫外パルスによる液体の超高速光電子分光	佐藤 元樹[1], ○足立 俊輔[1,2], 鈴木 俊法[1,2]	1.京大理, 2.理研
	17:30 - 17:45	13p-A15-5	レーザーによる固体電子励起過程のためのKeldysh理論の再構築	○乙部 智仁[1], 篠原 康[2], 佐藤 駿丞[3], 矢花 一浩[3]	1.原子力機構, 2.マックスプランク, 3.筑波大
	17:45 - 18:00		休憩/Break		
	18:00 - 18:15	13p-A15-6	カルコゲナイド半導体薄膜の超高速相変化ダイナミクス	大庭 航[1], 片山 郁文[1], 南 康夫[1], 桑原 正史[2], 斎木 敏治[3], ○武田 淳[1]	1.横浜国大院工, 2.産総研, 3.慶大理工
	18:15 - 18:30	13p-A15-7	アルカンチオール鎖の銀ナノ粒子吸着状態のコヒーレント超高速振動分光	○首藤 健一[1], 杉山 夏輝[1], 片山 郁文[1], 北島 正弘[1,2,3], 武田 淳[1]	1.横浜国立大学, 2.株式会社ルクスレイ, 3.防衛大
	18:30 - 18:45	13p-A15-8	波形整形中赤外パルスによる反応制御に向けた試み:$K_2[RuCl_5(NO)]$重水溶液のNO伸縮振動ラダークライミング	○(PC)田山 純平[1], 芦原 聡[1]	1.東大生研
	18:45 - 19:00	13p-A15-9	波形整形中赤外パルスによる液相分子の2振動自由度コヒーレント制御	○若林 直樹[1], 田山 純平[2], 芦原 聡[2]	1.農工大工, 2.東大生研

3.6 超高速・高強度レーザー / Ultrashort-pulse and high-intensity lasers　ポスター講演

3月13日(金)　9:30 - 11:30

		13a-P5-1	正常分散型モード同期Ybファイバーレーザーの開発とその動作解析	○山中 紀幸[1], 芦原 聡[2]	1.農工大工, 2.東大生研

3.6 超高速・高強度レーザー / Ultrashort-pulse and high-intensity lasers　口頭講演

3月14日(土)　9:15 - 12:00

	9:15 - 9:30	E 14a-A15-1	Scalings of High-Order Harmonics from Relativistic Electron Spikes	○Alexander Pirozhkov[1], Masaki Kando[1], Timur Esirkepov[1], Tatiana Pikuz[2], Anatoly Faenov[2], Koichi Ogura[1], Yukio Hayashi[1], Hideyuki Kotaki[1], Eugene Ragozin[3], David Neely[4], Hiromitsu Kiriyama[1], Manabu Tanoue[1], Yoshiki Nakai[1], Masahiro Okamoto[1], Kazuhiro Torimoto[1], Shuji Kondo[1], Shuhei Kanazawa[1], James Koga[1], Yuji Fukuda[1], Masaharu Nishikino[1], Takashi Imazono[1], Noboru Hasegawa[1], Tetsuya Kawachi[1], Hiroyuki Daido[1], Yoshiaki Kato[5], Sergei Bulanov[1], Kiminori Kondo[1]	1.JAEA, 2.Osaka Univ., 3.Lebedev Phys. Inst., 4.CLF RAL, 5.GPI
	9:30 - 9:45	14a-A15-2	レーザー駆動イオン加速のための水素クラスターターゲットの生成とその評価	○神野 智史[1], 田中 宏尭[2,3], 金崎 真聡[3], 榊 泰直[3], 近藤 公伯[3], 松井 隆太郎[3,4], 岸本 泰明[4], 福田 祐仁[2,3]	1.東大院工, 2.九大総理工, 3.原子力機構関西, 4.京大エネ科
	9:45 - 10:00	奨 14a-A15-3	クラスターターゲットを用いたレーザー駆動イオン加速における背景ガスイオンの加速	○金崎 真聡[1], 神野 智史[1], 榊 泰直[1], Faenov A. Ya.[1], Pikuz T. A.[1], 西内 満美子[1], 桐山 博光[1], 神門 正城[1], 近藤 公伯[1], 松井 隆太郎[2], Scullion C.[3], Smyth A. G.[3], Aaron A.[3], Doria D.[3], Borghesi M.[3], 小田 啓二[4], 山内 知也[4], 岸本 泰明[2], 福田 祐仁[1]	1.原子力機構関西研, 2.京大エネ科, 3.QUB, 4.神大院海事
	10:00 - 10:15	奨 14a-A15-4	配列した二酸化炭素分子から発生する高次高調波強度の楕円率依存性	○(M2)中川 桂[1], 峰本 紳一郎[1], 酒井 広文[1]	1.東大院理
	10:15 - 10:30	奨 14a-A15-5	硫化カルボニル分子の多チャンネル解離性イオン化における角度依存性	○酒見 悠介[1], 峰本 紳一郎[1], 長野 晃士[1], 酒井 広文[1]	1.東大院理
	10:30 - 10:45	奨 14a-A15-6	状態選別した分子のフィールドフリーな配列および配向制御	○文 堤會[1], 夏 沛宇[1], 峰本 紳一郎[1], 酒井 広文[1]	1.東大院理
	10:45 - 11:00		休憩/Break		
招待	11:00 - 11:15	14a-A15-7	**「講演奨励賞受賞記念講演」(15分)** **フェムト秒時間分解電子線回折法の開発:トポロジカル絶縁体の光誘起構造ダイナミクスの観測**	**○羽田 真毅[1,2], 則松 桂[1,3], 田中 誠一[4], Keskin Sercan[5], 鶴田 哲也[1,3], 五十嵐 九四朗[1], 石川 忠彦[4], 萱沼 洋輔[1,3], Miller R. J. Dwayne[5,6], 笹川 崇男[1], 恩田 健[2,4], 腰原 伸也[3,4], 中村 一隆[1,3]**	**1.東工大応セラ研, 2.JST-さきがけ, 3.JST-CREST, 4.東工大理工, 5.マックス・プランク研, 6.トロント大**
	11:15 - 11:30	奨 14a-A15-8	トポロジカル絶縁体Bi_2Te_3の光励起電子・格子ダイナミクス	○則松 桂[1,2,3,4], 羽田 真毅[1,5], 鶴田 哲也[1,3,4], 五十嵐 九四朗[1,3], 田中 誠一[6], 恩田 健[5,6], 笹川 崇男[1,3], 中村 一隆[1,3,5]	1.東工大応セラ研, 2.JSPS, 3.東工大総理工, 4.JST-CREST, 5.JST-さきがけ, 6.東工大理工
	11:30 - 11:45	奨 14a-A15-9	広帯域線形周波数チャープパルスを用いた全光学超高速イメージング	○(B)鈴木 敬和[1], 藤井 令央[1], 伊佐 文宏[1], 廣澤 賢一[1], 神成 文彦[1]	1.慶大理工
	11:45 - 12:00	奨 14a-A15-10	気体を用いたチャープパルス上方変換による中赤外ポンプ・プローブ分光	○(PC)白井 英登[1], 葉 恬恬[2], 野村 雄高[1], 羅 志偉[2], 藤 貴夫[1]	1.分子研, 2.台湾交通大

3月14日(土)　13:00 - 15:00

招待	13:00 - 13:30	14p-A15-1	**「第16回光・量子エレクトロニクス業績賞(宅間宏賞)受賞記念講演」(30分)** **コンパクトSASE型X線自由電子レーザーSACLA**	**○石川 哲也[1], 新竹 積[2], 北村 英男[1]**	**1.理化学研究所, 2.沖縄科技大**
	13:30 - 13:45	14p-A15-2	単一アト秒パルス用回折限界集光システムの開発	澤田 和寛[1,2], 森 哲[3], 田丸 裕基[1,4], 豊田 光紀[3], ○高橋 栄治[1], 神成 文彦[2], 須田 亮[4], 緑川 克美[1], 柳原 美廣[3]	1.理研, 2.慶応大, 3.東北大多元研, 4.東京理科大
	13:45 - 14:00	14p-A15-3	アト秒パルス列によって生成された振動波束の非自明な位相変調	○鍋川 康夫[1], 古川 裕介[1], 沖野 友哉[1], アマニ イランル[1], 高橋 栄治[1], 山内 薫[2], 緑川 克美[1]	1.理研光量子, 2.東大院理
	14:00 - 14:15	14p-A15-4	高強度レーザー中の多電子ダイナミクス: 時間依存・多配置自己無撞着場法の原子のための実装	○佐藤 健[1], 石川 顕一[1]	1.東大院工
	14:15 - 14:30	14p-A15-5	Multi Resolution TDSE / MCTDHFの開発	○澤田 亮人[1], 佐藤 健[1], 石川 顕一[1]	1.東大院工
	14:30 - 14:45	E 14p-A15-6	Time-Dependent Multiconfiguration Study of High Harmonic Generation from Multielectron Atoms	○(M2)Iliya Tikhomirov[1], Takeshi Sato[1], Ryohto Sawada[1], Kenichi Ishikawa[1]	1.University of Tokyo
	14:45 - 15:00	14p-A15-7	シリコンのコヒーレントフォノンの発生起源に関する実験的考察	○加藤 景子[1], 小栗 克弥[1], 後藤 秀樹[1]	1.NTT物性研

3.7 レーザープロセシング / Laser processing　口頭講演

3月11日(水)　9:30 - 12:30

	9:30 - 9:45	11a-A11-1	プラズモン援用フェムト秒レーザナノ還元の偏波依存性制御	○西山 宏昭[1], 大関 透典[1]	1.山形大院理工
	9:45 - 10:00	11a-A11-2	汎用グリーンレーザーを用いた紫外透過性フッ素ポリマーの微細加工技術開発	○(B)小川 達也[1], 及川 良太[1], 花田 修賢[1,2]	1.弘前大学, 2.理研
	10:00 - 10:15	11a-A11-3	短パルスレーザーを利用した材料表面改質による水素吸蔵合金の吸蔵能変化	○阿部 浩之[1], 徳平 真之介[2], 下村 拓也[3], 島田 幸洋[3], 竹仲 祐介[3], 古山 雄太[3], 西村 昭彦[3], 大道 博行[3], 内田 裕久[2], 大島 武[1]	1.原子力機構量子ビーム, 2.東海大学院応理, 3.原子力機構レーザー共研
	10:15 - 10:30	11a-A11-4	時間分解反射率の振動から探る高分子材料のフェムト秒レーザーアブレーションにおける非熱効果の研究	○熊田 高之[1], 赤木 浩[1], 板倉 隆二[1], 乙部 智仁[1], 横山 淳[1]	1.原子力機構関西
	10:30 - 10:45	11a-A11-5	第一原理計算によるレーザー損傷閾値及び深さの解析	○佐藤 駿丞[1], 矢花 一浩[1], 篠原 康[2], 乙部 智仁[3], 李 畊旻[4], G.F. Bertsch[5]	1.筑波大, 2.Max-Planck Inst., 3.JAEA関西, 4.韓国CoReLS, 5.ワシントン大
	10:45 - 11:00	11a-A11-6	イットリア安定化ジルコニア表面への短パルスレーザー誘起周期的構造形成	○欠端 雅之[1], 屋代 英彦[1], 大矢根 綾子[2], 伊藤 敦夫[3], 鳥塚 健二[1]	1.産総研 電子光技術, 2.産総研 ナノシステム, 3.産総研 ヒューマンライフテクノロジー
	11:00 - 11:15		休憩/Break		
	11:15 - 11:30	11a-A11-7	シリコン表面におけるフェムト秒レーザサブミクロン加工形状へのリップル形成の影響	○八木 隆志[1], 菅原 諒[1], 曽根 有紀[1], 関口 翔大[1], 門井 慎[1], 林 竜生[1]	1.東海大理

	11:30 - 11:45	11a-A11-8	ラジアルおよびアジミューサル偏光ベッセルビームによるSiおよびAlの微細加工パターン形成メカニズムの研究	○八木 隆志[1], 関口 翔大[1], 曽根 有紀[1], 菅原 諒[1], 北原 俊一[1], 鈴木 貴士[1], 牧野 渉[1]	1.東海大理
	11:45 - 12:00	11a-A11-9	四角穴加工のための分割構造複屈折素子	○菊池 弘[1], 安西 雄祐[1], 水谷 彰夫[1], 菊田 久雄[1], 平井 義彦[1], 川田 博昭[1]	1.大阪府立大院工
	12:00 - 12:15	11a-A11-10	大規模並列フェムト秒レーザー加工	○長谷川 智士[1], 早崎 芳夫[1]	1.宇都宮大オプティクス
	12:15 - 12:30	11a-A11-11	多点同時フェムト秒レーザー照射による単結晶内部の過渡応力分布の変調と亀裂進展への影響	○坂倉 政明[1], 岡田 拓郎[2], 福田 直晃[1], 下間 靖彦[3], 三浦 清貴[3]	1.京大産連本部, 2.京大工, 3.京大院工
	3月11日(水)　14:00 - 18:00				
招待	**14:00 - 14:15**	**11p-A11-1**	**「講演奨励賞受賞記念講演」(15分) 水中レーザー誘起ブレークダウン分光法における蒸発速度差を考慮した組成比の補正**	**○松本 歩[1], 田村 文香[1], 天野 健一[1], 深見 一弘[1], 西 直哉[1], 作花 哲夫[1]**	**1.京大院工**
	14:15 - 14:30	奨 11p-A11-2	レーザー駆動EUV光による物質アブレーションにおけるイオン膨張に関する研究	○出口 亮[1], 田中 のぞみ[2], 増田 将也[1], 砂原 淳[2], 村上 匡且[1], 余語 覚文[1], 西村 博明[1]	1.阪大レーザー研, 2.レーザー総研
	14:30 - 14:45	奨 11p-A11-3	フェムト秒パルスレーザーが誘起する気泡生成過程の高時間分解計測	○(DC)水嶋 祐基[1], 齋藤 隆之[2]	1.静大創科院, 2.静大グリーン研
	14:45 - 15:00	奨 11p-A11-4	フェムト秒レーザー誘起衝撃力が微小物体に及ぼす作用ダイナミクスの定式化	○(M1)山川 健[1], 丸山 彰大[1], 飯野 敬矩[1], 細川 陽一郎[1]	1.奈良先端大物質
	15:00 - 15:15	奨 11p-A11-5	フェムト秒レーザー照射による周期的微細構造形成がチタン基板上の細胞伸展に与える効果	○河 拓弥[1], 塚本 雅裕[2], 篠永 東吾[2], 原 一之[1], 宮川 和也[1], 徐 賢先[3], 陳 鵬[4], 永井 亜希子[4], 塙 隆夫[4]	1.阪大院工, 2.阪大接合研, 3.阪大工, 4.東医歯大生材工研
	15:15 - 15:30		休憩/Break		
	15:30 - 15:45	奨 11p-A11-6	フェムト秒レーザ直接還元描画法におけるCuOナノ粒子の還元特性評価	○溝尻 瑞枝[1], 荒金 駿[1], 櫻井 淳平[1], 秦 誠一[1]	1.名大院工
	15:45 - 16:00	奨 11p-A11-7	フェムト秒レーザーアブレーションにおけるタングステン剥離薄膜形状の局所強度依存性	○井筒 類[1], 江山 剛史[1], 柿本 直也[1], 富田 卓朗[1], 長谷川 登[2], 錦野 将元[2], 南 康夫[3], 馬場 基芳[3], 河内 哲哉[2], 山極 満[2], 末元 徹[3]	1.徳島大院ソシオ, 2.原子力機構関西研, 3.東大物性研
	16:00 - 16:15	奨 11p-A11-8	CO_2レーザーによる熱的効果を付与したガラス内部への超短光パルスマイクロ加工	○浅田 拓斗[1], 玉木 隆幸[1]	1.奈良高専
	16:15 - 16:30	奨 11p-A11-9	ナノ秒レーザーを用いたCFRPの切断加工と熱的影響領域の雰囲気ガス依存性I	○松岡 史浩[1], 塚本 雅裕[2], 山下 顕資[3], 佐藤 雄二[2], 升野 振一郎[2], 高橋 謙次郎[2]	1.阪大院工, 2.阪大接合研, 3.阪大工学
	16:30 - 16:45	奨 11p-A11-10	液中レーザー溶融法生成粒子に及ぼすパルス波形の影響	○榊 祥太[1], 越崎 直人[1], 池上 浩[2], 辻 剛志[3], 石川 善恵[4]	1.北大工, 2.九大工, 3.島根大工, 4.産総研
	16:45 - 17:00		休憩/Break		
	17:00 - 17:15	奨 11p-A11-11	垂直配向ZnOナノウォールアレイの作製とランダムレージング	○(M1)高橋 将大[1], 原田 浩輔[1], 中尾 しほみ[1], 東畠 三洋[1], 池上 浩[1], 中村 大輔[1], 中田 芳樹[2], 岡田 龍雄[1]	1.九大大学院 シス情, 2.阪大 レーザー研
	17:15 - 17:30	奨 11p-A11-12	大気中レーザーアブレーションによるドープZnOマイクロスフィアの作製	○(M1)田中 稔伸[1], 永嵜 史明[1], 藤原 優輝[1], 東畠 三洋[1], 中村 大輔[1], 岡田 龍雄[1]	1.九大シス情
	17:30 - 17:45	奨 11p-A11-13	光励起ZnOマイクロ球の紫外レーザー発振における周囲媒質の影響	○植山 健史[1], 佐藤 雄太[1], 東畠 三洋[1], 中村 大輔[1], 池上 浩[1], 岡田 龍雄[1]	1.九大シス情
	17:45 - 18:00	奨 11p-A11-14	ZnOバッファ層の四光束干渉UVレーザー照射によるパターン加工とZnO微小結晶の作製	○(DC)下垣 哲也[1], 川原 裕貴[1], 中尾 しほみ[1], 東畠 三洋[1], 池上 浩[1], 中村 大輔[1], 中田 芳樹[2], 岡田 龍雄[1]	1.九州大学, 2.大阪大学
	3月12日(木)　9:30 - 11:30				
	9:30 - 9:45	12a-A11-1	窒化チタン粉末を用いた液中レーザー溶融法による球状粒子の作製	○川添 晃佑[1], 石川 善恵[2], 越崎 直人[3], 矢野 哲司[4], 小田原 修[1], 和田 裕之[1]	1.東工大院総理工, 2.産総研, 3.北大院工, 4.東工大院理工
	9:45 - 10:00	12a-A11-2	液中レーザーアブレーションによる金属微粒子生成ダイナミクスの高速度レーザーストロボビデオ撮影:気泡内部観察の試み	○勝部 孝行[1], 倉田 修吾[1], 田辺 里枝[1], 伊藤 義郎[1]	1.長岡技大機械
	10:00 - 10:15	12a-A11-3	各種材料におけるフェムト秒レーザーの透過特性	○佐野 秀[1], 橋新 裕一[1,2]	1.近大理工, 2.近大院総理研
	10:15 - 10:30		休憩/Break		
	10:30 - 10:45	12a-A11-4	フェムト秒レーザーを用いた植物単細胞への巨大分子の導入	○(M1)片桐 大輔[1], 坂口 さやか[1], 米田 新[2], 出村 拓[2], 細川 陽一郎[1]	1.奈良先端大物質創成, 2.奈良先端大バイオ
	10:45 - 11:00	12a-A11-5	フェムト秒レーザー衝撃力と原子間力顕微鏡による疑似細胞組織の振動解析	○(M1)宮本 敏男[1], 福嶋 亮介[1], 飯野 敬矩[1], 藪 浩[2], 細川 陽一郎[1]	1.奈良先端大物質, 2.東北大多元研
招待	**11:00 - 11:30**	**E 12a-A11-6**	**[Invited lecture of overseas researcher] (30min.) Intracellular molecular manipulation by femtosecond laser triggering**	**○He Hao[1]**	**1.Shanghai Jiaotong University**
	3月13日(金)　9:30 - 12:30				
	9:30 - 9:45	13a-A11-1	高圧ガス中レーザー蒸発法によるスズ/炭素コアシェルナノワイヤーの形成	○冨田 裕誉[1], 小塩 明[1], 小海 文夫[1]	1.三重大院工
	9:45 - 10:00	13a-A11-2	高圧ガス中レーザー蒸発法による酸化ケイ素ナノワイヤー形成と直径制御	○澤田 直樹[1], 小塩 明[1], 小海 文夫[1]	1.三重大院工
	10:00 - 10:15	13a-A11-3	銅ナノ粒子薄膜へのレーザー直接描画による銅グリッドパターンの形成	○渡辺 明[1], Qin Gang[1], Cai Jinguang[1]	1.東北大多元研
	10:15 - 10:30	13a-A11-4	数密度に依存した奇異なナノバブル成長過程の観測	Wang Xiaolong[1], Chatterjee Souvik[1], 作花 哲夫[2], ○中嶋 隆[1]	1.京大エネ研, 2.京大工
	10:30 - 10:45	13a-A11-5	中赤外自由電子レーザーを用いたユウキハクマクの相変化観測II －膜質の改善と薄膜温度の評価－	溝端 圭介[1], Maurya Sandeep[1], ○中嶋 隆[1], 全 炳俊[1], 紀井 俊輝[1], 大垣 英明[1]	1.京大エネ研
	10:45 - 11:00		休憩/Break		
	11:00 - 11:15	13a-A11-6	高温ステンレス試験片に付着した塩分のレーザアブレーションによるプラズマ発光の特徴	○江藤 修三[1], 藤井 隆[1]	1.電中研
	11:15 - 11:30	13a-A11-7	F_2レーザーを用いたパルスレーザー堆積法によるポーラスSiO_2膜の形成	○谷山 大地[1], 池上 浩[1], 大久保 智幸[1], 中村 大輔[1], 岡田 龍雄[1]	1.九大シス情
	11:30 - 11:45	13a-A11-8	フッ素レーザーによる鉄薄膜表面への微細周期構造の形成(3)	○大越 昌幸[1], 山下 嗣人[2]	1.防衛大, 2.関東学院大
	11:45 - 12:00	13a-A11-9	ナノ秒レーザーを用いたCFRPの切断加工と熱的影響領域の雰囲気ガス依存性II	○(PC)佐藤 雄二[1], 塚本 雅裕[1], 松岡 史浩[2], 山下 顕資[3], 高橋 謙次郎[1], 升野 振一郎[1]	1.阪大接合研, 2.阪大院工, 3.阪大工
	12:00 - 12:15	13a-A11-10	QFP-ICはんだ付けのためのレーザ光スキャンプロセス評価	○(D)土屋 均[1,2], 本間 哲哉[1]	1.芝浦工業大学大学院, 2.東芝生産技術センター

	12:15 - 12:30	13a-A11-11	レーザ光スキャンシステムを用いたQFP-ICはんだ付け	○(D)土屋 均[1,2], 本間 哲哉[1]	1.芝浦工業大学大学院, 2.東芝生産技術センター

3.7 レーザープロセシング / Laser processing　ポスター講演

3月13日(金)　16:30 - 18:30

		13p-P2-1	プラズモニックバブルの光学顕微鏡とAFMによるハイブリッド観察	○柳谷 伸一郎[1], 堀内 加奈[1], 橋本 修一[1], 後藤 信夫[1]	1.徳島大工
		13p-P2-2	溶融塩中レーザーアブレーションによるナノ粒子作成	○谷口 誠治[1], 中島 信昭[1,2]	1.レーザー総研, 2.大市大
		13p-P2-3	軟X線レーザーの集光照射による表面ナノ加工	○石野 雅彦[1], 圓山 桃子[1], 長谷川 登[1], 錦野 将元[1], 保 智己[2], Faenov Anatoly[3,4], Pikuz Tatiana[3,4], 河内 哲哉[1], 山極 満[1]	1.原子力機構, 2.奈良女大, 3.大阪大, 4.ロシア科学アカデミー
		E 13p-P2-4	Photo-reduced Graphene Oxide with Tunable Properties by Femtosecond Laser Irradiation	○Muttaqin Muttaqin[1], Takahiro Nakamura[1], Yuta Nishina[2], Shunichi Sato[1]	1.IMRAM, Tohoku Univ., 2.Okayama Univ.

3.8 光計測技術・機器 / Optical measurement, instrumentation, and sensor　口頭講演

3月11日(水)　9:00 - 12:30

	9:00 - 9:15	11a-A14-1	微粒子レーザー回折像の画像処理による粒径測定	○額田 祐輔[1], 北村 卓仁[1], 椿 光太郎[1]	1.東洋大総合情報
	9:15 - 9:30	11a-A14-2	偏光回折素子を利用した2次元複屈折プロファイラーの位相差定量評価	○江本 顕雄[1], 中島 亮平[1], 大谷 直毅[1], 福田 隆史[2]	1.同志社大理工, 2.産総研
	9:30 - 9:45	11a-A14-3	分光光度計による半導体薄膜の屈折率の算出	宮崎 卓幸[1], ○(B)松原 良典[1], 安達 定雄[1]	1.群馬大院理工
	9:45 - 10:00	11a-A14-4	テラヘルツパルス波を用いた膜厚計測の高分解能化	○落合 孝典[1], 高橋 一雄[1]	1.パイオニア
	10:00 - 10:15	奨 11a-A14-5	2色法を用いた高温環境下高精度距離計測	○針山 達雄[1], 笠井 啓晃[1], 谷口 敦史[1], 渡辺 正浩[1]	1.日立製作所
	10:15 - 10:30	E 11a-A14-6	Accuracy of optical frequency comb profilometry using a single pixel camera for different frequency selections	○(P)Quang Duc Pham[1], Yoshio Hayasaki[1]	1.Utsunomiya University Center for Optical Research and Education (CORE)
	10:30 - 10:45	11a-A14-7	ファイバー光コム共振器の外乱/RF周波数変換機能を用いたひずみ計測に関する基礎研究	○小倉 隆志[1], 中嶋 善晶[2,3], 山岡 禎久[4], 美濃島 薫[2,3], 安井 武史[1,3]	1.徳島大, 2.電通大, 3.JST-ERATO, 4.京都府立医大
	10:45 - 11:00	奨 11a-A14-8	ファイバ型光コム干渉計による光路長走査範囲の拡大	○中嶋 善晶[1,2], 美濃島 薫[1,2]	1.電通大 先進理工, 2.JST, ERATO知的光シンセサイザ
	11:00 - 11:15		休憩/Break		
	11:15 - 11:30	11a-A14-9	1156 nm半導体レーザーを用いたYb光格子時計のための時計遷移励起用レーザー	○保坂 一元[1], 赤松 大輔[1], 小林 拓実[2], 安田 正美[1], 稲場 肇[1], 大久保 章[1], 田邊 健彦[1], 大苗 敦[1], 洪 鋒雷[1,2]	1.産総研, 2.横国大理工
	11:30 - 11:45	奨 11a-A14-10	光周波数コムを用いたイッテルビウム原子の$^1S_0$-$^1P_1$遷移の絶対周波数測定	○田邊 健彦[1], 赤松 大輔[1], 小林 拓実[1,2], 安田 正美[1], 稲場 肇[1], 大久保 章[1], 大苗 敦[1], 洪 鋒雷[1,2], 保坂 一元[1]	1.産総研, 2.横浜国大
	11:45 - 12:00	11a-A14-11	Ti原子a^3F_2-y^3F_2におけるg因子の評価	○小林 慎治[1], 西宮 信夫[1], 鈴木 正夫[1]	1.工芸大
	12:00 - 12:15	11a-A14-12	周期的な光パルス列を用いた近赤外離散フーリエ変換分光	○大久保 章[1,2], 謝 宜達[2,3], 稲場 肇[1,2], 大苗 敦[1,2], 保坂 一元[1,2], 橋本 守[4], 安井 武史[2,3,4]	1.産総研, 2.美濃島ERATO, 3.徳島大工, 4.阪大基礎工
	12:15 - 12:30	奨 11a-A14-13	波長計を用いたCRDSによるガス中微量水分の高感度スペクトル測定	○橋口 幸治[1], Lisak Daniel[2], Cygan Agata[2], 阿部 恒[1]	1.産総研, 2.ニコラス・コペルニクス大学

3月11日(水)　14:00 - 18:00

	14:00 - 14:15	11p-A14-1	相互相関に基づく蛍光寿命イメージング法の提案	○水野 孝彦[1], 水谷 康弘[1,2], 岩田 哲郎[1,2]	1.徳島大, 2.JST-ERATO
	14:15 - 14:30	11p-A14-2	蛍光 LIDAR によるストレス条件下における植物蛍光寿命計測	○冨田 孝幸[2], 梅田 隼[1], 小林 一樹[2], 斉藤 保典[2]	1.信州大学 理工, 2.信州大学 工
	14:30 - 14:45	11p-A14-3	酸素Aバンドを利用した植物蛍光の分光画像計測	○栗山 健二[1], 斉藤 隼人[2], 眞子 直弘[2], 久世 宏明[2]	1.静岡大工, 2.千葉大CEReS
	14:45 - 15:00	11p-A14-4	広帯域多波長画像の組み合わせによる植物健康診断システム	○片岡 圭司[1], 川本 章博[1], 冨田 孝幸[1], 大谷 武志[1], 小林 一樹[1], 斉藤 保典[1], 小平 計美[2], 丸山 次郎[2]	1.信州大工, 2.アールエフ
	15:00 - 15:15	11p-A14-5	水中レーザーリモートセンシングに向けた海水溶存ガスのラマン分光	○染川 智弘[1], 藤田 雅之[1,2]	1.レーザー総研, 2.阪大レーザー研
	15:15 - 15:30	11p-A14-6	近赤外差分吸収分光法を利用した都市域大気中における二酸化炭素及び水蒸気濃度計測	○(DC)齊藤 隼人[1], 眞子 直弘[1], 栗山 健二[2], 久世 宏明[1]	1.千葉大学CEReS, 2.静岡大学工学部
	15:30 - 15:45	11p-A14-7	小型1.6μm DIALによる下層大気中のCO_2濃度分布計測	○柴田 泰邦[1], 長澤 親生[1], 阿保 真[1]	1.首都大院シスデザ
	15:45 - 16:00	11p-A14-8	PANDAドップラーライダーの風測定精度検証 -GPSゾンデおよび超音波風速計測定との比較-	○青木 誠[1], 岩井 宏徳[1], 中川 勝広[1], 水谷 耕平[1]	1.情報通信研究機構
	16:00 - 16:15		休憩/Break		
	16:15 - 16:30	11p-A14-9	航空機搭載植生ライダー	○水谷 耕平[1], 石井 昌憲[1], 浅井 和弘[2], 佐藤 篤[1,2]	1.情通機構, 2.東北工大
	16:30 - 16:45	11p-A14-10	可搬LIFSライダを用いたエアロゾルの種類判別と立体計測	○(M1)西澤 直人[1], 冨田 孝幸[2], 小林 一樹[2], 斉藤 保典[2]	1.信大理工, 2.信大工
	16:45 - 17:00	11p-A14-11	浮遊火山灰濃度測定のためのパーティクルカウントライダー	○阿保 真[1], 茂木 達也[1]	1.首都大院シスデザ
	17:00 - 17:15	11p-A14-12	ヘテロダインレーザ干渉計用新方式デジタル位相差計測法	○穀山 渉[1], 野里 英明[1], 大田 明博[1]	1.産総研 計測標準
	17:15 - 17:30	11p-A14-13	新しいサブナノ秒過渡吸収測定手法、RIPT 法	○中川 達央[1], 岡本 基土[1], 花田 啓明[1], 加藤 隆二[2]	1.ユニソク, 2.日本大学
	17:30 - 17:45	11p-A14-14	周波数領域単一ショット任意光波形計測の基礎検討	○宮本 貴幸[1], 塩田 達俊[1]	1.埼玉大理工
	17:45 - 18:00	11p-A14-15	二波長同時ヘテロダイン検波法を用いた並列同時分散計測システムの高速化の検討	○春日 海秀[1], 宮本 貴幸[1], 塩田 達俊[1]	1.埼玉大工

3.8 光計測技術・機器 / Optical measurement, instrumentation, and sensor　ポスター講演

3月13日(金)　9:30 - 11:30

		13a-P6-1	医療応用を目指したGPUとCPUを併用した光散乱シミュレーションの高速化	○大槻 莊一[1]	1.産総研健康工学
		13a-P6-2	異方性媒質における旋光性と円二色性の同時測定法	○(D)中川 鉄馬[1], 中村 洸太[1], 朝日 透[1,2]	1.早大先進理工, 2.早大科健機構
		13a-P6-3	無限遠補正光学系を用いた共通光路位相シフト干渉顕微鏡	○佐藤 貴則[1], 冨川 望[1], 陳 軍[1]	1.東京工芸大工
		13a-P6-4	シングルスリットによる回折光の偏光特性	金 蓮花[1], ○(B)丹沢 貴之[1]	1.山梨大工
		13a-P6-5	LiNbO3結晶の電気光学係数 r22の波長分散の計測	金 蓮花[1], ○(B)奈良 晃兵[1], 滝澤 國治[2]	1.山梨大工, 2.浜松ホトニクス中央研
		13a-P6-6	GPS周波数標準にトレースした光周波数コムとその周波数安定性	○韋 冬[1], 明田川 正人[1]	1.長岡技大工
		13a-P6-7	可視光広帯域光源を用いたμm-OCTの半導体微細加工プロセスへの応用	○西 剛史[1], 尾崎 信彦[1], 大里 啓孝[2], 渡辺 英一郎[2], 池田 直樹[2], 杉本 喜正[2]	1.和歌山大学シス工, 2.物質・材料研究機構
		13a-P6-8	ハニカム構造を有するマイクロホログラムアレイを用いたホログラフィックShack-Hartmann波面センサーによる波面計測	○最田 裕介[1], 神藤 宏伸[1], 野村 孝徳[1]	1.和歌山大システム工
		13a-P6-9	シリコンフォトダイオード応答非直線性の波長依存性要因の実験的・理論的検証 III	○田辺 稔[1], 雨宮 邦招[1], 沼田 孝之[1], 福田 大治[1]	1.産総研

3.8 光計測技術・機器 / Optical measurement, instrumentation, and sensor　口頭講演

3月14日(土)　9:00 - 11:30

	9:00 - 9:15	14a-A14-1	配向方向の異なる長球状マイクロレンズアレイを用いた広ダイナミックレンジShack-Hartmann波面センサー	○神藤 宏伸[1], 最田 裕介[1], 野村 孝徳[1]	1.和歌山大院システム工
	9:15 - 9:30	奨 14a-A14-2	薄明視野顕微鏡法を用いた4 0 n m 金ナノ粒子の3 次元位置計測	○(M1)後藤 和史[1], 早崎 芳夫[1]	1.宇都宮大学オプティクス教育研究センター
	9:30 - 9:45	14a-A14-3	偏光無依存な垂直共鳴型屈折率センサ	○山下 大輔[1], 水谷 彰夫[1], 菊田 久雄[1], 平井 義彦[1], 川田 博昭[1]	1.大阪府立大院工
	9:45 - 10:00	E 14a-A14-4	Brillouin Optical Correlation Domain Reflectometry with Lock-in Detection Scheme	○(DC)Yuguo Yao[1], Masato Kishi[1], Kazuo Hotate[1]	1.the Univ. of Tokyo
	10:00 - 10:15	奨 14a-A14-5	無人航空機搭載を目指した超小型軽量中赤外分光イメージング装置	○(BC)西藤 翼[1], 斉 威[1], 佐藤 俊[1], 藤原 大[1], 石丸 伊知郎[1]	1.香川大学工学部
	10:15 - 10:30		休憩/Break		
	10:30 - 10:45	14a-A14-6	位相変調された光による干渉信号を用いた振動変位計測ー大振幅三角波変調による自動較正	○木村 亮祐[1], 伊藤 孝優[1], 田中 洋介[1], 黒川 隆志[1]	1.農工大工
	10:45 - 11:00	14a-A14-7	シングルショット形状計測測定範囲のSPM入射角依存性	○小堺 崇也[1], バン トゥアン[1,2], 塩田 達俊[1]	1.埼玉大, 2.セブンシックス株式会社
	11:00 - 11:15	E 14a-A14-8	Improvement of the zoomable single-shot tomography and profilometry using a low-dense groove spatial phase modulator	○(P)Tuan Banh[1,2], Tatsutoshi Shioda[1]	1.Saitama University, 2.Sevensix Inc.
	11:15 - 11:30	E 14a-A14-9	Temporal phase measurements using a pixelated polarization phase shifting interferometer	○(P)David Serrano[1], Yukitoshi Otani[1]	1.Utsunomiya Univ.

3月14日(土)　13:00 - 15:00

	13:00 - 13:15	14p-A14-1	準ニュートン法を用いたエリプソメトリー計測の窓補正	金 蓮花[1], ○(B)春日 翔貴[1], 近藤 英一[1]	1.山梨大工
	13:15 - 13:30	14p-A14-2	VIPAコム干渉を用いたシングルショット2次元断層計測および形状計測	○宮岡 拓実[1], 塩田 達俊[1]	1.埼玉大工
	13:30 - 13:45	14p-A14-3	単一露光ワイドフィールドOCTによる屈折率測定	○木村 暁[1]	1.山形大工
	13:45 - 14:00	14p-A14-4	光学干渉計による多層膜吸収試料の層毎のスペクトル計測	○(B)大仁田 竜馬[1], 塩田 達俊[1]	1.埼玉大工
	14:00 - 14:15	14p-A14-5	低コヒーレンス動的光散乱法における多重散乱光の影響	○泉谷 悠介[1,2], 岩井 俊昭[1]	1.東京農工大BASE, 2.大塚電子
	14:15 - 14:30	奨 14p-A14-6	半導体レーザを用いたスペックルシアリング干渉計	○平岡 幹基[1], 押田 至啓[1], 岩橋 善久[2]	1.奈良高専, 2.大阪産大
	14:30 - 14:45	奨・E 14p-A14-7	Ultra short-term growth behaviour of plants under the influence of Cadmium using a highly sensitive interferometric technique, SIT	○(D)KanchanaMuthumali Kokge[1,2], Hirofumi Kadono[1], Kokyo Oh[3]	1.Saitama Univ., 2.Univ. of Ruhuna, 3.CESS
	14:45 - 15:00	14p-A14-8	機能的OCTによる塗膜の乾燥モニタリング	○(DC)深井 俊宏[1,2], 門野 博史[1]	1.埼玉大, 2.東洋精機製作所

3.9 テラヘルツ全般 / Terahertz technologies　ポスター講演

3月11日(水)　16:00 - 18:00

		奨 11p-P3-1	ボウタイアンテナを集積したテラヘルツ波源における放射特性の構造依存性解析	○山倉 裕和[1], 斉藤 光史[1], 須原 理彦[1]	1.首都大院理工
		11p-P3-2	テラヘルツ帯周波数コム放射用広帯域集積デバイスの構造設計	○加藤 優斗[1], 浅川 澄人[1], 斉藤 光史[1], 須原 理彦[1]	1.首都大院理工
		11p-P3-3	テラヘルツ帯ゼロバイアス検波用レクテナにおける出力側集積構造設計	○(B)徳岡 岳海[1], 山倉 裕和[1], 斉藤 光史[1], 須原 理彦[1]	1.首都大学東京
		11p-P3-4	有機非線形光学結晶DAST及びBNAを用いたE-O変調に関する研究	○野竹 孝志[1], 縄田 耕二[1], 瀧田 佑馬[1], 時実 悠[1], 岡安 雄一[2], 冨澤 宏光[2], 南出 泰亜[1]	1.理研・光量子工学研究領域, 2.高輝度光科学研究センター
		11p-P3-5	ダブルクラッドYb添加ファイバー増幅器を使ったDAST結晶からの高出力THz波発生	○浜崎 淳一[1], 関根 徳彦[1], 笠松 章史[1], 寶迫 巌[1]	1.情通機構
		奨 11p-P3-6	結合二重上位準位構造を用いた差周波発生テラヘルツ量子カスケードレーザ光源の室温動作	○日高 正洋[1], 藤田 和上[1], 伊藤 昭生[1], 枝村 忠孝[1], 山西 正道[1]	1.浜松ホトニクス
		11p-P3-7	テラヘルツ量子カスケードレーザの水平横モードに対する光制御	○酒瀬川 洋平[1], 齋藤 伸吾[1], 関根 徳彦[1], 笠松 章史[1], 芦田 昌明[2], 寶迫 巌[1]	1.情報通信研究機構, 2.阪大基礎工
		奨 11p-P3-8	分布実効屈折率0<n<1をホールアレーにより制御した金属スリットレンズアンテナの設計と実験	○佐藤 竜也[1], 古謝 望[2], 鈴木 健仁[1,2]	1.茨城大工, 2.茨城大院理工
		奨 11p-P3-9	非対称ペアカットワイヤーによる負の分布屈折率を有するフレキシブル薄フィルムレンズの設計	○梅原 一樹[1], 佐藤 竜也[1], 石原 功基[1], 竹林 佑記[2], 鈴木 健仁[1,2]	1.茨城大工, 2.茨城大院理工
		奨 11p-P3-10	フレキシブル薄フィルム上2層構造カットワイヤーによるテラヘルツ波用1/4波長板の設計と評価	○大内 隆嗣[1], 鈴木 健仁[1]	1.茨城大院理工

		11p-P3-11	THz帯における45度反射を用いた無参照反射分光の検討	○大野 誠吾[1], 石原 照也[1]	1.東北大院理
		奨 11p-P3-12	テラヘルツ波を利用した非接触温度・気圧センサーに関する研究	○(M1)駒井 翔伍[1]	1.首都大院シスデザ
		11p-P3-13	YBCO超伝導体のテラヘルツ吸収スペクトルの評価	○安田 新[1], 中島 伸陽[1], 佐々木 哲朗[2]	1.鶴岡高専制御情報工, 2.静岡大電研
		11p-P3-14	高感度テラヘルツ光伝導検出器とバンドパスフィルタによるテラヘルツマルチスペクトル分光イメージング	○青木 誠[1], 廣本 宣久[2]	1.情報通信研究機構, 2.静大院工
		11p-P3-15	テラヘルツケミカルイメージングシステムを用いた錠剤中の医薬品成分の擬似結晶形転移の拡散過程の解析	○坂本 知昭[1], 佐々木 哲朗[2], 香取 典子[1], 合田 幸広[1]	1.国立衛研, 2.静岡大電研
		奨 11p-P3-16	RuO_2ナノシートのテラヘルツ応答	○(B)楠本 雅志[1], 中田 陽介[1], 宮丸 文章[1], 杉本 渉[1], 武田 三男[1]	1.信州大
		11p-P3-17	外部共振器を用いた高周波数確度CWテラヘルツ分光システムの開発	○飯塚 悠円[1], 安藤 慶一[1], 音 賢一[1], 室 清文[2], 中嶋 誠[3]	1.千葉大院理, 2.Spectra Quest Lab., 3.阪大レーザー研

3.9 テラヘルツ全般 / Terahertz technologies　口頭講演

3月12日(木)　9:15 - 12:15

	9:15 - 9:30	12a-A14-1	時間-周波数解析によるテラヘルツパルス波からの構造情報の抽出(3)	○高橋 功将[1], 深澤 亮一[1], 碇 智文[1], 大島 誉寿[2], 水谷 義弘[2]	1.スペクトルデザイン, 2.東工大
	9:30 - 9:45	奨 12a-A14-2	グラフェンのテラヘルツ帯における運動量緩和時間の実験的導出	○(M1)若生 洋由希[1], 佐藤 昭[1], ヴィクトール リズィー[1], 河原 憲治[3], 吾郷 浩樹[3], 河野 淳一郎[2], 尾辻 泰一[1]	1.東北大学通研, 2.ライス大学, 3.九大先導研
	9:45 - 10:00	12a-A14-3	p 型GaInP におけるフォノン-電子系量子干渉パラメータの評価	○坂本 裕則[1], 馬 蓓[1], 森田 健[1], 石谷 善博[1]	1.千葉大工
	10:00 - 10:15	奨 12a-A14-4	高強度THz波が誘起する金ナノ構造薄膜における非線形電気伝導	○吉岡 克将[1], 南 康夫[1], 首藤 健一[1], Thang Duy Dao[2,3,4], 長尾 忠昭[2,3], 北島 正弘[1,2,3,5], 武田 淳[1], 片山 郁文[1]	1.横浜国大工, 2.物材機構WPI-MANA, 3.CREST JST, 4.奈良先端大, 5.ルクスレイ
	10:15 - 10:30	12a-A14-5	超広帯域赤外時間領域分光によるInSbにおける光誘起拡張ドルーデ応答	○松原 英一[1,2], 森本 智英[2], 永井 正也[2], 芦田 昌明[2]	1.阪歯大物理, 2.阪大基礎工
招待	**10:30 - 10:45**	**12a-A14-6**	**「講演奨励賞受賞記念講演」(15分) スプリットリング共振器の高強度テラヘルツ近接磁場による非線形反強磁性共鳴励起**	**○向井 佑[1], 廣理 英基[2,3,4], 山本 隆文[5], 陰山 洋[2,5], 田中 耕一郎[1,2,4]**	**1.京大院理, 2.京大iCeMS, 3.JST-PRESTO, 4.JST-CREST, 5.京大院工**
	10:45 - 11:00		休憩/Break		
	11:00 - 11:15	12a-A14-7	非対称二重格子ゲート構造を有するグラフェントランジスタにおけるプラズマ不安定性	○小関 勇気[1], リズィー ヴィクトール[1], 尾辻 泰一[1], ポポフ ヴィアチェスラフ[2], 佐藤 昭[1]	1.東北大通研, 2.IREE ロシア
	11:15 - 11:30	12a-A14-8	THz帯量子カスケードレーザの高温動作のための半導体材料	○安田 浩朗[1]	1.情報通信研究機構
	11:30 - 11:45	12a-A14-9	共鳴トンネルダイオードの真性遅延削減による1.86 THz基本波発振及び真性遅延と外部遅延削減による高周波化の見積もり	○(D)金谷 英敏[1], 前川 猛[1], 鈴木 左文[2], 浅田 雅洋[1]	1.東工大 総理工, 2.東工大 理工
	11:45 - 12:00	奨 12a-A14-10	共鳴トンネルダイオードテラヘルツ周波数可変発振器の多素子集積化による580-900GHz広範囲周波数掃引	○北川 成一郎[1], 鈴木 左文[2], 浅田 雅洋[1]	1.東工大 総理工, 2.東工大 理工
	12:00 - 12:15	12a-A14-11	負の屈折率媒質による電子ビームからの電磁波放射	○李 大治[1], 高野 恵介[2], 中嶋 誠[2], 宮本 修治[3]	1.レーザー総研, 2.阪大レーザー研, 3.兵庫大

3月12日(木)　13:30 - 17:00

	13:30 - 13:45	奨 12p-A14-1	光注入型THz波パラメトリック光源の広帯域化	○(M2)村手 宏輔[1], 今山 和樹[1], 林 伸一郎[2], 川瀬 晃道[1,2]	1.名大院工, 2.理研
	13:45 - 14:00	12p-A14-2	パラメトリック過程を用いた高ダイナミックレンジテラヘルツ波分光器の開発	○今山 和樹[1], 村手 宏輔[1], 林 伸一郎[2], 南出 泰亜[2], 川瀬 晃道[1,2]	1.名大院工, 2.理研
	14:00 - 14:15	12p-A14-3	$LiNbO_3$リッジ導波路における高出力広帯域テラヘルツ波発生	○南 翼[1], 岡野 紘世[1], 竹家 啓[1], 川瀬 晃道[1,2]	1.名大院工, 2.理研
	14:15 - 14:30	12p-A14-4	(113)B基板上のInAs量子ドットを有するGaAs/AlAs結合共振器へのフェムト秒パルス照射によるテラヘルツ帯差周波発生 (II)	○大柄根 斉宣[1], 高木 俊昭[1], 盧 翔孟[1], 熊谷 直人[1], 北田 貴弘[1], 井須 俊郎[1]	1.徳島大院フロンティア
	14:30 - 14:45	奨 12p-A14-5	超短パルスレーザー励起による金ナノロッドからのテラヘルツ波放射	○(M2)浅井 基希[1], 込山 英秋[2], 彌田 智一[2,3], 田所 譲[1], 高野 恵介[1], 中嶋 誠[1], 萩行 正憲[1]	1.大阪大レーザー研, 2.JST-ERATO, 3.東工大資源化学
	14:45 - 15:00	12p-A14-6	両性不純物添加したGaSe液相成長	○佐藤 陽平[1], 鈴木 康平[2], 前田 健作[2], 小山 裕[2]	1.東北大工, 2.東北大院工
	15:00 - 15:15	12p-A14-7	高温超伝導テラヘルツ光源における偏光制御	吉岡 佑介[1], 辻本 学[1], 中川 裕也[1], ○掛谷 一弘[1]	1.京大院工
	15:15 - 15:30		休憩/Break		
	15:30 - 15:45	12p-A14-8	光ファイバ経由のテラヘルツ周波数基準信号伝送とその応用	○熊谷 基弘[1], 長野 重夫[1], 入交 芳久[1], 諸橋 功[1], 川上 彰[1], 伊東 宏之[1], 花土 ゆう子[1], 寶迫 巌[1]	1.情報通信研究機構
	15:45 - 16:00	12p-A14-9	低損失な光学結合方式によるテラヘルツ波パラメトリック発生および検出	○瀧田 佑馬[1], 野竹 孝志[1], 縄田 耕二[1], 時実 悠[1], 林 伸一郎[1], 南出 泰亜[1]	1.理研
	16:00 - 16:15	12p-A14-10	非対称二重格子ゲートHEMTによるテラヘルツ波検出の周波数特性	○佐藤 昭[1], Stephane Boubanga Tombet[1], 渡辺 隆之[1], 川﨑 鉄哉[1], 糟谷 文月[1], 末光 哲也[1], Denis V. Fateev[2], Vyacheslav V. Popov[2], 南出 泰亜[3], 伊藤 弘昌[3], Dominique Coquillat[4], Wojciech Knap[4], Guillaume Ducournau[5], Yahya Meziani[6], 尾辻 泰一[1]	1.東北大, 2.IREE, 3.理研仙台, 4.モンペリエ第2大, 5.IEMN, 6.サラマンカ大
	16:15 - 16:30	12p-A14-11	MEMS両持ち梁構造を用いた室温テラヘルツ光検出の可能性	○渡辺 康行[1,2], 吉田 健治[1,2], 平川 一彦[1,2]	1.東大生研, 2.ナノ量子機構
	16:30 - 16:45	12p-A14-12	量子ドット光伝導スイッチのメサ加工による暗電流の抑制	○村雲 圭佑[1], 山岡 裕也[1], 熊谷 直人[1], 北田 貴弘[1], 井須 俊郎[1]	1.徳島大院フロンティア
	16:45 - 17:00	奨 12p-A14-13	$BaTiO_3$結晶を用いたTHz波のヘテロダインEOサンプリング	○東 奨悟[1], 小澤 慎平[1], 堀 貴陽[1], シュテファン フンクナー[1], グドルン ニフース[1], 岩前 敦[1], 山本 晃司[1], 古屋 岳[2], エルマー エスタシオ[3], マイケル バクノフ[4], 谷 正彦[1]	1.福井大遠赤セ, 2.福井大工, 3.フィリピン大, 4.ニジニノブゴロド大

3月13日(金)　9:00 - 12:15					
	9:00 - 9:15	13a-A14-1	テラヘルツ帯金属薄膜サブ波長格子構造偏光子の金属膜厚分布と光学特性の金属種依存性	○村木 兼吾[1], 諏訪 翔也[1], 山本 浩輔[1], 白石 和男[1]	1.宇都宮大工
	9:15 - 9:30	13a-A14-2	MEMS可変スパイラルメタマテリアルのテラヘルツ応答	○菅 哲朗[1], 磯崎 瑛宏[1], 神田 夏輝[1,2], 根本 夏紀[1], 小西 邦昭[1], 五神 真[1], 松本 潔[1], 下山 勲[1]	1.東京大学, 2.理研
	9:30 - 9:45	奨 13a-A14-3	テラヘルツ領域における分割リング共振器の構造と共鳴周波数のシフト	○(B)五味 蔵酒[1], 森田 博紀[1], 西田 翼[1], 中田 陽介[1], 中西 俊博[2], 宮丸 文章[1], 武田 三男[1]	1.信大, 2.京大
	9:45 - 10:00	奨 13a-A14-4	Berry位相を用いた光渦生成テラヘルツメタ表面	○(B)平良 優大[1], 中田 陽介[1], 宮丸 文章[1], 武田 三男[1]	1.信大
	10:00 - 10:15	奨 13a-A14-5	自己補対近傍チェッカーボードパターンのテラヘルツ応答	○田中 翼[1], 高野 恵介[1], Abdallah Chahadih[2], Abbas Ghaddar[2], Xiang-Lei Han[2], François Vaurette[2], Tahsin Akalin[2], 宮丸 文章[3], 中嶋 誠[1], 萩行 正憲[1]	1.阪大レーザー研, 2.IEMN, Lille 1 Univ, 3.信州大理
	10:15 - 10:30	13a-A14-6	V溝(テーパつき伝送線路)によるsub-THz電磁波集束のアパーチャを用いた評価	○森川 治[1], 山本 晃司[2], 谷 正彦[2], 栗原 一嘉[2], 桒島 史欣[3]	1.海保大, 2.福井大, 3.福井工大
	10:30 - 10:45		休憩/Break		
	10:45 - 11:00	13a-A14-7	集積型 光-THz 信号直接変換素子の設計	○安井 章雄[1], 雨宮 智宏[2], 西山 伸彦[1], 荒井 滋久[1,2]	1.東工大, 2.量子ナノエレクトロニクス研究センター
	11:00 - 11:15	13a-A14-8	グラフェンを電極に用いたランダム配向液晶セルによるテラヘルツ波の位相制御	○佐々木 友之[1], 野田 浩平[1], 川月 喜弘[2], 小野 浩司[1]	1.長岡技科大, 2.兵庫県立大
	11:15 - 11:30	奨 13a-A14-9	グラフェンチャネルFETのサブテラヘルツ帯ミキサ応用	○菅原 健太[1], 川﨑 鉄哉[1], Binti Hussin Mastura[1], 玉虫 元[1], 末光 眞希[1], 吹留 博一[1], 可児 淳一[2], 寺田 純[2], 桑野 茂[2], 岩月 勝美[3], 末光 哲也[1,3], 尾辻 泰一[1,3]	1.東北大通研, 2.NTTAS研, 3.東北大電気通信研究機構
	11:30 - 11:45	E 13a-A14-10	Improvement of THz imager with hybridization system of metamaterial and cholesteric liquid crystal	○(P)Boyoung Kang[1], Tomohiro Nishikawa[1], Yuzuru Tadokoro[1], Keisuke Takano[1], Makoto Nakajima[1]	1.Institute of Laser Engineering, Osaka University
	11:45 - 12:00	奨 13a-A14-11	サブ波長銅球集団における高電場テラヘルツ誘起コヒーラー	○田所 譲[1], 西川 智啓[1], 高野 恵介[1], 中嶋 誠[1], 萩行 正憲[1]	1.阪大レーザー研
	12:00 - 12:15	13a-A14-12	中赤外マイクロストリップ線路の位相定数評価	○川上 彰[1], 堀川 隼世[1,2], 兵頭 政春[3], 田中 秀吉[1], 武田 正典[4], 島影 尚[2]	1.情通機構, 2.茨城大院, 3.金沢大, 4.静岡大院
3月13日(金)　16:15 - 19:00					
	16:15 - 16:30	奨 13p-A14-1	テラヘルツ波ケミカル顕微鏡を用いた液中イオンの同時検出	○秋宗 広祐[1], 大川 裕貴[1], 紀和 利彦[1], 堺 健司[1], 塚田 啓二[1]	1.岡山大自然
	16:30 - 16:45	奨 13p-A14-2	テラヘルツ波ケミカル顕微鏡によるD-(+)-マンノースの非標識検出	○小川 真寛[1], 中村 彰宏[1], 紀和 利彦[1], 堺 健司[1], 塚田 啓二[1]	1.岡山大自然
	16:45 - 17:00	13p-A14-3	低コヒーレンスサブテラヘルツ波による煙越しのイメージング	○清水 直文[1], 内田 英建[2], 松山 賢[2]	1.NTT 先デ研, 2.東理大 火災科学研究センター
	17:00 - 17:15	奨 13p-A14-4	ビデオレートテラヘルツ電場ベクトルイメージング装置の構築	○高井 茉佑子[1], 渡邉 紳一[1]	1.慶大理工
	17:15 - 17:30	E 13p-A14-5	THz wavefront measurement using 2D electro-optic imaging combined with Hartmann sensor principle	○Harsono Cahyadi[1], Jerome Degert[2], Eric Freysz[2], Takeshi Yasui[1], Emmanuel Abraham[2]	1.Tokushima Univ., 2.Bordeaux Univ.
	17:30 - 17:45	13p-A14-6	カーボンブラック分散体のテラヘルツ分光特性	○能勢 秀俊[1], 児島 孝則[1], 次田 浩[1], 門脇 信傑[1], 奥野 雅史[1], 小林 正樹[1]	1.協和ファインテック
	17:45 - 18:00		休憩/Break		
	18:00 - 18:15	13p-A14-7	テラヘルツ波を用いたガスハイドレートの研究	○高橋 亮平[1], 竹家 啓[1], 川瀬 晃道[1]	1.名大院工
	18:15 - 18:30	13p-A14-8	光注入型テラヘルツ波パラメトリック発生器を用いた遮蔽物内試薬の透過分光	○山崎 良[1], 加藤 三樹矢[1], 村手 宏輔[1], 今山 和樹[1], 川瀬 晃道[1,2]	1.名古屋大学, 2.理研
	18:30 - 18:45	13p-A14-9	テラヘルツ電場波形の高速シングルショット検出	○(B)小林 真隆[1], Johnson Jeremy[1,2], 南 康夫[1], 武田 淳[1], 片山 郁文[1]	1.横浜国大, 2.Brigham Young University
	18:45 - 19:00	13p-A14-10	全室温動作連続波GaPテラヘルツ信号発生・検出システムの性能	○佐々木 哲朗[1], 田邉 匡生[2], 西澤 潤一[3]	1.静岡大電研, 2.東北大多元研, 3.東北大

3.10 光量子物理・技術 / Optical quantum physics and technologies　口頭講演

3月11日(水)　9:15 - 12:00					
	9:15 - 9:30	11a-A17-1	アレイ導波路回折格子を用いた高次元量子もつれ状態生成	○松田 信幸[1,2], Karkus Peter[2], 西 英隆[1,3], 土澤 泰[1,3], 山田 浩治[1,3], 武居 弘樹[2]	1.NTT NPC, 2.NTT物性基礎研, 3.NTT先端集積デバイス研
	9:30 - 9:45	11a-A17-2	時間分解同時測定による高明瞭度のHong-Ou-Mandel干渉実験	○(M1)田中 元基[1], 遠本 吉郎[1], 杉浦 幸大[1], 生田 力三[1], 三木 茂人[2], 山下 太郎[2], 寺井 弘高[2], 藤原 幹生[2], 山本 俊[1], 小芦 雅斗[3], 佐々木 雅英[2], Zhen Wang[2], 井元 信之[1]	1.阪大基礎工, 2.情通機構, 3.東大工
	9:45 - 10:00	E 11a-A17-3	Separable Schmidt modes generation by using a Hong-Ou-Mandel interference	○Ruibo Jin[1], Ryosuke Shimizu[2], Mikio Fujiwara[1], Ryota Wakabayashi[1,3], Masahiro Takeoka[1], Masahide Sasaki[1]	1.NICT, 2.Univ. of Electro-Comm., 3.Waseda Univ.
	10:00 - 10:15	11a-A17-4	フォトニックメタマテリアルを用いたエンタングルメント蒸留実験	○浅野 元紀[1], Muriel Bechu[2], Mark Tame[3], Sahin Kaya Ozdemir[4], 生田 力三[1], Durdu O Guney[5], 山本 俊[1], Lan Yang[4], Martin Wegener[2], 井元 信之[1]	1.阪大基礎工, 2.カールスルーエ大, 3.クワズール・ナタール大, 4.ワシントン大, 5.ミシガン工科大
	10:15 - 10:30	11a-A17-5	単一光子源を用いたサイドチャンネルフリー量子暗号	○南部 芳弘[1]	1.NECスマエネ研
	10:30 - 10:45	11a-A17-6	エラーレート揺らぎを考慮した現実的想定下における DPS-QKD の性能	○(M1)生田 拓也[1], 井上 恭[1]	1.阪大工
	10:45 - 11:00		休憩/Break		
	11:00 - 11:15	11a-A17-7	微弱光の自己ヘテロダインビートの測定	○大川 洋平[1], 大岡 佳生[1], 大村 史倫[1], 安武 裕輔[1,2], 深津 晋[1]	1.東大院総合, 2.JST さきがけ
	11:15 - 11:30	11a-A17-8	高効率単一光子検出へ向けたSPADクエンチング抵抗に関する一考察	○(M2)高野 晃[1], 行方 直人[1], 井上 修一郎[1]	1.日大量科研
	11:30 - 11:45	11a-A17-9	スペクトルフィルタリングされた場に対する光子統計の簡易計算法とその応用	○上出 健仁[1], 岩本 敏[1,2], 荒川 泰彦[1,2]	1.東大ナノ量子機構, 2.東大生研

	11:45 - 12:00	奨 11a-A17-10	対称ファイバ干渉計を用いた光子数スクイーズド光の生成	○保坂 有杜[1], 廣澤 賢一[1], 澤田 亮太[1], 神成 文彦[1]	1.慶大理工
	3月11日(水)　14:00 - 16:45				
	14:00 - 14:15	11p-A17-1	カオス駆動半導体レーザにおける周期成分の低減	○近藤 博文[1], 大坪 順次[1]	1.静大院工
	14:15 - 14:30	11p-A17-2	直交偏光戻り光のある面発光半導体レーザの矩形波発振	○近藤 弘基[1], 大坪 順次[1]	1.静大院工
	14:30 - 14:45	11p-A17-3	スター型結合半導体レーザにおけるカオス同期特性	○松本 卓也[1], 大坪 順次[1]	1.静大院工
	14:45 - 15:00	奨 11p-A17-4	戻り光量子ドット半導体レーザの変調特性解析	○加藤 雅史[1], 大坪 順次[1]	1.静大工
	15:00 - 15:15	11p-A17-5	半導体レーザの相互結合多数リングにおけるカオス同期	○南部 真志[1], 大坪 順次[1]	1.静大工
	15:15 - 15:30		休憩/Break		
	15:30 - 15:45	11p-A17-6	不均一な注入電流を有するブロードエリア半導体レーザにおける時空カオスの数値解析	○野澤 隆宏[1], 荒幡 真也[1], 森勝 進一朗[1], 内田 淳史[1]	1.埼玉大
	15:45 - 16:00	奨 11p-A17-7	ブロードエリア半導体レーザの空間モード間の反位相ダイナミクスの 数値計算	○荒幡 真也[1], 内田 淳史[1]	1.埼玉大
	16:00 - 16:15	11p-A17-8	「ナノカオス」の乱数性と複雑性	○金 成主[1], 成瀬 誠[2], 青野 真士[3,4], 堀 裕和[5]	1.物材機構, 2.情通機構, 3.東工大, 4.JST, 5.山梨大
	16:15 - 16:30	11p-A17-9	Penrose unilluminable room共振器の波動伝搬解析	○福嶋 丈浩[1], 板谷 諒介[1], 篠原 晋[2], 砂田 哲[3], 原山 卓久[4], 坂口 浩一郎[1], 徳田 安紀[1]	1.岡山県立大, 2.NTT CS研, 3.金沢大, 4.早稲田大
	16:30 - 16:45	11p-A17-10	レーザーカオスと金属V溝導波路を用いた高効率THz時間領域分光法	○桑島 史欣[1], 白尾 拓也[1], 岸端 俊宏[1], 赤峰 勇佑[1], 谷 正彦[2], 栗原 一嘉[3], 山本 晃司[2], 長島 健[4], 荻行 正憲[5]	1.福井工大, 2.福井大遠赤セ, 3.福井大教育, 4.摂南大, 5.阪大レーザー研

3.10 光量子物理・技術 / Optical quantum physics and technologies　ポスター講演

	3月12日(木)　9:30 - 11:30				
		12a-P6-1	PPLN導波路を用いた大規模時分割多重光パラメトリック発振器	○武居 弘樹[1], 稲垣 卓弘[1], 梅木 毅伺[2], 忠永 修[2], 竹ノ内 弘和[2]	1.NTT物性研, 2.NTT先デ研
		12a-P6-2	利得変調半導体レーザーの時間ジッター計測に関する数値計算II	○松山 哲也[1], 山上 雄基[1], 松倉 聖[1], 北川 直昭[1], 田中 天翔[1], 和田 健司[1], 堀中 博道[1]	1.阪府大院工
		12a-P6-3	半導体レーザーの周波数雑音を利用した測距法に関する検討	○土井 康平[1], 新井 秀明[2], 齋藤 高大[2], 前原 進也[2], 大平 泰生[2], 坂本 秀一[2], 佐藤 孝[2]	1.東大, 2.新潟大

3.11 フォトニック構造・現象, 13.7 超薄膜・量子ナノ構造のコードシェアセッション　口頭講演

	3月12日(木)　9:00 - 12:30				
	9:00 - 9:15	奨 12a-A10-1	有機ヒ素を用いたMOVPE法によるフォトニック結晶の埋め込み成長	○河崎 正人[1,3], 吉田 昌宏[1], 石崎 賢司[1], Menaka De Zoysa[1,2], 北村 恭子[1,2], 野田 進[1]	1.京大院工, 2.京大白眉, 3.三菱電機先端総研
	9:15 - 9:30	12a-A10-2	$(Sc, Er)_2O_3$薄膜におけるサイト選択励起でのエネルギー移動とアップコンバージョン	○川上 欣洋[1], 俵 毅彦[2,3], 尾身 博雄[2,3], 鍛治 怜奈[1], 足立 智[1]	1.北大院工, 2.NTT物性基礎研, 3.NTTナノフォトニクスセンタ
	9:30 - 9:45	12a-A10-3	(ErSc)2O3 薄膜におけるアップコンバージョン発光とフォトニックバンドギャップによる抑制	○俵 毅彦[1,2], Thomas McManus[1,3], 川上 欣洋[4], 尾身 博雄[1,2], Adel Najar[1], 鍛治 怜奈[4], 足立 智[4], 後藤 秀樹[1]	1.NTT物性研, 2.NTTナノフォトニクスセンタ, 3.バース大, 4.北大
	9:45 - 10:00	奨 12a-A10-4	InP(311)B基板上InAs量子ドットからの単一光子発生とその温度特性	○(M2)細井 響子[1], 高熊 亨[1], 黒澤 裕之[3], 中島 秀朗[3], 赤羽 浩一[2], 熊野 英和[3], 末宗 幾夫[3], 早瀬 潤子[3]	1.慶大理工, 2.情通機構, 3.北大電子研
	10:00 - 10:15	12a-A10-5	(111)A 面上量子ドットにおける励起子微細構造分裂の高精度評価	○中島 秀朗[1], 熊野 英和[1], 劉 祥明[2], 間野 高明[2], 黒田 隆[2], 末宗 幾夫[1]	1.北大電子研, 2.物材機構
	10:15 - 10:30	E 12a-A10-6	Entangled photon emission at temperatures up to 60 K from droplet epitaxial quantum dots	○(P)Xiangming Liu[1], Takashi Kuroda[1], Takaaki Mano[1], Hideaki Nakajima[2], Hidekazu Kumano[2], Ikuo Suemune[2], Yoshiki Sakuma[1], Kazuaki Sakoda[1]	1.NIMS, 2.RIES Hokkaido Univ.
	10:30 - 10:45	12a-A10-7	量子ドット-ナノ共振器強結合系における光散逸経路間干渉	○太田 泰友[1], 太田 竜一[2], 熊谷 直人[1], 岩本 敏[1,2], 荒川 泰彦[1,2]	1.東大ナノ量子機構, 2.東大生研
	10:45 - 11:00	奨 12a-A10-8	走査型電子顕微鏡による量子ドットの位置検出とナノ共振器との結合状態評価	○車 一宏[1], 太田 泰友[2], 高宮 大策[1], 角田 雅弘[2], 岩本 敏[1,2], 荒川 泰彦[1,2]	1.東大生研, 2.東大ナノ量子機構
	11:00 - 11:15		休憩/Break		
	11:15 - 11:30	12a-A10-9	ウエハ接合界面での光損失を低減した量子ドット結合共振器の作製	○北田 貴弘[1], 原山 千穂[1], 太田 寛人[1], 前川 知久[1], 盧 翔孟[1], 熊谷 直人[1], 井須 俊郎[1]	1.徳島大院フロンティア
	11:30 - 11:45	12a-A10-10	一次元フォノニック結晶導波路におけるフォノン伝搬のバンド構造依存性	○畑中 大樹[1], ドデル アモリ[1], マブーブ イムラン[1], 小野満 恒二[1], 山口 浩司[1]	1.NTT物性研
	11:45 - 12:00	奨 12a-A10-11	多モード干渉を利用した表面プラズモンポラリトン交差導波路	○太田 雅[1], 福原 誠史[1], 住村 あさひ[1], 伊藤 基[1], 相原 卓磨[1], 石井 佑弥[1], 福田 光男[1]	1.豊技大
	12:00 - 12:15	奨 12a-A10-12	グラフェン装荷型プラズモニクス導波路における光吸収の増強	○(M1)常川 雅人[1,2], 小野 真証[1,3], 納富 雅也[1,2,3]	1.NTT物性研, 2.東工大理工, 3.NTTナノフォトニクスセンタ
	12:15 - 12:30	奨 12a-A10-13	プラズモニック導波路のSi細線導波路への結合	○小野 真証[1,2], Hao Xu[1,2], 倉持 栄一[1,2], 野崎 謙悟[1,2], 谷山 秀昭[1,2], 常川 雅人[2,3], 納富 雅也[1,2,3]	1.NTTナノフォトニクスセンタ, 2.NTT物性科学基礎研, 3.東工大理工

3.11 フォトニック構造・現象 / Photonic structures and phenomena　ポスター講演

	3月11日(水)　9:30 - 11:30				
		11a-P3-1	GPU の総和計算アルゴリズムによるFDTD の高速化	○谷山 秀昭[1,2], 納富 雅也[1,2]	1.NTT NPC, 2.NTT物性基礎研
		11a-P3-2	ナノインプリントと干渉フォトリソグラフィを用いた三次元周期多孔構造体の作製	○鷲田 一博[1], 三宅 正男[1], 池之上 卓己[1], 平藤 哲司[1]	1.京都大エネ科
		11a-P3-3	フォトニック結晶バンド端共振器とナノ金属共振器の相互作用	○李 潤植[1], 北村 恭子[1,2], 浅野 卓[1], 石崎 賢司[1], 野田 進[1]	1.京大院工, 2.京大白眉
		11a-P3-4	3次元フォトニック結晶における並列水平導波路の結合特性解析(II)	○(D)権平 皓[1], 石崎 賢司[1], 北野 圭輔[1], 浅野 卓[1], 野田 進[1]	1.京大院工

		11a-P3-5	熱光発電のための赤外透明基板の熱輻射スペクトルの評価	○堤 達紀[1], 末光 真大[2], 橋本 康平[1], 浅野 卓[1], De Zoysa Menaka[3], 野田 進[1]	1.京大院工, 2.大阪ガス, 3.京大白眉
		11a-P3-6	AlGaAsフォトニック結晶スラブ導波路による和周波発生	○小田 久哉[1], 孟田 量宏[1], 山中 明生[1], 尾崎 信彦[2], 池田 直樹[3], 杉本 喜正[3]	1.千歳科技大, 2.和歌山大, 3.物材研

3.11 フォトニック構造・現象 / Photonic structures and phenomena　口頭講演

3月12日(木)　14:00 - 18:45

	14:00 - 14:15	12p-A10-1	ダブルホール格子点をもつフォトニック結晶レーザの作製	○渡辺 明佳[1,3], 廣瀬 和義[1,3], 杉山 貴浩[1,3], 梁 永[2,3], 北川 均[2,3], 野田 進[2,3]	1.浜ホト, 2.京大院工, 3.ACCEL JST
	14:15 - 14:30	E 12p-A10-2	Observation of plasmonic Fabry-Perot modes in a GaAs nanowire embedding multi-stacked InGaAs/GaAs quantum dots	○(D)Jinfa Ho[1], Jun Tatebayashi[1], Sylvain Sergent[1], Chee Fai Fong[1], Satoshi Iwamoto[1,2], Yasuhiko Arakawa[1,2]	1.Nanoquine, Univ. of Tokyo, 2.IIS, Univ. of Tokyo
	14:30 - 14:45	12p-A10-3	InGaAs/GaAs量子ドットを有するナノワイヤレーザの室温発振	○館林 潤[1], 加古 敏[1,2], Ho Jinfa[2], 太田 泰友[1], 岩本 敏[1,2], 荒川 泰彦[1,2]	1.東大ナノ量子機構, 2.東大生研
	14:45 - 15:00	12p-A10-4	フォトニック結晶レーザにおける不均一ポンピング効果の理論解析	○北川 均[1,2], 梁 永[1,2], 中川 翔太[1,2], Gelleta John[1,2], 野田 進[1,2]	1.京大院工, 2.ACCEL JST
	15:00 - 15:15	E 12p-A10-5	Theoretical analysis of nanolaser with a few quantum dot gain	○(M2)VINCENT ELFVING[1,2], YASUTOMO OTA[1,2], KENJI KAMIDE[1,2], SATOSHI IWAMOTO[1,2,3], YASUHIKO ARAKAWA[1,2,3]	1.Univ. of Tokyo, 2.IIS, 3.NanoQuine
	15:15 - 15:30	12p-A10-6	フォトニック結晶レーザにおける空間ホールバーニング現象の理論解析	○北川 均[1,2], 梁 永[1,2], 中川 翔太[1,2], Gelleta John[1,2], 野田 進[1,2]	1.京大院工, 2.ACCEL JST
	15:30 - 15:45	12p-A10-7	単一モード位相アレイフォトニック結晶レーザ	○新家 昭彦[1,2], 野崎 謙悟[1,2], 倉持 栄一[1,2], 谷山 秀昭[1,2], 納富 雅也[1,2]	1.NTTナノフォトセンタ, 2.NTT物性基礎研
	15:45 - 16:00		休憩/Break		
招待	**16:00 - 16:45**	**12p-A10-8**	**「第15回応用物理学会業績賞(研究業績)受賞記念講演」(45分) フォトニック結晶工学の進展と今後の展望**	**○野田 進[1]**	**1.京大**
	16:45 - 17:00	奨 12p-A10-9	2次元ビーム走査のための変調フォトニック結晶レーザの動作特性	○(M1)安田 大貴[1], 北村 恭子[1,2], 李 潤植[1], 野田 進[1]	1.京大院工, 2.京大白眉
	17:00 - 17:15	奨 12p-A10-10	共振器共鳴励起によるナノレーザの自然放出係数増大	○高宮 大策[1], 太田 泰友[2], 渡邉 克之[2], 角田 雅弘[2], 岩本 敏[1,2], 荒川 泰彦[1,2]	1.東大生研, 2.東大ナノ量子機構
	17:15 - 17:30	E 12p-A10-11	Coupled-wave analysis for photonic-crystal surface-emitting lasers –Effect of multiple external reflectors on threshold gain–	○John Gelleta[1,2], Yong Liang[1,2], Hitoshi Kitagawa[1,2], Susumu Noda[1,2]	1.Kyoto Univ., 2.ACCEL JST
	17:30 - 17:45	12p-A10-12	円偏光ビームを出射するフォトニック結晶レーザ構造の検討	○(M1)前川 享平[1], 西本 昌哉[1], 石崎 賢司[1], 北村 恭子[1,2], 野田 進[1]	1.京大院工, 2.京大白眉
	17:45 - 18:00	奨 12p-A10-13	半導体三次元カイラルフォトニック結晶の偏光バンド端における量子ドットからの高純度円偏光の発光	○高橋 駿[1], 田尻 武義[2], 太田 泰友[1], 館林 潤[1], 岩本 敏[1,2], 荒川 泰彦[1,2]	1.東大ナノ量子機構, 2.東大生研
	18:00 - 18:15	奨 12p-A10-14	3次元フォトニック結晶内部の極薄空隙面における光伝搬の観測	○北野 圭輔[1], 石崎 賢司[1], 権平 皓[1], 野田 進[1]	1.京大院工
	18:15 - 18:30	12p-A10-15	Q ~ 60,000を有する三次元フォトニック結晶ナノ共振器	○高橋 駿[1], 田尻 武義[2], 太田 泰友[1], 渡邉 克之[1,2], 岩本 敏[1,2], 荒川 泰彦[1,2]	1.東大ナノ量子機構, 2.東大生研
	18:30 - 18:45	奨 12p-A10-16	プレート差込型積層方式を用いた三次フォトニック結晶 ～提案と作製～	○田尻 武義[1], 高橋 駿[2], 太田 泰友[2], 館林 潤[2], 岩本 敏[1,2], 荒川 泰彦[1,2]	1.東大生研, 2.ナノ量子機構

3月13日(金)　9:00 - 12:15

招待	**9:00 - 9:15**	**13a-A10-1**	**「講演奨励賞受賞記念講演」(15分) 離れた光ナノ共振器間の任意タイミングでの断熱的光転送の実現**	**○鴻池 遼太郎[1], 中川 遥之[1], 浅野 卓[1], 田中 良典[1], 野田 進[1]**	**1.京大院工**
	9:15 - 9:30	13a-A10-2	無点欠陥／少数点欠陥ナノ光共振器の超高Q値設計	○倉持 栄一[1,2], Duprez Hadrien[2], 谷山 秀昭[1,2], 角倉 久史[1,2], 野崎 謙悟[1,2], 新家 昭彦[1,2], 納富 雅也[1,2]	1.NTT NPC, 2.NTT物性基礎研
	9:30 - 9:45	奨 13a-A10-3	マイクロヒータの集積による結合光ナノ共振器の離調制御	○中川 遥之[1], 鴻池 遼太郎[1], 浅野 卓[1], 田中 良典[1], 野田 進[1]	1.京大院工
	9:45 - 10:00	奨 13a-A10-4	超精密切削加工による結晶材料WGM共振器の作製および熱光学機械振動の共振器サイズ依存性についての検討	○糸部 大貴[1], 中川 陽介[1], 茆 駿也[1], 柿沼 康弘[1], 田邉 孝純[1]	1.慶大理工
	10:00 - 10:15	奨 13a-A10-5	ナノファイバを用いたフォトニック結晶導波路上での高Q値共振器形成	○鐵本 智大[1], 大岡 勇太[1], 伏見 亮大[1], 田邉 孝純[1]	1.慶大理工
	10:15 - 10:30	奨 13a-A10-6	SiCナノビームフォトニック結晶共振器の設計(3)	○山口 祐樹[1], 田 昇愚[1], 宋 奉植[1,2], 浅野 卓[1], 田中 良典[1], 野田 進[1]	1.京大院工, 2.成均館大
	10:30 - 10:45		休憩/Break		
	10:45 - 11:00	13a-A10-7	L3 型Ge フォトニック結晶ナノビーム共振器における共振器モード(Q>1,300)の観測	○黒木 理宏[1], 加古 敏[1], 石田 悟己[1], 小田 克矢[2], 井戸 立身[2], 岩本 敏[1], 荒川 泰彦[1]	1.東大生研/ナノ量子機構, 2.日立中研
	11:00 - 11:15	13a-A10-8	InGaAsP埋込みヘテロ構造をもつフォトニック結晶ナノ共振器による微小光変調器	○野崎 謙悟[1,2], ディヌレスク シルビウ[2], 松尾 慎治[1,3], 藤井 拓郎[1,3], 武田 浩司[1,3], 倉持 栄一[1,2], 納富 雅也[1,2]	1.NTT NPC, 2.NTT物性基礎研, 3.NTT先端集積デバイス研
	11:15 - 11:30	奨 13a-A10-9	フォノニック結晶共振器を用いた光弾性変調器の特性解析	○金 仁基[1], 岩本 敏[1,2], 荒川 泰彦[1,2]	1.東大生研, 2.東大ナノ量子機構
	11:30 - 11:45	13a-A10-10	フォトニック結晶光ディテクタと変調器の連結による波長変換回路の構成	○野崎 謙悟[1,2], 松尾 慎治[1,3], 納富 雅也[1,2]	1.NTT NPC, 2.NTT物性基礎研, 3.NTT先端集積デバイス研
	11:45 - 12:00	奨 13a-A10-11	表面にフォトニック結晶を形成したmc-Si太陽電池の理論解析	○川本 洋輔[1], 田中 良典[1], 石崎 賢司[1], De Zoysa Menaka[1,2], 梅田 尚実[1], 基平 暉人[1], 藤田 奨也[1], 浅野 卓[1], 野田 進[1]	1.京大院工, 2.京大白眉
	12:00 - 12:15	13a-A10-12	フォトニック結晶μc-Si太陽電池の作製―表面層のみへのフォトニック結晶形成効果の検討ー	○梅田 尚実[1], 元平 暉人[1], 石崎 賢司[1], De Zoysa Menaka[1,2], 田中 良典[1], 川本 洋輔[1], 藤田 奨也[1], 野田 進[1]	1.京大院工, 2.京大白眉

3月13日(金)　16:30 - 18:45

招待	16:30 - 17:00	13p-A10-1	**「第5回女性研究者研究業績・人材育成賞(小舘香椎子賞)受賞記念講演」(30分) フォトニック結晶レーザによる新奇集光ビームの生成とその応用**	**○北村 恭子[1]**	**1.京大**
	17:00 - 17:15	13p-A10-2	Design of Super-Robust All-Dielectric Zero Index Material	○Shota Kita[1], Yang Li[1], Philip Munoz[1], Orad Reshef[1], Daryl Vulis[1], Bobby Day[1], Charles Lieber[1], Eric Mazur[1], Loncar Marko[1]	1.Harvard Univ.
	17:15 - 17:30	13p-A10-3	Demonstration of Super-Robust All-Dielectric Zero Index Material	○Shota Kita[1], Yang Li[1], Philip Munoz[1], Orad Reshef[1], Daryl Vulis[1], Bobby Day[1], Charles Lieber[1], Eric Mazur[1], Loncar Marko[1]	1.Harvard Univ.
	17:30 - 17:45	奨 13p-A10-4	フォトニック結晶スローライト導波路での光誘起ドップラーシフト	○近藤 圭祐[1], 馬場 俊彦[1]	1.横国大院工
	17:45 - 18:00	13p-A10-5	広帯域低分散スローライトを発現するシリカクラッドフォトニック結晶導波路のメカニズムの考察と最適化	○田村 卓也[1], 近藤 圭祐[1], 馬場 俊彦[1]	1.横国大院工
	18:00 - 18:15	13p-A10-6	マイクロキャビティ構造からの波長選択性熱ふく射スペクトル狭帯域化	○(DC)小桧山 朝華[1], 清水 信[1], 井口 史匡[1], 湯上 浩雄[1]	1.東北大院工
	18:15 - 18:30	13p-A10-7	低消費電力・狭帯域熱輻射光源の開発	○井上 卓也[1], De Zoysa Menaka[1,2], 浅野 卓[1], 野田 進[1]	1.京大院工, 2.京大白眉
	18:30 - 18:45	13p-A10-8	狭帯域近赤外Siフォトニック結晶熱輻射光源の検討(VI)	○末光 真大[2], 橋本 康平[1], 浅野 卓[1], 堤 達紀[1], De Zoysa Menaka[3], 野田 進[1]	1.京大院工, 2.大阪ガス, 3.京大白眉

3.12 ナノ領域光科学・近接場光学 / Nanoscale optical science and near-field optics　口頭講演

3月11日(水)　9:00 - 12:30

招待	9:00 - 9:15	11a-A12-1	**「講演奨励賞受賞記念講演」(15分) 金ナノロッドによる中赤外超短パルス電場の共鳴増強と光電界放出**	**○草 史野[1,2], エヒテルンカンプ カタリナ[3], ロパース クラウス[3], 芦原 聡[2]**	**1.農工大院工, 2.東大生研, 3.ゲッティンゲン大**
	9:15 - 9:30	11a-A12-2	A nanoscale vacuum-tube diode triggered by few-cycle laser pulses	○(P)Higuchi Takuya[1], Hommelhoff Peter[1]	1.University of Erlangen-Nuremberg
	9:30 - 9:45	11a-A12-3	中赤外光スロットアンテナによる光増強効果の垂直方向依存性(II)	○(M1)國近 祐太[1], 川野 貴裕[1], 宮田 純一[1], 山本 悠人[1], 西村 悠希[1], 笠原 健一[1], 家路 豊成[2], 池田 直樹[3], 大里 啓考[3], 杉本 喜正[3]	1.立命館大理工, 2.立命館大 SR センター, 3.物質・材料研究機構
	9:45 - 10:00	11a-A12-4	Alの異方性アノードエッチングにもとづいた熱放射制御構造の放射波長制御	近藤 敏彰[1], ○長谷川 駿[1], 木村 直史[2], 吉岡 文孝[2], 豊永 隆[2], 益田 秀樹[1]	1.首都大都市環境, 2.オキツモ
	10:00 - 10:15	11a-A12-5	大面積プラズモニックメタ表面における共鳴調整と界面改質	○岩長 祐伸[1], 崔 峯碩[1], 宮崎 英樹[1], 杉本 喜正[1], 迫田 和彰[1]	1.物材機構
	10:15 - 10:30	奨 11a-A12-6	プラズモニック結晶キャビティによる発光の制御	○斉藤 光[1], 山本 直紀[1]	1.東工大
	10:30 - 10:45		休憩/Break		
	10:45 - 11:00	11a-A12-7	近接場光顕微鏡を用いた中赤外ログスパイラルアンテナの解析	○藤村 直紀[1], 石川 昴[1], 陸 昴義[1], 小田 俊理[1], 河野 行雄[1]	1.東工大量子ナノ研セ
	11:00 - 11:15	11a-A12-8	GaAs/Ti ストライプ構造における LO フォノン周波数での赤外光吸収	○(B)竹内 映人[1], 石谷 善博[1], 森田 健[1], 馬 蓓[1]	1.千葉大工
	11:15 - 11:30	奨 11a-A12-9	湾曲金ナノロッドダイマー構造とV字型金ナノダイマー構造の光学特性の比較	○横田 幸恵[1], 田中 拓男[1,2]	1.理研, 2.北大電子研
	11:30 - 11:45	11a-A12-10	テラヘルツ帯域に共鳴を有する光アンテナ構造の分光特性と分子計測への応用	○上野 貢生[1], 野澤 翔[1], 三澤 弘明[1]	1.北大電子研
	11:45 - 12:00	11a-A12-11	プラズモニック結晶のリング状欠陥　- 四重極子モード -	○酒井 恭輔[1], 山本 岳明[1], 大村 竜矢[1], 笹木 敬司[1]	1.北大 電子研
	12:00 - 12:15	11a-A12-12	メタマテリアルレンズアレーを実装した超解像光学顕微鏡	○岩長 祐伸[1]	1.物材機構
	12:15 - 12:30	11a-A12-13	力検出を用いた近接場光イメージングの高さ依存性観測	○山西 絢介[1], 徳山 貴士[1], 内藤 賀公[1], 李 艶君[1], 菅原 康弘[1]	1.阪大院工

3月11日(水)　14:00 - 18:00

招待	14:00 - 14:15	11p-A12-1	**「講演奨励賞受賞記念講演」(15分) 深紫外プラズモニクスにおけるインジウムとアルミニウムの利用**	**○熊本 康昭[1], 齊藤 結花[2], 田口 敦清[2], 本田 光裕[2], 河田 聡[1,2]**	**1.理研, 2.阪大院工**
	14:15 - 14:30	奨・E 11p-A12-2	Characterization of Step, Ridge, and Crack Submicro/Nano-structure on Epitaxial Graphene using Tip-enhanced Raman Spectroscopy	○(D)Sanpon Vantasin[1], Yoshito Tanaka[1], Ichiro Tanabe[1], Toshiaki Suzuki[1], Tamitake Itoh[2], Yasunori Kutsuma[1], Koji Ashida[1], Tadaaki Kaneko[1], Yukihiro Ozaki[1]	1.Kwansei Gakuin Univ., 2.AIST
	14:30 - 14:45	11p-A12-3	TERS顕微鏡のためのマルチグレインプローブ	○田口 敦清[1,2], 河田 聡[1,2]	1.阪大工, 2.理研
	14:45 - 15:00	11p-A12-4	表面増強ラマン散乱法を用いたプラズモニック光化学反応の追跡	○(PC)山本 裕子[1,2], 茅野 優也[1], 伊藤 民武[3], 中西 俊介[1]	1.香川大工, 2.学振RPD, 3.産総研四国
	15:00 - 15:15	11p-A12-5	単一SERSホットスポットにおけるスペクトル変化分析	○伊藤 民武[1], 山本 裕子[2], 田丸 博晴[3], バスデバンビライ ビジュ[1], 脇田 慎一[1]	1.産総研健工, 2.香大工, 3.東大院工
	15:15 - 15:30	11p-A12-6	アンチストークス近接場蛍光を使ったナノ領域の温度測定	○山本 賢[1], 藤村 隆史[1], 梶川 浩太郎[1]	1.東工大総理工
	15:30 - 15:45		休憩/Break		
	15:45 - 16:00	11p-A12-7	ドレスト光子利用波長変換フィルムによる結晶シリコン太陽電池の高効率化	○川添 忠[1], 雨海 千秋[1], 大津 元一[1]	1.東大工
	16:00 - 16:15	11p-A12-8	ドレスト光子フォノン援用アニールで作製されたSi-LED中のドーパント分布の特徴	○川添 忠[1], 大津 元一[1]	1.東大工
	16:15 - 16:30	奨 11p-A12-9	フォトンブリーディング効果によるSi-LEDの偏光制御	○西岡 克紘[1], 川添 忠[1], 大津 元一[1]	1.東大工
	16:30 - 16:45	奨 11p-A12-10	レーザードーピングによる可視発光 Si-LED の開発	○山口 真生[1], 西岡 克紘[1], 川添 忠[1], 大津 元一[1]	1.東大院工
	16:45 - 17:00	奨 11p-A12-11	ドレスト光子を用いた増幅型のSi青-紫外光検出器	○(M1)池川 晶貴[1], 川添 忠[1], 大津 元一[1]	1.東大院工
	17:00 - 17:15	11p-A12-12	ドレスト光子を利用したSiレーザー導波路の光増幅利得の評価	○田中 肇[1], 川添 忠[1], 大津 元一[1], 赤羽 浩一[2], 山本 直克[2]	1.東大工, 2.情通機構
	17:15 - 17:30	奨 11p-A12-13	ドレスト光子フォノン援用過程を用いたGaP LEDスペクトルの加工条件依存性	○(D)金 俊亨[1], 川添 忠[1], 大津 元一[1]	1.東大院工
	17:30 - 17:45	11p-A12-14	ドレスト光子フォノンエッチングによる半導体の表面損傷の修復	○野村 航[1], 川添 忠[1], 八井 崇[1], 大津 元一[1]	1.東大院工

	17:45 - 18:00	11p-A12-15	DPPエッチングを利用したナノダイヤモンドの発光制御	○南雲 亮佑[1], Brandenburg Felix[1], 八井 崇[1], Ermakova Anna[2], Jelezko Fedor[2]	1.東京大, 2.ウルム大
	3月12日(木)　9:00 - 12:15				
	9:00 - 9:15	12a-A12-1	Theory of the Single Susceptibility equally associated with Non-radiative and Radiative Fields in Optics IV	○Itsuki Banno[1]	1.Univ. of Yamanashi
	9:15 - 9:30	12a-A12-2	3Dプリンター造形バフ研磨エバネッセント光原子ファネル	○横山 雄大[1], 吉田 貴広[1], 佐川 研太[1], 伊藤 治彦[1]	1.東工大総理工
	9:30 - 9:45	12a-A12-3	近接場光原子センシング用ナノスリットのエッジ急峻化	○(M2)永井 弥夕[1], 鈴木 匠[1], 伊藤 治彦[1]	1.東工大総理工
	9:45 - 10:00	12a-A12-4	金属ナノスリットを用いた可変回折レンズの開発	山中 裕貴[1], 大津 朋也[1], 石井 智[2], ○山口 堅三[1]	1.香川大工, 2.物材機構
	10:00 - 10:15	奨 12a-A12-5	石英基板上での単結晶銀ナノ粒子の作製と評価	○森 智博[1,2], 田中 康弘[1], 須崎 嘉文[1], 山口 堅三[1]	1.香川大工, 2.和歌山工技セ
	10:15 - 10:30	奨 12a-A12-6	銀ナノ石畳構造を利用した新規反射防止構造	○安田 英紀[1], 松野 亮[2], 谷 武晴[1], 納谷 昌之[1]	1.富士フイルム先端研, 2.富士フイルム生産技術センター
	10:30 - 10:45	12a-A12-7	FDTD計算による多層積層銀ナノ粒子シートの紫外・可視吸収機構の解明	○田中 大輔[1], 出川 亮[2], Li Xinheng[2], 岡本 晃一[2], 玉田 薫[2]	1.大分高専, 2.九大先導研
	10:45 - 11:00		休憩/Break		
	11:00 - 11:15	12a-A12-8	金ナノ粒子を介した金薄膜の光透過	藤井 一輝[1], 藤村 隆史[1], 下条 雅幸[2], ○梶川 浩太郎[1]	1.東工大総合理工, 2.芝浦工大工
	11:15 - 11:30	12a-A12-9	固体表面に担持した金属ナノクラスターの光吸収	○飯田 健二[1], 野田 真史[1], 信定 克幸[1]	1.分子研
	11:30 - 11:45	12a-A12-10	金属ナノ粒子分散液晶メタマテリアルにおけるDyakonov表面波	○松井 龍之介[1,2]	1.三重大院工, 2.三重大極限ナノエレ
	11:45 - 12:00	12a-A12-11	蓮の葉をバイオテンプレートに使った黒体メタマテリアル	○海老原 佑亮[1], 下条 雅幸[2], 梶川 浩太郎[1]	1.東京工大, 2.芝浦工大
	12:00 - 12:15	12a-A12-12	反射光検出型LSPRガスセンサの検討	○加沢 エリト[1], 紋川 亮[1]	1.都産技研
	3月13日(金)　9:00 - 12:30				
	9:00 - 9:15	奨 13a-A12-1	表面プラズモンを介した光ビート信号による電子回路の動作	○酒井 宏基[1], 岡久 真也[1], 相原 卓磨[1], 福原 誠史[1], 石井 佑弥[1], 福田 光男[1]	1.豊技大
	9:15 - 9:30	13a-A12-2	高分子系有機EL素子の薄膜化とそれに伴う表面プラズモンの散乱特性	○乾 貴大[1], 川瀬 博人[1], 溝口 雄太[1], 米田 拓也[1], 笠原 健一[1], 池田 直樹[2], 大里 啓孝[2], 杉本 喜正[2]	1.立命大理工, 2.物質・材料研究機構
	9:30 - 9:45	13a-A12-3	金属ナノ構造中の局在プラズモン場の高空間分解分光イメージング	○安田 有輝[1], 藤原 英樹[1], 酒井 恭輔[1], 石田 周太郎[1], 田中 嘉人[2], 笹木 敬司[1]	1.北大電子研, 2.関西学院大
	9:45 - 10:00	奨 13a-A12-4	非同径ポンプ-プローブレーザー励起顕微鏡法による局所励起表面プラズモン波束のフェムト秒時間分解映像	○加藤 佳祐[1], 久保 敦[1]	1.筑波大物理
	10:00 - 10:15	奨 13a-A12-5	金属ナノブリッジにおける表面プラズモン伝搬	○(M1)長崎 裕介[1], 宮田 将司[1], 高原 淳一[1,2]	1.阪大院工, 2.阪大フォトニクスセ
	10:15 - 10:30	13a-A12-6	Gap plasmon resonance in a film-coupled floating gold nanowire	○(DC)宮田 将司[1], Aaron Holsteen[2], 長崎 裕介[1], Mark L. Brongersma[2], 高原 淳一[1,3]	1.阪大院工, 2.GLAM, Stanford Univ., 3.阪大フォトニクセ
	10:30 - 10:45	13a-A12-7	陽極酸化ポーラスアルミナにもとづいた同軸ナノケーブルアレーの形成と集光デバイスへの応用	○近藤 敏彰[1], 堀 龍太郎[1], 柳下 崇[1], 益田 秀樹[1]	1.首都大都市環境
	10:45 - 11:00		休憩/Break		
	11:00 - 11:15	13a-A12-8	銀薄膜の表面プラズモンによる酸化亜鉛の可視発光増強：銀膜厚依存性	○(M2)肖 貴宝[1], 中村 俊博[1], 安達 定雄[1]	1.群馬大院理工
	11:15 - 11:30	13a-A12-9	銀ナノキューブ担持酸化チタンの非対称な光学挙動およびその制御	○齋藤 滉一郎[1], 田邉 一郎[1], 立間 徹[1]	1.東大生研
	11:30 - 11:45	13a-A12-10	プラズモニック多層ナノ粒子によるアップコンバージョン増強(I)	○山本 薫[1], 大瀬 昌明[1], 今北 健二[1], 藤井 稔[1]	1.神戸大院工
	11:45 - 12:00	13a-A12-11	金ナノ粒子-シリコンナノ結晶複合体の発光特性(I)	○井上 飛鳥[1], 杉本 泰[1], 今北 健二[1], 藤井 稔[1]	1.神戸大工
	12:00 - 12:15	13a-A12-12	シリカで被覆したポリスチレン@Auコアシェル粒子の2光子励起蛍光増大への応用	○志野木 駿伍[1], 加藤 徳剛[1]	1.明大理工
	12:15 - 12:30	奨 13a-A12-13	局在増強電場下での量子干渉効果と高効率2光子上方変換	○(D)逢坂 良樹[1], 余越 伸彦[1], 中谷 正俊[1], 石原 一[1]	1.阪府大院工

3.12 ナノ領域光科学・近接場光学 / Nanoscale optical science and near-field optics　ポスター講演

	3月13日(金)　16:30 - 18:30				
		13p-P3-1	遠紫外表面プラズモンセンサーの開発	○田中 嘉人[1], 領木 貴之[1], 田邉 一郎[1], 後藤 剛善[1], 黄川田 昌和[2], 居波 渉[2,3], 川田 善正[2,3], 尾崎 幸洋[1]	1.関西学院大理工, 2.静大院工, 3.JST-CREST
		13p-P3-2	導波路クレッチマン型SPRセンサの高感度化・広測定範囲化の検討	○(M2)日高 直哉[1], 黒田 康彰[1], 松島 裕一[2], 石川 浩[1], 宇高 勝之[1]	1.早大理工, 2.GCS研究機構
		13p-P3-3	一次元金属回折格子を用いた伝搬型表面プラズモンセンサーによる高屈折率媒質の検出	○水戸 慎也[1], 元垣内 敦司[1,2], 三宅 秀人[1,2], 平松 和政[1,2]	1.三重大院工, 2.三重大極限ナノエレセンター
		13p-P3-4	金属ナノスリットを用いた可変回折レンズの機構設計	○山口 堅三[1], 山中 裕貴[1], 大津 朋也[1], 石井 智[2]	1.香川大工, 2.物材機構
		13p-P3-5	石英基板上での銀成膜段階における結晶粒成長機構	○森 智博[1,2], 田中 康弘[1], 須崎 嘉文[1], 山口 堅三[1]	1.香川大工, 2.和歌山工技セ
		13p-P3-6	金属ナノ構造との相互作用検証のための蛍光微小球配置技術の開発	○田崎 俊[1], 谷口 敏規[1], 齋藤 蘭[1], 岡本 敏弘[1], 原口 雅宣[1]	1.徳島大院
		13p-P3-7	金ナノロッド/非線形光学ポリマー複合型非線形光学素子のポリマー積層条件による最適化	○棚倉 悠史[1], 平林 拓磨[1], 二橋 俊介[1], 小野篤史[1], 川田 善正[1], 杉田 篤史[1]	1.静岡大工
		13p-P3-8	ナノロッドアレイによる赤外域での電場増強と表面増強赤外吸収	○竹上 明伸[1,2], 草 史野[1,2], 生嶋 健司[1], 芦原 聡[2]	1.農工大工, 2.東大生研
		13p-P3-9	近赤外域に共鳴をもつ金ナノロッドの合成とその非線形光学応答の評価	○萬 大輔[1], 草 史野[1], 田山 純平[2], 西 弘泰[2], 立間 徹[2], 芦原 聡[2]	1.農工大(工), 2.東大生研
		13p-P3-10	金 / 銀 / 銅合金系の複素誘電率と結晶構造の評価	○橋本 佳和[1], 西島 喜明[1], Gediminas Seniutinas[2], Saulius Juodkazis[2], Lorenzo Rosa[2]	1.横国大院工, 2.スインバーン工科大学
		13p-P3-11	Pt薄膜上へのPtコート極細糸の配置によるPt複素屈折率の変化の可能性	○但馬 文昭[1], 西山 善郎[1]	1.横国大教

		13p-P3-12	ルビジウム原子2光子遷移スペクトルの励起レーザーパワー依存性	○(M2)真下 太郎[1], 伊藤 拓馬[1], 小林 豊[1], 柴田 康介[1], 東條 賢[1]	1.中央大理工
		13p-P3-13	レーザー冷却原子観測のための高解像度測定の実現	○(M2)須永 裕司[1], 柴田 康介[1], 東條 賢[1]	1.中央大理工
		13p-P3-14	近接場マルチプローブ顕微鏡による半導体量子井戸内の励起輸送観察(V)	○三輪 嘉彦[1], 大久保 領[1], 酒井 優[1], 東海林 篤[1], 内山 和治[1], 小林 潔[1], 松本 俊[1], 岸野 克巳[2], 堀 裕和[1]	1.山梨大院医工, 2.上智大理工
		13p-P3-15	二重トンネル接合された金ナノロッド系における近接場光分布と電流-電圧特性の相関	○西川 直樹[1], 内山 和治[1], 久保田 悟[1], 小林 潔[1], 堀 裕和[1]	1.山梨大工
		13p-P3-16	金属ナノ構造体における超高速プラズモン場の時空間制御のモデル計算	○(B)小島 康裕[1], 正木 雄太[1], 藤間 一憲[1], 神成 文彦[1]	1.慶大理工
		13p-P3-17	フェムト秒レーザ波形整形による回折格子結合超高速表面プラズモンパルス及び非線形放射制御	○正木 雄太[1], 藤間 一憲[1], 廣澤 賢一[1], 神成 文彦[1]	1.慶大理工
		13p-P3-18	金属マルチスリットを組み込んだLED構造による表面プラズモンポラリトン発生素子の検討	○大正谷 皓司[1], 村中 隆二[1], 原口 雅宣[1], 岡本 敏弘[1], 井須 俊郎[1], 福井 萬壽夫[1]	1.徳島大工
		13p-P3-19	高効率熱光発電のためのNiW熱輻射光源の分光計測	○穴澤 勇人[1], 那 順[2], 岩見 健太郎[2], 梅田 倫弘[2]	1.農工大工, 2.農工大院工
		13p-P3-20	高効率吸収材料とプラズモニクスを融合した光熱発電モデルの構築	○小松 諒祐[1], 山村 拓也[1], 西島 喜明[1], GEDIMINAS SENIUTINAS[2], SAULIUS JUODKAZIS[2]	1.横国大院工, 2.スインバーン工科大学
		13p-P3-21	プラズモン共振器を含むトレンチ型導波路の透過特性解析	○岡本 浩行[1], 日下 晃佑[1], 山口 堅三[2], 原口 雅宣[3], 岡本 敏弘[3]	1.阿南高専, 2.香川大工, 3.徳島大院
		13p-P3-22	プラズモニック導波路を用いた温度計測デバイスの検討	○日下 晃佑[1], 岡本 浩行[1], 山口 堅三[2], 原口 雅宣[3], 岡本 敏弘[3]	1.阿南高専, 2.香川大工, 3.徳島大学院
		13p-P3-23	ハーフコアシェルMIM構造による磁気共鳴	○藤井 鐘多[1], 藤村 隆史[1], 梶川 浩太郎[1]	1.東工大総理工
		13p-P3-24	TERS探針先端における増強電場のFDTD計算解析	北濱 康孝[1], 鈴木 利明[2], 尾崎 幸洋[3], ○伊藤 民武[1]	1.産総研健工, 2.ユニソク, 3.関学理工
		奨 13p-P3-25	V型溝を組み合わせたAuアパーチャーアンテナによるナノ円偏光生成の波長依存性	○(DC)蔡 永福[1], 池田 壮志[1], 中川 活二[2], 菊池 宏[3], 清水 直樹[3], 石橋 隆幸[1]	1.長岡技科大, 2.日大理工, 3.NHK技研
		13p-P3-26	格子構造近傍における局所偏光場の空間プロファイルのFDTD解析	清水 健史[1], 大平 泰生[1], ○岡 寿樹[2]	1.新潟大工, 2.新潟大超域
		13p-P3-27	2次元空間におけるメタマテリアルの検討	○日野 湧也[1], 市川 裕之[1]	1.愛媛大院理工
		13p-P3-28	局在光と分子振動の相互作用	○岩佐 豪[1], 武次 徹也[1]	1.北大院理

3.13 半導体光デバイス / Semiconductor optical devices　口頭講演

3月12日(木)　9:00 - 13:00

	9:00 - 9:15	12a-A17-1	バイオテンプレート極限加工を用いたGeナノディスクの作製と光学特性	○藤井 拓也[1,2], 磯田 大河[3,5], シェンティエル モハメッド タハール[1,4], 遠藤 広考[2], 伊藤 公平[3,5], 寒川 誠二[1,4,5]	1.東北大・流体研, 2.本田技術研究所, 3.慶應大・理工, 4.東北大WPI-AIMR, 5.JST-CREST
	9:15 - 9:30	E 12a-A17-2	Change in Photo Induced Minority Carrier Lifetime of PN Junction with Bias Voltage	○(B)Takayuki Motoki[1], Keisuke Yasuta[1], Shousuke Saitou[1], Hidenao Suzuki[1], Shousuke Kimura[1], Tomohiko Nakamura[1], Masahiko Hasumi[1], Toshiyuki Samesima[1]	1.TUAT
	9:30 - 9:45	12a-A17-3	電力置換法による太陽電池エネルギー変換効率の測定	○齋藤 輝文[1,2], 阿部 大和[1], 佐藤 宏樹[1], 武澤 港斗[2]	1.東北工大工, 2.東北工大院工
	9:45 - 10:00	12a-A17-4	Ga_2O_3／$CuInGaSe_2$ ヘテロ接合ダイオードにおける光電流増倍現象	○菊地 健司[1], 為村 成亨[1], 宮川 和典[1], 大竹 浩[1], 久保田 節[1], 中田 時夫[2]	1.NHK技研, 2.東理大総研
	10:00 - 10:15	12a-A17-5	近接障壁層の構造変化よる量子ドット赤外線検出器の検知波長制御	○各務 惣太[1,2], 田中 朋[1], 角田 雅弘[2], 渡邉 克之[3], 山本 剛[1,2], 白根 昌之[1,2], 萬 伸一[1,2], 荒川 泰彦[2,3]	1.NECスマエネ研, 2.東大ナノ量子機構, 3.東大生研
	10:15 - 10:30	12a-A17-6	プラズモニックナノギャップアンテナを利用した電荷敏感型赤外光子検出器(CSIP)	○金 鮮美[1], 小宮山 進[2,3], 佐藤 崇[1], パトラシン ミハイル[3], 梶原 優介[1]	1.東大生研, 2.東大総文, 3.情通研
	10:30 - 10:45	12a-A17-7	テーパー構造を有する電界制御型分岐比可変多モード干渉カプラーの損失低減の検討	○金子 慎[1], 川崎 直道[1], 盧 柱亨[1], 荒川 太郎[1]	1.横国大院工
	10:45 - 11:00	12a-A17-8	マイクロリング装荷型マッハツェンダー2×2光スイッチの設計	○堀 健人[1], 西村 真樹[1], 荒川 太郎[1], 國分 泰雄[1]	1.横国大院工
	11:00 - 11:15	12a-A17-9	EOポリマ/TiO_2多層薄膜スロット導波路光変調器におけるバリア層とクラッド層による電気光学係数の増強	○中村 英弘[1], Jouane Youssef[1], Luo J.[2], Jen Alex K-Y.[2], 榎波 康文[1]	1.高知工科大学, 2.ワシントン大学
	11:15 - 11:30		休憩/Break		
	11:30 - 11:45	12a-A17-10	混晶化法を用いたAlAs選択酸化に関する基礎実験	○魏 徹[1], 宮本 智之[1]	1.東工大・精研
	11:45 - 12:00	E 12a-A17-11	Fabrication of SiC Membrane High Contrast Grating Using Nanoimprint Lithography	○(D)YingYu Lai[1,2], Shunya Inoue[1], Tien-Chang Lu[2], Shing-Chung Wang[2], Fumio Koyama[1]	1.TIT, 2.NCTU
	12:00 - 12:15	奨 12a-A17-12	横方向複合共振器面発光レーザのVernier効果による横モード制御	○(PC)中濱 正統[1], 小林 拓貴[1], 丸山 彰[1], 坂口 孝浩[1], 松谷 晃宏[2], 小山 二三夫[1]	1.東工大精研, 2.半導体MEMSプロセス技術センター
	12:15 - 12:30	12a-A17-13	励起準位を用いたVCSELの動作温度範囲拡大	○(M2)角田 健[1], 松谷 晃宏[2], 宮本 智之[1]	1.東工大 精研, 2.東工大 技術部
	12:30 - 12:45	E 12a-A17-14	Chirp Reduction Along with Modulation Bandwidth Enhancement Utilizing Coupled Cavity VCSEL	○(M1)Shanting Hu[1], Fumio Koyama[1]	1.Titech
	12:45 - 13:00	E 12a-A17-15	Fabrication and photoluminescence characterization of capsule-shaped metallic InP/InGaAs cavity structures	○(D)Baifu Zhang[1], Takuya Okimoto[1], Takuo Tanemura[1], Yoshiaki Nakano[1]	1.The Univ. of Tokyo

3月12日(木)　14:00 - 19:00

招待	14:00 - 14:15	12p-A17-1	**「講演奨励賞受賞記念講演」(30分) ハーフリッジ型導波路構造を用いたInPモノリシック偏波変調器の試作と実証**	**○川端 祐斗[1], 財津 優[1], 種村 拓夫[1], 中野 義昭[1]**	**1.東大院工**
	14:15 - 14:30	奨 12p-A17-2	Optical interconnection between III-V chips on Si by using photonic wire bonding	○(M2)ZhiChen Gu[1], Tomohiro Amemiya[2,3], Atsushi Ishikawa[3], Yuki Atsumi[4], JoonHyun Kang[1], Takuo Hiratani[1], Nobuhiko Nishiyama[1], Takuo Tanaka[3], Shigehisa Arai[1,2]	1.Tokyo Tech, 2.QNERC, 3.RIKEN, 4.AIST
	14:30 - 14:45	12p-A17-3	スポットサイズ変換器集積GaAs基板上量子ドットレーザ	○植竹 理人[1], 高林 和雅[1], 木村 徳治[1], 山本 剛之[1], 山口 正臣[2], 高田 幹[2], 武政 敬三[2], 菅原 充[2], 荒川 泰彦[3]	1.富士通研, 2.QDレーザ, 3.東大ナノ量子機構
	14:45 - 15:00	12p-A17-4	近赤外広帯域光源を目指したInAs 量子ドットLD の発光特性[2]	○沢渡 義規[1], 吉沢 勝美[1], 赤羽 浩一[2], 山本 直克[2]	1.ﾊﾟｲｵﾆｱﾏｲｸﾛﾃｸﾉﾛｼﾞｰ㈱, 2.情通機構
	15:00 - 15:15	12p-A17-5	1.1μm帯広帯域量子ドットリッジ導波路型LDの開発	○吉沢 勝美[1], 沢渡 義規[1], 赤羽 浩一[2], 山本 直克[2]	1.パイオニアMTC, 2.情報通信研究機構
	15:15 - 15:30	12p-A17-6	p 変調ドープInAs/InP ダブルキャップ量子ドット構造の電流注入特性	○(M1)鋤柄 俊樹[1], 山元 雄太[1], 西山 哲央[1], 下村 和彦[1]	1.上智大理工
	15:30 - 15:45	12p-A17-7	(775)B InP 基板上にMBE成長したInGaAs層のコラゲーションと光学的特性のIn組成依存性	○松田 晃賢[1], 下村 哲[1], 森貞 俊[1]	1.愛媛大院理工
	15:45 - 16:00	12p-A17-8	ウエハ接合で形成した量子ドット結合共振器による二波長面発光レーザ構造の作製	原山 千穂[1], ○太田 寛人[1], 前川 知久[1], 盧 翔孟[1], 熊谷 直人[1], 北田 貴弘[1], 井須 俊郎[1]	1.徳島大院フロンティア
	16:00 - 16:15	12p-A17-9	InAs/InGaAsP歪み量子ドット構造半導体の量子準位の解析	○山口 萌花[1], 新井 暢子[1], 結女 井出[1], 今井 元[1]	1.日女大理
	16:15 - 16:30		休憩/Break		
	16:30 - 16:45	奨 12p-A17-10	BJB構造を有する半導体薄膜分布反射型レーザの室温連続動作	○平谷 拓生[1], 井上 大輔[1], 冨安 高弘[1], 厚地 祐輝[1], 雨宮 智宏[2], 西山 伸彦[1], 荒井 滋久[1,2]	1.東工大, 2.東工大量子ナノ
	16:45 - 17:00	奨 12p-A17-11	GaInAsP/InP半導体薄膜レーザの低電圧動作	○厚地 祐輝[1], 福田 快[1], 平谷 拓生[1], 井上 大輔[1], 雨宮 智宏[2], 西山 伸彦[1], 荒井 滋久[1,2]	1.東工大電電, 2.量子ナノ
	17:00 - 17:15	12p-A17-12	直接貼付InP/Quartz基板上GaInAs/InP MQW LEDの電流注入動作	○松本 恵一[1], 高巣 誠[1], 金谷 佳則[1], 岸川 純也[1], 下村 和彦[1]	1.上智大理工
	17:15 - 17:30	12p-A17-13	直接貼付InP/Si基板における接合状態評価	○(M1)岸川 純也[1], 松本 恵一[1], 金谷 佳則[1], 下村 和彦[1]	1.上智大理工
	17:30 - 17:45	奨 12p-A17-14	急速加熱処理により作製したGeSn-on-quartz構造のフォトルミネッセンス測定	○(M1)天本 隆史[1], 冨永 幸平[1], 梶村 恵子[1], 細井 卓治[1], 志村 孝功[1], 渡部 平司[1]	1.阪大院工
	17:45 - 18:00	12p-A17-15	III-V-OI基板上における量子井戸インターミキシングの検討	○高島 成也[1,2], 一宮 佑希[1,2], 竹中 充[1,2], 高木 信一[1,2]	1.東大院工, 2.JST-CREST
	18:00 - 18:15	12p-A17-16	F イオン注入と熱処理によるGaAsP 歪量子井戸選択的無秩序化を用いた導波光伝搬損失低減	奥田 真也[1], ○上向井 正裕[1], 栖原 敏明[1]	1.阪大院工
	18:15 - 18:30	12p-A17-17	高効率動作を目的とした共振点シフトDFB-LDの提案と解析	○(M1)市川 敬一郎[1]	1.立命館大理工
	18:30 - 18:45	12p-A17-18	Spin-LEDにおける円偏光ヘリシティーの高速切替え実験	○青山 政樹[1], 西沢 望[1], 西林 一彦[1], 宗片 比呂夫[1]	1.東工大像情報
	18:45 - 19:00	12p-A17-19	265nm深紫外LEDの光取出し効率向上による90mW高出力動作の実証	○井上 振一郎[1], 溜 直樹[1,2], 谷口 学[1], 中屋 晃成[1], 木下 亨[2], 小幡 俊之[2], 柳 裕之[2]	1.情報通信研究機構, 2.トクヤマ

3.13 半導体光デバイス / Semiconductor optical devices　　ポスター講演

3月13日(金)　16:30 - 18:30

		13p-P4-1	高密度InAs歪量子ドットを活性層に含むリッジレーザの作製と評価	○伴 龍太郎[1], 菅原 宏治[1], 赤羽 浩一[2], 山本 直克[2]	1.首都大SD, 2.情通機構
		13p-P4-2	非対称結合量子井戸における励起子吸収を考慮したフォトダイオードの光応答特性シミュレーション	○坂口 浩一郎[1], 船木 洸希[1], 福嶋 丈浩[1], 徳田 安紀[1]	1.岡山県立大
		13p-P4-3	三角障壁フォトトランジスタによる高感度赤外光検出	○大森 雅登[1], 杉村 和哉[1], 小嶋 友也[1], 加戸 作成[1], 野田 武司[2], Vitushinskiy Pavel[1], 岩田 直高[1], 榊 裕之[1,2]	1.豊田工大, 2.物材研

3.5 レーザー装置・材料, 3.14 光制御デバイス・光ファイバーのコードシェアセッション　　口頭講演

3月13日(金)　9:00 - 11:15

招待	9:00 - 9:15	13a-A13-1	**「講演奨励賞受賞記念講演」(15分) 中赤外(9-12μm)光渦レーザーにおける符号制御**	**○堀川 マイケル知樹[1], 尾川 あずさ[1], 古城 健司[1], 宮本 克彦[1], 尾松 孝茂[1,2]**	**1.千葉大融合, 2.JST-CREST**
	9:15 - 9:30	奨・E 13a-A13-2	Widely tunable optical vortex parametric laser	○(D)ABULIKEMU AIZITIAILI[1], Taximaiti Yusufu[1,2], Katsuhiko Miyamoto[1], Takashige Omatsu[1,2]	1.Chiba Univ, 2.JST-CREST
	9:30 - 9:45	13a-A13-3	マイクロチップレーザー励起中赤外光パラメトリック発生の検討	○石月 秀貴[1], 平等 拓範[1]	1.分子研
	9:45 - 10:00	奨 13a-A13-4	CsLiB6O10結晶を用いた非同軸位相整合方式の高効率 355nm 紫外光発生	○(D)曲 晨[1], 吉村 政志[1], 高橋 義典[1], 森 勇介[1]	1.阪大院工
	10:00 - 10:15	奨 13a-A13-5	金属/液体電極を用いた電圧印加による$MgO:LiNbO_3$周期分極反転構造の作製と緑色光第二高調波発生	○沖野 行佑[1], 栖原 敏明[1]	1.阪大院工
	10:15 - 10:30	奨 13a-A13-6	接合イオンスライス$LiNbO_3$結晶におけるプロトン交換増速エッチングによるリッジ光導波路の作製	○田中 圭祐[1], 栖原 敏明[1]	1.阪大院工
	10:30 - 10:45	奨 13a-A13-7	MgO(8mol%)添加c-$LiTaO_3$アニールプロトン交換導波路の作製	○岡 寿治[1], 栖原 敏明[1]	1.阪大院工
	10:45 - 11:00	13a-A13-8	AlGaAs/AlOx 高屈折率差U字導波路における第二高調波発生の位相整合特性	○中村 勇貴[1], 松下 智紀[1], 近藤 高志[1]	1.東大工
	11:00 - 11:15	奨 13a-A13-9	周期空間反転AlGaAsのAs_2を用いたMBE成長	○楢崎 亮太[1], 松下 智紀[1], 近藤 高志[1]	1.東大工

3.14 光制御デバイス・光ファイバー / Optical control devices and optical fibers　口頭講演

3月11日(水)　9:15 - 12:30

	9:15 - 9:30	11a-A13-1	中赤外光アンテナの干渉効果による反射率低減	○(M1)川野 貴裕[1], 國近 祐太[1], 西村 悠希[1], 宮田 純一[1], 山本 悠人[1], 笠原 健一[1], 家路 豊成[2], 池田 直樹[3], 大里 啓孝[3], 杉本 喜正[3]	1.立命館大理工, 2.立命館大SRセンター, 3.物質・材料研究機構
	9:30 - 9:45	11a-A13-2	中赤外用用金属薄膜サブ波長多重格子構造偏光子の挿入損失低減化	○樋口 翔吾[1], 柿沼 洋[1], 清水 淳[1], 白石 和男[1], 依田 秀彦[1], 六本木 誠[1]	1.宇都宮大工
	9:45 - 10:00	11a-A13-3	非対称-金属/Ge/金属構造を有する光素子の試作と特性評価	○(M1)前蔵 貴行[1], 山本 圭介[2], 王 冬[1], 中島 寛[2]	1.九大総理工, 2.九大産セ
	10:00 - 10:15	11a-A13-4	スローライト導波路フェイズドアレイフェーズドアレイを用いた二次元ビーム掃引に向けた研究の検討	○森 裕之[1], 顧 暁冬[1], 小山 二三夫[1]	1.東工大 精研
	10:15 - 10:30	11a-A13-5	光導波路とエバネッセント結合したGdFe薄膜の磁気光学応答	○岩崎 大和[1], 西林 一彦[1], 松谷 晃宏[2], 佐藤 美那[2], 久我 淳[3], 宗片 比呂夫[1]	1.東工大・像情報, 2.東工大・半導体MEMS, 3.NHK放送技研
	10:30 - 10:45	奨 11a-A13-6	フェムト秒レーザーによるYIG光磁気造形を利用した磁気光学回路	○雨宮 智宏[1,3], 顧 之琛[2], 石川 篤[3,4], 庄司 雄哉[2], ファム ナムハイ[2], 田中 雅明[5], 水本 哲弥[2], 田中 拓男[3,6], 荒井 滋久[1,2]	1.東工大量子ナノ, 2.東工大院工, 3.理研, 4.岡大院工, 5.東大院工, 6.北大電子研
	10:45 - 11:00		休憩/Break		
	11:00 - 11:15	奨 11a-A13-7	外部制御を用いない偏波整列素子に関する検討	○阪本 隼志[1], 佐藤 昇男[2], 山口 城治[1], 橋本 俊和[1]	1.NTT 先端集積デバイス研, 2.NTTデバイスイノベーションセンタ
	11:15 - 11:30	奨 11a-A13-8	液晶素子におけるリタデーション電圧依存性導出の高精度化	○(B)寺島 康平[1], 若生 一広[1]	1.仙台高専
	11:30 - 11:45	11a-A13-9	有機マイクロワイヤリングによるWGMレーザー出力結合	平川 昇[1], 中野 光浩[1], 吉岡 宏晃[1], ○興 雄司[1]	1.九大シス情
	11:45 - 12:00	11a-A13-10	ドナー電子増強型FTC系EOポリマーを用いたマッハ・ツェンダー干渉計型光デバイスの試作	○石川 佳澄[1], 細川 洋一[1], 本谷 将之[1], 及川 哲[1], 市川 潤一郎[1], 山本 和広[2], 横山 士吉[2], 前田 大輔[3], 安井 圭[3], 小澤 雅昭[3], 大友 明[4]	1.住友大阪セメント, 2.九大先導研, 3.日産化学工業, 4.NICT
	12:00 - 12:15	11a-A13-11	光側帯波の偏光操作による6通倍信号の生成	○赤松 洋介[1], 千葉 明人[1], 高田 和正[1]	1.群馬大工
	12:15 - 12:30	11a-A13-12	Non-uniform distortion in optical QAM receiver	○Takahide Sakamoto[1], Guo-Wei Lu[1], Tetsuya Kawanishi[1]	1.NICT

3月11日(水)　14:00 - 16:45

	14:00 - 14:15	11p-A13-1	(Pb,La)(Zr,Ti)O_3(PLZT)薄膜を用いた25Gb/s光変調器	○原 英生[1], 増田 伸[1], 阿部 峻佑[1]	1.アドバンテスト研究所
	14:15 - 14:30	11p-A13-2	光強度の時間制御によるLN位相変調器を用いたSSB変調	○大村 史倫[1], 浅場 智也[1], 安武 裕輔[1,2], 深津 晋[1]	1.東大院総合(駒場), 2.JST さきがけ
	14:30 - 14:45	11p-A13-3	8角柱KTN可変焦点レンズの最適化検討	○川村 宗範[1], 今井 欽之[1], 宮津 純[1], 阪本 匡[1]	1.NTTデバイスイノベーションセンタ
	14:45 - 15:00	11p-A13-4	球面湾曲モデルによるKTN光偏向器の透過波面の解析	○今井 欽之[1], 川村 宗範[1], 宮津 純[1], 阪本 匡[1]	1.NTTデバイスイノベーションセンタ
	15:00 - 15:15		休憩/Break		
	15:15 - 15:30	奨 11p-A13-5	高周波動作へ向けた新構造KTN平面光偏向器	○辰己 詔子[1], 佐々木 雄三[1], 豊田 誠治[1], 今井 欽之[1], 小林 潤也[1], 阪本 匡[1]	1.日本電信電話株式会社, NTTデバイスイノベーションセンタ
	15:30 - 15:45	11p-A13-6	KTN高速光スキャナの光路長制御による偏向角増大	○豊田 誠治[1], 饗場 悠太[2], 上野 雅浩[1], 佐々木 雄三[1], 坂本 尊[1], 小林 潤也[1], 阪本 匡[1]	1.日本電信電話株式会社 NTT デバイスイノベーションセンタ, 2.東京工業大学院 理工学研究科
	15:45 - 16:00	11p-A13-7	PPLN導波路を用いた中赤外光源によるホルムアルデヒドの検出	○遊部 雅生[1], 林 書都[1], 松谷 雄平[1], 竹宮 勇太郎[1], 青木 輝世[1], 加藤 明[1], 染谷 竜太[1], 登倉 明雄[2], 竹ノ内 弘和[2], 山口 滋[1]	1.東海大, 2.NTT 先端集積デバイス研
	16:00 - 16:15	11p-A13-8	EO効果による位相変調を用いた光PLLにおける信号品質の検討	○中村 一貴[1], 入野 辰夫[1], 藤沢 涼平[1], 曽我 俊太[1], 遊部 雅生[1], 梅木 毅伺[2], 竹ノ内 弘和[2]	1.東海大工, 2.NTT先端集積デバイス研
	16:15 - 16:30	奨 11p-A13-9	複数PPLN集積素子を用いた第二高調波励起波長変換の帯域特性	○風間 拓志[1], 梅木 毅伺[1], 遊部 雅生[2], 竹ノ内 弘和[1]	1.NTT, 2.東海大学
	16:30 - 16:45	11p-A13-10	熱光学効果を用いた直接接合PPLN導波路の擬似位相整合特性制御	○梅木 毅伺[1], 風間 拓志[1], 圓佛 晃次[1], 忠永 修[1], 遊部 雅生[2], 竹ノ内 弘和[1]	1.NTT先デ研, 2.東海大

3月12日(木)　9:00 - 11:45

	9:00 - 9:15	12a-A13-1	一点露光法による長周期ファイバグレーティングの製作条件	○川崎 啓太[1], 笠原 啓暉[1], 田村 祐起[1], 村上 巧磨[1], 桐山 拓也[2], 神村 共住[2], 西 壽巳[2]	1.阪工大, 2.阪工大院
	9:15 - 9:30	12a-A13-2	ねじれファイバに形成したマイクロベンド誘起LPFGの偏光特性	○木舩 拓也[1], 原田 智弘[1], 坂田 肇[1]	1.静岡大工
	9:30 - 9:45	12a-A13-3	逆結合型LPFGの光入射方法	○(B)笠原 啓暉[1], 中野 剛司[2], 西 壽巳[2]	1.阪工大, 2.阪工大院
	9:45 - 10:00	12a-A13-4	光導波型マイクロホンにおけるダンピング効果の考察	○老川 仁志[1], 大河 正志[2], 佐藤 孝[2]	1.新潟大学大学院, 2.新潟大学
	10:00 - 10:15	12a-A13-5	シリコン基板光導波型加速度センサにおけるおもりサイズと位相感度の関係	○坂部 亮[1], 大河 正志[2], 佐藤 孝[2]	1.新潟大学大学院, 2.新潟大学
	10:15 - 10:30		休憩/Break		
	10:30 - 10:45	奨 12a-A13-6	有線・無線を統合したWDM方式光給電型ファイバセンサ網	○杉山 裕亮[1], 小林 周平[1], 塩道 明優[1], 田中 洋介[1], 黒川 隆志[1]	1.東京農工大学
	10:45 - 11:00	12a-A13-7	プラノコンベックス型レンズドファイバの集光特性の改善	○斎藤 矯[1], 鈴木 裕太[1], 白石 和男[1], 依田 秀彦[1]	1.宇都宮大工
	11:00 - 11:15	奨 12a-A13-8	プラスチック光ファイバを用いたブリルアン光相関領域反射計の簡素化	○(D)林 寧生[1], 水野 洋輔[1], 中村 健太郎[1]	1.東工大 精研
	11:15 - 11:30	奨 12a-A13-9	外部熱源を用いないプラスチック光ファイバのテーパ加工法の提案	○(B)氏原 大希[1], 林 寧生[1], 皆川 和成[1], 田原 麻梨江[1], 水野 洋輔[1], 中村 健太郎[1]	1.東工大 精研
	11:30 - 11:45	12a-A13-10	Tmファイバリング共振器へのCNT挿入によるQスイッチ発振	○高橋 紀人[1], 金原 健太[1], 坂田 肇[1]	1.静岡大工

3.14 光制御デバイス・光ファイバー / Optical control devices and optical fibers　ポスター講演

3月13日(金)　9:30 - 11:30

		13a-P7-1	カスケード型チャープ長周期光ファイバグレーティングを用いたひずみおよび温度計測	○(M1)ゴ タン トゥン[1], 月田 統[1], 田中 哲[1], 内村 良太郎[1], 和田 篤[1], 高橋 信明[1]	1.防衛大学校
		13a-P7-2	可視光励起によるエルビウム添加光ファイバーの蛍光特性	○(M2)加藤 康平[1], 大友 一槻[1], 古瀬 裕章[1], 本越 伸二[2], 本田 能之[3], 藤本 靖[3], 曽根 宏靖[1]	1.北見工大, 2.レーザー総研, 3.阪大レーザー研
		13a-P7-3	二次元4×4ポリマー光スイッチの特性	○若松 果奈[1], 小林 久也[1], 木村 優一[1], 宇高 勝之[1], 松島 裕一[2], 石川 浩[1]	1.早大理工, 2.GCS機構
		13a-P7-4	3次元光インターコネクション用ポリマー2層構造4×4光スイッチの作製	○木村 優一[1], 小林 久也[1], 若松 果奈[1], 松島 裕一[2], 石川 浩[1], 宇高 勝之[1]	1.早大基幹理工, 2.GCS機構
		13a-P7-5	3次元光接続用ポリマー3層構造3×3光スイッチの作製	○小林 久也[1], 木村 優一[1], 若松 果奈[1], 松島 裕一[2], 石川 浩[1], 宇高 勝之[1]	1.早大, 2.GCS機構
		13a-P7-6	全光論理ゲート素子に向けた多重積層量子ドットのイオン注入と熱処理による組成拡散の検討	○武井 勇樹[1], 尾﨑 太斎[1], 松本 敦[2], 赤羽 浩一[2], 松島 裕一[1], 石川 浩[1], 宇高 勝之[1]	1.早大理工, 2.情報通信研究機構
		13a-P7-7	液晶を用いたシリコン細線マッハツェンダー光スイッチ	○(M2)宮崎 哲男[1,2], 渥美 祐樹[2], 岡野 誠[2], 武井 亮平[2], 三浦 登[1], 森 雅彦[2], 榊原 陽一[2]	1.明大院理工, 2.産業技術総合研究所
		13a-P7-8	磁気光学材料$Bi_3Fe_5O_{12}$を用いたSiリング共振器光スイッチの磁場方位依存性	○岡田 一也[1], 平田 智士[1], 野田 和希[1], 雨宮 嘉照[1], 田部井 哲夫[1], 横山 新[1]	1.広大ナノデバ
		13a-P7-9	磁気光学材料を用いたフォトニック結晶光共振器の研究	○野田 和希[1], 千日 拓馬[1], 本澤 圭太[1], 岡田 一也[1], 雨宮 嘉照[1], 田部井 哲夫[1], 横山 新[1]	1.広大ナノデバイス

3.15 シリコンフォトニクス / Silicon photonics　口頭講演

3月11日(水)　14:00 - 17:00

	14:00 - 14:15	11p-A16-1	窒化シリコン光導波路の分散制御	○古澤 健太郎[1], 関根 徳彦[1], 笠松 章史[1]	1.情通機構
	14:15 - 14:30	奨 11p-A16-2	SiD_4を用いたECRプラズマCVD法による低損失SiN導波路作製	○岡崎 功太[1,2], 西 英隆[1,2], 土澤 泰[1,2], 山本 剛[2], 山田 浩治[1,2]	1.NTTナノフォトニクスセンタ, 2.NTT先端集積デバイス研
	14:30 - 14:45	11p-A16-3	波長405／488nm領域におけるSiON導波路の光学特性	○高 磊[1,2], 土澤 泰[1,2], 岡崎 功太[1,2], 井上 鈴代[2], 上野 祐子[3], 開 達郎[1,2], 山本 剛[2], 山田 浩治[1,2]	1.NTT ナノフォトセンタ, 2.NTT 先端集積デバイス研, 3.NTT 物性科学基礎研
	14:45 - 15:00	11p-A16-4	TiO_2微粒子ポリマを用いたシリコン細線光導波路のアサーマル化	○北 智洋[1], 眞坂 美江子[2], タン フレディ[2], 山田 博仁[1], 井上 大介[3], 山下 達弥[3], 各務 学[3], 杉原 興浩[2]	1.東北大工, 2.宇都宮大, 3.豊田中研
	15:00 - 15:15	11p-A16-5	合成石英基板上水素化アモルファスシリコン細線導波路	○岡野 誠[1], 面田 恵美子[1], 前神 有里子[1], 渥美 裕樹[1], 榊原 陽一[1], 亀井 利浩[1], 森 雅彦[1]	1.産総研
	15:15 - 15:30		休憩/Break		
	15:30 - 15:45	11p-A16-6	シングルモードファイバ直結用偏波無依存2段テーパスポットサイズ変換器	○高橋 博之[1], 岡山 秀彰[1], 小野 英輝[1], 八重樫 浩樹[1], 佐々木 浩紀[1]	1.沖電気
	15:45 - 16:00	11p-A16-7	Siの結晶異方性エッチングを利用したスポットサイズ変換器	○宮村 悟史[1], 小野 英輝[1], 岡部 豊[1], 太縄 陽介[1], 八重樫 浩樹[1], 堀川 剛[1,2], 平山 直紀[2], 佐々木 浩紀[1]	1.PETRA, 2.産総研
	16:00 - 16:15	11p-A16-8	SiO_2スペーサ付スポットサイズ変換器:スペーサ膜厚依存性評価	○前神 有里子[1], 岡野 誠[1], 武井 亮平[1], 面田 恵美子[1], 天野 建[1], 森 雅彦[1], 榊原 陽一[1], 亀井 利浩[1]	1.産総研
	16:15 - 16:30	11p-A16-9	非対称導波路の方向性結合を利用した導波路型光アイソレータの設計	○細田 昌志[1], 佐藤 譲[1], ダニシュ アブドゥルワヒド[1], 服部 貴也[1], 清水 大雅[1]	1.農工大工
	16:30 - 16:45	11p-A16-10	非相反結合を利用したSi導波路プラズモン光アイソレータの設計	○福田 登[1], 梅津 沙緒里[1], 貝原 輝則[1], 清水 大雅[1]	1.農工大工
	16:45 - 17:00	11p-A16-11	TE-TMモード変換器を集積したSi干渉導波路型光アイソレータ	○藤江 彰裕[1], 庄司 雄哉[1], 水本 哲弥[1]	1.東工大工

3月12日(木)　9:30 - 12:30

	9:30 - 9:45	12a-A16-1	狭間隔スロットリング共振器型MEMS光学素子の検討	○雨宮 嘉照[1], 岡田 一也[1], 本澤 圭太[1], 野田 和希[1], 千日 拓馬[1], 福山 正隆[1], 横山 新[1]	1.広島大
	9:45 - 10:00	12a-A16-2	EOポリマーを用いたプラズモン変調器の構造検討	○北條 直也[1], 雨宮 智宏[2], 西山 伸彦[1], 荒井 滋久[1,2]	1.東工大, 2.量子ナノエレクトロニクス研究センター
	10:00 - 10:15	12a-A16-3	小型低損失8x8シリコン光スイッチモジュール	○中村 滋[1], 柳町 成行[1], 竹下 仁士[1], 田島 章雄[1], 樋野 智之[1], 加藤 友章[1], 福知 清[1]	1.NEC グリーンプラットフォーム研
	10:15 - 10:30	12a-A16-4	偏波ダイバーシティー4×4 光スイッチの作製	○鈴木 恵治郎[1], Kim Sang-Hun[1], 谷澤 健[1], Cong Guangwei[1], 池田 和浩[1], 並木 周[1], 河島 整[1]	1.産総研
	10:30 - 10:45	12a-A16-5	櫛形pn接合を搭載したフォトニック結晶小型シリコンQPSK変調器	○北條 恵子[1], 寺田 陽祐[1], 雛倉 陽介[1], 矢澤 直哉[1], 渡邊 友彦[1], 馬場 俊彦[1]	1.横国大・院工
	10:45 - 11:00	12a-A16-6	Siフォトニック結晶変調器のドーピング分布最適化による変調速度向上	○竹内 萌江[1], 寺田 陽祐[1], 馬場 俊彦[1]	1.横国大院工
	11:00 - 11:15		休憩/Break		
	11:15 - 11:30	12a-A16-7	Siフォトニック結晶光変調器の周波数特性	○寺田 陽祐[1], 竹内 萌江[1], 馬場 俊彦[1]	1.横国大院工
	11:30 - 11:45	12a-A16-8	Siフォトニック結晶マッハツェンダー光変調器における広い波長範囲での25 Gbps動作の検証	○雛倉 陽介[1], 寺田 陽祐[1], 馬場 俊彦[1]	1.横国大・院工
	11:45 - 12:00	12a-A16-9	歪SiGeインターリーブPN接合型光変調器の検討	○(B)武内 和治[1], 金 栄現[1], 竹中 充[1], 高木 信一[1]	1.東大工
	12:00 - 12:15	12a-A16-10	Si光変調器に向けた歪SiGe成長に関する検討	○野口 将高[1], 韓 在勲[2], 藤方 潤一[1], 中村 隆宏[1], 竹中 充[2]	1.PETRA, 2.東大
	12:15 - 12:30	12a-A16-11	歪SiGe層を用いた空乏化型Si光変調器の検討	○藤方 潤一[1], 野口 将高[1], 金 栄現[2], 高橋 重樹[1], 中村 隆宏[1], 竹中 充[2]	1.光電子融合基盤技術研究所, 2.東大

3月12日(木)　14:00 - 17:30					
	14:00 - 14:15	12p-A16-1	Ge/SiGeヘテロ接合アバランシェフォトダイオード	○(B)宮坂 祐司[1], 石川 靖彦[1], 開 達郎[2,3], 岡崎 功太[2,3], 武田 浩太郎[2,3], 土澤 泰[2,3], 山田 浩治[2,3], 和田 一実[1]	1.東大工, 2.NTT先端集積デバイス研, 3.NTTナノフォトニクスセンタ
	14:15 - 14:30	12p-A16-2	残留歪とマイクロ構造を用いたSOI上Ge成長膜の2軸伸張歪の増強	○石田 悟己[1], 加古 敏[1,2], 小田 克矢[3], 井戸 立身[3], 岩本 敏[1,2], 荒川 泰彦[1,2]	1.東大生研・先端研, 2.東大ナノ量子機構, 3.日立中研
	14:30 - 14:45	奨 12p-A16-3	熱酸化を用いた表面不活性化による引っ張り歪みGe on Siの発光強度増大	○(M2)高林 昂紀[1], 徐 学俊[1], 澤野 憲太郎[1], 丸泉 琢也[1]	1.都市大総研
	14:45 - 15:00	12p-A16-4	伸張歪ゲルマニウムにおける間接Lバレー端の円偏光蛍光	○松下 智昭[1], 安武 裕輔[1,2], 揖場 聡[3], 齋藤 秀和[3], 湯浅 新治[3], 深津 晋[1]	1.東大院総合, 2.JST さきがけ, 3.産総研
	15:00 - 15:15	12p-A16-5	Geの顕微フォトルミネセンスにおける励起光強度密度の影響	○(B)東垂水 直樹[1], 石川 靖彦[1]	1.東大工
	15:15 - 15:30	E 12p-A16-6	Study of Thermal Annealing Effect on Smartcut Ge-on-Insulator Substrate	○Jian Kang[1,2], Xiao Yu[1,2], Mitsuru Takenaka[1,2], Shinichi Takagi[1,2]	1.Tokyo Univ., 2.JST-CREST
	15:30 - 15:45	12p-A16-7	SOI上直接成長Geを用いたマイクロディスク共振器の作製と光学評価	○加古 敏[1,2], 石田 悟己[1], 小田 克矢[3], 斎藤 慎一[4], 井戸 立身[3], 荒川 泰彦[1,2]	1.東大生研・先端研, 2.東大ナノ量子機構, 3.日立中研, 4.サザンプトン大
	15:45 - 16:00	12p-A16-8	Si(111)基板上化学修飾ゲルマネンの作製	○安武 裕輔[1,2], 深津 晋[1]	1.東大院総合, 2.JSTさきがけ
	16:00 - 16:15		休憩/Break		
	16:15 - 16:30	E 12p-A16-9	Ridge-Type InAs/GaAs Quantum Dot Lasers on Silicon-on-Insulator Substrates by Metal-Stripe Bonding	○(D)YuanHsuan Jhang[1], Katsuaki Tanabe[2], Satoshi Iwamoto[1,2], Yasuhiko Arakawa[1,2]	1.IIS, Univ. Tokyo, 2.NanoQuine, Univ. Tokyo
	16:30 - 16:45	12p-A16-10	Si細線上へのInP系埋込みヘテロ構造の集積	○藤井 拓郎[1,2], 武田 浩司[1,2], 西 英隆[1,2], 長谷部 浩一[1,2], 礒塚 孝明[1,2], 山本 剛[1], 山田 浩治[1,2], 松尾 慎治[1,2]	1.NTT先端集積デバイス研, 2.ナノフォトニクスセンタ
	16:45 - 17:00	12p-A16-11	SOI光導波路上III-Vリングレーザ/光検出器の集積(I) ～周回モード制御～	○飯塚 紀夫[1], 大平 和哉[1], 上村 紘崇[1], 吉田 春彦[1], 江崎 瑞仙[1], 上村 浩[1], 栗田 洋一郎[1], 古山 英人[1]	1.PETRA
	17:00 - 17:15	12p-A16-12	SOI光導波路上III-Vリングレーザ/光検出器の集積(II)～反射戻り光制御～	○吉田 春彦[1], 大平 和哉[1], 上村 紘崇[1], 飯塚 紀夫[1], 江崎 瑞仙[1], 上村 浩[1], 栗田 洋一郎[1], 古山 英人[1]	1.PETRA
	17:15 - 17:30	12p-A16-13	InAs量子ドット光増幅器を用いた1.2mm帯シリコンフォトニック波長可変レーザ	○北 智洋[1], 山本 直克[2], 川西 哲也[2], 山田 博仁[1]	1.東北大工, 2.NICT

3.15 シリコンフォトニクス / Silicon photonics　ポスター講演

3月13日(金)　9:30 - 11:30					
		E 13a-P8-1	Bio Sensor Using Photonic Crystal Multi-Resonator	○(DC)Amrita Kumar Sana[1], Keita Honzawa[1], Yoshiteru Amemiya[1], Shin Yokoyama[1]	1.Hiroshima Univeristy
		奨 13a-P8-2	グラフェン集積シリコンリング共振器の方向性結合率調整による透過率向上	○小林 弓月[1], 高 磊[2,3], 土澤 泰[2,3], 井上 鈴代[3], 上野 祐子[4], 日比野 浩樹[4], 山本 剛[3], 山田 浩治[2,3], 中島 啓幾[1]	1.早大先進理工, 2.NTT ナノフォトセンタ, 3.NTT 先端集積デバイス研, 4.NTT物性科学基礎研
		13a-P8-3	Siリング共振器を用いた1Portグレーテイング光導波路屈折率センサー	○(M1)筒井 誠貴[1], 高久 寛基[1], 岡山 秀彰[1,2], 中島 啓幾[1]	1.早大先進理工, 2.沖電気工業
		13a-P8-4	主/副リング共振器を用いたグレーティング結合型Si光導波路屈折率センサー	○高久 寛基[1], 筒井 誠貴[1], 岡山 秀彰[1,2], 中島 啓幾[1]	1.早大先進理工, 2.沖電気工業
		13a-P8-5	Si細線導波路による偏波変換Braggグレーティングにおける1次モード回折に関する検討	○岡山 秀彰[1], 太縄 陽介[1], 佐々木 浩紀[1], 八重樫 浩樹[1]	1.沖電気
		13a-P8-6	Si細線導波路干渉器素子における多領域構造による特性設定の検討	○岡山 秀彰[1], 八重樫 浩樹[1], 佐々木 浩紀[1]	1.沖電気
		13a-P8-7	組み合わせリング共振器を用いたCバンド帯における狭帯域フィルタの解析	○横井 裕人[1], 三橋 頼人[1], 松島 裕一[2], 石川 浩[1], 宇高 勝之[1]	1.早大理工, 2.GCS機構
		13a-P8-8	浅いメサ導波路からなるシリコン反射交差導波路型2x2光スイッチの検討	○(M1)嶋田 裕介[1], 藤原 裕士[1], 松本 敦[3], 松島 裕一[2], 石川 浩[1], 宇高 勝之[1]	1.早大 理工, 2.早大 GCS機構, 3.情報通信研究機構
		13a-P8-9	波長可変なシリコンフォトニクス波長多重送信回路	○伊藤 寛之[1], 寺田 陽祐[1], 馬場 俊彦[1]	1.横浜国大

6 薄膜・表面 / Thin Films and Surfaces

6.1 強誘電体薄膜 / Ferroelectric thin films　ポスター講演

3月11日(水)　16:00 - 18:00					
		11p-P4-1	PLD法による$BiFeO_3$-$LaAlO_3$系薄膜の作製とその誘電特性	○泉 宏和[1], 吉村 武[2], 藤村 紀文[2]	1.兵庫工技セ, 2.阪府大院工
		11p-P4-2	RFマグネトロンスパッタ法による(100)$BiFeO_3$/(100)$LaNiO_3$ヘテロ構造の作製	○堂安 豪[1], 苅谷 健人[1], 荒牧 正明[1], 吉村 武[1], 藤村 紀文[1]	1.阪府大工
		11p-P4-3	$BiFeO_3$薄膜に用いる新規下部電極の検討	○荒牧 正明[1], 苅谷 健人[1], 堂安 豪[1], 吉村 武[1], 藤村 紀文[1]	1.府大院工
		11p-P4-4	ZnO単結晶基板上での$BiFeO_3$薄膜の成長	○(M1)小前 智也[1], 山田 裕明[1], 吉村 武[1], 藤村 紀文[1]	1.阪府大工
		11p-P4-5	$BiFeO_3$薄膜のドメインウォール幅(II)	坂本 広太[1], ○藤沢 浩訓[1], 中嶋 誠二[1], 清水 勝[1]	1.兵庫県大工
		11p-P4-6	アルコール系インクによるチタン酸ビスマス薄膜の作成	○柿元 信利[1], 山口 正樹[1]	1.芝浦工大工
		11p-P4-7	強相関系強誘電体$YMnO_3$薄膜の光誘起電流と分極反転の相関	宇賀 洋志[1], ○張 楽駿[1], 芦田 淳[1], 古川 喜彬[2], 中山 正昭[2], 藤村 紀文[1]	1.阪府大, 2.阪市大
		11p-P4-8	ハーフメタル/$Ba_xSr_{1-x}TiO_3$ヘテロ積層構造における歪み効果と電気的特性	○ソ ジョンミン[1], 許 方舟[1], 伊東 和徳[1], 羽尻 哲也[1], 植田 研二[1], 浅野 秀文[1]	1.名大院工
		11p-P4-9	PZT薄膜の縦方向圧電定数$d_{33,f}$と横方向圧電定数d_{31}の比較	○牧本 なつみ[1], 竹下 俊弘[2], 前田 龍太郎[1], 小林 健[1]	1.産総研, 2.九州大
		11p-P4-10	圧電応答顕微鏡を用いたP(VDF-TrFE)のナノスケール分極操作	○宝田 隼[1], 佐藤 宙樹[1], 古川 昭雄[1]	1.東理大理工

6.1 強誘電体薄膜 / Ferroelectric thin films　口頭講演

3月13日(金)　9:00 - 12:30

9:00 - 9:15	13a-A21-1	Ptナノコロイドを分散させた不均一$Pb(Zr,Ti)O_3$薄膜の微細組織と圧電特性	○松平 佳巳[1], 橋爪 洋一郎[1], 中嶋 宇史[1], 飯島 高志[2], 岡村 総一郎[1]	1.東理大理, 2.産総研
9:15 - 9:30	13a-A21-2	Pb過剰$(Pb,La)(Zr,Ti)O_3$薄膜の結晶粒巨大化とその電気特性評価	○倉持 裕介[1], 橋爪 洋一郎[1], 中嶋 宇史[1], 山本 孝[2], 岡村 総一郎[1], 飯島 高志[3]	1.東理大理, 2.防衛大, 3.産総研
9:30 - 9:45	奨 13a-A21-3	Zr/(Zr+Ti)比による$Pb(Zr,Ti)O_3$薄膜のドメイン制御	○一ノ瀬 大地[1], 中島 崇明[1], 江原 祥隆[1], 及川 貴弘[1], 清水 荘雄[1], 山田 智明[2,3], 舟窪 浩[1]	1.東工大, 2.名大, 3.PRESTO
9:45 - 10:00	奨 13a-A21-4	急冷法によってc軸配向させたSi基板上のPMnN-PZT単結晶薄膜の高温特性	○半澤 弘明[1], 吉田 慎哉[1], 和佐 清孝[2], 田中 秀治[1]	1.東北大, 2.横浜市立大
10:00 - 10:15	13a-A21-5	$Pb(Hf,Ti)O_3$薄膜の作製と圧電特性評価	○西尾 正悟[1], 黒川 文弥[1], 肥田 博隆[1], 神野 伊策[1]	1.神大院工
10:15 - 10:30		休憩/Break		
10:30 - 10:45	13a-A21-6	チタン酸バリウムナノキューブ規則配列マイクロパターン集積体の作製と評価	○三村 憲一[1], 加藤 一実[1]	1.産総研
10:45 - 11:00	13a-A21-7	(111) $Ba_{1-x}Ca_xTiO_3$/ZnOヘテロ構造の作製とその電気的特性	○山田 裕明[1], 吉村 武[1], 藤村 紀文[1]	1.阪府大院工
11:00 - 11:15	E 13a-A21-8	Development of 400° C operational relaxor ferroelectric based thin-film capacitor with exceptionally high stability	○Kumaragurubaran Somu[1], Takahiro Nagata[1], Kenichiro Takahashi[1,2], Sung-Gi Ri[1,2], Yoshifumi Tsunekawa[1,2], Setsu Suzuki[1,2], Toyohiro Chikyow[1]	1.NIMS, 2.COMET Inc.
11:15 - 11:30	13a-A21-9	化学溶液法により合成した$Bi_{0.5}Na_{0.5}TiO_3$強誘電体薄膜の特性に対するMnドープの影響	○坂本 渉[1], 牧野 成道[1], 飯島 高志[2], 余語 利信[1]	1.名大エコトピア研, 2.産総研つくば
11:30 - 11:45	13a-A21-10	巨大なc/a比を有する$BiFe_{1-x}Co_xO_3$薄膜の結晶構造と圧電特性の関係	○清水 啓佑[1], 北條 元[1], 東 正樹[1]	1.東工大応セラ研
11:45 - 12:00	13a-A21-11	新規非鉛強誘電体$Bi_2ZnTi_{1-x}Mn_xO_6$薄膜の育成	○富永 健[1], 北條 元[1], 清水 啓佑[1], 松田 奈瑠美[1], 東 正樹[1]	1.東工大応セラ
12:00 - 12:15	奨 13a-A21-12	単一ドメイン$BiFeO_3$薄膜の電気的特性にMn及びZnドープが及ぼす影響(III)	○(M1)重松 晃二[1], 中嶋 誠二[1], 藤沢 浩訓[1], 清水 勝[1]	1.兵庫県大工
12:15 - 12:30	13a-A21-13	$SrTiO_3$バイクリスタル基板上への$BiFeO_3$薄膜の作製	○瀬戸 翔太[1], 中嶋 誠二[1], 藤沢 浩訓[1], 清水 勝[1]	1.兵庫県大工

3月13日(金)　16:15 - 18:30

16:15 - 16:30	13p-A21-1	化学溶液堆積法によるHfO_2-ZrO_2極薄膜の作製と特性評価	阿部 千穂子[1], 塩川 真里奈[1], 白石 貴久[2], 清水 荘雄[2], 舟窪 浩[2], ○内田 寛[1]	1.上智大, 2.東工大
16:30 - 16:45	13p-A21-2	斜方晶相を含むエピタキシャルHfO_2基薄膜の結晶構造解析	○片山 きりは[1], 清水 荘雄[2], 横内 達彦[1], 白石 貴久[1], 及川 貴弘[1], 木口 賢紀[3], 赤間 章裕[3], 今野 豊彦[3], 内田 寛[4], 舟窪 浩[1,2]	1.東工大総理工, 2.東工大元素, 3.東北大金研, 4.上智大理工
16:45 - 17:00	13p-A21-3	電子強誘電体$YbFe_2O_4$エピタキシャル薄膜のキャリア伝導特性	○樫本 涼[1], 吉村 武[1], 芦田 淳[1], 藤村 紀文[1]	1.阪府大工
17:00 - 17:15	奨 13p-A21-4	ハードディスクドライブ型強誘電体記録装置における更なる高密度化とビット列の実時間再生	○青木 朋徳[1], 平永 良臣[1], 長 康雄[1]	1.東北大 通研
17:15 - 17:30	13p-A21-5	強誘電体プローブデータストレージ用PZT薄膜媒体の表面層のXPS測定	○平永 良臣[1], 陳 一桐[1], 長 康雄[1]	1.東北大通研
17:30 - 17:45	奨 13p-A21-6	圧電MEMSのためのスパッタ堆積による大口径Si基板上へのYSZバッファ層のエピタキシャル成長	○西澤 信典[1], 吉田 慎哉[1], 和佐 清孝[2], 田中 秀治[1]	1.東北大学, 2.横浜市立大学
17:45 - 18:00	13p-A21-7	有機強誘電体イミダゾールのブレードコート法による薄膜作製と物性	○(PC)野田 祐樹[1,2], 山田 寿一[1], 賀川 史敬[2,3], 小林 賢介[4], 熊井 玲児[2,4], 堀内 佐智雄[1,2], 長谷川 達生[1,2,5]	1.産総研FLEC, 2.JST-CREST, 3.理研CEMS, 4.KEK物構研PF, 5.東大工
18:00 - 18:15	13p-A21-8	PVDF系共重合高分子を用いた高誘電率・低損失コンデンサフィルム	○安藤 正彦[1], 吉本 尚起[1], 吉武 勇一郎[2], 加藤 修治[2], 児玉 秀和[3], 古川 猛夫[3], 田代 孝二[4]	1.日立中研, 2.日立日研, 3.小林理研, 4.豊田工大
18:15 - 18:30	13p-A21-9	高分子強誘電体VDF/TeFE共重合体薄膜の分極反転特性	○中川 佑太[1], 橋爪 洋一郎[1], 中嶋 宇史[1], 岡村 総一郎[1]	1.東理大理

3月14日(土)　9:00 - 12:00

9:00 - 9:15	E 14a-A21-1	Theoretical Analysis of Nonlinear Response in Vibrational Energy Harvesters	○Ali Mohamed Eltanany[1,2], Takeshi Yoshimura[1], Norifumi Fujimura[1], Nour Zaki Elsayed[2], Mohamed Refat Ebeid[2], Mohamed Galal Sayed Ali[2]	1.Osaka Pref. Univ., 2.Minia Univ.
9:15 - 9:30	奨 14a-A21-2	自励振動を利用した圧電薄膜気流振動発電素子	○辻浦 裕一[1], 諏訪 英作[1], 黒川 文弥[1], 肥田 博隆[1], 神野 伊策[1]	1.神大院工
9:30 - 9:45	14a-A21-3	水熱合成$(K,Na)NbO_3$膜を用いたフレキシブル圧電素子の作製と特性評価	○白石 貴久[1], 金子 祈之[1], 黒澤 実[1], 内田 寛[2], 鈴木 靖弘[3], 小林 健[3], 舟窪 浩[1]	1.東工大院, 2.上智大, 3.産総研
9:45 - 10:00	14a-A21-4	複数梁構造を有する圧電MEMS振動発電素子の振動解	○苅谷 健人[1], 吉村 武[1], 村上 修一[2], 藤村 紀文[1]	1.阪府大工, 2.阪府産技研
10:00 - 10:15	14a-A21-5	PVDF圧電ポリマーによるエレクトロクロミックセルの駆動	○鳥山 真[1], 中嶋 宇史[1], 橋爪 洋一郎[1], 岡村 総一郎[1]	1.東理大理
10:15 - 10:30		休憩/Break		
10:30 - 10:45	奨 14a-A21-6	強誘電体光起電力効果の増強に向けた界面設計 -$BiFeO_3$系キャパシタを例に-	○(D)松尾 拓紀[1], 北中 佑樹[1], 井上 亮太郎[1], 野口 祐二[1], 宮山 勝[1]	1.東大
10:45 - 11:00	14a-A21-7	$SrTiO_3$基板上に成長した単一ドメイン$BiFeO_3$薄膜の異常光起電力効果	○(B)高山 幸太[1]	1.兵庫県立大工
11:00 - 11:15	14a-A21-8	$(Bi,Pr)(Fe,Mn)O_3$強誘電体薄膜の分極誘起光起電力効果	○川畑 創[1], 川江 健[1], 森本 章治[1]	1.金沢大
11:15 - 11:30	14a-A21-9	強相関系強誘電体$YMnO_3$薄膜の光吸収および発光特性と それらの光誘起電流との相関	○宇賀 洋志[1], 芦田 淳[1], 吉村 武[1], 古川 喜彬[2], 中山 正昭[2], 藤村 紀文[1]	1.阪府大工, 2.阪市大工
11:30 - 11:45	奨 14a-A21-10	UV-LED光駆動の圧電薄膜アクチュエータの作製	○黒川 文弥[1], 大地 優平[1], 佐段田 温朗[1], 辻浦 裕一[1], 肥田 博隆[1], 神野 伊策[1]	1.神大院工
11:45 - 12:00	14a-A21-11	強誘電体薄膜における電気熱量効果の直接測定の検討	○松下 裕司[1], 吉村 武[1], 藤村 紀文[1]	1.阪府大

6.2 カーボン系薄膜 / Carbon-based thin films　口頭講演

3月11日(水)　13:15 - 18:00

	13:15 - 13:30	11p-C1-1	プラズマCVDを用いたダイヤモンド単結晶成長における基板温度変化と窒素添加効果	○山田 英明[1], 茶谷原 昭義[1], 杢野 由明[1]	1.産総研
	13:30 - 13:45	11p-C1-2	(001)面高濃度ボロンドープダイヤモンド成長のオフ角依存性	○(DC)川島 宏幸[1,2,3], 加藤 宙光[2,3], 小倉 政彦[2,3], 牧野 俊晴[2,3], 竹内 大輔[2,3], 山崎 聡[1,2,3]	1.筑波大, 2.産総研, 3.JST/CREST
	13:45 - 14:00	奨 11p-C1-3	X線回折法を用いたボロンドープ超伝導ダイヤモンド薄膜の臨界膜厚評価	○(B)柴田 将暢[1], 蔭浦 泰資[1], 山口 尚秀[2], 高野 義彦[2], 川原田 洋[1]	1.早大理工, 2.物材機構
	14:00 - 14:15	11p-C1-4	高濃度リンドープn型ダイヤモンド薄膜の評価	○(PC)大谷 亮太[1], 山本 卓[1], 小泉 聡[1]	1.物材機構
	14:15 - 14:30	11p-C1-5	シンクロトロンX線トポグラフィーによる(110)高温高圧合成ダイヤモンド単結晶の観察	○嘉数 誠[1], 村上 竜一[1], 桝谷 聡士[1], 植松 卓也[1], 角谷 均[2]	1.佐賀大院工, 2.住友電工
	14:30 - 14:45	奨・E 11p-C1-6	Direct observation and mechanism for enhanced electron emission sites in Pt ion implanted/post-annealed ultra nanocrystalline diamond films	○(PC)Kalpataru Panda[1], Eiichi Inami[1], K. J Sankaran[2], Yoshiaki Sugimoto[1], N-H Tai[2], I-Nan Lin[3]	1.Osaka Univ., 2.NTHU, 3.Tamkang Univ.
	14:45 - 15:00		休憩/Break		
	15:00 - 15:15	奨 11p-C1-7	格子状核発生領域を用いたダイヤモンドのヘテロエピタキシャル成長	○市川 公善[1], 児玉 英之[1], 鈴木 一博[2], 澤邊 厚仁[1]	1.青学大理工, 2.トウプラスエンジニアリング
	15:15 - 15:30	11p-C1-8	ダイヤモンド/立方晶窒化ホウ素(c-BN)薄膜ヘテロ構造成長	○平間 一行[1], 谷保 芳孝[1], 狩元 慎一[1], 山本 秀樹[1]	1.NTT物性研
	15:30 - 15:45	11p-C1-9	CVDダイヤモンド表面伝導層のバンドダイヤグラム：表面直下の下向きバンド曲がりの再確認	○河野 省三[1], 竹内 大輔[2], 児玉 英之[1], 澤邊 厚仁[1]	1.青山学院大理工, 2.産総研
	15:45 - 16:00	奨 11p-C1-10	ダイヤモンド基板の表面制御によるアプタマーを用いたATP検出	○(B)楢村 卓朗[1], スアエバ エヴィ[1], 明道 三穂[1], 小林 幹典[1], 稲葉 優文[1], 平岩 篤[1], 川原田 洋[1]	1.早大理工
	16:00 - 16:15		休憩/Break		
	16:15 - 16:30	11p-C1-11	(111)基板上へのアンサンブルNVセンターを含むダイヤモンド薄膜合成	○小澤 勇斗[1], 岩崎 孝之[1,2], 田原 康佐[1], 古山 聡子[1], 清水 麻希[1,2], 波多野 睦子[1,2]	1.東工大, 2.CREST
	16:30 - 16:45	11p-C1-12	ホモエピタキシャルダイヤモンド(111)薄膜中に形成されたNVセンターの配向度と極性	○寺地 徳之[1], Michl Julia[2], Zaiser Sebastian[2], Yakobi Ingmar[2], Waldherr Gerald[2], Dolde Florian[2], Neumann Philipp[2], Doherty Marcus[3], Manson Neil[3], Isoya Junichi[4], Wrachtrup Jorg[2]	1.物材機構, 2.シュツットガルト大, 3.オーストラリア国立大, 4.筑波大
	16:45 - 17:00	11p-C1-13	ダイヤモンド(111)基板における窒素-空孔複合欠陥の配向整列機構	○宮崎 剛英[1,2], 宮本 良之[1,2], 牧野 俊晴[1,3], 加藤 宙光[1,3], 山崎 聡[1,3], 福井 貴大[1,4], 土井 悠生[1,4], 徳田 規夫[5], 波多野 睦子[1,6], 水落 憲和[1,4]	1.JST-CREST, 2.産総研ナノシステム, 3.産総研エネルギー技術, 4.大阪大院基礎工, 5.金沢大理工, 6.東工大院理工
	17:00 - 17:15	11p-C1-14	リンドナーによるダイヤモンド NV 中心の電荷状態制御	○土井 悠生[1], 福井 貴大[1], 加藤 宙光[2,3], 牧野 俊晴[2,3], 山崎 聡[2,3], 田嶌 俊之[1], 森下 弘樹[1], 三輪 真嗣[1], Jelezko Fedor[4], 鈴木 義茂[1], 水落 憲和[1,3]	1.阪大基礎工, 2.産総研, 3.CREST, 4.ウルム大
	17:15 - 17:30	11p-C1-15	ダイヤモンドJFETの内部電界測定に向けたNVセンターの形成	○成木 航[1], 田原 康佐[1], 岩崎 孝之[1,3], 加藤 宙光[2,3], 牧野 俊晴[2,3], 小倉 政彦[2,3], 竹内 大輔[2,3], 山崎 聡[2,3], 波多野 睦子[1,3]	1.東工大, 2.産総研, 3.CREST
	17:30 - 17:45	11p-C1-16	ダイヤモンド選択成長によるNVセンターの集光率向上	○古山 聡子[1], 岩崎 孝之[1,2], 清水 麻希[1,2], 矢板 潤也[1], 小寺 哲夫[1,2], 波多野 睦子[1,2]	1.東工大, 2.CREST-JST
	17:45 - 18:00	11p-C1-17	イオン注入によるCVDダイアモンド膜へのSiVセンターの導入	○小副川 裕太[1], 中尾 基[1], 坪田 敏樹[1], 長町 信治[2]	1.九州工業大学, 2.株式会社長町サイエンスラボ

6.2 カーボン系薄膜 / Carbon-based thin films　ポスター講演

3月11日(水)　9:30 - 11:30

		11a-P4-1	高品質ダイヤモンド膜合成用廉価マイクロ波プラズマCVD装置の開発	○宮田 昌和[1], 毎田 修[1], 南光 正平[2], 伊藤 利道[1]	1.阪大院工, 2.ニッシン
		11a-P4-2	{111}リンドープダイヤモンド薄膜成長のオフ角依存性	○(PC)山本 卓[1], 小泉 聡[1]	1.物材機構
		11a-P4-3	高濃度ホウ素ドープ縮退ダイヤモンド薄膜における縮退領域の局在クラスター化とその積層	○田渕 智大[1], 毎田 修[1], 伊藤 利道[1]	1.阪大院工
		11a-P4-4	簡易リソプロセスを用いた≈1μm径の高品質柱状ダイヤモンド周期構造の作製とその粒子検出器への応用	○清水 彰人[1], 毎田 修[1], 伊藤 利道[1]	1.阪大院工
		11a-P4-5	Si基板上への高配向ボロンドープ・ダイヤモンドの選択成長	○(M1C)小宮 一輝[1], 市川 直斗[1], 小島 隆平[1], 相馬 勇治[1], 一色 秀夫[1]	1.電通大院先進理工
		11a-P4-6	ホウ素ドープCVDダイヤモンド薄膜における 過渡光容量法による結晶欠陥評価	○堀 敬憲[1], 毎田 修[1], 伊藤 利道[1]	1.阪大院工
		11a-P4-7	電子線誘起電流(EBIC)法によるダイヤモンドの欠陥位置の視覚化	○河野 省三[1], 寺地 徳之[2], 児玉 英之[1], 澤邊 厚仁[1]	1.青山学院大理工, 2.物材機構
		奨・E 11a-P4-8	Role of the oxygen interlayer on electrical properties of WC/p-diamond Schottky diodes	○(PC)Alexandre FIORI[1], Tokuyuki TERAJI[1], Jose PINERO[2], Daniel ARAUJO[2], Yasuo KOIDE[1]	1.NIMS, 2.University of Cadiz
		11a-P4-9	原子状Si誘起核発生により形成したナノ・ダイヤモンドからのSi-V中心発光	○小島 隆平[1], 市川 直斗[1], 小宮 一輝[1], 相馬 勇治[1], 一色 秀夫[1]	1.電通大院先進理工
		11a-P4-10	ダイヤモンドへの銀コーティング(2)	○(M1)井山 年明[1], 大島 龍司[1], 飯塚 完司[1]	1.日工大
		11a-P4-11	種々の炭化水素を原料として極低温合成したa-C:Hの物性評価	○齋藤 登之[1], 内藤 瑛慈[1], 小林 直樹[1], 佐藤 哲也[1]	1.山梨大医工総研
		奨 11a-P4-12	X線反射率法を用いたRFプラズマCVD成膜におけるDLC膜界面の分析	○針谷 達[1], 安岡 佑起[1], 古田 寛[1,2], 八田 章光[1,2]	1.高知工科大, 2.高知工科大ナノテクセンター
		11a-P4-13	アモルファス炭素膜の電気的特性に及ぼす安定同位体の影響	○鈴木 裕太郎[1], 鈴木 常生[2], 神田 一浩[3], 大竹 尚登[1], 赤坂 大樹[1]	1.東工大, 2.長岡技科大, 3.兵庫県立大
		奨 11a-P4-14	Excel上で動作する$sp^2/(sp^2+sp^3)$比算出のためのDLC薄膜のC-K端NEXAFSスペクトル用シミュレーションプログラムの開発	○高松 大樹[1,2]	1.兵庫県立大工, 2.高度研
		11a-P4-15	極低温合成a-C:F膜のマイクロスクラッチ試験による密着性評価	○曽我 遥華[1], 山井 孝太[1], 森川 恭兵[1], 佐藤 哲也[1], 中川 清和[1]	1.山梨大院医工総研
		11a-P4-16	PBII法により作製したヨウ素添加アモルファスカーボン薄膜への熱処理効果	○(M2)溝上 知広[1], 中尾 節男[2], 岸 直希[1], 曽我 哲夫[1]	1.名工大, 2.産総研

		11a-P4-17	Arのマイクロ波放電フローにおける有機ケイ素化合物の解離励起反応解析	○(M1)佐伯 駿介[1], 熊倉 基起[1], 伊藤 治彦[1]	1.長岡技科大工
		奨 11a-P4-18	アモルファス窒化炭素薄膜の光誘起体積変化における長時間光照射の影響	○原田 人萌[1], 青野 祐美[1], 北沢 信章[1], 渡邉 芳久[1]	1.防大材料

6.2 カーボン系薄膜 / Carbon-based thin films　口頭講演

3月12日(木)　9:00 - 11:45

	9:00 - 9:15	奨 12a-C1-1	ダイヤモンド上SiO_2ゲート絶縁膜の形成と評価	○(B)原 壮志[1], 袴田 知宏[1], 小野 和子[1], 瀬下 裕志[1], 林 佑哉[1], 平岩 篤[1], 川原田 洋[1]	1.早大理工
	9:15 - 9:30	奨 12a-C1-2	耐圧1600Vを超える高温ALD-Al_2O_3絶縁膜を用いた水素終端ダイヤモンドMOSFET	○(B)北林 祐哉[1], 山田 哲也[1], 許 徳琛[1], 坪井 秀俊[1], 斎藤 俊輝[1], 齊藤 達也[1], 松村 大輔[1], 平岩 篤[1], 川原田 洋[1]	1.早大理工
	9:30 - 9:45	奨 12a-C1-3	原子層堆積Al_2O_3-MOSキャパシタの高温電気的絶縁性に対するゲート電極材質の影響	○松村 大輔[1], 齊藤 達也[1], 平岩 篤[1], 川原田 洋[1]	1.早大理工
	9:45 - 10:00	奨 12a-C1-4	トレンチチャネルを有する C-H ダイヤモンド MOSFET	○斎藤 俊輝[1], 小林 幹典[1], 山田 哲也[1], 許 徳琛[1], 北林 祐哉[1], 松村 大輔[1], 坪井 秀俊[1], 稲葉 優文[1], 平岩 篤[1], 川原田 洋[1]	1.早大
	10:00 - 10:15	奨 12a-C1-5	(001)ダイヤモンド上MBE薄膜AlNのIn-Plane X線回折法による評価	○(B)林 佑哉[1], 小野 和子[1], 袴田 知宏[1], 平岩 篤[1], 川原田 洋[1]	1.早大理工
	10:15 - 10:30		休憩/Break		
	10:30 - 10:45	奨 12a-C1-6	(111)基板上の{1-10}面を接合面としたダイヤモンド横型p-n接合の作製	○佐藤 一樹[1], 岩崎 孝之[1,2,3], 清水 麻希[1,3], 加藤 宙光[3,4], 牧野 俊晴[3,4], 小倉 政彦[3,4], 竹内 大輔[3,4], 山崎 聡[3,4], 波多野 睦子[1,2,3]	1.東工大, 2.ALCA, 3.CREST, 4.産総研
	10:45 - 11:00	奨 12a-C1-7	ダイヤモンド横型p-n接合についてケルビンプローブフォース顕微鏡による 表面電位評価と内部構造との相関	○白田 和也[1,2], 竹内 大輔[2], 牧野 俊晴[2], 加藤 宙光[2], 小倉 政彦[2], 山崎 聡[1,2]	1.筑波大学数理, 2.産総研
	11:00 - 11:15	12a-C1-8	ダイヤモンドJFETのノーマリーオフ動作	○諏訪 泰介[1], 岩崎 孝之[1,2,3], 佐藤 一樹[1], 加藤 宙光[3,4], 牧野 俊晴[3,4], 小倉 政彦[3,4], 竹内 大輔[3,4], 山崎 聡[3,4], 波多野 睦子[1,2,3]	1.東工大, 2.ALCA, 3.CREST, 4.産総研
	11:15 - 11:30	12a-C1-9	ホッピング伝導層を用いたダイヤモンドp^+-i-n^+接合の電気特性	○牧野 俊晴[1,2], 桑原 大輔[1,2,3], 加藤 宙光[1,2], 竹内 大輔[1,2], 小倉 政彦[1,2], 大串 秀世[1,2], 山崎 聡[1,2,3]	1.産総研エネ部門, 2.CREST/JST, 3.筑波大
	11:30 - 11:45	奨 12a-C1-10	ダイヤモンドLEDにおける励起子発光の温度依存性	○(D)桑原 大輔[1,2,3], 牧野 俊晴[2,3], 加藤 宙光[2,3], 竹内 大輔[2,3], 小倉 政彦[2,3], 大串 秀世[2,3], 山崎 聡[2,3]	1.筑波大, 2.産総研, 3.CREST/JST

3月12日(木)　13:15 - 19:00

	13:15 - 13:30	12p-C1-1	ラマン解析より求めたダイヤモンドライクカーボンの形成要素	○鷹林 将[1], 楊 猛[3], 高桑 雄二[3], 高萩 隆行[2]	1.東北大・通研, 2.広島大・先端研, 3.東北大・多元研
	13:30 - 13:45	12p-C1-2	ダイヤモンドライクカーボン薄膜の耐熱性向上に関する分光学的解析	○鷹林 将[1], 高萩 隆行[2]	1.東北大・通研, 2.広島大・先端研
	13:45 - 14:00	12p-C1-3	高周波マグネトロンスパッタリング法により堆積したアモルファス状炭素膜の構造と光学定数	○荒川 悟[1], 中谷 恭之[1], 周 小龍[1], トゥンミー サラユット[1], 小松 啓志[1], 大塩 茂夫[1], 齋藤 秀俊[1]	1.長岡技科大
	14:00 - 14:15	E 12p-C1-4	The chemical information evaluation of hydrogenated amorphous carbon films by XPS and NEXAFS at different thicknesses	○(D)Sarayut Tunmee[1], Ratchadaporn Supruangnet[2], Hideki Nakajima[2], Xiaolong Zhou[1], Yasuyuki Nakaya[1], Satoru Arakawa[1], Keiji Komatsu[1], Shigeo Ohshio[1], Kazuhiro Kanda[3], Hidetoshi Saitoh[1]	1.Nagaoka Univ. Tech., 2.SLRI, 3.LASTI, Univ. of Hyogo
	14:15 - 14:30	12p-C1-5	熱CVDアモルファスカーボンの低温成膜技術	○北村 昌幸[1], 水永 覚[1], 清水 亮[1], 柿本 明修[1], 早川 欣延[2], 濱田 康弘[3]	1.東京エレクトロン東北, 2.東京エレクトロン宮城, 3.東京エレクトロン
	14:30 - 14:45	奨 12p-C1-6	フィルタードアーク蒸着においてDCバイアスで成膜したDLC膜の諸特性	○藤井 裕真[1], 今井 貴大[1], 宮本 優[1], 須田 善行[1], 滝川 浩史[1], 田上 英人[2], 神谷 雅男[3], 瀧 真[4], 長谷川 祐史[4], 辻 信広[4], 金子 智[5], 安井 治之[6], 國次 真輔[7], 川口 雅弘[8], 三浦 健一[9]	1.豊橋技科大, 2.北九州高専, 3.伊藤光学, 4.オンワード技研, 5.神奈川県産技セ, 6.石川工試, 7.岡山県工技セ, 8.東京都産技研, 9.大阪府産技研
	14:45 - 15:00		休憩/Break		
	15:00 - 15:15	E 12p-C1-7	Formation of popcorn-like nanostructure in C_{60}-incorporated DLC by exposing to H_2O vapor	○(DC)Wei Xie[1], Aiko Kawahito[1], Takashi Yanase[1], Taro Nagahama[2], Toshihiro Shimada[2]	1.Graduate School of Chemical Sciences and Engineering, Hokkaido University, 2.Hokkaido University
	15:15 - 15:30	12p-C1-8	変調SiO2基板上へのグラフェン成膜と特性評価に関する研究	○今村 友紀[1], 伊崎 貴生[1], 西口 博樹[1], 松尾 経太[1], 松川 誠也[1], 吉岡 昌雄[2], 久保田 弘[1,2]	1.熊大院自, 2.熊大工
	15:30 - 15:45	奨 12p-C1-9	ホットメッシュ堆積法によるペンタセン系有機膜の形成	○(M1)平野 竣[1], 部家 彰[1], 松尾 直人[1]	1.兵庫県立大院工
	15:45 - 16:00	12p-C1-10	硬質炭素膜のSRV摩擦摩耗試験機を用いたはく離特性評価に及ぼす膜厚の影響	○大花 継頼[1], 間野 大樹[1], 中村 挙子[1]	1.産総研
	16:00 - 16:15	12p-C1-11	酸素プラズマ処理によるDLCの表面改質	○(B)河内 佑太[1], 大越 康晴[1], 本間 章彦[1], 平栗 健二[1], 荒船 龍彦[1], 野口 展士[1]	1.東京電機大
	16:15 - 16:30	奨 12p-C1-12	軟X線照射によるSi含有水素化DLC膜の体積変化	○田中 祥太郎[1], 今井 亮[1], 岡田 真[1], 松井 真二[1], 神田 一浩[1]	1.兵庫県大高度研
	16:30 - 16:45		休憩/Break		
招待	16:45 - 17:45	12p-C1-13	**「薄膜・表面 分科内招待講演」(60分) DLC膜の現在と将来展望**	**○大竹 尚登[1]**	**1.東工大**
	17:45 - 18:00	12p-C1-14	N_2とアセトニトリルの混合気体マイクロ波放電フローで生成するa-CN_x:H薄膜の窒素源	○(M1)茂木 紳令[1], 津留 紘樹[1], 伊藤 治彦[1]	1.長岡技科大工
	18:00 - 18:15	奨 12p-C1-15	アモルファス窒化炭素薄膜の柱状構造がガス応答性に及ぼす影響	○田村 尚之[1], 青野 祐美[1], 北沢 信章[1], 渡邉 芳久[1]	1.防大材料
	18:15 - 18:30	12p-C1-16	スーパーマグネトロンプラズマによる電界放出用a-CNx:H/Al膜の作製	○木下 治久[1], 鈴木 昌[1], 田口 亮平[1], 竹内 宏樹[1]	1.静大院工
	18:30 - 18:45	奨 12p-C1-17	グアニジン炭酸塩を用いたグラファイト状窒化炭素薄膜の合成とその基礎的評価	○藤田 詩織[1], 羽渕 仁恵[1], 髙木 俊作[1], 滝川 浩史[2]	1.岐阜高専, 2.豊橋技科大
	18:45 - 19:00	E 12p-C1-18	Large area synthesis of hexagonal boron nitride (hBN) with controlled thickness and crystal shape	○(D)Subash Sharma[1], Golap Kalita[1], Masaki Tanemura[1]	1.Nagoya Inst of Tech

6.3 酸化物エレクトロニクス / Oxide electronics　口頭講演

3月11日(水)　9:00 - 11:45

	9:00 - 9:15	11a-D10-1	対向ターゲット反応性スパッタ法によるp形NiO薄膜作製とCdTe太陽電池応用	○古谷 靖明[1], 荒木 涼一[1], 小川 洋平[2], 細野 藍響[2], 野本 隆宏[1], 石川 亮佑[1], 保 岡本[2], 望 坪井[1]	1.新潟大学, 2.木更津高専
	9:15 - 9:30	11a-D10-2	RFリアクティブスパッタ堆積したLi添加NiO薄膜の正孔濃度制御	○中井 洋志[1], 前田 亮[1], 小笠原 愛理[1], 森山 和眞[1], 川出 大佑[1], 秩父 重英[2], 杉山 睦[1]	1.東京理科大学 理工学部/総合研究機構, 2.東北大学 多元物質科学研究所
	9:30 - 9:45	11a-D10-3	熱酸化p形Cu_2Oシートの電気的特性に対するNa添加の影響	○宮田 俊弘[1], 西 祐希[1], 南 内嗣[1]	1.金沢工大
	9:45 - 10:00	11a-D10-4	P形Na添加Cu_2Oベースヘテロ接合太陽電池	○西 祐希[1], 宮田 俊弘[1], 南 内嗣[1]	1.金沢工大 OEDS R&D センター
	10:00 - 10:15	11a-D10-5	複合ターゲットスパッタリングによるMgO単結晶基板を用いた$Ni_xMg_{1-x}O$系紫外線フォトコンダクタの作製と評価	○西谷 拓樹[1]	1.関大シス理
	10:15 - 10:30		休憩/Break		
	10:30 - 10:45	11a-D10-6	電気化学堆積法によるCu_2O/GaNヘテロ構造の形成と特性評価	○熊崎 祐介[1], 近江 沙也夏[1], 谷田部 然治[1], 佐藤 威友[1]	1.北大量集セ
	10:45 - 11:00	11a-D10-7	TiO_2超微粒子の軟X線照射によるNEXAFSスペクトル形状の回復	○新部 正人[1], 佐野 桂治[1], 川上 烈生[2], 中野 由崇[3]	1.兵庫県大高度研, 2.徳島大院工, 3.中部大工
	11:00 - 11:15	11a-D10-8	酸化鉄ナノチューブアレイを用いた気相メタノール光触媒分解	太田 貴洋[1], ○野田 啓[1]	1.慶應大理工
	11:15 - 11:30	11a-D10-9	光触媒チタンアパタイトによる液相中有機物の吸着分解	○穴澤 俊久[1], 若村 正人[1], 今中 佳彦[1], 塚田 峰春[1]	1.富士通研
	11:30 - 11:45	11a-D10-10	Modulation of band gap in SnO by controlling interlayer Sn-Sn lone pair interaction	○梅澤 直人[1]	1.物材機構

3月11日(水)　13:15 - 17:45

招待	**13:15 - 13:30**	**11p-D10-1**	**「講演奨励賞受賞記念講演」(15分) パイロクロア型Ir酸化物の磁気ドメイン境界における磁気輸送現象**	**○藤田 貴啓[1], 佐野 航[1], 打田 正輝[1], 小塚 裕介[1], 塚崎 敦[2,3], 有馬 孝尚[4,5], 川﨑 雅司[1,5]**	**1.東大院工, 2.東北大金研, 3.JSTさきがけ, 4.東大新領域, 5.理研CEMS**
	13:30 - 13:45	奨 11p-D10-2	パイロクロア型Ir酸化物薄膜の磁気ドメイン制御と局所輸送特性	○小川 翔平[1], 藤田 貴啓[1], 打田 正輝[1], 小塚 裕介[1], 塚崎 敦[2,3], 有馬 孝尚[4,5], 川﨑 雅司[1,5]	1.東大院工, 2.東北大金研, 3.JSTさきがけ, 4.東大新領域, 5.理研CEMS
	13:45 - 14:00	奨 11p-D10-3	ダブルペロブスカイト型Sr_2CoRuO_6の薄膜合成と物性	○渡会 啓介[1], 吉松 公平[1], 大島 孝仁[1], 大友 明[1,2]	1.東工大院理工, 2.元素戦略
	14:00 - 14:15	奨 11p-D10-4	トポタクティック酸化・還元法によるAサイト秩序型ペロブスカイト$YBaCo_2O_x$ ($x = 4.5-6$)エピタキシャル薄膜の作製	○(DC)片山 司[1], 近松 彰[1,2], 福村 知昭[1,2], 長谷川 哲也[1,2,3]	1.東大院理, 2.JST-CREST, 3.KAST
	14:15 - 14:30	奨 11p-D10-5	スピネル型フェライト$(Fe,Ti)_3O_4$薄膜のキャリア極性制御	○山原 弘靖[1], 足立 真輝[1], 高橋 雅尚[1], 関 宗俊[1], 堀場 弘司[2], 組頭 広志[2], 田畑 仁[1]	1.東大工, 2.高エネ研
	14:30 - 14:45	奨 11p-D10-6	フタロシアニン系金属錯体を用いた遷移金属酸化物薄膜のMBE合成	○清水 亮太[1], 白木 将[1], 一杉 太郎[1,2]	1.東北大AIMR, 2.JST-さきがけ
	14:45 - 15:00	奨 11p-D10-7	マルチフェロイック$BiFe_{1-x}Co_xO_3$薄膜のスピン構造変化	○川邊 諒[1], 北條 元[1], 山本 孟[1], 清水 啓佑[1], 壬生 攻[2], 東 正樹[1]	1.東京工業大学応セラ, 2.名工大工
	15:00 - 15:15	奨 11p-D10-8	$Ca_xSm_{1-x}TiO_3$エピタキシャル薄膜の作製と電気特性評価	○(B)岡部 宏和[1], 吉松 公平[1], 大島 孝仁[1], 大友 明[1,2]	1.東工大院理工, 2.元素戦略
	15:15 - 15:30	奨 11p-D10-9	有機金属ガス源分子線エピタキシー法による$Eu_{1-x}La_xTiO_3$薄膜の高移動度化と異常ホール効果	○(M2C)村田 智城[1], 高橋 圭[2], 松原 雄也[2,3], 打田 正輝[1], 小塚 裕介[1], 川﨑 雅司[1,2]	1.東大院工, 2.理研CEMS, 3.東北大金研
	15:30 - 15:45		休憩/Break		
	15:45 - 16:00	11p-D10-10	パルスレーザー蒸着法を用いた$Nd_3Fe_5O_{12}$薄膜作製とその磁気特性	○那須 英和[1], 足立 真輝[1], 山原 弘靖[1], 関 宗俊[1], 田畑 仁[1]	1.東大工
	16:00 - 16:15	11p-D10-11	P型透明酸化物半導体Si:FeOのエピタキシャル薄膜の形成	○関 宗俊[1], シャモハディ アミン[1], 高橋 雅尚[1], 足立 真輝[1], 那須 英和[1], 山原 弘靖[1], 田畑 仁[1]	1.東大工
	16:15 - 16:30	11p-D10-12	$Lu_3Fe_{5-2x}Co_xSi_xO_{12}$薄膜におけるリエントラントクラスターグラス特性	○足立 真輝[1], 那須 英和[1], 山原 弘靖[1], 関 宗俊[1], 松井 裕章[1], 田畑 仁[1]	1.東大院工
	16:30 - 16:45	11p-D10-13	$SrRu_{0.5}Cr_{0.5}O_3$エピタキシャル薄膜の作製及び物性評価	○山田 佳補[1], 近松 彰[1,2], 重松 圭[1], 福村 知昭[1,2], 長谷川 哲也[1,2,3]	1.東大理, 2.JST-CREST, 3.KAST
	16:45 - 17:00	11p-D10-14	強磁性金属/r面配向Cr_2O_3積層膜の磁気特性	○隅田 貴士[1], 橋本 浩介[1], 中村 拓未[1], 渡部 雄太[1], 永田 知子[1], 高瀬 浩一[1], 山本 寛[1], 岩田 展幸[1]	1.日大理工
	17:00 - 17:15	11p-D10-15	$BiFe_{1-x}Mn_xO_3$擬ペロブスカイト系薄膜および人工超格子の結晶構造と電気的磁気的特性	○稲葉 隆哲[1], 渡部 雄太[1], 大島 佳祐[1], 及川 貴大[1], 王 春[1], 宋 華平[1], 永田 知子[1], 橋本 拓也[2], 高瀬 浩一[1], 山本 寛[1], 岩田 展幸[1]	1.日大理工, 2.日大文理
	17:15 - 17:30	11p-D10-16	酸化物-金属界面結合予測ソフト:InterChemBond	○吉武 道子[1]	1.物材機構
	17:30 - 17:45	11p-D10-17	有機金属熱分解(MOD)法による$LaMnO_3$薄膜の作製とその電気伝導特性	○祐本 美久[1], 牧野 壱[1], 小堀 裕己[1], 山崎 篤志[1], 谷口 年史[2], 清水 哲夫[3]	1.甲南大理工, 2.阪大院理, 3.産総研

3月12日(木)　9:00 - 11:45

	9:00 - 9:15	12a-D10-1	Niプルシャンブルー類似体における高速インターカレーション	○(PC)柴田 恭幸[1], 濱口 純[1], 守友 浩[1,2]	1.筑波大数理, 2.筑波大CiRfSE
	9:15 - 9:30	12a-D10-2	P2型Na_xCoO_2薄膜電極の放電曲線のレート依存性	○柳田 歩[1], 柴田 恭幸[1], 小林 航[1,2], 守友 浩[1,2]	1.筑波大数理, 2.筑波大 CiRfSE
	9:30 - 9:45	12a-D10-3	全固体リチウム電池の酸化物電解質/電極界面におけるイオン伝導特性	○白木 将[1], 春田 正和[2], 鈴木 竜[1], 高木 由貴[1], 清水 亮太[1], 一杉 太郎[1]	1.東北大AIMR, 2.同志社大
	9:45 - 10:00	奨 12a-D10-4	酸化物ヘテロ界面における室温近傍での酸素イオン伝導	○平井 慧[1], 菅 大介[1], 市川 能也[1], 麻生 亮太郎[1], 倉田 博基[1,2], 島川 祐一[1,2]	1.京大化研, 2.JST-CREST
	10:00 - 10:15	奨 12a-D10-5	2元スパッタリング法で作製したInSiO系チャネル材料の電気特性	○(M1)栗島 一徳[1,2], 生田目 俊秀[2], 三苫 伸彦[2], 木津 たきお[2], 塚越 一仁[2], 澤田 朋実[2], 大井 暁彦[2], 山本 逸平[2,3], 大石 知司[3], 知京 豊裕[2], 小椋 厚志[1]	1.明治大, 2.物材機構 WPI-MANA, 3.芝浦工大
	10:15 - 10:30		休憩/Break		
	10:30 - 10:45	奨 12a-D10-6	高移動度β-Ga_2O_3(201)単結晶を用いたショットキーバリアダイオードの作製	○(B)古賀 優太[1], 原田 和也[1], 大石 敏之[1], 嘉数 誠[1]	1.佐賀大院工
	10:45 - 11:00	奨 12a-D10-7	ワイドバンドギャップ半導体ZnInONをi層に用いたpin太陽電池の作製	○松島 宏一[1], 清水 僚太[1], 井手 智章[1], 山下 大輔[1], 徐 鉉雄[1], 古閑 一憲[1], 白谷 正治[1], 板垣 奈穂[1,2]	1.九州大学, 2.JSTさきがけ

	11:00 - 11:15	奨 12a-D10-8	配向を制御したα-Fe_2O_3薄膜のインピーダンス測定評価	○(D)増子 尚徳[1], 吉松 公平[1], 大島 孝仁[1], 大友 明[1,2]	1.東工大院理工, 2.元素戦略
	11:15 - 11:30	奨 12a-D10-9	パルスレーザー堆積法による α-PbO/$SrTiO_3$エピタキシャルヘテロ接合の作製と光電子物性	○真島 英司[1], 小塚 裕介[1], 打田 正輝[1], 川崎 雅司[1,2]	1.東大院工, 2.理研CEMS
	11:30 - 11:45	12a-D10-10	強誘電抵抗スイッチングにおける終端表面依存性	○山田 浩之[1,2], 福地 厚[1], 小林 正起[3], 長井 拓郎[4], 豊崎 喜精[1], 組頭 広志[3], 澤 彰仁[1]	1.産総研, 2.JSTさきがけ, 3.KEK, 4.NIMS
	3月13日(金) 9:00 - 11:45				
	9:00 - 9:15	13a-D10-1	$SrTiO_3$−イオン液体界面におけるキャリア蓄積のメカニズム	○清水 直[1], 小野 新平[1,2], 畑野 敬史[3], 岩佐 義宏[1,4], 十倉 好紀[1,4]	1.理研 CEMS, 2.電中研, 3.名大工, 4.東大工
	9:15 - 9:30	奨 13a-D10-2	様々な電解液を用いた$SrTiO_3$の電場誘起金属絶縁体転移	○佐藤 洋平[1], 土井 聖将[1], 上野 和紀[1]	1.東大院総合
	9:30 - 9:45	E 13a-D10-3	Electrostatic Carrier Doping to $KTaO_3$ Using Organic Parylene-C/High-k Oxide Hybrid Gate Insulator	○TINGTING WEI[1,2], Kohei Fujiwara[1], Hidekazu Takana[1]	1.ISIR Osaka Univ., 2.Kunming Sci Tech Univ
	9:45 - 10:00	奨 13a-D10-4	ペロブスカイト型WO_3薄膜の作製とキャリアドーピング	○西早 辰一[1], 打田 正輝[1], 小塚 裕介[1], 岩佐 義宏[1,2], 川崎 雅司[1,2]	1.東大工, 2.理研CEMS
	10:00 - 10:15	奨 13a-D10-5	電気化学的Li挿入によるWO_3エピタキシャル薄膜の金属化	○相馬 拓人[1], 吉松 公平[1], 丹羽 三冬[1], 大島 孝仁[1], 大友 明[1,2]	1.東工大院理工, 2.元素戦略
	10:15 - 10:30		休憩/Break		
	10:30 - 10:45	13a-D10-6	全固体エレクトロクロミックWO_3薄膜トランジスタ	○廣野 未沙子[1], 片瀬 貴義[2], 太田 裕道[2]	1.北大工, 2.北大電子研
	10:45 - 11:00	13a-D10-7	全固体$SrCoO_{3-d}$強磁性薄膜トランジスタ	○鈴木 雄喜[1], 片瀬 貴義[2], 太田 裕道[2]	1.北大工, 2.北大電子研
	11:00 - 11:15	13a-D10-8	サイドゲート型トランジスタを用いた電界効果によるVO_2ナノワイヤへの水素イオンドープと拡散の時空間解析	○(M2)佐々木 翼[1], 神吉 輝夫[1], 田中 秀和[1]	1.阪大産研
	11:15 - 11:30	13a-D10-9	TiO_2固体絶縁膜を用いたVO_2モットトランジスタの動作機構の研究	○矢嶋 赳彬[1,2], 西村 知紀[1,2], 鳥海 明[1,2]	1.東大, 2.JST-CREST
	11:30 - 11:45	13a-D10-10	$LaVO_xN_y$エピタキシャル薄膜の電気輸送特性及び光学特性	○佐野 真仁[1,3], 廣瀬 靖[1,2,3], 中尾 祥一郎[2,3], 福村 知昭[1,2,3], 長谷川 哲也[1,2,3]	1.東大院理, 2.JST-CREST, 3.KAST
	3月13日(金) 16:30 - 19:00				
	16:30 - 16:45	13p-D10-1	酸化物界面双極子を用いたPt/anatase TiO_2ショットキー障壁の制御	○疋田 育之[1], 立川 卓[1,2], 簑原 誠人[1,3], ベルクリストファー[1,4], ファン ハロルド[1,5]	1.SLAC, 2.東大新領域, 3.高エネ研, 4.プリストル大, 5.スタンフォード大
	16:45 - 17:00	奨 13p-D10-2	スピントロニクス応用に向けた遷移金属/Nb:$SrTiO_3$界面の接触抵抗制御	○(D)井上 悠[1], Adrian Swartz[1], 立川 卓[2,3], 疋田 育之[2], Harold Hwang[1,2]	1.スタンフォード大, 2.SLAC国立加速器研, 3.東大新領域
	17:00 - 17:15	13p-D10-3	$LaNiO_3$/$SrTiO_3$における界面ダイポールを用いたポテンシャル変調	○坂井 延寿[1], 堀場 弘司[1], 小林 正起[1], 簑原 誠人[1], 北村 未歩[1], 組頭 広志[1]	1.KEK-PF
	17:15 - 17:30	奨 13p-D10-4	ペロブスカイト酸化物$LaMnO_3$/$LaNiO_3$ヘテロ界面における電荷移動	○(DC)北村 未歩[1,2], 堀場 弘司[2], 小林 正起[2], 坂井 延寿[2], 簑原 誠人[2], 三橋 太一[2], 藤森 淳[3], 藤岡 洋[1], 組頭 広志[2]	1.東大生研, 2.高エネ研, 3.東大院理
	17:30 - 17:45	奨 13p-D10-5	パルスレーザー堆積法による新物質($[Bi_2O_2]_pRhO_2$)単結晶薄膜の作製	○大羽 健太[1], 打田 正輝[1], 大内 祐貴[1], 小塚 裕介[1], 川崎 雅司[1,2]	1.東大院工, 2.理研CEMS
	17:45 - 18:00	奨 13p-D10-6	バイアススパッタ法によるVO_2/Al_2O_3 (001)の転移特性制御と特異成長モードの発現	○(D)ヌルーハニス ピンティアズハン[1], 沖村 邦雄[1], 蘇 魁[1], ムスタファ ザグリウィ[2], 坂井 穣[2]	1.東海大院理工, 2.トゥール大GREMAN
	18:00 - 18:15	奨 13p-D10-7	VO_2/TiN/Si積層構造デバイスにおけるMHz帯発振	○(D)モハメッド シュルズ[1], 沖村 邦雄[1], 坂井 穣[2]	1.東海大院理工, 2.トゥール大GREMAN
	18:15 - 18:30	13p-D10-8	リン酸を用いたMgO基板の結晶異方性エッチング	○(M2)山崎 翔太[1], 神吉 輝夫[1], ペリグリーノ ルカ[2], マンカ ニコラ[2,3], マレー ダニエル[2,3], 田中 秀和[1]	1.阪大産研, 2.CNR-SPIN, 3.Genova Univ.
	18:30 - 18:45	13p-D10-9	高い絶縁破壊電界強度を持ったナノ構造セラミックス成膜技術	○渕田 英嗣[1], 時崎 栄治[1], 小澤 英一[1]	1.有限会社渕田ナノ技研
	18:45 - 19:00	13p-D10-10	白色発光を伴う化合物半導体/酸化物複合ナノワイヤの作製	○石川 史太郎[1], 日比 秀昭[2], 山本 直紀[3]	1.愛媛大院理工, 2.阪大院工, 3.東工大院理工

6.3 酸化物エレクトロニクス / Oxide electronics ポスター講演

	3月13日(金) 16:30 - 18:30				
		13p-P5-1	Nd:YAGレーザーの第4次高調波を用いた$SrTiO_3$薄膜の低温成長	○石川 竜介[1], 和田 雄太[1], 小野里 尚記[1], 中村 基訓[1], 篁 耕司[1]	1.旭川高専
		13p-P5-2	極薄Ta_2O_5膜の抵抗変化型メモリへの適用	○大野 武雄[1,2], 寒川 誠二[1,3]	1.東北大WPI-AIMR, 2.JSTさきがけ, 3.東北大流体研
		13p-P5-3	マイクロ波励起プラズマを用いたWO_3の形成と抵抗変化メモリへの応用	○(M1)高木 翔太[1], 荒井 哲司[1], 有元 圭介[1], 山中 淳二[1], 中川 清和[1], 高松 利行[2]	1.山梨大学, 2.株式会社SST
		13p-P5-4	抵抗変化メモリ(ReRAM)の導電性パス生成機構の検討 〜 NiOの様々な面方位の第一原理電子状態解析 〜	○(D)森山 拓洋[1,4], 山崎 隆浩[2], 大野 隆央[2,3], 岸田 悟[1,4], 木下 健太郎[1,4]	1.鳥取大工, 2.物材機構, 3.東大生産研, 4.TiFREC
		13p-P5-5	可視光透過型太陽電池の作製と評価	○佐藤 和弥[1], 山口 竜典[1], 金 相澈[1], 小室 修二[2], 趙 新為[1]	1.東理大理, 2.東洋大理工
		13p-P5-6	IrO_2薄膜における結晶性と電気抵抗率	○侯 秀一[1], 高橋 竜太[1], Lippmaa Mikk[1]	1.東大物性研
		13p-P5-7	ReRAMの発熱挙動観察	○上沼 睦典[1], 浦岡 行治[1]	1.奈良先端大
		13p-P5-8	p-Cu_2O/AlO_x/n-SiC pnダイオード構造の抵抗変化型不揮発性メモリ	○土屋 充沙[1], 山下 敦史[1], 塚本 貴広[1], 須田 良幸[1]	1.東京農工大
		13p-P5-9	Au/CuO_x/NiO_x/n-Si 2層金属酸化物構造の抵抗変化型不揮発性メモリ	○岩佐 太陽[1], 塚本 貴広[1], 須田 良幸[1]	1.東京農工大院工
		13p-P5-10	Pt担持TiO_2ハイブリッド薄膜を用いたリソグラフィプロセスII	猪岡 航介[1], ○前田 篤志[1], 松田 厚範[2]	1.府大高専, 2.豊橋技科大
		13p-P5-11	可視光透過型太陽電池に向けたGZO薄膜の作製と評価III	○金 相ちょり[1], 山口 竜典[1], 小室 修二[2], 趙 新為[1]	1.東理大理, 2.東洋大理工
		13p-P5-12	CdSe量子ドットを吸着した逆オパール構造TiO_2電極の光電変換特性-周期依存性-	○(B)廣中 基記[1], 常 進[1,3], 秋元 正哉[1], 豊田 太郎[1,3], 尾込 裕平[2,3], 早瀬 修二[2,3], 沈 青[1,3]	1.電通大先進理工, 2.九工大生命体工, 3.JST CREST
		13p-P5-13	増感型太陽電池への応用を目的とした水熱合成による単結晶TiO_2ナノロッド電極の作製と評価	○(B)梶 知史[1], 常 進[1,3], 秋元 正哉[1], 豊田 太郎[1,3], 尾込 裕平[2,3], 早瀬 修二[2,3], 沈 青[1,3]	1.電通大先進理工, 2.九工大生命体工, 3.JST CREST
		13p-P5-14	銅酸化物多孔膜とポリピロールの複合膜の構造制御と光蓄電池への応用	○(M1C)前田 大輝[1], 野見山 輝明[1], 堀江 雄二[1]	1.鹿児島大

		13p-P5-15	ペロブスカイト型酸窒化物光触媒$ATaO_2N$(A = Ca, Mg)における電子状態の構造依存性	○(M2)久保 綾子[1], Giacomo Giorgi[1], 山下 晃一[1,2]	1.東京大学大学院, 2.JST-CREST
		13p-P5-16	Fe_3O_4薄膜のDewettingプロセスの観察	○正能 大起[1], 高橋 竜太[1], 小沼 碧海[2], 丸山 伸伍[2], 松本 祐司[2], Jahangir Solmaz[3], Nagarajan Valanoor[3], Lippmaa Mikk[1]	1.東大物性研, 2.東北大院工, 3.UNSW

6.3 酸化物エレクトロニクス / Oxide electronics　口頭講演

3月14日(土)　9:30 - 11:45

9:30 - 9:45	14a-D10-1	RFバイアス三極スパッタ法におけるイオン照射を利用したO面, Zn面, a面およびm面ZnO薄膜の形成	○橋本 亮介[1], 高柳 真司[1], 柳谷 隆彦[2], 松川 真美[1]	1.同志社大学, 2.名工大
9:45 - 10:00	14a-D10-2	RFマグネトロンスパッタ法におけるZnOターゲット温度がc軸平行配向ZnO膜の形成に及ぼす影響	○高田 千裕[1], 高柳 真司[1], 柳谷 隆彦[2], 松川 真美[1]	1.同志社大, 2.名工大
10:00 - 10:15	14a-D10-3	ZnO/grapheneナノ複合体の作製とその電気的特性	○奥村 竜二[1], 高田 直也[1], 大久保 貴雅[1], 近藤 祐太[1], 市川 洋[1]	1.名工大
10:15 - 10:30	14a-D10-4	グラフェン上へのZnOナノロッドの直接成長	○奥村 竜二[1], 高田 直也[1], 大久保 貴雅[1], 近藤 祐太[1], 市川 洋[1]	1.名工大
10:30 - 10:45	14a-D10-5	抵抗変化メモリの低抵抗状態における残留抵抗の起源	○(D)森山 拓洋[1,2], 榎本 雄太郎[1], 岸田 悟[1,2], 木下 健太郎[1,2]	1.鳥取大工, 2.TiFREC
10:45 - 11:00	14a-D10-6	溶媒置換によるHfO_2導電性ブリッジメモリのスイッチング特性制御 2	○(M2)吉原 正人[1], 原田 晃典[1], 伊藤 敏幸[1], 岸田 悟[1,2], 木下 健太郎[1,2]	1.鳥取大工, 2.TiFREC
11:00 - 11:15	14a-D10-7	電子ビーム吸収電流(EBAC)法によるReRAMのメモリ動作領域の解析	○島 久[1], 秋永 広幸[1]	1.産総研ナノエレ部門
11:15 - 11:30	14a-D10-8	MOD法$BaTiO_3$薄膜の抵抗変化型メモリ特性向上の検討	○杉江 敏幸[1], 橋本 修平[1], 張 子洋[1], 山下 馨[1], 野田 実[1]	1.京工繊工芸
11:30 - 11:45	14a-D10-9	抵抗変化メモリ用MOD法$BaTiO_3$薄膜作製時焼成雰囲気が薄膜特性に与える影響	○橋本 修平[1], 杉江 敏幸[1], 張 子洋[1], 山下 馨[1], 野田 実[1]	1.京工繊工芸

3月14日(土)　13:00 - 14:45

13:00 - 13:15	E 14p-D10-1	Effects of the Oxide Film Density on the Resistive Switching Characteristics of Atomic Switches	○(P)Cedric Mannequin[1], Tohru Tsuruoka[1], Tsuyoshi Hasegawa[1], Masakazu Aono[1]	1.NIMS-WPI-MANA
13:15 - 13:30	14p-D10-2	高分子電解質を用いた原子スイッチ動作の温度依存性	○鶴岡 徹[1], モハパトラ ソーミャ[1], クリシュナン カーティック[1], 長谷川 剛[1], 青野 正和[1]	1.物材機構
13:30 - 13:45	奨 14p-D10-3	$AlFeO_3$エピタキシャル薄膜における抵抗スイッチング特性および負性抵抗現象	○(M2)韓 業飛[1], 瀬嵜 容丞[1], 安井 伸太郎[1], 谷山 智康[1], 伊藤 満[1]	1.東工大応セラ研
13:45 - 14:00	14p-D10-4	ノンポーラ型抵抗変化メモリの構造非対称性がリセット特性に及ぼす影響	○(M1)木村 康平[1], 小石 遼介[1], 河野 公紀[1], 岸田 悟[1,2], 木下 健太郎[1,2]	1.鳥大工, 2.TiFREC
14:00 - 14:15	奨 14p-D10-5	プレーナー型四端子抵抗変化メモリ(ReRAM)を用いたフィラメント物性の解析	○(M1)澤居 優圭[1], 高 相圭[1], 青木 智宏[1], 岸田 悟[1,2], 木下 健太郎[1,2]	1.鳥取大工, 2.TiFREC
14:15 - 14:30	奨 14p-D10-6	NiOを用いたReRAMのセミフォーミング後におけるコンダクタンスの温度依存性	○篠倉 弘樹[1], 西 佑介[1], 木本 恒暢[1]	1.京大院工
14:30 - 14:45	E 14p-D10-7	Active dislocations for resistance switching in $SrTiO_3$	○JUN CHEN[1], JIANYONG LI[2], SHUN ITO[3], SEKIGUCHI TAKASHI[1]	1.NIMS, 2.JST, 3.Tohoku Unvi.

6.4 薄膜新材料 / Thin films and New materials　口頭講演

3月11日(水)　9:00 - 11:45

9:00 - 9:15	11a-D8-1	(CH) ポリマーとAl_2O_3(0001)との反応によるAl_4C_3のエピタキシャル成長	大見 浩輔[1], 長谷川 幸樹[2], 柳瀬 隆[2], 長浜 太郎[2], ○島田 敏宏[2]	1.北大総化, 2.北大工
9:15 - 9:30	11a-D8-2	イオン液体ナノ薄膜における伝導度の温度依存性	○丸山 伸伍[1], 鳥屋部 果穂[1], 松本 祐司[1]	1.東北大院工
9:30 - 9:45	11a-D8-3	Pulsed laser deposition法を用いたLiH薄膜成長	○大口 裕之[1], 白木 将[2], 桑野 博喜[1], 折茂 慎一[2,3], 一杉 太郎[2]	1.東北大院工, 2.東北大AIMR, 3.東北大金研
9:45 - 10:00	11a-D8-4	Si(100)基板上の複合面方位CeO$_2$領域間の分離	○井上 知泰[1], 信田 重成[1]	1.いわき明星大科学技術
10:00 - 10:15	11a-D8-5	斜め入射堆積Ti薄膜の熱酸化による酸化チタン薄膜の作製	○星 陽一[1], 小林 信一[1], 北原 直人[1], 澤田 豊[1]	1.東京工芸大工
10:15 - 10:30		休憩/Break		
10:30 - 10:45	11a-D8-6	二次元非熱平衡プラズマを利用したSnO_2薄膜の形成	金指 翔大[1], 花井 利通[1], 丹 祐人[1], ○奥谷 昌之[1,2]	1.静岡大院工, 2.静岡大グリーン研
10:45 - 11:00	11a-D8-7	非平衡プラズマを用いたTiO_2膜の作成における雰囲気制御の影響	○増田 優貴[1], 丹 祐人[1], 金指 翔大[1], 奥谷 昌之[1,2]	1.静岡大院工, 2.静岡大グリーン研
11:00 - 11:15	11a-D8-8	Mg-Sn薄膜作製に及ぼすガラス基板表面の効果	○横山 達己[1], 西谷 幹彦[2], 森田 幸弘[2], 倉敷 哲生[1]	1.大阪大学, 2.パナソニック株式会社
11:15 - 11:30	11a-D8-9	室温でガラス化硬化するSiO2膜の封止スペース内形成	○歸山 敏之	
11:30 - 11:45	11a-D8-10	金属–EDTAの原料粒径を制御して合成した酸化物膜	白井 友之[1], 淡 エンキン[1], ○小松 啓志[1], 中村 淳[1,2], 大塩 茂夫[1], 齋藤 秀俊[1]	1.長岡技科大, 2.中部キレスト

3月12日(木)　9:00 - 11:45

9:00 - 9:15	12a-D8-1	Sr_2SiO_4ターゲットで作製したSr_2SiO_4膜組成のアニール温度依存性	○(M1)今西 啓司[1], 谷脇 将太[1], 馬野 光博[1], 堀田 育志[1,3], 吉田 晴彦[1,3], 新船 幸二[1,3], 小椋 厚志[2,3], 佐藤 真一[1,3]	1.兵庫県立大, 2.明治大, 3.JST-CREST
9:15 - 9:30	12a-D8-2	2種類のHigh-k材料とSiO_xを用いた三色超構造の作製	○三宅 省三[1], 豊嶋 祐樹[1], 上岡 聡史[1], 堀田 育志[1,3], 吉田 晴彦[1,3], 新船 幸二[1,3], 小椋 厚志[2,3], 佐藤 真一[1,3]	1.兵庫県立大, 2.明治大, 3.JST-CREST
9:30 - 9:45	12a-D8-3	$YAlO_3$(001)基板上でのCr_2O_3薄膜成長及び結晶構造解析	○橋本 浩佑[1], 隅田 貴士[1], 林 佑太郎[1], 中村 拓未[1], 永田 知子[1], 山本 寛[1], 岩田 展幸[1]	1.日大理工
9:45 - 10:00	12a-D8-4	[$CaFeO_x$/$LaFeO_3$]人工超格子の電気的磁気的特性	○大島 佳祐[1], 渡部 雄太[1], 及川 貴大[1], 稲葉 隆哲[1], 王 春[1], 宋 華平[1], 永田 知子[1], 高瀬 浩一[1], 橋本 拓也[2], 山本 寛[1], 岩田 展幸[1]	1.日大理工, 2.日大文理
10:00 - 10:15	12a-D8-5	$SmFe_7$薄膜のエピタキシーと窒化処理による磁気特性変化	○楠森 毅[1], 藤田 麻哉[1], 尾崎 公洋[1]	1.産総研中部
10:15 - 10:30		休憩/Break		

	10:30 - 10:45	12a-D8-6	PLD法を用いたサマリウム単酸化物薄膜の作製	○内田 悠[1], 神永 健一[1], 福村 知昭[1,2], 長谷川 哲也[1,2]	1.東大理化, 2.JST-CREST
	10:45 - 11:00	12a-D8-7	高耐熱抵抗材料を目指したFe_3O_4膜の合成と評価	○藤原 宏平[1], 坪田 智司[1], 田中 秀和[1]	1.阪大産研
	11:00 - 11:15	12a-D8-8	PLD法によるSi基板上へのLaVO$_3$薄膜の作製	○(M1)稲垣 遼[1], 近成 将[1], 堀田 育志[1], 佐藤 真一[1]	1.兵庫県立大
	11:15 - 11:30	12a-D8-9	バイアス印加スパッタ法によるVO_2(B)及びVO_2(M)の選択成長	○蘇 魁[1], NurulHanis BinitAzhan[1], 沖村 邦雄[1]	1.東海大院工
	11:30 - 11:45	12a-D8-10	$(Ti_{0.4}V_{0.6})O_2$薄膜におけるスピノーダル分解	○村岡 祐治[1], 大塚 翼[1], 寺嶋 健成[1], 脇田 高徳[1], 横谷 尚睦[1]	1.岡山大院自然
	3月12日(木)　13:15 - 18:30				
招待	**13:15 - 13:30**	**E 12p-D8-1**	**[Young Scientist Presentation Award Speech] (15min.) Thermoplasmonic control of Marangoni flow around a micro bubble**	**○Kyoko Namura[1,2], Kaoru Nakajima[1], Kenji Kimura[1], Motofumi Suzuki[1]**	**1.Kyoto Univ., 2.J S P S Research Fellow**
	13:30 - 13:45	E 12p-D8-2	Nanoscale measurements of the work function in nanocrystalline TiN and amorphous films by multimode scanning probe microscopy and spectroscopy	○Leonid Bolotov[1], Takashi Matsukawa[1], Koichi Fukuda[1], Meishoku Masahara[1], Tetsuya Tada[1]	1.AIST
	13:45 - 14:00	E 12p-D8-3	Measurements of absolute densities of Cu, Zn, Sn and S atoms in magnetron sputtering plasma employing a Cu_2ZnSnS_4 target	○Nayan Nafarizal[1,2], Koichi Sasaki[1]	1.Hokkaido Univ., 2.Univ. Tun Hussein Onn Malaysia
	14:00 - 14:15	E 12p-D8-4	Characterization of Thick AlN Templates Grown on Micro-circle Patterned-Si Substrates	○(P)Tinh Tran[1], Noritoshi Maeda[1], Shiro Toyoda[1], Hideki Hirayama[1]	1.RIKEN
	14:15 - 14:30	E 12p-D8-5	Low-temperature fabricating uniform and controllable ZnO Nanorods	○(DC)Shengwen Hou[1], Miyuki Nishino[1], Chaoyang Li[1]	1.Kochi Univ. Tech.
	14:30 - 14:45	E 12p-D8-6	Influence of N_2O doped buffer layer on the properties of ZnO thin films on glass substrates grown by catalytic-reaction-assisted chemical vapor deposition	Yuuki Ishidzuka[1], Yuuki Ohashi[1], Hironori Katagiri[2], Koichiro Oishi[2], Yasuhiro Tamayama[1], Takahiro Kato[1], ○Kanji Yasui[1]	1.Nagaoka Univ. Technol., 2.Nagaoka. Nat. Coll. Technol.
	14:45 - 15:00	E 12p-D8-7	Spinel Oxide Flexible Film Thermistors	○Tomohiko Nakajima[1], Tetsuo Tsuchiya[1]	1.AIST
	15:00 - 15:15	奨・E 12p-D8-8	Electron Transport Mechanism of Oxygen-doped Zinc Nitride Thin Films	○(D)Xiang Cao[1], Atsushi Sato[1], Yoshihiko Ninomiya[1], Naoomi Yamada[1]	1.Chubu Univ.
	15:15 - 15:30		休憩/Break		
招待	**15:30 - 15:45**	**奨 12p-D8-9**	**「薄膜・表面 分科内招待講演」(15分) 透明強磁性鉄薄膜**	**○千原 真志[1], 角谷 直紀[1], 藤本 亮祐[1], 中村 伊吹[1], 畑野 敬史[1], 飯田 和昌[1], 生田 博志[1]**	**1.名大工**
	15:45 - 16:00	奨 12p-D8-10	ストロンチウム置換ハイドロキシアパタイト薄膜の作製	○(B)齋藤 絢香[1], 橋本 典也[2], 西川 博昭[1]	1.近大生物理工, 2.大阪歯科大
	16:00 - 16:15	奨 12p-D8-11	パルスレーザ堆積法においてレーザビームの強度分布がハイドロキシアパタイト薄膜の化学組成に及ぼす影響	○(M1)長谷川 司[1], 橋本 典也[2], 西川 博昭[3]	1.近大院生物理工, 2.大阪歯科大, 3.近大生物理工
	16:15 - 16:30	奨 12p-D8-12	浸漬離膜すくい上げ法による多孔基板上への自立Au薄膜の作製	○宮本 優[1], 山野 将史[1], 藤井 裕真[1], 須田 善行[1], 滝川 浩史[1], 田上 英人[2], 西内 満美子[3], 榊 泰直[3], 近藤 公伯[3]	1.豊橋技科大, 2.北九州高専, 3.原子力機構
	16:30 - 16:45	奨 12p-D8-13	一軸圧縮下の熱処理による機能性酸化物薄膜の固相結晶化挙動	○野沢 靖久[1], 譚 ゴオン[1], 船迫 友之[1], 金子 智[2], 松田 晃史[1], 吉本 護[1]	1.東工大 総理工, 2.神奈川県産技セ
	16:45 - 17:00	奨 12p-D8-14	化学気相蒸着法による六角形NbS_2フレークの合成	○柳瀬 隆[1], 渡邊 翔[1], 翁 夢婷[1], 長浜 太郎[1], 島田 敏宏[1]	1.北大工
	17:00 - 17:15	奨 12p-D8-15	金属メッシュ配線への窒化Al系光吸収薄膜の応用検討	○志田 陽子[1], 越智 元隆[1], 後藤 裕史[1], 釘宮 敏洋[1], 奥野 博行[2], 金丸 守賀[2]	1.(株)神戸製鋼所, 2.(株)コベルコ科研
	17:15 - 17:30		休憩/Break		
	17:30 - 17:45	12p-D8-16	ミスト CVD 法による光透過性銅薄膜の作製	○上野 仁希[1], 池之上 卓己[1], 三宅 正男[1], 平藤 哲司[1]	1.京大院エネ科
	17:45 - 18:00	12p-D8-17	TiO_2光学薄膜の機械的特性	○羽尾 衛[1], 室谷 裕志[1]	1.東海大工
	18:00 - 18:15	12p-D8-18	アクリル基板上へ形成した光学薄膜の密着性の研究	○田島 直弥[1], 室谷 裕志[1], 松本 繁治[2], 本多 博光[2]	1.東海大工, 2.(株)シンクロン
	18:15 - 18:30	12p-D8-19	ランタンとチタンの複合酸化物(H4)光学薄膜の内部応力の経時変化	○中野 良太[1], 室谷 裕志[1]	1.東海大院工

6.4 薄膜新材料 / Thin films and New materials　　ポスター講演

3月13日(金)　16:30 - 18:30

		奨・E 13p-P6-1	Flexible flow through transition metal doped TiO_2 nanotubular film for photocatalytic applications	○(DC)Amir Abidov[1,2], Bunyod Allabergenov[1], Feiyi Xiao[1], Cuili Chu[1], Xing Jin[1], Yong Bae Kim[2], Min Kyu Song[4], Cho-Hyun Jeon[4], Hitoshi Habuka[3], Sungjin Kim[1]	1.Kumoh Nat. Inst. Tec, 2.Gumi Elec. Res. Inst, 3.Yokohama univ., 4.Korea Tex. Dev. Inst
		E 13p-P6-2	Comprehensive study about ZnO film growth on (001) Si substrate by rf-sputtering	○Dongcheol Oh[1], Kangbok Kim[1], Sooman Lee[1]	1.Defense Sci. & Tech. Hoseo University
		E 13p-P6-3	Electron transport of ZnO films on semi-insulating, p-type, and n-type (001) Si substrates	○Dongcheol Oh[1], Sooman Lee[1], Kangbok Kim[1]	1.Defense Sci. & Tech. Hoseo University
		13p-P6-4	ペチーニ法で作製したBi過剰$BiFeO_x$ターゲットを用いて成膜した$BiFeO_3$薄膜の作製と評価	○王 春[1], 大島 佳祐[1], 稲葉 隆哲[1], 宋 華平[1], 渡部 雄太[1], 永田 知子[1], 橋本 拓也[2], 高瀬 浩一[1], 山本 寛[1], 岩田 展幸[1]	1.日大理工, 2.日大文理
		13p-P6-5	$MoSi_2$-Si複合体薄膜の抵抗率とHall係数の温度依存性	木谷 僚介[1], ○下薗 宏祐[1], 佐藤 祐喜[1], 吉門 進三[1]	1.同志社大学理
		13p-P6-6	金属-EDTA錯体由来の急速加熱冷却に耐えうるY_2O_3膜の合成	外山 歩[1], 白井 友之[1], 佐藤 彰紀[1], 淡 エンキン[1], ○小松 啓志[1], 中村 淳[1,2], 戸田 育民[1], 大塩 茂夫[1], 村松 寛之[1], 齋藤 秀俊[1]	1.長岡技科大, 2.中部キレスト

6.5 表面物理・真空 / Surface Physics, Vacuum　　口頭講演

3月11日(水)　9:00 - 12:00

9:00 - 9:15	11a-D9-1	GaN系半導体を用いたNEA半導体フォトカソードの開発	○佐藤 大樹[1], 西谷 智博[3], 本田 善央[1], 天野 浩[1,2]	1.名大院工, 2.名大ARC, 3.名大SRC
9:15 - 9:30	11a-D9-2	コンパクト半導体フォトカソード電子銃の研究・開発	○西谷 智博[1], 佐藤 大樹[2], 天野 浩[2], 本田 善央[2], 田渕 雅夫[1], 岡田 育夫[1]	1.名大SRC, 2.名大院工
9:30 - 9:45	11a-D9-3	スピン偏極準安定原子線を用いた放出電子顕微鏡	○山内 泰[1], 倉橋 光紀[1], 鈴木 拓[1], 孫 霞[2], Pratt Andrew[3], 張 晗[1], 吉武 道子[1]	1.物材機構, 2.中国科技大, 3.York大
9:45 - 10:00	11a-D9-4	針状試料の先端開き角度を活用したアトムプローブにおける像の再構築	○湯川 豪[1], 森田 真人[1], 唐澤 正信[1], 間山 憲仁[3], 石村 聡[3], 内田 博[3], 河村 踊子[4], 伊藤 公平[4], 尾張 真則[1,2]	1.東大生研, 2.東大環セ, 3.東芝ナノアナリシス, 4.慶大理工
10:00 - 10:15	11a-D9-5	透過型電子顕微鏡で触媒反応を可視化する	○田中 崇之[1,3], 山本 直紀[2,3], 高柳 邦夫[2,3]	1.名城大理工, 2.東工大院理工, 3.JST-CREST
10:15 - 10:30		休憩/Break		
10:30 - 10:45	11a-D9-6	色素増感太陽電池のための酸化チタン表面の硫黄処理	○下村 勝[1,2], 太田 紘志[1], Ariyasinghe D.M.B.P.[2], Rajapakse R.M.G.[3]	1.静岡大院工, 2.静岡大院創造, 3.ペラデニア大学
10:45 - 11:00	奨 11a-D9-7	In situ真空電気化学測定による イオン液体 / TiO_2(110)界面の特性評価	○渡邉 光[1], 丸山 伸伍[1], 松本 祐司[1]	1.東北大院工
11:00 - 11:15	11a-D9-8	水酸化した鉄表面とH_2Oの第一原理計算シミュレーション	○布村 紀男[1], 砂田 聡[2]	1.富山大情セ, 2.富山大院理工
11:15 - 11:30	11a-D9-9	ガラスナノピペットにおける希ガスの真空コンダクタンス	○高見 知秀[1], 西本 究[2], 後藤 忠彦[2], 小川 修一[2], 高桑 雄二[2]	1.広大クロマチン, 2.東北大多元研
11:30 - 11:45	11a-D9-10	ぬれ性の測定に用いる微小Ga粒形成法	○(M2)大宮 佑介[1], 松下 浩一[1], 奥山 澄雄[1]	1.山形大工
11:45 - 12:00	11a-D9-11	二次元超薄膜への可逆的非破壊電気コンタクト	○吉武 道子[1], 柳生 進二郎[1], 知京 豊裕[1], 渡辺 英二郎[1]	1.物材機構

3月12日(木)　13:15 - 17:00

13:15 - 13:30	12p-D13-1	複数の金属ナノ構造における局在プラズモンの理論	○市川 昌和[1]	1.東大院工
13:30 - 13:45	奨 12p-D13-2	表面増強ラマン分光法を活用した1,4-ベンゼンジチオール単分子接合の電子輸送特性の解明	○金子 哲[1], 村井 大午[1], 小本 祐貴[1], 塚越 一仁[2], 木口 学[1]	1.東工大院理工, 2.物材機構
13:45 - 14:00	12p-D13-3	「バンド分散への歪み効果」測定システムにおけるUHV高分解能ラマン分光の開発	○武田 さくら[1], 久米田 晴香[1], 前田 昂平[1], 桃野 浩樹[1], 竹内 克行[1], 中尾 敏臣[1], Ang Artoni K. R.[1], 坂田 智裕[1], 大門 寛[1]	1.奈良先端大物質創成
14:00 - 14:15	奨 12p-D13-4	Pb及びIn吸着Ge(001)表面における表面近傍の電子状態	○坂田 智裕[1], 武田 さくら[1], 入江 広一郎[1], 大門 寛[1]	1.奈良先端大 物質創成
14:15 - 14:30	12p-D13-5	最表面原子層のPt原子の価電子帯構造のオージェスペクトルによる評価	○石塚 知明[1], 松林 信行[2], 多田 哲也[1], 富江 敏尚[1]	1.産総研ナノエレ, 2.産総研計測フロンティア
14:30 - 14:45	12p-D13-6	AFMとXPSを用いたMgO(100)単結晶表面の溶解の解析	○笹原 亮[1], 村上 達也[1], 富取 正彦[1]	1.北陸先端大
14:45 - 15:00	奨 12p-D13-7	走査トンネル顕微鏡を用いて作製された単一銀ナノ粒子の形状制御	○(M1)寶槻 雅樹[1]	1.東北大通研
15:00 - 15:15		休憩/Break		
15:15 - 15:30	12p-D13-8	X線光電子分光法によるGoethite表面におけるCesiumの吸着形態の観察	○山田 智之[1], 石塚 裕介[1], 宮内 直弥[1], 高木 祥示[1]	1.東邦大理
15:30 - 15:45	12p-D13-9	TiO_2(110)-1×1基板上の吸着層形成過程のSTM観察	○眞銅 雅子[1], 間仲 智洋[1], 内山 真伸[2], 首藤 健一[1,2]	1.横国大院工, 2.理研
15:45 - 16:00	奨 12p-D13-10	超高真空中におけるSiC上への$Si_4O_5N_3$層の形成	○松尾 ともみ[1], 白濵 順哉[1], 竹嶋 祐城[1], 竹尾 隆善[1], 中川 剛志[1], 水野 清義[1], 徐 超男[1]	1.九大総理工
16:00 - 16:15	12p-D13-11	鉄シリサイド核/Siを用いた鉄酸化物のエピタキシャル成長	○松井 秀紀[1], 中村 芳明[1], 中本 悠太[1], 竹内 正太郎[1], 酒井 朗[1]	1.阪大院基礎工
16:15 - 16:30	12p-D13-12	SiO_2/Si(001)界面酸化プロセスにおける熱歪みの寄与	○小川 修一[1], 唐 佳芸[1], 吉越 章隆[2], 石塚 眞治[3], 寺岡 有殿[2], 高桑 雄二[1]	1.東北大, 2.原子力機構, 3.秋田高専
16:30 - 16:45	12p-D13-13	Ge(100)表面の大気酸化物の放射光光電子分光分析	○吉越 章隆[1], 岡田 隆太[2], 岩井 優太郎[3], 寺岡 有殿[1,3], 山田 洋一[2], 佐々木 正洋[2]	1.原子力機構, 2.筑波大学, 3.兵県大
16:45 - 17:00	12p-D13-14	Si(113)表面における酸化メカニズムの解析	○田中 一馬[1], 大野 真也[1], 小玉 開[1], 吉越 章隆[2], 寺岡 有殿[2], 田中 正俊[1]	1.横国大院工, 2.原子力機構

6.5 表面物理・真空 / Surface Physics, Vacuum　　ポスター講演

3月13日(金)　16:30 - 18:30

	13p-P7-1	Ni/Si(111)-$\sqrt{19}\times\sqrt{19}$再構成表面における空孔湧出過程	○(M1)今津 研太[1], 武良 光太郎[1], 木谷 哲[1], 小花 紘暉[1], 橋本 修一郎[1], 神岡 武文[2], 渡邉 孝信[1]	1.早大理工, 2.豊田工大
	13p-P7-2	Si(001)表面に吸着したCOの透過FT-IRによる解析	○大野 真也[1], 田中 一馬[1], 田中 正俊[1], 吉信 淳[2]	1.横国大院工, 2.東大物性研
	13p-P7-3	電界放出微小電子源を用いた低速電子回折	千原 佑太[1], 達城 裕樹[1], 高田 賢哉[1], 中川 剛志[1], ○水野 清義[1]	1.九大総理工
	13p-P7-4	Cs吸着したGaAs(001)熱処理表面におけるSTM観察 〜 表面形状と量子効率の関係 〜	○矢崎 貴紀[1], 山中 大地[1], 山崎 颯[1], 飯島 北斗[1], 目黒 多加志[1]	1.東理大
	13p-P7-5	4H-SiC 表面のπ-結合鎖模型の安定性についての第一原理解析	○金子 智昭[1,2], 山崎 隆浩[1,2], 田島 暢夫[1,2], 大野 隆央[1,2,3]	1.物質・材料研究機構, 2.高効率電デバコンソ, 3.東大生産研
	13p-P7-6	GaAsにおけるNEA活性化表面過程の面方位依存性	○稲垣 雄大[1], 早瀬 和哉[1], 飯島 北斗[1], 目黒 多加志[1]	1.東理大
	13p-P7-7	NEA GaAs フォトカソードのための針構造の作成	○田中 翔太[1], 平尾 昌幸[1], 松尾 和俊[1], 飯島 北斗[1], 塩川 高雄[2], 目黒 多加志[1]	1.東理大, 2.理研
	13p-P7-8	Ge(110)表面におけるPt／Auナノワイヤー単一ドメインの作製	○渡邉 貴弘[1], 石津 友康[1], 山田 洋一[1], 佐々木 正洋[1]	1.筑波大数物
	13p-P7-9	超音速希ガス原子線を用いたPt(111)上のgrapheneとh-BNの状態計測	○生津 達也[1], 金城 厚[1], 國原 淳[1], 山田 洋一[1], 佐々木 正洋[1]	1.筑波大数物
	13p-P7-10	滑液性表面における防霜性能の検証	○(B)守谷 赳夫[1], 真部 研吾[1], 白鳥 世明[1]	1.慶大理工
	13p-P7-11	セルロース繊維への生体適合性材料による耐摩耗性片面超撥水機能	○(B)佐々木 開地[1], 天神林 瑞樹[1], 真部 研吾[1], 白鳥 世明[1]	1.慶大理工

		奨 13p-P7-12	動的Shirley法を活用したXPS定量分析の安定性向上	○(B)松本 凌[1], 田中 博美[1], 吉川 英樹[2], 田沼 繁夫[2], 吉原 一紘[3]	1.米子高専, 2.物材機構, 3.オミクロンナノテクノロジージャパン

6.6 プローブ顕微鏡, 12.2 評価・基礎物性のコードシェアセッション　口頭講演

3月13日(金)　9:00 - 12:00

	9:00 - 9:15	奨 13a-D14-1	多段階光強度のLM-STSによるP3HT:PCBM系有機薄膜太陽電池の局所測定	○落合 貴大[1,2], 安田 剛[3], 加藤 洋和[1], 小林 祐貴[1], 吉田 昭二[1], 武内 修[1], 重川 秀実[1]	1.筑波大数理物質, 2.タカノ(株), 3.物質・材料研究機構
	9:15 - 9:30	奨 13a-D14-2	動作中の有機トランジスタにおける過渡的キャリア分布のナノスケール可視化	○山岸 裕史[1], 木村 知玄[1], 小林 圭[1,2], 野田 啓[3], 山田 啓文[1]	1.京大院工, 2.京大白眉セ, 3.慶應大理工
	9:30 - 9:45	13a-D14-3	時間分解静電気力顕微鏡による有機半導体グレインへの電荷注入・排出過程の可視化	○木村 知玄[1], 山岸 裕史[1], 小林 圭[1,2], 山田 啓文[1]	1.京大工, 2.京大白眉セ
	9:45 - 10:00	奨 13a-D14-4	探針増強ラマン散乱分光測定における金属探針の温度評価と熱拡散手法	○(DC)望月 誠仁[1], 小口 真弘[1], 角井 杏帆[1], 矢野 隆章[1], 原 正彦[1], 林 智広[1]	1.東工大総理工
	10:00 - 10:15	13a-D14-5	液中FM-AFMによる免疫グロブリンM(IgM)の抗原結合評価	○黄 雲飛[1], 木南 裕陽[1], 小林 圭[1,2], 山田 啓文[1]	1.京大工, 2.京大白眉セ
	10:15 - 10:30	奨 13a-D14-6	自己検知型カンチレバーを用いた液中における単一吸着細胞の剥離力測定	○橋本 重孝[1], 安達 誠[1], 岩田 太[1,2]	1.静岡大院工, 2.静岡大電研
	10:30 - 10:45		休憩/Break		
招待	**10:45 - 11:00**	13a-D14-7	**「講演奨励賞受賞記念講演」(15分) ポルフィリン-TbIIIダブルデッカー型単分子磁石のSTMによるパターニングと近藤状態の評価**	**○猪瀬 朋子[1], 田中 大輔[1], Liu Jie[2], 梶原 美珠[2], 米田 忠弘[2], 小川 琢治[1]**	**1.阪大院理, 2.東北大多元研**
	11:00 - 11:15	奨 13a-D14-8	単一分子伝導における分子形状効果の3次元計測	○片山 智貴[1], 中村 美紀[1], 吉田 昭二[1], 武内 修[1], 重川 秀実[1]	1.筑波大数理
	11:15 - 11:30	奨 13a-D14-9	CuPc追加蒸着によるPCBMの配列構造の変化	○(M1)桝井 茜[1], 坂上 弘之[1], 高萩 隆行[1], 鈴木 仁[1]	1.広島大院先端研
	11:30 - 11:45	奨 13a-D14-10	力検出による近接場光の高分解能観測	○山西 絢介[1], 徳山 貴士[1], 内藤 賀公[1], 李 艶君[1], 菅原 康弘[1]	1.阪大院工
	11:45 - 12:00	13a-D14-11	電気化学FM-AFMを用いたイオン液体／ルブレン(001)界面における探針誘起ナノリソグラフィー	○坂東 賢一[1], 原 援又[1], 森野 裕介[1], 岡田 悠悟[2], 今西 哲士[1], 横田 泰之[1], 植村 隆文[2], 竹谷 純一[2], 福井 賢一[1]	1.阪大院基礎工, 2.東大院新領域

6.6 プローブ顕微鏡 / Probe Microscopy　口頭講演

3月12日(木)　10:00 - 11:45

	10:00 - 10:15	奨 12a-D9-1	非接触走査型非線形誘電率顕微鏡を用いた酸素吸着Si(100)-2×1表面における電気双極子モーメント分布の観察	○鈴木 将敬[1], 山末 耕平[1], 長 康雄[1]	1.東北大通研
	10:15 - 10:30	奨 12a-D9-2	走査型トンネル/マイクロ波顕微鏡の開発と低温応用	○(DC)高橋 英幸[1], 今井 良宗[1], 前田 京剛[1]	1.東大院総合
	10:30 - 10:45	奨 12a-D9-3	ルチル型TiO_2(110)表面上の局所接触電位差のFM-AFM/KPFM同時測定	○末貞 昌英[1], 温 煥飛[1], 神林 良佑[1], 内藤 賀公[1], 李 艶君[1], 菅原 康弘[1]	1.阪大院工
	10:45 - 11:00	奨 12a-D9-4	高分解能SSRM測定におけるプローブ接触半径の影響評価	○原田 一範[1], 広田 潤[2], 中居 司[2], 藪原 秀彦[1]	1.東芝生産技術センター, 2.東芝S&S社
	11:00 - 11:15	奨 12a-D9-5	マイクロ波照射機構を備えた極低温光てこ原子間力顕微鏡の開発	○有馬 英司[1], 徳田 郁実[1], 内藤 賀公[1], 李 艶君[1], 菅原 康弘[1]	1.阪大院工
	11:15 - 11:30	奨 12a-D9-6	フィードバックなしのKPFMを用いたPd原子の接触電位差測定	○横山 弘尭[1], 渡邉 友啓[1], 内藤 公賀[1], 李 艶君[1], 菅原 康弘[1]	1.阪大院工
	11:30 - 11:45	奨 12a-D9-7	3次元走査型力顕微鏡とMDシミュレーションを用いたカルサイト／水界面の水和構造観察機構の解明	○宮澤 佳甫[1], 小林 成貴[2], Bernhard Reischl[3], Peter Spijker[4], Fillippo Federici Canova[5], Adam S. Foster[4], 福間 剛士[1,6]	1.金大院, 2.埼玉大, 3.ヘルシンキ大, 4.アールト大, 5.東北大, 6.ACT-C

6.6 プローブ顕微鏡 / Probe Microscopy　ポスター講演

3月12日(木)　13:30 - 15:30

		12p-P4-1	炭素質ガス吸着膜における表面電位の過渡現象	○須田 順子[1], 杉本 岩雄[1], 村松 宏[2], 高橋 和彦[3]	1.東京工科大学CS学部, 2.東京工科大学BS学部, 3.同志社大学理工学部
		12p-P4-2	STM探針径制御	○阿部 巧[1], 山田 豊和[1]	1.千葉大院融合
		12p-P4-3	酸化Ga/Si(111)表面の熱処理過程のSTM観察	○苗代迫 拓也[1], 岡田 有史[1], 西村 慶也[1], 吉村 雅満[2], 角野 広平[1]	1.京工繊大, 2.豊田工大
		12p-P4-4	MoS_2上シリコンナノシートの電子状態評価	○重原 正明[1], 大村 良輔[1], 久家 隆太郎[1], 田畑 博史[1], 久保 理[1], 片山 光浩[1]	1.阪大院工
		12p-P4-5	非接触AFMを用いたGa/$MgAl_2O_4$(111)の吸着初期過程の観察	○西村 慶也[1], 岡田 有史[1], 苗代迫 拓也[1], 吉村 雅満[2], 角野 広平[1]	1.京工繊大, 2.豊田工大
		12p-P4-6	バイモーダルAFMによる金属内包フラーレンの室温での高分解能分子内構造観察	○山下 貴裕[1], 野田 晃浩[1], 小林 圭[1,2], 山田 啓文[1]	1.京大工, 2.京大白眉セ
		12p-P4-7	導電性ナノ粒子インクのSTMポテンショメトリー	○茂木 裕幸[1], 甲山 智規[1], 三成 剛生[2], 武内 修[1], 重川 秀実[1]	1.筑波大院数理物質, 2.NIMS
		12p-P4-8	Ag (110) 上シリセンナノリボン上の電子状態密度分布	大村 良輔[1], ○久保 理[1], 中島 規晴[1], 重原 正明[1], 田畑 博史[1], 森 伸也[1], 片山 光浩[1]	1.阪大院工
		12p-P4-9	ポルフィリン系分子の超高真空昇華制御	○島崎 幹朗[1], 山田 豊和[1]	1.千葉大院融合
		12p-P4-10	チタン酸リチウム$Li_4Ti_5O_{12}$(111)表面のイオン液体中FM–AFM観察	○(M1)内田 辰徳[1], 橘田 晃宜[2], 一井 崇[1], 宇都宮 徹[1], 杉村 博之[1]	1.京大院工, 2.産総研
		12p-P4-11	STMに適したPt(111)基板の作成	○田中 裕行[1], 谷口 正輝[1]	1.阪大産研
		奨 12p-P4-12	走査トンネル顕微鏡によるグラフェンオキサイドの表面ナノ構造観察	○(M1)魏 濤[1], 片野 諭[1], 上原 洋一[1]	1.東北大通研

6.6 プローブ顕微鏡 / Probe Microscopy　口頭講演

3月13日(金)　16:30 - 19:30

	16:30 - 16:45	13p-D9-1	原子間力顕微鏡を用いたナノスペース間の原子操作	○杉本 宜昭[1], Yurtsever Ayhan[2], 平山 直樹[1], 阿部 真之[3], 森田 清三[2]	1.阪大院工, 2.阪大産研, 3.阪大院基礎工
	16:45 - 17:00	13p-D9-2	室温で動作する鉛クラスタースイッチの組立	○(PC)稲見 栄一[1], 濱田 幾太郎[2], 上田 啓市[1], 阿部 真之[3], 森田 清三[4], 杉本 宜昭[1]	1.阪大院工, 2.物材研, 3.阪大院基礎工, 4.阪大産研
	17:00 - 17:15	13p-D9-3	原子操作による人工二次元電子系の創成	○南任 真史[1], 石橋 幸治[1]	1.理研
	17:15 - 17:30	E 13p-D9-4	Damping on Quantum Interference by single molecules and single atoms	○Nazriq Nana[1], Toyo Kazu Yamada[1]	1.Chiba Univ.
	17:30 - 17:45	13p-D9-5	非接触原子間力顕微鏡/力分光法によるNH_3 反応Si(111)-(7x7) 表面上のNH_2とH吸着基の識別	○坂野 友樹[1], 稲村 竜[1], 富取 正彦[2], 新井 豊子[1]	1.金沢大, 2.北陸先端大
	17:45 - 18:00		休憩/Break		
	18:00 - 18:15	13p-D9-6	非接触原子間力顕微鏡におけるSi探針上の水素終端膜によるエネルギー散逸量への影響	○稲村 竜[1], 坂野 友樹[1], 富取 正彦[2], 新井 豊子[1]	1.金沢大, 2.北陸先端大
	18:15 - 18:30	13p-D9-7	磁場計測方向を制御可能な超常磁性探針を用いた交番磁気力顕微鏡によるFePt永久磁石厚膜の表面近傍磁場イメージング	中山 翔太[1], 江川 元太[1,3], 木下 幸則[2,3], 吉村 哲[1,3], ○齊藤 準[1,3]	1.秋田大院工資, 2.秋田大VBL, 3.JST/先端計測
	18:30 - 18:45	13p-D9-8	STM/STSによるFe(001)ウィスカ上のMg超薄膜の酸化研究	○(M1C)坂口 雄基[1], Gerhard Lukas[2], 山田 豊和[1]	1.千葉大院融合, 2.カールスルーエ工科大
	18:45 - 19:00	13p-D9-9	1次元系ハロゲン架橋有機錯体における電荷密度波-モットハバード相転移のSTM観察	○細見 友香[1], 吉田 昭二[1], 高石 慎也[2], 山下 正廣[2], 吉田 健文[2], 武内 修[1], 重川 秀実[1]	1.筑波大学, 2.東北大学
	19:00 - 19:15	13p-D9-10	室温FM-AFMによる金属内包フラーレンの分子内構造観察	○野田 晃浩[1], 小林 圭[1,2], 山田 啓文[1]	1.京大工, 2.京大白眉セ
	19:15 - 19:30	13p-D9-11	モアレ構造を利用したGraphene/Pt(111)上での鉄フタロシアニン成長	○小幡 誠司[1], 斉木 幸一朗[1]	1.東大新領域

3月14日(土)　9:00 - 12:00

	9:00 - 9:15	14a-D9-1	マイカ基板上に形成されるStreptavidin 2次元結晶の液中FM-AFM高分解能構造観察	○崔 子鵬[1], 宮本 眞之[1], 木南 裕陽[1], 小林 圭[1,2], 平田 芳樹[3], 山田 啓文[1]	1.京大工, 2.京大白眉セ, 3.産総研
	9:15 - 9:30	14a-D9-2	2探針AFMによる塗布成膜高結晶性有機薄膜の局所電気伝導評	○清水 太一[1], 山岸 裕史[1], 小林 圭[1,2], 山田 啓文[1]	1.京大工, 2.京大白眉セ
	9:30 - 9:45	14a-D9-3	水素フリー超硬質DLC薄膜に接する混合有機溶媒の構造：FM-AFMと中性子反射率による解析	水光 俊介[1], 藤井 裕真[2], 滝川 浩史[2], 平山 朋子[3,4], ○大西 洋[1]	1.神戸大理, 2.豊橋技科大工, 3.同志社大理工, 4.JSTさきがけ
	9:45 - 10:00	14a-D9-4	ナノ電気化学セル顕微鏡：有機グルピペットを用いた局所電気化学測定条件の検討	○熊谷 明哉[1], 高橋 康史[1,2,3], 猪又 宏貴[2], 白木 将[1], 山本 邦子[1], 春田 正和[1], 伊野 浩介[2], 珠玖 仁[2], 一杉 太郎[1], 末永 智一[1,2]	1.東北大AIMR, 2.東北大院, 3.JSTさきがけ
	10:00 - 10:15	E 14a-D9-5	Study on the Bottom Tracking Technique for Chemical Contrast Imaging.	○(PC)Damiron Denis[1,2], Pierre E. Allain[1,2], Yuta Miyazaki[2], Dai Kobayashi[2], Naruo Sasaki[3], Hideki Kawakatsu[1,2]	1.LIMMS/IIS Tokyo Univ, 2.IIS Tokyo Univ., 3.Electro-Com. Univ
	10:15 - 10:30	14a-D9-6	ピコ秒レーザーにより誘起されるSb_2Te_3の電子状態ダイナミクス	○上原 洋一[1], 桑原 正史[2], 片野 諭[1]	1.東北大通研, 2.産総研
	10:30 - 10:45		休憩/Break		
	10:45 - 11:00	14a-D9-7	走査型非線形誘電率ポテンショメトリによる自発分極誘起電位の選択的測定	○山末 耕平[1], 長 康雄[1]	1.東北大通研
	11:00 - 11:15	14a-D9-8	NC-AFMに組み込んだチャージアンプと電流アンプ出力の同時計測	○野上 真[1], 新井 豊子[2], 笹原 亮[1], 富取 正彦[1]	1.北陸先端大, 2.金沢大
	11:15 - 11:30	E 14a-D9-9	Simultaneous measurement of local contact potential difference and density of state on Au/TiO_2(110) surface by KPFM/STM	○(D)HUANFEI WEN[1], Ryosuke Kanbayashi[1], Masahide Suesada[1], Yanjun Li[1], Yasuhiro Sugawara[1]	1.Osaka Univ
	11:30 - 11:45	14a-D9-10	容量補償回路を用いたNC-AFM用検出回路の低雑音化	大江 弘晃[1], ○藤居 幹大[1], 新井 豊子[1]	1.金沢大
	11:45 - 12:00	E 14a-D9-11	A passive THz near-field microscope with a helium-free cryostat	○KuanTing Lin[1], Susumu Komiyama[2], Sunmi Kim[1], Ken-ichi Kawamura[3], Yusuke Kajihara[1]	1.Institute of Industrial Science, Univ. Tokyo, 2.Department of Basic Science, Univ. Tokyo, 3.Tokyo Instruments, Inc.

3月14日(土)　13:00 - 15:00

	13:00 - 13:15	14p-D9-1	大規模シミュレーションによるAFMのエネルギー減衰の解明	○仙田 康浩[1], 嶋村 修二[1], ブロンクビスト ヤンネ[2], ニエミネン リスト[2]	1.山口大工, 2.アールト大
	13:15 - 13:30	14p-D9-2	周波数変調原子間力顕微鏡によるNaCl(001)表面の大気中原子分解能観察	○阿部 晃平[1], 新井 豊子[1]	1.金大院
	13:30 - 13:45	14p-D9-3	イオン液体/固体界面に形成される層構造の厚み評価: フォースカーブ測定における周波数シフト信号及び撓み信号の同時測定	○横田 泰之[1], 大坂 法紀[1], 今西 哲士[1], 福井 賢一[1]	1.阪大院基礎工
	13:45 - 14:00	14p-D9-4	ブルッカイト型TiO_2ナノ粒子の液中原子分解能FM-AFM計測	○山村 俊貴[1], 淺川 雅[1], 横野 照尚[2,3], 福間 剛士[1,3]	1.金大, 2.九工大, 3.ACT-C/JST
	14:00 - 14:15	14p-D9-5	アルカリハライド結晶のステップ周辺における水和構造評価 (2)	○長谷川 俊[1], 小林 圭[1,2], 山田 啓文[1]	1.京大工, 2.京大白眉セ
	14:15 - 14:30	14p-D9-6	FM-AFMによる界面活性剤分子集合体構造の形成過程評価 (3)	○鈴木 一博[1], 小林 圭[1,2], 山田 啓文[1]	1.京大工, 2.京大白眉セ
	14:30 - 14:45	14p-D9-7	液中動作FM-AFMを用いたイオン液体の局所溶媒和構造と表面構造/電荷との相関に関する研究	○(PC)梅田 健一[1], 小林 圭[1,2], 山田 啓文[1]	1.京大工, 2.京大白眉セ
	14:45 - 15:00	14p-D9-8	液中AFM用フローセルの開発とCu配線腐食過程の直接観察	○北川 拓弥[1], 尾形 奨一郎[1], 福永 明[2], 嶋昇平[2], 高東 智佳子[2], 淺川 雅[3], 福間 剛士[1,3]	1.金沢大理工, 2.荏原製作所, 3.金沢大バイオAFMセンター

7 ビーム応用 / Beam Technology and Nanofabrication

7.1 X線技術 / X-ray technologies　口頭講演

3月11日(水)　13:15 - 17:30

	13:15 - 13:30	11p-A26-1	画像接続によるX線位相コントラスト顕微鏡の視野の拡大	○渡辺 紀生[1], 円谷 雄二[1], 島田 晃広[1], 青木 貞雄[1]	1.筑波大数物
	13:30 - 13:45	11p-A26-2	X線Talbot-Lau干渉計によるスキャン方式位相イメージ装置の開発	○百生 敦[1], Bachche Shivaji[1], 阿部 航[1], 野々口 雅弘[2], 加藤 光一[2], 影山 将史[2], 小池 崇文[2], 栗林 勝[2]	1.東北大, 2.リガク
	13:45 - 14:00	11p-A26-3	非標準縞走査法を用いたX線顕微鏡の位相回復アルゴリズム	○廉 松哲[1], 楊 海圏[1]	1.緑野リサーチ
	14:00 - 14:15	11p-A26-4	埋め込みX線ターゲットを用いた自己像直接検出型2次元Talbot-Lau干渉計の光学設計とその検証	○(DC)森本 直樹[1], 藤野 翔[1], 伊藤 康浩[1], 山崎 周[1], 佐野 壱成[1], 細井 卓治[1], 渡部 平司[1], 志村 考功[1]	1.阪大院工
	14:15 - 14:30	奨 11p-A26-5	埋め込みターゲットによる透過型X線撮影法の高分解能化の検討	○佐野 壱成[1], 森本 直樹[1], 細井 卓治[1], 渡部 平司[1], 志村 考功[1]	1.阪大院工
	14:30 - 14:45	11p-A26-6	$LiTaO_3$単結晶による発生X線の温度差に対する変化	○花元 克巳[1], 片岡 隆浩[1], 山岡 聖典[1]	1.岡山大院保
	14:45 - 15:00	11p-A26-7	高エネルギーX線集光用石英ガラス製屈折レンズの開発	○木村 滋[1], 今井 康彦[1]	1.高輝度光科学研セ
	15:00 - 15:15	11p-A26-8	軸対称多段斜入射ミラー光学系の設計と試作	○青木 貞雄[1], 渡辺 紀生[1], 浅見 博[1], 島田 晃広[1]	1.筑波大数理物質
	15:15 - 15:30		休憩/Break		
	15:30 - 15:45	奨 11p-A26-9	点回折干渉計によるEUV対物ミラーのサブnm精度波面測定	○砂山 諒[1], 豊田 光紀[1], 柳原 美廣[1]	1.東北大多元研
	15:45 - 16:00	11p-A26-10	EUV リソグラフィ光源プラズマの光学厚さの最適化	○細田 達矢[1], 松隈 啓[1], 吉田 健祐[1], 藤岡 慎介[1], 余語 覚文[1], 西村 博明[1]	1.阪大レーザー研
	16:00 - 16:15	奨 11p-A26-11	レーザー駆動EUV光源プラズマにおける先行膨張の最適化	○(PC)松隈 啓[1], 吉田 健祐[1], 細田 達矢[1], 藤岡 慎介[1], 余語 覚文[1], 西村 博明[1]	1.阪大レーザー研
	16:15 - 16:30	11p-A26-12	プリパルスレーザー照射時の ドロップレットの挙動III	○砂原 淳[1], 竹内 靖[1], 佐々木 明[3], 西原 功修[2]	1.レーザー総研, 2.阪大レーザー研, 3.原研関西研
	16:30 - 16:45	11p-A26-13	自己組織化ラグランジメッシュを用いた流体コードによるEUV光源ターゲット分散過程のモデル化	○佐々木 明[1], 砂原 淳[2], 西原 功修[3]	1.原子力機構, 2.レーザー総研, 3.阪大レーザー研
	16:45 - 17:00	11p-A26-14	120 mW 出力「水の窓」軟 X 線の連続発生	○天野 壮[1]	1.兵庫県大高度研
	17:00 - 17:15	11p-A26-15	ゲルマニウム多価イオンの EUV 放射特性	○(M1)原 広行[1], ヂン タン フン[2], 大橋 隼人[3], 坂上 裕之[4], 鈴木 千尋[4], 加藤 太治[4], 村上 泉[4], 東口 武史[1,2]	1.宇都宮大院工, 2.宇都宮大オプト, 3.富山大工, 4.核融合研
	17:15 - 17:30	11p-A26-16	高輝度 EUV 光源の放射特性	○(M1)荒居 剛己[1], 原 広行[1], ヂン タンフン[2], 砂原 淳[3], 三浦 泰祐[4], 遠藤 彰[4], 東口 武史[1,2]	1.宇都宮大院工, 2.宇都宮大オプト, 3.レーザー総研, 4.HiLASE Center

7.1 X線技術 / X-ray technologies　ポスター講演

3月11日(水)　9:30 - 11:30

		11a-P5-1	非走査型蛍光X線/XAFS イメージングのS/B 比向上	○桜井 健次[1,2], Zhao Wenyang[1,2], 岩元 めぐみ[1]	1.物材機構, 2.筑波大数理

7.2 電子ビーム応用 / Applications and technologies of electron beams　口頭講演

3月12日(木)　13:30 - 19:00

招待	13:30 - 13:45	12p-A11-1	**「講演奨励賞受賞記念講演」(15分) グラフェンのステップ成長のその場TEM観察**	**○狩野 絵美[1,2], 橋本 綾子[1,2], 竹口 雅樹[1,2]**	**1.筑波大数理, 2.NIMS**
	13:45 - 14:00	12p-A11-2	アルカリハライドを触媒とした電子線励起による炭素ケージの生成	○舘 昌志[1,2], 村上 勝久[1,2], 竹口 雅樹[3], 藤田 淳一[1,2]	1.筑波大数理, 2.TIMS, 3.物質・材料研究機構
	14:00 - 14:15	12p-A11-3	ナトリウムを吸蔵したチタン酸リチウムの高分解能電子顕微鏡観察	○橘田 晃宜[1], 香山 正憲[1], 秋田 知樹[1]	1.産総研
	14:15 - 14:30	奨 12p-A11-4	反射電子エネルギー損失分光法を用いたリチウム化合物の評価	○田口 昇[1], 橘田 晃宜[1], 栄部 比夏里[1], 秋田 知樹[1]	1.産総研
	14:30 - 14:45	12p-A11-5	金微粒子-チタン酸ストロンチウム界面構造の電子顕微鏡観察	○秋田 知樹[1], 前田 泰[1], 香山 正憲[1]	1.産総研ユビキタス
	14:45 - 15:00	12p-A11-6	電子ビーム照射による絶縁体薄膜帯電のバイアス電圧依存性	○半田 勇希[1], 東海 昌司[1], 小寺 正敏[1]	1.大阪工大
	15:00 - 15:15	12p-A11-7	アウトレンズ型低エネルギー二次電子検出器の開発と像観察	○関口 隆史[1], 岩井 秀夫[1]	1.物材機構
	15:15 - 15:30	12p-A11-8	低加速電子線偏向法による高空間分解能電界可視化	○吉田 木の実[1,2], 粟飯原 有輝[1,2], 村上 勝久[1,2], 藤田 淳一[1,2]	1.筑波大数理, 2.TIMS
	15:30 - 15:45	12p-A11-9	強度輸送方程式による長周期位相情報の取得	○三石 和貴[1], 雷 丹[1], 下条 雅幸[2], 竹口 雅樹[1]	1.物材機構, 2.芝工大
	15:45 - 16:00	12p-A11-10	環状明視野位相法による像コントラストの信号対雑音比の改善	○(D)石田 高史[1], 川崎 忠寛[2,3,4], 丹司 敬義[2,4], 生田 孝[5]	1.名大院工, 2.名大エコ, 3.JFCC, 4.GREEN, 5.大阪電通大
	16:00 - 16:15	12p-A11-11	ホローコーンTEMによる軽元素カラムの可視化	○川崎 忠寛[1,2,4], 石田 高史[3,4], 丹司 敬義[2,4]	1.JFCC, 2.名大エコトピア, 3.名大院工, 4.GREEN
	16:15 - 16:30	12p-A11-12	環境電子顕微鏡用の液体セルの開発(2)	○今枝 紀裕[1], 川崎 忠寛[2,3,4], 丹司 敬義[3,4]	1.名大院工, 2.JFCC, 3.名大エコトピア科学研究所, 4.ナノ材料科学環境拠点
	16:30 - 16:45	12p-A11-13	ナノポアおよび電場を利用した水溶液中のナノ粒子操作	○星野 隆行[1], 満渕 邦彦[1]	1.東大情理
	16:45 - 17:00		休憩/Break		
	17:00 - 17:15	12p-A11-14	電界放出誘起成長ナノ電子源の計算機シミュレーションによる輝度評価	○中原 仁[1], 伊藤 真一[1], 齋藤 弥八[1]	1.名大院工
	17:15 - 17:30	12p-A11-15	p型シリコンフィールドエミッタからの光支援電子放射(II)	○嶋脇 秀隆[1], 長尾 昌善[2], 根尾 陽一郎[3], 三村 秀典[3], 若家 冨士男[4], 高井 幹夫[4]	1.八戸工大工, 2.産総研, 3.静岡大, 4.大阪大
	17:30 - 17:45	12p-A11-16	GaAs負性電子親和力カソードの活性化過程とその分光感度特性	○(B)光野 圭悟[1], 増澤 智昭[1], 畑中 義式[1], 根尾 陽一郎[1], 三村 秀典[1]	1.静岡大

	17:45 - 18:00	12p-A11-17	表面をプラズマ処理した窒化ハフニウム薄膜の仕事関数の評価	藤原 将[1], 辻 博司[1], ○後藤 康仁[1]	1.京大院工
	18:00 - 18:15	奨 12p-A11-18	第一原理計算を用いた転写モールド法エミッタ用導電性セラミック材料の電子状態(IV)	○(M2)石川原 俊夫[1], 中本 正幸[1]	1.静岡大院工
	18:15 - 18:30	12p-A11-19	スピン方向を制御可能な電界放出型偏極電子源に向けたW(001)面上に堆積されたCr薄膜の結晶構造の観察	○阪井 那央哉[1], 永井 滋一[1,2], 岩田 達夫[1,2], 梶原 和夫[1,2], 畑 浩一[1,2]	1.三重大院工, 2.三重大極限ナノセレセ
	18:30 - 18:45	12p-A11-20	エタノール浸漬処理したタングステンエミッタの電界放射顕微鏡および電界イオン顕微鏡観察	○入場 紀明[1], 辻 博司[1], 後藤 康仁[1]	1.京大院工
	18:45 - 19:00	12p-A11-21	スピント型エミッタの放射線耐性の評価	○長尾 昌善[1], 後藤 康仁[2], 佐藤 信浩[3], 秋吉 優史[2], 高木 郁二[2]	1.産総研, 2.京大院工, 3.京大原子炉

7.2 電子ビーム応用 / Applications and technologies of electron beams　ポスター講演

3月12日(木)　9:30 - 11:30

		E 12a-P7-1	Measurement of interfacial potential using transport of intensity equation	○(P)Xiaobin Zhang[1,2], Yoshifumi Oshima[2,3]	1.Tokyo Institute of Technology, 2.JST-CREST, 3.JAIST
		奨 12a-P7-2	TiO_2を蒸着したカーボンナノチューブからの電界電子放出のTEMその場観察	○松田 薫洋[1], 中原 仁[1], 安坂 幸師[1], 齋藤 弥八[1]	1.名大院工
		12a-P7-3	先鋭化したシャープペンシル芯からの電界電子放出	○明神 拓真[1], 麻薙 健[1], 堀江 翔太[1], 山田 洋一[1], 佐々木 正洋[1]	1.筑波大数物
		12a-P7-4	メッシュ型フィラメントによる電子雲の生成	○(B)金森 圭太[1], 溝口 亜優[1], 粕谷 俊郎[1], 和田 元[1]	1.同志社大理工

7.3 微細パターン・微細構造形成技術 / Micro/Nano patterning and fabrication　口頭講演

3月11日(水)　9:00 - 11:45

	9:00 - 9:15	11a-B2-1	デスクトップ型液晶マトリックス投影露光装置の最適Fナンバの検討	○堀内 敏行[1], 小山 宗一郎[1], 小林 宏史[1]	1.東京電機大工
	9:15 - 9:30	11a-B2-2	ビルトインレンズマスクリソグラフィによる3次元露光の検討II	上田 直樹[1], 田中 利樹[1], 菊田 久雄[1], 川田 博昭[1], 笹子 勝[1], ○平井 義彦[1]	1.大阪府立大
	9:30 - 9:45	11a-B2-3	半導体露光用ArFエキシマレーザにおけるチャンバ構造とガス流速の最適化による消費電力の低減	○池田 宏幸[1], 諏訪 輝[1], 勝海 久和[1], 對馬 弘朗[1], 熊崎 貴仁[1], 黒須 昭彦[1], 太田 毅[1], 柿崎 弘司[1], 松永 隆[1], 溝口 計[1]	1.ギガフォトン
	9:45 - 10:00	11a-B2-4	表面増強ラマン分光測定のための放射光光化学反応によるAuナノ粒子合成	○山口 明啓[1], 松元 健[1], 岡田 育夫[2], 櫻井 郁也[2], 内海 裕一[1]	1.兵庫県大高度研, 2.名古屋大学
	10:00 - 10:15	奨 11a-B2-5	高次高調波を用いたコヒーレントスキャトロメトリー顕微鏡によるパタン欠陥観察(II)	○藤野 貴大[1], 田中 祐輔[1], 原田 哲男[1], 永田 豊[2], 渡邊 健夫[1], 木下 博雄[1]	1.兵庫県立大学, 2.理化学研究所
	10:15 - 10:30	奨 11a-B2-6	EUVコレクターミラー用の高精度反射率測定法の開発	○井口 晴貴[1]	1.兵庫県立大
	10:30 - 10:45		休憩/Break		
	10:45 - 11:00	11a-B2-7	ポリフッ化ビニリデン表面への陽子線照射効果	○西川 宏之[1], 松岡 北斗[1], 佐野 遼[1], 林 英臣[1], 前川 康成[2]	1.芝浦工大工, 2.原子力機構
	11:00 - 11:15	奨 11a-B2-8	新規ポリマー型高感度電子線ネガレジストの露光特性	○高山 智寛[1], 池田 紳悟[1], 岸村 由紀子[1], 浅田 裕法[1], 津川 直樹[2], 赤鹿 洋介[2], 星野 亮一[3]	1.山口大学, 2.ナード研究所, 3.グルーオンラボ
	11:15 - 11:30	奨 11a-B2-9	PMMAレジストの現像過程における溶解挙動	○誉田 明宏[1], 山本 洋揮[1], 光安 將騎[1], 古澤 孝弘[1], 吉武 秀介[2]	1.阪大産研, 2.NuFlare Technology
	11:30 - 11:45	11a-B2-10	ポリスチレンに対する高選択比PMMAエッチング	○下向 主真[1], 川田 博昭[1], 安田 雅昭[1], 平井 義彦[1]	1.大阪府大工

3月11日(水)　13:15 - 16:30

招待	13:15 - 13:45	11p-B2-1	**「ビーム応用 分科内招待講演」(30分)** **易液化ガスPFPを用いたナノインプリント**	**○廣島 洋[1]**	**1.産総研**
	13:45 - 14:00	11p-B2-2	ラジカル重合型光硬化樹脂薄膜の表面弾性率のナノ不均一性	○(B)矢野 春菜[1], 久保 祥一[1], 中川 勝[1], 梁 暁斌[2], 藤波 想[2], 中嶋 健[2]	1.東北大多元研, 2.東北大WPI-AIMR
	14:00 - 14:15	11p-B2-3	誘導自己組織化リソグラフィへ向けたPS-b-PMMAのミクロ相分離構造の高速形成挙動	○廣芝 伸哉[1], 大窪 諒[1], 服部 梓[2], 田中 秀和[2], 中川 勝[1]	1.東北大多元研, 2.阪大産研
	14:15 - 14:30	11p-B2-4	熱アニール法によるポリスチレンとポリジメチルシロキサンからなるブロック共重合体のランダム配向面内シリンダ構造の形成(2)	○山口 徹[1], 藤原 聡[1]	1.NTT物性基礎研
	14:30 - 14:45		休憩/Break		
	14:45 - 15:00	11p-B2-5	ナノインプリントにおける離型力のモールド側壁傾斜角依存性I	植村 公亮[1], 藤井 一緒[1], ミカロフスキ マーチン[2], ○(M1C)栩野 貴充[1], 中村 直人[1], 川田 博昭[1], リムザ ジグムント[2], 平井 義彦[1]	1.大阪府大院工, 2.ワルシャワ工科大
	15:00 - 15:15	奨 11p-B2-6	ナノインプリントにおける離型力のモールド側壁傾斜角依存性II	○(M1C)栩野 貴充[1], 藤井 一緒[1], ミカロフスキ マーチン[2], 植村 公亮[1], 川田 博昭[1], リムザ ジグムント[2], 平井 義彦[1]	1.大府大院工, 2.ワルシャワ工科大
	15:15 - 15:30	11p-B2-7	連続UVナノインプリントにおける離型層の耐久性の検討	○伊吉 就三[1], 岡田 真[1], 春山 雄一[1], 松井 真二[1]	1.兵庫県立大学 高度産業科学技術研究所
	15:30 - 15:45	11p-B2-8	液晶高分子へのナノインプリントグラフォエピタキシー	○岡田 真[1], 細田 理沙[2], 谷口 雄亮[2], 春山 雄一[1], 小野 浩司[3], 川月 喜弘[2], 松井 真二[1]	1.兵県大高度研, 2.兵県大工, 3.長岡技科大
	15:45 - 16:00	11p-B2-9	光ナノインプリント成形体の残膜厚均一化に向けたスクリーン印刷法による光硬化性組成物の吐出量制御	○(M1)田辺 明[1], 上原 卓也[1], 永瀬 和郎[2], 池戸 裕明[2], 廣芝 伸哉[1], 中川 勝[1]	1.東北大多元研, 2.ミノグループ
	16:00 - 16:15	11p-B2-10	sub-20 nmの孔径を有する炭素被覆モールドを用いた光硬化性組成物の充填に関する研究	○中川 勝[1], 中谷 顕史[1], 千川 康人[1], 京谷 隆[1]	1.東北大多元研
	16:15 - 16:30	11p-B2-11	光ナノインプリント-原子層堆積法によるナノ造形 (II) ～ALD装置の構築と樹脂表面への成膜検討～	○(B)畔柳 志帆[1], 廣芝 伸哉[1], 中川 勝[1]	1.東北大多元研

7.3 微細パターン・微細構造形成技術 / Micro/Nano patterning and fabrication　ポスター講演

3月12日(木)　9:30 - 11:30

		12a-P8-1	電子線リソグラフィの分子シミュレーション(3)	○人見 洋[1], 道下 勝司[1], 安田 雅昭[1], 川田 博昭[1], 平井 義彦[1]	1.大阪府大工

7.4 量子ビーム界面構造計測 / Buried interface sciences with quantum beam　ポスター講演

3月13日(金)　16:30 - 18:30

		13p-P8-1	高圧水蒸気熱処理によるメソ多孔体薄膜の膜質改善	○田尻 恭之[1], 関 将吾[1], 古賀 玲奈[1], 香野 淳[1]	1.福岡大理
		13p-P8-2	硬X線光電子分光測定における電子・イオン同時照射を用いた帯電中和	○吉木 昌彦[1], 細井 慎[2], 尾角 英毅[3], 稲葉 雅之[4], 久保 優吾[5], 林 利彦[6], 野口 真一[7], 磯村 典武[8], 川村 朋晃[9], 松本 匡史[10], 黒岡 和巳[11], 上田 和浩[12], 野村 健二[13], 清井 明[14], 梅本 慎太郎[15]	1.東芝, 2.ソニー, 3.川崎重工, 4.神戸製鋼, 5.住友電工, 6.関西電力, 7.電中研, 8.豊田中研, 9.日亜, 10.日産, 11.パナソニック, 12.日立, 13.富士通, 14.三菱電機, 15.スプリングエイトサービス
		13p-P8-3	金薄膜／希硫酸水溶液界面電気二重層の中性子反射率測定	○水沢 まり[1,2], 桜井 健次[2], 武田 全康[3], 山崎 大[3], 宮田 登[1]	1.CROSS 東海, 2.物材機構, 3.原子力機構, J-PARCセンター
		13p-P8-4	X線反射率法によるデルタ層を有する多層膜構造の評価	○東 康史[1], 黒河 明[1]	1.産総研計測標準
		13p-P8-5	X線反射率による多層膜解析の改良	○藤居 義和[1]	1.神戸大

7.4 量子ビーム界面構造計測 / Buried interface sciences with quantum beam　口頭講演

3月14日(土)　9:00 - 12:00

	9:00 - 9:15	奨 14a-A16-1	シード型自由電子レーザーを用いたGdFeCoのM殻共鳴磁気光学効果による超高速磁化反転機構の研究	○(D)山本 真吾[1,2], 田口 宗孝[3], 染谷 隆史[1,2], 久保田 雄也[1,2], 伊藤 俊[1,2], 和達 大樹[1,2], 藤澤 正美[2], Capotondi Flavio[4], Pedersoli Emanuele[4], Manfredda Michele[4], Casolari Francesco[4], Kiskinova Maya[4], 藤井 純[5], Moras Paolo[5], 中村 哲也[2,6], 加藤 剛志[7], 岩田 聡[8], 辛 埴[2], 松田 巌[1,2]	1.東大理, 2.物性研, 3.奈良先端大, 4.FERMI, 5.ELETTRA, 6.JASRI, 7.名古屋大工, 8.名古屋大エコトピア科学研究所
	9:15 - 9:30	14a-A16-2	時間分解共鳴軟X線散乱で見た$La_{1/3}Sr_{2/3}FeO_3$薄膜における磁気秩序の超高速融解	津山 智之[1], 伊藤 俊[1], Pontius Niko[2], Schussler-Langeheine Christian[2], 松田 巌[1], 蓑原 誠人[3], 組頭 広志[3], 山崎 裕一[4,5], 中尾 裕則[3], 村上 洋一[3], ○和達 大樹[1]	1.東大物性研, 2.HZB BESSYII, 3.KEK-PF, 4.東大工, 5.理研CEMS
	9:30 - 9:45	14a-A16-3	水素吸蔵特性をもつAg-Rh合金ナノ粒子の価電子帯スペクトル観測	○坂田 修身[1], 楊 安麗[1], 草田 康平[2], 屋山 巴[3], 吉川 英樹[1], 石元 孝佳[3], 古山 通久[3], 小林 浩和[2], 北川 宏[2]	1.物材機構, 2.京大, 3.九大
	9:45 - 10:00	E 14a-A16-4	Hard X-ray photoelectron spectroscopy of epitaxially grown $M_xNi_{1-x}O$ (M = Li, Mg)	○(P)Rosantha Kumara[1], Anli Yang[1], Osami Sakata[1,2], Ryosuke Yamauchi[2], Muneetaka Taguchi[3], Satoshi Ishimaru[1], Akifumi Matsuda[2], Mamoru Yoshimoto[2]	1.NIMS/SPring-8, 2.Tokyo Tech., 3.NAIST
	10:00 - 10:15	14a-A16-5	パルスレーザーメルティング法を用いたマンガン過飽和ドープシリコンの作製と結晶構造	○香野 淳[1], 溝上 諒[1], 田尻 恭之[1]	1.福岡大・理
	10:15 - 10:30	14a-A16-6	化学溶液堆積法を用いたLa置換チタン酸ビスマス薄膜の作製における膜厚と結晶相の制御	○香野 淳[1], 斉田 浩一[1], 田尻 恭之[1]	1.福岡大理
	10:30 - 10:45		休憩/Break		
	10:45 - 11:00	14a-A16-7	一枚の位相型回折格子を用いたGIUSAXS実空間イメージング	○矢代 航[1], 加藤 宏祐[2], 池田 進[3], 和田 恭雄[4], 鈴木 芳生[5], 竹内 晃久[5]	1.東北大多元研, 2.東北大院工, 3.東北大原子分子, 4.慶大理工, 5.JASRI
	11:00 - 11:15	14a-A16-8	ナノ物質の構造・元素分析に向けたX線支援非接触原子間力顕微鏡（XANAM）の開発	○鈴木 秀士[1], 向井 慎吾[2], 田 旺帝[3], 野村 昌治[4], 朝倉 清高[2]	1.名大院工, 2.北大触媒セ, 3.ICU, 4.KEK-PF
	11:15 - 11:30	14a-A16-9	放射光X線回折によるSiC熱分解表面のその場観察法の開発	○(P)吉田 雅洋[1,2], 河邉 文哉[1], 久津間 保徳[1], 堂島 大地[1], 重政 英史[1], 大和田 謙二[2], 稲見 俊哉[2], 玉井 尚登[1], 大谷 昇[1], 金子 忠昭[1], 水木 純一郎[1]	1.関学大理工, 2.原子力機構
	11:30 - 11:45	14a-A16-10	J-PARC/MLF BL17偏極中性子反射率計「写楽」の現状	○宮田 登[1], 武田 全康[2,3], 山崎 大[3], 阿久津 和宏[1], 水沢 まり[1], 笠井 聡[1], 野島 建大[2], 久保田 正人[2], 鈴木 淳市[1], 曽山 和彦[3]	1.総合科学研究機構東海事業センター, 2.原子力機構量子ビーム, 3.J-PARCセンター
	11:45 - 12:00	14a-A16-11	中性子反射投影による埋もれた界面の可視化技術の検討	○桜井 健次[1,2], Jiang Jinxing[1,2], 水沢 まり[1,3], 伊藤 崇芳[3], Li Dan[1,2], 阿久津 和宏[3], 宮田 登[3]	1.物材機構, 2.筑波大数理, 3.CROSS東海

7.5 原子・分子線およびビーム関連新技術 / Atomic/molecular beams and beam-related new technologies　口頭講演

3月13日(金)　10:30 - 12:00

招待	10:30 - 11:15	13a-A16-1	**「ビーム応用 分科内招待講演」(45分)** **ナノクラスタービーム技術の新展開**	**○中嶋 敦[1,2]**	**1.慶大理工, 2.JST-ERATO**
	11:15 - 11:30	奨 13a-A16-2	Cu_3Au(111)合金表面の耐酸化保護膜形成	○津田 泰孝[1], 岡 耕平[1], 牧野 隆正[1], Lehmuskoski Johannes[1], 岡田 美智雄[1], Diño Wilson[1], 笠井 秀明[1], 吉越 章隆[2], 寺岡 有殿[2]	1.阪大, 2.原子力機構
	11:30 - 11:45	13a-A16-3	超低軌道宇宙環境模擬のためのレーザーデトネーションビーム装置	○横田 久美子[1], 井出 健太[1], 大平 淳貴[1], 渡邉 大樹[1], 山崎 勇希[1], 初田 光嶺[1], 守本 郁[1], 田川 雅人[1]	1.神戸大工
	11:45 - 12:00		休憩/Break		

7.5 原子・分子線およびビーム関連新技術 / Atomic/molecular beams and beam-related new technologies　ポスター講演

3月13日(金)　16:30 - 18:30

		13p-P9-1	電子ビーム照射下の単層二次元SiCのダイナミクス解析	○多田 和広[1], 和泉 遼[1], 安田 雅昭[2]	1.富山高専, 2.大阪府大院工

7.6 イオンビーム一般 / Ion beams　ポスター講演

3月13日(金)　16:30 - 18:30

		13p-P10-1	Li窒化物とGaNのプロトンビームを用いたラザフォード後方散乱法による組成比決定	○竹内 優作[1], 山下 大輝[1], 栗山 一男[1], 串田 一雅[2]	1.法大大学院理工, 2.大阪教育大
		13p-P10-2	集束陽子ビーム加工によるPDMS薄膜内包型光スイッチング素子の開発	○川端 駿介[1], 猿谷 良太[1], 加藤 聖[2], 新木 潤[1], 三浦 健太[1], 加田 渉[1], 佐藤 隆博[2], 江夏 昌志[3], 石井 保行[3], 神谷 富裕[3], 西川 宏之[2], 花泉 修[1]	1.群馬大, 2.芝浦工大, 3.原研
		13p-P10-3	低周波交流放電からの水素負イオンビーム引き出し	○(B)山本 瞬[1], 岡野 祐樹[1], 宮本 直樹[1], 粕谷 俊郎[1], 和田 元[1]	1.同大理工
		13p-P10-4	高周波イオン源による金属イオンビームの引き出し	○(B)渡辺 悠太[1], 神田 将摩[1], 粕谷 俊郎[1], 和田 元[1]	1.同大理工
		13p-P10-5	電子線回折による水クラスターの構造解析	中川 穣[1], 飼沼 徹[1], ○竹内 光明[1], 龍頭 啓充[1], 高岡 義寛[1]	1.京大光電子理工セ

7.6 イオンビーム一般 / Ion beams　口頭講演

3月14日(土)　9:00 - 12:00

	9:00 - 9:15	14a-C1-1	MARLOWE二体衝突シミュレータのプリ・ポストプロセス	○青木 学聡[1], 瀬木 利夫[1], 松尾 二郎[1]	1.京大工
	9:15 - 9:30	14a-C1-2	高出力インパルスマグネトロンスパッタリングを用いた金属クラスターイオン源の開発	○(M1)水内 勇[1], 秋元 健吾[1], 山本 宏晃[2], 戸名 正英[2], 塚本 恵三[1,2], 中野 元善[1], 大下 慶次郎[1], 美齊津 文典[1]	1.東北大院理, 2.(株)アヤボ
	9:30 - 9:45	14a-C1-3	共鳴イオン化(RIMS)法を用いた放射性セシウムイメージング装置の開発	○(PC)大石 乾詞[1], 坂本 哲夫[1,2], 川上 勇[2], 奥村 丈夫[3]	1.工学院大工, 2.阿藤工務店, 3.日本中性子光学
	9:45 - 10:00	奨 14a-C1-4	ビスマスクラスターSIMS法による有機材料分析に関する研究	○藤井 麻樹子[1], 宍戸 理恵[2], 鈴木 茂[2], 松尾 二郎[1]	1.京大院工, 2.東北大多元研
	10:00 - 10:15	14a-C1-5	ガスクラスターイオンビームを用いた 有機材料の三次元質量イメージング技術の開発	○若本 恵佑[1], 中川 駿一郎[1], 瀬木 利夫[1], 青木 学聡[1], 松尾 二郎[1]	1.京大院工
	10:15 - 10:30		休憩/Break		
	10:30 - 10:45	14a-C1-6	ガスクラスターイオンビームによる極薄膜の非接触硬度評価	○林 雅祐[1], 豊田 紀章[1], 山田 公[1]	1.兵庫県立大工
	10:45 - 11:00	14a-C1-7	低真空下におけるArクラスターイオンビームの輸送特性	○鈴木 敢士[1], 瀬木 利夫[1], 青木 学聡[1], 松尾 二郎[1]	1.京大工
	11:00 - 11:15	14a-C1-8	ClF_3中性クラスタービームによる微細パターンエッチング	○瀬木 利夫[1], 山本 洋揮[2], 古澤 孝弘[2], 吉野 裕[3], 妹尾 武彦[3], 小池 国彦[3], 青木 学聡[1], 松尾 二郎[1]	1.京大院工, 2.阪大産研, 3.岩谷産業
	11:15 - 11:30	14a-C1-9	Ni表面へのGCIB照射による炭素膜の低温形成	○中山 大地[1], 魚住 裕樹[1], 豊田 紀章[1], 山田 公[1]	1.兵庫県立大工
	11:30 - 11:45	14a-C1-10	希ガス混合下における電界電離イオン種の混在比の電界依存性	○小牧 啓介[1], 永井 滋一[1,2], 岩田 達夫[1,2], 梶原 和夫[1,2], 畑 浩一[1,2]	1.三重大院工, 2.三重大極限ナノエレセ
	11:45 - 12:00	14a-C1-11	走査型ヘリウムイオン顕微鏡を用いた電圧印加時のコンデンサの電位分布オベランド計測	○酒井 智香子[1], 石田 暢之[1], 増田 秀樹[1], 永野 聖子[1], 藤田 大介[1]	1.物材機構

3月14日(土)　13:00 - 15:00

	13:00 - 13:15	14p-C1-1	シリコン酸化膜へのゲルマニウム負イオン注入と熱処理で形成したGeナノ粒子の酸化状態評価	○辻 博司[1], 加藤 幹雄[2], 佐々木 智一[2], 野村 英一[3], 後藤 康仁[1]	1.京大院工, 2.東芝ナノアナリシス, 3.開発受託21
	13:15 - 13:30	14p-C1-2	真空エレクトロスプレーにより得られる帯電液滴ビームの特性	○二宮 啓[1], 境 悠治[2], チェン リーチュイン[1], 平岡 賢三[2]	1.山梨大総合, 2.山梨大クリーン
	13:30 - 13:45	14p-C1-3	炭化水素多原子分子イオンビームによる固体及び液体表面へのイオン照射	○長山 功論[1], 林 恭平[1], 竹内 光明[1], 龍頭 啓充[1], 高岡 義寛[1]	1.京大光電子理工セ
	13:45 - 14:00	14p-C1-4	イオン液体EMIM-DCAイオンビームのスパッタリング特性	○星出 優輝[1], 竹内 光明[1], 龍頭 啓充[1], 高岡 義寛[1]	1.京大光電子教育研究セ
	14:00 - 14:15	14p-C1-5	イオン液体ビーム照射による有機系試料の二次イオン質量分析(SIMS)	○藤原 幸雄[1], 齋藤 直昭[1]	1.産総研
	14:15 - 14:30	14p-C1-6	重イオンビームを用いたTOF-ERDA測定	○安田 啓介[1], 石神 龍哉[2], 中田 吉則[2], 日比 章五[3]	1.京都府大, 2.若狭湾エネ研セ, 3.豊田中研
	14:30 - 14:45	14p-C1-7	液体中イオンビーム照射による材料表面への白金微粒子担持	○(M1)松林 洋太[1], 小林 知洋[2], 寺井 隆幸[1], 鈴木 晶大[1]	1.東京大, 2.理研
	14:45 - 15:00	14p-C1-8	大気圧分析を目指した高速重イオンプローブによる二次イオン質量分析法の開発	○草刈 将一[1], 藤井 麻樹子[1], 瀬木 利夫[1], 青木 学聡[1], 松尾 二郎[1]	1.京大院工

8 プラズマエレクトロニクス / Plasma Electronics

8.0 Plasma Electronics English Session　口頭講演

3月12日(木)　9:00 - 10:45

	9:00 - 9:15	E 12a-D14-1	Time-resolved Curling Probe Measurement of Plasma Modulated at High Frequency	○(D)Anil Pandey[1], Sakakibara Wataru[2], Hiroyuki Matsuoka[2], Keiji Nakamura[1], Hideo Sugai[1]	1.Chubu Univ., 2.DOWA Thermotech
	9:15 - 9:30	E 12a-D14-2	In-situ Monitoring of GaN Film in Process Plasma	○DAISUKE OGAWA[1], YOSHITAKA NAKANO[1], KEIJI NAKAMURA[1]	1.Chubu University
	9:30 - 9:45	12a-D14-3	パーフルオロエーテルの解離過程	○石川 健治[1], 林 俊雄[1], 近藤 祐介[1], 宮脇 雄大[1], 竹田 圭吾[1], 近藤 博基[1], 関根 誠[1], 堀 勝[1]	1.名古屋大学
	9:45 - 10:00	奨・E 12a-D14-4	ROS/RNS generation by various discharge plasma	○Kazuhiro Takahashi[1], Kohki Satoh[1], Hidenori Itoh[1], Hideki Kawaguchi[1], Igor Timoshkin[2], Martin Given[2], Scott MacGregor[2]	1.Muroran I. T., 2.Univ. of Strathclyde
	10:00 - 10:15	E 12a-D14-5	Production Efficiency of RONS in Plasma Activated Water Improved by Atmospheric-Pressure Microplasma Jet	○(PC)JunSeok Oh[1,2], Maito Kakuta[1], Hiroshi Furuta[1,2], Akimitsu Hatta[1,2]	1.Kochi Univ. Technol., 2.Cetner for Nanotech
	10:15 - 10:30	E 12a-D14-6	Advanced Microwave Antenna by Addition of Plasma Components	○Osamu Sakai[1], Akinori Iwai[2], Keiko Saito[1]	1.Univ. Shiga Pref., 2.Kyoto Univ.

招待	10:30 - 10:45	E 12a-D14-7	**[Young Scientist Presentation Award Speech] (15min.) Non-thermal plasma synthesis of silicon nanoparticles and its optical, electrical and photovoltaic properties**	**○Yi Ding[1], Shu Zhou[1], Sugaya Michihiro[1], Nozaki Tomohiro[1]**	**1.Titech**

8.0 Plasma Electronics English Session　ポスター講演

3月13日(金)　9:30 - 11:30

		E 13a-P9-1	Study of Temporal Behavior of Microwave sheath-Voltage combination Plasma	○(P)Satyananda Kar[1], Hiroyuki Kousaka[1]	1.Nagoya Univ.

8.1 プラズマ生成・制御 / Plasma production and control　ポスター講演

3月12日(木)　16:00 - 18:00

		E 12p-P9-1	Plasma Production and Stability in Electron Cyclotron Resonance Source	○(D)Camille Romero[1], Motoi Wada[1]	1.Doshisha University
		12p-P9-2	絶縁管内での水中プラズマの発生機構	○前原 常弘[1], 松友 真哉[2], 田中 彩果[1], 向笠 忍[1], 川嶋 文人[1]	1.愛媛大, 2.新居浜高専
		12p-P9-3	大気圧マイクロ波ラインプラズマにおけるプラズマ挙動シミュレーション	○鈴木 陽香[1], 中野 優[1], 伊藤 仁[2,3], 関根 誠[1,2], 堀 勝[1,2], 豊田 浩孝[1,2]	1.名大工, 2.名大工プラズマナノ, 3.東京エレクトロン
		12p-P9-4	パルスマイクロ波プラズマを用いたインライン溶液処理装置における処理性能のDuty比依存性	○伊藤 美智子[1,3], 高島 成剛[3], 野村 記生[4], 北川 富則[4], 豊田 浩孝[1,2]	1.名大工, 2.名大プラズマナノ, 3.プラズマ技術産業応用センター, 4.三進製作所
		奨 12p-P9-5	水−アルコール混合溶液中ソリューションプラズマ反応場の解明：気/液界面への水素結合の影響	○簾 智仁[1], 上野 智永[1,4], 齋藤 永宏[1,2,3,4]	1.名大院工, 2.名大グリモ, 3.未来社会創造機構, 4.JST-CREST

8.1 プラズマ生成・制御 / Plasma production and control　口頭講演

3月13日(金)　16:30 - 19:00

	16:30 - 16:45	13p-A28-1	同軸ケーブル置換型ECRプラズマスパッタ装置	○赤沢 方省[1], 小野 俊郎[2]	1.NTT DIC, 2.弘前大理工
	16:45 - 17:00	13p-A28-2	Si製スロットアンテナを用いたマイクロ波励起水中気泡プラズマによるレジスト除去プロセスの開発	○伊藤 卓也[1], 石島 達夫[1], 田中 康規[1], 上杉 喜彦[1], 西山 聖[2], 堀邊 英夫[2]	1.金沢大, 2.大阪市大
	17:00 - 17:15	13p-A28-3	電子サイクロトロン共鳴イオン源プラズマからの多種多様なイオンビーム電流向上のための電極改良	○今井 洋太[1], 熊倉 翔[1], 西岡田 卓也[1], 長家 知生[1], 萩野 尚吾[1], 上田 和輝[1], 村松 正幸[2], 佐藤 文信[1], 加藤 裕史[1], 北川 敦志[2], 飯田 敏行[1]	1.阪大院工, 2.放医研
	17:15 - 17:30	13p-A28-4	ECR多価イオン源プラズマの画像計測と共鳴現象との対応	○西岡田 卓也[1], 今井 洋太[1], 熊倉 翔[1], 長家 知生[1], 上田 和輝[1], 萩野 尚吾[1], 佐藤 文信[1], 加藤 裕史[1], 飯田 敏行[1]	1.阪大院工
	17:30 - 17:45	13p-A28-5	ECR多価イオン源の電子エネルギー分布関数の空間分布と磁力線との対応	○熊倉 翔[1], 今井 洋太[1], 長家 知生[1], 西岡田 卓也[1], 上田 和輝[1], 萩野 尚吾[1], 佐藤 文信[1], 加藤 裕史[1], 飯田 敏行[1]	1.阪大院工
	17:45 - 18:00	13p-A28-6	タンデム型ECRイオン源第1ステージプラズマへの蒸発源設置による影響とステージ間のビーム輸送	○長家 知生[1], 今井 洋太[1], 熊倉 翔[1], 西岡田 卓也[1], 上田 和輝[1], 萩野 尚吾[1], 佐藤 文信[1], 加藤 裕史[1], 飯田 敏行[1]	1.阪大院工
	18:00 - 18:15	奨 13p-A28-7	大面積マイクロ波プラズマの円筒キャビティ励起の最適化II	○(B)長谷川 雄一[1], 小川 大輔[1], 中村 圭二[1], 小林 理[2], 菅井 秀郎[3]	1.中部大工, 2.アプライドマテリアルズ, 3.名産研
	18:15 - 18:30	奨 13p-A28-8	メタマテリアル効果を用いたマイクロ波プラズマでの高調波生成の効率化(II)	○岩井 亮憲[1], 中村 嘉浩[1], 酒井 道[1,2]	1.京都大院工, 2.滋賀県立大工
	18:30 - 18:45	13p-A28-9	マイクロ波を用いた大気圧ラインプラズマの生成	○宮田 弘志[1], 内田 雅人[2], 山口 健志[1], 進藤 春雄[1], 桑畑 周司[1], 磯村 雅夫[1]	1.東海大院工, 2.東海大工
	18:45 - 19:00	13p-A28-10	RFマグネトロンスパッタにおけるACカソードバイアス印加の効果	○秋元 隆宏[1], 進藤 春雄[1], 磯村 雅夫[1]	1.東海大院工

3月14日(土)　9:00 - 11:45

	9:00 - 9:15	14a-A28-1	狭ギャップ電極系用いた大気圧非平衡プラズマの生成と診断	○中野 俊樹[1], 北嶋 武[1]	1.防衛大学校
	9:15 - 9:30	14a-A28-2	絶縁管内における純水中の高周波プラズマ	○田中 彩果[1], 前原 常弘[1]	1.愛媛大理工
	9:30 - 9:45	奨 14a-A28-3	液体と接する大気圧グロー放電によって誘起される液中反応プロセスの検討	○二戸 愛仁[1], 白井 直機[1], 内田 諭[1], 杤久保 文嘉[1]	1.首都大院理工
	9:45 - 10:00	奨 14a-A28-4	高圧気体・超臨界流体中における密度揺らぎのスケール依存性を考慮した放電モデルの構築	○(DC)宗岡 均[1,2], 占部 継一郎[1,2], シュタウス スヴェン[1], 寺嶋 和夫[1]	1.東大院新領域, 2.学振特別研究員
	10:00 - 10:15	14a-A28-5	3次元PIC/MC法による矩形マグネトロンスパッタカソードのエロージョン形状の解析	○矢部 裕[1], 小寺 恭介[1], 吉田 武史[1], 久保 信一[1], 高橋 理[1], 南部 健一[2]	1.昭和真空, 2.東北大流体研
	10:15 - 10:30		休憩/Break		
	10:30 - 10:45	14a-A28-6	非平衡大気圧Heプラズマ基礎特性に及ぼす水蒸気の影響	○(M2)坂下 准哉[1], 小田 昭紀[1]	1.千葉工大
	10:45 - 11:00	奨 14a-A28-7	二重接地DBDプラズマアクチュエータの作動メカニズムに関する数値解析	○(B)中野 朝[1], 西田 浩之[1], 白石 朋巳[1]	1.農工大
	11:00 - 11:15	14a-A28-8	PIC/MCC法によるマイクロECRプラズマスラスタの数値解析	○(M1)上野 佳祐[1], 森 大輔[1], 鷹尾 祥典[1], 江利口 浩二[1], 斧 高一[1]	1.京大院工
	11:15 - 11:30	奨 14a-A28-9	針対平板電極における高気圧非平衡Neプラズマのシミュレーション	○元島 一樹[1], 白井 直機[1], 内田 諭[1], 杤久保 文嘉[1]	1.首都大院理工
	11:30 - 11:45	14a-A28-10	プラズマプロセス中の基板温度制御のための熱流束モデルの解析	○(DC)堤 隆嘉[1], 福永 祐介[1], 石川 健治[1], 竹田 圭吾[1], 近藤 博基[1], 太田 貴之[2], 伊藤 昌文[2], 関根 誠[1], 堀 勝[1]	1.名大院工, 2.名城大理工

8.2 プラズマ診断・計測 / Plasma measurements and diagnostics　口頭講演

3月11日(水)　14:00 - 18:00

	14:00 - 14:15	11p-A27-1	RF印加電圧波形解析と中性粒子ビーム加速機構のモデル化2	○榊原 康明[1], 菊地 良幸[1,2], 寒川 誠二[2]	1.東京エレクトロン, 2.東北大学
	14:15 - 14:30	11p-A27-2	禁則遷移を用いた超高感度レーザー吸収分光法による 酸素原子数密度測定	○松井 信[1], 森田 陵[1]	1.静大工
	14:30 - 14:45	11p-A27-3	分子性ガスを含むアルゴンプラズマにおける電子密度計測への飽和吸収分光法の応用	○西山 修輔[1], 王 恵民[1], 佐々木 浩一[1]	1.北大院工
	14:45 - 15:00	E 11p-A27-4	Spectroscopic Measurement and Number Density Calculation of NO (B, C) excited states in N_2-O_2 mixture microwave discharge	○(D)HAO TAN[1], Atsushi Nezu[1], Haruaki Matsuura[1], Hiroshi Akatsuka[1]	1.Titech

8.2 プラズマ診断・計測 / Plasma measurements and diagnostics　ポスター講演

3月13日(金)　9:30 - 11:30

		13a-P10-1	吸収分光法によるArパルスマイクロ波プラズマのガス温度時分解測定	○瀬高 健太[1], 豊田 浩孝[1,2]	1.名大工, 2.名大プラズマナノ工学研究センター
		13a-P10-2	フローティングプローブ法による電子温度の測定	○納富 聡士[1], 佐藤 修一[1], 大内 幹夫[1]	1.東京電機大

8.3 プラズマ成膜・表面処理 / Plasma deposition of thin film and surface treatment　ポスター講演

3月12日(木)　16:00 - 18:00

		12p-P10-1	粉体ターゲットプロセスによる機能性薄膜作製～成膜速度～	○川崎 仁晴[1], 大島 多美子[1], 柳生 義人[1], 猪原 武士[1], 田中 雪[1], 須田 義昭[1]	1.佐世保高専
		12p-P10-2	ターゲット有効利用のための様々な形状の磁化プラズマ生成と評価	○大津 康徳[1], 鶴田 昇平[1], 井手 翼[1], 田原 竜夫[2], 秋山 守人[2]	1.佐大院工, 2.産総研九州センター
		12p-P10-3	リング状ホロー電極型高密度容量結合プラズマの溝深さの影響	○大津 康徳[1], 松本 直樹[1]	1.佐大院工
		奨 12p-P10-4	メゾプラズマCVDによる高速横方向エピタキシャルオーバー成長	○小谷野 哲郎[1], 今村 雄将[1], 神原 淳[1]	1.東大院工
		12p-P10-5	吸引プラズマによるポリイミド表面の親水性処理	○狩野 諒[1], 菅 洋志[1], 高橋 賢[2], 白山 裕也[2], 新堀 俊一郎[2], 清水 哲夫[3]	1.千葉工大, 2.三友製作所, 3.産総研
		12p-P10-6	マイクロ波プラズマを用いた熱電子発電器用半導体エミッタの表面処理	○(M1)井上 健吾[1], 荻野 明久[1], 渡邉 孝俊[2]	1.静大院工, 2.静大工
		12p-P10-7	a-Si:H:Fの極低温合成とレーザーアニーリングによる結晶化	○坂巻 直[1], 佐藤 哲也[1], 中川 清和[1]	1.医工総研
		12p-P10-8	プラズマ支援原子層堆積法によるa-TiN_x薄膜の低温合成	○柳 炳學[1], 関 渓太[1], 佐藤 哲也[1]	1.山梨大

8.3 プラズマ成膜・表面処理 / Plasma deposition of thin film and surface treatment　口頭講演

3月13日(金)　9:00 - 12:30

	9:00 - 9:15	13a-A27-1	VHF-DC重畳マグネトロンスパッタにおける成膜速度評価	○福井 崇史[1], 福岡 侑士[1], 高田 昇治[2], 笹井 建典[1], 豊田 浩孝[1,3]	1.名大工, 2.名大技術部, 3.名大プラズマナノ工学研究センター
	9:15 - 9:30	13a-A27-2	ハイブリッド対向スパッタによるPETフィルム上へのITO透明導電膜の作製	○諸橋 信一[1], 谷本 司[1], 辻田 圭佑[1], 荒川 俊也[1], 原田 直幸[1], 村田 卓也[1]	1.山口大工
	9:30 - 9:45	13a-A27-3	高周波マグネトロンスパッタリングにおける基板位置がタングステン薄膜の結晶配向性に及ぼす影響	○藤原 裕史[1], 辻 博士[1], 後藤 康仁[1]	1.京大院工
	9:45 - 10:00	13a-A27-4	DCマグネトロンカーボンスパッタリングプラズマ中の励起Ar原子の挙動	○(M1)佐郷 友亮[1], 太田 貴之[1], 小田 昭紀[2], 上坂 裕之[3]	1.名城大理工, 2.千葉工大, 3.名大院工機械
	10:00 - 10:15	13a-A27-5	異なる粒子サイズのTi粉体ターゲットを用いたスパッタリング堆積	○大島 多美子[1], 前田 堯[1], 田中 雪[1], 川崎 仁晴[1], 柳生 義人[1], 猪原 武士[1], 須田 義昭[1]	1.佐世保高専
	10:15 - 10:30	13a-A27-6	スパッタを用いた低温高速層交換Ge結晶成長に対する基板温度の効果	○古閑 一憲[1], 市田 大樹[1], 橋本 慎史[1], 徐 鉉雄[1], 山下 大輔[1], 板垣 奈穂[1,2], 白谷 正治[1]	1.九大, 2.JST PRESTO
	10:30 - 10:45	13a-A27-7	水素化アモルファスシリコン薄膜中Si-H_2結合生成に対するクラスタ混入とラジカル表面反応の寄与	○古閑 一憲[1], 都甲 将[1], 鳥越 祥宏[1], 毛屋 公孝[1], 徐 鉉雄[1], 板垣 奈穂[1,2], 白谷 正治[1]	1.九大, 2.JST PRESTO
	10:45 - 11:00		休憩/Break		
	11:00 - 11:15	奨 13a-A27-8	誘導結合プラズマ支援型多重磁極マグネトロンスパッタ法によりABS樹脂上に作製したNi薄膜物性の膜厚依存性	○諏訪 智巳[1], 宮下 翔[1], 幸田 龍典[1], 森久 英[1], 豊田 宏[1]	1.広島工大
	11:15 - 11:30	13a-A27-9	プラズマ支援反応性スパッタリング法を用いたアモルファスIGZO薄膜の低温形成とその特性評価	節原 裕一[1], 中田 慶太郎[1], 陶山 悠太郎[1], ○竹中 弘祐[1], 内田 儀一郎[1], 江部 明憲[2]	1.阪大接合研, 2.イー・エム・ディー
	11:30 - 11:45	奨 13a-A27-10	ラジカル注入型プラズマ励起化学気相堆積法で成長したアモルファスカーボン膜の膜構造及び電子物性に対するイオン照射効果	○杉浦 啓嗣[1], 賈 凌雲[1], 徐 達[1], 中村 将之[1], 近藤 博基[1], 石川 健治[1], 竹田 圭吾[1], 関根 誠[1], 堀 勝[1]	1.名大院工
	11:45 - 12:00	13a-A27-11	CH_4およびSiH_4の解離過程	○林 俊雄[1], 石川 健治[1], 関根 誠[1], 堀 勝[1]	1.名大
	12:00 - 12:15	13a-A27-12	窒素・水素プラズマ照射によるポリスチレン表面アミノ基生成プロセスの解析	○(M1)後藤 健作[1], 斉宮 大[1], 礒部 倫郎[1], 杉本 敏司[1], 浜口 智志[1]	1.大阪大工
	12:15 - 12:30	奨 13a-A27-13	Ar/O_2プラズマ処理によるプラズマインジケータの変色	○宮崎 裕司[1], 菱川 敬太[1], 山川 裕[1], 采山 和弘[1], 井上 浩[1]	1.サクラクレパス

8.4 プラズマエッチング / Plasma etching　ポスター講演

3月13日(金)　9:30 - 11:30

		13a-P11-1	フルオロカーボンプラズマによりエッチングされたHfO_2基板最表面における化学組成分析	○大村 俊輔[1], 高橋 和生[1]	1.京都工芸繊維大
		13a-P11-2	Hプラズマによる Si表面エッチングにおける温度依存性の解析 -バルク上・表面H拡散の影響-	○稲垣 耕司[1,2], 森川 良忠[1], 安武 潔[1,2]	1.阪大院工, 2.JST-CREST

8.4 プラズマエッチング / Plasma etching　口頭講演

3月14日(土)　9:00 - 13:00

	9:00 - 9:15	14a-A27-1	COクラスター照射による磁性体エッチング反応 (2)	○唐橋 一浩[1], 瀬木 利夫[2], 松尾 二郎[2], 浜口 智志[1]	1.阪大院工, 2.京大院工
	9:15 - 9:30	奨 14a-A27-2	透明電極材料のエッチング反応における水素ラジカル照射効果	○李 虎[1], 唐橋 一浩[1], 深沢 正永[2], 長畑 和典[2], 辰巳 哲也[2], 浜口 智志[1]	1.阪大院工, 2.ソニー
	9:30 - 9:45	E 14a-A27-3	InGaAs quantum dot fabrication by a top-down approach for optical devices applications: effect of nanoscale etching mask	○Cedric Thomas[1,4], Chang-Yong Lee[1], Akio Higo[2], Naofumi Okamoto[3], Ichiro Yamashita[3,4], Seiji Samukawa[1,2,4]	1.Tohoku Univ., 2.WPI-AIMR, Tohoku Univ., 3.Nara Inst. of Info. and Technol., 4.JST-CREST
	9:45 - 10:00	奨 14a-A27-4	有機膜エッチングにおける側壁保護作用の基板温度依存性	○福永 裕介[1], 堤 隆嘉[1], 竹田 圭吾[1], 石川 健治[1], 近藤 博基[1], 関根 誠[1], 堀 勝[1]	1.名大院工
	10:00 - 10:15	奨 14a-A27-5	ハイドロフルオロカーボン(HFC)プラズマによるSiNエッチングにおける水素反応効果:分子動力学シミュレーション解析	○(M1)村上 雄一[1], 礒部 倫郎[1], 三宅 啓太[1], 深沢 正永[2], 長畑 和典[2], 辰巳 哲也[2], 浜口 智志[1]	1.阪大工, 2.ソニー(株)
	10:15 - 10:30	14a-A27-6	酸素中性粒子ビームによる酸化及び錯体反応を用いた遷移金属エッチングメカニズム(2)	○久保田 智広[1], 菊地 良幸[1], 寒川 誠二[1,2]	1.東北大流体研, 2.東北大WPI-AIMR
	10:30 - 10:45	14a-A27-7	シースコントロールプレートを用いた基板表面へのイオン斜入射とリップル形成	○(D)中崎 暢也[1], 園部 蒼馬[1], 初瀬 巧[1], 松本 悠[1], 江利口 浩二[1], 斧 高一[1]	1.京大院工
	10:45 - 11:00	14a-A27-8	Cl_2プラズマSiエッチングにおける表面ラフネスの解析：初期表面ラフネスの影響	○(M1)松本 悠[1]	1.京大院工
	11:00 - 11:15		休憩/Break		
	11:15 - 11:30	14a-A27-9	1/C^2法によるH_2およびHeプラズマ誘起ダメージ層構造の解析	○江利口 浩二[1], 深沢 正永[2], 長畑 和典[2], 辰巳 哲也[2], 斧 高一[1]	1.京大院工, 2.ソニー(株)
	11:30 - 11:45	奨 14a-A27-10	光学定数を用いたプラズマ誘起Si基板ダメージの面方位依存性	○(B)岡田 行正[1], 江利口 浩二[1], 斧 高一[1]	1.京大院工
	11:45 - 12:00	14a-A27-11	Cu配線Layoutに依存した新たなLow-kプラズマダメージモデル	○池田 太郎[1], 江利口 浩二[2], 谷原 聡[1], 山本 伸彦[1], 河西 繁[1], 斧 高一[2]	1.東京エレクトロン山梨, 2.京大院工
	12:00 - 12:15	奨 14a-A27-12	マイクロ波加熱によるシリコン表面近傍のプラズマ誘起欠陥修復	○岩井 隆晃[1], 江利口 浩二[3], 山内 祥平[2], 野呂 尚孝[1], 北川 淳一[1], 斧 高一[3]	1.東京エレクトロン山梨, 2.東京エレクトロン, 3.京大院工
	12:15 - 12:30	14a-A27-13	ウエハ面内入射イオンエネルギー分布制御によるエッチングレート分布制御技術の開発	○荒巻 徹[1], 森本 未知数[1], 池田 紀彦[1]	1.日立ハイテク
	12:30 - 12:45	奨 14a-A27-14	ミニマルファブ用 TSV プラズマエッチング装置におけるフッ素ラジカルの発光強度依存性	○本村 大成[1,2], 高橋 和貴[3], 笠嶋 悠司[1], 上杉 文彦[1], 安藤 晃[3], 小木曽 久人[1,2], クンプアン ソマワン[1,2], 原 史朗[1,2]	1.産総研, 2.ミニマルファブ技術研究組合, 3.東北大
	12:45 - 13:00	奨 14a-A27-15	プラズマエッチング中の剥離パーティクルの突発的多量発生	○笠嶋 悠司[1], 本村 大成[1], 上杉 文彦[1]	1.産総研

8.5 プラズマナノテクノロジー / Plasma nanotechnology　口頭講演

3月13日(金)　16:30 - 18:45

	16:30 - 16:45	E 13p-A27-1	Semiconducting silicon-tin quantum dots as environmentally friendly material for carrier multiplication solar cell at low cost	○Svrcek Vladimir[1], Mickael Lozach[1], Davide Mariotti[2], Noboru Ohashi[3], Tetsuhiko Miyadera[1], Koji Matsubara[1]	1.AIST-Tsukuba, 2.Univ. of Ulster UK, 3.Tohoku University
	16:45 - 17:00	奨 13p-A27-2	TiO_2ナノ粒子生成中の誘導熱プラズマトーチ内における原料粉体蒸発およびTiO分子生成過程に対する考察	○兒玉 直人[1], 北 健太郎[1], 田中 康規[1], 上杉 喜彦[1], 石島 達夫[1], 渡邉 周[2], 中村 圭太郎[2]	1.金沢大院自然, 2.日清製粉グループ本社
	17:00 - 17:15	13p-A27-3	大気圧Ar/NH_3プラズマプロセスによるN_2H_4を用いた銀粒子パターンの作製(II)	○木原 直也[1], Blanquet Ella[1,2], 平岡 悠[1], 酒井 道[1,2]	1.京都大院工, 2.滋賀県大工
	17:15 - 17:30	13p-A27-4	プラズマ化学輸送法によるh-BN原子層の形成	○北嶋 武[1], 中野 俊樹[1]	1.防大電気
	17:30 - 17:45	13p-A27-5	リモートプラズマを用いたグラフェンの作製	○東松 真和[1], 平松 美根男[1], 近藤 博基[2], 堀 勝[2]	1.名城大理工, 2.名大工
	17:45 - 18:00	奨 13p-A27-6	ナノ膜厚Ni/Cu積層触媒を用いたMPCVD法によるグラフェン合成	○(M1)楠本 雄司[1], 西森 俊作[1], 宮地 弘樹[1], 針谷 達[1], 古田 寛[1,2], 八田 章光[1,2]	1.高知工科大, 2.高知工科大総研ナノテクC
	18:00 - 18:15	奨 13p-A27-7	液中プラズマで合成したナノグラフェンを用いた燃料電池用白金触媒電極における酸素還元特性	○(M2)天野 智貴[1], 近藤 博基[1], 竹田 圭吾[1], 石川 健治[1], 太田 貴之[2], 伊藤 昌文[2], 平松 美根男[2], 加納 浩之[3], 関根 誠[1], 堀 勝[1]	1.名大院工, 2.名城大理工, 3.NUエコ
	18:15 - 18:30	奨 13p-A27-8	白金微粒子担持カーボンナノウォールの耐久性能および劣化機構の解明	○今井 駿[1], 近藤 博基[1], 石川 健治[1], 平松 美根男[2], 関根 誠[1], 堀 勝[1]	1.名大院工, 2.名城大理工
	18:30 - 18:45	奨 13p-A27-9	カーボンナノウォールを用いた固体高分子型燃料電池の評価 ～カーボンナノウォールの構造の影響～	○(M1)大慶 亮佑[1], 太田 貴之[1], 伊藤 昌文[1], 平松 美根男[1], 近藤 博基[2], 堀 勝[2]	1.名城大理工, 2.名大院理工

8.5 プラズマナノテクノロジー / Plasma nanotechnology　ポスター講演

3月13日(金)　9:30 - 11:30

		奨 13a-P12-1	プラズマCVDによるグラフェンナノリボンの架橋合成機構	○鈴木 弘朗[1], 加藤 俊顕[1], 金子 俊郎[1]	1.東北大院工
		奨 13a-P12-2	プラズマ誘起ミクロ液相反応による酸化亜鉛ナノ粒子合成	○妻木 正尚[1], 清水 禎樹[2], 伊藤 剛仁[1]	1.阪大院工, 2.産総研
		13a-P12-3	大気中でのナノ粒子連続合成に向けた大気圧プラズマプロセスの開発	○清水 禎樹[1], 川口 建二[1]	1.産総研ナノシステム
		13a-P12-4	斜め堆積反応性スパッタリングにおける原料質量数の影響	○仲尾 昌浩[1], 枡川 尊重[1], 井上 泰志[1], 高井 治[2]	1.千葉工大工, 2.材料・表面工学研究所
		13a-P12-5	離散的ナノ柱状構造化InN薄膜の非水電解質におけるEC繰返し耐久性	○(M1)枡川 尊重[1], 石井 万紀也[1], 小林 正樹[1], 姫松 克成[1], 井上 泰志[1], 高井 治[2]	1.千葉工大工, 2.関学材料・表面工研

8.6 プラズマライフサイエンス / Plasma life sciences　ポスター講演

3月12日(木)　16:00 - 18:00

		12p-P11-1	大腸菌コロニーへのFEDBD照射が遺伝子発現に与える影響	○柳生 義人[1], 畑山 雄大[1], 松本 直樹[1], 川崎 仁晴[1], 大島 多美子[1], 猪原 武士[1], 山崎 隆志[1], 須田 義昭[1], 林 信哉[2]	1.佐世保高専, 2.九大総理工
		12p-P11-2	酸素プラズマガスのバブリングによる水中殺菌	○吉木 宏之[1], 石川 福人[1], 菅原 哲也[2]	1.鶴岡高専, 2.山形県工業技術センター
		12p-P11-3	ラットに皮下投与したInナノ粒子の体内輸送	○古閑 一憲[1], 天野 孝昭[1], 平田 美由紀[2], 田中 昭代[2], 白谷 正治[1]	1.九大シス情, 2.九大医
		12p-P11-4	気液界面を介した大気圧非平衡プラズマ照射が液体中のアミノ酸へ与える影響	○竹中 弘祐[1], 内田 儀一郎[1], 川端 一史[1], 中島 厚[1], 阿部 浩也[1], 節原 裕一[1]	1.阪大接合研

8.6 プラズマライフサイエンス / Plasma life sciences　口頭講演

3月13日(金)　9:00 - 12:15

	9:00 - 9:15	奨 13a-A28-1	酸素ラジカル照射した血清含有培地の線維芽細胞の増殖能への影響	○(M1)森 洋介[1], 村田 富保[1], 堀 勝[2], 伊藤 昌文[1]	1.名城大学, 2.名古屋大学
	9:15 - 9:30	奨 13a-A28-2	定期的酸素ラジカル照射による出芽酵母細胞の増殖効果	○(M1)小林 潤[1], 正岡 祐輝[1], 橋爪 博司[2], 太田 貴之[1], 堀 勝[2], 伊藤 昌文[1]	1.名城大理工, 2.名古屋大学
	9:30 - 9:45	奨 13a-A28-3	酸素ラジカル定量照射溶液中の活性種計測	○小林 剛士[1], 唐渡 卓也[1], 橋爪 博司[2], 太田 貴之[1], 石川 健治[2], 掘 勝[2], 伊藤 昌文[1]	1.名城大理工, 2.名大
	9:45 - 10:00	13a-A28-4	殺菌剤としてのプラズマ処理水	○北野 勝久[1], 井川 聡[2], 中島 陽一[2], 谷 篤史[3]	1.阪大工, 2.大阪産技研, 3.阪大理
	10:00 - 10:15	13a-A28-5	乳腺由来細胞を用いたプラズマ照射培養液による選択的細胞死の検討	○橋爪 博司[1], 田中 宏昌[1], 中村 香江[1], 吉川 史隆[1], 石川 健治[1], 加納 浩之[2], 水野 正明[1], 堀 勝[1]	1.名古屋大, 2.NU eco
	10:15 - 10:30	奨 13a-A28-6	大気圧プラズマ活性培養液の抗腫瘍効果作用機構の解析	○(M1)倉家 尚之[1], 田中 宏昌[1], 石川 健治[1], 中村 香江[2], 梶山 広明[2], 吉川 史隆[2], 近藤 隆[3], 水野 正明[2], 竹田 圭吾[1], 近藤 博基[1], 関根 誠[1], 堀 勝[1]	1.名大院工, 2.名大医, 3.富山大
	10:30 - 10:45		休憩/Break		
招待	**10:45 - 11:00**	**13a-A28-7**	**「講演奨励賞受賞記念講演」(15分) 大気圧プラズマ照射による水溶性高分子の細胞膜透過性促進**	**○佐々木 渉太[1], 保苅 雄太郎[1], 神崎 展[2], 金子 俊郎[1]**	**1.東北大院工, 2.東北大院医工**
	11:00 - 11:15	13a-A28-8	リポソームを用いたプラズマ遺伝子導入機構の解明	○相原 大二郎[1], 永岩 秀憲[1], 木戸 祐吾[1,2], 池田 善久[1], 本村 英樹[1], 佐藤 晋[1,3], 神野 雅文[1], 橘 邦英[4]	1.愛媛大院理工, 2.パール工業, 3.ワイ'ズ, 4.大阪電通大工
	11:15 - 11:30	13a-A28-9	ラジカルがプラズマ遺伝子導入に及ぼす影響	○立花 宏紀[1], 木村 真徳[1], 池田 洋平[1], 木戸 祐吾[1,2], 池田 善久[1], 本村 英樹[1], 佐藤 晋[1,3], 神野 雅文[1], 橘 邦英[4]	1.愛媛大学, 2.パール工業, 3.ワイ'ズ, 4.大阪電通大学
	11:30 - 11:45	13a-A28-10	脂質二重膜への誘電体バリア放電処理による拡散係数の変化	○山下 龍舞[1], 須田 善行[1], 滝川 浩史[1], 手老 龍吾[1]	1.豊橋技科大
	11:45 - 12:00	奨 13a-A28-11	マルチプレックスコヒーレントアンチストークスラマン散乱(CARS)顕微鏡を用いたプラズマ誘起生体反応機構の解明	○(B)古田 凌[1], 野村 多加博[2], 橋爪 博司[1], 竹田 圭吾[1], 近藤 博基[1], 石川 健治[1], 太田 貴之[2], 伊藤 昌文[2], 関根 誠[1], 堀 勝[1]	1.名大工, 2.名城大
	12:00 - 12:15	13a-A28-12	大気圧プラズマ照射による経皮吸収改善の基礎検討	○清水 一男[1,2], 林田 健太郎[1], マリウス ブラジャン[2]	1.静大院, 2.静大イノベーション

8.7 プラズマ現象・新応用・融合分野 / Plasma phenomena, emerging area of plasmas and their new applications　口頭講演

3月11日(水)　14:00 - 18:00

	14:00 - 14:15	11p-A28-1	液相レーザーアブレーション誘起キャビテーション気泡周辺での放電現象	○(M1)高橋 裕太[1], 佐々木 浩一[1]	1.北大工
	14:15 - 14:30	11p-A28-2	気液界面プラズマによる液相過酸化水素生成機構	石橋 直人[1], ○竹内 希[1]	1.東工大
	14:30 - 14:45	11p-A28-3	大気圧プラズマにより生成された液中活性種の対流輸送数値シミュレーション	○幾世 和将[1], 浜口 智志[1]	1.大阪大工
	14:45 - 15:00	11p-A28-4	AC励起大気圧Arプラズマの培養液照射中における気相活性種の計測	梁 思潔[1], ○竹田 圭吾[1], 熊倉 匠[1], 近藤 博基[1], 石川 健治[1], 関根 誠[1], 堀 勝[1]	1.名大院工
	15:00 - 15:15	11p-A28-5	気液二相スラグ流内における放電プラズマの形成と発光特性	○(B)間野 翔[1], 林 祐衣[1], 高田 昇治[1], 神田 英輝[1], 後藤 元信[1]	1.名大工
	15:15 - 15:30	奨 11p-A28-6	ナノスケール針状電極を用いた液中放電の機構解明	○青山 智成[1], 藤田 英理[2], 佐藤 岳彦[2], 金子 俊郎[1]	1.東北大院工, 2.東北大流体研
	15:30 - 15:45	11p-A28-7	大気圧プラズマジェット放電特性に及ぼす放電電圧パルス幅の効果	○内田 儀一郎[1], 竹中 弘祐[1], 川端 一史[1], 節原 裕一[1]	1.阪大接合研
	15:45 - 16:00	奨 11p-A28-8	H_2O vapour中の電子輸送特性	○(M2)川口 悟[1], 佐藤 孝紀[1], 伊藤 秀範[1]	1.室蘭工大
	16:00 - 16:15		休憩/Break		
	16:15 - 16:30	奨 11p-A28-9	超臨界流体を用いた擬似微小重力環境下ダストプラズマの創製	○松林 康仁[1], 占部 継一郎[1], シュタウス スヴェン[1], 寺嶋 和夫[1]	1.東大院新領域
	16:30 - 16:45	11p-A28-10	プラズマ誘起流の時間分解測定	○志村 尚彦[1], 雨森 清行[1], 田中 元史[1], 安井 祐之[1]	1.(株)東芝
	16:45 - 17:00	奨 11p-A28-11	光電子制御タウンゼント放電Arプラズマの空間電位分布	○(M1)小谷川 祐貴[1], 阿加 賽見[1], 小川 修一[1], 高桑 雄二[1]	1.東北大学
	17:00 - 17:15	E 11p-A28-12	Effect of Radicals on Inactivation of Spore-forming Microorganisms Studied with Porous Ceramic Plate in N_2/O_2 Surface-wave Plasma	○(D)Xiaoli Yang[1], Syuhei Hamajima[1], Reitou Tei[1], Masaaki Nagatsu[1]	1.Shizuoka Univ.
	17:15 - 17:30	奨 11p-A28-13	直流コロナ放電照射による水中のROS生成	○杉山 豪[1], 佐藤 孝紀[1], 伊藤 秀範[1], 川口 秀樹[1], Timoshkin Igor[2], Given Martin[2], MacGregor Scott[2]	1.室蘭工大, 2.ストラスクライド大
	17:30 - 17:45	11p-A28-14	ミスト・気体混合媒質中での放電プラズマ解析	○井上 翔太[1], 劉 舒滴[1], 池田 善久[1], 本村 英樹[1], 神野 雅文[1]	1.愛媛大院理工
	17:45 - 18:00	11p-A28-15	水ー誘電体多層電極を用いた立体形状大気圧プラズマの殺菌特性	○三沢 達也[1], 三島 朋子[2], 高井 雄一郎[2], 西岡 輝美[2]	1.佐賀大工, 2.大阪府立環境農水研

8.7 プラズマ現象・新応用・融合分野 / Plasma phenomena, emerging area of plasmas and their new applications　ポスター講演

3月13日(金)　16:30 - 18:30

		13p-P11-1	マイクロ波プラズマを用いた無電極紫外ランプの開発	○西川 拓[1], 豊田 浩孝[1,2]	1.名大工, 2.名大プラズマナノ工学研究センター
		13p-P11-2	超臨界流体レーザー誘起プラズマによる二酸化炭素変換	○後藤 拓[1], 小泉 仁人[1], Mark A. Cappelli[2], 伊藤 剛仁[1]	1.阪大院工, 2.スタンフォード大
		奨 13p-P11-3	パルス放電照射による水中のROS/RNS生成	○中井 基嗣[1], 佐藤 孝紀[1], 伊藤 秀範[1], 川口 秀樹[1], Timoshkin Igor[2], Given Martin[2], MacGregor Scott[2]	1.室蘭工大, 2.ストラスクライド大
		奨 13p-P11-4	AC パルス放電による気液界面プラズマ発光の時空間分解計測	○(M2)林 祐衣[1], 神田 英輝[1], 高田 昇治[1], 佐々木 浩一[2]	1.名大院工, 2.北大院工
		奨 13p-P11-5	Comsol®による低温プラズマ中に存在する液滴の蒸発の計算	○森山 誠[1], 堀田 将也[1], 中村 圭二[1], 小川 大輔[1]	1.中部大工
		13p-P11-6	大気圧グロー放電における電流密度が放電と水質に与える影響	○佐藤 修一[1], 神田 兼二郎[1], 大内 幹夫[1]	1.東京電機大
		13p-P11-7	流通式液中放電プラズマによる溶液中の難分解性有機物の分解	○石田 猛[1], 小原 賢信[1], 甲田 公良[2]	1.日立中研, 2.日立ハイテクサイエンス
		13p-P11-8	自己組織化単分子膜と液中プラズマの相互作用の赤外分光解析	○篠原 正典[1], 吉田 裕太[1], 丸野 尚紀[1], 中野 大和[1], 谷口 雄二郎[1], 伊東 和樹[1], 松田 良信[1], 藤山 寛[1]	1.長崎大院工
		13p-P11-9	プラズマによる硝酸溶液肥料を用いた花のまちづくり	藤井 栄人[1], 渡邊 直弥[1], 饒村 修[1], ○池澤 俊治郎[1]	1.中部大工
		13p-P11-10	プラズマによるアンモニアストリッピング法の効率	藤井 栄人[1], 渡邊 直弥[1], 饒村 修[1], ○池澤 俊治郎[1]	1.中部大工
		13p-P11-11	バリア放電を用いた揮発性化学兵器用剤分解装置の開発と性能評価	○井上 裕貴[1], 宇都宮 嘉孝[1], 岩井 貴弘[2], 長島 央行[2], 名児耶 友樹[2], 宮原 秀一[1], 瀬戸 康雄[2], 沖野 晃俊[1]	1.東工大院総理工, 2.科警研
		13p-P11-12	アルミ蒸着薄膜への大気圧プラズマジェット照射	○桑畑 周司[1], 山口 健志[1]	1.東海大院工
		13p-P11-13	大気圧プラズマジェットの高速度カメラ観察	○山口 健志[1], 磯村 雅夫[1], 桑畑 周司[1]	1.東海大院工
		13p-P11-14	水素ラジカルによるW、Niの選択加熱を用いたa-Siの固相成長法とTFTの作製	○(M1)上村 和貴[1], 荒井 哲司[1], 有元 圭介[1], 山中 淳二[1], 佐藤 哲也[1], 中家 大希[1], 中川 清和[1], 高松 利行[2], 澤野 憲太郎[3]	1.山梨大, 2.株式会社SST, 3.東京都市大
		13p-P11-15	大気圧プラズマジェットの照射によるジャガイモの萌芽防止	○(B)鈴木 崇久[1], 西山 修輔[1], 佐々木 浩一[1]	1.北大工
		13p-P11-16	低圧プラズマ照射による病原性細菌の不活化	○内田 詳平[1], 中村 研太[1], 小野 大帝[1], 林 信哉[1]	1.九大総理工

8.8 プラズマエレクトロニクス分科内招待講演　口頭講演

3月12日(木)　11:00 - 11:30

招待	**11:00 - 11:30**	**12a-D14-8**	**「プラズマエレクトロニクス 分科内招待講演」(30分)** **プラズマを学び科学・技術の最先端に挑戦する**	**○石井 彰三**	**1.東工大**

プラズマエレクトロニクス賞授賞式 / Plasma Electronics Award Ceremony　口頭講演

3月12日(火)　11:30 - 11:45

	11:30 - 11:45	12a-D14-9	「プラズマエレクトロニクス賞授賞式」(15分)		

9 応用物性 / Applied Materials Science

9.1 誘電材料・誘電体 / Dielectrics, ferroelectrics　ポスター講演

3月11日(水)　16:00 - 18:00

		11p-P5-1	$KSr_2Nb_5O_{15}$セラミックスの比誘電率温度依存性におよぼす熱処理の影響	○岩井 裕[1], 味方 陵[1], 星 啓佑[1]	1.長岡高専
		11p-P5-2	ポーラス非鉛系圧電セラミックスの作製	○(M1)馬場 亮佑[1], 唐木 智明[1], 藤井 正[1]	1.富山県立大学

9.1 誘電材料・誘電体 / Dielectrics, ferroelectrics　口頭講演

3月12日(木)　9:00 - 12:30

	9:00 - 9:15	奨 12a-B5-1	$LaAlO_3$のフォトルミネセンスに与える熱処理の影響	○(M1)針間 正幸[1], 森本 貴明[1,2], 大木 義路[1,3]	1.早大先進理工, 2.学振DC2, 3.早大材研
	9:15 - 9:30	奨 12a-B5-2	YSZにおける酸素空孔に起因するフォトルミネセンス	○黒田 康裕[1], 金子 昇司[1], 森本 貴明[1,3], 大木 義路[1,2]	1.早大先進理工, 2.早大材研, 3.学振DC2
	9:30 - 9:45	奨 12a-B5-3	YSZ中の酸素空孔による発光の励起・緩和機構	○(DC)森本 貴明[1,3], 金子 昇司[1], 大木 義路[1,2]	1.早大先進理工, 2.早大材研, 3.学振DC2
	9:45 - 10:00	12a-B5-4	$K(Nb, Ta)O_3$固溶及び放電プラズマ焼結による$(Bi_{0.5}K_{0.5})TiO_3$-$BiFeO_3$強誘電体の特性改善と結晶・電子構造	○宮崎 浩輔[1], 石田 直哉[1], 井手本 康[1], 北村 尚斗[1]	1.東理大理工
	10:00 - 10:15	奨 12a-B5-5	$SrTiO_3$を置換した$BaTiO_3$-$Bi(Mg_{1/2}Ti_{1/2})O_3$セラミックスの誘電特性	○西川 佳佑[1], 青柳 倫太郎[1], 鈴木 一行[2]	1.名工大工, 2.産総研
	10:15 - 10:30	12a-B5-6	コンポジット構造を持つ$NaNbO_3$-$BaTiO_3$セラミックスの作製	○青柳 倫太郎[1], 那須 悠二[1], 坂野 聡一[1], 西川 佳佑[1], 鈴木 一行[2]	1.名工大工, 2.産総研
	10:30 - 10:45	12a-B5-7	常誘電相における$BaTiO_3$結晶の角度分解偏光ラマン散乱	○塚田 真也[1], 藤井 康裕[2], 小島 誠治[3], 秋重 幸邦[1]	1.島根大教育, 2.立命館大理工, 3.筑波大数物
	10:45 - 11:00		休憩/Break		
招待	**11:00 - 11:15**	**12a-B5-8**	**「講演奨励賞受賞記念講演」(15分)** **遠赤外分光エリプソメータを用いた相転移現象の観測**	**○金原 一樹[1], 保科 拓也[1], 武田 博明[1], 鶴見 敬章[1]**	**1.東工大院**

招待	11:15 - 11:30	12a-B5-9	「講演奨励賞受賞記念講演」(15分) KTN結晶の電界誘起相転移を用いた光制御	○稲垣 卓弘[1], 今井 欽之[2], 宮津 純[2], 武居 弘樹[1], 小林 潤也[2]	1.NTT物性研, 2.NTTデバイスイノベーションセンタ
	11:30 - 11:45	12a-B5-10	PZTセラミックス、PVDFフィルム、PMN-PT結晶の電気熱量効果	○真岩 宏司[1]	1.湘南工大工
	11:45 - 12:00	12a-B5-11	希土類, Nb置換Pb(Zr,Ti)O_3系強誘電体における強誘電特性と平均・局所, 電子構造の関係	○田村 拓也[1], 石田 直哉[1], 北村 尚斗[1], 井手本 康[1]	1.東理大理工
	12:00 - 12:15	12a-B5-12	$Ca_xBa_{1-x}Nb_2O_6$固溶体における強誘電相転移	○符 徳勝[1], 深澤 研介[1]	1.静岡大工
	12:15 - 12:30	12a-B5-13	一軸性リラクサーSBN の常誘電相における電場効果と熱履歴	松本 和也[1], ○小島 誠治[1]	1.筑波大数理

9.2 ナノワイヤ・ナノ粒子 / Nanowires and Nanoparticles　口頭講演

3月12日(木)　9:30 - 12:15

	9:30 - 9:45	奨 12a-A20-1	InAs 量子ドットを埋め込んだ ナノワイヤ構造の Si 基板上成長とその光学特性	○(D)權 晋寛[1], 渡邉 克之[1,2], 岩本 敏[1,2], 荒川 泰彦[1,2]	1.東大生研, 2.東大ナノ量子
	9:45 - 10:00	奨 12a-A20-2	InP/AlGaPコアシェルナノワイヤの結晶構造評価	○石坂 文哉[1], 平谷 佳大[1], 冨岡 克広[1,2], 福井 孝志[1]	1.北大院情報科学および量子集積センター, 2.JST さきがけ
	10:00 - 10:15	12a-A20-3	MOVPE選択成長法によるSi(100), SOI基板上のInAsナノワイヤ成長	○冨岡 克広[1,2], 石坂 文哉[1], 中井 栄治[1], 本久 順一[1], 福井 孝志[1]	1.北大院情報科学および量子集積センター, 2.JSTさきがけ
	10:15 - 10:30	12a-A20-4	GaAs/InGaAs/GaAs コアマルチシェルナノワイヤ共振器の評価	○(M2)和田 年弘[1], 原 真二郎[1,2], 本久 順一[1]	1.北大院, 2.量子集積研究センター
	10:30 - 10:45	12a-A20-5	間隔の広いInP系NWアレイと量子ドットの形成と評価	○(M2)柳瀬 祥吾[1], 原 真二郎[1,2], 本久 順一[1]	1.北大院, 2.量子集積センター
	10:45 - 11:00		休憩/Break		
	11:00 - 11:15	12a-A20-6	ナノワイヤFET作製におけるインクジェットプリンタとマニピュレータを用いたナノワイヤ転写精度の改善	○佐々木 智[1], 舘野 功太[1], 章 国強[1], 原田 裕一[1], 齊藤 志郎[1], 藤原 聡[1], 村木 康二[1]	1.NTT物性基礎研
	11:15 - 11:30	12a-A20-7	InAsP/InPナノワイヤ成長におけるTBAsパルス供給とTBClの効果	○舘野 功太[1,2], 滝口 雅人[1,2], 章 国強[1,2], 後藤 秀樹[2]	1.NTT-NPC, 2.NTT物性研
	11:30 - 11:45	12a-A20-8	自己触媒VLSナノワイヤにおける軸方向成長速度の均一化	○章 国強[1], 舘野 功太[1], 後藤 秀樹[1]	1.NTT 物性研
	11:45 - 12:00	12a-A20-9	InAsおよびInPナノワイヤFETにおけるポストアニーリング効果の電極材料依存性	○芦川 耶眞登[1,2], Guoqiang Zhang[1], 舘野 功太[1], 原田 裕一[1], 齊藤 志郎[1], 藤原 聡[1], 村木 康二[1], 佐々木 智[1,2]	1.NTT物性基礎研, 2.東北大理
	12:00 - 12:15	12a-A20-10	自己触媒VLS法によるInP/GaInAs/InPコアシェルナノワイヤの成長	○(M1)荻野 雄大[1], 朝倉 啓太[1], 下村 和彦[1], 和保 孝夫[1]	1.上智大理工

3月12日(木)　14:00 - 18:30

	14:00 - 14:15	奨 12p-A20-1	半導体ナノワイヤの変形ポテンシャル・弾性限界のその場顕微分光評価	○(PC)渡辺 健太郎[1,2], 長田 貴弘[1], 若山 裕[1], 関口 隆史[1], フォルク ヤノシュ[3]	1.物材機構, 2.筑波大学, 3.ハンガリー科学アカデミー
	14:15 - 14:30	12p-A20-2	Au触媒GaAsナノワイヤの構造多形メカニズム	○佐々木 拓生[1], 出来 亮太[2], 高橋 正光[1,2]	1.原子力機構, 2.兵庫県立大
	14:30 - 14:45	E 12p-A20-3	Effects of Fabrication Process of Anodic Aluminum Oxide on Selective Growth of Si Nanowire Arrays	○(P)Hoang Nguyen Van[1,2], Sergii TUT-ASHKONKO[1,2], Yusuke HOSHI[2], Noritaka USAMI[1,2], Makoto KONAGAI[1,3]	1.MEXT, FUTURE-PV Innovation, Japan Science and Technology Agency, Japan, 2.Graduate School of Engineering, Nagoya University, Japan, 3.Graduate School of Science and Engineering, Tokyo Institute of Technology, Japan
	14:45 - 15:00	12p-A20-4	Ge/Si コアシェルナノワイヤ作製に向けたナノワイヤ形状に対するSiシェル膜厚依存性の観測	○野口 智弘[1], 森田 広大[1], Simanullang Marolop[1], Xu Zhengyu[1], 宇佐美 浩一[1], 河野 行雄[1,2], 小寺 哲夫[2], 小田 俊理[1,2]	1.東工大量子ナノ研セ, 2.東工大電子物理
	15:00 - 15:15	12p-A20-5	Ge/Si コアシェルナノワイヤの熱電特性評価	○森田 広大[1], 野口 智弘[1], 宇佐美 浩一[1], マロロプ シマニュラン[1], 河野 行雄[1,2], 小寺 哲夫[2], 小田 俊理[1,2]	1.東工大量子ナノ研セ, 2.東工大電子物理
	15:15 - 15:30	奨 12p-A20-6	イオン液体中への金ナノ粒子の合成と結晶学・電気的特性の評価	○松本 雄介[1], 竹内 光明[1], 龍頭 啓充[1], 高岡 義寛[1]	1.京大院工
	15:30 - 15:45		休憩/Break		
	15:45 - 16:00	12p-A20-7	高密度FePtナノドットスタック構造の電子輸送特性	○(M2)壁谷 悠希[1], 満行 優介[1], 張 海[1], 大田 晃生[1], 牧原 克典[1], 宮崎 誠一[1]	1.名大院工
	16:00 - 16:15	12p-A20-8	外部磁場がFePt合金ナノドットへの電子注入特性に及ぼす影響	○満行 優介[1], 壁谷 悠希[1], 張 海[1], 大田 晃生[1], 牧原 克典[1], 宮崎 誠一[1]	1.名大院工
	16:15 - 16:30	E 12p-A20-9	Atomic Characterization of Si Nanocrystals Embedded in SiO_2 Matrix by Atom Probe Tomography	○(DC)Bin Han[1], Yasuo Shimizu[1], Koji Inoue[1], Gabriele Seguini[2], Michele Perego[2], Yasuyoshi Nagai[1]	1.IMR Tohoku Univ., 2.IMM-CNR
	16:30 - 16:45	12p-A20-10	CeO_2ナノ粒子上へ選択的結晶成長させたアナターゼ型TiO_2の結晶構造	○北條 大介[1], 阿尻 雅文[1]	1.東北大WPI-AIMR
	16:45 - 17:00	12p-A20-11	シリコンナノ結晶ソリッドにおけるナノ結晶間相互作用(II)	○古田 健太[1], 杉本 泰[1], 今北 健二[1], 藤井 稔[1]	1.神戸大院工
	17:00 - 17:15	12p-A20-12	シリコンナノ結晶コロイド塗布薄膜の形成と評価 (II)	○佐々木 誠仁[1], 杉本 泰[1], 加納 伸也[1], 今北 健二[1], 藤井 稔[1]	1.神戸大院工
	17:15 - 17:30		休憩/Break		
	17:30 - 17:45	12p-A20-13	ポストレーザー照射によるナノ結晶 Si コロイドの発光波長制御	○(B)渡邊 幹太[1], 袁 澤[1], 中村 俊博[1], 安達 定雄[1]	1.群馬大理工
	17:45 - 18:00	12p-A20-14	シリコン切粉からのシリコンナノパーティクルの作製と応用	○松本 健俊[1,3], 前田 譲章[1,3], 喜村 勝矢[1,3], 松田 真輔[1,3], 小林 悠輝[1,3], 今村 健太郎[1,3], 金谷 弥生[2,3], 肥後 徹[2,3], 小林 光[1,3]	1.阪大産研, 2.日新化成, 3.CREST-JST
	18:00 - 18:15	12p-A20-15	自己組織化多孔質誘電体薄膜を用いた周期的孤立ナノ金属構造の形成	○今里 真之[1], 塚本 新[1]	1.日大理工
	18:15 - 18:30	12p-A20-16	静電気放電による樹脂系粉体の最小着火エネルギーにパージ用窒素濃度が及ぼす影響	○崔 光石[1], 西村 浩次郎[2]	1.安衛研, 2.産業安全技術協会

9.2 ナノワイヤ・ナノ粒子 / Nanowires and Nanoparticles　ポスター講演

3月13日(金)　16:30 - 18:30

		13p-P12-1	白色発光を伴う水蒸気酸化GaAs/AlGaAs ヘテロ構造ナノワイヤ	○石川 史太郎[1], 日比 秀昭[2], 山本 直紀[3]	1.愛媛大院理工, 2.阪大院工, 3.東工大院理工
		13p-P12-2	Si(111)基板上GaAsBiナノワイヤの分子線エピタキシャル成長	○赤松 良彦[1], 石川 史太郎[1], 下村 哲[1]	1.愛媛大院理工
		13p-P12-3	InGaN/InGaN多重積層構造ナノワイヤおよびIn偏析に関する検討	○堤 裕理[1], 木津 良祐[1], 本田 善央[1], 天野 浩[1,2]	1.名大工, 2.赤崎記念研究センター
		13p-P12-4	自己触媒VLS法によるInPナノワイヤのTMI供給量依存性	○(B)朝倉 啓太[1], 荻野 雄大[1], 下村 和彦[1], 和保 孝夫[1]	1.上智大理工
		E 13p-P12-5	H_2 Annealing for Improving of Si Nanowire-based Solar cells	○Wipakorn Jevasuwan[1], Kiyomi Nakajima[1], Yoshimasa Sugimoto[1], Naoki Fukata[1]	1.NIMS
		E 13p-P12-6	Structural control of Ge/Si core/shell nanowire	Minke Yu[1,2], ○Wipakorn Jevasuwan[1], Naoki Fukata[1]	1.NIMS, 2.Univ. of Tsukuba
		13p-P12-7	Auナノ粒子を用いたSiナノコーンの形成と反射率特性の評価	○(M1C)田中 規寛[1], 近藤 彰人[1], 清水 智弘[1], 新宮原 正三[1]	1.関西大
		13p-P12-8	Siナノワイヤの熱電特性に関する理論的検討: 構造多形の影響	○(M1)菰田 貴都[1], 秋山 亨[1], 中村 浩次[1], 伊藤 智徳[1]	1.三重大院工
		13p-P12-9	リチウムイオン電池負極材料に向けた ゲルマニウムナノワイヤ形成法へのウエットエッチング法の導入	○伊藤 和希[1], 呂 志強[1], 山浦 大地[1], 荻野 俊郎[1,2]	1.横国大, 2.CREST/JST
		13p-P12-10	エレクトロスピニング法によるPolyamide 6極細ナノファイバーの透明電極への応用	○(B)竹中 一生[1], 真部 研吾[1], 深田 健太[1], 能登屋 桃子[1], 白鳥 世明[1]	1.慶大理工
		13p-P12-11	Nb:TiO_2ナノファイバを含む原料液を用いた電界紡糸法の開発と色素増感太陽電池への応用	○郭 世栄[1], 今田 慎二[1], 堀江 雄二[1], 野見山 輝明[1]	1.鹿児島大院理工
		13p-P12-12	TiO_2ナノ粒子/WO_3ナノファイバ交互積層法による光蓄電電極の作製	○(M1C)田畑 寿樹[1], 荒川 大樹[1], 野見山 輝明[1], 堀江 雄二[1]	1.鹿児島大院理工
		13p-P12-13	微小空間に閉じ込め加熱された金属の挙動解析	○運天 政貴[1], 徳永 智春[2], 吉田 弥伸[1], 飯島 徹[1], 上杉 祐生[1], 西川 亘[1], 山下 善文[1], 林 靖彦[1]	1.岡山大院自然, 2.名古屋大院工
		13p-P12-14	$ZnAl_2O_4$ナノ粒子の2液プリカーサーからの水熱合成	○石井 聡[1], 古澤 崇哉[1], 中根 茂行[2]	1.東京電機大理工, 2.物材機構
		13p-P12-15	真空蒸着法による有機溶媒中での金ナノ粒子の合成	○藤田 朗人[1], 松本 雄介[1], 竹内 光明[1], 龍頭 啓充[1], 高岡 義寛[1]	1.京大光電子理工セ
		13p-P12-16	静電吸着法を利用した微粒子集積化II	安東 優輝[1], ○前田 篤志[1], 武藤 浩行[2], 松田 厚範[2]	1.府大高専, 2.豊橋技科大

9.3 ナノエレクトロニクス / Nanoelectronics　ポスター講演

3月13日(金)　16:30 - 18:30

		13p-P13-1	非局所測定法を用いた超伝導Alのスピン拡散長評価	○佐藤 孝幸[1], 滝口 将志[1], 島田 宏[1], 水柿 義直[1,2]	1.電通大院 情報理工, 2.CREST-JST
		奨・E 13p-P13-2	Vertical Phase Separation and Light-Soaking Improvements by Active Layer Spin Coating Initiation Time Control in Air-Processed Inverted Organic Solar Cells	○(D)Il Jeon[1], Yutaka Matsuo[1]	1.The Univ. of Tokyo
		13p-P13-3	低ダメージGaAs系ナノ構造形成のための高精度ウェットエッチング技術の開発	○黒田 亮太[1,2], 佐藤 将来[1,2], 葛西 誠也[1,2]	1.北大量子集積センター, 2.北大院情報科学
		13p-P13-4	高温環境下における白金ナノギャップ電極の抵抗値保持特性	○菅 洋志[1], 柏原 翔太[1], 塚越 一仁[2], 清水 哲夫[3], 内藤 泰久[3]	1.千葉工大, 2.物材機構, 3.産総研

9.3 ナノエレクトロニクス / Nanoelectronics　口頭講演

3月14日(土)　9:00 - 11:45

	9:00 - 9:15	14a-A20-1	軍隊ガニの挙動に学ぶ単電子論理回路の構造検討	○(M1)浜名 良樹[1], 大矢 剛嗣[1]	1.横国大院工
	9:15 - 9:30	14a-A20-2	細胞性粘菌に学ぶ単電子情報処理回路	○(B)里見 航汰[1], 大矢 剛嗣[1]	1.横国大理工
	9:30 - 9:45	14a-A20-3	熱雑音を利用する神経細胞軸索の単電子回路化と評価	○(M1)平島 諒[1], 大矢 剛嗣[1]	1.横国大院工
	9:45 - 10:00	奨 14a-A20-4	単電子連想記憶回路の設計と評価	○(B)高野 誠[1], 大矢 剛嗣[1]	1.横国大理工
	10:00 - 10:15	E 14a-A20-5	Stochastic Resonance in Single-Electron Inverter Improved by Attachment of Input Discretizer	○(D)Huong Tran[1], Hiroshi Shimada[1], Yoshinao Mizugaki[1,2]	1.The Univ. of Electro-Communications, Tokyo, 2.CREST, JST
	10:15 - 10:30		休憩/Break		
	10:30 - 10:45	E 14a-A20-6	Fabrication and Characterization of Coupled Quantum Dots in Ge/Si Core/Shell Nanowires	○(P)Rui Wang[1], Kenji Wada[1,4], Russell S. Deacon[1,2], Jun Yao[3], Charles M. Lieber[3], Koji Ishibashi[1,2]	1.RIKEN, 2.RIKEN-CEMS, 3.Harvard Univ., 4.Chiba Univ.
	10:45 - 11:00	14a-A20-7	ダブルLC共振回路を用いた高速FETセンサ	○西口 克彦[1], 山口 浩司[1], 藤原 聡[1], Zant Herre[2], Steele Gary[2]	1.NTT物性研, 2.デルフト工科大学
	11:00 - 11:15	14a-A20-8	ナノ表面電荷ダイナミクス評価にむけた金属短針によるGaAsナノワイヤ表面局所電位変調の基礎的検討	○佐藤 将来[1,2], 殷 翔[1,2], 黒田 亮太[1,2], 井上 慎也[1,2], 葛西 誠也[1,2]	1.北大量集センター, 2.北大院情報科学
	11:15 - 11:30	14a-A20-9	リアルタイムOSを用いたFCE法によるAuナノワイヤの高精度エレクトロマイグレーション制御による狭窄化	○佐藤 秀亮[1], 金丸 祐真[1], 加藤木 悠[1], 白樫 淳一[1]	1.東京農工大院工
	11:30 - 11:45	14a-A20-10	FPGAを用いた高速エレクトロマイグレーションによるAuナノワイヤの狭窄化とコンダクタンスの制御	○加藤木 悠[1], 金丸 祐真[1], 佐藤 秀亮[1], 白樫 淳一[1]	1.東京農工大院工

3月14日(土)　13:00 - 14:45

	13:00 - 13:15	14p-A20-1	ナノギャップを利用した単電子トランジスタの作製と電気的特性の検討	○加瀬 将[1], 森原 康平[1], 岡田 憲昂[1], 白樫 淳一[1]	1.東京農工大学院工
	13:15 - 13:30	14p-A20-2	直列に接続されたナノギャップでの通電による単電子トランジスタの同時一括作製	○岡田 憲昂[1], 森原 康平[1], 加瀬 将[1], 伊藤 光樹[1], 白樫 淳一[1]	1.東京農工大学院工
	13:30 - 13:45	14p-A20-3	蒸着中エレクトロマイグレーション法を用いた精密ナノギャップ作製	○内藤 泰久[1], 堀川 昌代[1], 石田 敬雄[1]	1.産総研ナノシステム
	13:45 - 14:00	奨・E 14p-A20-4	Thermoelectric Effect of Thiophene-based Tripodal Molecular Junctions	○(P)SeeKei Lee[1], Yutaka Ie[2], Yoshio Aso[2], Ryo Yamada[1], Hirokazu Tada[1]	1.Osaka Univ., 2.ISIR, Osaka Univ.

	14:00 - 14:15	奨 14p-A20-5	ナノギャップ電極により誘起された高強度THz局所電場と単一分子との量子的相互作用	○吉田 健治[1], 柴田 憲治[2], 平川 一彦[1]	1.東大生研・ナノ量子機構, 2.東北工大
	14:15 - 14:30	14p-A20-6	電極幅の狭いナノギャップ電極の作製	○大沼 悠人[1], 東 康男[1], 真島 豊[1]	1.東工大応セラ研
	14:30 - 14:45	14p-A20-7	ポルフィリン誘導体保護金ナノ粒子を用いたボトムアップ単電子トランジスタ	○東 康男[1], 坂本 雅典[2], 寺西 利治[2], 真島 豊[1]	1.東工大応セラ, 2.京大化研

9.4 熱電変換 / Thermoelectric conversion　口頭講演

3月12日(木)　9:00 - 12:30

	9:00 - 9:15	12a-A22-1	ポリスチレンマトリックスを用いることによるカーボンナノチューブ膜の熱電特性の向上	○末森 浩司[1], 渡邉 雄一[1], 星野 聰[1]	1.産総研
	9:15 - 9:30	12a-A22-2	ボロンカーバイドナノワイヤの構造と熱電特性	○桐原 和大[1], 向田 雅一[1], 清水 禎樹[1]	1.産総研ナノシステム
	9:30 - 9:45	E 12a-A22-3	Thermal conductivity reduction mechanism in Si 1D phononic crystals at room temperature	○(DC)Jeremie Maire[1,2], Takuma Hori[3], Junichiro Shiomi[3], Masahiro Nomura[1,4]	1.IIS, Univ. of Tokyo, 2.LIMMS, 3.Univ. of Tokyo, 4.Nanoquine
	9:45 - 10:00	奨 12a-A22-4	Si中エピタキシャルGeナノドットを用いた熱抵抗制御	○(DC)山阪 司祐人[1], 中村 芳明[1,2], 上田 智広[1], 竹内 正太郎[1], 酒井 朗[1]	1.阪大院基礎工, 2.さきがけ-JST
	10:00 - 10:15	12a-A22-5	非対称シリコンナノ構造における熱伝導に関する研究	○鹿毛 雄太[1], 萩野 春俊[2], 宮崎 康次[2], Maire Jeremie[3], 野村 政宏[1,4]	1.東大生研, 2.九工大院, 3.東大LIMMS, 4.東大ナノ量子機構
	10:15 - 10:30	12a-A22-6	共ドープナノ構造SOI層のゼーベック係数に関する考察	○鈴木 悠平[1,2], ファイズ サレ[1,2], 下村 勝[2], 鎌倉 良成[3], 池田 浩也[1,2]	1.静大電研, 2.静大院工, 3.阪大院工
	10:30 - 10:45		休憩/Break		
	10:45 - 11:00	12a-A22-7	基板貼り合わせ法で作製したp型GOI層のゼーベック係数	○池田 浩也[1], ベラッパン マニムス[1], ムスサミ オムプラカシュ[1], 鈴木 悠平[1], ファイズ サレ[1], ムカンナン アリバナンドハン[1], 鎌倉 良成[2], 早川 泰弘[1]	1.静大電研, 2.阪大院工
	11:00 - 11:15	12a-A22-8	マルチスケールフォノンブロッキングによる熱伝導の低減効果	○野村 政宏[1,2], 鹿毛 雄太[1], 中川 純貴[1], Maire Jeremie[1], Moser Dominik[3], Paul Oliver[3]	1.東大生研, 2.東大ナノ量子機構, 3.フライブルク大
	11:15 - 11:30	奨 12a-A22-9	スパッタリング法によるCa-Si膜の作製と熱電特性評価	○上原 睦雄[1], 新井 洋樹[1], 小川 正太[1], 秋山 賢輔[1,2], 松島 正明[1], 内田 寛[3], 木村 好里[1], 舟窪 浩[1]	1.東工大院, 2.神奈川県産業技術セ, 3.上智大
	11:30 - 11:45	12a-A22-10	単結晶Si二次元フォノニック結晶における熱伝導率の空隙率依存性	○中川 純貴[1], 鹿毛 雄太[1], Jeremie Maire[2], 野村 政宏[1,3]	1.東大生研, 2.LIMMS, 3.ナノ量子機構
	11:45 - 12:00	奨・E 12a-A22-11	Impact of the phononic structure design on the reduction of thermal conductivity	○(P)Roman Anufriev[1], Masahiro Nomura[1,2]	1.IIS, Univ. of Tokyo, 2.Nanoquine, Univ. of Tokyo
	12:00 - 12:15	12a-A22-12	$CoSb_3$の価電子帯の非放物線性に起因するHall因子の強い温度依存性	○梶川 靖友[1]	1.島根大総合理工
	12:15 - 12:30	奨 12a-A22-13	キャリア運動の有効次元数による熱電特性の評価	○井上 裕之[1], 大杉 功[1], 小林 隆秀[1], 米田 征司[2]	1.テックスイージー, 2.神奈川大学

3月12日(木)　14:00 - 18:00

	14:00 - 14:15	12p-A22-1	第一原理計算に基づく半導体のゼーベック係数シミュレーション	○中村 康一[1,2]	1.京大学際センター, 2.エジプト日本科技大
	14:15 - 14:30	12p-A22-2	バルク熱電材料のゼーベック係数・抵抗率・熱拡散率の同時測定	○(M1)本間 亮英[1], 寺門 宏樹[1], 長谷川 靖洋[1], 村田 正行[2], 山本 淳[2], 小峰 啓史[3], 森田 寛之[4]	1.埼玉大学, 2.産総研, 3.茨城大学, 4.埼玉県産総センター
	14:30 - 14:45	12p-A22-3	$SrTiO_3$単結晶における光照射下での輸送特性	○(M1)白石 祐芽[1], 岡崎 竜二[1], 谷口 博基[1], 寺崎 一郎[1]	1.名大院理
	14:45 - 15:00	12p-A22-4	$CaTiO_3$の異方性による熱電特性への影	西條 泰紹[1], ○白井 光雲[1]	1.阪大産研
	15:00 - 15:15	12p-A22-5	ハーマン法による酸化物材料の熱伝導率測定	○掛本 博文[1], 河野 拓人[2], 入江 寛[1,2]	1.山梨大学 クリーンエネルギー研究センター, 2.山梨大学 大学院医学工学総合教育部
	15:15 - 15:30	12p-A22-6	非対角熱電効果によるCa_xCoO_2薄膜からのテラヘルツ電磁波発生	○高橋 宏平[1], 菅野 勉[1], 酒井 章裕[1], 玉置 洋正[1], 草田 英夫[1], 山田 由佳[1]	1.パナソニック
	15:30 - 15:45	12p-A22-7	Na–Ga–Sn系ジントル化合物の結晶構造と熱電特性評価	○山田 高広[1], 永井 秀明[2], 山根 久典[1]	1.東北大多元研, 2.産総研
	15:45 - 16:00		休憩/Break		
	16:00 - 16:15	12p-A22-8	シリサイド熱電モジュールの長期耐久性に関する研究	○舟橋 良次[1], 松村 葉子[1], 鈴木 亮輔[2], 勝山 茂[3], Barbier Tristan[1], Combe Emmanuel[1]	1.産総研, 2.北大工, 3.阪大工
	16:15 - 16:30	12p-A22-9	Chimney-ladder型$MnSi_\gamma$相における遷移金属の微量置換効果	○宮崎 譲[1], 菊池 祐太[1], 濱田 陽紀[1], 林 慶[1]	1.東北大院工
	16:30 - 16:45	12p-A22-10	構成元素MnをReで部分置換した高マンガンシリサイドの熱電物性	○山本 晃生[1], 広石 尚也[2], 竹内 恒博[1,3]	1.豊田工大, 2.名大工, 3.JSTさきがけ
	16:45 - 17:00	12p-A22-11	W を過剰に固溶させた高マンガンシリサイド $MnSi_\gamma$ の熱電物性 II	○竹内 恒博[1,2], 広石 尚也[3]	1.豊田工大, 2.JSTさきがけ, 3.名大工
	17:00 - 17:15	12p-A22-12	3ω 法を用いた$MnSi_\gamma$ リボン状試料の熱伝導率測定	○(D)西野 俊佑[1], 広石 尚也[2], 宮田 全展[1], 大平 圭介[1], 小矢野 幹夫[1], 竹内 恒博[3,4]	1.北陸先端大, 2.名大工, 3.豊田工大, 4.JST-さきがけ
	17:15 - 17:30	奨・E 12p-A22-13	Effect of silicon nano particles on thermoelectric properties of higher manganese silicide	○(D)Swapnil ghodke[1], Akio yamamoto[2], Hiroshi Ikuta[1], Tsunehiro Takeuchi[2,3]	1.Nagoya Univ., 2.Toyota Tech. Inst., 3.PRESTO
	17:30 - 17:45	E 12p-A22-14	Thermoelectric properties enhancement of a silicon-based compound by synthesis optimization and cationic substitution	○(PC)Tristan Barbier[1], Ryoji Funahashi[1], Emmanuel Combe[1], Tomonari Takeuchi[1], Ryosuke O. Suzuki[2], Atsuko Kosuga[3]	1.AIST Kansai, 2.Hokkaido University, 3.Osaka Prefecture
	17:45 - 18:00	12p-A22-15	層状無機有機ハイブリッド単結晶における熱電特性	○田中 寛人[1], 笹川 崇男[1]	1.東工大応セラ研

3月13日(金)　9:00 - 12:30

	9:00 - 9:15	13a-A22-1	Cu_2ZnSnS_4の大気中での高温安定性と熱電特性	○小菅 厚子[1], 松沢 美恵[1], 舟橋 良次[2]	1.阪府大・ナノ, 2.産総研・ユビキタス
	9:15 - 9:30	奨 13a-A22-2	不定比化合物$Ag_{0.37}Cr_{1.21}X_2$ (X = S, Se)単結晶の熱電特性	○(DC)矢野 力三[1], 笹川 崇男[1]	1.東工大 応セラ研
	9:30 - 9:45	13a-A22-3	Fe置換ウルマナイトの電子物性と第一原理電子状態計算	○(M2)宮田 全展[1], 尾崎 泰助[1,2], 西野 俊佑[1], 小矢野 幹夫[1]	1.北陸先端大, 2.東大物性研
	9:45 - 10:00	13a-A22-4	Mg_2(Si,Ge,Sn)粉末の低温固相合成とその焼結体の評価	○ブンダリッヒ ビルフリド[1], 浦川 亮一[2], 鈴木 義人[2], 佐藤 正志[2], カン アタ[3], 森 孝雄[3]	1.東海大工 材料, 2.東海大工 応用化, 3.材料研

	10:00 - 10:15	奨 13a-A22-5	$Mg_{2+x}Si$の格子間サイトにおけるMgの定量的評価	○窪内 将隆[1], 小川 陽平[1], 林 慶[1], 髙松 智寿[1], 宮崎 讓[1]	1.東北大院工
	10:15 - 10:30	13a-A22-6	強い相対論効果を有するMg_3Bi_2の単結晶育成と熱電特性評価	○岩橋 直哉[1], 加納 学[1], 笹川 崇男[1]	1.東工大応セラ研
	10:30 - 10:45	13a-A22-7	層状窒化物$SrMN_2$(M=Zr, Hf)の電子状態と熱電輸送特性の3次元性	○大久保 勇男[1], 森 孝雄[1]	1.物材機構
	10:45 - 11:00		休憩/Break		
	11:00 - 11:15	13a-A22-8	タイプ2構造Snクラスレートの電子状態に対する元素添加効果	○赤井 光治[1], 岸本 堅剛[1], 小柳 剛[1], 山本 節夫[1]	1.山口大
	11:15 - 11:30	奨 13a-A22-9	type-IIクラスレート化合物$K_8Ba_{16}Al_{40}Sn_{96}$の作製と熱電気的特性	○宇都宮 卓[1], 幸田 翔大[1], 岸本 堅剛[1], 赤井 光治[1], 浅田 裕法[1], 小柳 剛[1]	1.山口大院理工
	11:30 - 11:45	13a-A22-10	クラスレート化合物を用いたセグメント型素子の熱電発電特性	土谷 陽平[1], 岸本 堅剛[1], 石川 雄基[1], 赤井 光治[1], 浅田 裕法[1], ○小柳 剛[1]	1.山口大院理工
	11:45 - 12:00	E 13a-A22-11	Improving thermoelectric performances of n-type Bi-Sb alloys by post treatment after pulse electric current sintering (SPS)	○(P)Emmanuel Combe[1], Ryoji Funahashi[1], Tristan Barbier[1], Tomonari Takeuchi[1], Kunio Yubuta[2]	1.AIST Kansai, 2.Tohoku University
	12:00 - 12:15	13a-A22-12	焼結法により作製したBi-Sb合金の磁場中の熱電物性	○村田 正行[1], 山本 淳[1], 長谷川 靖洋[2], 小峰 啓史[3]	1.産業技術総合研究所, 2.埼玉大, 3.茨城大
	12:15 - 12:30	13a-A22-13	Bi_2Te_3熱電微粒子から作製したバルク体の熱電特性	○(M2)大熊 高光[1], 水谷 慎吾[1], 林 祐司[1], 宮田 全展[1], 西野 俊佑[1], 小矢野 幹夫[1], 田中 哲史[2], 福田 克史[2]	1.北陸先端大, 2.KELK

9.4 熱電変換 / Thermoelectric conversion　ポスター講演

3月13日(金)　16:30 - 18:30

		奨 13p-P14-1	塑性成形法によるカルシウム・コバルト酸化物熱電材料の作製に関する研究	○杉山 泰庸[1], 奥山 剛史[1], 小川 清[2], 田橋 正浩[1], 高橋 誠[1], 後藤 英雄[1]	1.中部大学, 2.オザワ科学株式会社
		奨 13p-P14-2	カルシウム・コバルト酸化物熱電材料の結晶相と熱電特性におよぼす焼成条件の影響	○鬼頭 知希[1], 奥山 剛[1], 小川 清[2], 田橋 正浩[1], 高橋 誠[1], 後藤 英雄[1]	1.中部大学, 2.オザワ科学株式会社
		奨 13p-P14-3	a-InGaZnO薄膜の熱電特性評価	○(M1)藤本 裕太[1], 上沼 睦典[1], 石河 泰明[1], 浦岡 行治[1]	1.奈良先端大
		13p-P14-4	BiCuSeOへの二価元素置換効果とその熱電性能	○(M1)水野 州[1], 内藤 智之[1], 藤代 博之[1]	1.岩手大工
		13p-P14-5	第一原理計算による$CaMnO_3$の電子状態に及ぼす元素置換の影響	○小杉山 雄基[1], 谷林 慧[2], 中村 雄一[1], 井上 光輝[1]	1.豊橋技術科学大学, 2.一関高専
		13p-P14-6	バナジウム酸化物ナノワイヤーを用いた塗布型熱電変換素子	○荒木 圭一[1], 樋口 章二[1]	1.(株)KRI
		13p-P14-7	ZnOナノ粒子を添加したZn_4Sb_3熱電材料の作製と特性評価	○田橋 正浩[1], 苑 帙[2], 小川 清[3], 高橋 誠[1], 王 強[2], 後藤 英雄[1]	1.中部大学, 2.中国東北大学, 3.オザワ科学株式会社
		13p-P14-8	格子ひずみを負荷したビスマステルライド薄膜の電子輸送特性	○稲本 拓也[1], 高尻 雅之[1]	1.東海大工
		13p-P14-9	ビスマステルライド系熱電半導体ナノプレートの製作と評価	○甲斐 真太郎[1], 高杉 壮一[2], 冨田 恒之[3], 高尻 雅之[1]	1.東海大工, 2.東海大院総理工, 3.東海大理
		13p-P14-10	Effect of Phonon Boundary Scattering on Seebeck Coefficient in Silicon Thin Films	○Indra Nur Adisusilo[1], Faiz Salleh[2], Hiroya Ikeda[2], Yoshinari Kamakura[1]	1.Osaka University, 2.Shizuoka University
		奨 13p-P14-11	$Ba_8Al_{16}Si_{30}$系クラスレートにおける同時ドーピング効果	○(M1C)上田 貴大[1], 佐久間 裕教[1], 阿武 宏明[1]	1.山口東理大工
		13p-P14-12	$Ba_8Al_{16}Si_{30}$系クラスレート焼結体の機械的特性	○阿武 宏明[1], 上田 貴大[1], 平田 柊作[2], 藤田 恒輝[1], 飯田 努[2], 向後 保雄[2]	1.山口東理大工, 2.東理大基礎工

9.5 新機能材料・新物性 / New functional materials and new phenomena　口頭講演

3月11日(水)　10:00 - 11:45

	10:00 - 10:15	奨・E 11a-A20-1	Removal of BTEX Compounds From Concentrated Solutions Using Carbene Generating Gels	○(M1)Brian Omondi[1], Hirotaka Okabe[1], Yoshiki Hidaka[1], Kazuhiro Hara[1]	1.Kyushu Univ.
	10:15 - 10:30	奨 11a-A20-2	帯電膜上における液滴のエレクトロウェッティング動作	○田頭 健司[1], 大西 慶治[1], 金子 由利子[1], 石川 貴之[1], 表 篤志[1]	1.パナソニック先端研究本部
	10:30 - 10:45	奨 11a-A20-3	二層構造を有する新規熱放射材料の開発	○伊藤 真紀[1], 石井 利昭[1], 真田 和昭[2]	1.日立研, 2.富山県立大
	10:45 - 11:00	11a-A20-4	リモート水素プラズマ支援によるTaナノドットの高密度一括形成	○王 亜萍[1], 牧原 克典[1], 大田 晃生[2], 竹内 大智[1], 宮崎 誠一[1]	1.名大院工, 2.名大VBL
	11:00 - 11:15	11a-A20-5	金ナノ粒子配列における赤外吸収増大スペクトルのシミュレーション	○中嶋 洋[1], 碇 亜紀彦[2], 石郷 侑汰[2], 津島 将導[2], 熊谷 遊太[3], 島田 透[3], 鈴木 裕史[1]	1.弘前大院理工, 2.弘前大理工, 3.弘前大教育
	11:15 - 11:30	11a-A20-6	Ag形ゼオライトの励起光依存Photoluminescence	○成田 翔[1], 鈴木 裕史[1], 宮永 崇史[1], 中村 敦[1]	1.弘前大理工
	11:30 - 11:45	奨・E 11a-A20-7	Study of Adsorption and Desorption of Cs^+ Ions on Chitosan-Grafted Magnetic Bentonite	○(DC)Shubin Yang[1,2], Naoya Okada[1], Nagatsu Masaaki[1]	1.Shizuoka University, 2.IPP, CAS, China

3月11日(水)　14:00 - 16:30

	14:00 - 14:15	11p-A20-1	固体電解質$A_3LiTa_3ZrSi_4O_{26}$ (A=Sr, Ba)中でのLi拡散経路の第一原理計算による解析	○池田 稔[1], 大野 隆央[1], 相見 晃久[2], 稲熊 宜之[2], 森 大輔[2]	1.物質材料研究機構, 2.学習院大理
	14:15 - 14:30	奨 11p-A20-2	トポロジカル絶縁体カルコゲナイド薄膜のスパッタ法による高配向成膜	○齊藤 雄太[1], 富永 淳二[1], 牧野 孝太郎[1], Paul Fons[1], Alexander V. Kolobov[1], 中野 隆志[1]	1.産総研
	14:30 - 14:45	11p-A20-3	$GeTe/Sb_2Te_3$相変化材料の赤外線・THz波検出器応用に向けた研究	○牧野 孝太郎[1], 齊藤 雄太[1], 富永 淳二[1], 中野 隆志[1]	1.産総研
	14:45 - 15:00	11p-A20-4	P2型Na_xMO_2の結晶構造の温度依存性	赤羽 隆弘[1], 柳田 歩[1], ○小林 航[1,2], 守友 浩[1,2]	1.筑波大数理, 2.学際物質科学研究センター
	15:00 - 15:15		休憩/Break		
	15:15 - 15:30	11p-A20-5	$Gd_xY_{1-x}H_2$(0≪x≪1)のホール抵抗および磁気抵抗	○工藤 駆[1], 酒井 政道[1], 桜庭 琢士[1], 春山 翔太[1], 北島 彰[2], 大島 明博[2], 樋口 宏二[2], 長谷川 繁彦[2]	1.埼大院理工, 2.阪大産研
	15:30 - 15:45	11p-A20-6	$Gd_xY_{1-x}H_2$ (0≦x≦1)における磁性のGd濃度依存性	○桜庭 琢士[1], 酒井 政道[1], 本多 善太郎[1], 工藤 駆[1], 樋口 宏二[2], 北島 彰[2], 大島 明博[2], 長谷川 繁彦[2], 中村 修[3]	1.埼大院理工, 2.阪大産研, 3.岡山理科大

	15:45 - 16:00	11p-A20-7	スカンジウム二水素化物(ScH_2)の作製とホール効果	○松永 智善[1], 酒井 政道[1], 樋口 宏二[2], 北島 彰[2], 大島 明博[2], 長谷川 繁彦[2]	1.埼大院理工, 2.阪大産研
	16:00 - 16:15	11p-A20-8	高保磁力層状コバルト水酸化物の磁性と構造	○穴井 克樹[1], 中村 哲也[1], 萩原 政幸[2], 木田 孝則[2], 奥谷 顕[2], 香取 浩子[3], 太田 寛人[3], 酒井 政道[1], 福田 武司[1], 鎌田 憲彦[1], 本多 善太郎[1]	1.埼玉大学院理工学, 2.阪大先端強磁場, 3.東京農工大院工
	16:15 - 16:30	11p-A20-9	金属フタロシアニンを基にした磁性炭素材料の合成と磁性	○佐藤 峻[1], 武藤 祐太[1], 萩原 政幸[2], 木田 孝則[2], 酒井 政道[1], 福田 武司[1], 鎌田 憲彦[1], 本多 善太郎[1]	1.埼玉大院理工, 2.阪大先端強磁場

9.5 新機能材料・新物性 / New functional materials and new phenomena　ポスター講演

3月12日(木)　13:30 - 15:30

		12p-P5-1	3元タリウム化合物における光誘起変形の照射光スポット形状効果	○(M1)今西 慎[1], 沈 用球[1], 脇田 和樹[2], Mamedov Nazim[3]	1.阪府大院工, 2.千葉工大工, 3.アゼルバイジャン科学アカデミー
		12p-P5-2	エアロゾルデポジション法によるゼオライト膜の作製	○飯塚 一智[1], 湯澤 修孝[1], 加藤 栄[1], 廣瀬 伸吾[2], 明渡 純[2], 松本 泰治[1]	1.栃木産技セ, 2.産総研
		12p-P5-3	熱制御用マンガン酸化物結晶のバンド・フィリング制御	○村上 良明[1], 太刀川 純孝[3], 齋藤 智彦[2], 桑原 英樹[1]	1.上智大理工, 2.東理大理, 3.ISAS/JAXA

10 スピントロニクス・マグネティクス / Spintronics and Magnetics

10 スピントロニクス・マグネティクス / Spintronics and Magnetics　ポスター講演

3月11日(水)　13:30 - 15:30

		E 11p-P1-1	Magnetic tunnel junctions with alloys of Fe and 4f rare-earth metals	○(M1)Kazuhito Tanaka[1], Shinji Miwa[1], Norikazu Mizuochi[1], Yoshishige Suzuki[1]	1.Osaka Univ.
		11p-P1-2	Voltage induced magnetic anisotropy change in FePt	○(M1)松田 健彰[1], 三輪 真嗣[1], 野崎 隆行[2], 湯浅 新治[2], 水落 憲和[1], 鈴木 義茂[1,2]	1.阪大院基礎工, 2.産総研ナノスピン
		E 11p-P1-3	Fabrication of MTJ array for bio-magnetic field sensor	○Mikihiko Oogane[1], Sabri Cakir[1], Daiki Kato[1], Kosuke Fujiwara[1], Hiroshi Naganuma[1], Yasuo Ando[1]	1.Tohoku Univ.
		11p-P1-4	磁場センサ型MTJ実現のためのピン層IrMn膜厚および熱処理温度最適化	○木村 豪[1], 藤原 耕輔[1], 大兼 幹彦[1], 永沼 博[1], 安藤 康夫[1]	1.東北大院工
		E 11p-P1-5	Magnetic Tunnel Junctions with Amorphous CoFeSiB Free Layer for Highly Sensitive Magnetic Field Sensor Devices	○Daiki Kato[1], Mikihiko Oogane[1], Kosuke Fujiwara[1], Junichi Jouno[2], Hiroshi Naganuma[1], Hiroyuki Katsurada[2], Yasuo Ando[1]	1.Tohoku Univ., 2.Konicaminolta
		E 11p-P1-6	Magnetic tunnel junction with perpendicularly magnetized sensing layer for magnetic sensor with small nonlinearity and large sensing range	○(D)Takafumi Nakano[1], Mikihiko Oogane[1], Hiroshi Naganuma[1], Yasuo Ando[1]	1.Tohoku Univ.
		奨・E 11p-P1-7	Resistive Switching induced Multi-State Tunnel Magneto-Resistance in Wurtzite-MgZnO MTJs	○(PC)Mohamed Belmoubarik[1], Muftah Al-Mahdawi[1], Hideyuki Sato[1], Tomohiro Nozaki[1], Masashi Sahashi[1]	1.Tohoku Univ.
		11p-P1-8	800 °Cでアニーリングされた$In_{0.8}Ga_{0.2}As_{0.45}P_{0.55}$におけるスピン緩和の観測	○ショウ サンウ[1], 原澤 遼[1], 安江 雄也[1], Wu Hao[1], 有竹 貴紀[1], Lu Shulong[2], Ji Lian[2], 竹内 淳[1]	1.早大先進理工, 2.中国科学院
		奨 11p-P1-9	$GaIn_{0.36}N_{0.006}AsSb_{0.015}$/$GaN_{0.01}AsSb_{0.11}$/GaAs量子井戸のスピン緩和	○浅川 将輝[1], 本多 一輝[1], 山本 直輝[1], Lianhe Li[2], Harmand Jean-Christoph[3], Shulong Lu[4], 竹内 淳[1]	1.早大理工, 2.Leeds Univ., 3.LPN-CNRS, 4.SINANO-CAS
		E 11p-P1-10	Effect of growth conditions on carrier and spin lifetimes in (001) GaAs/AlGaAs quantum wells	○Satoshi Iba[1], Hidekazu Saito[1], Ken Watanabe[2], Yuzo Ohno[2], Shinji Yuasa[1]	1.AIST, 2.Univ. of Tsukuba
		E 11p-P1-11	Investigation of gate controllability in InGaAs/InAlAs double quantum wells towards the spin-filter application	○Takashi Yamashige[1], Atsushi Sawada[1], Shoichiro Yokota[1], Hang Chen[1], Bolin Liu[1], Hiroki Sugiyama[2], Yoshiaki Sekine[3], Takaaki Koga[1]	1.GSIST Hokkaido Univ., 2.NTT Device Technology Laboratories, 3.NTT Basic Research Laboratories
		E 11p-P1-12	Simulation of Holographic Imaging based on Magneto-Optical Spatial Light Modulator	○(P)Roman Antos[1,2], Eva Jesenska[1,2], Martin Veis[2], Kenji Machida[3], Daisuke Kato[3], Hiroshi Kikuchi[3], Naoki Shimidzu[3], Takayuki Ishibashi[1]	1.Nagaoka Univ. of Tech., 2.Charles Univ., 3.NHK Sci. & Tech. Res. Lab.
		11p-P1-13	InP基板上に成長したInMnAs薄膜の評価	○林 伸一郎[1], 吉沢 勇人[1], 豊田 英之[1], 中村 新一[2], 内富 直隆[1]	1.長岡技術科学大学, 2.青山学院大学
		11p-P1-14	Ce添加によるSi上Ge三次元ドット成長プロセスの変化	○植野 和也[1], 宮田 祐輔[1], 吉村 武[1], 芦田 淳[1], 藤村 紀文[1]	1.大阪府大院工
		E 11p-P1-15	The effect of B co-doping on the surface morphology and transport characteristics of Si:Ce films	○(D)Yusuke Miyata[1], Ueno Kazuya[1], Yoshimura Takeshi[1], Ashida Atsushi[1], Fujimura Norifumi[1]	1.Osaka Pref. Univ.
		奨 11p-P1-16	強磁性電極$La_{0.67}Sr_{0.33}MnO_3$/有機物界面のトンネル異方性磁気抵抗効果におけるアニール処理の効果	○宮原 千紘[1], 神谷 建[1], 森田 稜也[1], 寻田 博一[1]	1.阪大基礎工
		E 11p-P1-17	Magnetotransport properties of graphene directly grown on permalloy in CPP configuration	○Shiro Entani[1], Hiroshi Naramoto[1], Seiji Sakai[1]	1.JAEA
		E 11p-P1-18	Electronic Structure of Ferromagnetic Semiconductor $Ge_{1-x}Fe_x$ Studied by Soft X-ray Angle Resolved Photoemission Spectroscopy	○(M2)Shoya Sakamoto[1], Yuki Wakabayashi[1], Yukiharu Takeda[2], Shin-ichi Fujimori[2], Hakuto Suzuki[1], Hiroshi Yamagami[2,3], Masaaki Tanaka[1], Shinobu Ohya[1], Atsushi Fujimori[1]	1.the Univ. of Tokyo, 2.JAEA, 3.Kyoto Sangyo Univ.
		11p-P1-19	全光型磁化反転形成磁区のGdFeCo薄膜隣接層構成依存性	○吉川 大貴[1], 佐藤 哲也[1], 塚本 新[1]	1.日大理工
		E 11p-P1-20	Spin-dependent transport property of organic-ferromagnetic hybrid junctions using [6]cyclo-2,7-naphthylenes	○Kazuya Suzuki[1], Xiao Xhang[1], Sugihara Atsushi[1], Sato Sota[1,2,4], Izumi Tomoo[2,3], Taka Hideo[2,3], Isobe Hiroyuki[1,2,4], Mizukami Shigemi[1]	1.Tohoku Univ.WPI-AIMR, 2.JST ERATO, 3.Konica Minolta, 4.Tohoku Univ. Dept. of Chemistry
		11p-P1-21	Fe酸化物挿入によるMgO上超薄膜FeおよびCo層の磁気特性改善	○野崎 隆行[1,4], 大久保 忠勝[2], 塩田 陽一[1,4], 久保田 均[1,4], 福島 章雄[1,4], 宝野 和博[2], 鈴木 義茂[3,4], 湯浅 新治[1,4]	1.産総研, 2.物材機構, 3.阪大基礎工, 4.JST-CREST
		奨・E 11p-P1-22	Fabrication of perpendicular magnetized spin filter junctions	○Hiroki Kajita[1], Takashi Yanase[1], Taro Nagahama[1], Toshihiro Shimada[1]	1.Hokkaido Univ.
		奨・E 11p-P1-23	Influence of oxygen pressure on electrical and magnetic properties of $CoFe_2O_4$ thin film	○Masato Araki[1], Takashi Yanase[1], Taro Nagahama[1], Toshihiro Shimada[1]	1.Hokkaido Univ.

		奨 11p-P1-24	MOD法によりガラス基板上へ作製した $Nd_{0.5}Bi_{2.5}Fe_{5-y}Ga_yO_{12}$ (y = 0〜1) 薄膜の磁気異方性	○婁 庚健[1], 佐々木 教真[1], 加藤 剛志[2], 岩田 聡[2], 石橋 隆幸[1]	1.長岡技科大, 2.名古屋大
		E 11p-P1-25	Magnetocrystalline Anisotropy in $Co_2(Fe_xMn_{1-x})Si$ Heusler Thin Films	○Takeshi Seki[1,2], Tatsuya Yamamoto[1], Takahide Kubota[1], Koki Takanashi[1]	1.IMR, Tohoku Univ., 2.JST-PRESTO
		E 11p-P1-26	Heusler ferrimagnetic multilayer with perpendicular magnetic anisotropy	Qinli Ma[1], Xianmin Zhang[1], Terunobu Miyazaki[1], ○Shigemi Mizukami[1]	1.WPI-AIMR, Tohoku Univ.
		E 11p-P1-27	Exchange bias in bilayers using anti-ferromagnetic Ni_2MnAl Heusler alloy thin film	○Tomoki Tsuchiya[1], Tomoko Sugiyama[1], Takahide Kubota[1], Koki Takanashi[1]	1.IMR, Tohoku Univ.
		11p-P1-28	垂直磁化磁気抵抗素子形成のためのMn_3Geエピタキシャル薄膜の表面平坦化	○(PC)杉原 敦[1], 鈴木 和也[1], 宮崎 照宣[1], 水上 成美[1]	1.東北大WPI-AIMR
		E 11p-P1-29	Temperature dependence of electric field effect on Magnetic Anisotropy in Pd/Co/Pt system	○(M1)Yuki Hibino[1], Aya Obinata[1], Tomohiro Koyama[1], Kazumoto Miwa[2], Shimpei Ono[2], Daichi Chiba[1]	1.The Univ. of Tokyo, 2.CRIEPI
		E 11p-P1-30	Dependence of Curie temperature on Pt underlayer thickness in Co/Pt system	○Tomohiro Koyama[1], Aya Obinata[1], Yuki Hibino[1], Atsuhumi Hirohata[2], Balati Kuerbanjiang[2], Vlado Lazalov[2], Daichi Chiba[1]	1.The Univ. of Tokyo, 2.The Univ. of York
		11p-P1-31	MOD法によるMgO(100)基板上に作製したCoフェライト薄膜の評価	○佐々木 教真[1], 二宮 南[1], 鶴井 隆雄[1], 篠崎 健二[1], 小松 高行[1], 柳原 英人[2], 喜多 英治[2], 石橋 隆幸[1]	1.長岡技科大, 2.筑波大
		E 11p-P1-32	Electric field effect on magnetic moment in Co/Pt using electric double layer capacitor structure	○Aya Obinata[1], Daichi Hayakawa[1], Kazumoto Miwa[2], Shimpei Ono[2], Tomohiro Koyama[1], Daichi Chiba[1]	1.The Univ. of Tokyo, 2.CRIEPI
		11p-P1-33	逆ペロブスカイト窒化物交換結合膜における電流誘起磁化スイッチング	榊原 英樹[1], ○黒木 庸次[1], 安藤 弘紀[1], 河合 俊介[1], 羽尻 哲也[1], 植田 研二[1], 浅野 秀文[1]	1.名大院工
		11p-P1-34	逆ペロブスカイトCo_3FeN薄膜の異方性磁気抵抗効果とスピン分極率	○安藤 弘紀[1], 河合 俊介[1], 榊原 英樹[1], 黒木 庸次[1], 羽尻 哲也[1], 植田 研二[1], 浅野 秀文[1]	1.名大院工
		11p-P1-35	形状制御したMn-Znフェライトの高周波特性	○星 和志[1], 茂木 光[1], 福長 隆之[2], 鈴木 宏輔[1], 古澤 伸一[1], 櫻井 浩[1]	1.群馬大理工, 2.東京パーツ工業
		11p-P1-36	Fe/MgO接合における磁気緩和の電界効果の第一原理計算	○三浦 良雄[1], 辻川 雅人[2,3], 白井 正文[2,3]	1.京都工繊大, 2.東北大通研, 3.東北大CSIS
		E 11p-P1-37	Implementation of phase locked loop using spin torque oscillator as a voltage controlled oscillator	○Shingo Tamaru[1], Bochong Wang[1], Hitoshi Kubota[1], Kay Yakushiji[1], Akio Fukushima[1], Shinji Yuasa[1]	1.AIST
		11p-P1-38	電流誘起磁化反転における電子散乱過程に関する非平衡第一原理計算	○洗平 昌晃[1], 山本 貴博[2], 白石 賢二[1]	1.名大院工, 2.東理大工
		E 11p-P1-39	Effect of High Substrate Temperature Fabrication on Spin Pumping in Polycrystalline Structured Co Films	○Shinji Isogami[1], Shintaro Hinata[2]	1.Fukushima NCT., 2.Tohoku Univ.
		E 11p-P1-40	Study of spin injection into few-layer graphene	○(M2)Dinh Hiep Duong[1], Muruganathan Manoharan[1], Hiroshi Mizuta[1,2]	1.JAIST, 2.Univ. of Southampton
		E 11p-P1-41	Composition- and cap-layer-dependence of electric-current-induced dynamics of bubble domains in TbFeCo wires	○Masaaki Tanaka[1], Hiroki Kanazawa[1], Sho Sumitomo[1], Syuta Honda[2], Ko Mibu[1], Hiroyuki Awano[3]	1.Nagoya Inst. of Tech., 2.Univ. of Tsukuba, 3.Toyota Tech. Inst.
		11p-P1-42	TbFeCoを電極としたYH_2チャネルの磁気電気伝導特性	○高尾 啓[1], 松永 智善[1], 飯笹 圭太郎[1], 西間木 誠[1], 酒井 政道[1], 樋口 宏二[2], 北島 彰[2], 大島 明博[2], 長谷川 繁彦[2], 兼平 冬馬[3], 粟野 博之[3]	1.埼玉大院理工, 2.阪大産研, 3.豊田工大
		E 11p-P1-43	Temperature dependence of magneto-transport properties in $Co_2Fe(Ga_{0.5}Ge_{0.5})$/Cu lateral spin valves	○(D)Ikhtiar Ikhtiar[1,3], Shinya Kasai[3], Akihide Itoh[2,3], Yukiko Takahashi[3], Tadakatsu Ohkubo[2,3], Seiji Mitani[1,3], Kazuhiro Hono[1,3]	1.Univ. of Tsukuba, 2.Tokyo Univ.of Science, 3.NIMS
		奨 11p-P1-44	新規3端子スピン軌道トルク素子の動作実証	○姉川 哲朗[1], 張 超亮[1], 深見 俊輔[2,3], 大野 英夫[1,2,3,4]	1.東北大通研, 2.東北大CSIS, 3.東北大CIES, 4.東北大WPI-AIMR
		E 11p-P1-45	High speed spin dynamics in CoFeB/Ta/CoFeB investigated by optical pump-probe technique	○Tatsuya Ito[1], Yuta Sasaki[2], Shinji Miwa[1], Kohei Nawaoka[1], Tashima Toshiyuki[1], Yoichi Shiota[1], Yosuke Wakatake[1], Katsunori Konishi[1], Hiroyuki Tomita[1], Norikazu Mizuochi[1], Shigemi Mizukami[3], Yoshishige Suzuki[1]	1.Osaka Univ., 2.Tohoku Univ., 3.WPI-Tohoku Univ.
		E 11p-P1-46	Magnetic resonance of Fe thin-films investigated by the anomalous Hall effect	○Shinji Miwa[1], Norikazu Mizuochi[1], Yoshishige Suzuki[1]	1.Osaka Univ.
		11p-P1-47	外部磁場中のスピンホール効果に関する古典的運動方程式	○酒井 政道[1]	1.埼玉大院理工
		11p-P1-48	MOD法により作製したNd系磁性ガーネット薄膜における縦型スピンゼーベック効果	○桑原 惇[1], 浅田 裕法[1], 婁 庚健[2], 石橋 隆幸[2], 岸本 堅剛[1], 小柳 剛[1]	1.山口大院理工, 2.長岡技科大工
		11p-P1-49	スピンゼーベック熱電変換素子の作製と評価	○平田 智士[1], 野田 和希[1], 岡田 一也[1], 雨宮 嘉照[1], 田部井 哲夫[1], 横山 新[1]	1.広島大学ナノデバイス・バイオ融合科学研究所
		11p-P1-50	補償組成近傍TbFeCo垂直磁気異方性薄膜の異常ネルンスト効果	○安藤 亮[1], 加藤 健[1], 飯村 修志[1], 小峰 啓史[2], 長谷川 靖洋[3]	1.茨城県工業技術センター, 2.茨城大学, 3.埼玉大学
		11p-P1-51	Py薄膜における励起スピン波の磁化方向依存性	○中山 真佐[1], 田島 摩百合[1], 葛西 伸哉[2], 三谷 誠司[2], 眞砂 卓史[1]	1.福岡大理, 2.物材機構
		11p-P1-52	静磁表面波の減衰長の磁性層厚依存性	○太田 雅己[1], 葛西 伸哉[2], 三谷 誠司[2], 眞砂 卓史[1]	1.福岡大理, 2.物材機構
		11p-P1-53	強磁性トンネル接合素子の非破壊検査への応用	○(M1)阿部 雅彦[1], 大兼 幹彦[1], 藤原 耕輔[1], 遠藤 基[1], 永沼 博[1]	1.東北大院工
		11p-P1-54	Study on Magnetic Separation Applied to Remove Micro Particles in Boiler Feed Water.	○(M2)今村 健太郎[1], 岡田 秀彦[2], 安藤 努[1], 廣田 憲之[2], 西嶋 茂宏[3]	1.日大院生産工, 2.物材機構, 3.阪大工
		11p-P1-55	磁場中コロイドプロセスによる$REBa_2Cu_3O_y$配向体の作製	○堀井 滋[1], 松浦 瞬[1], 土井 俊哉[1], 下山 淳一[2], 岸尾 光二[2]	1.京大院エネ科, 2.東大院工
		奨・E 11p-P1-56	Crystallization of taurine by LLIP method in high magnetic fields	○(B)tetsuya onotou[1]	1.YNU
		奨・E 11p-P1-57	Crystallization of Ice by LLIP Method under Magnetic Field	○(M1)yuta kimura[1]	1.YNU
		11p-P1-58	磁場配向グアニン結晶による光散乱強度の濃度依存性	○宮下 惟人[1,2], 岩坂 正和[1,3]	1.広島大, 2.JSPS, 3.JST

10.1 新物質創成(酸化物・ホイスラー・金属磁性体等) / Emerging materials in spintronics and magnetics (excluding semiconductors)　口頭講演

3月11日(水)　15:45 - 18:30

	15:45 - 16:00	E 11p-D11-1	Magnetoresistance of the Group-IV Ferromagnetic Semiconductor $Ge_{1-y}Fe_y$/Ge:B/$Ge_{1-x}Fe_x$ Trilayer Heterostructures	○Yoshisuke Ban[1], Ryosho Nakane[1], Masaaki Tanaka[1]	1.Univ. Tokyo
	16:00 - 16:15	E 11p-D11-2	Study on the onset of photo-excited precession of magnetization in Co/Pd multilayers	○Takashi Matsuda[1], Kazuhiro Nishibayashi[1], Hiro Munekata[1]	1.Tokyo Inst. Tech.
	16:15 - 16:30	11p-D11-3	種々の基板に成長したCo/Pd結晶性多層膜の光誘起磁化歳差運動	○(M1)高橋 克典[1], 西沢 望[1], 西林 一彦[1], 松田 喬[1], 岩崎 大和[1], 北本 仁孝[2], 宗片 比呂夫[1]	1.東工大像情報, 2.東工大物質科学
	16:30 - 16:45	11p-D11-4	Co/Pd 多層積層膜における磁化才差運動の局所的光励起・検出	○堀江 慧[1], 南 不二雄[1], 西林 一彦[1], 宗片 比呂夫[1]	1.東工大
	16:45 - 17:00	11p-D11-5	$Co_xMn_{4-x}N$ エピタキシャル薄膜の飽和磁化と垂直磁気異方性の評価	○伊藤 啓太[1,2,3], 安富 陽子[1], 鹿原 和樹[2], 具志 俊希[1], 東小薗 創真[1], 都甲 薫[1], 角田 匡清[2], 末益 崇[1]	1.筑波大数理物質, 2.東北大工, 3.学振
	17:00 - 17:15	11p-D11-6	MBE法によるα''-$Fe_{16}N_2$薄膜のエピタキシャル成長	○(B)東小薗 創真[1], 伊藤 啓太[1,2,3], 安富 陽子[1], 具志 俊希[1], 都甲 薫[1], 末益 崇[1]	1.筑波大 数理物質, 2.東北大 工, 3.学振
	17:15 - 17:30	11p-D11-7	負のスピン分極率を有するFe_4N強磁性細線の磁壁形成位置の制御	○具志 俊希[1], 伊藤 啓太[1,2,3], 安富 陽子[1], 東小薗 創真[1], 都甲 薫[1], 大里 啓孝[4], 杉本 喜正[4], 浅川 潔[1], 太田 憲雄[1], 本多 周太[1], 末益 崇[1]	1.筑波大数理物質, 2.東北大工, 3.学振, 4.物材機構
	17:30 - 17:45	E 11p-D11-8	High-frequency magnetic resonance in strained rare-earth iron garnet thin films	○Masaki Adachi[1], Hidekazu Nasu[1], HIroyasu Yamahara[1], Munetoshi Seki[1], Hiroaki Matsui[1], Hitoshi Tabata[1]	1.Univ. of Tokyo
	17:45 - 18:00	奨・E 11p-D11-9	Fabrication of Ga doped Gadolinium Iron Garnet Thin Films by Metal Organic Decomposition and their Magneto-optics Characterizations	○Jo Sato[1], Abdul Wahid Danish[1], Takaya Hattori[1], Hiromasa Shimizu[1]	1.Tokyo Univ. of Agri. & Tech
	18:00 - 18:15	E 11p-D11-10	Optical and magneto-optical properties of Bi substituted yttrium iron garnets prepared by metal organic decomposition	○(D)Eva Jesenska[1,2], Tomohiko Yoshida[1], Lukas Beran[2], Roman Antos[2], Martin Veis[2], Takayuki Ishibashi[1]	1.Nagaoka Univ. of Tech., 2.Charles Univ.
	18:15 - 18:30	11p-D11-11	スピン量子十字デバイス創製に向けたCo と$Ni_{75}Fe_{25}$ 薄膜の磁気特性	○森 澄人[1], 三澤 貴浩[1], 笠 晴也[1], 阿部 太郎[1], 海住 英生[1], 西井 準治[1]	1.北大電子研

3月12日(木)　9:00 - 11:45

	9:00 - 9:15	E 12a-D11-1	Crystal structure characterization of α-Cr_2O_3 layer of Pt/Co/α-Cr_2O_3 film possessing different exchange anisotropy energy	○Yu Shiratsuchi[1], Yuuta Nakano[1], Nobuhito Inami[2], Tetsuro Ueno[3], Kanta Ono[2], Reiji Kumai[2], Ryoko Sagayama[2], Chiharu Mitsumata[3], Tetsuya Nakamura[4], Ryoichi Nakatani[1]	1.Osaka Univ, 2.KEK, 3.NIMS, 4.JASRI/SPring-8
	9:15 - 9:30	E 12a-D11-2	Isothermal switching of perpendicular exchange anisotropy in Pt/Co/α-Cr_2O_3/Pt layered structure by pulsed voltage	○Yu Shiratsuchi[1], Kentaro Toyoki[1], Atsushi Kobane[1], Chiharu Mitsumata[2], Ryoichi Nakatani[1]	1.Osaka Univ, 2.NIMS
	9:30 - 9:45	奨・E 12a-D11-3	Antiferromagnetic anisotropy of buffered Cr_2O_3 thin films	○Tomohiro Nozaki[1], Naoki Shimomura[1], Satya Prakashi Pati[1], Masashi Sahashi[1]	1.Tohoku Univ.
	9:45 - 10:00	奨・E 12a-D11-4	Ir-doping effect on Morin temperature of alpha-Fe_2O_3 (0001) thin film	○(P)Satya Prakash Pati[1], N. Shimomura[1], Y. Hoshino[1], T. Nozaki[1], K. Mibu[2], M. Sahashi[1]	1.Tohoku University, 2.Nagoya Institute of Technology
	10:00 - 10:15	奨・E 12a-D11-5	Effect of off-stoichiometry on the half-metallic character of Heusler alloy Co_2(Mn,Fe)Si thin films	○(DC)Kidist Ayele[1], Yusuke Honda[1], Tetsuya Uemura[1], Masafumi Yamamoto[1], Yoshio Miura[2], Masafumi Shirai[3]	1.Division of Electronics for Informatics, Hokkaido Univ., 2.Mathematical and Physical Science, Kyoto Institute of Tech., 3.Research Institute of Electrical Communication, Tohoku Univ.
	10:15 - 10:30	E 12a-D11-6	Improvement of $L2_1$-ordering in half-metallic Heusler compounds by Ag-doping	Subrojati Bosu[1], ○Yuya Sakuraba[1], Taisuke Sasaki[1], Songtian Li[1], Kazuhiro Hono[1]	1.NIMS
	10:30 - 10:45	12a-D11-7	$L1_0$オーダーを制御した FePt 薄膜の Pt $L_{2,3}$ 吸収端 X 線磁気円二色性	○石上 啓介[1], 芝田 悟朗[1], 関 剛斎[2], 坂本 祥哉[1], 野中 洋亮[1], 鈴木 基寛[3], 高梨 弘毅[2], 藤森 淳[1]	1.東大理, 2.東北大金研, 3.JASRI
	10:45 - 11:00	E 12a-D11-8	Observation of perpendicular magnetization in Cu layer inserted between Co and Pt layers	○Jun Okabayashi[1], Tomohiro Koyama[2], Daichi Chiba[2]	1.School of Science, Univ. of Tokyo, 2.School of Engineering, Univ. of Tokyo
	11:00 - 11:15	12a-D11-9	Extended Study on Perpendicular Magnetic Anisotropy in Fe/MgO interfaces	具 正祐[1,2], 向 清懿[1,2], 温 振超[2], 介川 裕章[2], ○三谷 誠司[1,2]	1.筑波大数理, 2.物材機構
	11:15 - 11:30	E 12a-D11-10	Magnetic properties of Co ultra-thin film deposited directly on polar ZnO substrates	○Daichi Chiba[1], Naoya Shibata[2], Atsushi Tsukazaki[3]	1.Dep. of Appl. Phys., The Univ. of Tokyo, 2.IEI, The Univ. of Tokyo, 3.IMR, Tohoku Univ.
	11:30 - 11:45	E 12a-D11-11	Anomalous Nernst effect in heavy elements-doped Fe films	○Yuya Sakuraba[1], Yohei Kinoshita[2], Taisuke Sasaki[1], Mamoru Ishikiriyama[2], Kazuhiro Hono[1]	1.NIMS, 2.TOYOTA

10.2 スピントルク・スピン流・回路・測定技術 / Spin torque, spin current, circuits, and measurement technologies　口頭講演

3月12日(木)　13:15 - 18:30

	13:15 - 13:30	奨 12p-D11-1	垂直磁気異方性CoFeB-MgO磁気トンネル接合における閾値電流の温度依存性	○(M2)竹内 祐太朗[1,2], エノビオ エライ クリストファー[2], 佐藤 英夫[3,4], 深見 俊輔[3,4], 池田 正二[2,3,4], 松倉 文礼[1,2,3], 大野 英男[1,2,3,4]	1.東北大 WPI-AIMR, 2.東北大 通研 ナノスピン実験施設, 3.東北大 CSIS, 4.東北大 CIES
	13:30 - 13:45	奨 12p-D11-2	NCMR-Trilayer-STO素子を用いた低磁場での高Q値発振	○塩川 陽平[1], 戸田 裕介[1], Al-Mahdawi Muftah K.O[1], 佐橋 政司[1]	1.東北大工
	13:45 - 14:00	奨・E 12p-D11-3	Spin Torque Oscillator Based on a Point-Contact Geometry with Highly Spin-Polarized Co_2(Fe, Mn)Si	○(D)Tatsuya Yamamoto[1], Takashi Seki[1,2], Takahide Kubota[1], Hitomi Yako[1], Koki Takanashi[1]	1.IMR, Tohoku Univ., 2.JST-PRESTO
	14:00 - 14:15	奨・E 12p-D11-4	Universality classes for current- and field-induced domain wall creep in a Ta/CoFeB/MgO/Ta wire	○(D)Samik Duttagupta[1], Shunsuke Fukami[2,3], Chao Liang Zhang[1], Hideo Sato[2,3], Michihiko Yamanouchi[1,2], Fumihiro Matsukura[1,2,4], Hideo Ohno[1,2,3,4]	1.RIEC, Tohoku Univ., 2.CSIS, Tohoku Univ., 3.CIES, Tohoku Univ., 4.WPI-AIMR, Tohoku Univ.
	14:15 - 14:30	奨・E 12p-D11-5	Device size dependence of switching current for magnetization reversal induced by spin-orbit torque in Ta/CoFeB/MgO structures down to 30 nm	○Chaoliang Zhang[1], Shunsuke Fukami[2,3], Hideo Sato[2,3], Fumihiro Matsukura[1,2,4], Hideo Ohno[1,2,3,4]	1.RIEC, Tohoku Univ., 2.CSIS, Tohoku Univ., 3.CIES, Tohoku Univ., 4.WPI-AIMR, Tohoku Univ.
	14:30 - 14:45	E 12p-D11-6	Controlling spin transmission and the Dzyaloshinskii-Moriya interaction at interfaces in magnetic heterostructures	○Masamitsu Hayashi[1], Jacob Torrejon,-Junyeon Kim,Peng Sheng,Seiji Mitani	,1.NIMS

	14:45 - 15:00	E 12p-D11-7	Layer thickness dependence of spin orbit torques and fields in Pt/Co/AlO trilayer structure	○(B)Minsik KONG[1], Tim Yang[1], Makoto Kohda[1], Takeshi Seki[2], Koki Takanashi[2], Junsaku Nitta[1]	1.Tohoku Univ., 2.Tohoku Univ. IMR
	15:00 - 15:15	E 12p-D11-8	Spin orbit interaction depending on crystal structures of Ta thin films	○Hiromu Gamou[1], Jeongchun Ryu[1], Rento Ohsugi[1], Makoto Kohda[1], Junsaku Nitta[1]	1.Tohoku Univ.
	15:15 - 15:30	E 12p-D11-9	Critical current of magnetization dynamics excited by spin-Hall torque in the presence of transverse magnetic field	○Tomohiro Taniguchi[1], Seiji Mitani[2], Masamitsu Hayashi[2]	1.AIST, 2.NIMS
	15:30 - 15:45	12p-D11-10	低融点ガラスに挟まれたCo薄膜の磁気特性評価とスピン注入デバイスへの応用	○三澤 貴浩[1], 森 澄人[1], 阿部 太郎[1], 笠 晴也[1], 海住 英生[1], 西井 準治[1]	1.北大電子研
	15:45 - 16:00		休憩/Break		
	16:00 - 16:15	12p-D11-11	2端子Co_2FeSiスピン注入による巨大純スピン流の生成	○黒川 孝幸[1], 沖 宗一郎[1], 山田 晋也[1], 金島 岳[1], 浜屋 宏平[1,2]	1.阪大基礎工, 2.JST-CREST
	16:15 - 16:30	E 12p-D11-12	Generation and detection of pure spin currents through epitaxial Ge/Fe_3Si heterostructures	○Makoto Kawano[1], Kohei Santo[1], Soichiro Oki[1], Shinya Yamada[1], Takeshi Kanashima[1], Kohei Hamaya[1,2]	1.Osaka Univ., 2.JST-CREST
	16:30 - 16:45	E 12p-D11-13	Large spin accumulation signal in a lateral spin valve with nondegenerate Si channel	○Yuichiro Ando[1], Hayato Koike[2], Takayuki Tahara[1], Makoto Kameno[3], Tomoyuki Sasaki[2], Yoshishige Suzuki[3], Masashi Shiraishi[1]	1.Kyoto Univ., 2.TDK Corporation, 3.Osaka Univ
	16:45 - 17:00	E 12p-D11-14	Highly efficient spin pumping from a single-crystalline Fe_3Si layer into a Si channel	○Yuichiro Ando[1], Kouki Ichiba[2], Shinya Yamada[2], Teruya Shinjo[1], Kohei Hamaya[2], Masashi Shiraishi[1]	1.Kyoto Univ., 2.Osaka Univ.
	17:00 - 17:15	E 12p-D11-15	Observation of Joule-heating-induced spin injection and transport in highly-doped n-type Si	○(DC)Makoto Kameno[1,2], Hayato Koike[3], Yuichiro Ando[2], Teruya Shinjo[2], Tomoyuki Sasaki[3], Yoshishige Suzuki[1], Masashi Shiraishi[2]	1.Osaka Univ., 2.Kyoto Univ., 3.TDK Co.
	17:15 - 17:30	奨・E 12p-D11-16	Dynamical spin injection into n-type 4H-SiC	○(B)Ei Shigematsu[1], Yuuichiro Ando[1], Gaku Eguchi[1], Teruya Shinjo[1], Tsunenobu Kimoto[1], Masashi Shiraishi[1]	1.Kyoto Univ.
	17:30 - 17:45	E 12p-D11-17	Ferromagnetic resonance induced electrical signals in Pt/(Ga,Mn)As	○Hiroyasu Nakayama[1], Lin Chen[2], Hsiao Wen Chang[1,3], Fumihiro Matsukura[1,2,4], Hideo Ohno[1,2,4]	1.LNS, RIEC, Tohoku Univ., 2.WPI-AIMR, Tohoku Univ., 3.National Sun Yat-Sen Univ., 4.CSIS, Tohoku Univ.
	17:45 - 18:00	奨・E 12p-D11-18	Fe impurity contribution to Spin-Seebeck effect in Pt thin film	○Jeongchun Ryu[1], Kotaro Mizunuma[2], Yuta Saiga[2], Yasushi Kono[2], Makoto Kohda[1], Junsaku Nitta[1]	1.Tohoku univ., 2.DENSO CORPORATION
	18:00 - 18:15	E 12p-D11-19	Spin-Seebeck effect in CuPt thin films with different Pt concentration	○hiroshi ono[1], Jeong Chun Ryu[1], Yuta Saiga[2], Kotaro Mizunuma[2], Yasushi Kono[2], Makoto Kohda[1], Junsaku Nitta[1]	1.Tohoku Univ, 2.DENSO CORPORATION
	18:15 - 18:30	E 12p-D11-20	Composition dependence of anomalous Nernst effect in Mn_x-Ga_{1-x} epitaxial thin films	○Masaki Inoue[1], Masaki Mizuguchi[1], Shigemi Mizukami[2], Koki Takanashi[1]	1.IMR, Tohoku Univ., 2.WPI-AIMR, Tohoku Univ.

10.3 GMR・TMR・磁気記録技術 / Giant magnetoresistance (GMR), tunnel magnetoresistance (TMR) and magnetic recording technologies
口頭講演

3月13日(金) 16:15 - 18:15

	16:15 - 16:30	奨・E 13p-D11-1	A theoretical study of thermally activated magnetization switching under microwave assistance	○Hirofumi Suto[1], Kiwamu Kudo[1], Tazumi Nagasawa[1], Taro Kanao[1], Koichi Mizushima[1], Rie Sato[1], Satoshi Okamoto[2], Nobuaki Kikuchi[2], Osamu Kitakami[2], Takehito Shimatsu[2]	1.Toshiba R&D Center, 2.Tohoku Univ.
	16:30 - 16:45	E 13p-D11-2	Resonant magnetization switching induced by spin-torque-driven oscillations	○Kiwamu Kudo[1], Hirofumi Suto[1], Nagasawa Tazumi[1], Mizushima Koichi[1], Sato Rie[1]	1.Toshiba Corporation
	16:45 - 17:00	E 13p-D11-3	High-output microwave detector using voltage-induced ferromagnetic resonance	○Yoichi Shiota[1,2,3], Shinji Miwa[2,3], Shingo Tamaru[1], Takayuki Nozaki[1,3], Hitoshi Kubota[1,3], Akio Fukushima[1,3], Yoshishige Suzuki[1,2,3], Shinji Yuasa[1,3]	1.AIST Spintronics RC, 2.Osaka Univ., 3.JST-CREST
	17:00 - 17:15	13p-D11-4	dc Bias Voltage Dependence of Magnetic Anisotropy in CoFeB/MgO Investigated by Electric Field-Induced Ferromagnetic Resonance	○金井 駿[1,3], Gajek Martin[2], Worledge Daniel[2], 松倉 文礼[1,3,4], 大野 英男[1,3,4]	1.東北大学通研, 2.IBM TJ Watson Research Center, 3.東北大学CSIS, 4.東北大学WPI-AIMR
	17:15 - 17:30	奨・E 13p-D11-5	rf power dependence of homodyne-detected ferromagnetic resonance spectra of a CoFeB/MgO magnetic tunnel junction	○Eriko Hirayama[1], Shun Kanai[1], Jun-ichiro Ohe[2], Hideo Sato[3,4], Fumihiro Matsukura[1,3,5], Hideo Ohno[1,3,4,5]	1.Laboratory for Nanoelectronics and Spintronics, RIEC, Tohoku Univ., 2.Department of Physics, Toho Univ., 3.CSIS, Tohoku Univ., 4.CIES, Tohoku Univ., 5.WPI-AIMR, Tohoku Univ.
	17:30 - 17:45	E 13p-D11-6	Effects of Transition Metal Oxide on Voltage Control of Magnetic Anisotropy of CoFeB/MO_x Stacks	○Ryusuke Oishi[1], Kazuki Segawa[1], Koji Kita[1]	1.The Univ. of Tokyo
	17:45 - 18:00	奨・E 13p-D11-7	Highly (001) textured $L1_0$-CoPt/TiN multilayer films with perpendicular magnetic anisotropy	○(DC)HONGYU AN[1]	1.Titech
	18:00 - 18:15	E 13p-D11-8	Effect of oxygen exposure at Co_2FeSi/MgO interfaces on perpendicular magnetic anisotropy of Co_2FeSi layer	○Kouki Shinohara[1], Takahiro Suzuki[1], Yota Takamura[1], Shigeki Nakagawa[1]	1.Dept. of Phys. Electron., Tokyo Tech.

3月14日(土) 13:00 - 15:00

招待	**13:00 - 13:30**	**14p-D11-1**	**「第5回女性研究者研究業績・人材育成賞(小舘香椎子賞)受賞記念講演」(30分) 垂直通電型巨大磁気抵抗効果増大の開発 ～スピントロニクス産業へ向けて～**	**○湯浅 裕美[1]**	**1.東芝**
	13:30 - 13:45	E 14p-D11-2	Bias voltage dependence in magnetic tunnel junctions with a spinel Mg-Al-O barrier	○Hiroaki Sukegawa[1], Koichiro Inomata[1], Seiji Mitani[1]	1.NIMS
	13:45 - 14:00	E 14p-D11-3	Enhancement of CPP-GMR by a CuZn alloy spacer layer	○Takao Furubayashi[1], Yukiko Takahashi[1], Taisuke Sasaki[1], Kazuhiro Hono[1]	1.NIMS
	14:00 - 14:15	E 14p-D11-4	Current-perpendicular-to-plane giant magnetoresistance effect in Co_2(Fe-Mn)Si/Ag-Mg/Co_2(Fe-Mn)Si junctions	Hiroyuki Narisawa[1], ○Takahide Kubota[1], Koki Takanashi[1]	1.IMR, Tohoku Univ.
	14:15 - 14:30	E 14p-D11-5	Polycrystalline CPP-GMR devices using <001> textured $Co_2Fe(Ga_{0.5}Ge_{0.5})$ Heusler alloy layer and conductive $Mg_{0.5}Ti_{0.5}O_x$ buffer layer	○(D)YE DU[1,2], Takao Furubayashi[2], Yukiko Takahashi[2], Yuya Sakuraba[2], Kazuhiro Hono[1,2]	1.Univ. of Tsukuba, 2.NIMS
	14:30 - 14:45	奨・E 14p-D11-6	Temperature dependence of spin-dependent tunneling resistances of Co_2MnSi and Co_2(Mn,Fe)Si MTJs showing high tunneling magnetoresistances	○(D)Bing Hu[1], Takeshi Kawami[1], Kidist Moges[1], Tetsuya Uemura[1], Masafumi Yamamoto[1]	1.Hokkaido Univ.

	14:45 - 15:00	奨・E 14p-D11-7	Crystal orientation dependence in all-B2-trilayer current-perpendicular-to-plane giant magnetoresistance pseudo spin-valves using $Co_2Fe(Ge_{0.5}Ga_{0.5})$ Heusler alloy and NiAl spacer	○(D)Jiamin CHEN[1,2], Takao Furubayashi[1], Yukiko Takahashi[1], Taisuke Sasaki[1], Kazuhiro Hono[1,2]	1.NIMS, 2.Tsukuba Univ.

10.4 半導体・有機・光・量子スピントロニクス / Semiconductors, organic, optical, and quantum spintronics　口頭講演

3月14日(土)　9:00 - 12:00

招待	**9:00 - 9:30**	**14a-D2-1**	**「第5回化合物半導体エレクトロニクス業績賞(赤﨑勇賞)受賞記念講演」(30分) AlInAs/GaInAsから強磁性半導体GaMnAsまで**	**○大野 英男[1]**	**1.東北大学**
招待	**9:30 - 9:45**	**E 14a-D2-2**	**[Young Scientist Presentation Award Speech] (15min.) Electrical modulation of ferromagnetism via controlling the wavefunction in n-type ferromagnetic semiconductor (In,Fe)As quantum wells**	**○Duc Anh Le[1], Nam Hai Pham[1,2], Yuichi Kasahara[1,3], Yoshihiro Iwasa[1,4], Masaaki Tanaka[1]**	**1.The University of Tokyo, 2.Tokyo Institute of Technology, 3.Kyoto University, 4.RIKEN Center for Emergent Matter Science**
	9:45 - 10:00	奨・E 14a-D2-3	Temperature dependent direction of in-plane uniaxial magnetic anisotropy in (Ga,Mn)As codoped with Li	○Shohei Miyakozawa[1], Lin Chen[2], Fumihiro Matsukura[2,3], Hideo Ohno[1,2,3]	1.LNS-RIEC, Tohoku Univ., 2.WPI-AIMR, Tohoku Univ., 3.CSIS, Tohoku Univ.
	10:00 - 10:15	奨・E 14a-D2-4	Room-temperature local ferromagnetism and its nanoscale domain growth in the ferromagnetic semiconductor $Ge_{1-x}Fe_x$	○(D)Yuuki Wakabayashi[1], Shoya Sakamoto[1], Keisuke Ishigami[1], Yukio Takahashi[1], Yukiharu Takeda[2], Yuji Saitoh[2], Hiroshi Yamagami[2], Atushi Fujimori[1], Masaaki Tanaka[1], Shinobu Ohya[1]	1.Univ. of Tokyo, 2.JAEA
	10:15 - 10:30	奨・E 14a-D2-5	Fabrication and evaluation of a GaMnAs-based three-terminal magnetoresistance-modulation device	○Toshiki Kanaki[1], Hirokatsu Asahara[2], Shinobu Ohya[1], Masaaki Tanaka[1]	1.The Univ. of Tokyo, Graduate School, 2.The Univ. of Tokyo
	10:30 - 10:45		休憩/Break		
	10:45 - 11:00	奨・E 14a-D2-6	The dependence on carrier density, Co content, and thickness of magnetic domain structure in anatase $(Ti,Co)O_2$ thin films	○(D)Thantip Krasienapibal[1], Tomoteru Fukumura[1,2,3], Tetsuya Hasegawa[1,2,3]	1.University of Tokyo, 2.JST-CREST, 3.KAST
	11:00 - 11:15	奨・E 14a-D2-7	Intrinsic spectrum of reflection magnetic circular dichroism of GaMnAs thin films	○Hiroshi Terada[1], Shinobu Ohya[1], Masaaki Tanaka[1]	1.The Univ. of Tokyo
	11:15 - 11:30	奨・E 14a-D2-8	Band structure of GaMnAs near the Fermi level studied by time-resolved light-induced reflectivity measurements	○(M2)Tomoaki Ishii[1], Tadashi Kawazoe[1], Yusuke Hashimoto[2], Hiroshi Terada[1], Iriya Muneta[1], Motoichi Ohtsu[1], Masaaki Tanaka[1], Shinobu Ohya[1]	1.The Univ. of Tokyo, 2.Radboud Univ. Nijmegen
	11:30 - 11:45	E 14a-D2-9	The effect of F-doping on magnetism in diluted magnetic semiconductor (Zn,Co)O thin films	○(M2)Ryo Ishikawa[1], Shinji Kuroda[1], Hironori Ofuchi[2]	1.Grad. School of Pure & Appl. Sci., Univ. Tsukuba, 2.JASRI/SPring-8
	11:45 - 12:00	奨・E 14a-D2-10	Magneto-optical and magneto-transport characteristics of heavily Fe-doped ferromagnetic semiconductor (Ga,Fe)Sb	○Thanh Tu Nguyen[1], Pham Nam Hai[1,2], Le Duc Anh[1], Masaaki Tanaka[1]	1.Tokyo Univ., 2.Tokyo Tech Inst.

3月14日(土)　13:00 - 15:00

	13:00 - 13:15	E 14p-D2-1	A phenomenological model for the helicity dependent photocurrent in a ferromagnet – insulator – semiconductor junction	○(D)Ronel Roca[1], Nozomi Nishizawa[1], Takashi Matsuda[1], Hiro Munekata[1]	1.Tokyo Tech.
	13:15 - 13:30	奨・E 14p-D2-2	Electrical detection of the ratio of Rashba and Dresselhaus spin orbit interactions in InGaAs/InAlAs quantum wires	○Kohei Yoshizumi[1], Makoto Kohda[1], Junsaku Nitta[1]	1.Tohoku Univ.
	13:30 - 13:45	E 14p-D2-3	Spatial mapping of spin polarization in InGaAs quantum wells at high temperature using Monte Carlo simulation	○RYOTA KUROSAWA[1], KEN MORITA[1], YOSHIHIRO ISHITANI[1]	1.Chiba Univ.
	13:45 - 14:00	E 14p-D2-4	Electrical control of drifting spin coherence in GaAs quantum well	○Yoji Kunihashi[1], Haruki Sanada[1], Hideki Gotoh[1], Koji Onomitsu[1], Makoto Kohda[2], Junsaku Nitta[2], Tetsuomi Sogawa[1]	1.NTT BRL, 2.Tohoku Univ.
	14:00 - 14:15	奨・E 14p-D2-5	Electric-Field Dependence of Coherence Time of the Electron Spin in the Diamond Nitrogen-Vacancy Center	○Satoshi Kobayashi[1,2], Hiroki Morishita[1], Shinji Miwa[1], Yoshishige Suzuki[1], Norikazu Mizuochi[1,2]	1.Osaka Univ., 2.CREST
	14:15 - 14:30	奨・E 14p-D2-6	Electrical detection of nuclear magnetic resonance in GaAs using Heusler alloy Co_2MnSi	○Takafumi Akiho[1], Yuya Ebina[1], Masafumi Yamamoto[1], Tetsuya Uemura[1]	1.Grad. School of Information Science and Technology, Hokkaido Univ.
	14:30 - 14:45	E 14p-D2-7	Dynamical spin injection into solution-processed Carbon-nanotubes	○(B)Hiroshi Nagano[1], Yuichiro Ando[1], Teruya Shinjo[1], Hiromichi Kataura[2], Takeshi Tanaka[2], Masashi Shiraishi[1]	1.Kyoto Univ., 2.AIST
	14:45 - 15:00	14p-D2-8	シリコン上酸化マグネシウム薄膜中の常磁性欠陥評価	○林 寛[1], 松村 佳人[1], 森下 弘樹[1], 小池 勇人[2], 三輪 真嗣[1], 水落 憲和[1], 鈴木 義茂[1]	1.大阪大学, 2.TDK

10.5 磁場応用 / Application of magnetic field　口頭講演

3月14日(土)　9:00 - 12:00

	9:00 - 9:15	14a-D11-1	パルスならびに定常磁場を用いたCoO反強磁性相のバリアント再配列	○寺井 智之[1], 掛下 知行[1], 徳永 将史[2], 赤木 暢[3]	1.阪大工, 2.東大物性研, 3.阪大理先端強磁場
	9:15 - 9:30	14a-D11-2	銅磁気電析のキラル界面形成への添加剤の影響	○茂木 巖[1], 青柿 良一[2], 渡辺 和雄[1]	1.東北大金研, 2.職業大
	9:30 - 9:45	14a-D11-3	光触媒反応磁場効果モデルの検討	○奥村 英之[1], 遠藤 晋[1], 山末 英嗣[1], 石原 慶一[1]	1.京大エネ科
	9:45 - 10:00	14a-D11-4	Magnetic manipulation of light reflection and mirror angle for the organic crystal mirror in minute solution	○(D)水川 友里[1,2], 岩坂 正和[1,3]	1.広島大院, 2.日本学術振興会, 3.科学技術振興機構
	10:00 - 10:15	14a-D11-5	強磁場中回転容器内の非定常流れが配向粒子に及ぼす影響	○(M2)井上 真生[1], 安藤 努[1], 廣田 憲之[2]	1.日大院生産工, 2.物材機構
	10:15 - 10:30		休憩/Break		
	10:30 - 10:45	奨 14a-D11-6	強磁場中におけるBi-Mn合金の巨視的変化の観察	○(B)宮崎 泰樹[1], 平 敦志[1], 三井 好古[1], アベ松 賢一[1], 高橋 弘紀[2], 宇田 聡[2], 渡辺 和雄[2], 小山 佳一[1]	1.鹿大理, 2.東北大金研
	10:45 - 11:00	奨・E 14a-D11-7	Crystal Growth of NaCl by LLIP Method under Magnetic Fields II	○(M1)Ryusei Semba[1], Ryosuke Yoshida[1], Taku Arashiro[1], Shun Ozawa[1], Isao Yamamoto[1]	1.Yokokoku Univ.
	11:00 - 11:15	奨・E 14a-D11-8	Optical Properties of C_{60}NW Precipitated in Magnetic Fields	○Taku Arashiro[1], Kazuki Kanei[1], Syun Ozawa[1], Isao Yamamoto[1]	1.YNU
	11:15 - 11:30	E 14a-D11-9	Observation of Insulating Particle Motion in Electrically Conductive Fluid under Oscillating Electromagnetic Field	○Asuka Maruyama[1], Iwai Kazuhiko[1]	1.Hokkaido Univ.
	11:30 - 11:45	E 14a-D11-10	Magnetic Phase Transition for Supercooled Liquid of Bi-Mn II	○Rio Murase[1], Shun Ozawa[1], Isao Yamamoto[1]	1.Yokohama Nat'l Univ.

	11:45 - 12:00	E 14a-D11-11	Detection of Magnetic Nanoparticles Using Magnetically-assisted Impedance Spectroscopy	○BagusTrisnanto Suko[1], Yoshitaka Kitamoto[1]	1.Tokyo Inst. of Tech.

11 超伝導 / Superconductivity

11 超伝導 / Superconductivity　　ポスター講演

3月12日(木)　9:30 - 11:30

		12a-P9-1	グラファイト表面にアルカンを接触させることによる室温超伝導を引き起こすプロトン生成の証拠	○川島 康[1]	1.東海大工
		12a-P9-2	d波層状超伝導体におけるc軸方向パラ伝導率の理論的評価	青葉 知弥[1], 古瀬 京介[2], 今成 一雄[2], ○森 夏樹[2], 臼井 友洋[3], 足立 伸太郎[3], 渡辺 孝夫[3], 末松 久幸[1]	1.長岡技科大, 2.小山高専, 3.弘前大学
		12a-P9-3	MOD法による非c軸配向BSCCO薄膜の作製(II)	○山田 靖幸[1], 羽根田 海生[1], 松崎 亮博[1], 森 夏樹[1], 渥美 太郎[1], 加藤 孝弘[2], 石橋 隆幸[2]	1.小山高専, 2.長岡技科大
		12a-P9-4	改良型母材粉砕法によるBi系高温超伝導ウィスカーの育成	○田中 博美[1], 西尾 知美[1], 小西 那奈[1], 吉川 英樹[2], 岸田 悟[3]	1.米子高専, 2.物材機構, 3.鳥大院工
		12a-P9-5	固有ジョセフソン接合を用いたテラヘルツ波発振素子の放射特性の解析(II)	○立木 隆[1], 内田 貴司[1]	1.防衛大・電気電子
		12a-P9-6	NaOH-KOHフラックス法を用いて成膜したEu123, Eu124膜の特性評価	○宮地 優悟[1], 奥西 亮太[1], 舩木 修平[1], 山田 容士[1]	1.島根大学
		奨 12a-P9-7	KOHフラックス法を用いた$REBa_2Cu_3O_y$膜作製時の酸素分圧制御によるRE/Ba置換の抑制	○舩木 修平[1], 奥西 亮太[1], 宮地 優悟[1], 山田 容士[1]	1.島大総理工
		12a-P9-8	KOH flux法で合成したRE123相の酸素分圧の制御によるRE/Ba置換の制御	○奥西 亮太[1], 舩木 修平[1], 宮地 優悟[1], 山田 容士[1]	1.島大総理工
		12a-P9-9	部分的に立方体集合組織を有するニッケル平角線の作製	○山崎 裕文[1], 山口 巌[1]	1.産総研
		12a-P9-10	圧延と熱処理によるYBCOテープ用金属基板の作製(3)	○岡井 大祐[1,4], 信川 和毅[1], 山本 厚之[1], 土井 俊哉[2,4], 堀井 滋[2,4], 一瀬 中[3,4]	1.兵庫県立大工, 2.京大エネ科, 3.電中研, 4.JST-ALCA
		12a-P9-11	配向銅テープ上におけるNbドープ$SrTiO_3$薄膜の作製条件の検討	○橋本 真幸[1], 中 順平[1], 内間 貴之[1], 堀井 滋[1,2], 土井 俊哉[1,2]	1.京大院エネ科, 2.JST-ALCA
		12a-P9-12	単結晶基板を用いたY系超伝導体の縦磁界下における臨界電流特性	○木戸 竜馬[1], 秀島 匡彦[1], 木内 勝[1], 小田部 荘司[1], 松下 照男[1], 佐藤 迪夫[2], 三浦 正志[2]	1.九工大情報工, 2.成蹊大理工
		12a-P9-13	多種形状MgB_2超電導バルク磁石の捕捉磁場分布	○石原 篤[1], 赤坂 友幸[1], 富田 優[1], 山本 明保[2,3], 岸尾 光二[2]	1.鉄道総研, 2.東大院工, 3.さきがけ
		12a-P9-14	冷凍機冷却による多層リング状バルク超電導体の性能評価	○赤坂 友幸[1], 石原 篤[1], 福本 祐介[1], 富田 優[1], 禹 泰城[2], 関野 正樹[2], 大崎 博之[2]	1.鉄道総研, 2.東大
		12a-P9-15	超伝導線材を用いた液体水素液面計に関する理論的考察	渡邉 紗良[1,2], ○馬渡 康徳[2], 石田 茂之[2], 土屋 佳則[2], 吉田 良行[2], 西尾 太一郎[1]	1.東理大, 2.産総研
		E 12a-P9-16	Observation of inhomogeneous profiles of current density in BSCCO and YBCO tapes from residual magnetic field measurement	○(D)Mohamed Tallouli[1], Jian Sun[1], Yuri Ivanov[1], Mirofumi Watanabe[1], Makoto Hamabe[1], Noriko Chikumoto[1], Satarou Yamaguchi[1], Oleg Shyshkin[2], Samia Charfi-Kaddour[3]	1.Chubu Univ., 2.Kharkiv National Univ., 3.Univ. of El Manar
		12a-P9-17	Al層の追加によるNb/Al/AlOx/Nb接合のリーク電流の低減	○(M1)池谷 瑞基[1], 酒井 剛[1], 小嶋 崇文[2], 野口 卓[2]	1.電気通信大学, 2.国立天文台
		12a-P9-18	TiNバッファー層上のNbNトンネル接合の作製と評価	○牧瀬 圭正[1], 寺井 弘高[1]	1.情通機構
		12a-P9-19	2並列非対称ナノブリッジの特性	○伊藤 雄記[1], 井上 真澄[2], 藤巻 朗[1]	1.名大院工, 2.名城大理工
		12a-P9-20	単一磁束量子回路の高温動作化に向けたNbTiN配線のシートインダクタンスの温度依存特性評価	坂本 隼也[1], ○宗本 健太郎[1], 赤池 宏之[1], 藤巻 朗[1]	1.名大院工
		12a-P9-21	単結晶NbTiN薄膜の超伝導カイネティックインダクタンス非線形性	○武田 正典[1], 小嶋 崇文[2], 齊藤 敦[3], 牧瀬 圭正[4], 鵜澤 佳徳[4], 齋藤 伸吾[4], 島影 尚[5]	1.静大院工, 2.国立天文台, 3.山形大院工, 4.情通機構, 5.茨城大工
		12a-P9-22	700 MHz NMR用超伝導検出コイルの開発 ～サファイアプレートを用いた共振周波数シフト～	○越田 和磨[1], 北島 慶太[1], 今野 正貴[1], 山田 貴大[1], 高橋 雅人[2], 齊藤 敦[1], 大嶋 重利[1]	1.山形大院理工, 2.理研
		12a-P9-23	1000素子アレイ化に向けての3次元構造STJ-X線検出器の開発(3)	○藤井 剛[1], 浮辺 雅宏[1], 大久保 雅隆[1]	1.産総研
		12a-P9-24	量子効率100%のパラレル型超伝導ストリップイオン検出器	○全 伸幸[1], 志岐 成友[1], 藤井 剛[1], 浮辺 雅宏[1], 小池 正記[1], 大久保 雅隆[1]	1.産総研
		12a-P9-25	光ファイバ自己整合型構造を用いた高効率超伝導光子数識別器の開発	藪野 正裕[1,2], 布川 裕真[1,2], ○田辺 稔[2], 沼田 孝之[2], 吉澤 明男[2], 土田 英実[2], 枝松 圭一[1], 福田 大治[2]	1.東北大学, 2.産総研
		E 12a-P9-26	Broadening of Superconducting Transition in NbTiN Nanowires on Si-substrate	○Wei Qiu[1], Saburo Imamura[1], Shigehito Miki[1], Kazumasa Makise[1], Hirotaka Terai[1]	1.NICT
		12a-P9-27	N/I/S トンネル接合型固体冷凍素子の開発III	○柏谷 聡[1], 柏谷 裕美[1], 小柳 正男[1]	1.産総研
		12a-P9-28	溝によって分離されたゲート電極をもつ$YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$ナノチャネル素子において観測された電界効果	○守屋 雅隆[1], 新タ 智啓[1], 河原木 槙二[1], 水柿 義直[1,2]	1.電通大, 2.CREST, JST

11.1 基礎物性 / Fundamental properties　　口頭講演

3月11日(水)　14:00 - 16:45

	14:00 - 14:15	11p-A2-1	グラフェンを用いた交差アンドレーエフ反射検出器の作製	○上保 淳敬[1], 津村 公平[1], 高柳 英明[1,2]	1.東理大応, 2.物材機構MANA
	14:15 - 14:30	11p-A2-2	グラフェン／超伝導体接合の輸送特性に対する光照射効果のゲート電圧変化	○津村 公平[1], 古川 直紀[1], 伊藤 宙陛[2], 渡辺 英一郎[2], 津谷 大樹[2], 高柳 英明[1,3]	1.東理大, 2.NIMS微細加工PF, 3.NIMS-MANA
	14:30 - 14:45	11p-A2-3	$Bi_2Sr_{2-x}La_xCaCu_2O_{8+\delta}$における固有ジョセフソン特性	○野村 義樹[1], 温 一凡[1], 神原 仁志[1], 掛谷 一弘[1]	1.京大院工
	14:45 - 15:00	11p-A2-4	大面積固有ジョセフソン接合のリトラッピング特性	○村田 健一郎[1], 赤坂 圭司[1], 八巻 和宏[1], 入江 晃亘[1]	1.宇都宮大工
	15:00 - 15:15	11p-A2-5	パルス電流印加法を用いたメサ型固有接合の発熱評価	○(BC)岩塚 紳矢[1], 及川 大[1], 室谷 英彰[1], 杉浦 藤虎[1], 安藤 浩哉[1], 塚本 武彦[1]	1.豊田高専
	15:15 - 15:30		休憩/Break		

	15:30 - 15:45	11p-A2-6	塩酸改質法により作製した固有ジョセフソン接合テラヘルツ波発振素子	○赤坂 圭司[1], 倉成 友理[1], 八巻 和宏[1], 入江 晃亘[1]	1.宇都宮大工
	15:45 - 16:00	11p-A2-7	両面加工法で作製したBi系固有接合スタックの発振特性と温度分布評価	○加藤 孝弘[1], 西方 翼[1], 小瀧 侑央[1], 安井 寛治[1], 末松 久幸[1], 石橋 隆幸[1], 王 華兵[2], 羽多野 毅[2], 川上 彰[3]	1.長岡技大, 2.物材機構, 3.情報通信研究機構
	16:00 - 16:15	11p-A2-8	希塩酸法で作製された$Bi_2Sr_2CaCu_2O_y$スタックの電磁波放射特性の幾何学的依存性	○小瀧 侑央[1], 加藤 孝弘[2], H.B. Wang[3], 羽多野 毅[2], 川上 彰[4], 鈴木 常生[1], 中山 忠親[1], 新原 晧一[1]	1.長岡技大極限センター, 2.長岡技大 電気系, 3.物材研, 4.情報通信研究機構
	16:15 - 16:30	11p-A2-9	Laドープ$Bi_2Sr_2CaCu_2O_{8+\delta}$によるテラヘルツ波発振	○(M1)温 一凡[1]	1.京都大工
	16:30 - 16:45	11p-A2-10	$Bi_2Sr_2CaCu_2O_{8+\delta}$薄膜固有ジョセフソン接合テラヘルツ波発振デバイスの 液体窒素温度動作	○竹野 智史[1], 渡辺 祥吾[1], 木村 渉[1], 山田 博信[1], 立木 隆[2], 内田 貴司[2], 中島 健介[1]	1.山形大, 2.防衛大
	3月12日(木) 13:30 - 18:00				
招待	13:30 - 13:45	12p-A2-1	**「講演奨励賞受賞記念講演」(15分) 高フッ素濃度単結晶SmFeAsO1-xFxの合成とFIB を用いた微小結晶への4端子電極作製プロセス**	**○藤岡 正弥[1], Denholme Saleem[1], 田中 将嗣[1], 鈴木 皓司[1,2], 原 裕[1,2], 山木 拓馬[1,2], 山下 愛智[1,2], 山口 尚秀[1], 竹屋 浩幸[1], 高野 義彦[1,2]**	**1.物材機構, 2.筑波大学**
	13:45 - 14:00	12p-A2-2	SmFeAs(O,F)の相生成および超伝導特性に対するSn添加効果	○(B)林 功輔[1], 荻野 拓[1], 焼田 裕之[1], 岡田 朋之[1], 山本 明保[1], 岸尾 光二[1], 下山 淳一[1]	1.東大工
	14:00 - 14:15	12p-A2-3	(Ca,RE)$FeAs_2$の超伝導特性のRE依存性	○焼田 裕之[1], 荻野 拓[1], サラ アルベルト[1,2], 岡田 朋之[1], 山本 明保[1], 岸尾 光二[1], 伊豫 彰[2], 永崎 洋[2], 下山 淳一[1]	1.東大院工, 2.産総研
	14:15 - 14:30	12p-A2-4	ペアレンツ・アロイングによる$BaFe_2(As,P)_2$多結晶体の合成	○辻岳 千里[1], 山本 明保[1,2], 荻野 拓[1], 下山 淳一[1], 岸尾 光二[1]	1.東大院工, 2.JSTさきがけ
	14:30 - 14:45	12p-A2-5	Co添加$BaFe_2As_2$エピタキシャル薄膜における特異な圧力効果	○佐藤 光[1], 平松 秀典[1,2], 神谷 利夫[1,2], 細野 秀雄[1,2,3]	1.東工大 応セラ研, 2.東工大 元素戦略研, 3.東工大 フロンティア研
	14:45 - 15:00	奨 12p-A2-6	層間長の大きな新規インターカレーション超伝導体$Li_x(C_6H_{16}N_2)_yFe_{2-z}Se_2$の合成	○細野 祥平[1], 野地 尚[1], 畑田 武宏[1], 川股 隆行[1], 加藤 雅恒[1], 小池 洋二[1]	1.東北大院工
	15:00 - 15:15	12p-A2-7	CaF_2基板を用いた$FeSe_{1-x}Te_x$エピタキシャル薄膜の作製と相分離の抑制	○今井 良宗[1], 澤田 雄一[1], 鍋島 冬樹[1], 前田 京剛[1]	1.東大院総合
	15:15 - 15:30	奨 12p-A2-8	相分離を抑制した$FeSe_{1-x}Te_x$薄膜の磁場中輸送特性	○澤田 雄一[1], 鍋島 冬樹[1], 今井 良宗[1], 前田 京剛[1]	1.東大院総合
	15:30 - 15:45	12p-A2-9	$FeSe_{1-x}Te_x$ 薄膜における臨界電流密度特性の評価	○花輪 雅史[1], 塚田 一郎[1], 鍋島 冬樹[2], 今井 良宗[2], 前田 京剛[2], Tarantini Chiara[3], Polyanskii Anatolii[3], Larbalestier David[3]	1.電中研, 2.東大総合文化, 3.ASC/NHMFL/フロリダ州立大
	15:45 - 16:00		休憩/Break		
	16:00 - 16:15	12p-A2-10	Hg系超伝導銅酸化物のアンダードープ状態における高圧効果	○山本 文子[1], 竹下 直[2], 寺倉 千恵子[1], 十倉 好紀[1]	1.理研創発物性センター, 2.産総研電子光部門
	16:15 - 16:30	12p-A2-11	RE247相の簡便な合成方法と超伝導特性	○下山 淳一[1], 堀井 滋[2], 岸尾 光二[1]	1.東大院工, 2.京大院エネ科
	16:30 - 16:45	12p-A2-12	回転変調磁場下における$(Y_{1-x}Er_x)Ba_2Cu_3O_y$の配向挙動	○藤岡 祥太郎[1], 堀井 滋[1], 松浦 瞬[1], 土井 俊哉[1], 木村 史子[2], 木村 恒久[2]	1.京大院エネ科, 2.京大院農
	16:45 - 17:00	12p-A2-13	マティアスルール適用による$SrBi_3$の超伝導転移温度上昇	○伊豫 彰[1], 柳 陽介[1,2], 金城 達也[1,3], 西尾 太一郎[1,3], 長谷 泉[1], 柳澤 孝[1], 石田 茂之[1], 鬼頭 聖[1], 竹下 直[1], 岡 邦彦[1], 吉田 良行[1], 永崎 洋[1]	1.産総研, 2.イムラ材研, 3.東理大
	17:00 - 17:15	12p-A2-14	トポタクティック合成した$Bi_2(O,F)S_2$の圧力効果	岡田 朋之[1], ○荻野 拓[1], 下山 淳一[1], 岸尾 光二[1], 伊豫 彰[2], 竹下 直[2], 白川 直樹[2], 永崎 洋[2]	1.東大院工, 2.産総研
	17:15 - 17:30	12p-A2-15	$LaNO_3$から$LaNiO_2$へのトポタクティック変換におけるNi/La組成比依存性	○池田 愛[1], 真部 高明[2], 内藤 方夫[1]	1.農工大, 2.産総研
	17:30 - 17:45	12p-A2-16	O_3雰囲気中での銀酸化物薄膜の低温エピタキシャル成長	○七尾 美子[1]	1.農工大工
	17:45 - 18:00	12p-A2-17	(Sr,M)-(Mo,Mo')-O系113相酸化物(M = La, Ca; M' = V, Nb)の物性、導電率の組成依存	○福田 大地[1], 石田 直哉[1], 北村 尚斗[1], 井手本 康[1]	1.東理大理工

11.2 薄膜, 厚膜, テープ作製プロセスおよび結晶成長 / Thin and thick superconducting films, coated conductors and film crystal growth
口頭講演

3月12日(木) 14:00 - 17:30

14:00 - 14:15	12p-A1-1	1次元ピンを導入した高品質EuBa2Cu3O7−δ 薄膜の作製	○高井 洋輔[1], 向田 昌志[1], 三浦 正樹[2], 一瀬 中[3], 末吉 哲郎[4], 藤吉 孝則[4]	1.九州大工, 2.FANUC, 3.電中研, 4.熊本大工
14:15 - 14:30	12p-A1-2	YBCO薄膜における多層膜法によるハイブリッドAPCの導入	○堀出 朋哉[1], 坂本 宜優[1], 石丸 学[1], 一瀬 中[2], 松本 要[1]	1.九工大, 2.電中研
14:30 - 14:45	E 12p-A1-3	Tuning the angular variation of J_c of YBCO thin films by incorporating different combinations of hybrid APCs	○(P)Alok Jha[1], Kaname Matsumoto[1], Tomoya Horide[1], Shrikant Saini[2], Paolo Mele[2], Yutaka Yoshida[3], Satoshi Awaji[4]	1.Kyushu Instt Technol, 2.Hiroshima Univ., 3.Nagoya Univ., 4.Tohoku Univ.
14:45 - 15:00	12p-A1-4	APC導入REBCO 薄膜のJc角度依存性の解析モデル	○松本 要[1], ジャー アロク[1], 堀出 朋哉[1]	1.九工大工
15:00 - 15:15	12p-A1-5	エピタキシャルHg系超伝導薄膜の不可逆磁場特性	○松本 要[1], 加藤 拓[1], 堀出 朋哉[1], 吉田 隆[2], 淡路 智[3], 高野 義彦[4]	1.九州工業大学, 2.名古屋大学, 3.東北大学, 4.物材機構
15:15 - 15:30	12p-A1-6	無限層超伝導$Sr_{1-x}La_xCuO_2$ a軸成長膜における歪効果	○伊藤 雅崇[1], 何 軼倫[1], 羽尻 哲也[1], 植田 研二[1], 浅野 秀文[1]	1.名大院工
15:30 - 15:45		休憩/Break		
15:45 - 16:00	12p-A1-7	薄膜結晶成長シミュレーションによるREBCO薄膜中BMOの自己組織化メカニズムの検討	○一野 祐亮[1,2], 吉田 隆[2]	1.名大エコ研, 2.名大工
16:00 - 16:15	12p-A1-8	格子不整合性界面における中間層の結晶配向のメカニズム(II)	○一瀬 中[1,3], 中 順平[2], 内間 貴之[2], 堀井 滋[2,3], 土井 俊哉[2,3]	1.電中研, 2.京大院エネ科, 3.JST-ALCA
16:15 - 16:30	12p-A1-9	昇温速度がTFA-MOD $(Y_{0.77}Gd_{0.23})Ba_2Cu_3O_y$線材の結晶性及び超伝導特性に及ぼす影響	○丹羽 信博[1], 佐藤 迪夫[1], 三浦 正志[1], 高木 裕司[2], 中岡 晃一[2], 吉積 正晃[2], 和泉 輝郎[2]	1.成蹊大, 2.超工研
16:30 - 16:45	12p-A1-10	酸素アニール温度がTFA-MOD $(Y_{0.77}Gd_{0.23})Ba_2Cu_3O_{7-\delta}$線材の磁場中超伝導特性に及ぼす影響	○関 翼[1], 丹羽 信博[1], 佐藤 迪夫[1], 三浦 正志[1], 高木 裕司[2], 中岡 晃一[2], 吉積 正晃[2], 和泉 輝郎[2]	1.成蹊大, 2.超工研
16:45 - 17:00	奨 12p-A1-11	バッファ層の面内配向性がTFA-MOD ($Y_{0.77}Gd_{0.23})Ba_2Cu_3O_y$線材の磁場中超伝導特性に及ぼす影響	○佐藤 迪夫[1], 関 翼[1], 三浦 正志[1], 高木 裕司[2], 中岡 晃一[2], 吉積 正晃[2], 和泉 輝郎[2]	1.成蹊大, 2.超工研

	17:00 - 17:15	奨 12p-A1-12	TFA-MOD法を用いた磁場配向$REBa_2Cu_3O_{7-x}$の検討	○林 真理子[1], 荒木 猛司[1], 福家 浩之[1]	1.東芝研開セ
	17:15 - 17:30	12p-A1-13	TFA-MOD法による$YBa_2Cu_3O_y$膜中の$BaHfO_3$粒状ピン止め点の微細化	○寺西 亮[1], 堀田 宏志[1], 山田 和広[1], 金子 賢治[1], 吉積 正晃[2], 和泉 輝郎[2]	1.九州大工, 2.超電導工研
	3月13日(金) 12:00 - 19:00				
	12:00 - 12:15	13p-A1-1	さまざまなPLD条件で作製したFe(Te,Se)薄膜のT_c機構	○堀出 朋哉[1], 算用子 将弘[1], 一瀬 中[2], 松本 要[1]	1.九工大, 2.電中研
	12:15 - 12:30	13p-A1-2	$FeSe_{1-x}Te_x$ / CaF_2基板界面の微細構造のx依存性	○塚田 一郎[1], 一瀬 中[1], 鍋島 冬樹[2], 今井 良宗[2], 前田 京剛[2]	1.電中研, 2.東大院総合文化
	12:30 - 12:45	奨 13p-A1-3	鉄カルコゲナイド超伝導体を用いた超格子薄膜の作製とその輸送特性	○(DC)鍋島 冬樹[1], 澤田 雄一[1], 今井 良宗[1], 花輪 雅史[2], 一瀬 中[2], 塚田 一郎[2], 前田 京剛[1]	1.東大院総合, 2.電中研
	12:45 - 13:00	13p-A1-4	SmFeAs(O,F)薄膜のMBE成長における各種フッ素源の比較	○常木 孝信[1], 迫田 将仁[1], 石井 陽大[1], 渡辺 大樹[1], 内藤 方夫[1]	1.農工大
	13:00 - 13:15	13p-A1-5	分子線エピタキシー法を用いて成長した鉄系超伝導体SmFeAs(O,F)の積層膜と接合作製(2)	○迫田 将仁[1], 常木 孝信[1], 石井 陽大[1], 渡辺 大樹[1], 内藤 方夫[1]	1.農工大工
	13:15 - 13:30	13p-A1-6	CaF_2バリヤ層を用いたMgB_2ジョセフソン接合の最適化	○目出 和也[1], 迫田 将仁[1], 内藤 方夫[1]	1.東京農工大学
	13:30 - 13:45	13p-A1-7	電子ビーム蒸着法で作製したMgB_2薄膜のアニール効果	○竹原 寛人[1], 青木 翔太[1], 堀井 滋[1], 土井 俊哉[1], 楠 敏明[2], 山本 明保[3], 下山 淳一[3], 岸尾 光二[3]	1.京大院エネ科, 2.日立製作所, 3.東大院工
	13:45 - 14:00	13p-A1-8	コロネン熱分解でナノカーボンコートした硼素粉末により作製したMgB_2線材	○熊倉 浩明[1], 葉 術軍[1], 松本 明善[1], 長谷川 明[1]	1.物材機構

11.3 臨界電流, 超伝導パワー応用 / Critical Current, Superconducting Power Applications 口頭講演

3月11日(水) 14:00 - 18:00

	14:00 - 14:15	11p-A1-1	$BaHfO_3$添加$SmBa_2Cu_3O_y$薄膜の低磁場磁束ピン止めモデルと不可逆磁場曲線	○(D)鶴田 彰宏[1], 一野 祐亮[1], 吉田 隆[1], 一瀬 中[2], 松本 要[3], 淡路 智[4]	1.名大工, 2.電中研, 3.九工大, 4.東北大
	14:15 - 14:30	奨 11p-A1-2	$BaHfO_3$添加$SmBa_2Cu_3O_y$薄膜の高温領域磁束相図とピニング特性	○(PC)土屋 雄司[1], 淡路 智[1], 渡辺 和雄[1], 三浦 峻[2], 一野 祐亮[2], 吉田 隆[2]	1.東北大金研, 2.名大工
	14:30 - 14:45	11p-A1-3	BHOナノロッド導入Sm123薄膜における相関ピン特性	○淡路 智[1], 土屋 雄司[1], 渡辺 和雄[1], 三浦 峻[2], 鶴田 彰宏[2], 一野 祐亮[2], 吉田 隆[2], 松本 要[3]	1.東北大金研, 2.名大工, 3.九工大
	14:45 - 15:00	11p-A1-4	高速プロセスで作製した$BaHfO_3$人工ピン導入$Eu_1Ba_2Cu_3O_{7-\delta}$線材の臨界電流特性	○高崎 建[1], 井上 昌睦[1], 田中 健太[1], 衣斐 顕[2], 吉田 朋[2], 吉積 正晃[2], 和泉 輝郎[2], 木須 隆暢[1]	1.九大院シス情, 2.超電導工研
	15:00 - 15:15	11p-A1-5	成長制御したナノ粒子とYBCOからなる多層膜のJ_c特性	○末吉 哲郎[1], 上瀧 哲也[1], 浦口 雄世[1], 牧原 隆博[1], 末永 桃太郎[1], 藤吉 孝則[1]	1.熊大工
	15:15 - 15:30	11p-A1-6	磁気顕微法とX線CTによる希土類系高温超伝導テープ線材の臨界電流制限因子の解明	○井上 昌睦[1], 田中 健太[1], 高崎 健[1], 今村 和孝[1], 東川 甲平[1], 吉積 正晃[2], 和泉 輝郎[2], 木須 隆暢[1]	1.九大院シス情, 2.超電導工研
	15:30 - 15:45	11p-A1-7	REBCO線材のI_c統計分布に対する試料長ならびに空間解像度の影響	○木須 隆暢[1,2], 東川 甲平[1], 井上 昌睦[1]	1.九大院シス情, 2.iSTERA
	15:45 - 16:00		休憩/Break		
	16:00 - 16:15	11p-A1-8	MgB_2薄膜モデルを用いた磁束運動の数値解析:J_c の粒径、磁場依存性	○菅野 量子[1], 山本 浩之[1], 楠 敏明[2], 児玉 一宗[2], 一木 洋太[2], 田中 秀樹[2], 山本 明保[3], 下山 淳一[3]	1.日立中研, 2.日立日研, 3.東大工
	16:15 - 16:30	11p-A1-9	高捕捉磁場MgB_2超伝導バルク磁石の開発	杉野 翔[1], ○山本 明保[1,3], 下山 淳一[1], 岸尾 光二[1], 石原 篤[2], 赤坂 友幸[2], 富田 優[2]	1.東大, 2.鉄道総研, 3.JSTさきがけ
	16:30 - 16:45	11p-A1-10	HIP法で作製したMgB_2バルク超伝導体の磁束ピン止め特性と微細組織観察	○内藤 智之[1], 吉田 卓史[1], 望月 豪彦[1], 藤代 博之[1]	1.岩手大工
	16:45 - 17:00	11p-A1-11	高性能超伝導直流ケーブルの電流容量の検討	○松下 照男[1], ビアトキン ウラジミール[1], 木内 勝[1], 小田部 荘司[1]	1.九工大
	17:00 - 17:15	11p-A1-12	テストベンチを用いた直流超伝導ケーブルシステム向けペルチェ電流リードの性能評価と過電流試験	○宮田 成紀[1], 吉原 幸夫[1], 渡邉 裕文[1], 山内 健吾[1], 牧野 圭志[1], 山口 作太郎[1]	1.中部大
	17:15 - 17:30	11p-A1-13	有限要素法を用いた縦磁界中における超伝導体内の磁束の動きの評価	○増田 嘉道[1], 小田部 荘司[1], 木内 勝[1], 馬渡 康徳[2]	1.九工大, 2.産総研
	17:30 - 17:45	11p-A1-14	超伝導体におけるピンニング損失パワー密度	○松下 照男[1]	1.九工大
	17:45 - 18:00	11p-A1-15	Bi系超伝導線材の臨界電流に関する一考察	○伊豆 文里[1]	1.拓殖大工

11.4 アナログ応用および関連技術 / Analog applications and their related technologies 口頭講演

3月12日(木) 14:00 - 17:00

	14:00 - 14:15	12p-A3-1	Si 細線導波路結合型SSPD の作製	○柴田 浩行[1,2], 開 達郎[1,3], 土澤 泰[1,3], 武居 弘樹[2], 清水 薫[2], 山本 剛[3], 都倉 康弘[2], 山田 浩治[1,3]	1.NTT NPC, 2.NTT物性研, 3.NTT先デ研
	14:15 - 14:30	12p-A3-2	可視波長帯超伝導ナノワイヤ単一光子検出器を用いた蛍光相関分光II	○山下 太郎[1], 劉 登寛[2], 三木 茂人[1], 山本 条太郎[3], 原口 徳子[1,4], 金城 政孝[3], 平岡 泰[1,4], 王 鎮[1,2], 寺井 弘高[1]	1.情通機構, 2.上海微所, 3.北大先端生命, 4.阪大生命機能
	14:30 - 14:45	12p-A3-3	64ピクセル超伝導単一光子検出素子の特性評価II	○三木 茂人[1], 山下 太郎[1], 寺井 弘高[1]	1.情通機構
	14:45 - 15:00	12p-A3-4	導波路結合型超伝導ナノワイヤ単一光子検出器の開発III	○和木 健太朗[1,2], 山下 太郎[2], 井上 振一郎[2,3], 三木 茂人[2], 寺井 弘高[2], 生田 力三[1], 山本 俊[1], 井元 信之[1]	1.阪大院基礎工, 2.情通機構, 3.JSTさきがけ
	15:00 - 15:15	12p-A3-5	シリコン基板の深掘り加工による放射線検出器の感度向上	○宮本 法明[1], 成瀬 雅人[1], 田井野 徹[1], 明連 広昭[1]	1.埼玉大院理工
	15:15 - 15:30	12p-A3-6	ミリ波・サブミリ波オンチップ分光器の開発	○新井 慧一[1], 成瀬 雅人[1], 田井野 徹[1], 明連 広昭[1], 美馬 覚[2], 大谷 知行[2]	1.埼大院, 2.理研
	15:30 - 15:45		休憩/Break		
	15:45 - 16:00	12p-A3-7	TESマイクロ波多重読み出しのためのNbN共振特性評価	○平山 文紀[1], 入松川 知也[2], 佐藤 昭[1], 山森 弘毅[1], 永沢 秀一[1], 福田 大治[1], 日高 睦夫[1], 神代 暁[1], 大野 雅史[2], 高橋 浩之[2]	1.産総研, 2.東大工

	16:00 - 16:15	12p-A3-8	TaN薄膜を用いたマイクロ波力学インダクタンス検出器の作製	○山田 博信[1], 小川 裕平[1], 岡 大輝[1], 齊藤 敦[1], 大嶋 重利[1], 有吉 誠一郎[2], 中島 健介[1]	1.山形大, 2.豊橋技科大
	16:15 - 16:30	奨 12p-A3-9	積層された2つの電流バイアス運動インダクタンス検出器の同時計測	○(PC)宮嶋 茂之[1,2], 鳴神 吉人[1], 山口 裕之[1], 中山 弘貴[1], 宍戸 寛明[1,2], 藤巻 朗[3], 日高 睦夫[4], 石田 武和[1,2]	1.大阪府大工, 2.大阪府大ナノ研, 3.名古屋大工, 4.産総研
	16:30 - 16:45	12p-A3-10	超伝導バルク共振器を用いた 100 Wクラス送信用フィルタの開発	○(M1)鶴井 椋太[1], 齊藤 敦[1], 加藤 知己[1], 齋藤 大暉[1], 手嶋 英一[2], 大嶋 重利[1]	1.山形大理工, 2.新日鐵住金
	16:45 - 17:00	12p-A3-11	電圧標準チップの熱応力の数値解析	○山森 弘毅[1], 山田 隆宏[1], 佐々木 仁[1], 高橋 ひかり[1,2], 丸山 道隆[1], 天谷 康孝[1], 金子 晋久[1], 神代 暁[1], 桐生 昭吾[2]	1.産総研, 2.東京都市大
	3月14日(土) 9:00 - 12:00				
	9:00 - 9:15	14a-A3-1	超伝導量子干渉素子を用いた24-bitディジタル-アナログ変換器	○中西 正和[1]	1.産総研
	9:15 - 9:30	奨 14a-A3-2	SQUIDによる電子スピン偏極の検出	○樋田 啓[1], 松崎 雄一郎[1], 角柳 孝輔[1], 根本 香絵[2], ウィリアム ムンロー[1], 山口 浩司[1], 齊藤 志郎[1]	1.NTT物性基礎研, 2.国立情報学研究所
	9:30 - 9:45	14a-A3-3	反応性イオンエッチングを用いて作製したマイクロ・ナノSQUIDからなる局所磁場計測システムの開発	○佐久間 大輔[1], 永合 祐輔[1], 石黒 亮輔[2], 柏谷 聡[3], 髙柳 英明[1,4]	1.東理大, 2.理研, 3.産総研, 4.物材機構 MANA
	9:45 - 10:00	14a-A3-4	STM-SQUIDのための磁束量子の数値シミュレーション	○立木 実[1], 林 忠之[1,2], 町田 理[3], 大井 修一[1,4], 平田 和人[1,4]	1.物材機構, 2.仙台高専, 3.理研, 4.北大理
	10:00 - 10:15	奨 14a-A3-5	HTS-SQUIDを用いた高機能サンプル振動型磁化率計の開発	○松永 恭暁[1], Mohd Mawardi[1], 日下 瞬[1], 森田 洪爾[1], 堺 健司[1], 紀和 利彦[1], 塚田 啓二[1]	1.岡大工
	10:15 - 10:30		休憩/Break		
	10:30 - 10:45	奨 14a-A3-6	傾斜磁場を用いた磁気粒子イメージングシステムの開発	○森下 学[1], 宮崎 貴吏[1], 辻田 裕也[1], 笹山 瑛由[1], 円福 敬二[1]	1.九州大学シス情
	10:45 - 11:00	奨 14a-A3-7	SQUIDを用いた磁気的液相免疫検査法の高性能化	○浦 正和[1], 上岡 祐太[1], 中村 洸太[1], 笹山 瑛由[1], 吉田 敬[1], 円福 敬二[1]	1.九大システム情報
	11:00 - 11:15	14a-A3-8	高温超伝導コイルを用いた鉄板厚さの測定	○石田 智樹[1], 笹山 瑛由[1], 松尾 政晃[1], 円福 敬二[1]	1.九大シス情
	11:15 - 11:30	14a-A3-9	高温超伝導rf-SQUIDの共振周波数に対するスリット長依存性	酒井 章[1], 芦塚 拓也[1], ○宮戸 祐治[1], 糸崎 秀夫[1]	1.阪大基礎工
	11:30 - 11:45	奨 14a-A3-10	LN_2 冷却磁束トランスを用いた超低磁場HTS-SQUID-NMR 装置の検討	○廣瀬 勇野[1], 山本 将彰[1], 八田 純一[1], 有吉 誠一郎[1], 田中 三郎[1], 安達 成司[2], 田辺 圭一[2]	1.豊橋技科大, 2.超電導工学研究所
	11:45 - 12:00	奨 14a-A3-11	高温超伝導SQUIDと磁束トランスを用いた金属異物検査装置の検討	○成田 雄作[1]	1.豊橋技大工

11.5 接合, 回路作製プロセスおよびデジタル応用 / Junction and circuit fabrication procresss, digital applications 口頭講演

	3月13日(金) 16:15 - 17:45				
	16:15 - 16:30	13p-A2-1	配線包囲型構造による超伝導マイクロストリップライン間の磁気結合度の評価	○小野美 武[1], 中島 康治[1]	1.東北大電通研
	16:30 - 16:45	13p-A2-2	超伝導物理乱数生成器の動作安定のための後処理回路の研究	○(M1)菅田 裕道[1], 山梨 裕希[1], 吉川 信行[1]	1.横浜国立大学
	16:45 - 17:00	13p-A2-3	飛行時間型質量分析に向けた超伝導ストリップイオン検出器とSFQ時間測定回路の単一冷凍機内への実装	○佐野 京佑[1], 村松 祐希[1], 下田 知毅[1], 山梨 裕希[1], 吉川 信行[1], 全 伸幸[2], 大久保 雅隆[2]	1.横浜国大工, 2.産総研
	17:00 - 17:15	13p-A2-4	SFQ 回路と接続したナノワイア O/E 変換器のエラーフリー動作	○梶野 顕明[1], 三木 茂人[1], 山下 太郎[1], 寺井 弘高[1]	1.情通機構
	17:15 - 17:30	13p-A2-5	20 kA/cm^2 Nb/AlO_x/Nb接合を用いたRSFQ 100 GHzビットシリアル加算器	○田中 雅光[1], 佐藤 諒[1], 藤巻 朗[1], 永沢 秀一[2], 日高 睦夫[2]	1.名大, 2.産総研
	17:30 - 17:45	13p-A2-6	高温超伝導体を用いたランプエッジ型ジョセフソン接合のTEM観察	○安達 成司[1], 塚本 晃[1], 文 裕植[1], 押久保 靖夫[1], 田辺 圭一[1]	1.超電導工研
	3月14日(土) 9:00 - 12:00				
招待	9:00 - 9:15	14a-A2-1	**「講演奨励賞受賞記念講演」(15分) 磁束量子ラッチを用いたXORゲートの提案と動作実証**	**○竹内 尚輝[1], 山梨 裕希[1], 吉川 信行[1]**	**1.横浜国大**
	9:15 - 9:30	奨 14a-A2-2	磁性体を用いた超伝導位相シフタによる単一磁束量子回路の多機能化の検討	○谷口 壮耶[1], 伊藤 大[1], 石川 航太[1], 黒川 綜太[1], 津根 彰久[1], 田中 雅光[1], 赤池 宏之[1], 藤巻 朗[1]	1.名大院工
	9:30 - 9:45	14a-A2-3	Quantum Flux Latchの動作マージンの改善	○(B)辻 直樹[1], 竹内 直輝[2], 山梨 裕希[1], 吉川 信行[1]	1.横国大理工, 2.情通機構
	9:45 - 10:00	奨 14a-A2-4	磁性体を用いた再構成可能な磁束量子パラメトロン回路	○黒川 綜太[1], 津根 彰久[1], 伊藤 大[1], 谷口 壮耶[1], 田中 雅光[1], 赤池 宏之[1], 藤巻 朗[1]	1.名大院工
	10:00 - 10:15	奨 14a-A2-5	断熱型磁束量子パラメトロン1万ゲート回路の低速動作実証	○奈良間 達也[1], 竹内 尚輝[2], 山梨 裕希[1], 吉川 信行[1]	1.横浜国立大学, 2.情報通信研究機構
	10:15 - 10:30	奨 14a-A2-6	単一磁束量子回路と断熱型磁束量子パラメトロン回路間インターフェース回路の設計と評価	○知名 史博[1], Ortlepp Thomas[2], 山梨 裕希[1], 吉川 信行[1]	1.横浜国立大学, 2.CiS研究所
	10:30 - 10:45		休憩/Break		
	10:45 - 11:00	奨 14a-A2-7	SFISジョセフソン接合の磁性層が接合特性に与える影響の検討	○伊藤 大[1], 谷口 壮耶[1], 石川 航太[1], 赤池 宏之[1], 藤巻 朗[1]	1.名大院工
	11:00 - 11:15	奨 14a-A2-8	電流比較部を最適化したSFQ 論理ゲートにおけるビットエラーレートの測定	○(M1)朝倉 剣太[1], 山梨 裕希[1], 吉川 信行[1]	1.横国大院工
	11:15 - 11:30	奨 14a-A2-9	直列接続多元超伝導検出器アレイの個別読出し	○神谷 恭平[1], 喜多 祐真[1], 上阪 岬[1], Bozbey Ali[2], 藤巻 朗[1], 田中 雅光[1]	1.名古屋大, 2.TOBB UET
	11:30 - 11:45	奨 14a-A2-10	動的な内部リセット機構によるLRバイアス低電力単一磁束量子回路の高速化	佐藤 紘史[1], ○堤 隆太[1], 山梨 裕希[1], 吉川 信行[1]	1.横国大院工
	11:45 - 12:00	14a-A2-11	CB-KID/SFQモノリシックデバイスの作製プロセス	○日高 睦夫[1], 永沢 秀一[1], 宮嶋 茂之[2], 宍戸 寛明[2], 藤巻 朗[3], 石田 武和[2]	1.産総研, 2.大阪府大工, 3.名大工

12 有機分子・バイオエレクトロニクス / Organic Molecules and Bioelectronics

12.1 作製・構造制御 / Fabrications and Structure Controls　口頭講演

3月11日(水)　9:00 - 12:00

	9:00 - 9:15	11a-D2-1	窒素添加LaB_6薄膜上に形成したペンタセン薄膜の堆積レート依存性	○前田 康貴[1], 大見 俊一郎[1], 後藤 哲也[2], 大見 忠弘[2]	1.東工大総理工, 2.東北大未来研
	9:15 - 9:30	11a-D2-2	Si(111)基板上におけるジアセチレン薄膜成長過程の光学顕微鏡観察	○鎌田 勇人[1], 小幡 誠司[1], 上野 啓司[2], 斉木 幸一朗[1]	1.東大新領域, 2.埼玉大院理工
	9:30 - 9:45	11a-D2-3	有機薄膜トランジスタの被覆率と電気伝導のその場評価	○(PC)渡辺 剛[1], 小金澤 智之[1], 菊池 護[2], 西田 広作[2], 吉本 則之[2], 広沢 一郎[1]	1.高輝度光科学研究セ, 2.岩手大工
	9:45 - 10:00	11a-D2-4	α,ω-クオターチオフェン誘導体薄膜の結晶成長に及ぼす末端アルキル基の効果	○小鹿 曹汰[1], 小金澤 智之[2], 山本 秦平[3], 鈴木 充朗[3], 山田 容子[3], 吉本 則之[1]	1.岩手大工, 2.高輝度光化学研究セ, 3.奈良先端大物質
	10:00 - 10:15	11a-D2-5	大気圧走査電子顕微鏡を用いた共役高分子のナノパターニング	○樋口 剛志[1], 西山 英利[2], 須賀 三雄[2], 陣内 浩[3], 高原 淳[3,4]	1.東北大多元研, 2.日本電子, 3.九大先導研, 4.JST, ERATO高原ソフト界面プロ
	10:15 - 10:30	11a-D2-6	ペロブスカイト酸化物の極性に依存するフタロシアニン極薄層の形成	○小島 峻吾[1], 福村 知昭[1,2], 神坂 英幸[1,2], 長谷川 哲也[1,2]	1.東大院理, 2.JST-CREST
	10:30 - 10:45		休憩/Break		
招待	**10:45 - 11:00**	**11a-D2-7**	**「講演奨励賞受賞記念講演」(15分) インクジェット塗布された異種ミクロ液滴の混合挙動の制御と高度印刷薄膜製造技術への応用**	**○野田 祐樹[1], 峯廻 洋美[1], 山田 寿一[1], 長谷川 達生[1,2]**	**1.産総研 FLEC, 2.東大工**
	11:00 - 11:15	11a-D2-8	銀ナノワイヤーの電気伝導性と酸化耐性に関する表面結合ポリビニルピロリドンの効果	○富岡 明宏[1], 増田 啓宏[1], 波多野 雄亮[1], 前田 善貴[1], 新井 秀治[1], 川畑 公人[1]	1.大阪電通大工
	11:15 - 11:30	11a-D2-9	添加剤導入によるP3HT:PCBM混合膜の結晶成長過程のその場観察評価	○新井 康司[1,2], 柴田 陽生[2], 伊藤 英輔[2], 小金澤 智之[3], 宮寺 哲彦[2,4], 近松 真之[2], 矢口 裕之[1]	1.埼玉大工, 2.産総研・太陽光, 3.高輝度光科学研究センター, 4.JST さきがけ
	11:30 - 11:45	11a-D2-10	静電噴霧堆積(ESD)法による有機EL材料の積層化	○高久 英明[1], 早川 晴美[1], 青山 哲也[1], 田島 右副[1], 松下 聖志郎[1]	1.理研
	11:45 - 12:00	11a-D2-11	多電極型静電塗布法(ナノミスト堆積法)による低分子(CBP:PBD:T-PD:Ir(mppy)$_3$))有機薄膜の成膜特性の検討	○新沼 佳樹[1], 西 大紀[1], 石野 隼一[1], 菊池 昭彦[1,2]	1.上智大・理工, 2.上智大学ナノテクセンター

3月11日(水)　13:15 - 18:00

	13:15 - 13:30	奨 11p-D2-1	尿素オリゴマーを用いた真空蒸着膜の薄膜作製及び構造評価	○(M1)福冨 達也[1], 森本 勝大[1], 小柴 康子[1], 三崎 雅裕[1], 石田 謙司[1]	1.神戸大院工
	13:30 - 13:45	奨 11p-D2-2	Fe_3O_4ナノ粒子-C_{10}混合LB膜を用いたVA-CNTの合成および直径評価	○中村 健太郎[1], 栗山 直樹[1], 高際 翔太[1], 串田 正人[1]	1.千葉大工
	13:45 - 14:00	奨 11p-D2-3	Feナノ粒子-シリカナノ粒子混合LB膜から合成した垂直配向カーボンナノチューブの構造評価	○高際 翔太[1], 金杉 治[1], 中村 健太郎[1], 串田 正人[1]	1.千葉大工
	14:00 - 14:15	奨 11p-D2-4	交互間欠静電塗布法を用いたp-nブレンド膜の成膜方法の提案	○鈴木 勝己[1], 戸田 明日来[1], 福田 武司[1], 鎌田 憲彦[1], 本多 善太郎[1]	1.埼玉大
	14:15 - 14:30	奨 11p-D2-5	ベンゼンチオール誘導体による修飾表面の濡れと安定性	○鈩 信吾[1], 北村 雅季[1,2]	1.神戸大院工, 2.東大ナノ量子機構
	14:30 - 14:45	奨 11p-D2-6	液晶性フタロシアニンの加熱スピンコート薄膜における導電性高分子混合効果	○東 卓也[1], Mihary Fiderana Ramananarivo[1], 大森 雅志[1], 吉田 浩之[1], 藤井 彰彦[1], 尾崎 雅則[1]	1.阪大院工
	14:45 - 15:00	奨 11p-D2-7	Auストライプ構造上TIPS petacene単結晶ドメインの分子配向評価	○(M2)大長 規浩[1], 中村 綾斗[1], 小野島 紀夫[1]	1.山梨大
	15:00 - 15:15		休憩/Break		
	15:15 - 15:30	奨 11p-D2-8	動的光重合により誘起される分子配向挙動の構造依存性	○(M1)石津 真樹[1], 久野 恭平[1], 宍戸 厚[1,2]	1.東工大資源研, 2.JST さきがけ
	15:30 - 15:45	奨 11p-D2-9	電気化学キャパシタを指向したハイブリッドマイクロ粒子の作製	○鳥羽 彩伽[1], 早坂 泰史[2], 松田 圭吾[2], 増原 陽人[2,3]	1.山形大工, 2.山形大院理工, 3.有機エレクトロニクス研究センター
	15:45 - 16:00	奨 11p-D2-10	プラズモン特性を有するコア-シェル型電子供与体材料作製法の確立	○宮川 佳奈[1], 渡部 大輝[2], 内貴 博之[3], 雲林院 宏[3], 有田 稔彦[4], 増原 陽人[2,5]	1.山形大学工, 2.山形大院理工, 3.ルーヴァン・カトリック大, 4.東北大多元研, 5.有機エレ研
	16:00 - 16:15	奨 11p-D2-11	新規製膜手法によるペロブスカイト結晶薄膜の作製	○(B)梅本 和輝[1], 早坂 泰史[2], 増原 陽人[2,3]	1.山形大工, 2.山形大院理工, 3.有機エレクトロニクスセンター
	16:15 - 16:30	奨 11p-D2-12	再沈法における貧溶媒選択がC_{60}ナノ結晶形成に及ぼす影響の解明	○伊藤 直子[1], 志藤 慶治[2], 増原 陽人[3]	1.山形大工, 2.山形大学院理工, 3.有機エレクトロニクス研究センター
	16:30 - 16:45	奨 11p-D2-13	微小液滴中の量子ドット−色素結合体の高速合成及び反応速度の定量化	○宇高 光[1], 倉林 智和[1], 福田 武司[1], Yoon Dong Hyun[2], 鎌田 憲彦[1], 鈴木 美穂[1], 中原 旭[2], 関口 哲志[2], 庄子 習一[2]	1.埼玉大工, 2.早稲田大理工
	16:45 - 17:00		休憩/Break		
	17:00 - 17:15	E 11p-D2-14	Orientation of conjugated polymers by FTM method	○(D)MANISH PANDEY[1], Shuichi Nagamatsu[2], Shyam S. Pandey[1], Shuzi Hayase[1], Wataru Takashima[1]	1.Graduate School of LSSE, Kyushu Institute of Technology, 2.Depatment of Computer Science and Electronics, Kyushu Institute of Technology
	17:15 - 17:30	11p-D2-15	ナノ電解法による位置選択的ナノ単結晶作製 ～有機アクセプタ分子への展開～	○長谷川 裕之[1,2]	1.北大院理, 2.情報通信研未来
	17:30 - 17:45	11p-D2-16	高ドープされたCu-TCNQ錯体ナノ結晶の構造・物性評価	○廣瀬 嶺央[1], 小野寺 恒信[1], 笠井 均[1], 及川 英俊[1]	1.東北大多元研
	17:45 - 18:00	11p-D2-17	UV光照射による金属フタロシアニンナノ結晶のOne-pot合成	○樋口 剛志[1], 齊藤 祐太[1], 杉森 秀一[2], 藪 浩[1]	1.東北大多元研, 2.(株)KRI

3月12日(木)　9:00 - 11:30

	9:00 - 9:15	12a-D2-1	蛍光体の厚膜ペーストを形成するペースト供給方法	○(D)土屋 均[1,2], 宮内 攻[2], 本間 哲哉[1]	1.芝浦工業大学大学院, 2.東芝生産技術センター
	9:15 - 9:30	12a-D2-2	屈折率を制御した光応答性有機無機ハイブリッドの作製と光応答性評価	○和田 隆佑[1], 多和田 昌弘[1], 成田 麻美子[2], 渡辺 修[2]	1.名城大理工, 2.豊田中研
	9:30 - 9:45	12a-D2-3	スプレー交互積層法による水蒸気バリア性を備えた粘土/ポリマー複合膜の検討	○能登屋 桃子[1], 慶 奎弘[1], 藤本 幸司[1], 白鳥 世明[1]	1.慶大院理工
	9:45 - 10:00	12a-D2-4	水熱法による多孔質シリカ中空カプセルの作製とモデル薬物の充填	○(M2)加藤 直[1], 山口 優[1], 加藤 徳剛[1]	1.明大理工

	10:00 - 10:15	12a-D2-5	表面修飾による多孔質シリカカプセルの細孔封止	○山口 優[1], 加藤 直[1], 加藤 徳剛[1]	1.明大理工
	10:15 - 10:30	12a-D2-6	カテコール基含有高分子ナノシート上へのナノ微粒子の吸着制御	○山本 俊介[1], 内山 駿[1], 宮下 徳治[1], 三ツ石 方也[1]	1.東北大多元研
	10:30 - 10:45	12a-D2-7	液晶化に支配されたミクロ相分離構造膜の構造形成機構と制御	○小村 元憲[1], 彌田 智一[2]	1.沼津高専, 2.東工大資源研
	10:45 - 11:00	12a-D2-8	高分子/液晶のメゾ相分離と配向秩序形成の制御および熱応答型調光素子の開発	○垣内田 洋[1], 吉村 和記[1], 荻原 昭文[2]	1.産総研, 2.神戸高専
	11:00 - 11:15	12a-D2-9	ポリビニルイミダゾールのラビング膜における液晶配向特性 －液晶材料の選択的吸着－	○山口 留美子[1], 長沼 耀太[1], 小舘 輝[1]	1.秋田大工
	11:15 - 11:30	12a-D2-10	デザインした液晶配向欠陥の形成と3次元コロイド粒子制御	○吉田 浩之[1], 朝倉 啓太[1], 福田 順一[2], 尾崎 雅則[1]	1.阪大院工, 2.産総研ナノシステム

12.1 作製・構造制御 / Fabrications and Structure Controls　ポスター講演

3月13日(金)　9:30 - 11:30

		13a-P13-1	超高速真空蒸着による有機薄膜成長とデバイス特性への影響	○松原 亮介[1], 寺岡 拓麻[1], 小島 広孝[1], 中村 雅一[1]	1.奈良先端大物質
		13a-P13-2	溶媒離脱効果に起因する高分子半導体膜表面での金属堆積性変調	○(M2)山口 耕司[1], 辻岡 強[1]	1.大阪教育大
		13a-P13-3	種々のパラフィン系材料を用いた蒸着膜の作製と評価	○佐藤 慶太[1], 田中 邦明[1], 臼井 博明[1]	1.農工大工
		13a-P13-4	ポリイミド上へのイオン化蒸着法による銅シード層の作製と評価	○神野 友樹[1], 田中 邦明[1], 臼井 博明[1]	1.農工大工
		13a-P13-5	イオンアシスト蒸着法を用いたポリイミド表面改質層の形成	○河村 拓[1], 田中 邦明[1], 臼井 博明[1]	1.農工大工
		13a-P13-6	蒸着重合によるポリイミド膜の作製と配向制御	マハバン チャンヤー[1], 菊地 亮介[1], 田中 邦明[1], ○臼井 博明[1]	1.農工大工
		13a-P13-7	金属薄膜上での気固相反応によるオクタシアノ金属フタロシアニン合成とナノロッド成長	○小柴 康子[1], 三澤 明日香[1], 西本 光穂子[1], 三崎 雅裕[1], 石田 謙司[1]	1.神戸大院工
		13a-P13-8	脂肪酸薄膜形成に及ぼす気相中における会合状態の影響	○小林 拓磨[1], 竹田 治生[1], 蓬莱 健一[1], 久保野 敦史[1]	1.静岡大工
		13a-P13-9	バイオマス溶媒を用いた塗布型有機デバイスの作製	○永松 秀一[1], 有馬 幹尋[1], 高嶋 授[1], パンディ シャム[1], 早瀬 修二[1]	1.九工大
		13a-P13-10	反応性自己組織化膜を用いた陽極／正孔輸送層の界面制御	○小野 爽太郎[1], 田中 邦明[1], 金 性澈[1], Advincula Rigoberto C.[2], 臼井 博明[1]	1.東京農工大工, 2.Case Western大
		13a-P13-11	ダイヤモンドナノ粒子の電気泳動堆積過程のTEM観察	○後藤 洋介[1], 田中 邦明[1], 大石 不二夫[2], 臼井 博明[1]	1.農工大工, 2.神奈川大理
		13a-P13-12	料分散ポリマーコロイドによるフルカラーマイクロレンズアレイのシリコン基板への作製	○櫻井 芳昭[1], 畠山 冴子[2], 田中 剛[1], 佐藤 和郎[1], 村上 修一[1], 田中 恒久[1], 松永 崇[1], 榎本 博行[2], 山村 昌大[1]	1.阪府産技研, 2.大阪電通大
		13a-P13-13	エレクトロスピニングを用いた液体滑液膜の作製と評価	○塚本 拓也[1]	1.慶大理工院
		13a-P13-14	静電スプレー堆積法によるP3HT/PCBM相互貫入型構造の作製	○石間 康久[1], 高橋 和志[1], 小野島 紀夫[1]	1.山梨大
		13a-P13-15	極薄強誘電性高分子膜の作製と物性評価	○関根 智仁[1], 菅野 亮[1], 田代 智也[1], 福田 憲二郎[1,2], 熊木 大介[1], 時任 静士[1]	1.山形大ROEL, 2.JSTさきがけ
		13a-P13-16	光照射によるC_8-BTBT薄膜の再結晶化とトランジスタへの応用	○大西 洋輔[1], 飯塚 尚輝[1], 藤枝 一郎[1]	1.立命館大理工
		13a-P13-17	CuI層により分子配向制御されたCuPc膜の電気物性と縦型トランジスタへの応用	○篠田 亘[1,2], 武藤 隼斗[1,2], 中山 健一[1,2]	1.山形大院理工, 2.山形大ROEL
		13a-P13-18	摩擦転写法によるローバンドギャップポリマーPTB7の配向薄膜	○谷垣 宣孝[1], ヘック クライレ[1], 溝黒 登志子[1], 柴田 陽生[2], 宮寺 哲彦[2], 小金澤 智之[3]	1.産総研ユビキタス, 2.産総研太陽光, 3.JASRI
		13a-P13-19	量子ビームによる有機太陽電池薄膜におけるドメイン構造の研究	○久保田 正人[1], 宮寺 哲彦[2,4], 櫻井 岳暁[3,4], 吉田 郵司[2]	1.原子力機構, 2.産総研, 3.筑波大, 4.JSTさきがけ
		13a-P13-20	超高真空下での金単結晶上のペンタセンの薄膜形成過程の構造評価	○小栗 貴文[1], 多田 圭佑[1], 渡辺 剛[2], 小金澤 智之[3], 菊池 護[1], 谷 正安[2], 廣沢 一郎[3], 吉本 則之[1]	1.岩手大工, 2.RSE(株), 3.高輝度光化学研究セ
		13a-P13-21	エレクトロスピニング法により紡糸した 紫外線硬化型液晶混合ファイバー近傍のネマティック液晶配向	○渡戸 優介[1], 渡辺 大貴[1], 工藤 幸寛[1], 高橋 泰樹[1]	1.工学院大
		13a-P13-22	シアニン色素ー無機層状化合物複合体の作製とその光応答性	○石原 マリ[1], 平瀬 龍二[1], 吉岡 秀樹[1]	1.兵庫県工技セ
		13a-P13-23	酸化亜鉛微粒子-ポルフィリン複合体の発光特性V	○(M1)東影 勇介[1], 原村 聡志[1], 西村 浩二[2], 水野 斎[1], 広光 一郎[1]	1.島根大院総合理工, 2.島根大研究支援セ
		13a-P13-24	$CH(NH_2)_2Pb(I_{1-x}Br_x)_3$薄膜の作製および評価	○山中 孝紀[1], 石川 良[1], 本多 善太郎[1], 上野 啓司[1], 白井 肇[1]	1.埼玉大院理工
		13a-P13-25	TFEPDDとポリイミドを用いた周期構造の作製	○(M2)徳永 裕輔[1]	1.明治大理工
		13a-P13-26	規則ナノ細孔を有する多孔質薄膜を用いたナノバブル発生	○齋藤 栄幸[1], 馬 騰[1], 山本 英明[2,3,4], 平野 愛弓[2,3], 庭野 道夫[1]	1.東北大通研, 2.東北大院医工, 3.CREST, JST, 4.東北大 学際研
		13a-P13-27	主鎖型高分子錯体ナノ結晶の表面を認識した選択的分子吸着	○鈴木 龍樹[1], 小野寺 恒信[1], 笠井 均[1], 及川 英俊[1]	1.東北大多元研

6.6 プローブ顕微鏡, 12.2 評価・基礎物性のコードシェアセッション　口頭講演

3月13日(金)　9:00 - 12:00

	9:00 - 9:15	奨 13a-D14-1	多段階光強度のLM-STSによるP3HT:PCBM系有機薄膜太陽電池の局所測定	○落合 貴大[1,2], 安田 剛[3], 加藤 洋和[1], 小林 祐貴[1], 吉田 昭二[1], 武内 修[1], 重川 秀実[1]	1.筑波大数理物質, 2.タカノ(株), 3.物質・材料研究機構
	9:15 - 9:30	奨 13a-D14-2	動作中の有機トランジスタにおける過渡的キャリア分布のナノスケール可視化	○山岸 裕史[1], 木村 知玄[1], 小林 圭[1,2], 野田 啓[3], 山田 啓文[1]	1.京大院工, 2.京大白眉セ, 3.慶應大理工
	9:30 - 9:45	13a-D14-3	時間分解静電気力顕微鏡による有機半導体グレインへの電荷注入・排出過程の可視化	○木村 知玄[1], 山岸 裕史[1], 小林 圭[1,2], 山田 啓文[1]	1.京大工, 2.京大白眉セ
	9:45 - 10:00	奨 13a-D14-4	探針増強ラマン散乱分光測定における金属探針の温度評価と熱拡散手法	○(DC)望月 誠仁[1], 小口 真弘[1], 角井 杏帆[1], 矢野 隆章[1], 原 正彦[1], 林 智広[1]	1.東工大総理工
	10:00 - 10:15	13a-D14-5	液中FM-AFMによる免疫グロブリンM(IgM)の抗原結合評価	○黄 雲飛[1], 木南 裕陽[1], 小林 圭[1,2], 山田 啓文[1]	1.京大工, 2.京大白眉セ

	10:15 - 10:30	奨 13a-D14-6	自己検知型カンチレバーを用いた液中における単一吸着細胞の剥離力測定	○橋本 重孝[1], 安達 誠[1], 岩田 太[1,2]	1.静岡大院工, 2.静岡大電研
	10:30 - 10:45		休憩/Break		
招待	**10:45 - 11:00**	**13a-D14-7**	**「講演奨励賞受賞記念講演」(15分) ポルフィリン-TbIIIダブルデッカー型単分子磁石のSTMによるパターニングと近藤状態の評価**	**○猪瀬 朋子[1], 田中 大輔[1], Liu Jie[2], 梶原 美珠[2], 米田 忠弘[2], 小川 琢治[1]**	**1.阪大院理, 2.東北大多元研**
	11:00 - 11:15	奨 13a-D14-8	単一分子伝導における分子形状効果の3次元計測	○片山 智貴[1], 中村 美紀[1], 吉田 昭二[1], 武内 修[1], 重川 秀実[1]	1.筑波大数理
	11:15 - 11:30	奨 13a-D14-9	CuPc追加蒸着によるPCBMの配列構造の変化	○(M1)桝井 茜[1], 坂上 弘之[1], 高萩 隆行[1], 鈴木 仁[1]	1.広島大院先端研
	11:30 - 11:45	奨 13a-D14-10	力検出による近接場光の高分解能観測	○山西 絢介[1], 徳山 貴士[1], 内藤 賀公[1], 李 艶君[1], 菅原 康弘[1]	1.阪大院工
	11:45 - 12:00	13a-D14-11	電気化学FM-AFMを用いたイオン液体／ルブレン(001)界面における探針誘起ナノリソグラフィー	○坂東 賢一[1], 原 援又[1], 森野 裕介[1], 岡田 悠悟[2], 今西 哲士[1], 横田 泰之[1], 植村 隆文[2], 竹谷 純一[2], 福井 賢一[1]	1.阪大院基礎工, 2.東大院新領域

12.2 評価・基礎物性 / Characterization and Materials Physics　ポスター講演

3月12日(木)　13:30 - 15:30

		12p-P6-1	DNTT多層膜の成長過程の分子レベル観察	○長谷川 友里[1], 山田 洋一[1], 佐々木 正洋[1], 若山 裕[2]	1.筑波大数理, 2.物材機構WPI-MANA
		12p-P6-2	グラフェン－色素間の蛍光共鳴エネルギー移動の距離依存性	○古川 一暁[1], 上野 祐子[1], 高村 真琴[1], 日比野 浩樹[1]	1.NTT物性基礎研
		12p-P6-3	金基板およびシリコン基板上に作製したフェロセン誘導体 SAM の分子整流特性	○(M1)鄭 安純[1], 杉浦 慎太郎[1], 一井 崇[1], 宇都宮 徹[1], 杉村 博之[1]	1.京大院工
		12p-P6-4	熱刺激電流(TSC)- EFISHG同時測定によるIZO/polyimide/pentacene/Au素子のキャリアトラップ評価	○田口 大[1], 細川 英機[1], 間中 孝彰[1], 岩本 光正[1]	1.東工大
		12p-P6-5	バイアス印加硬X線光電子分光法による有機薄膜トランジスタの電位観察	○(PC)渡辺 剛[1], 多田 圭佑[2], 安野 聡[1], 陰地 宏[1], 吉本 則之[2], 広沢 一郎[1]	1.高輝度光科学研究セ, 2.岩手大工
		12p-P6-6	パルスレーザ光照射による大気中光電子放出	○細貝 拓也[1], 松﨑 弘幸[1], 古部 昭広[1], 中村 健[1]	1.産総研 計測フロンティア
		12p-P6-7	塗布により作成した有機TFT の方形波重み関数電流DLTS 測定	○吉田 友紀[1], 丹羽 弘典[1], 岡本 啓暉[1], 徳田 豊[1], 中村 健二[2], 加藤 哲弥[2], 片山 雅之[2]	1.愛知工大, 2.(株)デンソー
		12p-P6-8	バンドダイアグラム測定装置の開発	○柳生 進二郎[1], 吉武 道子[1], 知京 豊裕[1]	1.物材機構
		12p-P6-9	電極間距離が及ぼす単分子検出への影響	○谷本 幸枝[1], 森川 高典[1], 有馬 彰秀[1], 筒井 真楠[1], 谷口 正輝[1]	1.阪大産研
		12p-P6-10	コンダクタンスと熱起電力の同時計測による単分子接合の電子状態評価	○筒井 真楠[1], 森川 高典[1], 有馬 彰秀[1], 谷口 正輝[1]	1.阪大産研

12.2 評価・基礎物性 / Characterization and Materials Physics　口頭講演

3月13日(金)　16:30 - 19:00

	16:30 - 16:45	13p-D14-1	固体基板上への逐次担持によるイオン液体薄膜の作製とその界面構造の評価	○中条 文哉[1], 森野 裕介[1], 横田 泰之[1], 今西 哲士[1], 福井 賢一[1]	1.阪大院基礎工
	16:45 - 17:00	13p-D14-2	光電子分光法による有機発光デバイス材料Be錯体の集合構造と電子状態の相関研究	○高橋 理記[1], 牧野 凜太朗[1], 加藤 賢悟[1], 米澤 恵一朗[1], 山口 拓真[1], 須田 洋輔[1], 鎌田 太介[2], 深川 弘彦[3], 上野 信雄[1], 解良 聡[1,4]	1.千葉大院融合, 2.東京理科大, 3.NHK技研, 4.分子研
	17:00 - 17:15	13p-D14-3	紫外光電子分光によるテトラセン及びルブレンのホール-振動結合	○佐藤 一至[1], 米澤 恵一朗[1], 山口 拓真[1], 須田 洋輔[1], 解良 聡[1,2]	1.千葉大院, 2.分子研
	17:15 - 17:30	奨 13p-D14-4	超高感度負イオン光電子分光による極性有機薄膜の空準位の直接観察	○(DC)金城 拓海[1], Lim Hyunsoo[1], 大澤 祐介[1], 佐藤 友哉[1], 中光 栄仁[1], Thanh Luan Nguyen[1], 浦上 裕希[1], 山崎 純暉[2], 中山 泰生[1], 石井 久夫[1,3]	1.千葉大院融合, 2.千葉大工学部, 3.千葉大先進
	17:30 - 17:45	奨 13p-D14-5	有機半導体のイオン化エネルギーと電子親和力の分子配向依存と四重極モーメントの影響	○山田 一斗[1], 吉田 弘幸[1], 佐藤 直樹[1]	1.京大化研
	17:45 - 18:00		休憩/Break		
	18:00 - 18:15	13p-D14-6	低エネルギー逆光電子分光法によるHOPG上のシャトルコック型フタロシアニンの鏡像準位の観測	○吉田 弘幸[1], 白石 龍[1], 佐藤 直樹[1]	1.京大化研
	18:15 - 18:30	13p-D14-7	BCPの電子状態に関する理論的研究	○柳澤 将[1,2], 畑田 真之介[2], 森川 良忠[2], 吉田 弘幸[3]	1.琉球大理, 2.阪大院工, 3.京大化研
	18:30 - 18:45	13p-D14-8	弱い相互作用に誘起される分子内軌道エネルギー緩和	○米澤 恵一朗[1], 山口 拓真[1], 牧野 凜太朗[1], 須田 洋輔[1], Kaveenga Rasika Koswattage[1], 上野 信雄[1], 解良 聡[1,2]	1.千葉大院融合, 2.分子研
	18:45 - 19:00	奨 13p-D14-9	有機薄膜/グラファイト界面における電子-格子相互作用：光電子非弾性散乱の観測	○山口 拓真[1], Bussolotti Fabio[2], Yang Jinpeng[1], 木村 賢太郎[1], 松波 雅治[2], 上野 信雄[1], 解良 聡[1,2]	1.千葉大院融合, 2.分子研

3月14日(土)　9:00 - 12:00

	9:00 - 9:15	奨 14a-D14-1	透過電子顕微鏡を用いたブルー相液晶の格子構造観察	○田中 秀[1], 吉田 浩之[1], 亲原 隆亮[2], 西 竜治[2], 尾崎 雅則[1]	1.阪大院工, 2.阪大電顕センター
	9:15 - 9:30	奨 14a-D14-2	アルキル鎖長の異なる液晶性フタロシアニンの薄膜X線構造解析	○(M2)大森 雅志[1], 東 卓也[1], 藤井 彰彦[1], 尾崎 雅則[1]	1.阪大院工
	9:30 - 9:45	E 14a-D14-3	Shear-Induced Conformation Change in α-crystalline Nylon6: a Way to Modulate and Measure Properties	○Sergei Manzhos[1], Saerif Arabnejad[1], Victor Shim[1], Chaobin He[1]	1.Natl. Uni. Singapore
	9:45 - 10:00	14a-D14-4	赤外分光によるゼラチン薄膜の乾燥過程における結合水の構造変化の解析	○大塚 由紀子[1], 白樫 了[1], 平川 一彦[1]	1.東大生研
	10:00 - 10:15	奨 14a-D14-5	表面プラズモン増強電界によるアゾベンゼン光異性化を用いた透過型表面プラズモン励起特性変化	○(M1)太田 厳之[1], 桑原 尚希[1], 馬場 暁[1], 大平 泰生[1], 新保 一成[1], 加藤 景三[1], 金子 双男[1]	1.新潟大学
	10:15 - 10:30		休憩/Break		
	10:30 - 10:45	14a-D14-6	ポリマーダイオード動作過程の分光計測による評価	○鐘本 勝一[1], 石川 沙樹[1]	1.大阪市大院理

	10:45 - 11:00	14a-D14-7	有機半導体の構造秩序の乱れが電荷輸送に与える影響― 秩序ﾊﾟﾗﾒｰﾀｰに基づく相関のあるﾃﾞｨｽｵｰﾀﾞｰﾓﾃﾞﾙ ―	○大野 玲[1], 新田 武父[1], 高屋敷 由紀子[1], 飯野 裕明[1]	1.東工大像情報
	11:00 - 11:15	14a-D14-8	インピーダンス分光を用いた有機半導体デバイスの新規キャリア寿命評価法	○高木 謙一郎[1], 永瀬 隆[1,2], 小林 隆史[1,2], 内藤 裕義[1,2]	1.大阪府大院工, 2.大阪府大 分子エレクトロニックデバイス研
	11:15 - 11:30	奨 14a-D14-9	過渡電流測定及び電界誘起光第二次高調波測定によるMIS構造中の有機半導体層のキャリア移動度評価	○中村 大二郎[1], 貞方 敦雄[1], 田口 大[1], 間中 孝彰[1], 岩本 光正[1]	1.東工大理工
	11:30 - 11:45	14a-D14-10	電界誘起光第二次高調波発生法による2層積層(IZO/PMMA/a-NPD/Au)有機ダイオード素子の電界分布と電気伝導機構の解析	○(M2)西 翔平[1], 田口 大[1], 間中 孝彰[1], 岩本 光正[1]	1.東工大院理工
	11:45 - 12:00	14a-D14-11	電界注入型マイクロ波共振法による界面における電荷キャリア輸送評価	○筒井 祐介[1], 崔 旭鎮[1], 櫻井 庸明[1], 佐伯 昭紀[1], 関 修平[1]	1.阪大院工
	3月14日(土) 13:00 - 15:00				
	13:00 - 13:15	奨 14p-D14-1	EFISHG顕微法による有機素子(IZO/polyimide/C_{60}/Al)の絶縁破壊前駆現象の観察	○田口 大[1], 間中 孝彰[1], 岩本 光正[1]	1.東工大
	13:15 - 13:30	14p-D14-2	ペンタセン単結晶上へのC_{60}のヘテロエピタキシャル成長	○山本 真之[1], 水野 裕太[2], 金城 拓海[1], 浦上 裕希[1], 細貝 拓也[3], 小金澤 智之[4], 間瀬 一彦[5], Kaveenga Rasika Koswattage[6], 中山 泰生[1,2,6], 石井 久夫[1,2,6]	1.千葉大院融合, 2.千葉大工, 3.産総研, 4.JASRI, 5.KEK 物構研, 6.千葉大先進
	13:30 - 13:45	14p-D14-3	金属イオンを介したルテニウム錯体分子多層膜の長距離電子移動能	○大山 真紀子[1], 永嶌 匠[2], 小澤 寛晃[2], 芳賀 正明[2], 石田 敬雄[1]	1.産総研ナノシステム, 2.中央大理工
	13:45 - 14:00	14p-D14-4	Ni-C_{60}-Niスピンバルブ素子の第一原理計算	○大戸 達彦[1], 山田 亮[1], 浸田 博一[1]	1.阪大院基礎工
	14:00 - 14:15	14p-D14-5	カーボンナノチューブ・ポリ酸ネットワークのニューロン発火特性のカオス解析	○付 凌翔[1], 田向 権[1], 小川 琢治[2], 田中 啓文[1,2]	1.九州工業大学, 2.大阪大学
	14:15 - 14:30	奨 14p-D14-6	単層グラフェンを上部電極に利用した単分子膜素子の作製	○山口 真理子[1], 生田 昂[2], 金井 康[2], 大戸 達彦[1], 山田 亮[1], 大野 恭秀[2,3], 前橋 兼三[2,4], 松本 和彦[2], 浸田 博一[1]	1.阪大院基礎工, 2.阪大産研, 3.徳島大, 4.農工大工
	14:30 - 14:45	奨 14p-D14-7	Au/オリゴチオフェン/Au接合の非弾性トンネルスペクトル測定	○下店 隆史[1], Franchi Jimmy[2], 田中 彰治[3], 大戸 達彦[1], 山田 亮[1], 浸田 博一[1]	1.阪大院, 2.スウェーデン王立工科大, 3.分子研
	14:45 - 15:00	奨 14p-D14-8	アルカンチオール分子接合のTransition voltage spectroscopy における界面準位および非対称性の寄与	○野勢 大輔[1], 佐藤 友哉[1], 土手 宏樹[1], 石井 久夫[1,2], 野口 裕[3]	1.千葉大院融合, 2.千葉大先進, 3.明治大学

12.3 機能材料・萌芽的デバイス / Functional Materials and Novel Devices　口頭講演

	3月11日(水) 9:00 - 11:45				
	9:00 - 9:15	11a-D4-1	薄膜グラファイトを用いた歪みセンサによる指関節運動のモニタリング	○下田 寛[1], 齋藤 孝成[1], 白樫 淳一[1]	1.東京農工大学院工
	9:15 - 9:30	11a-D4-2	薄膜グラファイト細線を用いた装着型デバイスによる人体動作の観察	○齋藤 孝成[1], 下田 寛[1], 白樫 淳一[1]	1.東京農工大院工
	9:30 - 9:45	11a-D4-3	カーボンナノチューブ複合体電極を有する高速応答ポリイミド静電容量型湿度センサの作製とガス透過機構に関する検討	○伊東 栄次[1], 高田 明典[1]	1.信州大工
	9:45 - 10:00	奨 11a-D4-4	ストレッチャブル配線を用いた伸縮計測センサーの開発	○延島 大樹[1], 小笹 健仁[1], 植村 聖[1], 吉田 学[1]	1.産総研FLEC
	10:00 - 10:15	奨 11a-D4-5	ストレッチャブルな圧力分布計測シートの開発	○延島 大樹[1], 小笹 健仁[1], 吉田 学[1], 植村 聖[1]	1.産総研FLEC
	10:15 - 10:30		休憩/Break		
	10:30 - 10:45	奨・E 11a-D4-6	Programmable Biosensor Development for the Electrochemical Detection of Metal Ions	○(P)Rahul Bhardwaj[1], Manish Biyani[1], Yuzuru Takamura[1]	1.Japan Advanced Institute of Science and Technology
	10:45 - 11:00	奨 11a-D4-7	エレクトロスピニング法で作製したポリ乳酸ファイバー膜が有する圧電的挙動の解析	○(P)延島 大樹[1], 石井 佑弥[2], 酒井 平祐[3], 植村 聖[1]	1.産総研FLEC, 2.豊橋技科大, 3.北陸先端大
	11:00 - 11:15	奨 11a-D4-8	高導電性ハイドロゲルの合成と力学特性	○久保田 智章[1], 岩下 加奈[1], 奥崎 秀典[1]	1.山梨大院
	11:15 - 11:30	奨 11a-D4-9	PEDOT/PSS/ポリグリセリン複合フィルムの作製と電気力学特性	○(M1)佐藤 正樹[1], 谷川 諒[1], 久保田 智章[1], 奥崎 秀典[1]	1.山梨大院
	11:30 - 11:45	奨 11a-D4-10	熱応答性ポリマーを用いた無電源アクチュエータ	○山本 祐輝[1], 金尾 顕一朗[1], 有江 隆之[1], 秋田 成司[1], 竹井 邦晴[1]	1.大阪府大工
	3月11日(水) 13:15 - 17:45				
	13:15 - 13:30	11p-D4-1	ポリチオフェンナノファイバーとPEDOT:PSS積層膜の熱電変換特性評価	○涌井 純馬[1], 樋浦 翔悟[1], 下村 武史[1]	1.農工大院
	13:30 - 13:45	11p-D4-2	イオン液体添加による単層カーボンナノチューブ熱電変換特性の増強効果	○堀家 匠平[1], 小柴 康子[1], 三崎 雅裕[1], 斎藤 毅[2], 石田 謙司[1]	1.神戸大院工, 2.産総研
	13:45 - 14:00	11p-D4-3	巨大ゼーベック係数を示すフラーレンの回転運動と熱物性との相関性	○小島 広孝[1], 阿部 竜[1], 藤原 史弥[1], 伊藤 光洋[1], 橋爪 拓也[1], 松原 亮介[1], 中村 雅一[1]	1.奈良先端大物質
	14:00 - 14:15	11p-D4-4	温度変調に伴うキャリア伝導機構変化を利用した新奇有機熱電材料の探索(Ⅲ):巨大ゼーベック効果の特異性と普遍性	阿部 竜[1], 藤原 史弥[1], 高橋 功太郎[1], 小島 広孝[1], 松原 亮介[1], 葛原 大軌[1], 山田 容子[1], 山本 達也[2], 薬師寺 秀典[2], 池田 征明[2], ○中村 雅一[1]	1.奈良先端大物質, 2.日本化薬
	14:15 - 14:30	奨 11p-D4-5	ポリフッ化ビニリデンナノ粒子からなるコロイド結晶の構築とβ相化	○岡田 大地[1], 古海 誓一[2], 竹口 雅樹[3], 山本 洋平[1]	1.筑波大院数理物質, 2.東京理科大学, 3.物質材料機構
	14:30 - 14:45	奨・E 11p-D4-6	Tailored hierarchical architectures based on POSS-crystallization kinetics driven self-assembly	○(P)Jinguang Cai[1], Akira Watanabe[1]	1.IMRAM, Tohoku Univ.
	14:45 - 15:00	11p-D4-7	van der Waals 相互作用エネルギーが乾燥模様に及ぼす影響 II	○大森 豊司[1], 増田 貴史[1], 下田 達也[1,2]	1.北陸先端大, 2.グリーンデバイス研
	15:00 - 15:15	11p-D4-8	ジチオール置換銀微粒子単層膜の作製と評価	○龍崎 奏[1], 斎藤 鼎[1], 岡本 晃一[1], 玉田 薫[1]	1.九大先導研
	15:15 - 15:30	11p-D4-9	メタルコートされた異方的半球配列構造の反射光学特性	○福田 隆史[1], 江本 顕雄[2]	1.産総研 電子光技術, 2.同志社大理工
	15:30 - 15:45		休憩/Break		
	15:45 - 16:00	11p-D4-10	液晶素子を用いたレーザースペックルノイズの低減	○石川 隼[1]	1.東理大院基礎工
	16:00 - 16:15	11p-D4-11	強度変調と偏光変調が混在した2光波干渉紫外光の一度露光によるTN及びホモジニアス配向が混在したベクトル回折格子液晶セル形成	○河合 孝太郎[1], 佐々木 友之[1], 野田 浩平[1], 川月 喜弘[2], 小野 浩司[1]	1.長岡技科大, 2.兵庫県立大
	16:15 - 16:30	11p-D4-12	光架橋性高分子液晶を用いたファブリペロー構造を有するホログラフィックベクトル格子の回折特性	○山口 春樹[1], 河合 孝太郎[1], 佐々木 友之[1], 野田 浩平[1], 川月 喜弘[2], 小野 浩司[1]	1.長岡技科大, 2.兵庫県立大
	16:30 - 16:45	11p-D4-13	光架橋性高分子液晶を用いた回折格子液晶セル形成と回折特性のキラル分子添加効果	○志村 礼[1], 河合 孝太郎[1], 佐々木 友之[1], 野田 浩平[1], 川月 喜弘[2], 小野 浩司[1]	1.長岡技科大, 2.兵庫県立大

	16:45 - 17:00	奨 11p-D4-14	高分子安定化ブルー相液晶における電気光学カー効果の異方性の検討	○河田 優人[1], 吉田 浩之[1], 菊池 裕嗣[2], 尾崎 雅則[1]	1.阪大院工, 2.九大先導研
	17:00 - 17:15	奨 11p-D4-15	分子配向性ネマティックマイクロ粒子の液晶中における電界応答	○今村 弘毅[1], 片山 満吉[1], 吉田 浩之[1], 尾崎 雅則[1]	1.阪大院工
	17:15 - 17:30	奨 11p-D4-16	基板レス液晶ディスプレイの実現に向けた液晶・高分子配向複合膜の相分離制御	○佐々木 大介[1], 石鍋 隆宏[1], 藤掛 英夫[1]	1.東北大工
	17:30 - 17:45	奨 11p-D4-17	塗布・剥離形成基板を用いたフレキシブル液晶デバイスの作製	○生内 友輔[1], 石鍋 隆宏[1], 藤掛 英夫[1]	1.東北大工
	3月12日(木)　9:00 - 11:30				
	9:00 - 9:15	12a-D4-1	ずりを用いて作製された基板面内に螺旋軸を持つコレステリック液晶	○井上 曜[1], 森武 洋[1]	1.防衛大電気情報
	9:15 - 9:30	12a-D4-2	3つの応答成分を持つ面内螺旋配向コレステリック液晶の電気光学効果	○井上 曜[1], 森武 洋[1]	1.防衛大電気情報
	9:30 - 9:45	12a-D4-3	強誘電性液晶の一様垂直配向セルの作製	○(M1C)大塚 正志[1], 鈴木 裕二[1], 岡 真一郎[2], 小林 真一[2], 古江 広和[1]	1.東理大院基礎工, 2.ジャパンディスプレイ
	9:45 - 10:00	12a-D4-4	PSCOF構造を有する液晶セルの作製条件	○原田 拓明[1]	1.東理大院基礎工
	10:00 - 10:15	12a-D4-5	PSV-FLCD作製のための添加モノマー種の検討	○宿岡 真[1]	1.東理大基礎工
	10:15 - 10:30		休憩/Break		
	10:30 - 10:45	12a-D4-6	光配向性複合体液晶への偏光露光と光配向特性	○小歩 岳史[1], 佐々木 友之[1], 野田 浩平[1], 川月 喜弘[2], 後藤 浩平[3], 小野 浩司[1]	1.長岡技科大, 2.兵庫県立大, 3.日産化学工業
	10:45 - 11:00	12a-D4-7	アルキルアミン蒸気処理時間とポリイミド光配向膜の面内異方性との関係	○坂本 謙二[1]	1.物材機構
	11:00 - 11:15	12a-D4-8	アルキルスルホン化ポリイミド薄膜のライオトロピック液晶性により誘起された規則構造とプロトン伝導性の相関	○後藤 峻介[1], 原 光男[1], 長尾 祐樹[2], 永野 修作[3]	1.名大院工, 2.JAIST, 3.名大VBL
	11:15 - 11:30	12a-D4-9	糖脂質系グルコシド液晶の磁場・電場誘起相転移現象	○杉村 明彦[1], 浜砂 大地[1], H.S. Nguan[2], M. Rahman[2], R. Hashim[2], H. Zimmermann[3]	1.阪産大, 2.マラヤ大, 3.マックスプランク研
	3月12日(木)　13:15 - 17:45				
	13:15 - 13:30	12p-D4-1	バルビツール酸誘導体Ni錯体ディスコチック液晶中の正孔移動特性	○(M2)横山 昌憲[1], 向後 潤一[1], Gorecka Ewa[2], 石川 謙[1]	1.東工大院, 2.ワルシャワ大
	13:30 - 13:45	12p-D4-2	パーフルオロアルキル基を持つ有機半導体の光電子分光法により得られる仕事関数の特異性	夫 恒範[1], ソーサ-ヴァルガス リディア[1], 池原 成拓[2], 熊田 泰士[2], 奥田 大樹[1,3], 三宅 康雄[1,2], 藤井 彰彦[2], 尾崎 雅則[2], ○清水 洋[1]	1.産総研ユビキタス, 2.阪大院工, 3.龍谷大理工
	13:45 - 14:00	12p-D4-3	液晶性ジアルキルチエニルナフタレンとP3HTの2成分系におけるキャリヤ移動特性	川野 倖暉[1,2], 縄本 眞三[1], 西川 浩矢[1,2], 物部 浩達[1], ○清水 洋[1]	1.産総研ユビキタス, 2.龍谷大理工
	14:00 - 14:15	12p-D4-4	銀ナノ粒子-酸化チタン複合フィルムの光電導	○山崎 健輝[1], 石田 拓馬[1], 武者 拓人[1], 藤野 正家[1], 片桐 裕則[2], 河村 剛[3], 松田 厚範[3]	1.群馬高専, 2.長岡高専, 3.豊橋技科大
	14:15 - 14:30	12p-D4-5	ポリ(3-ヘキシルチオフェン)の基板界面近傍の分子配向	○水野 佑[1], 大野 慶太[1], 原 光生[1], 永野 修作[2], 関 隆広[1]	1.名大院工, 2.名大VBL
	14:30 - 14:45	12p-D4-6	混合膜系のp型およびn型導電性高分子の分子配向	○大野 慶太[1], 水野 佑[1], 原 光生[1], 永野 修作[2], 関 隆広[1]	1.名大院工, 2.名大VBL
	14:45 - 15:00		休憩/Break		
招待	**15:00 - 15:15**	**12p-D4-7**	**「講演奨励賞受賞記念講演」(15分) 自己組織化π共役高分子マイクロ球体からのWGM発光**	**○田畑 顕一[1], Daniel Braam[2], 櫛田 創[1], 童 亮[1], 桑原 純平[1], 神原 貴樹[1], Axel Lorke[2], 山本 洋平[1,3]**	**1.筑波大数理物質, 2.デュイスブルグ-エッセン大学物理, 3.筑波大TIMS**
	15:15 - 15:30	奨 12p-D4-8	高発光性π共役高分子球体によるWGM発光とエネルギー捕集	○櫛田 創[1], ブラーム ダニエル[2], 田畑 顕一[1], 柴崎 浩輔[1], タン ダオ[3], 石井 智[3], 長尾 忠昭[3], 桑原 純平[1], 神原 貴樹[1], 木島 正志[1], ロルケ アクセル[2], 山本 洋平[1]	1.筑波院数理, 2.Duisburg-Essen大物理, 3.NIMS, MANA
	15:30 - 15:45	奨 12p-D4-9	有機薄膜への酸素の導入によるSinglet-Triplet Annihilationの抑制	○井上 棟智[1], 松島 敏則[1,2], 安達 千波矢[1,2]	1.九州大 OPERA, 2.JST ERATO
	15:45 - 16:00	奨 12p-D4-10	結晶化制御による光導電性増強とその汎用化の検討	○(D)辻村 翔[1,2], 藤原 隆[2,3], 佐々 高史[2], 木梨 憲司[1], 坂井 亙[1], 石橋 幸治[2], 堤 直人[1]	1.京工繊大院, 2.理研, 3.九州先端研
	16:00 - 16:15	奨 12p-D4-11	高分子ナノシートから作製したSiO_2超薄膜の抵抗変化動作	○北中 孝尚[1], 山本 俊介[1], 宮下 徳治[1], 三ツ石 方也[1]	1.多元研
	16:15 - 16:30	12p-D4-12	TPCO結晶マイクロキャビティの角度分解および時間分解レーザー特性	田中 庸介[1], 後藤 要[2], 山下 兼一[2], 山雄 健史[2], 堀田 収[2], 佐々木 史雄[3], ○柳 久雄[1]	1.奈良先端大物質, 2.京工繊大院工芸, 3.産総研電子光技術
	16:30 - 16:45	12p-D4-13	サイズ制御したp-sexiphenyl単結晶キャビティの発光増幅特性	田村 健次[1], 佐々木 史雄[2], ○柳 久雄[1]	1.奈良先端大物質, 2.産総研電子光技術
	16:45 - 17:00	12p-D4-14	有機色素J会合体を用いたマイクロキャビティの光学特性	○水野 斎[1], 谷尻 尚之[1], 川西 有輝[1], 石墨 淳[2], 柳 久雄[2], 廣光 一郎[1]	1.島根大総合理工, 2.奈良先端大物質
	17:00 - 17:15	12p-D4-15	有機・無機層状ペロブスカイト光共振器の強結合モードを介した発光	○高田 徳幸[1]	1.産総研
	17:15 - 17:30	12p-D4-16	シアニン色素薄膜におけるエネルギー移動による励起子緩和時間の制御	○長内 順平[1], 小島 磨[1], 喜多 隆[1], 沈 用球[2]	1.神戸大院工, 2.阪府大院工
	17:30 - 17:45	12p-D4-17	温度変調法による電子型強誘電体 a-$(BEDT\text{-}TTF)_2I_3$の焦電流観測	○山本 薫[1], 川島 大樹[1], 横山 直[1]	1.岡山理大理
	3月13日(金)　9:00 - 11:00				
	9:00 - 9:15	奨 13a-D4-1	ポリビニルカルバゾールナノファイバーの作製と光導波	○里園 翔太[1], 石井 佑弥[1], 上ノ瀬 亮平[1], 福田 光男[1]	1.豊技大
	9:15 - 9:30	奨 13a-D4-2	PEDOT/PSSを用いたアルミ固体電解コンデンサの作製	○竹澤 裕美[1], 勝沼 将人[1], 奥崎 秀典[1]	1.山梨大院
	9:30 - 9:45	奨 13a-D4-3	1000 S/cmを超えるPEDOT/PSSの合成と電気特性	○雨宮 裕希[1], 堀井 辰衛[1], 奥崎 秀典[1]	1.山梨大院
	9:45 - 10:00	13a-D4-4	n型導電性高分子の安定性について　－アルキル化(p-ピリジルビニレン)－	○小野田 光宣[1]	1.兵庫県立大院工
	10:00 - 10:15	13a-D4-5	熱刺激電流測定法及び電気光学定数測定法による有機電気光学ポリマーの熱安定性の評価	○(M2)池本 龍馬[1], 田口 大[1], 間中 孝彰[1], 岩本 光正[1], 山田 俊樹[2], 大友 明[2]	1.東工大理工, 2.情報通信研究機構
招待	**10:15 - 11:00**	**13a-D4-6**	**「有機分子・バイオエレクトロニクス 分科内招待講演」(45分) 分子回路工学をめざした分子グリッド配線技術**	**○彌田 智一[1]**	**1.東工大**

12.3 機能材料・萌芽的デバイス / Functional Materials and Novel Devices　ポスター講演

3月13日(金)　16:30 - 18:30

		13p-P15-1	ハイブリッド配向型液晶偏光回折格子における高次回折特性	○(B)高橋 夏輝[1], 本間 道則[1], 能勢 敏明[1]	1.秋田県立大学
		13p-P15-2	液晶偏光マスクによる液晶光配向パターンの形成	○(B)安藝 諭宇馬[1], 本間 道則[1], 能勢 敏明[1]	1.秋田県立大学
		13p-P15-3	ナノファイバー／液晶複合素子の立ち下がり時間のファイバー密度依存性	○Duong Toan[1], 尾崎 良太郎[2], 井上 曜[1], 森武 洋[1]	1.防衛大電気情報, 2.愛媛大院理工
		13p-P15-4	高分子安定化ブルー相液晶セルの電気光学応答に与える高分子の影響に関する研究	○松本 崇裕[1], 木村 宗弘[1]	1.長岡技科大
		13p-P15-5	スリット電極型液晶シリンドリカルレンズアレイによる光偏向効果(II)	○内田 勝[1], 梁瀬 智[1], 王 濱[1]	1.秋田産技センター
		13p-P15-6	横電界駆動 TNLC によるフレクソエレクトリック係数評価	○(M2)FILZAHBINTI ZAINALARIF[1], 松本 紘希[1], 木村 宗弘[1], 赤羽 正志[1]	1.長岡技術科学大学
		13p-P15-7	マイクロストリップライン電極構造におけるn形液晶の分子配向特性	○永澤 雅[1], 小室 匠[1], 笹森 崇行[1], 磯田 陽次[1], 渡辺 猛[2], 伊藤 謙二[2], 伊東 良太[1], 本間 道則[1], 能勢 敏明[1]	1.秋田県大システム, 2.由利工業(株)
		13p-P15-8	導波管測定による多孔質PMMAフィルムにおける液晶分子配向効果の検討	○大野 真之介[1], 伊東 良太[1], 本間 道則[1], 能勢 敏明[1]	1.秋田県大システム
		13p-P15-9	±45° TN液晶セルの偏光回転効果におけるセル厚依存性の検討	○(M1)竹内 亨[1], 伊東 良太[1], 本間 道則[1], 藤田 直子[2], 岡野 桂樹[2], 村田 純[2], 村口 元[2], 尾崎 紀昭[2], 能勢 敏明[1]	1.秋田県大システム, 2.秋田県大生物
		13p-P15-10	厚いネマティック液晶層を有するデバイスの高分子安定化による応答改善	○ブイ バオ[1], 樋口 博紀[2], 菊池 裕嗣[2], 井上 曜[1], 森武 洋[1]	1.防衛大, 2.九大先導研
		13p-P15-11	Uniform Standing Helixモード液晶素子の基礎研究	○小野寺 郁也[1]	1.長岡技科大院工
		13p-P15-12	低電圧駆動型液晶レンズの高速駆動における解像度特性	○近藤 祐治[1], 王 濱[1], 石井 雅樹[2], 梁瀬 智[1], 高橋 慎吾[1]	1.秋田産技センター, 2.秋田県大
		13p-P15-13	第3電極を持つ液晶シリンドリカルレンズの2D/3D切り替え特性	○梁瀬 智[1], 内田 勝[1], 王 濱[1]	1.秋田産技センター
		13p-P15-14	TCF-CF_3アクセプターを含むNLO色素の合成	○(M1)鈴木 亮太[1], 北川 顕磨[1], 間瀬 暢之[1], 鳴海 哲夫[1], 杉田 篤史[1]	1.静岡大工
		13p-P15-15	ナノインプリントを用いたポリチオフェン誘導体の結晶構造制御	○塚田 涼太[1], 串 聡志[1], 下村 武史[1]	1.農工大院
		13p-P15-16	有機ナノファイバーコンポジットフィルムの半導体特性	○八木 杜仁[1], 下村 武史[2]	1.農工大工, 2.農工大院工
		13p-P15-17	ポリチオフェン誘導体のナノファイバー形成メカニズム	○伊藤 大樹[1], 下村 武史[2], 三浦 俊明[3]	1.農工大工, 2..農工大院工, 3.産総研
		13p-P15-18	有機層にπ共役系高分子を導入した臭化鉛系層状ペロブスカイト有機・無機超格子Langmuir-Blodgett膜の作製	○(B)白鳥 武[1], 早田 皓一[1], 坂口 幸一[1], 江良 正直[1]	1.佐賀大理工
		13p-P15-19	ポリジアセチレンナノ結晶の薄膜化と非線形光学応答のサイズ依存性	○(M1)眞木 晴季[1], 小野寺 恒信[1], Sato Rodrigo[2], 武田 良彦[2], 笠井 均[1], 及川 英俊[1]	1.東北大多元研, 2.物材機構
		13p-P15-20	色素添加ポリマー光ファイバーの垂直応力下での出射光解析	○(B)溝呂木 大地[1], 牧野 建志[1], 西村 亮一[2], 塚田 賢治[2], 二瓶 栄輔[2], 古川 怜[1]	1.電気大情報学先進古研, 2.慶應大理工学物理二研
		13p-P15-21	ポリマーダイオードにおける電気容量の磁場効果	○中嶋 敬幸[1], 鐘本 勝一[1]	1.阪市大院理
		13p-P15-22	溶液塗布法による有機強誘電体薄膜(PVDF薄膜)の成膜	○中山 貴裕[1], 今井 裕司[2], 馬 騰[1], 山本 英明[3,4], 平野 愛弓[3,4], 庭野 道夫[1]	1.東北大通研, 2.仙台高専, 3.東北大院医工, 4.CREST,JST
		13p-P15-23	アゾ・カルバゾール色素における光誘起屈折率格子の形成VII	○夛田 量宏[1], 今井 敏郎[1], 川辺 豊[1]	1.千歳科技大
		13p-P15-24	アゾビナフチル分散PMMA膜における光誘起屈折率変化の機構	○佐々 高史[1], 清水 智樹[1,2], 藤原 隆[1,3], 川本 益揮[1], 礒島 隆史[1], 木下 岳司[2], 石橋 幸治[1]	1.理研, 2.慶大理工, 3.九州先端研
		13p-P15-25	ジアリールエテン/銅複合膜における電流双安定性	○(B)信長 賢輝[1], 土肥 愛実[1], 辻岡 強[1]	1.大阪教育大
		13p-P15-26	ジアリールエテン膜のキャリア注入異性化反応を用いたメモリ素子の動作原理	○(M1)山本 一樹[1], 辻岡 強[1]	1.大阪教育大
		13p-P15-27	(TTF)(TCNQ)蒸着膜における抵抗率とゼーベック係数の温度依存性	○佐藤 諒之介[1], 角屋 智史[1], 川本 正[1], 森 健彦[1]	1.東工大院理工
		13p-P15-28	THz波センサ応用にむけた有機電界効果トランジスタの作製とTHz波光伝導度測定	○木元 鴻太郎[1], 鈴木 諒[1], 羽田 正雄[1], 李 世光[2], 小島 広孝[1], 松原 亮介[1], 中村 雅一[1]	1.奈良先端大物質, 2.西安理工大
		13p-P15-29	酸化亜鉛微粒子とアントラセン誘導体間のエネルギー移動	○水野 斎[1], 垣内 君斗[1], 東影 東影[1], 石墨 淳[2], 柳 久雄[2], 廣光 一郎[1]	1.島根大総合理工, 2.奈良先端大物質
		13p-P15-30	微細金属ワイヤへのポリピロール薄膜形成	○出村 洋智[1], 永吉 浩[1]	1.東京高専
		13p-P15-31	GZO/有機半導体/MoO_3/Au構造における抵抗変化型write onceメモリ効果の発現	○長谷川 純也[1], 永瀬 隆[1,2], 小林 隆史[1,2], 内藤 裕義[1,2]	1.大府大工, 2.大阪府立大分子エレクトロニックデバイス研
		13p-P15-32	シアノ置換TPCO誘導体結晶を用いたマイクロキャビティの発光特性	○畑野 良太[1], 田中 庸介[1], 山下 兼一[2], 山雄 健史[2], 堀田 収[2], 佐々木 史雄[3], 柳 久雄[1]	1.奈良先端大物質, 2.京工繊大院工芸, 3.産総研電子光技術
		13p-P15-33	メタルコートされた球・半球構造における反射光学特性の比較	○江本 顕雄[1], 川井 優也[1], 大谷 直毅[1], 福田 隆史[2]	1.同志社大理工, 2.産総研
		13p-P15-34	バイオミメティック匂いセンサ(BMOS)の最適ホスト材料の探索	○上野 陽佑[1], 小島 大樹[1], 三田地 成幸[1]	1.東京工科大
		13p-P15-35	スメクチック液晶におけるキラリティと分子ゆらぎ	○平岡 一幸[1], 川崎 良太[1], 山本 愛実[1], 小宮 研一郎[1]	1.東京工芸大工
		13p-P15-36	金属アルコキシドを用いた有機無機ハイブリッド薄膜太陽電池の高効率化	○加藤 岳仁[1], 梅壽 光大[1], 伊澤 悟[1], 田中 好一[1], 萩原 直樹[2], 加藤 有行[3]	1.小山高専, 2.アシザワ・ファインテック(株), 3.長岡技大

12.4 有機EL・トランジスタ / Organic light-emitting devices and organic transistors　口頭講演

3月11日(水)　9:30 - 11:45

	9:30 - 9:45	11a-D3-1	高効率白色リン光有機ELデバイスの開発	○宇田川 和男[1], 笹部 久宏[1,2], 五十嵐 史彬[1], 城戸 淳二[1,2]	1.山形大院理工, 2.山形大有機エレ研セ
	9:45 - 10:00	11a-D3-2	95 lm W^{-1} 超の電力効率を示す低駆動電圧緑色TADF有機ELデバイスの開発	猪股 晋[1], ○清野 雄基[1], 笹部 久宏[1,2], 夫 勇進[1,2], 城戸 淳二[1,2]	1.山形大院理工, 2.山形大有機エレ研セ
	10:00 - 10:15	11a-D3-3	酸化亜鉛透明導電膜を用いた逆構造有機発光ダイオードの作製と評価	○高田 誠[1], 永瀬 隆[1,2], 小林 隆史[1,2], 内藤 裕義[1,2]	1.大阪府立大, 2.大阪府立大分子エレクトロニックデバイス研

	10:15 - 10:30	奨 11a-D3-4	塗布マルチフォトンエミッション型有機EL素子	○千葉 貴之[1], 夫 勇進[1], 井手田 一茂[1], 高橋 省吾[1], 相澤 直矢[1], 引地 達也[1], 城戸 淳二[1]	1.山形大院理工
	10:30 - 10:45	奨 11a-D3-5	低屈折率電子輸送層を用いた有機EL素子における表面プラズモン損失の低減とその光学解析	○垣添 勇人[1], 米原 健矢[1], 澤部 智明[1], 杉 啓司[1], 加藤 大望[1], 真常 泰[1], 小野 富男[1], 中井 豊[1]	1.(株)東芝 研究開発センター
	10:45 - 11:00	11a-D3-6	熱活性化遅延蛍光材料の光誘導吸収の励起光強度依存性	○丹羽 顕嗣[1], 高木 絢生[1], 小林 隆史[1,2], 永瀬 隆[1,2], 合志 憲一[3,4], 安達 千波矢[3,4], 内藤 裕義[1,2]	1.大阪府大工, 2.大阪府大RIMED, 3.九大OPERA, 4.九大WPI-I2CNER
	11:00 - 11:15	11a-D3-7	有機EL膜の界面混合状態とその動的挙動に関するエリプソメトリー分析	○横山 大輔[1,2,3], 柴田 真希[1], 酒井 義也[2]	1.山形大院理工, 2.山形大工, 3.山形大有機エレ研究センター
	11:15 - 11:30	11a-D3-8	スピンコートにおける低分子及び高分子有機EL材料の膜形成過程の観察	○硯里 善幸[1,2], 井上 晴夫[2]	1.山形大有機イノベ, 2.首都大院都市環境
	11:30 - 11:45	奨・E 11a-D3-9	Horizontal molecular orientation in solution-processed organic light-emitting diodes based on an oligofluorene derivative	○(D)Li Zhao[1], Takeshi Komino[1,2,3], Munetomo Inoue[1], Ju-Hyung Kim[1], Jean-Charles Ribierre[1,3], Chihaya Adachi[1,2,3]	1.Center for Organic Photonics and Electronics Research (OPERA) Kyushu University, Japan, 2.Education Center for Global Leaders in Molecular System for Devices, Kyushu University, Japan, 3.Japan Science and Technology Agency (JST), ERATO, Adachi Molecular Exciton Engineering Project, Japan
	3月11日(水)　13:15 - 18:00				
	13:15 - 13:30	11p-D3-1	積層型有機ELにおける界面蓄積電荷に関するラマン分光研究	○唐津 勇作[1], 古川 行夫[1], 大畑 浩[2], 宮口 敏[2], 筒井 哲夫[2]	1.早稲田大先進理工, 2.次世代化学材料評価技術研究組合
	13:30 - 13:45	奨 11p-D3-2	ナノ微細構造OLEDを用いたSinglet-Polaron Annihilationの抑制	○(B)新田 篤志[1], 桑江 博之[2,3], 吉田 巧[1], 井上 棟智[1], 松島 敏則[1,2], 水野 潤[2,3], 安達 千波矢[1,2]	1.九大OPERA, 2.JST ERATO, 3.早大
	13:45 - 14:00	11p-D3-3	ドープ層を持つ有機EL素子の配向分極による深いトラップの観測	○石野 竜太[1], 中光 栄仁[1], 金 炯濬[1], 野口 裕[2], 石井 久夫[1,3]	1.千葉大融合, 2.明治大理工, 3.千葉大先進
	14:00 - 14:15	奨 11p-D3-4	EFISHGおよびLBIC測定による二層積層有機EL素子内のキャリア挙動解析	○貞方 敦雄[1], 田口 大[1], 間中 孝彰[1], 岩本 光正[1]	1.東工大・理工
	14:15 - 14:30	奨 11p-D3-5	デバイスシミュレータによるCuPc/正孔輸送層の電導解析	○坂井田 雅人[1], 光崎 茂松[1], 雷 丙尤[1], 古橋 秀夫[1], 森 竜雄[1]	1.愛知工大
	14:30 - 14:45		休憩/Break		
	14:45 - 15:00	11p-D3-6	ケルビンプローブフォース顕微鏡によるペンタセン薄膜トランジスタの局所活性化エネルギー評価	○黄 子玲[1], 木村 知玄[1], 小林 圭[1,2], 山田 啓文[1]	1.京大工, 2.京大白眉セ
	15:00 - 15:15	奨 11p-D3-7	化学修飾金電極がペンタセン薄膜トランジスタに及ぼす影響の数値的検討	○長浜 陽生[1], 野田 啓[1], 和田 恭雄[1], 島谷部 達[2]	1.慶應大理工, 2.東洋大
	15:15 - 15:30	11p-D3-8	CNT-電極間の接触抵抗解析	○殿内 規之[1], 松本 翼[1], 二瓶 史行[1], 遠藤 浩幸[1]	1.日本電気
	15:30 - 15:45	11p-D3-9	キャリアコヒーレンスに起因する有機半導体移動度のトランスファー積分符号依存性	○松井 弘之[1], 岡本 敏宏[1], 三津井 親彦[1], 山岸 正和[2], 佐藤 寛泰[3], 山野 昭人[3], 竹谷 純一[1]	1.東大新領域, 2.富山高専, 3.リガク
	15:45 - 16:00	E 11p-D3-10	Development of solvent-free tunable and flexible liquid organic semiconductor lasers	○JeanCharles Ribierre[1,2], Ju-Hyung Kim[1], Munetomo Inoue[1], Li Zhao[1], Takeshi Komino[1,2,3], Chihaya Adachi[1,2,3]	1.OPERA, Kyushu Univ., 2.JST ERATO, 3.Kyushu Univ.
	16:00 - 16:15	11p-D3-11	BP3T単結晶の光増幅特性におけるポーラロン効果	○宮崎 真澄[1], 坂上 知[1], 高橋 亘[1], 堀田 収[2], 竹延 大志[1]	1.早大先進, 2.京都工繊大
	16:15 - 16:30		休憩/Break		
	16:30 - 16:45	11p-D3-12	二種類の蛍光ポリマーを混合した発光電気化学セルにおける活性層組成と発光色の相関	○瀧澤 大介[1], 西出 宏之[1], 錦谷 禎範[1], 内田 聡一[2], 矢崎 さなみ[2], 西村 涼[2]	1.早大理工, 2.JX日鉱日石エネルギー(株)
	16:45 - 17:00	11p-D3-13	ホスホニウム系イオン液体を用いた青色発光電気化学セル	○松本 慶太[1], 酒井 平祐[1], 村田 英幸[1]	1.北陸先端大マテリアル
	17:00 - 17:15	11p-D3-14	イオン液体を用いた電気化学トランジスタにおける導電性高分子の薄膜構造と電気伝導特性	○(M2)原田 知典[1], 伊東 裕[1], 安藤 良洋[1], 田中 久暁[1], 黒田 新一[1]	1.名大院工
	17:15 - 17:30	11p-D3-15	PBTTT/イオン液体有機トランジスタのキャリヤー解析と電流電圧特性に関する研究	○古川 行夫[1], 秋山 浩太郎[1], 山本 潤[1]	1.早大先進理工
	17:30 - 17:45	11p-D3-16	Au / DNTT / Al ショットキーダイオードの伝導特性	○林 稔晶[1], 志立 錬[2], 横田 知之[2], 藤原 聡[1], 染谷 隆夫[2,3]	1.NTT物性研, 2.東京大学, 3.ERATO
	17:45 - 18:00	11p-D3-17	有機薄膜の電流電圧曲線および薄膜中の電荷分布に対する解析的な理論	○関 和彦[1]	1.産業技術総合研究所
	3月12日(木)　9:00 - 11:45				
	9:00 - 9:15	12a-D3-1	スライドボート法によるダブルヘテロ構造有機結晶薄膜作製	○佐々木 史雄[1], 望月 博孝[1], 柳 久雄[2], 堀田 收[3]	1.産総研電子光技術, 2.奈良先端大物質, 3.京工繊大院工芸
	9:15 - 9:30	12a-D3-2	p型変調による縦型面状発光トランジスタの発光効率改善	○小賀坂 直樹[1], 武藤 隼斗[1], 中山 健一[1,2]	1.山形大院理工, 2.山形大ROEL
	9:30 - 9:45	奨 12a-D3-3	赤色燐光材料ドープ層を有するフルオレン系積層有機発光トランジスタの作製と発光特性	○原 三喜雄[1], 梶井 博武[1], 大森 裕[1]	1.阪大院工
	9:45 - 10:00	奨 12a-D3-4	乳酸イオンを検出可能な延長ゲート有機トランジスタ型酵素センサの開発	○南 豪[1,2], 佐藤 翼[1,2], 南木 創[1,2], 福田 憲二郎[1,2], 熊木 大介[1,2], 時任 静士[1,2]	1.山形大院理工, 2.山形大ROEL
	10:00 - 10:15	奨 12a-D3-5	ポリマーを用いた高感度温度センサの生体・医療デバイス応用	○横田 知之[1,2], 井上 雄介[1,2], Reeder Jonathan[1,3], Ware Taylor[3], Voit Walter[3], 関野 正樹[1,2], 関谷 毅[2,4], 染谷 隆夫[1,2]	1.東京大学, 2.JST, ERATO, 3.The University of Texas, 4.阪大産研
	10:15 - 10:30		休憩/Break		
	10:30 - 10:45	12a-D3-6	印刷銀電極を用いたRFID回路用整流ダイオードの作製と評価	○FAIZ ADI[1], 岡部 羊平[1], 横澤 晃二[2,3], 泰典 竹田[2,3], 福田 憲次郎[2,3], 熊木 大介[2,3], 時任 静士[2,3]	1.サトーホールディングス, 2.山形大院理工, 3.山形大 ROEL
	10:45 - 11:00	12a-D3-7	印刷型超短チャネル有機薄膜トランジスタの変調特性改善	○竹田 泰典[1,2], 吉村 悠大[1,2], 岡本 朋子[3], 儘田 正史[1,5], 福田 憲二郎[1,2,4], 熊木 大介[1,2], 片山 嘉則[3], 時任 静士[1,2]	1.山形大院理工, 2.山形大 ROEL, 3.DIC株式会社, 4.JST さきがけ, 5.山形大 INOEL
	11:00 - 11:15	奨 12a-D3-8	塗布型有機単結晶トランジスタを用いたCMOS集積回路	○山村 祥史[1], 添田 淳史[1], 境 駿希[1], 岸村 眞治[3], 岸 柾之[1], 松井 弘之[1], 宇野 真由美[2], 金岡 祐介[2], 諫早 伸明[1], 柳生 慎悟[3], 三津井 親彦[1], 岡本 敏宏[1,4], 竹谷 純一[1,2,3]	1.東大新領域, 2.阪府産技研, 3.パイクリスタル, 4.JSTさきがけ

	11:15 - 11:30	奨 12a-D3-9	印刷型有機トランジスタの閾値電圧制御と回路応用	○塩飽 黎[1], 吉村 悠大[1], 竹田 泰典[1], 福田 貴[2], 福田 憲二郎[1,3,4], 熊木 大介[1,4], 時任 静士[1,4]	1.山形大院理工, 2.東ソー, 3.JST さきがけ, 4.山形大ROEL
	11:30 - 11:45	12a-D3-10	メタルベース有機トランジスタを用いたエミッタフォロワ回路	○上妻 嵩季[1], 武藤 隼斗[1], 小賀坂 直樹[1], 中山 健一[1,2]	1.山形大院理工, 2.山形大ROEL

12.4 有機EL・トランジスタ / Organic light-emitting devices and organic transistors　ポスター講演

3月12日(木)　16:00 - 18:00

		12p-P12-1	スカイブルー発光を示す熱活性化遅延蛍光材料の緩和過程の解析	○(B)長谷山 翔太[1], 高木 絢生[1], 丹羽 顕嗣[1], 小林 隆史[1,2], 永瀬 隆[1,2], 合志 憲一[3,4], 安達 千波矢[3,4], 内藤 裕義[1,2]	1.大阪府大工, 2.大阪府大分子エレクトロニックデバイス研, 3.九大 OPERA, 4.九大 WPI-I2CNER
		12p-P12-2	高次の三重項励起状態を考慮したTADF材料の緩和モデルの検討	○高木 絢生[1,2], 丹羽 顕嗣[1,2], 小林 隆史[1,2], 永瀬 隆[1,2], 合志 憲一[3,4], 安達 千波矢[3,4], 内藤 裕義[1,2]	1.大阪府大工, 2.RIMED,, 3.九大 OPERA, 4.九大 WPI-I2CNER
		12p-P12-3	電子注入層としてPEIEを用いた逆構造透明有機EL素子	○佐野 弘尚[1], 中 茂樹[1], 岡田 裕之[1,2]	1.富山大・院理工, 2.富山大・自然科学研究支援センター
		12p-P12-4	(チオフェン/フェニレン)コオリゴマー誘導体積層膜を用いた有機EL素子	○土器屋 翔平[1], 佐々木 史雄[2], 堀田 収[3], 柳 久雄[1]	1.奈良先端大物質, 2.産総研電子光技術, 3.京工繊大院工芸
		12p-P12-5	プラズマ重合法による有機EL素子用アントラセン薄膜の作製	○(M1)宮本 勝成[1], 佐藤 祐喜[1], 吉門 進三[1]	1.同志社大院理工
		12p-P12-6	スパッタ法による酸化モリブデンをホール注入層とした有機EL素子	○慈幸 範洋[1], 三木 綾[1], 志田 陽子[1], 越智 元隆[1], 釘宮 敏洋[1]	1.神戸製鋼所
		12p-P12-7	導電性高分子材料PEDOT:PSSを用いた二層積層有機ELのキャリア挙動解析	○大塚 貴子[1], 貞方 敦雄[1], 田口 大[1], 間中 孝彰[1], 岩本 光正[1]	1.東工大・理工
		12p-P12-8	ポリマーFETの印刷製造とキャリア注入層の挿入効果の検討	○金森 暉[1], 伊東 栄次[1]	1.信州大工
		12p-P12-9	紫外線重合したポリシルセスキオキサンゲート絶縁膜を用いたペンタセン薄膜トランジスタ	○芝尾 秀人[1], 中原 佳夫[1], 宇野 和行[1], 田中 一郎[1]	1.和歌山大システム工
		12p-P12-10	高移動度および高耐熱性を有する有機電界効果トランジスタ	○阿部 正宏[1,2], 森 崇充[2], 尾坂 格[2], 瀧宮 和男[2]	1.日本化薬株式会社, 2.理研CEMS
		12p-P12-11	有機半導体薄膜のインクジェット印刷形成のMD計算による検討	○米谷 慎[1], 峯廻 洋美[1], 山田 寿一[1], 長谷川 達生[1,2]	1.産総研, 2.東大
		12p-P12-12	C_{12}-BTBT OFETの作製と評価	○中道 諒介[1], 永瀬 隆[1,2], 小林 隆史[1,2], 貞光 雄一[3], 内藤 裕義[1,2]	1.大阪府立大学, 2.分子エレクトロニックデバイス研, 3.日本化薬 (株)
		E 12p-P12-13	Basic Study on Organic Thin-Film Transistors with Various Kinds of Interfacial Layers	○(DC)BINTISHAARI SAFIZAN[1], Hiroyuki Okada[1], Shigeki Naka[1]	1.University of Toyama
		12p-P12-14	アルキル置換酸素架橋N字型有機半導体の固体物性と塗布プロセス性の検証	○(M1)田中 翔太[1,2], 三津井 親彦[2], 井原 将司[2], 山岸 正和[3], 田中 佑治[1], 矢野 将文[1], 佐藤 寛泰[4], 山野 昭人[4], 竹谷 純一[2], 岡本 敏宏[1,2,5]	1.関西大院理工, 2.東大新領域, 3.富山高専, 4.リガク, 5.JSTさきがけ
		12p-P12-15	塗布プロセスによる高移動度n型有機電界効果トランジスタ	○末永 悠[1], 永瀬 隆[1,2], 小林 隆史[1,2], 内藤 裕義[1,2]	1.大阪府大工, 2.大阪府大分子エレクトロニックデバイス研
		12p-P12-16	有機フレキシブルTFTにおける繰り返し曲げの効果	○山口 祥平[1], 佐々木 達彦[1], 林 潤郎[1], 酒井 正俊[1], 国吉 繁一[1], 山内 博[1], 貞光 雄一[2], 品村 祥司[2], 工藤 一浩[1]	1.千葉大院工, 2.日本化薬
		12p-P12-17	光焼成法による銀ナノ粒子を使った印刷電極の高速焼成プロセスの検討	○熊木 大介[1,2], 原田 敦[1,2], 後藤 芳政[1,2], 福田 憲二郎[1,2], 時任 静士[1,2]	1.山大院理工, 2.山大ROEL
		12p-P12-18	電解質ゲート有機トランジスタを用いたヒスタミン検出	○橋間 裕貴[1], 南 豪[2,3], 南木 創[2,3], 熊木 大介[2,3], 時任 静士[2,3]	1.山形大工, 2.山形大院理工, 3.山形大ROEL
		12p-P12-19	延長ゲート有機トランジスタ型免疫センサによる非標識ヒトIgA検出	○(B)佐々木 由比[1], 南 豪[2,3], 南木 創[2,3], 栗田 僚二[4], 丹羽 修[4], 脇田 慎一[4], 福田 憲二郎[2,3], 熊木 大介[2,3], 時任 静士[2,3]	1.山形大工, 2.山形大院理工, 3.山形大ROEL, 4.産総研
		12p-P12-20	強誘電性高分子層の熱処理温度による強誘電体ゲート有機薄膜トランジスタのメモリ特性改善	○菅野 亮[1,2], 関根 智仁[1,2], 福田 憲二郎[1,2,3], 熊木 大介[1,2], 時任 静士[1,2]	1.山形大理工, 2.山形大 ROEL, 3.JST さきがけ
		12p-P12-21	有機半導体を用いたフレキシブル温度センサとCMOS読出回路	○中山 健吾[1], 車 溥相[1], 金岡 祐介[1,2], 宇野 真由美[1,2], 三津井 親彦[2], 岡本 敏宏[2,3], 竹谷 純一[1,2]	1.阪府産技研, 2.東大新領域, 3.JSTさきがけ
		12p-P12-22	フルオレン系高分子配向薄膜を用いた積層有機面発光トランジスタの偏光発光特性	○(M1)大友 隆弘[1], 田中 仁[1], 橋本 和弥[1], 梶井 博武[1], 大森 裕[1]	1.阪大院工
		12p-P12-23	半導体レーザ励起による有機VCSELの室温パルス発振	○谷沢 元春[1], 高橋 良平[1], 丸山 武男[1], 飯山 宏一[1]	1.金沢大理工

12.4 有機EL・トランジスタ / Organic light-emitting devices and organic transistors　口頭講演

3月13日(金)　9:00 - 11:45

	9:00 - 9:15	奨 13a-D3-1	グラフェン電極を用いたポリチオフェン誘導体の伝達特性評価	○生田 昂[1], 丹波 俊輔[1], 金井 康[1], 大野 恭秀[1,2], 前橋 兼三[1,3], 井上 恒一[1], 家 裕隆[1], 安蘇 芳雄[1], 松本 和彦[1]	1.阪大産研, 2.徳島大, 3.農工大
	9:15 - 9:30	奨 13a-D3-2	斜方蒸着を用いた電荷発生型有機電界効果トランジスタのオンオフ比改善	○田村 英継[1], 皆川 正寛[2], 馬場 暁[1], 新保 一成[1], 加藤 景三[1], 金子 双男[1]	1.新潟大学, 2.長岡高専
	9:30 - 9:45	13a-D3-3	圧縮粉末を用いた有機トランジスタ	○松島 敏則[1,2], 江崎 有[1], 安達 千波矢[1,2]	1.九大OPERA, 2.JST ERATO
	9:45 - 10:00	13a-D3-4	圧縮配向化による高移動度ポリマートランジスタの作製とバンド伝導性の評価	○山下 侑[1], 添田 淳史[2], 鶴見 淳人[1], 岡田 悠悟[1], 松井 弘之[1], 尾坂 格[3], 瀧宮 和男[3], 竹谷 純一[1]	1.東大新領域, 2.阪大工, 3.理研
	10:00 - 10:15	13a-D3-5	EFI-SHG 法による高配向高分子半導体薄膜の注入および輸送異方性評価	○(M2)安部 健太郎[1], 松原 幸平[1], 間中 孝彰[1], 岩本 光正[1]	1.東工大・理工
	10:15 - 10:30		休憩/Break		
	10:30 - 10:45	13a-D3-6	分子ドーピングしたポリマー薄膜のパターン電極を用いた全有機型トランジスタの作製	○但木 大介[1], 馬 騰[1], 木村 康男[2], 庭野 道夫[1]	1.東北大通研, 2.東京工科大
	10:45 - 11:00	13a-D3-7	超音波溶融法による低耐熱基板上への有機薄膜の形成	○佐々木 達彦[1], 高 徳幸[1], 山口 祥平[1], 林 潤郎[1], 山崎 陽太[1], 酒井 正俊[1], 山内 博[1], 国吉 繁一[1], 貞光 雄一[2], 品村 祥司[2], 工藤 一浩[1]	1.千葉大院工, 2.日本化薬
	11:00 - 11:15	13a-D3-8	印刷銅電極を用いた塗布型有機TFTの高性能化	○(M1)乗田 翔平[1], 松浦 陽[2], 福田 貴[3], 福田 憲二郎[1,4], 熊木 大介[1,4], 時任 静士[1,4]	1.山形大院理工, 2.山形大工, 3.東ソー, 4.山形大ROEL

	11:15 - 11:30	13a-D3-9	電荷変調イメージング法による有機薄膜トランジスタの劣化機構解析	○堤 潤也[1], 松岡 悟志[1], 山田 寿一[1], 長谷川 達生[1,2]	1.産総研, 2.東大工
	11:30 - 11:45	13a-D3-10	三端子容量-電圧測定による有機発光トランジスタのキャリア挙動の観測	○山本 紘平[1], 田中 仁[2], 梶井 博武[2], 大森 裕[2], 野口 裕[3], 石井 久夫[1,4]	1.千葉大院融合, 2.阪大院工, 3.明大理工, 4.千葉大先進
	3月14日(土) 9:15 - 12:00				
	9:15 - 9:30	14a-D3-1	V字型有機半導体分子の理論的研究: 分子間相互作用	○下位 幸弘[1], 都築 誠二[1], 岡本 敏宏[2,3], 三津井 親彦[2], 竹谷 純一[2], 佐藤 寛泰[4], 山野 昭人[4]	1.産総研ナノシステム, 2.東大院新領域, 3.JST さきがけ, 4.リガク
	9:30 - 9:45	14a-D3-2	フェナセン系有機薄膜電界効果トランジスタの形成と論理回路応用	○三上 隆弘[1], 下 侑馬[1], 村上 寛虎[1], 浜尾 志乃[1], 後藤 秀徳[1], 久保園 芳博[1], 林 靖彦[1]	1.岡山大院自然
	9:45 - 10:00	14a-D3-3	[8]フェナセン単結晶を用いた高性能電界効果トランジスタの作製	○(M1C)下 侑馬[1], 三上 隆弘[1], 村上 寛虎[1], 浜尾 志乃[1], 後藤 秀徳[1], 岡本 秀毅[1], 郷田 慎[2], 佐藤 かおり[2], 林 靖彦[1], 久保園 芳博[1]	1.岡山大院自然, 2.ナード研究所
	10:00 - 10:15	14a-D3-4	ビチアゾールテトラチオン骨格を用いた大気安定n型有機トランジスタ	Agathe Filatre-Furcate[1], Dominique Lorcy[1], ○東野 寿樹[2], 森 健彦[2]	1.レンヌ第一大学, 2.東工大院理工
	10:15 - 10:30	14a-D3-5	新規有機半導体 DTBDT の結晶薄膜形成過程の解析	○福田 貴[1], 山川 浩[1], 渡辺 真人[1], 古川 博章[1], 福田 憲二郎[2,3], 熊木 大介[2,3], 時任 静士[2,3]	1.東ソー株式会社, 2.山形大院理工, 3.山形大ROEL
	10:30 - 10:45		休憩/Break		
	10:45 - 11:00	奨 14a-D3-6	可溶性アルキルピセンを用いた単結晶トランジスタの特性	○小池 優作[1], 門崎 正樹[2], 岡本 一男[2], 功刀 義人[1]	1.東海大院工, 2.ウシオケミックス(株)
	11:00 - 11:15	14a-D3-7	モノアルキル置換Ph-BTBT誘導体を用いたFETの作製と特性評価―アルキル鎖長依存性―	○飯野 裕明[1], 岡村 寿[1], 臼井 孝之[1], 半那 純一[1]	1.東工大像情報
	11:15 - 11:30	14a-D3-8	Ph-BTBT-10多結晶薄膜を用いたBottom-gate Bottom-contact型FETの作製と特性評価	○飯野 裕明[1], 臼井 孝之[1], 半那 純一[1]	1.東工大像情報
	11:30 - 11:45	14a-D3-9	高溶解性アルキル置換セレン架橋V字型有機半導体材料の固体物性とデバイス特性	○岡本 敏宏[1,2], 三津井 親彦[1], 岸 柾之[1], 山岸 正和[3], 吉本 和美[1], 佐藤 寛泰[4], 山野 昭人[4], 竹谷 純一[1]	1.東大院新領域, 2.JSTさきがけ, 3.富山高専, 4.リガク
	11:45 - 12:00	奨 14a-D3-10	新規塗布型低分子半導体の高分子材料との混合による有機TFTの特性向上	○(M2)鈴木 達也[1], 福田 貴[2], 福田 憲二郎[1,3,4], 熊木 大介[1,3], 時任 静士[1,3]	1.山形大学院理工, 2.東ソー, 3.山形大ROEL, 4.JSTさきがけ
	3月14日(土) 13:00 - 14:45				
	13:00 - 13:15	14p-D3-1	ボトムコンタクト型ペンタセンOFETのL/W比依存性	○Fadli Ondi[1], Nithi Atthi[1], 大見 俊一郎[1]	1.東工大総理工
	13:15 - 13:30	14p-D3-2	n型低分子半導体/絶縁性高分子の混合インクを用いた有機薄膜トランジスタの高性能化	○(M2)青塚 晟[1], 垣田 一成[2], 島 秀好[2], 米田 康洋[2], 田中 康裕[2], 儘田 正史[1,3], 福田 憲二郎[1,4], 熊木 大介[1,4], 時任 静士[1,4]	1.山形大院理工, 2.宇部興産, 3.山形大INOEL, 4.山形大ROEL
	13:30 - 13:45	14p-D3-3	短チャネル・短コンタクト長全印刷型トランジスタ	○福田 憲二郎[1,2,3], 岡本 朋子[4], 儘田 正史[1,5], 熊木 大介[1,2], 片山 嘉則[4], 時任 静士[1,2]	1.山形大院理工, 2.山形大ROEL, 3.JSTさきがけ, 4.DIC株式会社, 5.山形大INOEL
	13:45 - 14:00	14p-D3-4	全印刷手法による基板レス有機トランジスタの作製 －剥離層と絶縁膜の条件探索－	○福田 憲二郎[1,2,3], 藤田 知樹[1], 熊木 大介[1,2], 時任 静士[1,2]	1.山形大院理工, 2.山形大ROEL, 3.JSTさきがけ
	14:00 - 14:15	14p-D3-5	オールウェットプロセスによる低電圧駆動可能な有機単結晶トランジスタ	○境 駿希[1], Roger Häusermann[1], 伊東 正浩[3], 金岡 祐介[2], 山村 祥史[1], 松井 弘之[1], 三津井 親彦[1], 岡本 敏宏[1,4], 宇野 真由美[2], 竹谷 純一[1,2]	1.東大新領域, 2.阪府産技研, 3.EEJA, 4.JSTさきがけ
	14:15 - 14:30	14p-D3-6	めっき法により形成したAuAg Hybrid電極を有する有機トランジス	○伊東 正浩[1,2], 宇野 真由美[2,3], 竹谷 純一[2,3]	1.EEJA, 2.東大新領域, 3.阪府産技研
	14:30 - 14:45	14p-D3-7	短チャネル塗布型有機トランジスタを用いた有機CMOS回路	○宇野 真由美[1,2], 金岡 祐介[1,2], 諫早 伸明[2], 柳生 慎悟[3], 境 駿希[2], 山村 祥史[2], 松井 弘之[2], 車 溥相[1], 中山 健吾[1], 三津井 親彦[2], 岡本 敏宏[2,4], 竹谷 純一[1,2,3]	1.阪府産技研, 2.東大新領域, 3.パイクリスタル, 4.JSTさきがけ

12.5 有機太陽電池 / Organic solar cells 口頭講演

	3月11日(水) 9:00 - 11:45				
	9:00 - 9:15	11a-D15-1	三元ブレンド系全高分子型薄膜太陽電池の開発	○辨天 宏明[1], 西田 貴哉[1], 森 大輔[1], 大北 英生[1,2], 伊藤 紳三郎[1]	1.京大院工, 2.JST さきがけ
	9:15 - 9:30	11a-D15-2	新規ナフトビスオキサジアゾール系ポリマーの太陽電池特性	○川島 和彰[1,2], 尾坂 格[1,3], 瀧宮 和男[1,2]	1.理研CEMS, 2.広大院工, 3.JSTさきがけ
	9:30 - 9:45	11a-D15-3	有機薄膜太陽電池の高電圧化に寄与するフラーレン誘導体	○辛川 誠[1], 永井 隆文[2], 足達 健二[2], 家 裕隆[1], 安蘇 芳雄[1]	1.阪大産研, 2.ダイキン
	9:45 - 10:00	11a-D15-4	スピロ(チオ)アセタール化フラーレン太陽電池の性能支配因子	○佐伯 昭紀[1], 三木江 翼[1], 伊熊 直彦[1], 小久保 研[1], 関 修平[1]	1.阪大院工
	10:00 - 10:15	奨 11a-D15-5	置換スピロアセタール化フラーレンの立体異性体構造が有機太陽電池性能に与える影響	○(DC)三木江 ツバサ[1], 佐伯 昭紀[1], 山崎 優[1], 伊熊 直彦[1], 小久保 研[1], 関 修平[1]	1.阪大院工
	10:15 - 10:30		休憩/Break		
	10:30 - 10:45	11a-D15-6	PTB7:C_{70}複合体を用いた耐熱性のある塗布型有機太陽電池	○多田 和也[1]	1.兵庫県立大工
	10:45 - 11:00	11a-D15-7	ジケトピロロピロール骨格を有する光変換半導体材料を用いた塗布積層型ヘテロp-i-n太陽電池	○山口 裕二[1,4], 高平 勝也[1,4], 内永 憲佑[2], 鈴木 充朗[2], 山田 容子[2,3], 中山 健一[1,3,4]	1.山形大院理工, 2.奈良先端大物質, 3.CREST, 4.山形大ROEL
	11:00 - 11:15	11a-D15-8	一重項分裂を示す非縮合多環系分子の合成と有機薄膜太陽電池への応用	○(DC)河田 総[1], 夫 勇進[1,2], 斉藤 彩華[1], 羽田 真毅[2,3], 笹部 久宏[1], 城戸 淳二[1]	1.山形大院理工, 2.JSTさきがけ, 3.東工大応セラ研
	11:15 - 11:30	11a-D15-9	ビフルオレニリデン誘導体の合成と有機薄膜太陽電池での一重項分裂挙動の検証	○古館 準樹[1], 夫 勇進[1,2], 木村 拓也[1], 河田 総[1], 斉藤 彩華[1], 羽田 真毅[2,3], 笹部 久宏[1], 城戸 淳二[1]	1.山形大院理工, 2.JSTさきがけ, 3.東工大応セラ研
	11:30 - 11:45	11a-D15-10	ベンゾトリアザボルフィリン誘導体の基礎物性とバルクヘテロ接合薄膜太陽電池における光電変換特性	○藤井 彰彦[1], Dao Quang-Duy[1], 大森 雅志[1], 渡辺 光一[1], 井谷 弘道[1,2], Sosa-Vargas Lydia[2], 清水 洋[2], 尾崎 雅則[1]	1.阪大院工, 2.産総研ユビキタス

	3月11日(水)　13:15 - 18:00				
招待	13:15 - 13:45	11p-D15-1	**「有機分子・バイオエレクトロニクス 分科内招待講演」(30分) 高効率ポリマーブレンド太陽電池の開発**	**○大北 英生[1,2], 森 大輔[1], 辨天 宏明[1], 伊藤 紳三郎[1]**	**1.京大院工, 2.JST さきがけ**
	13:45 - 14:00	11p-D15-2	2種類のドナーポリマーを積層したバルクヘテロ接合有機太陽電池	○岡田 健[1], 藤田 克彦[2]	1.九州大総理工, 2.九州大先導研
	14:00 - 14:15	11p-D15-3	高分子ドメイン内の$PC_{71}BM$含有量による太陽電池特性変化	○安田 剛[1], 米澤 宏平[2], 櫻井 岳暁[2], 武市 泰男[3], 菅 大暉[4], 高橋 嘉夫[5], 井波 暢人[3], 間瀬 一彦[3], 小野 寛太[3], 守友 浩[2]	1.物材機構, 2.筑波大, 3.高エネ研, 4.広島大, 5.東大
	14:15 - 14:30	11p-D15-4	PTB7 / C_{70} ヘテロ接合薄膜の電荷ダイナミクス	○米澤 宏平[1], 安田 剛[2], 守友 浩[1,3]	1.筑波大数理, 2.物材機構, 3.筑波大CiRfSE
	14:30 - 14:45	11p-D15-5	PFNバッファー層を有するPTB7:$PC_{71}BM$有機薄膜太陽電池の性能に及ぼす PFN膜厚の効果	○落合 鎮康[1], (P) ムルゲサン ヴィジェイ スリニバサン[1], 津田 紀生[1], 山田 諄[1]	1.愛知工大
	14:45 - 15:00		休憩/Break		
	15:00 - 15:15	11p-D15-6	MoO_3陰極バッファーを用いるバルクヘテロ接合型有機薄膜太陽電池の開発	○景山 弘[1], 長谷部 大知[1], 林 翔太郎[1], 梶井 博武[2], 大森 裕[2], 城田 靖彦[2]	1.琉球大工, 2.阪大院工
	15:15 - 15:30	11p-D15-7	p-i-n型素子を用いたdonor-acceptor分子における光電圧損失の評価	○大倉 達也[1], 吉田 司[1,2], 中山 健一[1,2]	1.山形大院理工, 2.山形大ROEL
	15:30 - 15:45	11p-D15-8	有機共蒸着光電変換層への100 ppmドーピングによる光電流増大	○大橋 知佳[1,2], 新村 祐介[2,3], 久保 雅之[2,3], 平本 昌宏[1,2,3]	1.総研大, 2.分子研, 3.CREST
	15:45 - 16:00	E 11p-D15-9	Electrodeposited Al-doped ZnO films for Hybrid Solar Cells	○(D)Jennifer DamascoTy[1], Nadine Dannehl[2], Derck Schlettwein[2], Yanagi Hisao[1]	1.NAIST, 2.JLU Giessen
	16:00 - 16:15	11p-D15-10	表面改質技術を用いた無機有機太陽電池の開発	○菅野 裕希[1], 佐藤 慶介[1], 深田 直樹[2], 平栗 健二[1]	1.東京電機大学工, 2.物質・材料研究機構
	16:15 - 16:30		休憩/Break		
	16:30 - 16:45	E 11p-D15-11	Performance evaluation of PTB7/$PC_{71}BM$ organic solar cells fabricated by spin and spray coating method	○Vijaysrinivasan MURUGESAN[1], Shusuke Ono[1], Norio Tsuda[1], Jun Yamada[1], Shizuyasu Ochiai[1]	1.Aitech
	16:45 - 17:00	11p-D15-12	電気泳動法により製膜した極薄酸化チタンナノシートを電子選択層とした逆構造バルクヘテロ接合型有機薄膜太陽電池の作製	○酒井 翔太[1], 後藤 慶紀[1], 大澤 彰浩[1], 坂 優助[1], 伊東 栄次[1]	1.信州大工
	17:00 - 17:15	11p-D15-13	逆構造型バルクヘテロ接合太陽電池のための塗布型極薄電子取り出し層と電極界面の電位障壁制御に関する検討	○伊東 栄次[1], 後藤 慶紀[1], 福田 勝利[2]	1.信州大工, 2.京大
	17:15 - 17:30	11p-D15-14	順構造型有機薄膜太陽電池の耐熱性向上	○森 茂彦[1], 五反田 武志[1], 大岡 青日[1], 中尾 英之[1], 都島 顕司[1], 斉藤 三長[1], 細矢 雅弘[1]	1.東芝研究開発センター
	17:30 - 17:45	11p-D15-15	モジュール構造が有機薄膜太陽電池の信頼性に与える影響	○森田 秀幸[1,2], 宮下 正範[2], 増田 淳[3]	1.太陽光発電技術研究組合, 2.東レ, 3.産総研
	17:45 - 18:00	11p-D15-16	インピーダンス分光とデバイスシミュレーションによるPTB7:$PC_{71}BM$有機薄膜太陽電池の劣化解析	大面 隆範[1], ○村田 憲保[1], 杉山 拓也[1], 中塚 英美[1,2], 小林 隆史[1,3], 永瀬 隆[1,3], 内藤 裕義[1,3,4]	1.大阪府立大学, 2.三菱化学科学技術研究センター, 3.大阪府立大分子エレクトロニックデバイス研, 4.JST-CREST
	3月12日(木)　9:00 - 11:30				
招待	9:00 - 9:15	12a-D15-1	**「講演奨励賞受賞記念講演」(15分) 結晶性有機薄膜太陽電池における電荷解離ダイナミクス**	**○玉井 康成[1], 津田 一樹[1], 大北 英生[1,2], 辨天 宏明[1], 伊藤 紳三郎[1]**	**1.京大院工, 2.JSTさきがけ**
	9:15 - 9:30	12a-D15-2	有機薄膜太陽電池の乱れた界面における励起子解離の量子過程	○(DC)飯塚 秀行[1], 中山 隆史[1]	1.千葉大理
	9:30 - 9:45	12a-D15-3	有機半導体界面での励起子解離過程におけるキャリア-格子相互作用	○(M1)枡潟 慶充[1], 中山 隆史[1]	1.千葉大理
	9:45 - 10:00	12a-D15-4	狭バンドギャップポリマーにおける一重項励起子分裂	○笠井 普文[1], 玉井 康成[1], 大北 英生[1,2], 辨天 宏明[1], 伊藤 紳三郎[1]	1.京大院工, 2.JST さきがけ
	10:00 - 10:15	12a-D15-5	ローバンドギャップポリマーを用いた有機薄膜太陽電池における正孔移動度の膜厚依存性	○成岡 達彦[1], 中塚 英美[1,2], 小林 隆史[1,3], 永瀬 隆[1,3], 内藤 裕義[1,3,4]	1.大阪府大工, 2.三菱化学, 3.分子エレクトロニックデバイス研, 4.JST-CREST
	10:15 - 10:30		休憩/Break		
	10:30 - 10:45	12a-D15-6	有機薄膜太陽電池における p 型半導体アルキル鎖長の電荷寿命への影響	○奥田 浩一[1], 森 正悟[2]	1.信州大院理工, 2.信州大繊
	10:45 - 11:00	12a-D15-7	赤外分光を用いた位置規則性ポリ(3-ヘキシルチオフェン)(P3HT):[6,6]-phenyl-C_{61}-butyric acid methyl ester (PCBM)混合膜のトラップキャリヤーおよび光化学反応の研究	○古川 行夫[1], 金澤 啓[1], 吉田 大樹[1]	1.早大先進理工
	11:00 - 11:15	12a-D15-8	TiO_x電子捕集層を用いた逆型高分子太陽電池における紫外光照射効果下の電荷蓄積箇所のESR研究	○(D)孫 東鉉[1], 矢野 勝寛[2], 桑原 貴之[2], 高橋 光信[2], 丸本 一弘[1,3]	1.筑波大院数物, 2.金沢大院自然, 3.筑波大学学際セ
	11:15 - 11:30	12a-D15-9	固体NMR分光法によるバルクヘテロ接合有機薄膜太陽電池への添加剤効果の解析(II)	○緒方 啓典[1,2], 河野 紗希[1]	1.法政大生命科学, 2.法政大マイクロ・ナノテクノロジー研

12.5 有機太陽電池 / Organic solar cells　　ポスター講演

	3月12日(木)　13:30 - 15:30				
		奨・E 12p-P7-1	Perovskite Morphology and Coverage Ratio Control to $CH_3NH_3PbI_3$ Solar Cells	○(PC)Binglong Lei[1], Eze Vincent[1], Hideo Furuhashi[1], Tatsuo Mori[1]	1.Aichi Inst. Tech.
		奨・E 12p-P7-2	Impact of Homogenous Perovskite Layer in Organometal Halide Perovskite Solar Cells	○(M2C)Vincent Eze[1], Binglong Lei[1], Furuhashi Hideo[1], Mori Tatsuo[1]	1.Aichi Institute of Technology
		奨 12p-P7-3	両極性低分子を用いたヘテロ接合型薄膜の電荷ダイナミクス	○高橋 洋輔[1], 米澤 宏平[1], 安田 剛[2], 守友 浩[1,3]	1.筑波大数理, 2.物材機構, 3.筑波大CiRfSE
		奨・E 12p-P7-4	Efficiency Enhancement of Organic Solar Cells by Suppressing Recombination at Cathode Interface	○(D)Xia Hao[1], Shenghao Wang[1], Takeaki Sakurai[1], Katsuhiro Akimoto[1]	1.Univ. of Tsukuba
		12p-P7-5	フタロシアニン薄膜を用いた擬ショットキー障壁型太陽電池の特性	岡田 香菜[1], 樋口 進哉[1], 宮崎 優[1], 水野 斎[1], ○広光 一郎[1]	1.島根大院総合理工
		12p-P7-6	金属/酸化物多層膜を陽極として用いた半透明有機薄膜太陽電池の作製	○藤井 俊治郎[1], 田中 丈士[1], 片浦 弘道[1]	1.産総研ナノシス
		12p-P7-7	キノキサリンイミド骨格を有する新規D-A-D型有機半導体材料の合成と有機薄膜太陽電池への応用	○松本 英俊[1], 青柳 晃太朗[1], 芦沢 実[1], 鴻巣 裕一[1]	1.東工大院理工
		E 12p-P7-8	Characterizations of Electron Transport Layer in Flexible Organic Thin Films Solar Cell via Spray LBL method	○(D)Atthaporn Ariyarit[1], Seimei Shiratori[1]	1.Keio Univ.
		12p-P7-9	静電塗布法を用いたPBDTTT-EFT:$PC_{71}BM$有機薄膜太陽電池	○戸田 明日来[1], 鈴木 勝己[1], 福田 武司[1], 鎌田 憲彦[1], 本多 善太郎[1]	1.埼玉大工
		12p-P7-10	ベンゾチアジアゾールで架橋されたポルフィリン二量体の合成とその太陽電池特性	○中川 貴文[1], 岡田 洋史[1], 松尾 豊[1]	1.東大院理

		12p-P7-11	繊維を基材とした色素増感太陽電池の開発	○嶋田 一裕[1], 豊田 丈紫[1], 広沢 清勝[2], 加藤 昭彦[2]	1.石川県工業試験場, 2.倉庫精練株式会社
		12p-P7-12	高電圧印加陽極酸化による酸化チタンナノチューブ光電極の作製	○藤満 新太[1], 岸 直希[1], 曾我 哲夫[1]	1.名古屋工大
		12p-P7-13	Pt-グラフェン対極を用いた色素増感太陽電池	○星 肇[1], 田中 駿平[1], 三好 崇司[1]	1.山口東京理科大工
		12p-P7-14	陽極酸化法による酸化チタンナノチューブ成長への電極金属の影響	○(M1)平賀 章浩[1], 川上 亮[1], 佐藤 祐喜[1], 吉門 進三[1]	1.同志社大院理工
		12p-P7-15	インクジェットプリンター用TiO_2インクの開発と評価	○下山 夕貴[1], 植松 弘哉[1], 功刀 義人[1]	1.東海大院工
		12p-P7-16	非加熱及びスプレー法により形成した色素増感太陽電池の特性	○吉田 博行[1], 明石 和也[1], 森田 廣[1]	1.山口東京理大工
		12p-P7-17	積層型ペロブスカイト太陽電池における大気暴露の影響	○山本 晃平[1], 古本 嘉和[1], 桑原 貴之[1], 高橋 光信[1], 當摩 哲也[1,2]	1.金沢大学, 2.JST-さきがけ
		12p-P7-18	正孔輸送材のペロブスカイト層への拡散についての考察	○金谷 周朔[1], 西野 仁[2], 伊藤 省吾[1]	1.兵県大工, 2.大阪ガス株式会社
		12p-P7-19	ペロブスカイト型太陽電池への銀ナノ粒子添加効果	○森川 弘理[1], 丸山 翔大[1], 片山 大輔[1], 緒方 啓典[1]	1.法政大学院理工
		12p-P7-20	真空蒸着法を用いた層状ペロブスカイト化合物の成膜と特性評価	○片山 大輔[1,2], 丸山 翔大[1,2], 森川 弘理[1,2], 緒方 啓典[1,2]	1.法政大学院理工, 2.法政大ﾏｲｸﾛ・ﾅﾉﾃｸ研
		12p-P7-21	Si/PEDOT:PSSヘテロ接合太陽電池の劣化機構	○武居 雄輝[1], 八木 大地[1], 石川 良[1], 白井 肇[1], 上野 啓司[1]	1.埼玉大院理工
		12p-P7-22	Si/PEDOT:PSSハイブリッド太陽電池の作製とPEDOT:PSS膜のGIXD測定	○池田 なつみ[1], 加治屋 大介[1,2], 小金澤 智之[4], 齋藤 健一[1,2,3]	1.広大理, 2.広大自然セ, 3.広大院理, 4.高輝度光科学研究セ
		12p-P7-23	霧化塗布法によるテクスチャーSi /PEDOT:PSS接合太陽電池	○大木 達也[1], 市川 浩気[1], 石川 良[1], 上野 啓司[1], 白井 肇[1]	1.埼玉大理工
		12p-P7-24	FTIR-ATR によるc-Si/PEDOT:PSS 界面化学結合評価と太陽電池性能	○船田 修司[1], 大木 達也[1], 市川 浩気[1], 石川 良[1], 上野 啓司[1], 白井 肇[1]	1.埼大理工研
		12p-P7-25	P(VDF-TeFE)強誘電体高分子を挿入したc-Si/PEDOT:PSS 太陽電池	○舛森 建太[1], 劉 奇明[1], 石川 良[1], 上野 啓司[1], 白井 肇[1]	1.埼玉大
		E 12p-P7-26	Enhanced BSF of c-Si/PEDOT:PSS heterojunction solar cells	○(M2C)Ramesh Devkota[1], Tatsuya Ohki[1], Koki Ichikawa[1], Ryo Ishikawa[1], Keiji Ueno[1], Hajime Shirai[1]	1.Saitama University
		12p-P7-27	低分子有機太陽電池のトラップと発電特性	○布村 正太[1,2], Che X.[2], Forrest S.[2]	1.産総研, 2.ミシガン大
		12p-P7-28	有機薄膜太陽電池における光劣化挙動の分光学的考察	○(PC)玉井 康成[1], 大北 英生[1], 辨天 宏明[1], 伊藤 紳三郎[1], 宮前 孝行[2], 山成 敏広[3]	1.京大院工, 2.産総研, 3.CEREBA
		12p-P7-29	インピーダンス分光法による逆構造太陽電池の電子物性解析	大面 隆範[1], ○村田 憲保[1], 杉山 拓也[1], 中塚 英美[1,2], 小林 隆史[1,3], 永瀬 隆[1,3], 内藤 裕義[1,3,4]	1.大阪府立大学, 2.三菱化学科学技術研究センター, 3.大阪府立大分子エレクトロニックデバイス研, 4.JST-CREST
		12p-P7-30	電界誘起光第2次高調波測定を用いたバルクヘテロ型太陽電池のPEDOT:PSS層への2次ドーピングの評価	○三和 健人[1], 田口 大[1], 間中 孝彰[1], 岩本 光正[1]	1.東工大・理工
		12p-P7-31	光誘導吸収測定による有機薄膜太陽電池におけるトラップの観察	○中美 総司[1,2,3], 成岡 達彦[1,2,3], 砂原 智徳[1,2,3], 永瀬 隆[1,2,3], 小林 隆史[1,2,3], 内藤 裕義[1,2,3]	1.大阪府大, 2.分子エレクトロニックデバイス研, 3.JST-CREST
		12p-P7-32	ITO透明導電性基板上への鉛ペロブスカイト太陽電池の低温プロセス作製	○水田 凱[1], 浦野 年由[2], 梅山 有和[3], 今堀 博[3,4], 伊藤 省吾[1]	1.兵県大工, 2.CEREBA, 3.京大工, 4.京大WPI-iCeMS
		12p-P7-33	平滑構造の$CH_3NH_3PbI_3$ / CuSCN太陽電池の作製	○田中 聡一郎[1], 西野 仁[2], 伊藤 省吾[1]	1.兵県大工, 2.大阪ガス株式会社
		12p-P7-34	有機鉛ペロブスカイト/結晶シリコンタンデム太陽電池	○(M2)神田 広之[1], ウズム アブドーラ[1], 田中 聡一郎[1], 梅山 有和[2], 今堀 博[2,3], 西野 仁[4], 伊藤 省吾[1]	1.兵県大工, 2.京大工, 3.京大WPI-iCeMS, 4.大阪ガス

12.5 有機太陽電池 / Organic solar cells　口頭講演

3月13日(金)　9:00 - 12:00

9:00 - 9:15	奨 13a-D15-1	ドナー／アクセプター界面第一層のエネルギー準位が有機薄膜太陽電池性能に与える影響	○(DC)伊澤 誠一郎[1,2], 中野 恭兵[2], 鈴木 かおり[2], 橋本 和仁[1], 但馬 敬介[2,3]	1.東大院工, 2.理研CEMS, 3.さきがけ
9:15 - 9:30	13a-D15-2	ドナー/アクセプター界面のエネルギー準位と二分子再結合過程	○中野 恭兵[1], 伊澤 誠一郎[1,2], 真弓 智裕[1,2], 鈴木 かおり[1], 橋本 和仁[2], 但馬 敬介[1,3]	1.理研 CEMS, 2.東大院工, 3.さきがけ
9:30 - 9:45	奨 13a-D15-3	高感度紫外光電子分光および光電子収量分光によるPTB7:$PC_{70}BM$混合膜の電子構造観察	○佐藤 友哉[1], 中山 泰生[1], 中村 浩昭[3], 石井 久夫[1,2]	1.千葉大融合, 2.千葉大先進, 3.出光興産
9:45 - 10:00	奨 13a-D15-4	有機薄膜太陽電池のドナー/アクセプター界面におけるキャリア挙動の解析	○真弓 智裕[1,2], 中野 恭兵[2], 橋本 和仁[1], 但馬 敬介[2,3]	1.東大院工, 2.理研, 3.さきがけ
10:00 - 10:15	奨 13a-D15-5	ppm極微量ドーピングによる光電流増大効果	○久保 雅之[1,2], 菊池 満[1,2], 平本 昌宏[1,2]	1.分子研, 2.CREST/JST
10:15 - 10:30	奨 13a-D15-6	ソルボサーマル法により合成したモリブデン化合物を正孔捕集層として用いた有機薄膜太陽電池	○濱田 圭祐[1], 村上 大貴[1], 中野 洋人[1], 上村 直[1], 村上 直也[1], 横野 照尚[1]	1.九工大院工
10:30 - 10:45		休憩/Break		
10:45 - 11:00	奨・E 13a-D15-7	Optimization of suitable chloride precursor for better crystal growth of $MAPbI_3$	○(DC)Vigneshwaran Murugan[1], Terumi Nishimura[1], Yuhei Ogomi[1], Tingli Ma[1], Shyam Pandey[1], Shuzi Hayase[1]	1.Kyushu Institute of Technology
11:00 - 11:15	奨 13a-D15-8	銀コア金シェルナノ粒子を含んだ色素増感太陽電池の特性	○(M1)祖母井 晶[1], 鈴木 仁[1], 高萩 隆行[1], 坂上 弘之[1]	1.広島大院 先端研
11:15 - 11:30	13a-D15-9	Study on plasmon induced electron injection mechanism in Au-TiO_2 nanoparticle system (1) --lifetime observation of excited states by fs laser pump-probe PEEM--	李 博超[1], 季 博宇[1], 林 景全[1], ○富江 敏尚[1,2]	1.長春理工大, 2.産総研
11:30 - 11:45	E 13a-D15-10	Computational Design of Small Phenothiazine Dyes for Dye-Sensitized Solar Cells by Functionalizations Affecting the Thiophene Unit	○Sergei Manzhos[1], Wei Han Tu[2], Yi Yin Tan[3], Omkar Rege[4]	1.Natl Univ Singapore, 2.Anderson Jr College, 3.Raffles Institution, 4.Uni. of Illinois
11:45 - 12:00	奨 13a-D15-11	ペロブスカイト層の表面処理による太陽電池の高効率化	○(M1)丸山 直輝[1], 西村 秀隆[1], 遠藤 克[1], 若宮 淳志[1,2], 村田 靖次郎[1]	1.京大化研, 2.JST-さきがけ

	3月13日(金)　16:30 - 19:00				
招待	16:30 - 17:00	13p-D15-1	**「有機分子・バイオエレクトロニクス 分科内招待講演」(30分) ペロブスカイト太陽電池の高耐久・高効率化開発における課題と将来展望**	**○宮坂 力[1]**	**1.桐蔭横浜大学院工**
	17:00 - 17:15	13p-D15-2	一括塗布による自己組織化中間層を形成したペロブスカイト太陽電池	○(M1)森谷 昌平[1], 濱園 康司[1], 藤川 直耕[1], 尾込 裕平[1,4], 沈 青[2,4], 吉野 賢二[3,4], 豊田 太郎[2,4], 早瀬 修二[1,4]	1.九工大院生命体工, 2.電通大先進理工, 3.宮崎大学工, 4.JST-CREST
	17:15 - 17:30	13p-D15-3	近赤外光電変換可能なスズ系ペロブスカイト太陽電池の特性評価	○尾込 裕平[1,4], 松隈 智寛[1], 藤原 幸星[1], リボレス サンチェス テレサ[1], 沈 青[2,4], 吉野 賢二[3,4], 豊田 太郎[2,4], 早瀬 修二[1,4]	1.九工大院生命体工, 2.電通大先進理工, 3.宮崎大工, 4.JST-CREST
	17:30 - 17:45	13p-D15-4	有機無機ペロブスカイトを用いた太陽電池構築のためのヨウ化鉛系ペロブスカイト蒸着膜作製条件の検討	○黒木 惟[1], 坂口 幸一[1], 江良 正直[1]	1.佐大理工
	17:45 - 18:00	13p-D15-5	十面体酸化チタン多孔膜を用いたペロブスカイト太陽電池の特性評価	○實平 義隆[1], 沼田 陽平[1], 宮坂 力[1]	1.桐蔭横浜大院工
	18:00 - 18:15	13p-D15-6	メソポーラスシリカ (MCM-41) 膜上の層状ペロブスカイト化合物の特性評価 (II)	○丸山 翔大[1], 片山 大輔[1], 森川 弘理[1], 緒方 啓典[1,2]	1.法政大院理工, 2.法政大ﾏｲｸﾛ・ﾅﾉﾃｸ研
	18:15 - 18:30	13p-D15-7	ペロブスカイト太陽電池構造中のTiO_2表面に対するPbI_2パッシベーション効果の観測	○廣谷 太佑[1], 尾込 裕平[1], 藤川 直耕[1], 早瀬 修二[1]	1.九工大院生命体工
	18:30 - 18:45	13p-D15-8	ヨウ化錫系有機無機ペロブスカイト蒸着膜の導電率その場測定	○江良 正直[1]	1.佐大理工
	18:45 - 19:00	13p-D15-9	酸化物混合体メソポーラス層を用いるペロブスカイト太陽電池におけるJ–V曲線のヒステリシス挙動に関する研究	○沼田 陽平[1], 實平 義隆[1], 宮坂 力[1]	1.桐蔭横浜大院工
	3月14日(土)　9:00 - 12:00				
	9:00 - 9:15	14a-D15-1	PbS量子ドット/ZnOナノワイヤアレイ太陽電池の光電変換特性の温度依存性	王 海濱[1], ○久保 貴哉[1], 中崎 城太郎[1], 瀬川 浩司[1]	1.東大先端研
	9:15 - 9:30	14a-D15-2	過渡吸収法を用いたPbS/CdS複合化量子ドット増感太陽電池の光励起キャリア移動過程の解明	○(M1)佐藤 光希[1,2], 桑原 彰太[1], 片山 建二[1], 豊田 太郎[2,3], 沈 青[2,3]	1.中大理工, 2.電通大, 3.JST CREST
	9:30 - 9:45	14a-D15-3	ルチル型TiO_2単結晶基板に吸着したCdSe量子ドットのイオン化ポテンシャルと光誘起電子移動	○豊田 太郎[1,5], インディースク ウィトウーン[1], 神山 慶太[2], 片山 健二[3], 早瀬 修二[4,5], 沈 青[1,5]	1.電通大情報理工学, 2.分光計器(株), 3.中央大理工, 4.九工大, 5.CREST
	9:45 - 10:00	14a-D15-4	ZnO単結晶上CdSe量子ドット吸着の面方位依存性ー光音響分光法と光電子収量分光法による評価	○豊田 太郎[1,4], インディースク ウィトゥーン[1], 神山 慶太[2], 早瀬 修二[3,4], 沈 青[1,4]	1.電通大情報理工学, 2.分光計器(株), 3.九工大, 4.CREST
	10:00 - 10:15	14a-D15-5	PbS量子ドット薄膜における光励起キャリアダイナミクス -電荷分離の量子ドット間距離依存性-	○久家 佑輝[1], 常 進[1,4], 豊田 太郎[1,4], 尾込 裕平[2,4], 早瀬 修二[2,4], 吉野 賢二[3,4], 沈 青[1,4]	1.電通大先進理工, 2.九工大生命体工, 3.宮崎大工, 4.JST CREST
	10:15 - 10:30		休憩/Break		
	10:30 - 10:45	14a-D15-6	高起電力タンデムセルに向けたn型及びp型色素増感太陽電池の作製	○茂木 勇樹[1], 大場 暁海[1], 趙 博文[1], 山内 博[1], 國吉 繁一[1], 酒井 正俊[1], 飯塚 正明[2], 工藤 一浩[1]	1.千葉大院工, 2.千葉大教
	10:45 - 11:00	E 14a-D15-7	TCO-less Tandem dssc featuring enhanced spectra with new architectures	○(DC)Ajay Baranwal[1], Naotaka Fujikawa[1], Shyam S Pandey[1], Yuhei Ogomi[1], Tingli Ma[1], Shuzi Hayase[1]	1.Kyushu Institute of Technology
	11:00 - 11:15	14a-D15-8	多段階陽極酸化法を用いた酸化チタンナノチューブ構造光電極の作製	○立木 元規[1], 岸 直希[1], 曽我 哲夫[1]	1.名工大
	11:15 - 11:30	E 14a-D15-9	Fluorin-Doped Tin Oxide Nanostructured Thin Films by Using Horizontally Spraying Technique	○Kenji Murakami[2], Ajith Bandara[1], Gamini Rajapakse[3]	1.GSST, Shizuoka Univ., 2.GSE, Shizuoka Univ., 3.Peradeniya Univ.
	11:30 - 11:45	14a-D15-10	電気泳動法による色素増感型太陽電池の負電極上への絶縁層の形成	○川上 亮[1], 左橋 知也[1], 佐藤 祐喜[1], 森 康維[1], 吉門 進三[1]	1.同志社大院理工
	11:45 - 12:00	14a-D15-11	色素増感型太陽電池のための電気泳動法を用いた色素吸着	○左橋 知也[1], 川上 亮[1], 湯浅 拓也[1], 佐藤 祐喜[1], 森 康維[1], 吉門 進三[1]	1.同志社大院理工
	3月14日(土)　13:00 - 15:00				
	13:00 - 13:15	14p-D15-1	固体型Sb_2S_3増感太陽電池の各界面における電荷再結合ダイナミクス	○(M1)山崎 康平[1], 佐藤 光希[2], 豊田 太郎[1,4], 片山 建二[2], 尾込 陽平[3,4], 早瀬 修二[3,4], 沈 青[1,4]	1.電通大先進理工, 2.中大理工, 3.九工大生命体工, 4.JST CREST
	13:15 - 13:30	14p-D15-2	インピーダンス分光法によるナノポーラス酸化チタンの電荷移動度評価	○青野 正規[1], 高木 謙一郎[1], 永瀬 隆[1,2], 小林 隆史[1,2], 内藤 裕義[1,2,3]	1.大阪府大院工, 2.分子エレクトロニックデバイス研, 3.戦略的創造研究推進機構
	13:30 - 13:45	14p-D15-3	鉛ハライドペロブスカイト$CH_3NH_3PbBr_3$単結晶における光キャリア再結合ダイナミクス	○(M1)山田 琢允[1], 山田 泰裕[1], 西村 秀隆[1], 中池 由美[1], 遠藤 克[1], 若宮 淳志[1], 村田 靖次郎[1], 金光 義彦[1]	1.京大化研
	13:45 - 14:00	14p-D15-4	時間分解発光分光による$CH_3NH_3PbI_3$ペロブスカイト太陽電池の電荷分離ダイナミクスの研究	○山田 泰裕[1], 遠藤 克[1], 若宮 淳志[1], 金光 義彦[1,2]	1.京大化研, 2.JST-CREST
	14:00 - 14:15	14p-D15-5	鉛ハライド系ペロブスカイト太陽電池の電界発光測定による特性評価	○岡野 真人[1], 遠藤 克[1], 若宮 淳志[1], 吉田 正裕[2,3], 秋山 英文[2,3], 金光 義彦[1,3]	1.京大化研, 2.東大物性研, 3.JST-CREST
	14:15 - 14:30	14p-D15-6	$CH_3NH_3Sn_xPb_{1-x}I_3$ペロブスカイトのSn混合比xによる光吸収特性と電荷分離・再結合特性の変化	○沈 青[1,5], 尾込 裕平[2,5], 豊田 太郎[1,5], 藤原 幸星[2], 山崎 康平[1], 佐藤 光希[1,3], 片山 建二[3], 吉野 賢二[4,5], 早瀬 修二[2,5]	1.電通大先進理工, 2.九工大院生命体工, 3.中大理工, 4.宮崎大工, 5.JST CREST
	14:30 - 14:45	14p-D15-7	臭素系ペロブスカイト型半導体$CH_3NH_3PbBr_3$の励起子特性	○佐野 惇郎[1], 中村 唯我[1], 松下 智紀[1,3], 橋本 翼[2], 清田 裕貴[2], 宇田川 洋祐[2], 石井 里歩[2], 加賀屋 葉子[2], 欅田 英之[2,3], 竹岡 裕子[2,3], 江馬 一弘[2,3], 近藤 高志[1,3]	1.東大工, 2.上智大理工, 3.JST-ALCA
	14:45 - 15:00	14p-D15-8	ヨウ化鉛系有機無機ペロブスカイトの基礎光物性	○江良 正直[1], 江馬 一弘[2], Richard Phillips[3]	1.佐大理工, 2.上智大理工, 3.ケンブリッジ大学キャベンディッシュ研

12.6 ナノバイオテクノロジー / Nanobiotechnology　口頭講演

	3月11日(水)　9:30 - 11:45				
	9:30 - 9:45	11a-D5-1	吸着ベシクルの開裂機構：吸着領域での欠陥孔形成が関わる機構	○片岡 知歩[1], 山崎 智彦[1]	1.物材機構
	9:45 - 10:00	奨 11a-D5-2	脂質二分子膜の自己展開現象への疎水性の影響	○(M2)大森 悠也[1], 坂上 弘之[1], 高萩 隆行[1], 鈴木 仁[1]	1.広島大院先端研
	10:00 - 10:15	奨 11a-D5-3	固体基板表面による人工脂質膜内分子拡散への非対称性と異方性の発現	○茂木 俊憲[1], 山崎 憲慈[2], 荻野 俊郎[3], 手老 龍吾[4]	1.豊技大 EIIRIS, 2.北大院工, 3.横浜大院工・JST-CREST, 4.豊技大 環境生命
	10:15 - 10:30	11a-D5-4	グラフェン酸化物上に形成した人工脂質膜の拡散係数測定	○岡本 吉晃[1], 茂木 俊憲[2], 岩佐 精二[1], サンドゥー アダルシュ[2,3], 手老 龍吾[1,2]	1.豊技大環境・生命, 2.豊技大EIIRIS, 3.豊技大電気・電子
	10:30 - 10:45		休憩/Break		

	10:45 - 11:00	11a-D5-5	金ナノ粒子を含む脂質二重膜の液中におけるAFM評価	○坂口 直駿[1], 横田 圭司[1], 仲山 智明[1], 木村 僚佑[1], 木村 康男[2,4], 平野 愛弓[3,4], 荻野 俊郎[1,4]	1.横国大院工, 2.東京工科大, 3.東北大院医工, 4.CREST/JST
	11:00 - 11:15	奨 11a-D5-6	脂質二重膜上におけるDNA被覆金ナノ粒子のセルフアセンブリに対するイオンの効果	○磯貝 卓巳[1], 赤田 英理[1], 中田 咲子[1], 吉田 直矢[1], 手老 龍吾[2], 原田 俊太[1], 宇治原 徹[1], 田川 美穂[1]	1.名大院工, 2.豊橋技科大
	11:15 - 11:30	11a-D5-7	人工脂質膜でシールした微小井戸の電気特性評価と構造最適化	○樫村 吉晃[1], フォミチェバ アンナ[1], 大嶋 梓[1], 住友 弘二[1]	1.NTT物性基礎研
	11:30 - 11:45	奨 11a-D5-8	電子線描画を用いた細胞膜穿孔現象の閾値探索	○吉岡 基[1], 宮廻 裕樹[1], 我妻 玲[1], 満渕 邦彦[1], 星野 隆行[1]	1.東京大学
	3月11日(水)　13:15 - 18:00				
	13:15 - 13:30	11p-D5-1	酸化亜鉛ウィスカー探針による官能基の化学イメージング	○日比野 政裕[1], 菅原 剛[1], 西田 ともみ[2]	1.室蘭工大, 2.ジェイテクト
	13:30 - 13:45	11p-D5-2	液中高分解能FM-AFMを用いた機能性タンパク質表面の水和構造の観察	○平田 芳樹[1], 小林 圭[2], 山田 啓文[2], 田中 睦生[1]	1.産総研, 2.京大工
	13:45 - 14:00	11p-D5-3	液中FM-AFMによる左巻きDNAの高分解能観察	○木南 裕陽[1], 小林 圭[1,2], 山田 啓文[1]	1.京大工, 2.京大白眉セ
	14:00 - 14:15	11p-D5-4	FM-AFMによるStreptavidin 2次元結晶の液中高分解能観察	○宮本 眞之[1], 木南 裕陽[1], 崔 子鵬[1], 小林 圭[1,2], 山田 啓文[1]	1.京大工, 2.京大白眉セ
	14:15 - 14:30	奨 11p-D5-5	液中サブナノ分解能AFM計測のための微小管外側表面モデルの確立	○高尾 一史[1], 淺川 雅[1], 内橋 貴之[1], 池上 浩司[2], 瀬藤 光利[2], 福間 剛士[1,3]	1.金大院, 2.浜松医大, 3.ACT-C/JST
	14:30 - 14:45	11p-D5-6	走査型アトムプローブによるペプチドの原子レベルでの定性・定量解析	○西川 治[1], 谷口 昌宏[1]	1.金沢工大
	14:45 - 15:00		休憩/Break		
	15:00 - 15:15	11p-D5-7	バイオセンサへ向けた$LiTaO_3$表面における自発分極ドメインの観察	○(B)磯部 亜紀子[1], 仲山 智明[1], 荻野 俊郎[1,2]	1.横国大理工, 2.CREST/JST
	15:15 - 15:30	11p-D5-8	垂直磁気ドメインを有する強磁性体表面へのタンパク質の吸着	○大和田 永作[1], 横田 圭司[1], 仲山 智明[1], 坂口 直駿[1], 荻野 俊郎[1,2]	1.横国大院工, 2.CREST/JST
	15:30 - 15:45	11p-D5-9	光ピンセットを用いた神経細胞に局在する受容体タンパク質の捕捉・集合	○前澤 安代[1], 工藤 卓[2], 田口 隆久[3], 細川 千絵[1]	1.産総研 健康工学, 2.関西学院大 理工, 3.情報機構 脳情報
	15:45 - 16:00	奨 11p-D5-10	ヒト血清溶媒リポソーム―各種タンパク質間相互作用の誘電分散解析	○吉川 知貴[1], 張 子洋[1], 島内 寿徳[2], 山下 馨[1], 野田 実[1]	1.京工繊大, 2.岡山大
	16:00 - 16:15	11p-D5-11	レーザー捕捉誘起液液相分離を利用したタンパク結晶化：顕微ラマン分光測定による局所濃度上昇の可視化	○吉松 泉[1], 三浦 篤志[1,2], 喜多村 昇[1,2]	1.北大院総化, 2.北大院理
	16:15 - 16:30		休憩/Break		
	16:30 - 16:45	11p-D5-12	掃引干渉縞励起蛍光相関分光法のセンシング応用	○服部 峰之[1]	1.産総研電子光
	16:45 - 17:00	11p-D5-13	高密度金ナノ粒子集合体を標識としたバクテリアの光学的検出	○(M2)木下 隆将[1], 福田 真帆[1], 西野 智昭[1], 椎木 弘[1], 長岡 勉[1]	1.阪府大院工
	17:00 - 17:15	11p-D5-14	金ナノ粒子サンドイッチアッセイを用いた抗原検出における夾雑物由来ノイズの低減	○水野 直人[1], 三反畑 輝[1], 江刺家 恵子[1], 斎木 敏治[1]	1.慶大院理工
	17:15 - 17:30	11p-D5-15	バクテリオロドプシン光センサーのpH緩衝液定量	○(M1)宮下 一馬[1], 田邉 季正[1], 三藤 剛[1], 春山 喜洋[2], 笠井 克幸[2], 岡田 佳子[1]	1.電通大先進理工, 2.情報通信研究機構
	17:30 - 17:45	11p-D5-16	バーコーティング法により作製されたバクテリオロドプシン(bR)薄膜を用いた光応答セルの時間微分型光電流の評価	○山田 俊樹[1], 春山 喜洋[1], 笠井 克幸[1], 梶 貴博[1], 富成 征弘[1], 田中 秀吉[1], 大友 明[1]	1.情報通信研究機構
	17:45 - 18:00	11p-D5-17	バクテリオロドプシンを用いたオプティカルフローセンシング技術の開発(2)	○笠井 克幸[1], 春山 喜洋[1,3], 山田 俊樹[1], 秋葉 誠[1], 富成 征弘[1], 梶 貴博[1], 田中 秀吉[1], 岡田 佳子[2], 大友 明[1]	1.情通機構, 2.電通大情報理工, 3.阪市大院

12.6 ナノバイオテクノロジー / Nanobiotechnology　ポスター講演

	3月12日(木)　9:30 - 11:30				
		E 12a-P10-1	Fabrication of natural material coated on the biodegradable fiber with calcium carbonate for improving hemostatic effect	○(M2)JUNYONG PARK[1], KYUHONG KYUNG[1], SAEHOON KIM[2], SEIMEI SHIRATORI[1]	1.Grad. Sch. Sci. Tech., Keio Univ., 2.Dep. Adv. Ceramic material. Eng., Gangneung-Wonju Univ
		12a-P10-2	AFMを用いたナノスリットに詰まるDNA形状観測	○(B)芝崎 賢作[1], 加藤 佑太[1], 川口 翔平[1], 石田 研太郎[1], 三井 敏之[1]	1.青学大理工
		12a-P10-3	モレキュラービーコンを用いた1分子FRET計測系の構築	○和泉 聡志[1], 大久保 幸太朗[1], 櫛田 昂歳[1], 山本 英明[2], 谷井 孝至[1]	1.早大理工, 2.東北大学際研
		12a-P10-4	薄膜干渉基板を用いたラマン分光イムノアッセイのための基礎研究	○安田 充[1], 秋元 卓央[2], 尾崎 幸洋[1]	1.関西学院大院理工, 2.東京工科大応用生物
		12a-P10-5	薄膜干渉基板を用いた偏光技術に基づく高コントラスト蛍光顕微鏡の開発とタンパク質分析への応用	○安田 充[1], 秋元 卓央[1]	1.東京工科大応用生物
		12a-P10-6	強誘電体基板上でのタンパク質の選択的吸着	○仲山 智明[1], 磯部 亜紀子[1], 荻野 俊郎[1,2]	1.横国大院工, 2.CREST/JST
		12a-P10-7	誘電泳動法と細菌鋳型膜による選択的捕捉機構の理論解析	○田村 守[1,2], 中田 啓之[1,3], 床波 志保[3], 飯田 琢也[2]	1.大阪府大院工, 2.大阪府大院理, 3.大阪府大ナノ科学材料セ
		12a-P10-8	プラズマ オン チップ の開発：気液界面を利用した1細胞へのプラズマ照射処理	張 淳堯[1], 鄭 鍾炫[1], 小林 未明[2], 清水 鉄司[3], 佐々木 実[1], ○熊谷 慎也[1]	1.豊田工大, 2.奈良先端大, 3.terraplasma GmbH

12.6 ナノバイオテクノロジー / Nanobiotechnology　口頭講演

	3月13日(金)　9:30 - 11:45				
	9:30 - 9:45	13a-D5-1	低アスペクト比マイクロポアを用いた浮遊微粒子の検出	○筒井 真楠[1], 横田 一道[1], 大城 敬人[1], 谷口 正輝[1], 川合 知二[1]	1.阪大産研
	9:45 - 10:00	奨 13a-D5-2	ナノポアトラップ法を用いた微粒子の蛍光-電流同時計測	○(DC)有馬 彰秀[1], 筒井 真楠[1], 谷口 正輝[1]	1.阪大産研
	10:00 - 10:15	13a-D5-3	電極組込型ナノポアデバイスにおける電極間クロストーク	○横田 一道[1], 筒井 真楠[1], 大城 敬人[1], 谷口 正輝[1], 川合 知二[1]	1.阪大産研
	10:15 - 10:30	奨 13a-D5-4	電荷差均一化によるナノポアデバイスの絶縁破壊の回避	○松井 一真[1], 柳 至[1], 武田 健一[1]	1.日立中研
	10:30 - 10:45		休憩/Break		

	10:45 - 11:00	13a-D5-5	複数ナノ間隙デバイスを用いた単分子計測法の開発	○大城 敬人[1], 筒井 真楠[1], 横田 一道[1], 谷口 正輝[1]	1.阪大産研
	11:00 - 11:15	13a-D5-6	DNAのポア通過前におけるナノポアやナノスリットとの相互作用	○川口 翔平[1], 加藤 祐太[1], 芝崎 賢作[1], 石田 研太郎[1], 三井 敏之[1]	1.青学大理工
	11:15 - 11:30	13a-D5-7	電極付加ナノポアのACゲート電位によるDNAの挙動制御	○加藤 佑太[1], 川口 翔平[1], 芝崎 賢作[1], 石田 研太郎[1], 三井 敏之[1]	1.青学大理工
	11:30 - 11:45	13a-D5-8	正に帯電したナノポアを用いた光学的DNAナノポア通過観察	○山崎 洋人[1], 伊藤 晋太郎[1], アマルビー ユーゴ[1], 江刺家 恵子[1], 斎木 敏治[1]	1.慶大院理工
	3月13日(金)　16:30 - 19:00				
	16:30 - 16:45	13p-D5-1	クラミドモナス非運動性変異株の力学コントロール	八木 俊樹[1], ○西山 雅祥[2]	1.県立広島大, 2.京大白眉セ
	16:45 - 17:00	13p-D5-2	フォトニック結晶ナノレーザバイオセンサにおけるセンサ界面の考察	○渡部 工[1], 羽中田 祥司[1], 古田 祐樹[1], 岸 洋次[1], 西島 喜明[1], 馬場 俊彦[1]	1.横国大・院工
	17:00 - 17:15	奨 13p-D5-3	水平円筒流路を用いた血漿分離システムの開発	○黒田 千愛[1], 大木 義路[1,2], 芦葉 裕樹[3], 藤巻 真[3], 粟津 浩一[3], 田中 寅彦[4], 槇島 誠[4]	1.早大先進理工, 2.早大材研, 3.産総研, 4.日大医
	17:15 - 17:30	奨 13p-D5-4	神経細胞パターンゲルフィルムによるバイオアッセイデバイスの構築	○平田 卓也[1], 岡本 滉平[1], 阿部 結奈[1], 長峯 邦明[1], 梶 弘和[1], 西澤 松彦[1]	1.東北大院工
	17:30 - 17:45	奨 13p-D5-5	伸縮可能なバイオ電池の開発	○高井 優樹[1], 加藤 悠人[1], 加藤 孝一郎[1], 小川 雄大[1], 山田 健郎[2], 畠 賢治[2], 西澤 松彦[1]	1.東北大院工, 2.産総研
	17:45 - 18:00		休憩/Break		
	18:00 - 18:15	奨 13p-D5-6	酵素発電システムを搭載したイオントフォレシスパッチの開発	○松坂 広太郎[1], 小川 雄大[1], 長峯 邦明[1], 西澤 松彦[1]	1.東北大院工
	18:15 - 18:30	奨 13p-D5-7	アパタイト結晶に対するフラグメント分子軌道法の試み #2	○加藤 幸一郎[1], 福澤 薫[2,4], 望月 祐志[3,4]	1.みずほ情報総研, 2.日大松戸歯, 3.立教大理, 4.東大生産研
	18:30 - 18:45	13p-D5-8	粘菌を利用した金属微粒子配列	○山口 博樹[1], 望月 裕文[1], 渡邉 満洋[1], 近藤 英一[1]	1.山梨大
	18:45 - 19:00	13p-D5-9	三次元構造誘電泳動デバイスを用いた金属ナノ材料の立体形成	○片岡 良介[1], 時田 寛也[1], 内田 諭[1], 佐野 遼[2], 西川 宏之[2]	1.首都大学東京, 2.芝浦工業大学

12.7 医用工学・バイオチップ / Biomedical Engineering and Biochips　口頭講演

	3月11日(水)　9:00 - 11:45				
	9:00 - 9:15	奨 11a-D6-1	多点高密度計測のためのノイズキャンセリング回路の設計(集積化脳神経プローブシステムの開発1)	○永藤 弘嵩[4], 谷 卓治[1], 長沼 秀樹[1], 岩上 卓磨[1], 川原 岬[2], 伊藤 圭汰[3], 清山 浩司[4], 田中 徹[1,2]	1.東北大院工, 2.東北大院医工, 3.東北大工, 4.長崎総科大
	9:15 - 9:30	奨 11a-D6-2	多点高密度計測のためのインピーダンス補正回路の設計(集積化脳神経プローブシステムの開発2)	○岩上 卓磨[1], 谷 卓治[1], 長沼 秀樹[1], 川原 岬[2], 伊藤 圭汰[3], 永藤 弘嵩[4], 清山 浩司[4], 田中 徹[1,2]	1.東北大院工, 2.東北大院医工, 3.東北大工, 4.長崎総科大
	9:30 - 9:45	奨 11a-D6-3	マルチグルーブシャンクを有する昆虫用In vivoシリコン神経プローブの作製(集積化脳神経プローブシステムの開発3)	○鈴木 雄策[1], 原島 卓也[1], 木野 久志[2], 田中 徹[1,3]	1.東北大院工, 2.東北大際研, 3.東北大院医工
	9:45 - 10:00	奨 11a-D6-4	表層刺激電極を有する網膜下埋植人工網膜チップモジュールの作製	○後藤 大輝[1], 長沼 秀樹[2], 木野 久志[3], 田中 徹[1,2]	1.東北大院医工, 2.東北大院工, 3.東北大際研
	10:00 - 10:15	11a-D6-5	a-InGaZnO TFT pHセンサの過渡応答特性	○岩松 新之輔[1], 竹知 和重[2], 阿部 泰[1], 矢作 徹[1], 田邉 浩[2], 加藤 睦人[1]	1.山形県工技セ, 2.NLTテクノロジー
	10:15 - 10:30		休憩/Break		
	10:30 - 10:45	奨 11a-D6-6	電荷転送読み出し方式を用いた圧力センサの提案とその動作検証	○(M2)岩下 彰宏[1], 岩田 達哉[1], 大石 泰三[1], 高橋 一浩[1], 石田 誠[1], 澤田 和明[1]	1.豊橋技科大
	10:45 - 11:00	11a-D6-7	イオンの複数同時計測に向けた電流検出型センサの製作	○(BC)水谷 信哉[1], 高橋 聡[1], 河野 顕輝[1,2], 服部 敏明[1,2], 石田 誠[1], 澤田 和明[1,2]	1.豊橋技術科学大学, 2.JST - CREST
	11:00 - 11:15	11a-D6-8	センサ感度差を利用した補正技術による参照電極のないイオンイメージセンサの提案	○渡邊 愼[1], 太齋 文博[1], 石田 誠[1], 服部 敏明[1], 澤田 和明[1,2]	1.豊技大, 2.JST-CREST
	11:15 - 11:30	奨 11a-D6-9	ポリイオンコンプレックスを用いた非標識ATPイメージセンサの製作	○土井 英生[1], 堀尾 智子[1], 奥村 弘一[1], 服部 敏明[1,2], 石田 誠[1], 澤田 和明[1,2]	1.豊橋技科大, 2.科学技術振興機構
	11:30 - 11:45	奨 11a-D6-10	イオンイメージセンサを用いたアルツハイマー病原因物質の高速・高感度検出装置の開発	○(P)奥野 海良人[1], 吉見 立也[1], 奥村 弘一[2], 澤田 和明[2], 滝川 修[1]	1.国立長寿医療研究セ, 2.豊橋技科大
	3月11日(水)　13:15 - 18:00				
	13:15 - 13:30	奨 11p-D6-1	レンズレスデジタル酵素結合免疫吸着法に向けた高感度 CMOS イメージセンサの設計	○永崎 瑞樹[1], 北口 一樹[1], 竹原 浩成[1], 竹原 宏明[1], 野田 俊彦[1,3], 笹川 清隆[1,3], 徳田 崇[1,3], 野地 博行[2,3], 太田 淳[1,3]	1.奈良先端大物質創成, 2.東大院工, 3.JST-CREST
	13:30 - 13:45	奨 11p-D6-2	生体埋植用自己リセット型CMOSイメージセンサ画素の低消費電力化	○山口 貴大[1], 須永 圭紀[1], 春田 牧人[1], 竹原 宏明[1], 野田 俊彦[1], 笹川 清隆[1], 徳田 崇[1], 太田 淳[1]	1.奈良先端大
	13:45 - 14:00	奨 11p-D6-3	埋殖型PWM出力CMOSイメージセンサの低電圧化	○永田 健悟[1], 速水 一[1], 笹川 清隆[1], 竹原 宏明[1], 野田 俊彦[1], 徳田 崇[1], 太田 淳[1]	1.奈良先端大
	14:00 - 14:15	奨 11p-D6-4	CMOSセンサ搭載生体埋埋め込みグルコースセンサのin vitro長期動作検証	○平井 智大[1], 増田 啓太[1], 河村 敏和[1], 竹原 宏明[1], 野田 俊彦[1], 笹川 清隆[1], 徳田 崇[1], 興津 輝[2], 竹内 昌治[2], 太田 淳[1]	1.奈良先端大, 2.東大
	14:15 - 14:30	11p-D6-5	埋植型デバイスによる生体内蛍光イメージングの光学シミュレーション	○竹原 宏明[1], 太田 安美[1], 元山 真由美[1], 春田 牧人[1], 野田 俊彦[1], 笹川 清隆[1], 徳田 崇[1], 太田 淳[1]	1.奈良先端大物質
	14:30 - 14:45	奨 11p-D6-6	スマート電極型人工視覚デバイスの刺激電極内蔵用CMOSチップの設計	○川崎 凌平[1], 藤澤 匠[1], 野田 俊彦[1], 竹原 宏明[1], 笹川 清隆[1], 徳田 崇[1], 太田 淳[1]	1.奈良先端大
	14:45 - 15:00	11p-D6-7	長さ500 μm以上の高アスペクト比Siマイクロワイヤの生体組織への刺入	○八木 智史[1], 山際 翔太[1], 今塩屋 竜也[1], 大井 英夫[1,2], 久保田 吉博[1], 石田 誠[1,2], 河野 剛士[1]	1.豊橋技科大 電気・電子情報工学系, 2.EIIRIS
	15:00 - 15:15	11p-D6-8	Pt/SiO2マイクロチューブ神経電極アレイの高空間分解能光刺激への応用	○松尾 朋幸[1], 中邨 友彦[1], 山際 翔太[1], 澤畑 博人[1], 石田 誠[1,2], 河野 剛士[1]	1.豊橋技科大, 2.EIIRIS
	15:15 - 15:30	11p-D6-9	完全埋込み神経インターフェースデバイスに向けたフレキシブル基板上へのフリップチップ実装技術	○Horagodage Prabhath[1], 岡部 謙志[1], 秋田 一平[1], 山際 翔太[1], 河野 剛士[1], 石田 誠[1]	1.豊橋技科大
	15:30 - 15:45		休憩/Break		

	15:45 - 16:00	奨 11p-D6-10	修飾したグラフェンFETとDNAの結合および脱離の電気的検出	○岡野 誠之[1], Norhayati Sabani[1], Rajiv Verma[1], 金井 康[1], 大野 恭秀[1,2], 前橋 兼三[1,3], 井上 恒一[1], 武井 史恵[1], 中谷 和彦[1], 松本 和彦[1]	1.阪大産研, 2.徳島大, 3.農工大
	16:00 - 16:15	11p-D6-11	微量生体サンプルを高感度に計測するペーパーゲートトランジスタの創製	○加治佐 平[1], 坂田 利弥[1]	1.東大院工
	16:15 - 16:30	奨 11p-D6-12	抗原-抗体反応計測へのMolecular Charge Contact法の応用	○宮澤 雄弥[1], 坂田 利弥[1]	1.東大院工
	16:30 - 16:45	11p-D6-13	移植前診断に向けたイオン感応型透明ゲートトランジスタの創製と評価	○西村 光太郎[1], 宮澤 雄弥[1], 齋藤 暁子[1], 加治佐 平[1], 坂田 利弥[1]	1.東大院工
	16:45 - 17:00	11p-D6-14	半導体バイオセンサによる人為的受精能獲得精子とその抑制作用の評価	○齋藤 暁子[1], 加治佐 平[1], 坂田 利弥[1]	1.東大院工
	17:00 - 17:15	奨 11p-D6-15	半導体バイオセンサによる再生ヒト軟骨細胞基質産生挙動のin situモニタリング	○佐竹 皓宇[1], 齋藤 暁子[1], 加治佐 平[1], 水野 秀一[2], 坂田 利弥[1]	1.東大院工, 2.ハーバード大
	17:15 - 17:30	奨 11p-D6-16	嗅上皮細胞トランジスタによるがん関連VOC認識機構の解明	○広瀬 雄一[1], 齋藤 暁子[2], 加治佐 平[2], 坂田 利弥[1,2]	1.東大工, 2.東大院工
	17:30 - 17:45	奨・E 11p-D6-17	Development of a novel device for allergy test based on semiconductor principle	○Haoyue Yang[1], Akiko Saito[1], Taira Kajisa[1], Yuki Yanase[2], Toshiya Sakata[1]	1.Univ. of Tokyo, 2.Hiroshima Univ.
	17:45 - 18:00	11p-D6-18	受精卵質量測定のためのホルダ型ピエゾ抵抗カンチレバの試作と評価	○曾根 逸人[1], 川上 智之[1], 齋藤 暁子[2], 須藤 寛文[1], 保坂 純男[1], 坂田 利弥[2]	1.群馬大院理工, 2.東京大院工

12.7 医用工学・バイオチップ / Biomedical Engineering and Biochips　ポスター講演

3月12日(木)　9:30 - 11:30

		12a-P11-1	水晶振動子センサーを用いる癌細胞に対する抗がん剤の影響評価	○アルサリーム アブドゥラ[1], 村松 宏[1]	1.東京工科大院
		12a-P11-2	小型蛍光偏光度測定装置による微生物遺伝子の計測	○小泉 大和[1], 湯沢 友之、鶴岡 誠[1]	1.東京工科大
		12a-P11-3	pH不感応膜としてのPMMA濃厚ブラシの提案	○清水 一輝[1], Baek Sungchul[2,3], 太斎 文博[1], 石田 誠[1], 辻井 敬亘[2,3], 澤田 和明[1,3]	1.豊技大, 2.京大, 3.JST-CREST
		12a-P11-4	糖鎖修飾グラフェンFETを用いたインフルエンザウイルスセンサの開発	麻植 丈史[1], 生田 昂[1], 林 亮太[1], 金井 康[1], 大野 恭秀[1,2], ○前橋 兼三[1,3], 井上 恒一[1], 松本 和彦[1], 渡邊 洋平[4], 河原 敏男[5], 鈴木 康夫[5], 中北 愼一[6]	1.阪大産研, 2.徳島大, 3.農工大, 4.阪大微研, 5.中部大, 6.香川大
		12a-P11-5	複素誘電率測定用オンチップインダクタモデルの提案	○外谷 昭洋[1], 北林 翔[1], 升井 義博[2], 吉川 公麿[3]	1.呉工業高等専門学校, 2.広島工業大学, 3.広島大学
		12a-P11-6	LC発振器を応用した複素誘電率測定用回路の提案	○外谷 昭洋[1], 石井 佑樹[1], 升井 義博[2], 吉川 公麿[3]	1.呉工業高等専門学校, 2.広島工業大学, 3.広島大学
		12a-P11-7	ミニ遠心機で動作する遠心型マイクロ流体デバイスによる自発的排液とバイオアッセイへの応用	○浮田 芳昭[1], 内海 裕一[2], 高村 禅[3]	1.山梨大学, 2.兵庫県立大学, 3.北陸先端大
		12a-P11-8	マイクロパターン基板上の単一神経細胞間に形成されるシナプスの解析	○高沖 英里[1,2], 山本 英明[1,2,3], 松村 亮佑[1,2], 桂林 秀太郎[4], 平野 愛弓[1,2], 庭野 道夫[1,2,5]	1.東北大院医工, 2.CREST, JST, 3.東北大学際研, 4.福岡大薬, 5.東北大通研
		12a-P11-9	マイクロパターン神経細胞回路の活動様式に関する理論的考察	○千田 雄大[1,2], 山本 英明[2,3], 平野 愛弓[2,4], 石原 広識[5], 藤森 壮也[5], 谷井 孝至[5], 久保田 繁[6], 庭野 道夫[1,2]	1.東北大通研, 2.CREST, JST, 3.東北大学際研, 4.東北大医工, 5.早大理工, 6.山形大理工
		E 12a-P11-10	Gold Nanoparticles Labeled Electrochemical Immunoassay of Human Chorionic Gonadotropin Hormone Detection using Open Circuit Potential	○(M2)Kanokwan Charoenkitamorn[1,2], Tue Phan Trong[1], Weena Siangproh[4], Orawon Chailapakul[2,3], Yuzuru Takamura[1]	1.JAIST, 2.Chulalongkorn Univ., 3.Petro. Mat Chula, 4.SWU
		12a-P11-11	分子鋳型ポリマーナノ粒子を用いた慢性ストレス関連ホルモン検出向けその場検査チップ	○谷口 伸一[1], 村瀬 敦郎[2], 竹内 俊文[2]	1.日立横研, 2.神戸大院工
		12a-P11-12	接着性細胞ハンドリングのための導電性シルクゲル薄膜	○手島 哲彦[1], 塚田 信吾[1], 河西 奈保子[1], 佐々木 智[1], 田中 あや[1], 中島 寛[1], 住友 弘二[1]	1.NTT物性研
		12a-P11-13	マイクロ流路結合導波モードセンサによる赤血球凝集検出	○芦葉 裕樹[1], 藤巻 真[1], 粟津 浩一[1], 傅 梦穎[2], 大木 義路[2,3], 田中 寅彦[4], 槇島 誠[4]	1.産総研, 2.早大先進理工, 3.早大材研, 4.日大医
		12a-P11-14	GaInAsP半導体のフォトルミネッセンスを用いたpH / バイオイメージング	○(B)酒本 真衣[1], 岸 洋次[1], 馬場 俊彦[1]	1.横国大
		12a-P11-15	フォトニック結晶ナノレーザバイオセンサとリムルス試薬を用いた高速・高感度エンドトキシン検出(II)	○高橋 大智[1], 羽中田 祥司[1], 渡部 工[1], 西島 喜明[1], 馬場 俊彦[1]	1.横国大院工
		12a-P11-16	POCTに向けた遠心促進熱対流型RT-PCR法の開発	○高橋 和也[1], 桐山 雄一朗[1], 齋藤 真人[1], 民谷 栄一[1]	1.阪大工
		E 12a-P11-17	Nano-pillar structured SERS-active substrate based on nano-imprint technology	○Shu Jiang[1], Mizuho Murahashi[1], Masato Saito[1], Eiichi Tamiya[1]	1.OSAKA Univ.
		E 12a-P11-18	SERS-based bio-sensing with surface modified aggregates of silver nanoparticles	○(M1)zhengjun shen[1], Yoshikawa Hiroyuki[1], Tamiya Eiichi[1]	1.Osaka Univ
		12a-P11-19	差動Siリング光共振器によるショ糖及び前立腺特異抗原検出	○谷口 智哉[1,2], 横山 脩平[1,2], 雨宮 嘉照[1], 池田 丈[1,3], 黒田 章夫[1,3], 横山 新[1,2]	1.広島大ナノデバ研, 2.先端研半導体専攻, 3.分子生命専攻
		12a-P11-20	アクセプタ型フォトニック結晶共振器を用いたバイオセンサーの温度依存性	○本澤 圭太[1], サナ アムリタ クマル[1], 千日 拓馬[1], 野田 和希[1], 雨宮 嘉照[1], 横山 新[1]	1.広島大ナノデバイス
		12a-P11-21	差動Siリング光共振器センサーの温度特性	○横山 脩平[1], 谷口 智哉[1], 雨宮 嘉照[1], 池田 丈[1,2], 黒田 章夫[1,2], 横山 新[1]	1.広島大ナノデバ, 2.広島大分子生命
		12a-P11-22	スポットサイズコンバータの特性評価およびバイオセンサーへの応用	○千日 拓馬[1], 本澤 圭太[1], 雨宮 嘉照[1], 横山 新[1]	1.広大ナノデバイス

12.7 医用工学・バイオチップ / Biomedical Engineering and Biochips　口頭講演

3月13日(金)　9:00 - 11:45

	9:00 - 9:15	奨 13a-D6-1	電子線による高電界生成を用いたナノ空間における物質輸送制御	○(M2)宮廻 裕樹[1], 満渕 邦彦[1], 星野 隆行[1]	1.東大院情理
	9:15 - 9:30	13a-D6-2	送液技術によるオイル封止マイクロウェルを用いた大規模タンパク質アレイチップの作製	○(M2)福田 拓海[1], 佐藤 秀介[1], 上野 真吾[1], 一木 隆範[1]	1.東大院工
	9:30 - 9:45	13a-D6-3	チップ電気泳動法を用いた高分子ナノ粒子の1粒子ゼータ電位分析	○花村 奈未[1], 赤木 貴則[1], 一木 隆範[1]	1.東大院工
	9:45 - 10:00	奨 13a-D6-4	埋め込み型形状記憶ポリマーマイクロバルブの作製	○(M2)蒋 晨陽[1], 宇都 甲一郎[2], 荏原 充宏[2], 青柳 隆夫[2], 一木 隆範[1]	1.東大院工, 2.物材機構
	10:00 - 10:15	奨・E 13a-D6-5	Microfluidic device-based electrical sensing of Nucleic acid	○(D)Tanzilur Rahman[1], Takanori Ichiki[1]	1.University of Tokyo

	10:15 - 10:30		休憩/Break		
	10:30 - 10:45	E 13a-D6-6	Microintaglio Printing (μ-IP) of Biomolecules using APTES Functionalized Substrate	○(D)Subhashini RajKumal[1], Hiromi Kuramochi[1], Shingo Ueno[1], Takanori Ichiki[1]	1.Department of Bioengineering, The University of Tokyo
	10:45 - 11:00	奨 13a-D6-7	金属アシスト型シリコンスロット導波路におけるセンサ感度の評価	○石坂 雄平[1], 長井 優[1], 藤澤 剛[1], 齊藤 晋聖[1]	1.北大情報科学研究科
	11:00 - 11:15	奨 13a-D6-8	フォトニック結晶ナノレーザバイオセンサにおける屈折率・電荷同時検出の可能性(Ⅲ)	○(M2)岸 ヨウジ[1], 酒本 真衣[1], 馬場 俊彦[1]	1.横国大・院工
	11:15 - 11:30	13a-D6-9	フォトニック結晶ナノレーザによる不純物を含む試料からの前立腺癌マーカーの高感度検出(II)	○(D)羽中田 祥司[1], 渡部 工[1], 馬場 俊彦[1]	1.横国大・院工
	11:30 - 11:45	奨 13a-D6-10	カンチレバーバイオセンサを用いたリポソーム脂質膜上でのAβタンパク質動態の経時変化の検討	○(PC)張 子洋[1], 寒川 雅之[2], 山下 馨[1], 野田 実[1]	1.京都工芸繊維大学, 2.新潟大学
	3月13日(金) 16:15 - 19:15				
	16:15 - 16:30	13p-D6-1	蛍光封入リポソームを用いた蛍光アレイセンサによるターゲット蛋白質の検出	○今村 亮太[1], 張 子洋[1], 吉川 知貴[1], 島内 寿徳[2], 村田 直樹[1], 福澤 理行[1], 山下 馨[1], 野田 実[1]	1.京工繊大, 2.岡山大
	16:30 - 16:45	13p-D6-2	局所光重合反応を利用した高感度バイオマーカー検出	○吉川 裕之[1], 井村 修平[1], 民谷 栄一[1]	1.阪大院工
	16:45 - 17:00	E 13p-D6-3	Long Term Monitoring of Single and Multiple Cardiomyocytes Trapped in a Centrifugal Microfluidic Chip	○(D)Wilfred Espulgar[1], Wataru Aoki[1], Daiki Mita[1], Masato Saito[1], Jong-Kook Lee[1], Eiichi Tamiya[1]	1.Osaka Univ.
	17:00 - 17:15	13p-D6-4	遠心促進熱対流型PCR法を利用した食品害虫検出システムの開発	○桐山 雄一朗[1], 齋藤 真人[1], 民谷 栄一[1]	1.阪大院工
	17:15 - 17:30	13p-D6-5	オンチップ質量分析に向けた熱パルスイオン化法と試料膜形成法	○(D)杉山 清隆[1], 高村 禅[1]	1.北陸先端大マテリアル
	17:30 - 17:45	13p-D6-6	ハの字型電極を用いた誘電泳動力による細胞輸送システム	○須田 隆夫[1], 濱田 拓也[1], 西元 稜太[1], 井上 貴仁[2]	1.鹿児島高専, 2.産総研ナノシステム
	17:45 - 18:00		休憩/Break		
	18:00 - 18:15	13p-D6-7	背面照射系プラズモニックチップを用いた高感度蛍光検出 —Ag薄膜及びSiO_2薄膜の膜厚の検討—	○中山 拓哉[1,2], 金高 健二[1], 田和 圭子[1,2]	1.産総研, 2.関学理工
	18:15 - 18:30	13p-D6-8	回折格子結合型表面プラズモン共鳴励起増強蛍光分光(GC-SPFS)を用いた肝細胞癌マーカー(AFP)の免疫測定系の開発	○永江 剛典[1], 彼谷 高敏[1], 中村 幸登[1], 野崎 昭俊[1], 井出 陽一[1], 石田 賢治[1], 須田 美彦[1], 田和 圭子[2]	1.コニカミノルタ(株), 2.産総研
	18:30 - 18:45	13p-D6-9	特異的高分子リガンド修飾プラズモニックチップを用いたC反応性タンパク質の高感度蛍光検出	○松浦 亮[1], 北山 雄己哉[1], 田和 圭子[2], 竹内 俊文[1]	1.神戸大院工, 2.産総研
	18:45 - 19:00	13p-D6-10	プラズモニックチップ上で培養した神経細胞接着分子の光捕捉	○細川 千絵[1,2], 宮内 康平[1,2], 工藤 卓[2], 田口 隆久[3], 田和 圭子[1,2]	1.産総研健康工学, 2.関西学院大理工, 3.情通機構脳情報
	19:00 - 19:15	13p-D6-11	Long-range SPR 法を利用した高感度・高深度な生細胞可視化法の開発	○柳瀬 雄輝[1], 川口 智子[1], 玉田 薫[2], 秀道広[1]	1.広大医, 2.九大理
	3月14日(土) 9:00 - 12:00				
	9:00 - 9:15	14a-D6-1	金ナノ粒子プローブよる組織切片のイメージング質量分析	○新留 康郎[1], 藤井 政徳[2], 中嶋 直敏[2,3], 新留 琢郎[4]	1.鹿大院理工, 2.九大院工, 3.I2CNER, JST, 4.熊大院自然
	9:15 - 9:30	14a-D6-2	表面プラズモンアンテナ付SOIフォトダイオードを用いた集積化バイオセンサーにおける屈折率測定の性能評価	○佐藤 弘明[1,2], 岩田 将平[2], 小野 篤史[1,2], 猪川 洋[1,2]	1.静岡大電子研, 2.静岡大院工
	9:30 - 9:45	14a-D6-3	量子ドットを蛍光標識としたV溝バイオセンサーの設計	藤巻 真[1], ○芦葉 裕樹[1], 王 暁民[1], 栗津 浩一[1]	1.産総研
	9:45 - 10:00	14a-D6-4	有機シラン単分子膜パターンへの接着差を用いた癌細胞の選別	○竹内 祐子[1], 柿沼 瑛介[1], 坂本 留実[1], 山本 英明[3], 佐藤 裕子[2,4], 谷井 孝至[1,2]	1.早大理工, 2.早大ナノ機構, 3.東北大学際研, 4.日赤看護大
	10:00 - 10:15	14a-D6-5	電気泳動コールター法における精度向上	○清水 俊彰[1], 水木 徹[1], 鵜飼 智文[1], 東 利晃[1], 中島 義賢[1], 花尻 達郎[1]	1.東洋大 バイオナノ研
	10:15 - 10:30		休憩/Break		
	10:30 - 10:45	14a-D6-6	ウェアラブル皮膚アセトン測定の実現に向けたゼオライトの評価	○山田 祐樹[1,2], 檜山 聡[2], 豊岡 継泰[2], 竹内 昌治[3], 板橋 慶治[1], 大久保 達也[1], 田畑 仁[1]	1.東大工, 2.NTTドコモ, 3.東大生研
	10:45 - 11:00	14a-D6-7	ウェーハスケール厚膜ポリマー・マイクロ流路のための感光性接着材	○稗田 克彦[1], 宮崎 智和[1], 窪 寛仁[1], 西村 功[1], Peeters Sara[2], Van Roosbroeck Ruben[2]	1.JSR, 2.JSR Micro NV
	11:00 - 11:15	14a-D6-8	住環境中ダニアレルゲンのon-site計測のためのSAW免疫センサ	○三木 大輔[1], 吉村 直之[2], 當麻 浩司[1], 宮島 久美子[3], 荒川 貴博[1], 谷津田 博美[4], 三林 浩二[1]	1.医科歯科大, 2.日本無線, 3.学振特研PD, 4.OJ-Bio
	11:15 - 11:30	14a-D6-9	リアルタイムマイクロ波マンモグラフィの開発	○木村 建次郎[1], 向殿 麦[1], 木村 憲明[2], 三木 万由子[3], 高尾 信太郎[3]	1.神戸大院理, 2.IGI, 3.兵庫県立がんセンター
	11:30 - 11:45	14a-D6-10	磁気共鳴法によるアスコルビン酸ラジカルの分子イメージング	○伊藤 慎治[1], 兵藤 文紀[1]	1.九大レドックスナビ
	11:45 - 12:00	14a-D6-11	蝸牛基底膜の振動センシング	白石 梓[1], 今野 英明[2], ○高橋 伸幸[2]	1.ユニアデックス, 2.北教大函

13 半導体 / Semiconductors

13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション / Fundamental properties, surface and interface, and simulations of Si related materials
口頭講演

3月11日(水) 9:00 - 12:30

招待	9:00 - 9:15	11a-A27-1	**「講演奨励賞受賞記念講演」(15分) 半導体プロセスを用いたナノギャップ電極の作製及びその電気特性**	**○吉水 康人[1], 田中 裕介[1], 冨田 寛[1]**	**1.東芝**
	9:15 - 9:30	奨 11a-A27-2	回転白金電極を用いるSiC基板の平坦化	○赤井 智喜[1], 今村 健太郎[1], 小林 光[1]	1.阪大産研
	9:30 - 9:45	奨 11a-A27-3	高Ge濃度SiGeにおけるフォノン変形ポテンシャルの導出	○武内 一真[1], 小瀬村 大亮[1], 山本 章太郎[1], 富田 基裕[1,3], 臼田 宏治[2], 小椋 厚志[1]	1.明治大理工, 2.産総研 GNC, 3.学振特別研究員 DC
	9:45 - 10:00	奨 11a-A27-4	高Ge濃度歪SiGeメサ構造に印加された異方性2軸応力評価	○山本 章太郎[1], 武内 一真[1], 富田 基裕[1,3], 小瀬村 大亮[1], 臼田 宏治[2], 小椋 厚志[1]	1.明治大理工, 2.産総研GNC, 3.学振特別研究員DC
	10:00 - 10:15	奨 11a-A27-5	EBSP法を用いた微細な全Ge濃度域における歪SiGeメサ構造に生じる応力緩和分布の評価	○(D)富田 基裕[1,2], 小瀬村 大亮[1], 臼田 宏治[3], 小椋 厚志[1]	1.明大理工, 2.学振特別研究員DC, 3.産総研GNC

	10:15 - 10:30	奨 11a-A27-6	シリコンナノ粒子による水の分解と水素濃度	○松田 真輔[1], 小林 悠輝[1], 赤井 智喜[1], 今村 健太郎[1], 小林 光[1]	1.阪大産研
	10:30 - 10:45		休憩/Break		
	10:45 - 11:00	奨 11a-A27-7	局在プラズモン共鳴を用いたラマン分光法におけるひずみSi表面のAg粒子被覆率と信号増強の関係	○木嶋 隆浩[1], 山本 章太郎[1], 横川 凌[1], 武内 一真[1], 村上 達美[1], 小瀬村 太亮[1], 小椋 厚志[1]	1.明大理工
	11:00 - 11:15	奨・E 11a-A27-8	Band Bending Model Reproducing Si(111) Hole Subband Levels Measured by ARPES	○Idayu Nur[1], Sakura Nishino Takeda[1], Takeshi J. Inagaki[1], Hiroshi Daimon[1]	1.NAIST
	11:15 - 11:30	奨 11a-A27-9	二光子吸収過程を用いたレーザーによるソフトエラーシミュレーションの再現性	○井辻 宏章[1,2], 小林 大輔[1,2], 廣瀬 和之[1,2]	1.東大院工, 2.JAXA宇宙研
	11:30 - 11:45	奨 11a-A27-10	トンネルFETのシングルイベント耐性評価	○呉 研[1], 山本 航汰[1], 家城 大輔[1], 高橋 芳浩[1]	1.日大理工
	11:45 - 12:00	奨 11a-A27-11	電界効果型マイクロウォール太陽電池の膜厚依存性	○(M1)大木 康平[1], 若宮 彰太[1], 部家 彰[1], 松尾 直人[1]	1.兵庫県立大学院工
	12:00 - 12:15	11a-A27-12	Si量子ドット多重集積構造の電界電子放出特性評価	○竹内 大智[1], 牧原 克典[1], 大田 晃生[2], 池田 弥央[3], 宮崎 誠一[1]	1.名大院工, 2.名大VBL, 3.広大院先端研
	12:15 - 12:30	11a-A27-13	P添加がGeコアSi量子ドットのPL特性に及ぼす影響	○近藤 圭悟[1], 牧原 克典[1], 宮崎 誠一[1]	1.名大院工
	3月12日(木) 10:00 - 12:30				
	10:00 - 10:15	12a-A27-1	Si表面平坦化の熱処理雰囲気依存性	○工藤 聡也[1], Atthi Nithi[1], 大見 俊一郎[1]	1.東工大
	10:15 - 10:30	12a-A27-2	NO_2を用いたSi系材料の低速ケミカルドライエッチング中の表面反応	○田嶋 聡美[1], 林 俊雄[1], 石川 健治[1], 関根 誠[1], 堀 勝[1]	1.名大院工
	10:30 - 10:45	12a-A27-3	Cuアシスト無電解エッチングによるSiナノワイヤの作製と評価	○高橋 翔平[1], 安達 定雄[1]	1.群馬大学
	10:45 - 11:00	12a-A27-4	Zr Lα線源を用いたAESによるSiO_2/Si界面構造の評価	○天野 裕士[1,2], 小林 大輔[2], 野平 博司[1], 廣瀬 和之[2]	1.東京都市大工, 2.宇宙研
	11:00 - 11:15	12a-A27-5	純水中極微量金属によるウエーハ汚染	○中津 正人[1]	1.三重富士通ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰ
	11:15 - 11:30		休憩/Break		
	11:30 - 11:45	12a-A27-6	QSSPCライフタイム測定におけるトラッピング効果の補正方法	○中山 明[1], 吉川 博道[1]	1.京セラ
	11:45 - 12:00	12a-A27-7	SSRMによる不純物揺らぎ測定の検討	○松沢 一也[1], 板井 翔吾[1], 小野 瑞城[1], 石原 貴光[1], 張 利[1]	1.東芝研究開発センター
	12:00 - 12:15	12a-A27-8	非線形誘電率顕微鏡法による低濃度ドーパントプロファイル評価	○広田 潤[1], 鷹野 正宗[1], 竹野 史郎[1], 赤堀 浩史[1], 茅根 慎通[2], 長 康雄[2]	1.東芝S&S社, 2.東北大通研
	12:15 - 12:30	12a-A27-9	深紫外レーザーを用いたレーザー補助3次元アトムプローブの検討	○金野 晃之[1], 大久保 忠勝[2], 富田 充裕[1], 宝野 和博[2]	1.東芝研究開発センター, 2.物質・材料研究機構
	3月12日(木) 14:00 - 18:00				
招待	14:00 - 14:15	12p-A27-1	**「講演奨励賞受賞記念講演」(15分) 酸化被膜型Siナノワイヤにおける熱伝導率低下の起源に関する原子論的考察**	**○図師 知文[1,3], 大毛利 健治[2], 山田 啓作[2], 渡邉 孝信[1]**	**1.早大理工, 2.筑波大, 3.学振特別研究員DC2**
	14:15 - 14:30	12p-A27-2	波付きシリコン量子細線における音響フォノンとその熱輸送	○服部 淳一[1], ウラジーミル ポポルチー[1], 多田 哲也[1]	1.産総研
	14:30 - 14:45	E 12p-A27-3	Atomistic phonon study of Hydrogen-terminated extremely thin silicon films	○Manoharan Muruganathan[1], Hiroshi Mizuta[1,2]	1.JAIST, 2.Univ. of Southampton
	14:45 - 15:00	12p-A27-4	BおよびPをドープしたSi量子ドットの電子状態 ～不純物準位のドーパント位置依存性～	○金田 千穂子[1]	1.富士通研
	15:00 - 15:15	12p-A27-5	SiO_2/Si構造中における金属原子の安定性に関する第一原理解析	○(M2)柴田 大生[1]	1.岡山県立大学情報工
	15:15 - 15:30	12p-A27-6	金属/Ge界面における点欠陥の理論:MIGSの役割に関する第一原理的検討	○佐々木 奨悟[1], 中山 隆史[1]	1.千葉大理
	15:30 - 15:45		休憩/Break		
	15:45 - 16:00	12p-A27-7	次世代TCAD(1) 第一原理計算を用いた4H-SiC中の格子欠陥準位と形成エネルギーの評価	○加藤 信彦[1], 岡崎 一行[1], 小池 秀耀[1]	1.(株)アドバンスソフト
	16:00 - 16:15	12p-A27-8	次世代TCAD(2) 3次元デバイスシミュレータによるCMOSインバータチェーンの一括過渡解析	○原田 昌紀[1], 桑原 匠史[1], 大倉 康幸[1], 山口 憲[1], 小池 秀耀[1]	1.アドバンストソフト
	16:15 - 16:30	12p-A27-9	次世代TCAD(3) 台形チャネルSi-nMOSFETの耐圧特性解析	○山田 吉宏[1], 大倉 康幸[1], 山口 憲[1], 小池 秀耀[1]	1.アドバンスソフト株式会社
	16:30 - 16:45	12p-A27-10	簡易SBDモデルによるデバイス回路混合シミュレーション	○松沢 一也[1], 阿部 真利[1], 小田 嘉則[1], 小町 潤[1], 伊藤 浩之[1], 秋山 豊[1]	1.STARC
	16:45 - 17:00	12p-A27-11	領域分割半導体デバイスシミュレーションの収束ループの検討	○福田 浩一[1], 服部 淳一[1], 越本 浩央[1], 池上 努[1]	1.産総研
	17:00 - 17:15	12p-A27-12	超高速撮像素子におけるアバランシェ増倍効果のシミュレーション解析	○南谷 夏海[1], Dao Vu Truong Son[2], 下ノ村 和弘[2], 江藤 剛治[2], 鎌倉 良成[1]	1.阪大工, 2.立命館理工
	17:15 - 17:30	12p-A27-13	放射線衝突に伴う不揮発メモリのソフトエラーに関するシミュレーション	○脇村 豪[1], 鎌倉 良成[1]	1.阪大院工
	17:30 - 17:45	12p-A27-14	SOI-MOSFETにおける重イオン照射誘起寄生バイポーラ効果	○(M1C)山本 航汰[1], 家城 大輔[1], 呉 研[1], 高橋 芳浩[1]	1.日大理工
	17:45 - 18:00	12p-A27-15	放射線による局所昇温現象を考慮したソフトエラーシミュレーションの適用可能性	○小林 大輔[1,2], 伊藤 大智[1], 廣瀬 和之[1,2]	1.JAXA宇宙研, 2.東大院工

13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション / Fundamental properties, surface and interface, and simulations of Si related materials
ポスター講演

	3月13日(金) 16:30 - 18:30				
		13p-P16-1	Al,Nを添加したSiの構造安定性と電子状態	○屋山 巴[1], 知京 豊裕[1]	1.物材機構
		13p-P16-2	アニール条件がGe表面の原子スケールのモフォロジーに与える影響	○森田 行則[1], 太田 裕之[1], 昌原 明植[1], 前田 辰郎[1]	1.産総研
		13p-P16-3	Ga-In-O薄膜のウェットエッチングプロセス検討	○(B)吉田 邦晃[1], 藤岡 秀平[1], 後藤 良介[1], 尾沼 猛儀[1,2], 永井 裕己[1], 山口 智広[1], 本田 徹[1]	1.工学院大工, 2.東京高専

		13p-P16-4	太陽電池用バイパスダイオードに自己バイアスチャネルMOSダイオードを用いた時の電気的特性の検討	○山田 大輔[1], 工藤 嗣友[1], 菅原 文彦[2]	1.神奈川工大, 2.東北学

13.2 探索的材料物性・基礎物性 / Exploratory Materials, Physical Properties, Devices　ポスター講演

3月12日(木)　13:30 - 15:30

		12p-P8-1	三元系Siクラスレート$K_8Al_7Si_{39}$の合成と物性	シン シバ クマール[1], ○今井 基晴[1]	1.物材機構
		12p-P8-2	β-$FeSi_2$(010)//Si(110)エピタキシャル膜における偏光ラマンスペクトル	○(M1C)山口 陽己[1], 尾方 済人[1], 塚本 裕明[1], 草原 彰吾[1], 服部 哲[1], 東 貴彦[1], 秋山 賢輔[2], 寺井 慶和[1]	1.鹿児島大理工, 2.神奈川産技セ
		12p-P8-3	SiGe(111)上へのβ-$FeSi_2$エピタキシャル成長とひずみの評価	○塚本 裕明[1], 草原 彰吾[1], 山口 陽己[1], 尾方 済人[1], 服部 哲[1], 東 貴彦[1], 寺井 慶和[1]	1.鹿児島大理工
		12p-P8-4	スパッタリング法によるβ-$FeSi_2$多結晶薄膜の伝導型制御	○(M1C)服部 哲[1], 三村 祐介[1], 東 貴彦[1], 中山 翔太[1], 塚本 裕明[1], 山口 陽己[1], 寺井 慶和[1]	1.鹿児島大理工
		12p-P8-5	単相高マンガンシリサイドの結晶性と熱電特性	○陣場 成行[1], 飯岡 優[1], 板倉 賢[2], 鵜殿 治彦[1]	1.茨城大院, 2.九州大院
		12p-P8-6	簡易合成法で合成したMg_2Si結晶の成長速度による結晶性への影響	○岡崎 大[1], 山口 桂汰[1], 鵜殿 治彦[1]	1.茨城大院
		12p-P8-7	ウェットエッチングによるメサ型Mg_2Si pn接合ダイオードの作製	○秋山 智洋[1], 大徳 健太[1], 堀 信彦[1], 鵜殿 治彦[1]	1.茨城大工
		12p-P8-8	溶液法で合成した単相$MnSi_{1.75-x}$の電気特性評価	飯岡 優[1], ○堀 俊平[1], 陣場 成行[1], 原 嘉昭[2], 鵜殿 治彦[1]	1.茨城大, 2.茨城高専
		12p-P8-9	イオンビームスパッタ蒸着法を用いたEr_2O_3膜の作製における照射イオン種の効果	○藤田 将弥[1,2], 山口 憲司[2], 朝岡 秀人[2], 毛偉[3], 近田 拓未[4], 鈴木 晶大[3], 寺井 隆幸[3]	1.茨城大理, 2.原子力機構, 3.東京大, 4.静岡大
		12p-P8-10	アモルファス窒化炭素薄膜の作製I	○内島 一哉[1], 佐竹 聖樹[2], 中村 重之[3], 財部 健一[4], 福井 一俊[5], 伊藤 國雄[1], 山本 伸一[1]	1.龍谷大理工, 2.明石高専, 3.津山高専, 4.岡山理大, 5.福井大学
		12p-P8-11	光デバイスに向けた金属薄膜を用いたZnO多層薄膜の研究	○西羅 涼[1], 山本 伸一[1]	1.龍谷大理工
		12p-P8-12	$BiVO_4$薄膜における表面状態の評価	○久保 勇翔[1], 山本 伸一[1], 西谷 幹彦[2]	1.龍谷大理工, 2.大阪大工
		12p-P8-13	コヒーレントフォノン分光法によるカーボンナノチューブ混合溶液のカイラリティ同定	○(M1)許 人杰[1], 片山 郁文[1], 南 康夫[1], 北島 正弘[1,2,3], 柳 和宏[4], 武田 淳[1]	1.横国大工, 2.防衛大理工, 3.ルクスレイ株式会社, 4.首都大学東京理工
		12p-P8-14	金属偏析予測システムSurfSegへの拡散温度予測の追加	○吉武 道子[1]	1.物材機構

13.2 探索的材料物性・基礎物性 / Exploratory Materials, Physical Properties, Devices　口頭講演

3月13日(金)　9:00 - 12:30

招待	9:00 - 9:15	13a-A25-1	**「講演奨励賞受賞記念講演」(15分) Mg2Si pn接合ダイオードのAg拡散係数評価と拡散深さ制御**	**○堀 信彦[1], 江坂 文孝[2], 鵜殿 治彦[1]**	**1.茨城大院, 2.原子力機構**
	9:15 - 9:30	13a-A25-2	リング電極Mg_2Si フォトダイオードにおけるメサ構造の形成	○大徳 健太[1], 堀 信彦[1], 谷川 俊太郎[2], 津谷 大樹[2], 鵜殿 治彦[1]	1.茨城大院, 2.物材機構
	9:30 - 9:45	13a-A25-3	Mg/Si薄膜積層構造により作製したMg_2Si膜の物性評価	○長谷川 明紀[1], 角嶋 邦之[2], 片岡 好則[2], 西山 彰[2], 杉井 信之[2], 若林 整[2], 筒井 一生[2], 名取 研二[1], 岩井 洋[1]	1.東工大フロンティア研, 2.東工大総理工
	9:45 - 10:00	13a-A25-4	液体封止VGF法によるMg_2Siバルク結晶成長	○中川 玲緒[1], 和田 大輝[1], 勝俣 裕[1], 櫻木 史郎[2], 橋本 哲[2]	1.明大理工, 2.ユニオンマテリアル(株)
	10:00 - 10:15	13a-A25-5	SPS法で作製したNi-Mg_2Si界面の断面TEM観察 (2)	○菅原 宏治[1], 山崎 由布紀[1], 中村 新一[2], 中村 重之[3], 森 嘉久[4], 財部 健一[4]	1.首都大SD, 2.青山学院大, 3.津山高専, 4.岡山理科大
	10:15 - 10:30	13a-A25-6	Mg_2Siの構造欠陥の合成圧力依存性についての考察	○今井 庸二[1], 森 嘉久[2], 中村 重之[3], 財部 健一[2]	1.産総研, 2.岡山理大, 3.津山高専
	10:30 - 10:45		休憩/Break		
	10:45 - 11:00	13a-A25-7	AuコートSi上に合成した鉄シリサイドのPL発光特性	○秋山 賢輔[1,2], 舟窪 浩[2]	1.神奈川産技セ, 2.東京工業大
	11:00 - 11:15	13a-A25-8	β-$FeSi_2$多結晶薄膜における電気伝導機構の検証	○(M1C)東 貴彦[1], 中山 翔太[1], 服部 哲[1], 三村 祐介[1], 塚本 裕明[1], 山口 陽己[1], 寺井 慶和[1]	1.鹿児島大理工
	11:15 - 11:30	13a-A25-9	共スパッタリング法によるアモルファスSi/β-$FeSi_2$複合薄膜の形成	○(M1)澤田 真志[1], 中沢 公大[1], 勝俣 裕[1]	1.明大理工
	11:30 - 11:45	13a-A25-10	リモート水素プラズマ支援によるFeシリサイドナノドットの高密度一括形成と磁化特性評価	○張 海[1], 牧原 克典[1], 大田 晃生[2], 壁谷 悠希[1], 宮崎 誠一[1]	1.名大院工, 2.名大VBL
	11:45 - 12:00	13a-A25-11	パルスレーザー堆積法で作製した$(Mn,Fe)Si_{\sim 1.7}$ 薄膜のバンドギャップ	○(B)石井 健太郎[1], 林 慶[1], 宮崎 讓[1]	1.東北大工
	12:00 - 12:15	E 13a-A25-12	Growth of $CaSi_2$ layers on Si substrates induced by Kirkendall void formation	Xiang Meng[1], Akiko Ueki[2], Haruo IMAGAWA[2], Hiroshi ITAHARA[2], ○Hirokazu Tatsuoka[3]	1.Graduate School of Science and Technology, Shizuoka Univ., 2.Toyota Central R&D Labs., Inc., 3.Graduate School of Engineering, Shizuoka Univ.
	12:15 - 12:30	13a-A25-13	キセノンイオンを注入したシリコンのアニールによる構造変化 II	○北川 淳嗣[1], 藤田 詩織[1], 羽渕 仁恵[1], 飯田 民夫[1], 大橋 史隆[2], 伴 隆幸[2], 久米 徹二[2], 野々村 修一[2]	1.岐阜高専, 2.岐大工

3月13日(金)　16:15 - 19:15

	16:15 - 16:30	奨 13p-A25-1	Na-Al-Sn系新規化合物の合成と結晶構造および電気的特性	○(M1)菅野 雅博[1], 山田 高広[1], 山根 久典[1]	1.東北大多元研
	16:30 - 16:45	奨 13p-A25-2	Siクラスレート薄膜のNa含有量と結晶歪みのヨウ素処理依存性	○(M1)竹下 博高[1], 境 健太郎[2], 原口 智宏[1], 鈴木 秀俊[1], 大橋 史隆[1], 久米 徹二[1], 福山 敦彦[1], 野々村 修一[1], 碇 哲雄[1]	1.宮崎大工, 2.宮崎大産・地連セ, 3.岐大工
	16:45 - 17:00	13p-A25-3	Na内包II型Siクラスレート前駆体膜作製条件の最適化	○野村 政貴[1], 野口 明宏[1], 阪上 真史[1], 大橋 史隆[1], 久米 徹二[1], 伴 隆幸[1], 野々村 修一[1]	1.岐大院工
	17:00 - 17:15	13p-A25-4	II型Siクラスレート薄膜に含まれる不純物の評価および低減	○上原 康暉[1], 砂場 昭吾[1], 浦野 和俊[1], 大橋 史隆[1], 久米 徹二[1], 伴 隆幸[1], 山家 光男[1], 野々村 修一[1]	1.岐大院工
	17:15 - 17:30	13p-A25-5	スパッタ膜を用いた透明基板上へのII型Geクラスレート膜の作製	○萬條 宏行[1], 船戸 一平[1], 向井 哲也[1], 大橋 史隆[1], 伴 隆幸[1], 久米 徹二[1], 野々村 修一[1]	1.岐大院工
	17:30 - 17:45	13p-A25-6	W内包Siクラスターを凝集したシリサイド半導体薄膜の電気伝導特性	○岡田 直也[1,2], 内田 紀行[2], 金山 敏彦[2]	1.JSTさきがけ, 2.産総研

	17:45 - 18:00	13p-A25-7	Bi 原子細線をドーパント源とするSi 結晶中へのBi δ ドーピング法：キャリア輸送特性評価	○三木 一司[1,2], 金澤 孝[1,2], 村田 晃一[1,2], 日塔 光一[1]	1.物材機構, 2.筑波大数物
	18:00 - 18:15	13p-A25-8	界面ナノ構造を利用したIV族半導体へのMnδドーピング：機構解明	村田 晃一[1,2], ○三木 一司[1,2], 新田 清文[3], 金澤 孝[1,2], 坪松 悟史[1,2], 日塔 光一[1], 坂田 修身[1], 寺田 靖子[3], 宇留賀 朋哉[3]	1.物材機構, 2.筑波大数物, 3.JASRI
	18:15 - 18:30	奨 13p-A25-9	希薄磁性半導体超格子GaGdAs/GaAsへのSiドープが及ぼす影響	○大西 吉行[1], 山野 高史[1], 行廣 克成[1], 原田 優[1], 宮川 勇人[1], 小柴 俊[1], 中西 俊介[1], 橋本 光博[2], 高橋 敏男[2]	1.香川大工, 2.東大物性研
	18:30 - 18:45	13p-A25-10	$Mn_{3-x}Co_xO_4$の磁気相図と新奇な物性	○平井 慈人[1], 山田 幾也[2], 八木 俊介[2], 神原 陽一[3], 的場 正憲[3]	1.高圧先進科研中心, 2.大府大21NRC, 3.慶大理工
	18:45 - 19:00	13p-A25-11	ナノアモルファス窒化炭素を用いたRe炭窒化物の高温高圧合成	○安井 望[1], 財部 健一[1], 岡田 卓[2], 山崎 大輔[3], 大藤 弘明[4], 小島 洋平[4]	1.岡山理大理, 2.東大物性研, 3.岡大地球研, 4.愛媛大GRC
	19:00 - 19:15	13p-A25-12	A型希土類構造とC型希土類構造の混晶系のラマン散乱	○知花 優太郎[1], 山中 明生[1]	1.千歳科学技術大学
	3月14日(土) 9:00 - 12:00				
	9:00 - 9:15	E 14a-A25-1	Formation of MoO3/n-BaSi2 heterojunctions for solar cell applications	○Weijie Du[1], Masakazu Baba[1], Ryota Takabe[1], Hiroki Takeuchi[1], Daichi Tsukahara[1], Kaoru Toko[1], Noritaka Usami[2,3], Takashi Suemasu[1,3]	1.Univ. of Tsukuba, 2.Nagoya Univ., 3.JST-CREST
	9:15 - 9:30	14a-A25-2	MBE法で形成した$BaSi_2$エピタキシャル膜/酸化膜界面の欠陥準位評価	○武内 大樹[1], Du Weijie[1], 高部 涼太[1], 都甲 薫[1], 原 康祐[2], 宇佐美 徳隆[3,4], 末益 崇[1,4]	1.筑波大学院, 2.山梨大学, 3.名古屋大学, 4.JST-CREST
	9:30 - 9:45	奨 14a-A25-3	$BaSi_2$ domain boundary の最安定構造及び界面特性についての考察	○馬場 正和[1], 香山 正徳[2], 都甲 薫[1], 末益 崇[1,3]	1.筑波大院数理, 2.産総研ユビキタス, 3.JST-CREST
	9:45 - 10:00	14a-A25-4	多結晶Si上に成長した$BaSi_2$薄膜表面のKFM法によるポテンシャル分布評価	○李 云鵬[1], 馬場 正和[1], 沼田 涼平[1], 都甲 薫[1], 宇佐美 徳隆[2,4], 関口 隆史[3], 末益 崇[1,4]	1.筑波大, 2.名大, 3.物材研, 4.JST-CREST
	10:00 - 10:15	14a-A25-5	KFM法によるバイアス印加時Si(111)基板上$BaSi_2$ pn接合におけるポテンシャル観察	○塚原 大地[1], 馬場 正和[1], 都甲 薫[1], 渡辺 健太郎[1,2], 関口 隆史[2], 末益 崇[1,3]	1.筑波大数理, 2.物材機構, 3.JST-CREST
	10:15 - 10:30	14a-A25-6	RFスパッタ法により作製した$BaSi_2$薄膜表面の粒界ポテンシャル評価	○(B)横山 晟也[1], Nurul A. A. Latiff[1], 馬場 正和[1], 李 云鵬[1], 召田 雅実[2], 倉持 豪人[2], 都甲 薫[1], 末益 崇[1,3]	1.筑波大院 電子・物理工学専攻, 2.東ソー株式会社, 3.JST-CREST
	10:30 - 10:45		休憩/Break		
	10:45 - 11:00	14a-A25-7	$BaSi_2$における不純物原子拡散と固溶度の理論検討	○(M1)大須賀 祐喜[1], 中山 隆史[1]	1.千葉大理
	11:00 - 11:15	14a-A25-8	希少元素フリーSnS/$BaSi_2$太陽電池の提案と数値シミュレーション	○原 康祐[1,2], 末益 崇[2,3], 宇佐美 徳隆[2,4]	1.山梨大クリスタル研, 2.JST-CREST, 3.筑波大院数理物質, 4.名大院工
	11:15 - 11:30	14a-A25-9	真空蒸着法による導電性基板上への $BaSi_2$薄膜の作製	○(B)須原 貴道[1], 原 康祐[2,3], 末益 崇[2,4], 宇佐美 徳隆[1,2]	1.名古屋大, 2.JST-CREST, 3.山梨大, 4.筑波大
	11:30 - 11:45	14a-A25-10	真空蒸着法により作製した$BaSi_2$薄膜の膜厚による影響	○中川 慶彦[1], 原 康祐[2,3], 末益 崇[3,4], 宇佐美 徳隆[1,3]	1.名大工, 2.山梨大, 3.JST-CREST, 4.筑波大
	11:45 - 12:00	14a-A25-11	SnS/$BaSi_2$ヘテロ接合太陽電池に向けた真空蒸着法によるSnS薄膜作製	○鈴木 慎太郎[1], 須原 貴道[1], 原 康祐[2,3], 末益 崇[3,4], 宇佐美 徳隆[1,3]	1.名大工, 2.山梨大クリスタル研, 3.JST-CREST, 4.筑波大
	3月14日(土) 13:00 - 14:00				
	13:00 - 13:15	14p-A25-1	アンモニアプロセスを用いた$BaSi_2$薄膜の合成と評価	○関口 隆史[1,2], 山根 久典[3], 陳 君[1], 渡辺 健太郎[1,2], 末益 崇[2]	1.物材機構, 2.筑波大数理, 3.東北大多元研
	13:15 - 13:30	14p-A25-2	固相成長テンプレートを用いたGe(111)基板上への$BaSi_2$ 膜作製	○高部 涼太[1], 原 康祐[2], 都甲 薫[1], 宇佐美 徳隆[3,4], 末益 崇[1,4]	1.筑波大電物, 2.山梨大学, 3.名古屋大学, 4.JST-CREST
	13:30 - 13:45	奨・E 14p-A25-3	Fabrication of $Ba(Si,C)_2$ films on Si(111) by plasma-assisted molecular beam epitaxy	○(B)JAEJUN LEE[1], HIROKI TAKEUCHI[2], RYOTA TAKABE[2], KAORU TOKO[1,2], TAKASHI SUEMASU[1,2,3]	1.Coll. of engineering sciences, Univ. of Tsukuba, 2.Inst. of Applied Physics, Univ. of Tsukuba, 3.JST-CREST
	13:45 - 14:00	14p-A25-4	$Ba_{1-x}Sr_xSi_2$の結晶構造	○今井 基晴[1], 松下 能孝[1]	1.物材機構

13.3 絶縁膜技術 / Insulator technology　ポスター講演

	3月12日(木) 9:30 - 11:30				
		12a-P12-1	MONOS型メモリにおける絶縁膜中の原子欠陥に関する第一原理計算	○白川 裕規[1], 洗平 昌晃[2], 神谷 克政[3], 白石 賢二[2]	1.筑波大院数理, 2.名大院工, 3.神奈工大
		12a-P12-2	定電流キャリヤ注入法を用いたMONOS構造の正孔捕獲特性の評価	○(M1)田中 伸[1], 内藤 慎二[1], 小林 清輝[1]	1.東海大院工
		E 12a-P12-3	Charge retention characteristics of charge trapping nonvolatile memories with silicon carbonitride (SiCN) dielectrics	○(D)SheikhRashel Ahmed[1], Shinji Naito[2], Hironori Shibayama[3], Jyunya Nakamura[3], Kyoteru Kobayashi[1,2,3]	1.GRAD SCH S&T, Tokai Univ, 2.GRAD SCH Eng, Tokai Univ, 3.SCH Eng, Tokai Univ.
		12a-P12-4	酸化剤を変えたALD-Al_2O_3膜のMOSキャパシタの特性評価	○福井 僚[1], 中村 嘉基[1], 角嶋 邦之[2], 片岡 好則[2], 西山 彰[2], 杉井 信之[2], 若林 整[2], 筒井 一生[2], 名取 研二[1], 岩井 洋[1]	1.東工大フロンティア研, 2.東工大総理工
		12a-P12-5	欠損を含むシリコン酸化膜中のアンモニア分子の透過	○奥 友希[1], 戸塚 正裕[1], 志賀 俊彦[1], 渡辺 斉[1]	1.三菱電機 波光電
		E 12a-P12-6	Improvement of Electrical Properties of InGaAs MOS Interfaces by Inserting La Oxide Interfacial Layers into InGaAs Gate Stacks	○(D)ChihYu Chang[1,3], Osamu Ichikawa[2,3], Takenori Osada[2,3], Hisashi Yamada[2,3], Mitsuru Takenaka[1,3], Shinichi Takagi[1,3]	1.The Univ. of Tokyo, 2.Sumitomo Chemical, 3.JST-CREST
		12a-P12-7	Radical-Enhanced ALD法によるGe基板上Alジャーマネイトの形成機構に関する検討	横平 知也[1], ○梁池 昂生[1], 柳 炳學[2], 山本 千綾[2], 山中 淳二[2], 佐藤 哲也[2], 岡本 浩[3], 福田 幸夫[1]	1.諏訪東京理科大学, 2.山梨大学, 3.弘前大学

13.3 絶縁膜技術 / Insulator technology　口頭講演

	3月13日(金) 9:00 - 12:30				
	9:00 - 9:15	E 13a-A24-1	Passivation of silicon surfaces by heat treatment in liquid water at 110°C	○Tomohiko Nakamura[1], Toshiyuki Sameshima[1], Masahiko Hasumi[1], Tomohisa Mizuno[2]	1.TUAT, 2.Kanagawa Univ.
	9:15 - 9:30	13a-A24-2	高圧水蒸気中における陽極酸化法により成膜したSiO_2膜の特性評価	○(M1C)手原 大貴[1], 尾和瀬 智成[1], 呉 研[1], 高橋 芳浩[1]	1.日大理工
	9:30 - 9:45	13a-A24-3	低温Kr/O_2プラズマ酸化法によるSiO_2/Si構造の作製および評価	○藤川 雄太[1], 岩崎 好孝[1], 上野 智雄[1]	1.農工大工

	9:45 - 10:00	13a-A24-4	Multi-Phonon遷移を考慮したSmall-PolaronのVariable Range Hopping	○宝玉 充[1], 谷本 弘吉[1], 青木 伸俊[1], 石丸 一成[1]	1.東芝セミコンダクター&ストレージ社
	10:00 - 10:15	13a-A24-5	XANES から推定したSiO_2/Si 界面の物性評価	○森谷 真帆[1,2], 小林 大輔[2], 山本 知之[1], 廣瀬 和之[2]	1.早大理工, 2.宇宙科学研究所
	10:15 - 10:30	13a-A24-6	SiC MOSキャパシタのTZDB測定時動画撮影による絨毯爆撃状破壊痕形成メカニズムの解明	○佐藤 創志[1], 廣井 佑紀[2], 山部 紀久夫[2], 北畠 真[3], 遠藤 哲郎[1,4,5], 丹羽 正昭[1]	1.東北大CIES, 2.筑波大院, 3.FUPET, 4.東北大CSIS, 5.東北大院工
	10:30 - 10:45	E 13a-A24-7	Effectiveness of surface potential fluctuation for representing inversion-layer mobility limited by Coulomb scattering in MOSFETs	○(D)Weili Cai[1,2], Mitsuru Takenaka[1,2], Shinichi Takagi[1,2]	1.Tokyo Univ., 2.JST CREST
	10:45 - 11:00		休憩/Break		
	11:00 - 11:15	奨 13a-A24-8	水蒸気を用いたプラズマ誘起原子層堆積法によるAl_2O_3膜の絶縁特性改善	○梅原 智明[1], 堀田 昌宏[1], 吉嗣 晃治[1], 石河 泰明[1], 浦岡 行治[1]	1.奈良先端大
	11:15 - 11:30	13a-A24-9	分子動力学法によるhigh-k/SiO_2界面のダイポール形成シミュレーション(2) −酸素密度緩和モデルで説明できないMgO/SiO_2界面ダイポールの再現−	○功刀 遼太[1], 橋口 誠広[1], 志村 昂亮[1], 小椋 厚志[3,5], 佐藤 真一[4,5], 渡邉 孝信[1,2,5]	1.早大理工, 2.早大ナノ機構, 3.明大理工, 4.兵庫県立大, 5.JST-CREST
	11:30 - 11:45	13a-A24-10	3次元アトムプローブ法によるAl_2O_3膜中の水素分布評価	○清水 康雄[1], 韓 斌[1], 井上 耕治[1], 矢野 史子[2], 井上 真雄[3], 国宗 依信[4], 島田 康弘[4], 片山 俊治[4], 井手 隆[4], 永井 康介[1]	1.東北大金研, 2.東京都市大, 3.ルネサス, 4.ルネサスセミコンダクタマニュファクチュアリング
	11:45 - 12:00	奨・E 13a-A24-11	Patterning of High-k/metal gate Stack by Neutral Beam Etching Technique for Sub-20 nm CMOS Technology	○YinHsien Su[1,2], JiaNan Shih[1], Tomohiro Kubota[2], WenHsi Lee[1], YingLang Wang[3], Seiji Samukawa[2]	1.National Cheng Kung Univ., 2.Tohoku Univ., 3.TSMC
	12:00 - 12:15	E 13a-A24-12	In-situ Formation of HfN_x Gate Stack Structures Utilizing ECR Plasma Sputtering	○Atthi Nithi[1], Shun-ichiro Ohmi[1]	1.Tokyo Inst. of Tech.
	12:15 - 12:30	13a-A24-13	TiN/HfO_2/TiN構造におけるHfO_2膜の強誘電的特性	○西村 知紀[1], 矢嶋 赳彬[1], 鳥海 明[1]	1.東大院工
	3月14日(土) 9:00 - 12:15				
	9:00 - 9:15	14a-A24-1	CVD法を用いたGeO_2/Ge構造の作製と評価	○小倉 大輝[1], 岩崎 好孝[1], 上野 智雄[1]	1.東京農工大工
	9:15 - 9:30	14a-A24-2	Hf-Post Metallization AnnealingによるGeO$_2$/Ge界面特性の改善効果	○新井田 淳平[1], 岩崎 好孝[1], 上野 智雄[1]	1.農工大院工
	9:30 - 9:45	14a-A24-3	低温アニールによるGeNx膜質改善	○田中 佑治[1], 岩崎 好孝[1], 上野 智雄[1]	1.農工大工
	9:45 - 10:00	14a-A24-4	プラズマ後窒化(100)面及び(110)面SiGe MOS界面の比較	○(D)韓 在勲[1,2], 竹中 充[1,2], 高木 信一[1,2]	1.東大院工, 2.JST-CREST
	10:00 - 10:15	奨 14a-A24-5	Al_2O_3/Ge構造に対する熱酸化にともなうGe表面からのGe原子放出過程	○柴山 茂久[1,2], 中嶋 薫[3], 坂下 満男[1], 中塚 理[1], 木村 健二[3], 財満 鎭明[1,4]	1.名大院工, 2.学振特別研究員, 3.京大院工, 4.名大エコトピア
	10:15 - 10:30	14a-A24-6	ALDとECRプラズマ酸化による酸化膜固定電荷密度の制御	○永冨 雄太[1], 長岡 裕一[1], 田中 慎太郎[1], 山本 圭介[2], 王 冬[1], 中島 寛[2]	1.九大総理工, 2.九大産学連携センター
	10:30 - 10:45		休憩/Break		
	10:45 - 11:00	奨 14a-A24-7	GaSb表面の純窒化プロセスの検討	○(M2)後藤 高寛[1,2], 藤川 紗千恵[1], 藤代 博記[1], 小倉 睦郎[2], 安田 哲二[2], 前田 辰郎[1,2]	1.東理大院基礎工, 2.産総研
	11:00 - 11:15	奨 14a-A24-8	Ge上ルチル型TiO_2層へのアクセプタドープによる絶縁性向上の試み	○(B)鈴木 良尚[1], 長田 貴弘[2], 山下 良之[2], チナマトゥ パウルサミー[2], 小橋 和義[1], 生田目 俊秀[2], 小椋 厚志[1], 知京 豊裕[2]	1.明治大学, 2.物質材料研究機構
	11:15 - 11:30	14a-A24-9	原子マッチングを利用した結晶性La_2O_3 high-k/Ge(111)構造の作製	○金島 岳[1], 梶原 康裕[1], 銭高 真人[1], 山田 晋也[1], 浜屋 宏平[1]	1.阪大基礎工
	11:30 - 11:45	14a-A24-10	結晶性La_2O_3/Ge(111)における電気特性のアニール効果	○銭高 真人[1], 梶原 康裕[1], 山田 晋也[1], 浜屋 宏平[1], 金島 岳[1]	1.阪大基礎工
	11:45 - 12:00	E 14a-A24-11	Reliability-aware Germanium Gate Stack Formation by GeO_2 Network Modification	○Cimang Lu[1,2], Choong Hyun Lee[1,2], Tomonori Nishimura[1,2], Kosuke Nagashio[1,2], Akira Toriumi[1,2]	1.The Univ. of Tokyo, 2.JST-CREST
	12:00 - 12:15	奨・E 14a-A24-12	Design of High-k and Interfacial Layer on Germanium for 0.5 nm EOT	○Cimang Lu[1,2], Choong Hyun Lee[1,2], Tomonori Nishimura[1,2], Kosuke Nagashio[1,2], Akira Toriumi[1,2]	1.The Univ. of Tokyo, 2.JST-CREST

13.4 Siプロセス・配線・MEMS・集積化技術 / Si wafer processing /MEMS/Integration technology 口頭講演

3月11日(水) 9:00 - 12:30

	9:00 - 9:15	11a-A29-1	高信頼性ULSI-Cu配線用PVD-Co(W)膜の特性	○百瀬 健[1], 冨田 皓太[1], 角田 隆明[2], 中川 隆史[2], 霜垣 幸浩[1]	1.東大院工, 2.キヤノンアネルバ
	9:15 - 9:30	11a-A29-2	超臨界CO_2流体中における金属薄膜のエッチング	○(M1)中村 良輝[1], 渡邉 満洋[1], 近藤 英一[1], ミハイル バクラノフ[2]	1.山梨大, 2.IMEC
	9:30 - 9:45	11a-A29-3	Auナノチャネルのエレクトロマイグレーションによる質量輸送過程のIn-Situ AFM観察	○八木 麻実子[1], 齋藤 孝成[1], 白樫 淳一[1]	1.東京農工大学院工
	9:45 - 10:00	奨 11a-A29-4	ナノシリコン弾道電子源を用いたCu薄膜のプリンティング堆積	○須田 隆太郎[1], 八木 麻実子[1], 小島 明[1], Romain Mentek[1], 白樫 淳一[1], 越田 信義[1]	1.農工大・院・工
	10:00 - 10:15	11a-A29-5	印刷+メッキ法による低抵抗銅配線技術の開発	○徳久 英雄[1], 富田 充[1], 森田 智子[1], 伊勢 翔吾[1], 塚本 志帆[1]	1.産総研
	10:15 - 10:30	11a-A29-6	シリコンフォトニクス光集積回路におけるプロセス課題(I) 高精度加工及びプロセスモニタリング	○堀川 剛[1,2], 志村 大輔[2], 鄭 錫煥[2], 徳島 正敏[2], 木下 啓藏[2], 最上 徹[2]	1.産総研, 2.PETRA
	10:30 - 10:45	11a-A29-7	シリコンフォトニクス光集積回路におけるプロセス課題 (II) 光機能素子の集積と実装	○木下 啓藏[1], 堀川 剛[1,2], 奥村 滋一[1], 竹村 浩一[1], 清水 隆徳[1], 藤方 潤一[1], 最上 徹[1]	1.PETRA, 2.産総研
	10:45 - 11:00		休憩/Break		
	11:00 - 11:15	奨 11a-A29-8	TSV Siアイランドの集積化に向けたDeep-Trenchへの酸化物埋め込み	○浦岡 泰之[1], 大井 英生[2], 石田 誠[1,2], 河野 剛士[1]	1.豊橋技科大 電気・電子情報工学, 2.豊橋技科大 EIIRIS
	11:15 - 11:30	11a-A29-9	ミニマル装置を用いた連続プロセスでのPZT薄膜形成	○数佐 純子[1], 古賀 和博[1], 梅山 規男[1], 野田 大二[3], 扇子 義久[1,4], 千葉 貴史[1,5], 寺田 昌男[1,5], クンプアン ソマワン[1,2], 原 史朗[1,2]	1.ミニマルファブ技術研究組合, 2.産総研, 3.マイクロマシンセンター, 4.リソテック, 5.坂口電熱
	11:30 - 11:45	11a-A29-10	ミニマルBOSCHプロセス	○田中 宏幸[1], 清水 禎樹[1,2], 小木曽 久人[1,2], 中野 禅[1,2], 速水 利泰[3], 宮崎 俊也[3], 富阪 賢一[3], 手錢 永充[3], クンプアン ソマワン[1,2], 原 史朗[1,2]	1.ミニマルファブ, 2.産総研, 3.SPPテクノロジーズ
	11:45 - 12:00	11a-A29-11	ミニマル装置群によるBGAパッケージングプロセス	○居村 史人[1], 井上 道弘[2], 猿渡 新水[1,2], クンプアン ソマワン[1,2], 原 史朗[1,2]	1.ミニマルファブ, 2.産総研

	12:00 - 12:15	11a-A29-12	ミニマルダイボンディングプロセス	○寶池 広由[1], 居村 史人[1], 宮本 清治[1,2], クンプアン ソマワン[1,3], 原 史郎[1,3]	1.ミニマル, 2.石井工作研究所, 3.産総研
	12:15 - 12:30	11a-A29-13	ミニマル圧縮モールド成形プロセス	○東野 泰英[1], 居村 史人[1], 小林 一彦[2], 井上 道弘[3], 猿渡 新水[1,3], クンプアン ソマワン[1,3], 原 史郎[1,3]	1.ミニマル, 2.アピックヤマダ, 3.産総研
	3月11日(水) 14:00 - 17:30				
	14:00 - 14:15	奨 11p-A29-1	触覚、摩擦、温度センサ集積人工電子皮膚	○原田 真吾[1], 金尾 顕一朗[1], 山本 祐輝[1], 有江 隆之[1], 秋田 成司[1], 竹井 邦晴[1]	1.大阪府大
	14:15 - 14:30	奨 11p-A29-2	触覚と曲げに対する高い選択性を有した電子皮膚デバイス	○金尾 顕一朗[1], 原田 真吾[1], 山本 祐輝[1], 本田 航[1], 有江 隆之[1], 秋田 成司[1], 竹井 邦晴[1]	1.大阪府大
	14:30 - 14:45	11p-A29-3	マイクロ流路を一体化したMEMS Fabry‐Perot干渉型表面応力センサの製作	○桝屋 善光[1], 小澤 遼[1], 石田 誠[1], 澤田 和明[1,2], 髙橋 一浩[1,2]	1.豊橋技科大, 2.JST-CREST
	14:45 - 15:00	11p-A29-4	リング型PZT電極を用いたMEMS共振センサの製作	○高橋 一浩[1,2], 石田 誠[1], 澤田 和明[1,2]	1.豊橋技科大, 2.JST-CREST
	15:00 - 15:15	11p-A29-5	エネルギーハーベスティングデバイスの検討(5)	○小西 敏文[1], 山根 大輔[2], 松島 隆明[1], 益一哉[2], 年吉 洋[3], 町田 克之[1,2]	1.NTT-AT, 2.東工大, 3.東大
	15:15 - 15:30	11p-A29-6	Optical Response of Micromechanical Infrared Thermal Detector	○(PC)Jonghyeon Jeong[1], Shinya Kumagai[1,3], Ichiro Yamashita[2,3], Yukiharu Uraoka[2,3], Minoru Sasaki[1,3]	1.Toyota Technological Institute, 2.Nara Institute of Science and Technology, 3.CREST JST
	15:30 - 15:45		休憩/Break		
	15:45 - 16:00	奨 11p-A29-7	ビーズを用いたPDMS製細菌捕獲チップの検討Ⅲ- 各種細菌の蛍光強度特性の時間依存性 -	○西村 祐典[1], 林 隆平[1], 中澤 寛一[1], 石田誠[1], 澤田 和明[1], 石井 仁[1], 町田 克之[2,3], 益一哉[2], 王 常楽[4], 飯田 健一郎[4], 齋藤 光正[4], 吉田 眞一[4]	1.豊橋技科大, 2.東工大, 3.NT-Tｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾃｸﾉﾛｼﾞ, 4.九州大学医学研究院
	16:00 - 16:15	E 11p-A29-8	Two-Dimensional Redox Imaging Employing Integrated Square Wave Voltammetric Pulse Generator Circuit	○(P)BYOUNGHYUN LIM[1], Sou Takahashi[1], Masato Futagawa[2], Fumihiro Dasai[1,3], Makoto Ishida[1], Kazuaki Sawada[1,3]	1.Toyohashi Univ. of Tech., 2.Shizuoka Univ., 3.CREST
	16:15 - 16:30	11p-A29-9	容量計測型呼吸センサのための衣服組み込み電極	寺澤 槙恵[1], 熊谷 慎也[1], ○佐々木 実[1]	1.豊田工大
	16:30 - 16:45	11p-A29-10	波長選択性熱放射による狭空間内における電子デバイス冷却技術	○津田 慎一郎[1], 清水 信[1], 井口 史匡[1], 湯上 浩雄[1]	1.東北大院工
	16:45 - 17:00	11p-A29-11	水蒸気酸化によるポーラスシリコンの3次元構造形成	○出野上 真樹[1], 石黒 敬太[1], 青木 画奈[1], 藤井 稔[1]	1.神戸大院工
	17:00 - 17:15	11p-A29-12	切削平坦化した金バンプを用いたウェハレベル真空封止接合	○平野 栄樹[1], 引地 広介[1], 田中 秀治[1]	1.東北大工
	17:15 - 17:30	11p-A29-13	高精度薄化研削のための水膜チャックの開発	○吉冨 健一郎[1], 宇根 篤暢[1], 餅田 正秋[1], 坂東 翼[2], 山本 栄一[2]	1.防大機械, 2.岡本工作機械
	3月12日(木) 9:00 - 12:00				
	9:00 - 9:15	12a-A29-1	青色半導体レーザアニール中のSi膜内光吸収量解析	○岡田 竜弥[1], 神村 盛太[1], 野口 隆[1]	1.琉球大工
	9:15 - 9:30	12a-A29-2	脱水素無しのアモルファスSi薄膜に対するBLDA低抵抗化	○若杉 智英[1], 安次富 卓哉[1], 岡田 竜弥[1], 野口 隆[1], 西方 靖[2], 太田 淳[2], 井上 和久[3], 山田 一雄[3]	1.琉球大工, 2.(株)アルバック, 3.プロダクトサポート社
	9:30 - 9:45	12a-A29-3	マイクロ熱プラズマジェット照射によるSi結晶成長の初期膜依存性	○林 将平[1,2], 森崎 誠司[1], 山本 将悟[1], 中谷 太一[1], 新 良太[1], 東 清一郎[1]	1.広大院先端研, 2.学振特別研究員PD
	9:45 - 10:00	12a-A29-4	大気圧マイクロ熱プラズマジェット結晶化によるa-Siパターン内結晶成長のその場観察	○(D)森崎 誠司[1], 林 将平[1], 山本 将悟[1], 中谷 太一[1], 笠原 拓也[1], 東 清一郎[1]	1.広大院先端研
	10:00 - 10:15	12a-A29-5	金誘起低温層交換法による高Ge組成(≧50%)SiGe/絶縁膜の大粒径・方位制御成長(≦300℃)	○佐道 泰造[1], パク ジョンヒョク[1,2], 青木 陸太[1], 宮尾 正信[1]	1.九大システム情報, 2.学振
	10:15 - 10:30		休憩/Break		
	10:30 - 10:45	12a-A29-6	非晶質C12A7 エレクトライド/結晶Si の接合とI-V 特性	○渡邉 俊成[1], 小穴 保久[2], 戸田 喜丈[3], 宮川直通[1], 古田 薫[2], 雲見 日出也[3], 細野 秀雄[3]	1.旭硝子, 2.LG Display, 3.東工大
	10:45 - 11:00	12a-A29-7	非晶質C12A7エレクトライドのTFT電極への適用	○小穴 保久[1], 渡邊 俊成[2], 戸田 喜丈[3], 宮川直通[2], 古田 薫[1], 雲見 日出也[3], 細野 秀雄[3]	1.エルジーディスプレイ, 2.旭硝子, 3.東工大
	11:00 - 11:15	12a-A29-8	パネル上高感度フォトセンサ応用へのBLDAによる多層膜構造Si膜の結晶性向上	Nakao Kota[1], ○(M2)Koswaththage Charith Jayanada[1], Wakasugi Tomohide[1], Okada Tatsuya[1], Noguchi Takashi[1]	1.琉球大学
	11:15 - 11:30	12a-A29-9	フレキシブル基板上での単結晶シリコンCMOSトランジスタの作製	○酒池 耕平[1,2], 中川 明俊[1], 赤澤 宗樹[1], 東清一郎[1,3]	1.広大院 先端研, 2.学振特別研究員PD, 3.広大ナノデバイス・バイオ融合科学研究所
	11:30 - 11:45	12a-A29-10	大気圧マイクロ熱プラズマジェット結晶化Ge膜を用いたTFTオフ電流の結晶化速度依存性	○中谷 太一[1], 林 将平[1], 森崎 誠司[1], 山本将悟[1], 東 清一郎[1]	1.広大院先端研
	11:45 - 12:00	12a-A29-11	積層チャネル3D-IC向け極薄Body Poly-Ge p-&n-MISFETsを用いたCMOSインバーターとリング発振器の作製および動作実証	○鎌田 善己[1], 小池 正浩[1], 黒澤 悦男[1], 黒澤 昌志[2,3], 太田 裕之[1], 中塚 理[2], 財満 鎭明[2], 手塚 勉[1]	1.産総研GNC, 2.名大院工, 3.学振

13.4 Siプロセス・配線・MEMS・集積化技術 / Si wafer processing /MEMS/Integration technology　ポスター講演

	3月13日(金) 9:30 - 11:30				
		奨 13a-P14-1	AuとGeの同時スパッタによるGe薄膜の結晶化(II)	○杉山 貴俊[1], 神子 公男[2], 弓野 健太郎[1]	1.芝浦工業大学, 2.東大生研
		13a-P14-2	二段階Pイオン注入によるメタル/n^+Geコンタクト低抵抗化とGe nMOSFETの寄生抵抗低減	○小池 正浩[1], 上牟田 雄一[1], 黒澤 悦男[1], 手塚 勉[1]	1.産総研GNC
		E 13a-P14-3	First Trial Fabrication of Poly-Si TFTs using Crystallization-Induction Layers of Yttria-Stabilized Zirconia and Pulsed Laser Annealing Crystallization Methods	○Lien Mai[1], Masayuki Yamano[2], Tatsuaki Hirata[2], Shin-Ichiro Kuroki[2], Susumu Horita[1]	1.JAIST, 2.Hiroshima Univ.
		奨 13a-P14-4	ガラス基板上の自己整合四端子平面型メタルダブルゲート低温poly-Si TFT の制御性	○大澤 弘樹[1], 佐々木 駿[1], 原 明人[1]	1.東北学院大工
		13a-P14-5	スパッタHfO_2を利用したCLC 低温poly-Si TFTのCMOS化	○目黒 達也[1], 原 明人[1]	1.東北学院大工
		奨 13a-P14-6	ガラス基板上の平面型メタルダブルゲート低温poly-Ge TFT	○西村 勇哉[1], 目黒 達也[1], 原 明人[1]	1.東北学院大工
		13a-P14-7	AlSi/TiNバンプおよびACPを用いたChip on Chip構造の接合抵抗評価	○秋山 正弘[1], Dali Zhang[2], Myung-Jae Lee[2], Edoardo Charbon[2]	1.長野高専, 2.デルフト工科大学

		E 13a-P14-8	Finite element method simulation of three-terminal graphene NEMS switches	○(D)Jothiramalingam Kulothungan[1], Manoharan Muruganathan[1], Hiroshi Mizuta[1,2]	1.JAIST, 2.Univ. of Southampton
		13a-P14-9	スペース赤外線望遠鏡のための極低温可変形鏡の開発	○(M1)高橋 葵[1], 塩谷 圭吾[1], Paul Bierden[2], Steven Cornelissen[2], Charlie Lam[2], Michael Feinberg[2]	1.JAXA宇宙研, 2.BMC
		13a-P14-10	プラズモニック素子内包アルギン酸ゲルによるグルコースセンシング	○齋藤 泰登[1], 西山 宏昭[1]	1.山形大院理工
		奨 13a-P14-11	SAB法によるSi/Si接合の界面特性の評価	○(B)山條 翔二[1], 森本 雅史[1], 梁 剣波[1], 重川 直輝[1]	1.大阪市大工
		奨 13a-P14-12	$Pb(Zr,Ti)O_3$薄膜と感光性樹脂の積層構造体作製とその評価	○大久保 昂[1]	1.兵庫県立大工
		奨 13a-P14-13	ポリイミドを構造体兼接着剤として用いたマイクロ流体デバイスの作製法	○小宮山 凌平[1], 近藤 正大[1], 宮下 英俊[1], 李 相錫[1]	1.鳥取大学
		13a-P14-14	レチクルフリー露光装置を用いた不均一伸縮基板対応アライメント方式の複数回路への対応	○刀根 輝徳[1], 長野 聖央[2], 久保田 弘[1], 吉岡 昌雄[2], 小坂 光二[3]	1.熊大院自, 2.熊大工, 3.TCK

13.4 Siプロセス・配線・MEMS・集積化技術 / Si wafer processing /MEMS/Integration technology　口頭講演

3月14日(土)　9:00 - 12:00

	9:00 - 9:15	14a-A29-1	光エッチングによる均一層厚を有する極薄SOIの形成	○宮田 優希[1], 中向 保徳[1], カッシア チエミアゼヴェド[1], 押鐘 寧[1], 川合 健太郎[1], 有馬 健太[1], 森田 瑞穂[1]	1.阪大院工
	9:15 - 9:30	14a-A29-2	IBEを用いたfinミリングによるFinFETの特性ばらつき改善	○松川 貴[1], 遠藤 和彦[1], 赤坂 洋[2], 神谷 保志[2], 池田 真義[2], 恒川 孝二[2], 中川 隆史[2], 柳 永勛[1], 昌原 明植[1]	1.産総研, 2.キヤノンアネルバ
	9:30 - 9:45	14a-A29-3	プラズマ後処理によって高い仕事関数を有する微結晶窒化チタン膜	○出貝 求[1], 中山 雅則[1], 原田 和宏[1], 芦原 洋司[1], 金山 健司[1]	1.(株)日立国際電気
	9:45 - 10:00	14a-A29-4	リン酸溶液中レーザドーピングにおけるGe基板面方位の効果	○高橋 恒太[1], 黒澤 昌志[1,2], 池上 浩[3], 柴山 茂久[1,4], 坂下 満男[1], 竹内 和歌奈[1], 中塚 理[1], 財満 鎭明[1,5]	1.名大院工, 2.学振特別研究員(PD), 3.九大院シス情, 4.学振特別研究員(DC), 5.名大エコトピア
	10:00 - 10:15	14a-A29-5	n-ウェルの形成のためのGe基板上へのSb拡散	○米田 亮太[1], 山本 圭介[2], 中島 寛[2]	1.九大・総合理工学府, 2.九大・産学連携センター
	10:15 - 10:30	奨 14a-A29-6	ゲート絶縁膜耐圧不良のラマン分光法による原因評価	○横川 凌[1], 富田 基裕[1,3], 水越 俊和[2], 平野 雄太[2], 草野 健一郎[2], 佐々木 克弘[2], 小椋 厚志[1]	1.明治大理工, 2.ラピスセミコンダクタ宮城, 3.学振特別研究員DC
	10:30 - 10:45		休憩/Break		
	10:45 - 11:00	14a-A29-7	レーザーアニールによる高性能パワー素子のプロセス検討	○陳 訳[1], 野口 隆[1], マッツァムト フルビオ[2], ヒュエット カリム[2]	1.琉球大学工, 2.スクリーンセミコンダクタ(株)
	11:00 - 11:15	14a-A29-8	Si/SiO_2界面準位密度と製造環境における絶対湿度の相関	○浅野 均[1], 居村 史人[1], 古賀 和博[1], クンプアン ソマワン[1,2], 原 史朗[1,2]	1.ミニマルファブ, 2.産総研
	11:15 - 11:30	14a-A29-9	ミニマル装置群で作製したpMOSインバータ	○居村 史人[1], 浦 伸吾[2], 北山 侑司[1], 古賀 和博[1], 浅野 均[1], 中戸 克彦[1], クンプアン ソマワン[1,3], 原 史朗[1,3]	1.ミニマルファブ, 2.ロジック・リサーチ, 3.産総研
	11:30 - 11:45	14a-A29-10	ミニマル液体ドーパントプロセスによるnMOSFET試作検討	○古賀 和博[1], 居村 史人[1], 浅野 均[1], クンプアン ソマワン[1,2], 原 史朗[1,2]	1.ミニマルファブ技術研究組合, 2.産総研
	11:45 - 12:00	14a-A29-11	ミニマル研削・研磨装置を用いたウェハ再生とそれを用いたMOSFET作製	○梅山 規男[1], 谷島 孝[1], 浅野 均[1], 居村 史人[1], 中戸 克彦[1], クンプアン ソマワン[1,2], 原 史朗[1,2]	1.ミニマルファブ技術研究組合, 2.産総研

3月14日(土)　13:00 - 15:00

	13:00 - 13:15	14p-A29-1	集光加熱FZ法によるハーフインチ径シリコン結晶成長	○池田 伸一[1,2], 西村 健史[3], 小澤 哲也[4], 長澤 亨[3], 高須 誠一[3], 原 史朗[1,2]	1.産業技術総合研究所, 2.ミニマルファブ技術研究組合, 3.キヤノンマシナリー, 4.リガク
	13:15 - 13:30	14p-A29-2	ミニマル集光加熱炉における温度均一性の改善(II)	○三浦 典子[1], 相澤 洸[1,2], 山田 武史[1,2], 伊藤 孝宏[1,3], 遠江 栄希[1], 池田 伸一[1,4], 石田 夕起[1,4], 三ケ原 孝則[1], 大西 康弘[1,2], クンプアン ソマワン[1,4], 原 史朗[1,4]	1.ミニマルファブ, 2.米倉製作所, 3.オリエンタルモーター, 4.産総研
	13:30 - 13:45	14p-A29-3	ミニマル抵抗加熱炉で形成した熱酸化膜の電気的特性(III)	○中戸 克彦[1], 居村 史人[1], 浅野 均[1], 鈴木 真之佑[1,3], 松田 祥吾[1,3], 柳沼 綾美[1,3], 森川 清彦[1,3], 服部 昌[1,3], 池田 伸一[1,2], クンプアン ソマワン[1,2], 原 史朗[1,2]	1.ミニマルファブ技術研究組合, 2.産業技術総合研究所, 3.光洋サーモシステム
	13:45 - 14:00	14p-A29-4	ミニマルレーザ加熱装置の高速昇降温特性の評価	○佐藤 和重[1], 遠江 栄希[1], 千葉 貴史[1,3], 寺田 昌男[1,3], 中戸 克彦[1], 三浦 典子[1], 池田 伸一[1,2], クンプアン ソマワン[1,2], 原 史朗[1,2]	1.ミニマルファブ技術研究組合, 2.産総研, 3.坂口電熱
	14:00 - 14:15	14p-A29-5	集光型赤外線加熱炉を用いたハーフインチシリコンCVD装置(4)	○李 寧[1], 羽深 等[1], 三ケ原 孝則[2], 池田 伸一[2,3], 石田 夕起[2,3], 原 史朗[2,3]	1.横国大院工, 2.ミニマルファブ技術研究組合, 3.産総研
	14:15 - 14:30	14p-A29-6	コーティングカップ内の局所温度制御によるミニマルコーティング特性	○奥田 修史[1], 武内 翔[1,2], 扇子 義久[1,2], 伊藤 孝宏[1,3], クンプアン ソマワン[1,4], 原 史朗[1,4]	1.ミニマルファブ技術研究組合, 2.リソテックジャパン, 3.オリエンタルモーター, 4.産総研
	14:30 - 14:45	14p-A29-7	ミニマル装置を使用したリソグラフィ工程の変動要因の解析	○北山 侑司[1], 奥田 修史[1], 東野 泰英[1], 寶池 広由[1], クンプアン ソマワン[1,2], 原 史朗[1,2]	1.ミニマルファブ技術研究組合, 2.産総研
	14:45 - 15:00	14p-A29-8	局所クリーン化ミニマルPLADエア循環システム(IV)	○谷島 孝[1], 安井 政治[1], クンプアン ソマワン[1,2], 前川 仁[1,2], 原 史朗[1,2]	1.ミニマルファブ技術研究組合, 2.産総研

13.5 デバイス／集積化技術 / Semiconductor devices and related techologies　口頭講演

3月11日(水)　9:00 - 12:15

	9:00 - 9:15	11a-A23-1	FLA法を用いて作製した高性能多結晶Ge tri-gate p-/n-MOSFETの実証	○臼田 宏治[1], 鎌田 善己[1], 上牟田 雄一[1], 森貴洋[1], 小池 正浩[1], 手塚 勉[1]	1.産総研GNC
	9:15 - 9:30	E 11a-A23-2	Mobility improvement of ultrathin-body Germanium-on-insulator (GeOI) MOSFETs on flipped Smart-Cut GeOI substrates	○(D)Xiao YU[1,2], Jian KANG[1,2], Rui ZHANG[1,2], Mitsuru TAKENAKA[1,2], Shinichi TAKAGI[1,2]	1.Univ. of Tokyo, 2.JST-CREST
	9:30 - 9:45	奨 11a-A23-3	表面ラフネス散乱がGeナノワイヤの正孔移動度に与える影響に関する理論的検討	○田中 一[1], 須田 淳[1], 木本 恒暢[1]	1.京大院工
	9:45 - 10:00	11a-A23-4	デバイスシミュレーションによる積層トランジスタ構造の検討	○服部 淳一[1], 福田 浩一[1], 太田 裕之[1], 前田 辰郎[1]	1.産総研

	10:00 - 10:15	11a-A23-5	Si上フロントゲートInAs/GaSb-OI p-MOSFETの移動度向上	○西 康一[1,3], 横山 正史[1], 横山 春喜[2,3], 星 拓也[2,3], 杉山 弘樹[2,3], 竹中 充[1,3], 高木 信一[1,3]	1.東大院工, 2.NTT先端集積デバイス研, 3.JST CREST
	10:15 - 10:30	奨 11a-A23-6	InGaAs-MOSFET のチャネル長微細化に関する研究	○大澤 一斗[1], 三嶋 裕一[1], 宮本 恭幸[1]	1.東工大理工
	10:30 - 10:45		休憩/Break		
	10:45 - 11:00	11a-A23-7	ナノワイヤ型ショットキー障壁トンネルFETのON電流密度増大	○麻田 修平[1], 小杉山 洋希[1], 橋本 修一郎[1], 武井 康平[1], ソン セイ[1], 張 旭[1], 徐 泰宇[1], 若水 昂[1], 松川 貴[2], 昌原 明植[2]	1.早大理工, 2.産総研
	11:00 - 11:15	11a-A23-8	ひずみSOIトンネルFETの作製と電気的特性	○植田 大貴[1,2], 金 閔洙[1,2], 竹中 充[1,2], 高木 信一[1,2]	1.東大, 2.JST CREST
	11:15 - 11:30	奨・E 11a-A23-9	Effects of strain, interface states and back bias on electrical characteristics of Ge-source UTB strained-SOI tunnel FETs	○Minsoo Kim[1,2], Yuki K. Wakabayashi[1], Ryosho Nakane[1], Masafumi Yokoyama[1,2], Mitsuru Takenaka[1,2], Shinichi Takagi[1,2]	1.The Univ. of Tokyo, 2.JST-CREST
	11:30 - 11:45	11a-A23-10	高In組成InGaAs量子井戸層の挿入によるプレーナ型InGaAsトンネルFETの性能向上の実証	○(M2)ジ サンミン[1,3], 市川 磨[2,3], 長田 剛規[2,3], 山田 永[2,3], 竹中 充[1,3], 高木 信一[1,3]	1.東京大工, 2.住友化学, 3.JST CREST
	11:45 - 12:00	11a-A23-11	Si/InGaAsヘテロ接合界面縦型トンネルFETのシェル層歪効果	○冨岡 克広[1,2], 石坂 文哉[1], 中井 栄治[1], 本久 順一[1], 福井 孝志[1]	1.北大院情報科学および量子集積センター, 2.JSTさきがけ
	12:00 - 12:15	11a-A23-12	電界依存型の誘電率を有するゲート絶縁膜を用いた急峻トランジスタの可能性とスイッチング性能の検討	○太田 裕之[1,3], 右田 真司[1,3], 福田 浩一[1], 鳥海 明[2,3]	1.産総研, 2.東大工, 3.JST CREST
	3月11日(水)　14:00 - 17:30				
	14:00 - 14:15	11p-A23-1	数nm-CMOS 素子用二次元Si層の検討 (X) 水素アニールによる影響	○鈴木 佑弥[1], 長嶺 由騎[1], 青木 孝[1], 水野 智久[1], 前田 辰郎[2]	1.神奈川大理, 2.産総研
	14:15 - 14:30	11p-A23-2	数nm-MOS素子用二次元Si層検討(XI) :C添加による物性変調	○長嶺 由騎[1], 鈴木 佑弥[1], 青木 孝[1], 水野 智久[1]	1.神奈川大理
	14:30 - 14:45	11p-A23-3	パターン依存酸化法を応用した直列三重結合シリコン量子ドットの作製	○内田 貴史[1], 吉岡 勇[1], 佐藤 光[1], 福地 厚[1], 有田 正志[1], 藤原 聡[2], 高橋 庸夫[1]	1.北大院情報, 2.NTT物性基礎研
	14:45 - 15:00	11p-A23-4	ゲート制御性を向上したSi-MOS量子ドットデバイスの作製と評価	○本田 拓夢[1], 小寺 哲夫[4,5], 米田 淳[3], 武田 健太[2], 樽茶 清悟[2,3,5], 小田 俊理[1]	1.東工大量子ナノ研, 2.東大, 3.理化学研究所, 4.東工大, 5.東大ナノ量子機構
	15:00 - 15:15	11p-A23-5	低濃度リンドープによるドーパント原子MOSFET	○高須 友貴[1], ダニエル モラル[2], 水野 武志[1], 田部 道晴[1]	1.静大電研, 2.静大院工
	15:15 - 15:30	E 11p-A23-6	First-principle calculations of the interactions between single phosphorus donor and boron acceptor in the P-B co-doped silicon nanostructures	○(P)Le The Anh[1], Daniel Moraru[2], Manoharan Muruganathan[1], Michiharu Tabe[2], Hiroshi Mizuta[1,3]	1.JAIST, 2.Shizuoka Univ., 3.Univ. of Southampton
	15:30 - 15:45		休憩/Break		
	15:45 - 16:00	11p-A23-7	コンパクトモデルから見たMOSFETのバリステイック特性の可能性	○名取 研二[1]	1.東工大フロンテイア
	16:00 - 16:15	11p-A23-8	単一Si/SiO_2界面トラップのチャージポンピング(CP)特性:P_{b0}センターの電気的直接観測と従来CP理論の原理的改善	○土屋 敏章[1], 小野 行徳[2]	1.島根大総理工, 2.富山大工
	16:15 - 16:30	奨 11p-A23-9	チャージポンピング電流の実時間計測による電子捕獲過程の解析	○堀 匡寛[1], 渡辺 時暢[1], 土屋 敏章[2], 小野 行徳[1]	1.富山大工, 2.島根大総合理工
	16:30 - 16:45	11p-A23-10	チャージポンピング電流の実時間計測による電子放出、再結合過程の直接観測	○堀 匡寛[1], 渡辺 時暢[1], 土屋 敏章[2], 小野 行徳[1]	1.富山大工, 2.島根大総合理工
	16:45 - 17:00	11p-A23-11	短チャネルトンネルトランジスタにおけるAl-Nイオン注入で形成した深い準位を介する単一電子輸送	○大野 圭司[1], 森 貴洋[2], 森山 悟士[3]	1.理研, 2.産総研, 3.物材機構
	17:00 - 17:15	11p-A23-12	Si中の等価電複合不純物の電子状態に関する第一原理計算	○(DC)飯塚 将太[1], 中山 隆史[1]	1.千葉大理
	17:15 - 17:30	11p-A23-13	シリコンPN接合における再結合電流のEDMR観察	○(M2)古田 慧梧[1], 小野 行徳[1], 西内 祐樹[1], 三谷 太希[1], 堀 匡寛[1]	1.富山大工
	3月12日(木)　14:00 - 17:30				
招待	14:00 - 14:45	12p-A23-1	**「第15回応用物理学会業績賞(研究業績)受賞記念講演」(45分) 大容量メモリ技術の産業展開への貢献と三次元集積化技術の先駆的研究**	**○小柳 光正[1]**	**1.東北大学**
	14:45 - 15:00	12p-A23-2	浮遊ゲート型三次元FinFETフラッシュメモリ電気特性のチャネル形状依存性	○柳 永シュン[1], 生田目 俊秀[2], 松川 貴[1], 遠藤 和彦[1], 大内 真一[1], 塚田 順一[1], 山内 洋美[1], 石川 由紀[1], 水林 亘[1], 森田 行則[1], 右田 真司[1], 太田 裕之[1], 知京 豊裕[2], 昌原 明植[1]	1.産総研, 2.物材研
	15:00 - 15:15	奨 12p-A23-3	30nm世代NANDフラッシュメモリにおけるRTNの空間及び統計分布のチャネル不純物依存性	○(M1)富田 季宏[1], 宮地 幸祐[1]	1.信州大院
	15:15 - 15:30	12p-A23-4	信頼性を考慮したストレージクラスメモリとNANDフラッシュメモリを用いたSSDの性能解析	○瀧下 博文[1], 田中丸 周平[1,2], 保坂 翔吾[1], 上口 光[1], 竹内 健[1]	1.中大理工, 2.東大工
	15:30 - 15:45	12p-A23-5	長期保存に向けたSSDの高信頼手法	○山崎 泉樹[1], 田中丸 周平[1,2], 北村 雄太[1], 竹内 健[1]	1.中大理工, 2.東大工
	15:45 - 16:00	12p-A23-6	エンタープライズ向けソリット・ステート・ドライブの高信頼手法	○山崎 泉樹[1], 田中丸 周平[1,2], 竹内 健[1]	1.中大理工, 2.東大工
	16:00 - 16:15		休憩/Break		
	16:15 - 16:30	12p-A23-7	TLC NAND フラッシュメモリ向け高速,高信頼LDPC符号	○徳冨 司[1], 土井 雅史[1], 蜂谷 尚悟[1], 田中丸 周平[1], 竹内 健[1]	1.中大理工
	16:30 - 16:45	12p-A23-8	TLCフラッシュメモリ向け読み出し電圧の動的最適化及びデータの自動回復技術	○小林 惇朗[1], 徳冨 司[1], 土井 雅史[1], 蜂谷 尚悟[1], 田中丸 周平[1], 竹内 健[1]	1.中大理工
	16:45 - 17:00	E 12p-A23-9	Measurements and Statistical Comparison of Four Write Stability Metrics in Bulk CMOS SRAM Cells	○(D)Hao Qiu[1], Tomoko Mizutani[1], Takuya Saraya[1], Toshiro Hiramoto[1]	1.IIS, Univ. of Tokyo
	17:00 - 17:15	奨・E 12p-A23-10	Statistical Analysis of Four Write Stability Metrics in Fully Depleted Silicon-on-Thin-BOX (SOTB) SRAM Cells at Low Supply Voltage Down to 0.4V	○(D)Hao Qiu[1], Tomoko Mizutani[1], Yoshiki Yamamoto[2], Hideki Makiyama[2], Tomohiro Yamashita[2], Hidekazu Oda[2], Shiro Kamohara[2], Nobuyuki Sugii[2], Takuya Saraya[1], Masaharu Kobayashi[1], Toshiro Hiramoto[1]	1.IIS, Univ. of Tokyo, 2.LEAP
	17:15 - 17:30	12p-A23-11	完全空乏型Silicon-on-Thin-BOX (SOTB) SRAMにおける異常不安定セルの最低動作電圧 (V_{min}) の詳細解	○水谷 朋子[1], 山本 芳樹[2], 槇山 秀樹[2], 山下 朋弘[2], 尾田 秀一[2], 蒲原 史朗[2], 杉井 信之[2], 平本 俊郎[1]	1.東大生研, 2.LEAP

13.5 デバイス／集積化技術 / Semiconductor devices and related techologies　ポスター講演

3月12日(木)　9:30 - 11:30

		12a-P13-1	SiO_2膜中の単一トラップ生成過程の観察	○与名本 欣樹[1]	1.日立横研
		12a-P13-2	n型トンネルトランジスタにおけるPBTI劣化の解析	○水林 亘[1], 森 貴洋[1], 福田 浩一[1], 柳 永勛[1], 松川 貴[1], 石川 由紀[1], 遠藤 和彦[1], 大内 真一[1], 塚田 順一[1], 山内 洋美[1], 右田 真司[1], 森田 行則[1], 太田 裕之[1], 昌原 明植[1]	1.産総研
		12a-P13-3	ナノワイヤ型ショットキー障壁トンネルFETの動作解析	○徐 泰宇[1], 小杉山 洋希[1], 橋本 修一郎[1], 武井 康平[1], ソン セイ[1], 麻田 修平[1], 張 旭[1], 若水 昂[1], 松川 貴[2], 昌原 明植[2], 渡邉 孝信[1]	1.早大理工, 2.産総研
		12a-P13-4	極低ドレイン電圧で急峻なサブスレッショルド特性を持つPNボディコンタクト付きSOI MOSFETの測定結果	○蔵本 陽介[1], 森 貴之[1], 井田 次郎[1]	1.金沢工業大学
		12a-P13-5	引張りひずみSi-on-Insulator (sSOI) 上に形成された圧縮ひずみ$Si_{0.1}Ge_{0.9}$ チャネルpMOSFET における移動度とSS 値の向上	○池田 圭司[1], 守山 佳彦[1], 入沢 寿史[1], 小野瑞城[1], 上牟田 雄一[1], 小田 穣[1], 宮木 智則[1], 黒澤 悦男[1], 手塚 勉[1]	1.産総研GNC
		12a-P13-6	スパッタエピタキシー法を用いたSiGe埋め込みチャネル型p-MOSFET	○櫻澤 健光[1], 塚本 貴広[1], 広瀬 信光[2], 笠松 章史[2], 松井 敏明[2], 三村 高志[2], 須田 良幸[1]	1.東京農工大院工, 2.情報通信研究機構
		12a-P13-7	デプレッション型極薄GeSn-pMOSFETs特性のSn濃度依存性	○前田 辰郎[1], Wipakorn Jevasuwan[1], 服部 浩之[1], 内田 紀行[1], 三浦 榑[2], 田中 正俊[2], Santos Nuno D. M.[3], Vantomme Andre[3], Locquet J. -P.[3], Lieten R. R.[3,4,5]	1.産総研, 2.横浜国立大学, 3.KU Lueven, 4.IMEC, 5.Entegris
		12a-P13-8	再成長ソース/ドレインを有するInGaAsマルチゲートMOSFET作製プロセスに関する研究	○(M1)木下 治紀[1], 金澤 徹[1], 祢津 誠晃[1], 三嶋 裕一[1], 宮本 恭幸[1]	1.東工大院理工
		12a-P13-9	Si単電子トランジスタにおける電界によるドット内準位の変化	○佐藤 光[1], 内田 貴史[1], 吉岡 勇[1], 福地 厚[1], 有田 正志[1], 藤原 聡[2], 高橋 庸夫[1]	1.北大院情報, 2.NTT物性基礎研
		12a-P13-10	リソグラフィにより形成されたシリコン2重結合量子ドット内の電子スピン状態のパルス測定	○堀部 浩介[1], 小寺 哲夫[2,3], 小田 俊理[1,2]	1.東工大量子ナノ研セ, 2.東工大電子物理, 3.東大ナノ量子機構
		12a-P13-11	超平坦Si/Cu同時研削と残留金属低減処理を用いたSi貫通電極露出工程	○渡辺 直也[1], 青柳 昌宏[1], 片川 大輔[2], 坂東 翼[3], 三井 貴彦[3], 山本 栄一[3]	1.産業技術総合研究所, 2.アプリシアテクノロジー, 3.岡本工作機械製作所

13.5 デバイス／集積化技術 / Semiconductor devices and related techologies　口頭講演

3月13日(金)　9:00 - 12:30

	9:00 - 9:15	13a-A23-1	パルス光伝導法による非接触テストの開発	○(M1)清水 公志郎[1], 福田 和樹[2], 深 純平[1], 古田 正昭[1], 吉岡 昌雄[2], 小林 一博[1], 久保田 弘[1], 吉永 径一[3]	1.熊大院自, 2.熊大工, 3.テラプローブ
	9:15 - 9:30	E 13a-A23-2	Development of amorphous Si / crystalline Si heterojunction strip detector for X-ray/gamma ray imaging	○Xiaosong Yan[1], Yang Tian[1], Shimazoe Kenji[1], Fujiwara Takeshi[1], Takahashi Hiroyuki[1], Ishikura Takeshi[2], Tomita Hideki[3]	1.Univ. Tokyo, 2.Fuji Electric Co. Ltd., 3.Nagoya Univ.
	9:30 - 9:45	奨・E 13a-A23-3	Thermal analysis on a vertical GaN Gunn diode	○(DC)Wang Ying[1,2], Lin-An Yang[1], Jin-Ping Ao[2], Zhi-Zhe Wang[1], Yue Hao[1]	1.Xidian Univ., 2.Tokushima Univ.
	9:45 - 10:00	13a-A23-4	エナジーハーベスト用ショットキーダイオード検討その1	○宮地 晃平[1], 松野下 誠[1], 長谷川 直輝[1,2], 野地 拓匡[1,3], 吉田 賢史[1], 川崎 繁男[1]	1.JAXA宇宙研, 2.京大生存研, 3.首都大理工
	10:00 - 10:15	13a-A23-5	SOI MOSFETを用いたアンテナ結合ボロメータの基礎検討	○(M1)植田 剛央[2], 鈴木 佑弥[2], 佐藤 弘明[1,2], ティワリ アジェイ[1], 廣本 宣久[2], 猪川 洋[1,2]	1.静岡大・電子研, 2.静岡大・工
	10:15 - 10:30	13a-A23-6	SOIトランジスタの自己加熱による水素センサの低消費電力化	○宮田 耕[1], 竹内 豪[1], 高橋 綱己[1,2], 内田 建[1,2]	1.慶應義塾大学, 2.JST CREST
	10:30 - 10:45		休憩/Break		
	10:45 - 11:00		第6回シリコンテクノロジー分科会論文賞・研究奨励賞授賞式 / Silicon Technology Division Award Ceremony		
招待	**11:00 - 11:30**	**13a-A23-7**	**「第6回シリコンテクノロジー分科会論文賞受賞記念講演」(30分) Au/SiO2ハイブリッド接合を用いた3次元集積回路の開発**	**○後藤 正英[1], 萩原 啓[1], 井口 義則[1], 大竹 浩[1], 更屋 拓哉[2], 日暮 栄治[2], 年吉 洋[2], 平本 俊郎[2]**	**1.NHK, 2.東大**
招待	**11:30 - 12:00**	**13a-A23-8**	**「第6回シリコンテクノロジー分科会論文賞受賞記念講演」(30分) 大口径化可能な貼り合わせ法によるSi上高性能InGaAs-OI MOSFETの作製**	**○金 相賢[1,2,3], 一宮 佑希[1,2], 横山 正史[1], 中根 了昌[1], Li Jian[4], Kao Yung-Chung[4], 竹中 充[1,2], 高木 信一[1,2]**	**1.東大院工, 2.JST-CREST, 3.Korea Institute of Science and Technology, 4.IntelliEPI, Inc.**
招待	**12:00 - 12:15**	**13a-A23-9**	**「第6回シリコンテクノロジー分科会研究奨励賞受賞記念講演」(15分) GeSn多結晶薄膜の進展 ～3D-ICを目指して～**	**○黒澤 昌志[1,2], 池上 浩[3], 田岡 紀之[1], 中塚 理[1], 財満 鎭明[1,4]**	**1.名大院工, 2.学振PD, 3.九大院システム情, 4.名大エコトピア**
招待	**12:15 - 12:30**	**E 13a-A23-10**	**[Silicon Technology Division Award Speech] (15min.) Si-based Light Emitting Devices with Ge Quantum Dots Embedded in Optical Microcavities**	**○Xuejun Xu[1], Takuya Maruizumi[1], Yasuhiro Shiraki[1]**	**1.Tokyo City Univ.**

3月13日(金)　16:15 - 19:00

	16:15 - 16:30	13p-A23-1	大面積MoS_2膜形成に向けたMoの硫化プロセスの検討	○(B)松浦 賢太朗[1], 大橋 匠[1], 山口 晋平[1], 須田 耕平[2], 石原 聖也[2], 澤本 直美[2], 角嶋 邦之[1], 杉井 信之[1], 西山 彰[1], 片岡 好則[1], 名取 研二[1], 筒井 一生[1], 岩井 洋[1], 小椋 厚志[2], 若林 整[1]	1.東工大, 2.明治大
	16:30 - 16:45	13p-A23-2	室温におけるNi/InAs間の固体拡散	○眞方山 貴也[1], 堀場 弘司[2], 組頭 広志[2], 雲見 日出也[3], 細野 秀雄[1,3,4], 真島 豊[1,3]	1.東工大応セラ研, 2.高エネ研PF, 3.東工大元素センター, 4.東工大フロンティア
	16:45 - 17:00	13p-A23-3	2層2次元InAs薄膜FETにおけるフローティングゲートメモリ効果	○眞方山 貴也[1], 加納 伸也[1], 竹井 邦晴[2], Steven Chuang[2], Ali Javey[2], 雲見 日出也[3], 細野 秀雄[1,3,4], 真島 豊[1,3]	1.東工大応セラ研, 2.カリフォルニア大バークレー校, 3.東工大元素センター, 4.東工大フロンティア
	17:00 - 17:15	13p-A23-4	TEMその場観察法による$Cu/MoO_x/Al_2O_3$抵抗変化型メモリの特性評価	○平田 周一郎[1], 高橋 謙仁[1], 工藤 昌輝[1], 廣井 孝弘[1], 中根 明俊[1], 福地 厚[1], 有田 正志[1], 高橋 庸夫[1]	1.北大院情報
	17:15 - 17:30	13p-A23-5	Cu系CBRAMにおける熱処理の影響	中根 明俊[1], 勝村 玲音[1], 廣井 孝弘[1], 福地 厚[1], ○有田 正志[1], 高橋 庸夫[1]	1.北大院情報
	17:30 - 17:45		休憩/Break		
	17:45 - 18:00	13p-A23-6	MOSFET挿入による抵抗変化型メモリの抵抗制御	廣井 孝弘[1], 中根 明俊[1], 勝村 玲音[1], 福地 厚[1], ○有田 正志[1], 高橋 庸夫[1], 浦邊 大史[2], 安藤 秀幸[2], 森江 隆[2]	1.北大院情報, 2.九工大生命体工

	18:00 - 18:15	奨 13p-A23-7	MOSFET上に集積化したCu-MoO_x-Al抵抗変化型メモリのアナログメモリ動作	○浦邊 大史[1], 富崎 和正[1], 安藤 秀幸[1], 森江 隆[1], 廣井 孝弘[2], 中根 明俊[2], 福地 厚[2], 有田 正志[2], 高橋 庸夫[2]	1.九工大生命体工, 2.北大院情報
	18:15 - 18:30	13p-A23-8	50 nm Al_xO_y ReRAMアレイの書き換え前後のデータ保持特性	○山沢 裕紀[1], 寧 渉洋[1,2], Iwasaki Tomoko Ogura[1], 田中丸 周平[1], 上口 光[1], 竹内 健[1]	1.中大, 2.東大
	18:30 - 18:45	13p-A23-9	抵抗変化型メモリの書き込み特性の評価	○西川 進[1], 寧 渉洋[1,2], 蜂谷 尚悟[1], 竹内 健[1]	1.中大理工, 2.東大工
	18:45 - 19:00	13p-A23-10	三次元積層ReRAM/NANDフラッシュメモリハイブリッドSSDの実装方法	○(M1)石井 智也[1], 上口 光[1], 竹内 健[1]	1.中大理工

13.6 Semiconductor English Session　口頭講演

3月12日(木)　9:00 - 12:15

	9:00 - 9:15	E 12a-A23-1	Surface potential observation of heavily-doped Si by KPFM	○(D)Krzysztof Tyszka[1,2], Daniel Moraru[1], Takeshi Mizuno[1], Ryszard Jablonski[2], Mihicharu Tabe[1]	1.Shizuoka Univ., 2.Warsaw Univ. of Tech.
	9:15 - 9:30	E 12a-A23-2	Development of apparatus supplying hydrogen radical remotely to decompose $SiCl_4$ source	○(D)Fatima DAHMANI[1], Yuji OKAMOTO[1,2], Daiki TSUTSUMI[1,3], Takamasa ISHIGAKI[3], Hideomi KOINUMA[4], Sumiya MASATOMO[1]	1.NIMS inst., 2.TSUKUBA Univ., 3.Hosei Univ., 4.Tokyo Univ.
	9:30 - 9:45	E 12a-A23-3	Interactions of individual dopants and macroscopic quantum dots in weakly-doped nanoscale SOI-FETs	○Daniel Moraru[1], Yuki Takasu[2], Arup Samanta[2], Takeshi Mizuno[2], Michiharu Tabe[2]	1.Fac. Eng. Shizuoka U, 2.RIE, Shizuoka U
	9:45 - 10:00	E 12a-A23-4	Non-destructive Characterization of Oxide/Ge Interface by Photoluminescence Measurement	○Shoichi Kabuyanagi[1,2], Tomonori Nishimura[1,2], Takeaki Yajima[1,2], Akira Toriumi[1,2]	1.Tokyo Univ., 2.JST-CREST
	10:00 - 10:15	E 12a-A23-5	n^+Si/pGe Heterojunctions Fabricated by Narrow Membrane Bonding	○(P)Chi Liu[1,2], Shoichi Kabuyanagi[1,2], Tomonori Nishimura[1,2], Akira Toriumi[1,2]	1.Univ. of Tokyo, 2.JST-CREST
	10:15 - 10:30	E 12a-A23-6	Electric-field-assisted formation of an interfacial double-donor molecule in Si nano-transistors	○(PC)Samanta Arup[1], Daniel Moraru[2], Takeshi Mizuno[1], Michiharu Tabe[1]	1.RIE, Shizuoka Univ., 2.DEMS, Shizuoka Univ.
	10:30 - 10:45		休憩/Break		
	10:45 - 11:00	奨・E 12a-A23-7	Inspection of elastic stress and generated defects in thin Ge film on GeOI wafer	○Toshimitsu Nakamura[1,2], Tomonori Nishimura[1,2], Takeaki Yajima[1,2], Akira Toriumi[1,2]	1.Univ. of Tokyo, 2.JST-CREST
	11:00 - 11:15	奨・E 12a-A23-8	Effect of Individual Dopants in Esaki Tunneling Diodes	○(M2)Tan Hoang[1], D. Moraru[1,2], R. Unno[1], A. Sapteka[3], S. Purwiyanti[3], L.T. Anh[4], M. Manoharan[4], T. Mizuno[1], H. Mizuta[4,5], D. Hartanto[3], M. Tabe[1]	1.RIE,Shizuoka Univ., 2.Shizuoka Univ., 3.Univ. of Indonesia, 4.JAIST, 5.Univ. of Southampton
	11:15 - 11:30	奨・E 12a-A23-9	Phonon-softening in Germanium by Free Carrier Accumulation -Experimental Distinction between Impurity and Free Carrier Effect-	○Shoichi Kabuyanagi[1,2], Tomonori Nishimura[1,2], Takeaki Yajima[1,2], Akira Toriumi[1,2]	1.Tokyo Univ., 2.JST-CREST
	11:30 - 11:45	奨・E 12a-A23-10	Catalytic Effect of Substrate-Si on SiO_2-IL Scavenging in HfO_2/SiO_2/Si Stacks	○(DC)Xiuyan Li[1], Takeaki Yajima[1], Tomonori Nishimura[1], Akira Toriumi[1]	1.Univ. of Tokyo
	11:45 - 12:00	奨・E 12a-A23-11	Analytical Model for SiO_2-IL Scavenging in HfO_2/SiO_2/Si Stacks	○(DC)Xiuyan Li[1], Takeaki Yajima[1], Tomonori Nishimura[1], Akira Toriumi[1]	1.Univ. of Tokyo
	12:00 - 12:15	奨・E 12a-A23-12	2-nm-EOT Y-Si-O Gate Stack Formation on $Si_{0.5}Ge_{0.5}$	○CheTsung Chang[1], Tomonori Nishimura[1], Akira Toriumi[1]	1.Univ. of Tokyo

3.11 フォトニック構造・現象, 13.7 超薄膜・量子ナノ構造のコードシェアセッション　口頭講演

3月12日(木)　9:00 - 12:30

	9:00 - 9:15	奨 12a-A10-1	有機ヒ素を用いたMOVPE法によるフォトニック結晶の埋め込み成長	○河崎 正人[1,3], 吉田 昌宏[1], 石崎 賢司[1], Menaka De Zoysa[1,2], 北村 恭子[1,2], 野田 進[1]	1.京大院工, 2.京大白眉, 3.三菱電機先端総研
	9:15 - 9:30	12a-A10-2	(Sc, Er)$_2O_3$薄膜におけるサイト選択励起でのエネルギー移動とアップコンバージョン	○川上 欣洋[1], 俵 毅彦[2,3], 尾身 博雄[2,3], 鍛治 怜奈[1], 足立 智[1]	1.北大院工, 2.NTT物性基礎研, 3.NTTナノフォトニクスセンタ
	9:30 - 9:45	12a-A10-3	(ErSc)2O3 薄膜におけるアップコンバージョン発光とフォトニックバンドギャップによる抑制	○俵 毅彦[1,2], Thomas McManus[1,3], 川上 欣洋[4], 尾身 博雄[1,2], Adel Najar[1], 鍛治 怜奈[4], 足立 智[4], 後藤 秀樹[1]	1.NTT物性研, 2.NTTナノフォトニクスセンタ, 3.バース大, 4.北大
	9:45 - 10:00	奨 12a-A10-4	InP(311)B基板上InAs量子ドットからの単一光子発生とその温度特性	○(M2)細井 響子[1], 高熊 亨[1], 黒澤 裕之[3], 中島 秀朗[3], 赤羽 浩一[2], 熊野 英和[3], 末宗 幾夫[3], 早瀬 潤子[3]	1.慶大理工, 2.情通機構, 3.北大電子研
	10:00 - 10:15	12a-A10-5	(111)A 面上量子ドットにおける励起子微細構造分裂の高精度評価	○中島 秀朗[1], 熊野 英和[1], 劉 祥明[2], 間野 高明[2], 黒田 隆[2], 末宗 幾夫[1]	1.北大電子研, 2.物材機構
	10:15 - 10:30	E 12a-A10-6	Entangled photon emission at temperatures up to 60 K from droplet epitaxial quantum dots	○(P)Xiangming Liu[1], Takashi Kuroda[1], Takaaki Mano[1], Hideaki Nakajima[2], Hidekazu Kumano[2], Ikuo Suemune[2], Yoshiki Sakuma[1], Kazuaki Sakoda[1]	1.NIMS, 2.RIES Hokkaido Univ.
	10:30 - 10:45	12a-A10-7	量子ドット-ナノ共振器強結合系における光散逸経路間干渉	○太田 泰友[1], 太田 竜一[2], 熊谷 直人[1], 岩本 敏[1,2], 荒川 泰彦[1,2]	1.東大ナノ量子機構, 2.東大生研
	10:45 - 11:00	奨 12a-A10-8	走査型電子顕微鏡による量子ドットの位置検出とナノ共振器との結合状態評価	○車 一宏[1], 太田 泰友[2], 高宮 大策[1], 角田 雅弘[2], 岩本 敏[1,2], 荒川 泰彦[1,2]	1.東大生研, 2.東大ナノ量子機構
	11:00 - 11:15		休憩/Break		
	11:15 - 11:30	12a-A10-9	ウエハ接合界面での光損失を低減した量子ドット結合共振器の作製	○北田 貴弘[1], 原山 千穂[1], 太田 寛人[1], 前川 知久[1], 盧 翔孟[1], 熊谷 直人[1], 井須 俊郎[1]	1.徳島大院フロンティア
	11:30 - 11:45	12a-A10-10	一次元フォノニック結晶導波路におけるフォノン伝搬のバンド構造依存性	○畑中 大樹[1], ドデル アモリ[1], マブーブ イムラン[1], 小野満 恒二[1], 山口 浩司[1]	1.NTT物性研
	11:45 - 12:00	奨 12a-A10-11	多モード干渉を利用した表面プラズモンポラリトン交差導波路	○太田 雅[1], 福原 誠史[1], 住村 あさひ[1], 伊藤 基[1], 相原 卓磨[1], 石井 佑弥[1], 福田 光男[1]	1.豊技大
	12:00 - 12:15	奨 12a-A10-12	グラフェン装荷型プラズモニクス導波路における光吸収の増強	○(M1)常川 雅人[1,2], 小野 真証[1,3], 納富 雅也[1,2,3]	1.NTT物性研, 2.東工大理工, 3.NTT-Tナノフォトニクスセンタ
	12:15 - 12:30	奨 12a-A10-13	プラズモニック導波路のSi細線導波路への結合	○小野 真証[1,2], Hao Xu[1,2], 倉持 栄一[1,2], 野崎 謙悟[1,2], 谷山 秀昭[1,2], 常川 雅人[2,3], 納富 雅也[1,2,3]	1.NTTナノフォトニクスセンタ, 2.NTT物性科学基礎研, 3.東工大理工

13.7 超薄膜・量子ナノ構造 / Quantum properties and fabrications of nanoscale structures and devices　口頭講演

3月11日(水)　9:15 - 12:30

	9:15 - 9:30	11a-A10-1	テーパードセル法を用いたPbS量子ドットの高密度配列	○加納 朋弥[1], 清水 雄大[1], 中嶋 聖介[1,2], 向井 剛輝[1]	1.横浜国大工学府, 2.理研
	9:30 - 9:45	11a-A10-2	PbS量子ドットのガラスコーティングによる発光特性への影響	○丹羽 慶輔[1], 藤川 裕恭[1], 牟田口 浩明[2], 田中 智也[2], 向井 剛輝[2], 中嶋 聖介[2,3]	1.横浜国大理工, 2.横浜国大院工, 3.理研
	9:45 - 10:00	11a-A10-3	ポリマー薄膜中のコロイドPbS量子ドットにおける励起緩和過程の偏光異方性	○廣田 舞[1], 芝川 忠慶[1], 原田 幸弘[1], 喜多 隆[1]	1.神戸大院工
	10:00 - 10:15	11a-A10-4	ポリマー/Siハイブリッド型可動式マイクロ光共振器からの量子ドットの発光	○野坂 貴大[1], 中嶋 聖介[1,2], 向井 剛輝[1]	1.横浜国大工学府, 2.理研
	10:15 - 10:30	11a-A10-5	電場のゆらぎによる単一CdSe/ZnSナノ粒子の発光スペクトル拡散現象	○(M1C)伊吹 博人[1], 井原 章之[1], 金光 義彦[1]	1.京大化研
	10:30 - 10:45		休憩/Break		
招待	**10:45 - 11:00**	**E 11a-A10-6**	**[Young Scientist Presentation Award Speech] (15min.) Terahertz spectroscopy of sublevel structures in single self-assembled InAs quantum dots**	**○Ya Zhang[1], Kenji Shibata[1], Naomi Nagai[1], Camile Ndebeka-Bandou[1,3], Gerald Bastard[1,3], Kazuhiko Hirakawa[1,2]**	**1.IIS, Univ. of Tokyo, 2.INQIE, University of Tokyo, 3.LPA, Ecole Normale Superieure**
	11:00 - 11:15	E 11a-A10-7	Dynamic Nuclear Spin Polarization in the Presence of Multiple Excitonic Complexes in Single InAs/GaAs Quantum Dots at Zero Applied Magnetic Field	○CheeFai Fong[1,2], Yasutomo Ota[1,2], Edmund Harbord[1,3], Satoshi Iwamoto[1,2], Yasuhiko Arakawa[1,2]	1.NanoQuine, 2.IIS, Univ. of Tokyo, 3.Univ. of Bristol
	11:15 - 11:30	11a-A10-8	単一量子リングにおける電子・正孔面内 g 因子評価	○冨永 隆宏[1], 冨井 拓真[2], 鍛治 怜奈[2], 呉 祐年[3], 鄭 舜仁[3], 足立 智[2]	1.北大工, 2.北大院工, 3.台湾国立交通大
	11:30 - 11:45	11a-A10-9	(113)B GaAs基板上に成長した量子ドットのPLの温度依存性	○盧 翔孟[1], 川口 晃弘[1], 熊谷 直人[1], 北田 貴弘[1], 井須 俊郎[1]	1.徳大
	11:45 - 12:00	11a-A10-10	InAs量子ドット積層構造の面内光伝導キャリアの移動度	○熊谷 直人[1], 村雲 圭佑[1], 北田 貴弘[1], 井須 俊郎[1]	1.徳島大院フロンティア
	12:00 - 12:15	11a-A10-11	InGaN/GaN堆積物除去と単一ナノコラム発光	○(B)山本 貴利[1], 前川 未知瑠[1], 今西 佑典[1], 関根 清登[1], 澄川 雄樹[1], 石沢 峻介[1], 中岡 俊裕[1], 岸野 克巳[1]	1.上智大理工
	12:15 - 12:30	11a-A10-12	Effect of Impurity Correlation on Electron Transport under Nano-Device Structures	○(M2)Muhammad Restu Zulhidza[1], Yuji Kaneno[1], Akiko Ueda[1], Syuta Honda[1], Katsuhisa Yoshida[1], Nobuyuki Sano[1]	1.Tsukuba Univ.

3月12日(木)　14:00 - 15:45

	14:00 - 14:15	12p-A24-1	半導体量子井戸における励起子量子ビートのポンプ光エネルギー依存性	○小島 磨[1], 喜多 隆[1]	1.神戸大院工
	14:15 - 14:30	12p-A24-2	GaAs 量子井戸における正孔スピン重ね合わせ状態の直線偏光分解ポンププローブ測定法による評価	○伊藤 哲[1,2], 後藤 英樹[3], 夫馬 宗一郎[1], 市田 正夫[4], 安藤 弘明[4]	1.静岡大電子研, 2.静岡大院工, 3.NTT物性科学基礎研, 4.甲南大理工
	14:30 - 14:45	奨 12p-A24-3	GaAs/AlGaAs トンネル双量子井戸のスピン緩和の温度及び障壁層幅依存性	○有竹 貴紀[1], 原澤 遼[1], 安江 雄也[1], Wu Hao[1], 武藤 俊一[2], 竹内 淳[1]	1.早大理工, 2.北大院工
	14:45 - 15:00	12p-A24-4	GaAs エピタキシャル構造中のキャリア輸送を利用した超高速光応答の制御	○長谷川 尊之[1], 竹内 日出雄[2], 山田 永[3], 秦 雅彦[3], 中山 正昭[2]	1.兵庫県大院物質理, 2.阪市大院工, 3.住友化学筑波研
	15:00 - 15:15	12p-A24-5	水素化非晶質Si中に形成された結晶Ge量子井戸構造に関する検討	○貝津 光[1], 磯村 雅夫[1]	1.東海大院工
	15:15 - 15:30	12p-A24-6	$CaF_2/CdF_2/CaF_2$共鳴トンネル量子井戸構造を用いた抵抗スイッチング特性の理論解析	○(DC)須田 慶太[1], 桑田 友哉[1], 渡辺 正裕[1]	1.東工大
	15:30 - 15:45	12p-A24-7	金属/Ge界面での偏析によるショットキーバリア変調の第一原理計算	○恩田 由紀子[1], 中山 隆史[1]	1.千葉大理

13.7 超薄膜・量子ナノ構造 / Quantum properties and fabrications of nanoscale structures and devices　ポスター講演

3月12日(木)　16:00 - 18:00

		12p-P13-1	量子ドット中V型3準位系集合体における3パルスフォトンエコー	○市川 翔大[1], 赤羽 浩一[2], 新井 悠人[1], 早瀬 潤子[1]	1.慶大理工, 2.情通機構
		12p-P13-2	Si/CaF_2共鳴トンネル構造を用いた抵抗スイッチング素子のパルス応答特性	○桑田 友哉[1], 須田 慶太[1], 渡辺 正裕[1]	1.東工大院総理工

13.8 化合物及びパワー電子デバイス・プロセス技術 / Compound and power electron devices and process technology　口頭講演

3月11日(水)　9:00 - 12:00

	9:00 - 9:15	11a-A21-1	タンデム太陽電池応用のためのSi/InGaPヘテロ接合の電気伝導特性	○梁 剣波[1], 柴 麗[1], 西田 将太[1], 重川 直輝[1]	1.大阪市立大学
	9:15 - 9:30	11a-A21-2	GaAsSb バックワードダイオードの実測特性の理論解析によるデバイスモデル構築	○小野 孝介[1], 藤田 尚成[1], 伊森 香織[1], 須原 理彦[1], 高橋 剛[2]	1.首都大理工, 2.富士通研
	9:30 - 9:45	11a-A21-3	InSb HEMT作製におけるプロセスダメージの検討	○前田 章臣[1], 辻 大介[1], 竹鶴 達哉[1], 藤川 紗千恵[1], 藤代 博記[1], 渡邊 一世[2], 山下 良美[2], 遠藤 聡[2], 原 紳介[2], 笠松 章史[2]	1.東理大院基礎工, 2.情報通信研究機構
	9:45 - 10:00	奨 11a-A21-4	ビスエチルメチルアミノシランを用いた原子層堆積SiO_2保護膜を有するAlGaAs/InGaAs HEMTの特性	○鈴木 貴之[1], 滝川 陽介[1], 張 東岩[1], 内藤 志麻子[1], 岩田 直高[1]	1.豊田工大
	10:00 - 10:15	奨 11a-A21-5	SiCN鋳型プロセスを用いた傾斜フィールドプレート構造を持つInGaAs系HEMTの作製とその特性	○吉田 智洋[1], 畠山 信也[1], 安川 奈那[1], 尾辻 泰一[1], 末光 哲也[1]	1.東北大通研
	10:15 - 10:30		休憩/Break		
	10:30 - 10:45	11a-A21-6	基板転写InP HBTにおけるメタルサブコレクタの熱抵抗低減効果	○白鳥 悠太[1,2], 星 拓也[1,2], 柏尾 典秀[1,3], 栗島 賢二[1,2], 日暮 栄治[4], 松崎 秀昭[1,2]	1.日本電信電話, 2.NTT先端集積ﾃﾞﾊﾞｲｽ研, 3.NTTﾃﾞﾊﾞｲｽｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀ, 4.東大
	10:45 - 11:00	11a-A21-7	原子拡散接合を用いてSiCウエハ上に作製したInP-DHBT	○渡邉 昌崇[1], 柳沢 昌輝[1], 上坂 勝己[1], 江川 満[1], 小路 元[1]	1.住友電工
	11:00 - 11:15	奨 11a-A21-8	容量測定法によるSiC-PNダイオードの電荷変動機構解析	○松島 宏行[1], 沖野 泰之[1], 望月 和浩[1], 山田 廉一[1]	1.日立中研
	11:15 - 11:30	11a-A21-9	パルスI-V法による4H-SiC MOSFETの界面特性評価	○磯野 弘典[1], 矢野 裕司[1,2], 冬木 隆[1]	1.奈良先端大, 2.筑波大
	11:30 - 11:45	奨 11a-A21-10	Demonstrate of a Low On-resistance 6.5kV PiN Diode Fabricated on a SiC Substrate with p+ epitaxial layer	○Yuan Bu[1], Norifumi Kameshiro[1], Akio Shima[1], Ren-ichi Yamada[1], Yasuhiro Shimamoto[1]	1.Hitachi Ltd.

	11:45 - 12:00	11a-A21-11	GIT双方向スイッチ等価回路モデルの高精度化	○井手 利英[1], 清水 三聡[1], 沈 旭強[1], 森田 竜夫[2], 大塚 信之[2], 上田 哲三[2]	1.産総研先進パワエレ, 2.パナソニック
	3月11日(水)　14:00 - 17:15				
	14:00 - 14:15	11p-A21-1	Arイオン照射によるダイヤモンド半導体用オーミック電極の形成	○関 裕平[1], 星野 靖[1], 斎藤 保直[1], 中田 穣治[1]	1.神奈川大理
	14:15 - 14:30	11p-A21-2	(-201), (010) Ga_2O_3 上における結晶化Al_2O_3 層の面方位依存性	○上村 崇史[1], ダイワシガマニ キルシナムルティ[1], 倉又 朗人[2], 山腰 茂伸[2], 東脇 正高[1]	1.情通研機構, 2.タムラ製作所
	14:30 - 14:45	11p-A21-3	(010) Ga_2O_3 上Al_2O_3 結晶化層厚と界面準位密度の相関	○上村 崇史[1], ダイワシガマニ キルシナムルティ[1], 倉又 朗人[2], 山腰 茂伸[2], 東脇 正高[1]	1.情通研機構, 2.タムラ製作所
	14:45 - 15:00	E 11p-A21-4	Planar Device Isolation for β-Ga_2O_3 Field Effect Transistors	○ManHoi Wong[1], Kohei Sasaki[2,1], Akito Kuramata[2], Shigenobu Yamakoshi[2], Masataka Higashiwaki[1]	1.NICT, 2.Tamura Corp.
	15:00 - 15:15	11p-A21-5	中性粒子ビームエッチングとプラズマエッチングにおけるAlGaNのエッチング表面状態の比較	○李 昌勇[1], 肥後 昭男[2], Thomas Cédric[1], 新村 忠[3], 寒川 誠二[1,2,4]	1.東北大流体研, 2.東北大学WPI-AIMR, 3.東芝生産技術センター, 4.JST-CREST
	15:15 - 15:30	11p-A21-6	中性粒子ビームによるAlGaN/GaN HEMTリセスゲート構造の作製	○李 昌勇[1], 肥後 昭男[2], 太田 実雄[3], 藤岡 洋[3,4], 寒川 誠二[1,2,4]	1.東北大流体研, 2.東北大学WPI-AIMR, 3.東京大学生産研, 4.JST-CREST
	15:30 - 15:45		休憩/Break		
	15:45 - 16:00	11p-A21-7	光照射下におけるn型GaN中プラズマ照射誘起欠陥の挙動の温度依存性	○折茂 力都[1]	1.首都大理工
	16:00 - 16:15	11p-A21-8	MOCVD n-GaNで観測されるEv+0.86eV正孔トラップのODLTS測定	○(M1)宮本 一輝[1], 徳田 豊[1]	1.愛知工大
	16:15 - 16:30	11p-A21-9	水素雰囲気異方性熱エッチングによる超微細ナノGaN構造の作製	○(M2)喜多 諒[1], 蜂屋 諒[1], 菊池 昭彦[1,2]	1.上智大理工, 2.上智大学ナノテクノロジーセンター
	16:30 - 16:45	11p-A21-10	段差付き基板上に成長したAlGaN/GaNヘテロ構造の電気的特性	○(DC)樹神 真太郎[1], Asubar Joel[1], 徳田 博邦[1], 中澤 敏志[2], 石田 昌宏[2], 上田 哲三[2], 葛原 正明[1]	1.福井大院工, 2.パナソニック(株)AIS社 技術本部
	16:45 - 17:00	11p-A21-11	Au-Au熱圧着転写によるAlGaN/GaN HEMTのDC特性の向上	○廣木 正伸[1], 熊倉 一英[1], 山本 秀樹[1]	1.NTT物性研
	17:00 - 17:15	11p-A21-12	リセスゲート促進障壁層AlGaN/GaN 非対称Open-Gate HFETの高温特性	○前田 就彦[1,2], 廣木 正伸[2], 佐々木 智[2], 原田 裕一[2]	1.東京工科大, 2.NTT研究所
	3月12日(木)　9:00 - 12:30				
	9:00 - 9:15	12a-A21-1	AlTiO/InAlN/AlN/GaN金属-絶縁体-半導体電界効果トランジスタにおけるゲートリーク電流の伝導機構	○梁 吉慶[1], 宇井 利昌[1], H.-A. Shih[1], 山口 慎也[1], 鈴木 寿一[1]	1.北陸先端大
	9:15 - 9:30	12a-A21-2	金属ゲート電極材料のAlGaN/GaN HEMT のリーク電流への影響	○大賀 一樹[1], 川那子 高暢[2], 角嶋 邦之[2], 片岡 好則[2], 西山 彰[2], 杉井 信之[2], 若林 整[2], 筒井 一生[2], 名取 研二[1], 岩井 洋[1]	1.東工大フロンティア研, 2.東工大総理工
	9:30 - 9:45	奨 12a-A21-3	界面顕微光応答法を用いたAlGaN/GaN HEMTの劣化過程の2次元評価	○山本 晋吾[1], 畠山 信也[2], 末光 哲也[2], 塩島 謙次[1]	1.福井大院工, 2.東北大学
	9:45 - 10:00	12a-A21-4	界面顕微光応答法を用いたイオン注入n - G a N ショットキー接触の2次元評価	○山本 晋吾[1], 村瀬 真悟[1], 田中 丈士[1,2], 三島 友義[2], 中村 徹[3], 塩島 謙次[1]	1.福井大院工, 2.日立金属, 3.法政大
	10:00 - 10:15	奨 12a-A21-5	自立基板の劈開面に形成したn-GaNショットキー接触の評価	○永縄 萌[1], 青木 俊周[1], 吉田 丈洋[2], 三島 友義[2,3], 塩島 謙次[1]	1.福井大院工, 2.日立金属(株), 3.法政大学
	10:15 - 10:30	奨 12a-A21-6	GaNショットキーバリアダイオードの順方向特性における アノード電極端効果	○吉川 大地[1], 山口 裕太郎[2], 山中 宏治[2], 大石 敏之[1]	1.佐賀大理工, 2.三菱電機
	10:30 - 10:45	奨 12a-A21-7	三端子構造を用いたGaN ショットキーバリアダイオードの寄生抵抗解析	○山口 修造[1], 山口 裕太郎[2], 山中 宏治[2], 大石 敏之[1]	1.佐賀大理工, 2.三菱電機
	10:45 - 11:00		休憩/Break		
	11:00 - 11:15	12a-A21-8	N極性p形GaNショットキー電極の電気的特性の評価	○青木 俊周[1], 谷川 智之[2], 片山 竜二[2], 松岡 隆志[2], 塩島 謙次[1]	1.福井大院工, 2.東北大金研
	11:15 - 11:30	12a-A21-9	走査型非線形誘電率顕微鏡によるAlGaN/GaN構造の2次元電子ガス及び分極の評価	○廣瀬 光太郎[1], 茅根 慎通[1], 長 康雄[1]	1.東北大通研
	11:30 - 11:45	12a-A21-10	GaN系半導体への局所レーザアニールによる注入Siの活性化	○(M1)永井 昂哉[1], 分島 彰男[1], 江川 孝志[1], 平田 智也[2], 安藤 聡[2], 谷 克彦[2]	1.名工大, 2.ワイエイシイフェトン
	11:45 - 12:00	奨 12a-A21-11	放射光光電子分光法によるn-GaN上Al/Tiコンタクトの界面反応分析	○伊藤 丈予[1], 淺原 亮平[1], 野崎 幹人[1], 中澤 敏志[2], 石田 昌宏[2], 上田 哲三[2], 吉越 章隆[3], 寺岡 有殿[3], 細井 卓治[1], 志村 考功[1], 渡部 平司[1]	1.阪大院工, 2.パナソニック, 3.原子力機構
	12:00 - 12:15	12a-A21-12	AlGaN/GaN HEMT構造への凹凸AlGaN層導入によるコンタクト抵抗の低減	○武井 優典[1], 下田 智裕[1], 筒井 一生[1], 齋藤 渉[2], 角嶋 邦之[1], 若林 整[1], 片岡 好則[1], 岩井 洋[1]	1.東工大, 2.東芝 ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰ&ｽﾄﾚｰｼﾞ 社
	12:15 - 12:30	12a-A21-13	δドープGaNキャップ/AlGaN/GaN構造のオーミックコンタクト抵抗	○(B)加藤 直樹[1], 安藤 彰浩[1], 分島 彰男[1], 江川 孝志[1], 長田 大和[2], 上村 隆一郎[2]	1.名工大, 2.アルバック
	3月12日(木)　14:00 - 17:30				
	14:00 - 14:15	12p-A21-1	超格子キャップ層を用いたAlGaN/GaN MOSFET	○按田 義治[1], 塩崎 奈々子[1], 根来 昇[1], 中澤 敏志[1], 鶴見 直大[1], 石田 昌宏[1], 上田 哲三[1]	1.パナソニック
	14:15 - 14:30	12p-A21-2	選択再成長を用いたノーマリオフAlGaN/GaN MOSFET	○中澤 敏志[1], 塩崎 奈々子[1], 根来 昇[1], 鶴見 直大[1], 按田 義治[1], 石田 昌宏[1], 上田 哲三[1]	1.パナソニック
	14:30 - 14:45	奨 12p-A21-3	酸素雰囲気熱処理プロセスがGaN MOS界面特性に与える影響	○大平 城二[1], 千崎 泰[1], 谷田部 然治[1,2], 橋詰 保[1,2]	1.北大量集センター, 2.JST-CREST
	14:45 - 15:00	12p-A21-4	n-GaN MOSキャパシタにおける界面電荷の温度特性	○高島 信也[1], 上野 勝典[1], 江戸 雅晴[1], T.Paul Chow[2]	1.富士電機, 2.RPI
	15:00 - 15:15	奨 12p-A21-5	AlGaN/GaN系PチャネルHFETのMOS構造によるノーマリーオフ化	○久保田 俊介[1], 萱沼 怜[1], 中島 昭[2], 西澤 伸一[3], 大橋 弘通[2,3], 筒井 一生[1], 角嶋 邦之[1], 若林 整[1], 岩井 洋[2]	1.東工大総理工, 2.東工大フロンティア研, 3.産総研
	15:15 - 15:30	12p-A21-6	AlGaN上にALD成膜したHfO_2を用いたMIS-HEMTの電気的特性	○西野 剛介[1], 吉田 雄祐[1], 久保 俊晴[1], 三好 実人[1], 江川 孝志[1]	1.名古屋工業大学
	15:30 - 15:45		休憩/Break		
	15:45 - 16:00	奨 12p-A21-7	AlGaN/GaN HEMT 構造のAlGaN層内部の電子トラップ解析	○(M1)馬場 俊之[1], 永久 雄一[2], 川那子 高暢[2], 角嶋 邦之[2], 片岡 好則[2], 西山 彰[2], 杉井 信之[2], 若林 整[2], 筒井 一生[2], 名取 研二[1], 岩井 洋[1]	1.東工大フロンティア研, 2.東工大総理工

	16:00 - 16:15	12p-A21-8	低周波インピーダンス測定によるGaN HEMTのトラップモデリング	○山口 裕太郎[1], 大塚 浩志[1], 小山 英寿[1], 加茂 宣卓[1], 南條 拓真[1], 山中 宏治[1], 大石 敏之[2]	1.三菱電機, 2.佐賀大学
	16:15 - 16:30	12p-A21-9	GaN HEMT Drain-lagのGaN channel層依存性	○鎌田 陽一[1], 岡本 直哉[1], 佐藤 優[1], 山田 敦史[1], 小谷 淳二[1], 石黒 哲郎[1], 多木 俊裕[1], 尾崎 史朗[1], 新井田 佳孝[1], 牧山 剛三[1], 渡部 慶二[1], 常信 和清[1]	1.株式会社富士通研究所
	16:30 - 16:45	奨 12p-A21-10	AlGaN/GaN HEMTにおけるオフ状態ストレス後の表面帯電評価	○西口 賢弥[1], 橋詰 保[1,2]	1.北大量集センター, 2.JST-CREST
	16:45 - 17:00	12p-A21-11	高圧水蒸気処理によるAlGaN/GaN HEMTの電流コラプス抑制	小林 洋平[1], ○Asubar Joel[1], 吉嗣 晃治[2], 谷田部 然治[3], 徳田 博邦[1], 堀田 昌宏[2], 浦岡 行治[2], 橋詰 保[3], 葛原 正明[1]	1.福井大院工, 2.奈良先端科学技術大学院大学, 3.北大量集センター
	17:00 - 17:15	12p-A21-12	AlGaN/GaN HEMTにおける発光と電流コラプスの相関	○(M1)大井 慎太郎[1], 坂井田 佳紀[1], Asubar Joel[1], 徳田 博邦[1], 葛原 正明[1]	1.福井大院工
	17:15 - 17:30	12p-A21-13	三次元フィールドプレート構造を用いたAlGaN/GaN HEMTの電流コラプス改善	○鈴木 敦也[1], 秋良 鴻介[1], Joel Asubar[1], 徳田 博邦[1], 葛原 正明[1]	1.福井大院工

13.8 化合物及びパワー電子デバイス・プロセス技術 / Compound and power electron devices and process technology　ポスター講演

3月13日(金)　16:30 - 18:30

		奨 13p-P17-1	高正孔濃度GaAsSbコンタクト層を有するGaAsSb/InGaAsSbベースDHBTのMOCVD成長	○星 拓也[1], 柏尾 典秀[2], 杉山 弘樹[1], 横山 春喜[1], 栗島 賢二[1], 井田 実[1], 松崎 秀昭[1]	1.NTT先端集積デバイス研, 2.NTTデバイスイノベーションセンタ
		13p-P17-2	InAs-PHEMT特性に及ぼす正孔蓄積の効果	○小松 竜大[1], 西尾 結[1], 佐藤 万里衣[1], 佐藤 宇人[1], 杉山 駿輔[1], 高梨 良文[1]	1.東理大
		13p-P17-3	In-Plane Gateデバイスの電流-電圧特性	○坂元 翔[1], 小野満 恒二[2], 山本 秀樹[2], 堀越 佳治[1], 牧本 俊樹[1]	1.早大理工, 2.NTT BRL
		奨 13p-P17-4	超格子FETに向けたダブルバリアp-i-n接合ダイオード	○行待 篤志[1], 柏野 壮志[1], 宮本 恭幸[1]	1.東工大院理工
		13p-P17-5	格子整合系InAlN/ AlGaN HEMT デバイスの試作と評価	○藤田 周[1], 三好 実[1], 江川 孝志[1]	1.名工大
		13p-P17-6	GaN/AlN共鳴トンネルダイオードで生じる双安定性の劣化メカニズム	○永瀬 成範[1], 高橋 言緒[1], 清水 三聡[1]	1.産総研
		奨 13p-P17-7	InAlN/GaN HEMTs における傾斜型フィールドプレートによるドレイン空乏領域長への影響	○安川 奈那[1], 畠山 信也[1], 吉田 智洋[1], 尾辻 泰一[1], 末光 哲也[1]	1.東北大通研
		13p-P17-8	独立に電圧印加可能なField Plateを有するAlGaN/GaN HEMTのパルスI-V特性	○間瀬 駿[1], 江川 孝志[1], 分島 彰男[1]	1.名工大
		13p-P17-9	サファイア基板上GaN PSJ(分極超接合)トランジスタの連続通電特性	○松本 壮太[1], 平田 祥子[1], 中村 文彦[1], 斎藤 武尊[1], 一丸 敬一[1], 八木 修一[1], 河合 弘治[1]	1.パウデック
		13p-P17-10	ノーマリーオフGaN-PSJトランジスタ	○平田 祥子[1], 松本 壮太[1], 一丸 敬一[1], 斎藤 武尊[1], 八木 修一[1], 中村 文彦[1], 河合 弘治[1]	1.株式会社パウデック
		13p-P17-11	GaNバラクタダイオードの製作	高橋 言緒[1], 坂村 祐一[1], 長南 紘志[1], 木内 真希[1], 井手 利英[1], 沈 旭強[1], ○清水 三聡[1], 板谷 太郎[1], 島田 雅夫[2]	1.産総研, 2.RFデバイステクノロジーズ
		奨 13p-P17-12	分極接合GaNウエハを用いたパワー集積回路	○萱沼 怜[1], 久保田 俊介[1], 中島 昭[2], 西澤 伸一[3], 大橋 弘通[2,3], 筒井 一生[1], 角嶋 邦之[1], 若林 整[1], 岩井 洋[2]	1.東工大総理工, 2.東工大フロンティア研, 3.産業技術総合研究所
		13p-P17-13	鉄ドープMOCVD n-GaNショットキーダイオードのアドミタンス分光	○上田 聖悟[1]	1.愛知工大
		13p-P17-14	Ar^+イオン照射したMOCVD-GaN:Si膜の電気的評価	○中野 由崇[1], 高木 健司[1], 小川 大輔[1], 中村 圭二[1], 新部 正人[2], 川上 烈生[3]	1.中部大工, 2.兵庫県立大高度研, 3.徳島大院工
		13p-P17-15	CF_4プラズマ処理したAlGaN/GaNヘテロ構造の電気的評価	○中野 由崇[1], 川上 烈生[2], 新部 正人[3], 高木 健司[1], 白濱 達夫[2], 向井 孝志[4]	1.中部大工, 2.徳島大院工, 3.兵庫県大高度研, 4.日亜化学
		13p-P17-16	ドライエッチングがAl_2O_3/AlGaN/GaN構造のMOS界面特性に与える影響	○谷田部 然治[1,2], 大平 城二[1], 佐藤 威友[1], 橋詰 保[1,2]	1.北大量集センター, 2.JST-CREST
		13p-P17-17	GaN基板上にプラズマCVDで形成したSiO_2-MOSキャパシタの特性	○上野 勝典[1], 高島 信也[1], 松山 秀昭[1], 江戸 雅春[1], 中川 清和[2]	1.富士電機, 2.山梨大
		13p-P17-18	Al_2O_3/InAlN界面特性のプロセス依存性	○千葉 勝仁[1], 赤澤 正道[1]	1.北大 量集センター
		13p-P17-19	ノーマリーオフGaN系MOSFETの実現に向けた再成長プロセス	○井上 恵太[1], 成田 知隆[1], 分島 彰男[1], 江川 孝志[1]	1.名工大
		13p-P17-20	AlGaN/GaN HEMTにおける局所リークへのエピタキシャル層の影響	○成田 知隆[1], 藤本 祐一[1], 分島 彰男[1], 江川 孝志[1]	1.名古屋工大
		13p-P17-21	GaN基板上AlGaN/GaN HEMT構造の表面モフォロジが耐圧に与える影響	○田邉 真一[1], 渡邉 則之[1], 内田 昌宏[2], 松崎 秀昭[1]	1.NTT先端集積デバイス研, 2.NTT-AT
		奨 13p-P17-22	表面活性化接合によるn^+-Si/n-GaNコンタクトの検討	○(B)西村 拓也[1], 梁 剣波[1], 渡邉 則之[2], 重川 直輝[1]	1.大阪市大工, 2.NTT研究所
		13p-P17-23	Low resistance ohmic contact on AlGaN/GaN heterostructures grown on GaN substrate	○Daryoush H. Zadeh[1], Shinichi Tanabe[1], Noriyuki Watanabe[1], Hideaki Matsuzaki[1]	1.NTT Dev. Tech. Labs.
		13p-P17-24	AlGaN/GaN HEMTへの凹凸AlGaN層導入によるコンタクト抵抗低減効果の凹凸構造パターン依存性	○下田 智裕[1], 武井 優典[1], 筒井 一生[1], 齋藤 渉[2], 角嶋 邦之[1], 若林 整[1], 片岡 好則[1], 岩井 洋[1]	1.東工大, 2.東芝ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰ&ｽﾄﾚｰｼﾞ社

13.9 光物性・発光デバイス / Optical properties and light-emitting devices　口頭講演

3月11日(水)　9:30 - 12:15

	9:30 - 9:45	E 11a-A25-1	Synthesis of $A_3B_8X_{15}$-type new oxynitride phosphors starting from a single crystal composition	○(P)Xiaojun Wang[1], Rong-Jun Xie[1], Naoto Hirosaki[1], Takashi Takeda[1], Shiro Funahashi[1]	1.NIMS
	9:45 - 10:00	E 11a-A25-2	Moisture-induced thermal degradation of red-emitting $CaAlSiN_3$:Eu	○Rong-Jun Xie[1], Jie Zhu[1,2], Yujin Cho[1,3], Takayuki Suehiro[1], Takeda Takashi[1], Naoto Hirosaki[1]	1.NIMS, 2.Nanjin Univ Sci Tech, 3.Uni Tsukuba
	10:00 - 10:15	11a-A25-3	サイアロン蛍光体ガラス薄膜を用いた固体照明デバイスの特性	○吉村 健一[1], 安念 一規[1], 福永 浩史[1], 原田 昌道[1], 和泉 真[1], 高橋 向星[2], 打越 哲郎[2], 広崎 尚登[2]	1.シャープ, 2.物材機構
	10:15 - 10:30	11a-A25-4	$Ba_3Si_6O_{12}N_2$:Eu^{2+}蛍光体の2波長励起PL測定ーAGEの前照射時間依存性	○高塚 洋右[1], 李 延延[1], 福田 武司[1], 本多 善太郎[1], 来島 友幸[2], 鎌田 憲彦[1]	1.埼玉大学, 2.三菱化学

	10:30 - 10:45		休憩/Break		
	10:45 - 11:00	11a-A25-5	$A_3M_8X_{12}$型新緑色窒化物蛍光体の結晶構造解析	○舟橋 司朗[1], 武田 隆史[1], 広崎 尚登[1], 解 栄軍[1]	1.物材機構
	11:00 - 11:15	11a-A25-6	$A_3B_8X_{12}$型新緑色窒化物蛍光体の発光特性	○武田 隆史[1], 広崎 尚登[1], 舟橋 司朗[1], 解 栄軍[1]	1.物材機構
	11:15 - 11:30	11a-A25-7	粉末合成した$A_3B_8X_{12}$型新緑色窒化物蛍光体のカソードルミネッセンス観察	○高橋 向星[1], Yujin Cho[1,2], 武田 隆史[1], 舟橋 司朗[1], 解 栄軍[1], 関口 隆史[1,2], 広崎 尚登[1]	1.物材機構, 2.筑波大学
	11:30 - 11:45	E 11a-A25-8	Microscopic approach for optimizing the growth conditions of $LaAl(Si_{6-z}Al_z)(N_{10-z}O_z)(z\sim1):Ce^{3+}$ blue phosphor	○(DC)Yujin Cho[1,2], Kohsei Takahashi[2], Benjamin Dierre[2], Rong-Jun Xie[2], Naoto Hirosaki[2], Takashi Sekiguchi[1,2]	1.Tsukuba Univ., 2.NIMS
	11:45 - 12:00	11a-A25-9	黄色発光蛍光体$Sr_2Si_7Al_3ON_{13}$:Ceの2つのサイトからの発光	○アルベサール 恵子[1], 石田 邦夫[1], 福田 由美[1], 加藤 雅礼[1]	1.東芝研開セ
	12:00 - 12:15	11a-A25-10	光励起下での結晶構造解析による$Sr_2Si_7Al_3ON_{13}$:Ce蛍光体の発光サイトの直接観察	○石田 邦夫[1], 星野 学[2], 野澤 俊介[2], 足立 伸一[2], アルベサール 恵子[1], 福田 由美[1], 加藤 雅礼[1]	1.東芝研開セ, 2.物構研
	3月11日(水)　13:30 - 17:30				
	13:30 - 13:45	11p-A25-1	サファイアC面基板上に成膜したZnO:Er膜からの可視PL	○赤沢 方省[1], 篠島 弘幸[2]	1.NTT DIC, 2.久留米高専
	13:45 - 14:00	11p-A25-2	RF-MBE法によるGaAs(100)基板上へのユーロピウム添加立方晶GaN薄膜の作製	○小山 裕生[1], 弓達 新治[1], 田所 眞尚[1], 竹内 一磨[1], 宮田 晃[1], 白方 祥[1]	1.愛媛大工
	14:00 - 14:15	E 11p-A25-3	Growth and Characterization of GaN/Eu-Doped GaN Nanolayer Structures by Low-Temperature Organometallic Vapor Phase Epitaxy	○Wanxin ZHU[1], Dolf Timmerman[1], Atsushi Koizumi[1], Yasufumi Fujiwara[1]	1.Osaka Univ.
	14:15 - 14:30	11p-A25-4	Eu,O共添加GaNにおけるトラップ準位のDLTS評価	○重宗 翼[1], 小泉 淳[1], 児島 貴徳[1], 藤原 康文[1]	1.阪大院工
	14:30 - 14:45	奨 11p-A25-5	Eu添加GaNにおけるEu発光特性の面内圧縮ひずみ依存性	○(M2)稲葉 智宏[1], 児島 貴徳[1], 小泉 淳[1], 藤原 康文[1]	1.阪大院工
	14:45 - 15:00	11p-A25-6	GaN:Eu赤色LEDの発光効率改善法：パルス駆動による注入電荷共振	○石井 真史[1], 小泉 淳[2], 藤原 康文[2]	1.物材機構, 2.阪大工
	15:00 - 15:15	11p-A25-7	「光らなかった」過程から観た希土類添加ガラス：欠陥電荷の局在/非局在と消光の関係	○石井 真史[1], 渕 真悟[2], 竹田 美和[3]	1.物材機構, 2.青学大, 3.名産研
	15:15 - 15:30		休憩/Break		
	15:30 - 15:45	奨 11p-A25-8	$Er_xYb_yY_{2-x-y}SiO_5$結晶における最大効率Yb^{3+}増感作用	○近藤 史哉[1], 一色 秀夫[1]	1.電通大院情報理工
	15:45 - 16:00	11p-A25-9	$Er_xY_{2-x}SiO_5$結晶中のエネルギー移動による緩和過	○一色 秀夫[1]	1.電通大院情報理工
	16:00 - 16:15	11p-A25-10	硬X線光電子分光によるSi(111)上にMBE成長した$(Er_xSc_{1-x})_2O_3$膜のバンド構造の決定	○尾身 博雄[1,2], ブラックスタッド ローガン[1], 俵 毅彦[1,2]	1.NTT物性研, 2.NTT NPC
	16:15 - 16:30	11p-A25-11	Sn添加シリコン酸窒化膜のフォトルミネッセンス特性評価	○(M1C)川俣 明[1], 竹内 寛稀[1], 鈴木 拓也[1], 呉 研[1], 高橋 芳浩[1]	1.日大理工
	16:30 - 16:45	11p-A25-12	不純物添加がSi量子ドット多重集積構造のEL特性に及ぼす影響	山田 敬久[1], ○牧原 克典[1], 池田 弥央[2], 宮崎 誠一[1]	1.名大院工, 2.広大院先端研
	16:45 - 17:00	奨 11p-A25-13	シリコンナノ粒子による吸着分子の発光増強	○前田 譲章[1], 松本 健俊[1], 小林 光[1]	1.阪大産研
	17:00 - 17:15	11p-A25-14	SOQ MOSFET特性の照射光波長依存性	○西澤 悠佑[1], 山田 辰哉[1], 東 利晃[1], 中島 義賢[1], 花尻 達郎[1]	1.東洋大学 バイオナノ研
	17:15 - 17:30	E 11p-A25-15	Monitoring Porous Silicon Photo-Dissolution in Hydrofluoric Acid	○Bernard Gelloz[1], Toshifumi Oya[2], Lianhua Jin[2]	1.Nagoya Univ., 2.Yamanashi Univ.
	3月12日(木)　9:00 - 12:30				
	9:00 - 9:15	12a-A25-1	$CuAlS_2$:Mn赤色蛍光体薄膜のポストアニールによる発光特性の改善	○(M1)足立 尚義[1], 川口 英紀[1], 石垣 雅[2], 大観 光徳[1,3]	1.鳥大院工, 2.TiFREC, 3.TEDREC
	9:15 - 9:30	12a-A25-2	Ga添加による$(Y,Ce)_4(SiS_4)_3$黄色蛍光体の発光波長制御	○(P)七井 靖[1], 大和 樹志[1], 奥野 剛史[1]	1.電通大 先進理工
	9:30 - 9:45	奨 12a-A25-3	アルカリ土類硫化物蛍光体の発光特性 ―第一原理計算と配位子場理論による電子状態解析―	○中野 博史[1], 大江 昌人[1]	1.シャープ
	9:45 - 10:00	奨 12a-A25-4	Eu^{2+}付活蛍光体温度消光特性と母体構造の構造活性相関解析	○青木 知也[1], 高羽 洋充[1]	1.工学院大学
	10:00 - 10:15	12a-A25-5	XPSによる青色蛍光体$Sr_3MgSi_2O_8:Eu^{2+}$の570nm発光の考察	○(B)郷津 建太[1], 宮川 勇人[1], 曽根 光作[1], 神垣 良昭[2], 岡本 慎二[3], 高橋 尚志[4]	1.香川大工, 2.EBL, 3.東京化研, 4.香川大教
	10:15 - 10:30	奨 12a-A25-6	$SrAl_2O_4$ファイバの高感度応力発光特性	○吉田 晃人[1], 松尾 ともみ[2], 原 陸洋[1], 川崎 悦子[1], 藤尾 侑輝[1], 徐 超男[1,2]	1.産総研, 2.九大
	10:30 - 10:45		休憩/Break		
	10:45 - 11:00	12a-A25-7	Ce^{3+}:GAGG結晶における光誘起欠陥の赤外分光	○(B)稲葉 涼太[1], 北浦 守[1], 鎌田 圭[2], 黒澤 俊介[3], 大西 彰正[1], 佐々木 実[1], 原 和彦[4]	1.山形大理, 2.東北大 NICHe, 3.東北大金研, 4.静岡大電研
	11:00 - 11:15	12a-A25-8	Ce,Mg 共添加 $(La, Gd)_2Si_2O_7$単結晶における発光特性の温度依存性	○村上 力輝斗[1], 黒澤 俊介[1,2], Vitezslav Jary[3], 北浦 守[4], 庄子 育宏[1,5], 山ノ井 航平[6], 有田 廉[6], 横田 有為[2], Jan Pejchal[2,3], 大橋 雄二[1], 鎌田 圭[2,5], 猿倉 信彦[6], 大西 彰正[4], Martin Nikl[3], 吉川 彰[1,2,5]	1.東北大金研, 2.東北大NICHe, 3.チェコ物理研, 4.山形大理, 5.(株)C&A, 6.阪大レーザー研
	11:15 - 11:30	12a-A25-9	Eu^{3+}をトラップ増感剤とした新規赤色Mn残光蛍光体$(Zn_yMg_{1-y})GeO_3:Mn^{2+}$-$Eu^{3+}$の光学特性評価	○家弓 朋広[1], 片山 裕美子[1], 上田 純平[1], 田部 勢津久[1]	1.京都大学
	11:30 - 11:45	奨 12a-A25-10	$LaAlO_3:Cr^{3+}$ペロブスカイト蛍光体の深赤色長残光特性	○(P)片山 裕美子[1], 小林 大晃[1], 田部 勢津久[1]	1.京大院人環
	11:45 - 12:00	12a-A25-11	ナノ蛍光体を用いた太陽電池用波長変換膜	○(M1)坂田 陵輔[1], 土井 直紀[1], 石垣 雅[2], 大観 光徳[1,3], 大倉 央[4]	1.鳥大院工, 2.TiFREC, 3.TEDREC, 4.メルク(株)
	12:00 - 12:15	奨 12a-A25-12	$CuInS_2$及び$AgInS_2$/ZnS量子ドットのZnSコーティング回数依存性	○菱沼 賢智[1], 倉林 智和[1], 福田 武司[1], 鎌田 憲彦[1], 本多 善太郎[1]	1.埼玉大学
	12:15 - 12:30	12a-A25-13	シリカガラス薄膜中に分散した色素ナノ粒子の昇華抑制	○八巻 建樹[1], 倉林 智和[1], 福田 武司[1], 鎌田 憲彦[1], 本多 善太郎[1]	1.埼玉大理工

3月12日(木)　14:00 - 17:00					
	14:00 - 14:15	12p-A25-1	$Tb_3Ga_5O_{12}$:Eu^{3+}蛍光体の発光特性	○澤田 健士[1], 安達 定雄[1]	1.群馬大院理工
	14:15 - 14:30	12p-A25-2	$CaTiO_3$:Eu^{3+}蛍光体の作製と評価	○(B)折橋 拓也[1], 新井 敬章[1], 安達 定雄[1]	1.群馬大院理工
	14:30 - 14:45	12p-A25-3	KClへの(Ce^{3+}, Sn^{2+})イオン共賦活効果	○(M1)登坂 優希[1], 安達 定雄[1]	1.群馬大院理工
	14:45 - 15:00	12p-A25-4	$ZnSnF_6 \cdot 6H_2O$:Mn^{4+}赤色蛍光体の作製と評価	○(M1)星野 良介[1], 安達 定雄[1]	1.群馬大院理工
	15:00 - 15:15	12p-A25-5	ZnO薄膜における光波ー分極波長距離結合による超高速輻射緩和	○一宮 正義[1,2], 馬越 隆之[2], 佐伯 昴[2], 木下 岳[3], 石原 一[3], 川上 将輝[4], 中山 正昭[4], 芦田 昌明[2]	1.滋賀県大工, 2.阪大院基礎工, 3.阪府大院工, 4.阪市大院工
	15:15 - 15:30	12p-A25-6	分子線交互供給法によるCdSe量子ドットの作成と光学的評価II	○川崎 泰登[1], 米田 稔[1], 瀬戸 悟[2], 本田 亮[3], 谷山 智康[4]	1.岡山理大院理, 2.石川工業高専, 3.鳴門教育大, 4.東工大応セラ研
	15:30 - 15:45		休憩/Break		
	15:45 - 16:00	12p-A25-7	バイオテンプレート極限加工によるGaAs量子ナノディスクLEDの試作	○肥後 昭男[1], 木場 隆之[2,7], トーマス セドリック[3], 王 云鵬[4], 山下 一郎[5,7], 杉山 正和[6], 中野 義昭[6], 村山 明宏[2,7], 寒川 誠ニ[1,3,7]	1.東北大学WPI-AIMR, 2.北大情報科学, 3.東北大流体研, 4.東大先端研, 5.奈良先端大, 6.東大院工, 7.JST-CREST
	16:00 - 16:15	12p-A25-8	$La_2Ti_2O_7$:Prのフォトルミネッセンスおよびエレクトロルミネッセンス特性	○京免 徹[1], 斎藤 志道[1], 花屋 実[1], 高島 浩[2]	1.群馬大院理工, 2.産総研
	16:15 - 16:30	12p-A25-9	$Ca_{0.6}Sr_{0.4}TiO_3$:Prを用いた薄膜型および粉末型EL素子における低電圧発光現象2	○池上 敬一[1], 中川 祐希[2], 三浦 登[2], 伯田 幸也[1], 高島 浩[1]	1.産総研, 2.明大理工
	16:30 - 16:45	12p-A25-10	$BaTiO_3$ナノ粒子を塗布した無機薄膜エレクトロルミネッセンス素子	○畑山 進也[1], 板垣 悠己[1], 手良向 晴貴[1], 石垣 雅[2], 大観 光徳[1,3]	1.鳥大院工, 2.TiFREC, 3.TEDREC
	16:45 - 17:00	12p-A25-11	発光側電極にグラフェンを使用した分散型ELの特性	張 栖岩[1], 大久保 貴雅[2], 奥村 竜二[2], 市川 洋[2], ○佐藤 利文[1]	1.東京工芸大工メディア, 2.名工大計測

13.9 光物性・発光デバイス / Optical properties and light-emitting devices　ポスター講演

3月13日(金)　16:30 - 18:30					
		13p-P18-1	誘導結合プラズマによるEu添加$KSrPO_4$蛍光体の還元効果の水素濃度依存性	○高地 満寿雄[1], 山上 紘平[1], 佐々木 徹[1], 菊池 崇志[1], 加藤 有行[1]	1.長岡技科大工
		13p-P18-2	電気泳動堆積によるペロブスカイト酸化物を用いた多層膜無機ELの作製	駒形 大樹[1], ○加藤 有行[1]	1.長岡技科大工
		13p-P18-3	白色LED応用に向けた$CaY_2Si_2S_8$:Ce^{3+}, Eu^{2+}蛍光体の発光特性	○田邊 冬夢[1], 加藤 有行[1]	1.長岡技科大工
		13p-P18-4	高圧相SrO:Eu青色蛍光体の焼成プロセス	○小松 啓志[1], 中村 淳[1,2], 大塩 茂夫[1], 齋藤 秀俊[1]	1.長岡技科大, 2.中部キレスト
		13p-P18-5	植物栽培用Mn付活蛍光体の合成	○藤田 佳子[1], 國本 崇[1]	1.徳文大理工
		13p-P18-6	$Y_4(SiS_4)_3$:Tb蛍光体へのGe添加による吸収帯の制御	○鈴木 智大[1], 七井 靖[1], 奥野 剛史[1]	1.電通大先進理工
		13p-P18-7	赤色硫化物蛍光体La_2S_3:Ce^{3+}の発光特性	○室崎 祐[1], 七井 靖[1], 奥野 剛史[1]	1.電通大先進理工
		13p-P18-8	希土類チオシリケート蛍光体$(Y_{1-x}Tb_x)_4(SiS_4)_3$の時間分解フォトルミネッセンス	○鈴木 洋介[1], 七井 靖[1], 奥野 剛史[1]	1.電通大先進理工
		13p-P18-9	サイト選択分光法による$(La,Ce,Y)_6Si_4S_{17}$蛍光体のスペクトル分離	○(P)七井 靖[1], 室崎 祐[1], 奥野 剛史[1]	1.電通大 先進理工
		13p-P18-10	高強度近赤外応力発光体$Sr_3Sn_2O_7$: Nd^{3+}の開発	○(M1)大城 裕貴[1,2], 塗 東[1,2], 藤尾 侑輝[2], 徐 超男[1,2,3]	1.九大総理工, 2.産総研, 3.九大WPI-I2CNER
		13p-P18-11	局在発光中心型酸化物蛍光体における光音響信号とPLの関係	○古川 恵大[1], 深田 晴己[1], 山口 敦史[1]	1.金沢工大O.E.D.S. R&Dセンター
		13p-P18-12	MOD法を用いたアップコンバージョン蛍光体の発光特性評価	○久保 孝徳[1], 菖蒲 勇[1], 大山 渓人[1], 野中 俊宏[1], 山本 伸一[1]	1.龍谷大理工
		13p-P18-13	LaOF:Yb^{3+}/Er^{3+}アップコンバージョン蛍光体の発光特性評価	○大山 渓人[1], 野中 俊宏[1], 山本 伸一[1]	1.龍谷大理工
		13p-P18-14	ホットインジェクション法を用いたCu-In-S/ZnS 量子ドットの作製	○宮城 拓未[1], 尾川 弘祐[1], 長久保 準基[2], 永田 智啓[2], 山本 伸一[1]	1.龍谷大理工, 2.(株)アルバック
		13p-P18-15	Cu-In-S/ZnS量子ドットの合成および発光特性評価	○尾川 弘祐[1], 宮城 拓未[1], 長久保 準基[2], 永田 智啓[2], 山本 伸一[1]	1.龍谷大理工, 2.(株)アルバック
		13p-P18-16	P$ドープ(NH_4)_2SiF_6$微粒子の発光特性評価	○北澤 駿[1], 佐藤 慶介[1], 深田 直樹[2], 平栗 健二[1]	1.東京電機大学院工, 2.物材機構
		13p-P18-17	引っ張り歪みGOIのCMP薄膜化による発光強度増大	○橋本 秀明[1], 徐 学俊[1], 澤野 憲太郎[1], 丸泉 琢也[1]	1.都市大総研
		13p-P18-18	Eu^{3+}イオンをドープしたZnOナノ粒子の発光特性における表面欠陥の影響	○安藤 俊介[1], 石墨 淳[1], 柳 久雄[1]	1.奈良先端大物質
		13p-P18-19	Mn^{2+}ドープコア/シェルCdS/ZnSナノ粒子における発光特性のドープ濃度及び位置依存性	○柳澤 祐介[1], 石墨 淳[1], 柳 久雄[1]	1.奈良先端
		13p-P18-20	O_2及びNOガスを用いて作製したEu,O共添加GaNの表面モフォロジーとEu発光特性	○高津 潤一[1], 松田 将明[1], 児島 貴徳[1], 小泉 淳[1], 藤原 康文[1]	1.大阪大工
		13p-P18-21	InPの2光子吸収係数βの偏光方向依存性シミュレーション	○李 修平[1], 坂東 弘之[1], 大石 真樹[1], 松末 俊夫[1]	1.千葉大院融合

13.10 化合物太陽電池, 15.2 II-VI族結晶および多元系結晶のコードシェアセッション　口頭講演

3月12日(木)　13:30 - 17:45					
	13:30 - 13:45	12p-A26-1	ZnTe基板上へのClドープCdTe薄膜のMBE成長	○(M1)寺沢 俊貴[1], 田中 徹[1], 斉藤 勝彦[1], 郭 其新[1], 西尾 光弘[1]	1.佐賀大院工
	13:45 - 14:00	12p-A26-2	MBEによる高不整合材料ZnCdTeO薄膜の成長	○(B)岡野 友紀[1], 溝口 耕輔[1], 寺沢 俊貴[1], 田中 徹[1], 斉藤 勝彦[1], 郭 其新[1], 西尾 光弘[1]	1.佐賀大学
	14:00 - 14:15	奨 12p-A26-3	PLD法による透明p型導電性BaCuSF膜の作製とCdTe太陽電池への応用	○川邉 利幸[1], 榊間 博[1], 小川 洋平[2], 細野 藍響[2], 岡本 保[2], 和田 隆博[1]	1.龍谷大理工, 2.木更津高専
	14:15 - 14:30	12p-A26-4	グラフェン透明導電膜の薄膜化合物太陽電池応用	○石川 亮佑[1], 大矢 智也[1], 野本 隆宏[1], 坪井 望[1]	1.新潟大工
	14:30 - 14:45	12p-A26-5	Se蒸気圧制御によるCZTSナノ粒子薄膜のSe化	○梅嶋 悠人[1], 井狩 華奈美[1], 上村 一生[1], 張 険峰[2], 小林 正和[1,3]	1.早大先進理工, 2.早大ICSEP, 3.早大材研

	14:45 - 15:00	12p-A26-6	ゾルゲル硫化法によるCu_2ZnSnS_4薄膜の作製におけるUV/O_3処理の効果 II	○宮沢 勇斗[1], 田中 久仁彦[1], 打木 久雄[1]	1.長岡技大
	15:00 - 15:15	12p-A26-7	ミスト CVD 法による Cu_2ZnSnS_4 薄膜の作製と評価	○渡辺 勇一郎[1], 池之上 卓己[1], 三宅 正男[1], 平藤 哲司[1]	1.京大院エネ科
	15:15 - 15:30	奨 12p-A26-8	ナフテン酸銅, ナフテン酸亜鉛およびオクチル酸スズとジメチルセレンを用いた$Cu_2ZnSnSe_4$薄膜の作製	○山田 諒太[1], 田橋 正浩[1], 高橋 誠[1], 吉野 賢二[2], 後藤 英雄[1]	1.中部大学, 2.宮崎大学
	15:30 - 15:45		休憩/Break		
	15:45 - 16:00	12p-A26-9	Cu_2ZnSnS_4ナノ粒子の液相合成におけるCu^{2+}還元過程	○(M1)森下 一喜[1], 須藤 裕之[1], 神谷 格[1]	1.豊田工大
	16:00 - 16:15	12p-A26-10	Cu_2ZnSnS_4ナノ粒子を用いた塗布型太陽電池の作製	○杉本 寛太[1], 桑名 潤[1], 後藤 仁憲[1], 陶山 直樹[1], 張 毅閒[2], 黒川 康良[1], 山田 明[1,3]	1.東工大院理工, 2.凸版印刷, 3.東工大PVREC
	16:15 - 16:30	12p-A26-11	HAXPESによる窓層/CdS層/CZTS層界面のバンド構造評価	○田島 伸[1], 片岡 恵太[1], 梅原 密太郎[1], 高橋 直子[1], 木本 康司[1], 北住 幸介[1], 磯村 典武[1]	1.豊田中研
	16:30 - 16:45	12p-A26-12	$Zn_{1-x}Mg_xO/Cu_2ZnSn(S, Se)_4$界面のバンド接続の in-situ 評価	○諏訪原 裕貴[1]	1.鹿児島大
	16:45 - 17:00	E 12p-A26-13	Photocarrier dynamics in $Cu_2ZnSn(S_xSe_{1-x})_4$ single crystals: Composition dependence	○(PC)Le Quang Phuong[1,2], Makoto Okano[1], Genki Yamashita[3], Masaya Nagai[3], Masaaki Ashida[3], Akira Nagaoka[1,4], Kenji Yoshino[4], Yoshihiko Kanemitsu[1,2]	1.Kyoto Univ., 2.JST-CREST, 3.Osaka Univ., 4.Univ. of Miyazaki
	17:00 - 17:15	E 12p-A26-14	Suppression of nonradiative recombination centers in Cu_2ZnSnS_4 single crystals by sodium doping	○(PC)Le Quang Phuong[1,2], Makoto Okano[1], Genki Yamashita[3], Masaya Nagai[3], Masaaki Ashida[3], Akira Nagaoka[1,4], Kenji Yoshino[4], Yoshihiko Kanemitsu[1,2]	1.Kyoto Univ., 2.JST-CREST, 3.Osaka Univ., 4.Univ. of Miyazaki
	17:15 - 17:30	12p-A26-15	電子線照射によるCu_2ZnSnS_4太陽電池の電気的・光学的特性への影響	○相原 理[1], 坂倉 秀徳[1], 片桐 裕則[2], 杉山 睦[1]	1.東京理科大 理工/総研, 2.長岡高専
	17:30 - 17:45	奨 12p-A26-16	ケステライト化合物$Cu_2ZnSn(S_x, Se_{1-x})_4$単結晶中の固有散乱メカニズム	○永岡 章[1,5], Scarpulla Michael[2], 柿本 浩一[3], 吉野 賢二[4], 野瀬 嘉太郎[1]	1.京大院工, 2.米ユタ大, 3.九大応力研, 4.宮崎大工, 5.学振特別研究員PD
	3月13日(金) 9:00 - 12:15				
	9:00 - 9:15	奨 13a-A17-1	近接昇華法を用いたサファイア基板上のAg(Ga,Al)Te_2混晶作製	○宇留野 彩[1], 薄井 綾香[1], 竹田 裕二[1], 井上 朋大[1], 小林 正和[1,2]	1.早大先進理工, 2.早大材研
	9:15 - 9:30	13a-A17-2	$CuInSe_2$-In_2Se_3系化合物の結晶構造と光学的性質	○(PC)前田 毅[1], 宮 イゲン[1], 和田 隆博[1]	1.龍谷大理工
	9:30 - 9:45	奨 13a-A17-3	$CuGaSe_2$-ZnSe系化合物の結晶構造と光学的性質	○山田 悠斗[1], 前田 毅[1], 竹井 康二[1], 和田 隆博[1]	1.龍谷大理工
	9:45 - 10:00	13a-A17-4	Znのサイト選択ドーピングによるp形CIGS薄膜の作製	○白方 祥[1], 吉田 正吾[1], 岸田 貴志[1], 弓達 新治[1], 宮田 晃[1]	1.愛媛大 工
	10:00 - 10:15	13a-A17-5	CIGS薄膜のその場PL測定	○深井 尋史[1], 池村 賢一郎[2], 井口 和也[2], エル リ カオ ザッカーリ[1], カトリ イズール[1], 松山 勇[1], 山口 博[1], 中田 時夫[1]	1.東京理科大総研, 2.浜松ホトニクス
	10:15 - 10:30	13a-A17-6	$CuIn_{1-x}Ga_xSe_2$ における光キャリアの緩和及び拡散ダイナミクス	○岡野 真人[1], 櫻井 岳暁[2], 秋本 克洋[2], 柴田 肇[3], 仁木 栄[3], 金光 義彦[1,4]	1.京大化研, 2.筑波大数物研, 3.産総研・太陽光発電工学研究センター, 4.JST-CREST
	10:30 - 10:45	E 13a-A17-7	Microstructure Characteristics of Cu(In, Ga)Se_2 Thin Films Investigated by TEM	○(PC)HyungSeok Kim[1,4], T. Ohkubo[1], K. Hono[1], K. Yoshida[2], T. Nakada[3]	1.NIMS, 2.Osaka Univ., 3.Tokyo Univ. of Sci., 4.LG Electronics
	10:45 - 11:00	13a-A17-8	Lift-off法を用いたsuperstrate型Cu(In,Ga)Se_2薄膜太陽電池におけるPEDOT:PSS裏面電極の検討	○新澤 雄高[1], 新井 裕之[1], 廣庭 大輔[1], 峯元 高志[1]	1.立命館大学
	11:00 - 11:15	13a-A17-9	裏面パッシベーション効果を利用したCIGS太陽電池特性	○崔 誠佑[1], 上川 由紀子[1], 西永 慈郎[1], 山田 昭政[1], 柴田 肇[1], 仁木 栄[1]	1.産総研
	11:15 - 11:30	E 13a-A17-10	Effect of KF-PDT on MBE-Grown Cu(In_{1-x},Ga_x)Se_2 Thin Film	○(PC)Ishwor Khatri[1], Hirofumi Fukai[1], Isamu Matsuyama[1], Hiroshi Yamaguchi[1], Tokio Nakada[1]	1.Tokyo University of Science
	11:30 - 11:45	13a-A17-11	Photovoltages and Their Dependence on Incident Light Wavelengths on CIGS Solar Cells Investigated by P-KFM	○(D)Hyeondeuk Yong[1], Takashi Minemoto[3], Takuji Takahashi[1,2]	1.IIS, The Univ. of Tokyo, 2.INQIE, The Univ. of Tokyo, 3.Coll. of Sci. and Eng., Ritsumeikan Univ.
	11:45 - 12:00	13a-A17-12	CIGS上でのケルビンプローブフォース顕微鏡及び静電引力顕微鏡による表面電位分布と静電引力スペクトルの観測	○石井 智章[1], 峯元 高志[3], 高橋 琢二[1,2]	1.東大生研, 2.東大ナノ量子機構, 3.立命館大理工
招待	**12:00 - 12:15**	**13a-A17-13**	**「講演奨励賞受賞記念講演」(15分) Cu(In,Ga)Se2薄膜太陽電池の 価電子帯制御による界面再結合抑制効果の理論的及び実験的検証**	**○西村 昂人[1], 平井 義晃[1], 黒川 康良[1], 山田 明[1,2]**	**1.東工大院理工, 2.太陽光発電システム研究センター**

13.10 化合物太陽電池, 15.2 II-VI族結晶および多元系結晶のコードシェアセッション　ポスター講演

3月13日(金) 16:30 - 18:30

		13p-P19-1	電着法によるFeSe薄膜の作製と物性評価II	○(M1)長屋 智紀[1], 高橋 誠[1], 鈴木 崇也[1], 田橋 正浩[1], 大木戸 貞夫[1]	1.中部大学
		13p-P19-2	酸性溶液中で硫黄源の仕込み量がSnS膜に与える影響	○石川 佑[1], 宮﨑 尚[1], 岡本 庸一[1], 守本 純[1]	1.防衛大材料
		13p-P19-3	硫化法を用いたSnS薄膜における組成比が電気特性に与える影響	○三上 俊太郎[1], 横井 翼[1], 鷲見 浩貴[1], 相原 理[1], 永易 京[1], 久富 一真[1], 杉山 睦[1]	1.東京理科大学理工学部/総合研究機構
		奨 13p-P19-4	GeS_2とS蒸気反応を用いたCu_2GeS_3薄膜太陽電池の作製	○知野 広太郎[1], 豊永 詞[1], 金井 綾香[1], 荒木 秀明[1,2]	1.長岡高専, 2.科学技術振興機構, さきがけ
		13p-P19-5	スプレー熱分解法によるCu_2ZnSnS_4薄膜太陽電池の作製	○(B)藤川 祥太朗[1], ヒエップ グエン ティ[1], ウィルマン セプティナ[1], 原田 隆史[1], 池田 茂[1], 松村 道雄[1]	1.阪大太陽エネルギー化学研セ
		13p-P19-6	2段階同時蒸着法による$Cu_2ZnSnSe_4$薄膜作製の検討	○村上 秀憲[1], 大塚 健介[1], 弓達 新治[1], 宮田 晃[1], 白方 祥[1]	1.愛媛大工
		13p-P19-7	$Cu_2ZnSn(S,Se)_4$ナノ粒子を用いた塗布薄膜の焼成条件による影響	○鈴木 俊正[1], 鈴木 吏[2], 堀 茂雄[2], 野々村 修一[2]	1.JFCC, 2.岐阜大学
		13p-P19-8	時間の経過による三次元構造Cu_2ZnSnS_4太陽電池の特性変化	○田中 久仁彦[1], 長橋 由樹[1], 石山 貴道[1], 森谷 克彦[2], 打木 久雄[1]	1.長岡技大, 2.鶴岡高専
		13p-P19-9	分子線エピタキシー法による$CuGaS_2$薄膜の作製と評価 ～$(NH_4)_2S_x$による過剰Cu_xSのエッチング～	○倉掛 真弥[1], 岡 優貴[1], 松下 将也[1], 山田 秀明[1], 阿部 友紀[1], 市野 邦男[1]	1.鳥大院工
		13p-P19-10	MEE法を用いて成長したGaAs(001)基板上CIS-CGS構造の評価	○豊田 康揮[1], 佐藤 知嵩[1], 谷口 龍希[1], サティア パマ[1], 堀越 佳治[1], 牧本 俊樹[1]	1.早稲田大学
		13p-P19-11	大気中におけるCIGS太陽電池の効率劣化の検証	○西永 慈郎[1], 上川 由紀子[1], 崔 誠佑[1], 柴田 肇[1], 仁木 栄[1]	1.産総研

		13p-P19-12	二波長蛍光分光法および光容量分光法を用いた鉛ハライド系ペロブスカイト太陽電池の欠陥準位評価	○中澤 紀祥[1], 櫻井 岳暁[1], M.M. Islam[1], 秋本 克洋[1], 尾込 裕平[2], 早瀬 修二[2]	1.筑波大, 2.九工大
		13p-P19-13	ペロブスカイト太陽電池に用いる多孔質酸化チタン層の昇温脱離分析	○(B)宝山 修士[1], ハシーヤ カリマ アディリ[1], 原田 隆史[1], 池田 茂[1], 伊藤 省吾[2], 松村 道雄[1]	1.大阪大基礎工, 2.兵庫県立大工
		13p-P19-14	量子ドット増感型太陽電池の量子ドット生成法に対するフォトキャリア取り出し効率の比較	○家山 昂[1], 尾崎 信彦[1], 大渕 隆文[2], 福田 直晃[2], 加藤 美奈子[3], 滝谷 俊夫[3]	1.和歌山大シス工, 2.京都大, 3.日立造船(株)
		13p-P19-15	ARMによるInGaP/GaAs/Si 3接合セル中サブセル特性の制御	○重川 直輝[1], 梁 剣波[1]	1.大阪市大工
		13p-P19-16	多接合太陽電池応用に向けたGaAs/Ge表面活性化接合技術の検討	○山下 大之[1], 河野 元紀[1], 渡辺 健太郎[1], 杉山 正和[1], 須賀 唯知[1], 中野 義昭[1]	1.東大工
		13p-P19-17	GaAs:N δドープ超格子を有する太陽電池の二段階光吸収	○鈴木 智也[1], 八木 修平[1], 土方 泰斗[1], 岡田 至崇[2], 矢口 裕之[1]	1.埼玉大理工, 2.東大先端研
		E 13p-P19-18	GaNAs quantum structures embedded in GaAs p-i-n for Intermediate Band Solar Cell with zero valance band offset	○Martin Elborg[1], Takeshi Noda[1], Liyuan Han[1]	1.NIMS, Tsukuba
		13p-P19-19	面内高密度InAs量子ドット層における光伝導特性	○(B)秋元 直己[1], 内田 俊介[1], 山口 浩一[1]	1.電通大
		13p-P19-20	ECRプラズマ作製によるCu/Cu_2O型PVセルの特性に与える水素プラズマ前処理の効果	○奈良 拓馬[1], 菊地 悠介[1], 佐藤 直幸[1], 池畑 隆[1]	1.茨城大院理工
		13p-P19-21	ECRプラズマ作製によるCu/Cu_2O型PVセルの大気曝露特性	○長谷川 基輝[1], 菊地 悠介[1], 佐藤 直幸[1], 池畑 隆[1]	1.茨城大院理工
		13p-P19-22	Free-standing InP Nanowire Array and Their Optical Properties Toward Resource-Saving Solar Cells	○(M1)muyi Chen[1], Eiji Nakai[1], katsuhiro Tomioka[1,2], takashi Fukui[1]	1.Graduate school of IST and RCIQE Hokkaido Univ.,, 2.JST-PRESTO

13.10 化合物太陽電池 / Compound solar cells　口頭講演

3月12日(木)　10:00 - 12:00

	10:00 - 10:15	12a-A26-1	電気化学堆積硫化鉄薄膜の硫黄アニール処理とZnOとのヘテロ接合への応用	○梶間 崇宏[1], 川井 正一[2], 市村 正也[1]	1.名工大, 2.デンソー
	10:15 - 10:30	12a-A26-2	電気化学法によるCu_2O/α-Fe_2O_3ヘテロ接合太陽電池の作製	○(M1)張 朝龍[1], 市村 正也[1]	1.名工大
	10:30 - 10:45	12a-A26-3	SnプレカーサへのS添加がSnS薄膜の硫化成長に与える影響	○横井 翼[1], 三上 俊太郎[1], 鷲見 浩貴[1], 相原 理[1], 永易 京[1], 久富 一真[1], 杉山 睦[1]	1.東京理科大学理工学部/総合研究機構
	10:45 - 11:00	奨 12a-A26-4	硫化物 / $ZnSnP_2$ ヘテロ接合界面におけるバンドオフセット評価	○(D)中塚 滋[1], 中元 宏[1], 野瀬 嘉太郎[1], 池田 茂[2], 白井 泰治[1]	1.京大院工, 2.阪大太陽エネ研セ
	11:00 - 11:15	12a-A26-5	硫化成膜したCu_2SnS_3薄膜とプレカーサのCu/Sn組成比との相関	○鷲見 浩貴[1], 佐藤 宗一[1], 史 冠男[1], 杉山 睦[1]	1.東京理科大学理工学部／総合研究機構
	11:15 - 11:30	奨 12a-A26-6	Na添加プリカーサを用いた硫化法によるCu_2SnS_3薄膜の作製	○中嶋 崇喜[1], 藤本 純弥[1], 山口 利幸[1]	1.和歌山高専
	11:30 - 11:45	12a-A26-7	Cu_2SnS_3薄膜におけるドナーアクセプター対再結合発光	○粟飯原 直也[1], 田中 久仁彦[1], 打木 久雄[1], 金井 綾香[2], 荒木 秀明[2,3]	1.長岡技大, 2.長岡高専, 3.JST-さきがけ
	11:45 - 12:00	12a-A26-8	第一原理計算によるCu_2SnS_3太陽電池材料の空格子欠陥の評価	○西原 弘訓[1], 前田 毅[1], 繁實 章夫[1], 和田 隆博[1]	1.龍谷大理工

3月13日(金)　9:30 - 12:15

	9:30 - 9:45	13a-A26-1	可視光励起光電子分光法を用いた半導体超格子における伝導電子のエネルギー分布測定	○(DC)市橋 史朗[1], 西谷 健治[1], 董 鑫宇[1], 川口 昂彦[2], 桑原 真人[1], 原田 俊太[1], 田川 美穂[1], 伊藤 孝寛[1], 宇治原 徹[1]	1.名大院工, 2.名大VBL
	9:45 - 10:00	奨・E 13a-A26-2	Carrier Collection Efficiency for Multiple Quantum Well Solar Cells under High Sunlight Concentration	○(D)Warakorn Yanwachirakul[1], Hiromasa Fujii[1], Kasidit Toprasartpong[1], Hassanet Sodabunlu[1], Kentaroh Watanabe[2], Masakazu Sugiyama[1], Yoshiaki Nakano[1]	1.Univ. of Tokyo, 2.RCAST
	10:00 - 10:15	奨 13a-A26-3	InAs/GaAs量子ドット超格子太陽電池における超高速過渡光電流応答	○谷渕 泰三[1], 加田 智之[1], 笠松 直史[1], 松村 拓哉[1], 朝日 重雄[1], 喜多 隆[1]	1.神戸大院工
	10:15 - 10:30	E 13a-A26-4	Design and Simulation of Grating-Shaped Nano-Wall Structures for Light Absorption Enhancement in Quantum Dot Solar Cells	○(M2)Cyril Digiola[1,2], Satoshi Iwamoto[1,2], Yasuhiko Arakawa[1,2]	1.NanoQuine, 2.IIS, Univ. of Tokyo
	10:30 - 10:45	13a-A26-5	Siドープ量子ドット太陽電池の集光特性評価	○(DC)内藤 駿弥[1,2], 宮下 直也[2], 下村 北斗[1,2], 玉置 亮[2], 星井 拓也[1,2], 岡田 至崇[1,2]	1.東大院工, 2.東大先端研
	10:45 - 11:00		休憩/Break		
	11:00 - 11:15	13a-A26-6	Si ドープしたInAs 量子ドット太陽電池における2 段階光吸収過程	○下村 北斗[1], 玉置 亮[2], 内藤 駿弥[1], 岡田 至崇[1,2]	1.東大院工, 2.東大先端研
	11:15 - 11:30	奨 13a-A26-7	フォトフィリング効果を考慮した2段階光吸収の定量評価	○玉置 亮[1], 庄司 靖[1], 岡田 至崇[1], 宮野 健次郎[1]	1.東大先端研
	11:30 - 11:45	奨 13a-A26-8	単一量子ドット中における2段階光吸収電流の波長依存性	○野澤 朋宏[1,3], 都木 宏之[1,2], 渡邉 克之[1], 荒川 泰彦[1,2]	1.東大ナノ量子, 2.東大生研, 3.シャープ
	11:45 - 12:00	E 13a-A26-9	Negative two-step two-photon-absorption photocurrent induced by infrared photons in quantum dots: dot density dependence	○(PC)David Tex[1,2], Kouichi Akahane[3], Yoshihiko Kanemitsu[1,2]	1.ICR Kyoto Univ., 2.JST-CREST, 3.NICT
	12:00 - 12:15	13a-A26-10	量子ドット中間バンド型太陽電池の2段階光電流の励起光強度依存性	○(DC)朝日 重雄[1], 寺西 陽之[1], 笠松 直史[1], 加田 智之[1], 海津 利行[1], 喜多 隆[1]	1.神戸大院工

3月14日(土)　9:30 - 12:00

	9:30 - 9:45	14a-A26-1	分極を制御したGa極性面上III族窒化物太陽電池の新規構造	○中村 亮裕[1], 藤井 克司[2], 杉山 正和[1], 中野 義昭[1]	1.東大工, 2.GS+I
	9:45 - 10:00	14a-A26-2	スマートスタック構造における接合界面の詳細分析	○水野 英範[1], 牧田 紀久夫[1], 穂積 康雄[1], 菅谷 武芳[1], 松原 浩司[1], 高遠 秀尚[1]	1.産総研
	10:00 - 10:15	E 14a-A26-3	Reduction in Optical Reflection Loss at Intermediate Adhesive Layer for Mechanical Stacked Multi-Junction Solar Cells	○Shunsuke Kimura[1], Tomohiko Nakamura[1], Shinya Yoshidomi[1], Masahiko Hasumi[1], Toshiyuki Sameshima[1]	1.TUAT
	10:15 - 10:30	E 14a-A26-4	Contribution of absorption and recombination losses in subcell photocurrent-spectra determined by wavelength-dependent time-resolved photoluminescence	○(PC)David Tex[1,4], Hidefumi Akiyama[2,4], Mitsuru Imaizumi[3], Yoshihiko Kanemitsu[1,4]	1.ICR Kyoto Univ., 2.ISSP Tokyo Univ., 3.JAXA, 4.JST-CREST
	10:30 - 10:45	14a-A26-5	3接合タンデム太陽電池から放射されるテラヘルツ波特性	○濱内 翔太[1], 酒井 裕司[1], 梅垣 俊仁[1], 伊藤 明[2], 中西 英俊[2], 川山 巌[1], 村上 博成[1], 斗内 政吉[1]	1.阪大レーザー研, 2.SCREEN ホールディングス
	10:45 - 11:00		休憩/Break		

	11:00 - 11:15	14a-A26-6	多接合太陽電池のエレクトロルミネッセンス絶対光量画像計測	○吉田 正裕[1], 朱 琳[1], 金 昌秀[1], 秋山 英文[1], 陳 少強[2], 望月 敏光[3], 久保田 英博[4], 中村 徹哉[5], 今泉 充[5], 金光 義彦[6]	1.東大物性研, 2.華東師範大, 3.産総研, 4.アトー(株), 5.JAXA, 6.京大化研
	11:15 - 11:30	14a-A26-7	InGaAs/GaAsP超格子の太陽電池における波状構造の影響	○(B)加藤 巧[1], 藤井 宏昌[1], ソダーバンル ハッサネット[2], 渡辺 健太郎[2], 杉山 正和[1], 中野 義昭[1]	1.東大工, 2.東大先端研
	11:30 - 11:45	E 14a-A26-8	Lattice-matched III-V/Ge triple junction solar cell with InGaAs/GaAsP superlattice middle cell	○Hassanet Sodabanlu[1], Hiromasa Fujii[2], Kentaroh Watanabe[1], Masakazu Sugiyama[2], Yoshiaki Nakano[1,2]	1.RCAST, The Univ. of Tokyo, 2.School of Engineering, The Univ. of Tokyo
	11:45 - 12:00	14a-A26-9	高効率格子整合4接合太陽電池に向けた実効バンドギャップ1.15 eVのInGaAs/GaAsP歪補償量子井戸	○トープラサートポン カシディット[1], 藤井 宏昌[1], Thomas Tomos[3], Führer Markus[3], Alonso-Álvarez Diego[3], Farrell Daniel J.[3], 渡辺 健太郎[2], 岡田 至崇[2], Ekins-Daukes Nicholas J.[3], 杉山 正和[1], 中野 義昭[1]	1.東大工, 2.東大先端研, 3.インペリアルカレッジ

15 結晶工学 / Crystal Engineering

15.1 バルク結晶成長 / Bulk crystal growth　口頭講演

3月12日(木)　9:30 - 11:45

	9:30 - 9:45	E 12a-D13-1	Properties of InGaSb crystals grown under μG at International Space Station and 1G conditions	○NirmalKumar Velu[1], Arivanandhan Mukannan[1], Rajesh Govindasamy[1], Tadanobu Koyama[1], Yoshimi Momose[1], Yuko Inatomi[2], Kaoruho Sakata[2], Takehiko Ishikawa[2], Masahiro Takayanagi[2], Shinnichi Yoda[2], Shigeki Kamigaichi[2], Tetsuo Ozawa[3], Yasunori Okano[4], Yasuhiro Hayakawa[1]	1.RIE, Shizuoka Univ., 2.JAXA, 3.Shizuoka Insti Sci., 4.Osaka Univ.
	9:45 - 10:00	12a-D13-2	宇宙環境を利用した均一組成SiGe結晶育成実験	○荒井 康智[1], 木下 恭一[1], 稲富 祐光[1], 塚田 隆夫[2], 阿部 敬太[2], 住岡 沙羅[2], 久保 正樹[2]	1.宇宙機構, 2.東北大院工
	10:00 - 10:15	12a-D13-3	$CaSi_2$多結晶の育成及び$CaSi_2$組成近傍のCa-Si 2元系状態図	○八百川 律子[1], 中野 秀之[1,2]	1.豊田中研, 2.さきがけ
	10:15 - 10:30	12a-D13-4	マイクロ引き下げ法による難加工性Ir合金細線作製技術の開発	○横田 有為[1], 中村 宗樹[2], 田中 邦弘[2], 坂入 弘一[2], 黒澤 俊介[1,3], 大橋 雄二[3], 鎌田 圭[1,4], 吉川 彰[1,3,4]	1.東北大NICHe, 2.田中貴金属工業, 3.東北大金研, 4.C&A
	10:30 - 10:45	12a-D13-5	直線集束ビーム超音波材料解析システムによる$Ca_3Ta(Ga_{0.5}Al_{0.5})_3Si_2O_{14}$単結晶の均質性評価法	○大橋 雄二[1], 工藤 哲男[1], 横田 有為[2], 庄子 育宏[3], 黒澤 俊介[1,2], 鎌田 圭[2,3], 吉川 彰[1,2,3]	1.東北大金研, 2.東北大NICHe, 3.C&A
	10:45 - 11:00	E 12a-D13-6	Congruency and Liquid Immiscibility in Langasite-type Crystal with Four Elements	○(DC)Hengyu Zhao[1], Jun Nozawa[1], Haruhiko Koizumi[1], Kozo Fujiwara[1], Satoshi Uda[1]	1.IMR, Tohoku Univ.,
	11:00 - 11:15	12a-D13-7	コングルエント・二オブ酸リチウム単結晶成長における酸素挙動	○宇田 聡[1]	1.東北大金研
	11:15 - 11:30	12a-D13-8	Ar雰囲気下での熱処理による不純物添加したニオブ酸リチウムの酸素欠陥の形成	○小山 千尋[1], 野澤 純[1], 藤原 航三[1], 宇田 聡[1]	1.東北大金研
	11:30 - 11:45	12a-D13-9	マイクロ引き下げ法を用いた$CeBr_3$結晶の育成における育成条件の改善とPr添加効果	○伊藤 友樹[1], 横田 有為[2], 黒澤 俊介[1,2], Pejchal Jan[2,4], 大橋 雄二[1], 鎌田 圭[2,3], 吉川 彰[1,2,3]	1.東北大金研, 2.東北大NICHe, 3.(株)C&A, 4.チェコ物理研

15.1 バルク結晶成長 / Bulk crystal growth　ポスター講演

3月12日(木)　16:00 - 18:00

		E 12p-P14-1	Thermoelectric properties of compositionally homogeneous p and n-type SiGe bulk crystals	○Omprakash Muthusamy[1], Arivanandhan Mukannan[1], Tadanobu Koyama[1], Yoshimi Momose[1], Hiroya Ikeda[1], Hirokazu Tatsuoka[1], Yasunori Okano[2], Tetsuo Ozawa[3], Yuko Inatomi[4], Bhattacharya Shovit[5], Aswal Dinesh[5], MoorthyBabu Sridharan[6], Yasuhiro Hayakawa[1]	1.RIE Shizuoka Univ, 2.Osaka Univ., 3.Shizuoka Insti Sci., 4.JAXA, 5.BARC, 6.Anna Univ
		12p-P14-2	RuO_2単結晶の合成とその特性評価	○八巻 和宏[1], 番場 幸大[1], 入江 晃亘[1]	1.宇都宮大工
		12p-P14-3	高品質$AgGaSe_2$単結晶育成に向けたSe添加効果の検討 (II)	○須崎 昌己[1]	1.大阪府立大学高専

15.1 バルク結晶成長 / Bulk crystal growth　口頭講演

3月14日(土)　10:00 - 12:00

	10:00 - 10:15	14a-D13-1	VBサファイア結晶中のWインクルージョンの形成機構の検討	○杉本 圭[1], 太子 敏則[2], 干川 圭吾[1]	1.信州大工, 2.信州大環境エネ研
	10:15 - 10:30	14a-D13-2	垂直ブリッジマン法により育成したAl_2O_3/YAG:Ce-MGCの微細組織	○山田 聖也[1], 大葉 悦子[1], 太子 敏則[2], 干川 圭吾[1], 吉村 正文[1,3], 坂田 信一[3]	1.信州大工, 2.信州大環境エネ研, 3.宇部興産
	10:30 - 10:45	E 14a-D13-3	Modeling basal plane dislocations in single-crystal sapphire by Alexander–Haasen model	○Bing Gao[1], Koichi Kakimoto[1]	1.RIAM, Kyushu Univ.
	10:45 - 11:00	E 14a-D13-4	Correlation study on heating profile and carbon contamination during the melting process of Czochralski silicon crystal growth	○(P)Xin Liu[1], Bing Gao[1], Satoshi Nakano[1], Koichi Kakimoto[1]	1.RIAM, Kyushu Univ.
	11:00 - 11:15	14a-D13-5	交流電場印加による高品質タンパク質結晶の育成機構の解明 I	○小泉 晴比古[1], 宇田 聡[1], 藤原 航三[1], 橘 勝[2], 小島 謙一[3], 野澤 純[1]	1.東北大・金研, 2.横市大・院生命ナノ, 3.創英大・教育
	11:15 - 11:30	14a-D13-6	荷電コロイド系結晶成長における不純物分配挙動	○野澤 純[1], 胡 素梦[1], 小泉 晴比古[1], 藤原 航三[1], 宇田 聡[1]	1.東北大金研
	11:30 - 11:45	E 14a-D13-7	Impurity Partitioning of Grain Boundary during Polycrystalline Colloidal	○Sumeng Hu[1], Jun Nozawa[1], Koizumi Haruhiko[1], Fujiwara Kozo[1], Uda Satohi[1]	1.IMR. Tohoku Univ.
	11:45 - 12:00	14a-D13-8	重力沈降によって生成したシリカコロイド結晶の構造観察(II)	○大木 芳正[1], 中野 勇二[1], 川中 智司[1], 内田 文生[1]	1.富士化学㈱

13.10 化合物太陽電池, 15.2 II-VI族結晶および多元系結晶のコードシェアセッション　口頭講演

3月12日(木)　13:30 - 17:45

	13:30 - 13:45	12p-A26-1	ZnTe基板上へのClドープCdTe薄膜のMBE成長	○(M1)寺沢 俊貴[1], 田中 徹[1], 斉藤 勝彦[1], 郭 其新[1], 西尾 光弘[1]	1.佐賀大院工
	13:45 - 14:00	12p-A26-2	MBEによる高不整合材料ZnCdTeO薄膜の成長	○(B)岡野 友紀[1], 溝口 耕輔[1], 寺沢 俊貴[1], 田中 徹[1], 斉藤 勝彦[1], 郭 其新[1], 西尾 光弘[1]	1.佐賀大学
	14:00 - 14:15	奨 12p-A26-3	PLD法による透明p型導電性BaCuSF膜の作製とCdTe太陽電池への応用	○川邉 利幸[1], 榊間 博[1], 小川 洋平[2], 細野 藍響[2], 岡本 保[2], 和田 隆博[1]	1.龍谷大理工, 2.木更津高専
	14:15 - 14:30	12p-A26-4	グラフェン透明導電膜の薄膜化合物太陽電池応用	○石川 亮佑[1], 大矢 智也[1], 野本 隆宏[1], 坪井 望[1]	1.新潟大工
	14:30 - 14:45	12p-A26-5	Se蒸気圧制御によるCZTSナノ粒子薄膜のSe化	○梅嶋 悠人[1], 井狩 華奈美[1], 上村 一生[1], 張 険峰[2], 小林 正和[1,3]	1.早大先進理工, 2.早大ICSEP, 3.早大材研
	14:45 - 15:00	12p-A26-6	ゾルゲル硫化法によるCu_2ZnSnS_4薄膜の作製におけるUV/O_3処理の効果 II	○宮沢 勇斗[1], 田中 久仁彦[1], 打木 久雄[1]	1.長岡技大
	15:00 - 15:15	12p-A26-7	ミスト CVD 法による Cu_2ZnSnS_4 薄膜の作製と評価	○渡辺 勇一郎[1], 池之上 卓己[1], 三宅 正男[1], 平藤 哲司[1]	1.京大院エネ科
	15:15 - 15:30	奨 12p-A26-8	ナフテン酸銅, ナフテン酸亜鉛およびオクチル酸スズとジメチルセレンを用いた$Cu_2ZnSnSe_4$薄膜の作製	○山田 諒太[1], 田橋 正浩[1], 高橋 誠[1], 吉野 賢二[2], 後藤 英雄[1]	1.中部大学, 2.宮崎大学
	15:30 - 15:45		休憩/Break		
	15:45 - 16:00	12p-A26-9	Cu_2ZnSnS_4ナノ粒子の液相合成におけるCu^{2+}還元過程	○(M1)森下 一喜[1], 須藤 裕之[1], 神谷 格[1]	1.豊田工大
	16:00 - 16:15	12p-A26-10	Cu_2ZnSnS_4ナノ粒子を用いた塗布型太陽電池の作製	○杉本 寛太[1], 桑名 潤[1], 後藤 仁憲[1], 陶山 直樹[1], 張 毅聞[2], 黒川 康良[1], 山田 明[1,3]	1.東工大院理工, 2.凸版印刷, 3.東工大PVREC
	16:15 - 16:30	12p-A26-11	HAXPESによる窓層/CdS層/CZTS層界面のバンド構造評価	○田島 伸[1], 片岡 恵太[1], 梅原 密太郎[1], 高橋 直子[1], 木本 康司[1], 北住 幸介[1], 磯村 典武[1]	1.豊田中研
	16:30 - 16:45	12p-A26-12	$Zn_{1-x}Mg_xO/Cu_2ZnSn(S, Se)_4$界面のバンド接続の in-situ 評価	○諏訪原 裕貴[1]	1.鹿児島大
	16:45 - 17:00	E 12p-A26-13	Photocarrier dynamics in $Cu_2ZnSn(S_xSe_{1-x})_4$ single crystals: Composition dependence	○(PC)Le Quang Phuong[1,2], Makoto Okano[1], Genki Yamashita[3], Masaya Nagai[3], Masaaki Ashida[3], Akira Nagaoka[1,4], Kenji Yoshino[4], Yoshihiko Kanemitsu[1,2]	1.Kyoto Univ., 2.JST-CREST, 3.Osaka Univ., 4.Univ. of Miyazaki
	17:00 - 17:15	E 12p-A26-14	Suppression of nonradiative recombination centers in Cu_2ZnSnS_4 single crystals by sodium doping	○(PC)Le Quang Phuong[1,2], Makoto Okano[1], Genki Yamashita[3], Masaya Nagai[3], Masaaki Ashida[3], Akira Nagaoka[1,4], Kenji Yoshino[4], Yoshihiko Kanemitsu[1,2]	1.Kyoto Univ., 2.JST-CREST, 3.Osaka Univ., 4.Univ. of Miyazaki
	17:15 - 17:30	12p-A26-15	電子線照射によるCu_2ZnSnS_4太陽電池の電気的・光学的特性への影響	○相原 理[1], 坂倉 秀徳[1], 片桐 裕則[2], 杉山 睦[1]	1.東京理科大 理工/総研, 2.長岡高専
	17:30 - 17:45	奨 12p-A26-16	ケステライト化合物$Cu_2ZnSn(S_x, Se_{1-x})_4$単結晶中の固有散乱メカニズム	○永岡 章[1,5], Scarpulla Michael[2], 柿本 浩一[3], 吉野 賢二[4], 野瀬 嘉太郎[1]	1.京大院工, 2.米ユタ大, 3.九大応力研, 4.宮崎大工, 5.学振特別研究員PD

3月13日(金)　9:00 - 12:15

	9:00 - 9:15	奨 13a-A17-1	近接昇華法を用いたサファイア基板上のAg(Ga,Al)Te_2混晶作製	○宇留野 彩[1], 薄井 綾香[1], 竹田 裕二[1], 井上 朋大[1], 小林 正和[1,2]	1.早大先進理工, 2.早大材研
	9:15 - 9:30	13a-A17-2	$CuInSe_2$-In_2Se_3系化合物の結晶構造と光学的性質	○(PC)前田 毅[1], 宮 イゲン[1], 和田 隆博[1]	1.龍谷大理工
	9:30 - 9:45	奨 13a-A17-3	$CuGaSe_2$-ZnSe系化合物の結晶構造と光学的性質	○山田 悠斗[1], 前田 毅[1], 竹井 康二[1], 和田 隆博[1]	1.龍谷大理工
	9:45 - 10:00	13a-A17-4	Znのサイト選択ドーピングによるp形CIGS薄膜の作製	○白方 祥[1], 吉田 正吾[1], 岸田 貴志[1], 弓達 新治[1], 宮田 晃[1]	1.愛媛大 工
	10:00 - 10:15	13a-A17-5	CIGS薄膜のその場PL測定	○深井 尋史[1], 池村 賢一郎[2], 井口 和也[2], エル リ カオ ザッカーリ[1], カトリ イズール[1], 松山 勇[1], 山口 博[1], 中田 時夫[1]	1.東京理科大総研, 2.浜松ホトニクス
	10:15 - 10:30	13a-A17-6	$CuIn_{1-x}Ga_xSe_2$ における光キャリアの緩和及び拡散ダイナミクス	○岡野 真人[1], 櫻井 岳暁[2], 秋本 克洋[2], 柴田 肇[3], 仁木 栄[3], 金光 義彦[1,4]	1.京大化研, 2.筑波大数物研, 3.産総研・太陽光発電工学研究センター, 4.JST-CREST
	10:30 - 10:45	E 13a-A17-7	Microstructure Characteristics of Cu(In, Ga)Se_2 Thin Films Investigated by TEM	○(PC)HyungSeok Kim[1,4], T. Ohkubo[1], K. Hono[1], K. Yoshida[2], T. Nakada[3]	1.NIMS, 2.Osaka Univ., 3.Tokyo Univ. of Sci., 4.LG Electronics
	10:45 - 11:00	13a-A17-8	Lift-off法を用いたsuperstrate型Cu(In,Ga)Se_2薄膜太陽電池におけるPEDOT:PSS裏面電極の検討	○新澤 雄高[1], 新井 裕之[1], 廣庭 大輔[1], 峯元 高志[1]	1.立命館大学
	11:00 - 11:15	13a-A17-9	裏面パッシベーション効果を利用したCIGS太陽電池特性	○崔 誠佑[1], 上川 由紀子[1], 西永 慈郎[1], 山田 昭政[1], 柴田 肇[1], 仁木 栄[1]	1.産総研
	11:15 - 11:30	E 13a-A17-10	Effect of KF-PDT on MBE-Grown $Cu(In_{1-x},Ga_x)Se_2$ Thin Film	○(PC)Ishwor Khatri[1], Hirofumi Fukai[1], Isamu Matsuyama[1], Hiroshi Yamaguchi[1], Tokio Nakada[1]	1.Tokyo University of Science
	11:30 - 11:45	13a-A17-11	Photovoltages and Their Dependence on Incident Light Wavelengths on CIGS Solar Cells Investigated by P-KFM	○(D)Hyeondeuk Yong[1], Takashi Minemoto[3], Takuji Takahashi[1,2]	1.IIS, The Univ. of Tokyo, 2.INQIE, The Univ. of Tokyo, 3.Coll. of Sci. and Eng., Ritsumeikan Univ.
	11:45 - 12:00	13a-A17-12	CIGS上でのケルビンプローブフォース顕微鏡及び静電引力顕微鏡による表面電位分布と静電引力スペクトルの観測	○石井 智章[1], 峯元 高志[3], 高橋 琢二[1,2]	1.東大生研, 2.東大ナノ量子機構, 3.立命館大理工
招待	12:00 - 12:15	13a-A17-13	**「講演奨励賞受賞記念講演」(15分) Cu(In,Ga)Se2薄膜太陽電池の 価電子帯制御による界面再結合抑制効果の理論的及び実験的検証**	**○西村 昂人[1], 平井 義晃[1], 黒川 康良[1], 山田 明[1,2]**	**1.東工大院理工, 2.太陽光発電システム研究センター**

13.10 化合物太陽電池, 15.2 II-VI族結晶および多元系結晶のコードシェアセッション　ポスター講演

3月13日(金)　16:30 - 18:30

		13p-P19-1	電着法によるFeSe薄膜の作製と物性評価II	○(M1)長屋 智紀[1], 高橋 誠[1], 鈴木 崇也[1], 田橋 正浩[1], 大木戸 貞夫[1]	1.中部大学
		13p-P19-2	酸性溶液中で硫黄源の仕込み量がSnS膜に与える影響	○石川 佑[1], 宮﨑 尚[1], 岡本 庸一[1], 守本 純[1]	1.防衛大材料
		13p-P19-3	硫化法を用いたSnS薄膜における組成比が電気特性に与える影響	○三上 俊太郎[1], 横井 翼[1], 鷲見 浩貴[1], 相原 理[1], 永易 京[1], 久富 一真[1], 杉山 睦[1]	1.東京理科大学理工学部/総合研究機構
		奨 13p-P19-4	GeS_2とS蒸気反応を用いたCu_2GeS_3薄膜太陽電池の作製	○知野 広太郎[1], 豊永 詞[1], 金井 綾香[1], 荒木 秀明[1,2]	1.長岡高専, 2.科学技術振興機構, さきがけ

		13p-P19-5	スプレー熱分解法によるCu_2ZnSnS_4薄膜太陽電池の作製	○(B)藤川 祥太朗[1], ヒエップ グエン ティ[1], ウィルマン セプティナ[1], 原田 隆史[1], 池田 茂[1], 松村 道雄[1]	1.阪大太陽エネルギー化学研セ
		13p-P19-6	2段階同時蒸着法による$Cu_2ZnSnSe_4$薄膜作製の検討	○村上 秀憲[1], 大塚 健介[1], 弓達 新治[1], 宮田 晃[1], 白方 祥[1]	1.愛媛大工
		13p-P19-7	$Cu_2ZnSn(S,Se)_4$ナノ粒子を用いた塗布薄膜の焼成条件による影響	○鈴木 俊正[1], 鈴木 吏[2], 堀 茂雄[2], 野々村 修一[2]	1.JFCC, 2.岐阜大学
		13p-P19-8	時間の経過による三次元構造Cu_2ZnSnS_4太陽電池の特性変化	○田中 久仁彦[1], 長橋 由樹[1], 石山 貴道[1], 森谷 克彦[2], 打木 久雄[1]	1.長岡技大, 2.鶴岡高専
		13p-P19-9	分子線エピタキシー法によるCuGaS$_2$薄膜の作製と評価 ～$(NH_4)_2S_x$による過剰Cu_xSのエッチング～	○倉掛 真弥[1], 岡 優貴[1], 松下 将也[1], 山田 秀明[1], 阿部 友紀[1], 市野 邦男[1]	1.鳥大院工
		13p-P19-10	MEE法を用いて成長したGaAs(001)基板上CIS-CGS構造の評価	○豊田 康揮[1], 佐藤 知嵩[1], 谷口 龍希[1], サティア パマ[1], 堀越 佳治[1], 牧本 俊樹[1]	1.早稲田大学
		13p-P19-11	大気中におけるCIGS太陽電池の効率劣化の検証	○西永 慈郎[1], 上川 由紀子[1], 崔 誠佑[1], 柴田 肇[1], 仁木 栄[1]	1.産総研
		13p-P19-12	二波長蛍光分光法および光容量分光法を用いた鉛ハライド系ペロブスカイト太陽電池の欠陥準位評価	○中澤 紀祥[1], 櫻井 岳暁[1], M.M. Islam[1], 秋本 克洋[1], 尾込 裕平[2], 早瀬 修二[2]	1.筑波大, 2.九工大
		13p-P19-13	ペロブスカイト太陽電池に用いる多孔質酸化チタン層の昇温脱離分析	○(B)宝山 修士[1], ハシーヤ カリマ アディリ[1], 原田 隆史[1], 池田 茂[1], 伊藤 省吾[2], 松村 道雄[1]	1.大阪大基礎工, 2.兵庫県立大工
		13p-P19-14	量子ドット増感型太陽電池の量子ドット生成法に対するフォトキャリア取り出し効率の比較	○家山 昂[1], 尾崎 信彦[1], 大渕 隆文[2], 福田 直晃[2], 加藤 美奈子[3], 滝谷 俊夫[3]	1.和歌山大シス工, 2.京都大, 3.日立造船(株)
		13p-P19-15	ARMによるInGaP/GaAs/Si 3接合セル中サブセル特性の制御	○重川 直輝[1], 梁 剣波[1]	1.大阪市大工
		13p-P19-16	多接合太陽電池応用に向けたGaAs/Ge表面活性化接合技術の検討	○山下 大之[1], 河野 元紀[1], 渡辺 健太郎[1], 杉山 正和[1], 須賀 唯知[1], 中野 義昭[1]	1.東大工
		13p-P19-17	GaAs:N δドープ超格子を有する太陽電池の二段階光吸収	○鈴木 智也[1], 八木 修平[1], 土方 泰斗[1], 岡田 至崇[2], 矢口 裕之[1]	1.埼玉大理工, 2.東大先端研
		E 13p-P19-18	GaNAs quantum structures embedded in GaAs p-i-n for Intermediate Band Solar Cell with zero valance band offset	○Martin Elborg[1], Takeshi Noda[1], Liyuan Han[1]	1.NIMS, Tsukuba
		13p-P19-19	面内高密度InAs量子ドット層における光伝導特性	○(B)秋元 直己[1], 内田 俊介[1], 山口 浩一[1]	1.電通大
		13p-P19-20	ECRプラズマ作製によるCu/Cu_2O型PVセルの特性に与える水素プラズマ前処理の効果	○奈良 拓馬[1], 菊地 悠介[1], 佐藤 直幸[1], 池畑 隆[1]	1.茨城大院理工
		13p-P19-21	ECRプラズマ作製によるCu/Cu_2O型PVセルの大気曝露特性	○長谷川 基輝[1], 菊地 悠介[1], 佐藤 直幸[1], 池畑 隆[1]	1.茨城大院理工
		13p-P19-22	Free-standing InP Nanowire Array and Their Optical Properties Toward Resource-Saving Solar Cells	○(M1)muyi Chen[1], Eiji Nakai[1], katsuhiro Tomioka[1,2], takashi Fukui[1]	1.Graduate school of IST and RCIQE Hokkaido Univ.,, 2.JST-PRESTO

15.2 II-VI族結晶および多元系結晶 / II-VI and related compounds　ポスター講演

3月12日(木)　16:00 - 18:00

		12p-P15-1	分子線エピタキシー法によるGaP基板上のZnSTe成長層の構造的評価	○樫山 翔太[1], 難波 直[1], 長谷川 浩康[1], 阿部 友紀[1], 市野 邦男[1]	1.鳥取大工
		12p-P15-2	GaAs(001)基板への(Zn,Ga,Sn)As_2薄膜の結晶成長と評価	○寺内 達也[1], 井上 寛明[1], 豊田 英之[1], 内富 直隆[1]	1.長岡技術科学大学
		12p-P15-3	水素イオン注入ZnOバルク単結晶中の水素の挙動:弾性反跳分析評価	○(B)西片 直樹[1], 甲斐田 卓也[1], 上岡 一馬[1], 西村 智明[1], 栗山 一男[1], 串田 一雅[2]	1.法政大理工, 2.大阪教育大
		12p-P15-4	新規Cuドーピング法で作製した多結晶CdTe膜のPL評価	○瀬戸 悟[1], 小川 洋平[2], 細野 藍響[2], 岡本 保[2]	1.石川高専, 2.木更津高専
		12p-P15-5	ZnTe(100)面上への(Cd,Cr)Te自己形成ドットの作製と磁気光学特性	○(M2)中澤 文生[1], 内海 駿人[1], 金澤 研[1], 黒田 眞司[1]	1.筑波大院数理物質

15.2 II-VI族結晶および多元系結晶 / II-VI and related compounds　口頭講演

3月13日(金)　16:15 - 19:15

	16:15 - 16:30	13p-A17-1	高温ZnTeバッファ層導入によるZnTe薄膜のドメイン構造の改善	○相場 貴之[1], 中須 大蔵[1], 山下 聡太郎[1], 服部 翔太[1], 木津 健[1], 孫 惟哲[1], 田栗 光祐[1], 風見 蕗乃[1], 橋本 勇輝[1], 小﨑 峻[1], 小林 正和[1,2], 朝日 聡明[3]	1.早大先進理工, 2.早大材研, 3.JX日鉱日石金属
	16:30 - 16:45	13p-A17-2	サファイア基板表面のステップ構造がZnTe薄膜成長にもたらす効果	○木津 健[1], 中須 大蔵[1], 山下 聡太郎[1], 相場 貴之[1], 服部 翔太[1], 孫 惟哲[1], 田栗 光祐[1], 風見 蕗乃[1], 小﨑 峻[1], 橋本 勇輝[1], 小林 正和[1,2], 朝日 聡明[3]	1.早大先進理工, 2.早大材研, 3.JX日鉱日石金属
	16:45 - 17:00	13p-A17-3	オフ角を持つサファイアa面基板のステップ構造によるZnTeドメイン構造の改善	○山下 聡太郎[1], 中須 大蔵[1], 木津 健[1], 相場 貴之[1], 服部 翔太[1], 孫 惟哲[1], 田栗 光祐[1], 風見 蕗乃[1], 橋本 勇輝[1], 小﨑 峻[1], 小林 正和[1,2], 朝日 聡明[3]	1.早大先進理工, 2.早大材研, 3.JX日鉱日石金属
	17:00 - 17:15	奨 13p-A17-4	S面サファイア基板上ZnTe薄膜の作製と成長方位関係の解析	○中須 大蔵[1], 山下 聡太郎[1], 相場 貴之[1], 木津 健[1], 服部 翔太[1], 孫 惟哲[1], 田栗 光祐[1], 風見 蕗乃[1], 小﨑 峻[1], 橋本 勇輝[1], 小林 正和[1,2], 朝日 聡明[3]	1.早大先進理工, 2.早大材研, 3.JX日鉱日石金属
	17:15 - 17:30	13p-A17-5	格子不整合がZnMgTe/ZnTe光導波路の表面形状に与える影響	○風見 蕗乃[1], 孫 惟哲[1], 田栗 光祐[1], 中須 太蔵[1], 相場 貴之[1], 山下 聡太郎[1], 服部 翔太[1], 木津 健[1], 小﨑 峻[1], 橋本 勇輝[1], 小林 正和[1,2], 朝日 聡明[3]	1.早大先進理工, 2.早大材研, 3.JX日鉱日石金属
	17:30 - 17:45	奨・E 13p-A17-6	The electro-optic signal improvement by ZnMgTe/ZnTe waveguide structures	○WeiChe Sun[1], Kosuke Taguri[1], Fukino Kazami[1], Taizo Nakasu[1], Sotaro Yamashita[1], Takayuki Aiba[1], Takeru Kizu[1], Shota Hattori[1], Shun Ozaki[1], Yuki Hashimoto[1], Masakazu Kobayashi[1,2], Toshiaki Asahi[3]	1.Waseda Univ. Dept. of Elec. Eng. & Biosci., 2.Waseda Univ. Lab. for Mat. Sci. & Tech, 3.JX Nippon Mining & Metals Corp.
	17:45 - 18:00		休憩/Break		
	18:00 - 18:15	13p-A17-7	InP基板上II－VI族半導体レーザに向けたpクラッド層材料の検討	○(B)小林 亮平[1], 野村 一郎[1], 高松 眞吾[1], 白石 智裕[1], 福島 浩二[1], 岸野 克巳[1]	1.上智大理工
	18:15 - 18:30	13p-A17-8	InP基板上II-VI族半導体レーザのための酸化インジウムスズpクラッド層の検討	○(B)福島 浩二[1], 野村 一郎[1], 白石 智裕[1], 高松 眞吾[1], 小林 亮平[1], 岸野 克己[1]	1.上智大理工

	18:30 - 18:45	E 13p-A17-9	Preparation of Ag-Er-TiO_2 nanocomposites and photo-catalytic activity	○Prakash Natarajan[1], Karthikeyan Rajan[1], Thangaraju Dheivasigamani[1], Navaneethan Mani[1], Arivanandhan Mukannan[1], Tadanobu Koyama[1], Yasuhiro Hayakawa[1]	1.Shizuoka Univ.
	18:45 - 19:00	13p-A17-10	$ZnSnN_2$結晶の作製と評価(1) －バルク結晶合成－	○川村 史朗[1], 谷口 尚[1], 山田 直臣[2]	1.物質・材料研究機構, 2.中部大工
	19:00 - 19:15	13p-A17-11	$ZnSnN_2$結晶の作製と評価(2) －スパッタ多結晶膜－	竹内 智之[1], 曹 祥[1], 川村 史朗[2], ○山田 直臣[1]	1.中部大工, 2.物材機構

15.3 III-V族エピタキシャル結晶 / III-V-group epitaxial crystals　口頭講演

3月13日(金)　16:15 - 19:00

	16:15 - 16:30	13p-D4-1	(111)面InP基板上のMBE成長InAlAs層の特性	○春元 雅貴[1]	1.阪府大院工
	16:30 - 16:45	13p-D4-2	表面窒化により成長したGaAsN混晶の発光特性	○浦上 法之[1], 山根 啓輔[1], 関口 寛人[1], 岡田 浩[1,2], 若原 昭浩[1]	1.豊橋技科大工, 2.EIIRIS
	16:45 - 17:00	13p-D4-3	GaAs中のエピタキシャル二次元窒素膜におけるアニール効果	○原田 幸弘[1], 小川 泰弘[1], 馬場 健[1], 海津 利行[1], 喜多 隆[1]	1.神戸大院工
	17:00 - 17:15	13p-D4-4	Si基板上格子整合系GaAsPN混晶の高品質化	○麦倉 俊[1], 浦上 法之[1], 山根 啓輔[1], 関口 寛人[1], 岡田 浩[1,2], 若原 昭浩[1]	1.豊橋技科大院・工, 2.豊橋技科大 EIIRIS
	17:15 - 17:30	13p-D4-5	Si基板上へのGaN/Ga(N)Asヘテロ構造のMBE成長	○(M2)加太 俊[1], 中井 裕子[1], 山崎 健平[1], 田中 康弘[1], 高橋 尚志[1], 橋本 光博[2], 高橋 敏男[2], 秋山 英文[2], 小柴 俊[1]	1.香大, 2.東大物性研
	17:30 - 17:45	13p-D4-6	MOVPE 法を用いたSi 基板上Ge バッファおよびInGaAs/GaAs MQW層の成長	○中尾 亮[1,2], 荒井 昌和[1,2], 山本 剛[1], 松尾 慎治[1,2]	1.NTT先端集積デバイス研, 2.ナノフォトニクスセンタ
	17:45 - 18:00	13p-D4-7	微細トレンチへの選択MOCVD成長における三元系化合物半導体の局所組成分析	○大場 大輔[1], 近藤 佳幸[1], 軍司 勲男[1], 飯塚 洋二[1], 杉山 正和[2], 保坂 重敏[1]	1.東京エレクトロン, 2.東大院工
	18:00 - 18:15	13p-D4-8	MOVPE法によるGaN基板上のウルツ鉱構造AlInP成長	○平谷 佳大[1], 石坂 文哉[1], 冨岡 克広[1,2], 福井 孝志[1]	1.北大院情報科学および量子集積センター, 2.JSTさきがけ
	18:15 - 18:30	13p-D4-9	低温成長$In_xGa_{1-x}As$の結晶構造の成長温度依存性	○富永 依里子[1], 廣瀬 伸悟[1], 角屋 豊[1]	1.広大院先端研
	18:30 - 18:45	13p-D4-10	GaSb基板の熱処理条件最適化	○横山 春喜[1,3], 星 拓哉[1,3], 杉山 弘樹[1,3], 西 康一[2,3], 竹中 充[2,3], 高木 信一[2,3]	1.日本電信電話株式会社, 2.東大, 3.JST CREST
	18:45 - 19:00	奨 13p-D4-11	Thermal annealing of Thin Film InSb on Mica and Glass Substrate	○(M2)Koswaththage Charith Jayanada[1], Noguchi Takashi[1], Taniguchi Shinichi[2], Yoshitome Shokichi[2]	1.Univ. of the Ryukyus, 2.e-tec INC.

15.3 III-V族エピタキシャル結晶 / III-V-group epitaxial crystals　ポスター講演

3月13日(金)　9:30 - 11:30

		13a-P15-1	希薄窒化物半導体の電子状態記述のための有効ハミルトニアンの方法	○森藤 正人[1], 山下 純貴[1], 近藤 正彦[1], 石川 史太郎[2]	1.阪大院工, 2.愛媛大院工
		13a-P15-2	第一原理計算によるInAsN混晶のバンド構造に関する研究	○(M1)宮崎 貴史[1], 八木 修平[1], 土方 泰斗[1], 矢口 裕之[1]	1.埼玉大院理工
		奨・E 13a-P15-3	H-related acceptor state associated with residual carriers in p-type GaAsN grown by chemical beam epitaxy	○Omar Elleuch[1], Li Wang[1], Kan Hua Lee[1], Koshiro Demizu[1], Kazuma Ikeda[1], Nobuaki Kojima[1], Yoshio Ohshita[1], Masafumi Yamaguchi[1]	1.Toyota Tech. Inst.
		13a-P15-4	Ge(111)基板上への$GaSb_xAs_{1-x}$のMBE成長	○孫 一博[1], 早瀬 久貴[1], 市場 太国[1], 森 涼介[1], 梶川 靖友[1]	1.島根大総合理工
		E 13a-P15-5	Molecualr beam epitaxial growth of MnAs/InAs/GaAs(111)B heterostructure	Cong Thanh Nguyen[1], Md. Earul Islam[1], ○Masashi Akabori[1]	1.CNMT, JAIST
		13a-P15-6	GaSb/GaAs量子ドットの光学異方性における後熱処理の効果	○川津 琢也[1], 野田 武司[1], 佐久間 芳樹[1], 榊 裕之[1,2]	1.物材機構, 2.豊田工大
		13a-P15-7	面内高密度InAs量子ドット層の発光特性のInAs成長量依存性	○(M2)佐藤 祐介[1], 秋元 直己[1], 内田 俊介[1], 山口 浩一[1]	1.電通大

15.3 III-V族エピタキシャル結晶 / III-V-group epitaxial crystals　口頭講演

3月14日(土)　9:00 - 11:30

	9:00 - 9:15	奨・E 14a-D4-1	GaAsBi/GaAs growth on (100) and (411)A GaAs Substrates by Molecular Beam Epitaxy	○(D)Pallavi Patil[1], Masataka Tatebe[1], Yuh Nabara[1], Koh-ichiroh Higaki[1], Nobutaka Nishi[1], Eric Eugenio[2], Saburo Tanaka[1], Satoshi Shimomura[1]	1.Ehime University, 2.CIACyT UASLP
	9:15 - 9:30	14a-D4-2	(100)面 GaAs基板上のGaAs/GaAsBi量子井戸のMBE成長	○西井 寅貴[1], 檜垣 興一郎[1], Patil Pallavi[1], 石川 史太郎[1], 下村 哲[1]	1.愛媛大院理工
	9:30 - 9:45	14a-D4-3	(100)A面 GaAs基板上のGaAs/GaAsBi超格子のBi組成プロファイルの解析	○檜垣 興一郎[1], 西井 寅貴[1], パラビ パティル[1], 石川 史太郎[1], 下村 哲[1]	1.愛媛大院理工
	9:45 - 10:00	14a-D4-4	GaAs傾斜基板上InGaP量子細線状構造の自己形成における積層数の影響	○満原 学[1], 渡邉 則之[1], 横山 春喜[1], 重川 直輝[2]	1.日本電信電話(株), 2.大阪市大
	10:00 - 10:15	14a-D4-5	GaAsキャップ層成長温度によるInAs/GaAs量子ドットの広帯域発光波長制御	松村 拓哉[1], ○海津 利行[1,2], 喜多 隆[1]	1.神戸大院工, 2.神戸大研究基盤セ
	10:15 - 10:30	14a-D4-6	GaAs(001)上のInAs量子ドットの1.55 μm以上での発光(2)	○下村 憲一[1], 神谷 格[1]	1.豊田工大
	10:30 - 10:45	14a-D4-7	InP(311)B基板上におけるデジタル埋め込みInAs量子ドットの時間分解PL測定	○赤羽 浩一[1], 山本 直克[1], 川西 哲也[1], 田中 健浩[2], 中村 新一[2], 外林 秀之[2]	1.情通機構, 2.青学大
	10:45 - 11:00	14a-D4-8	GaP歪補償InAs/GaAs量子ドット積層構造の成長とLD高温動作	○影山 健生[1], 渡邉 克之[2], ヴォ クオック フイ[2], 武政 敬三[3], 菅原 充[3], 岩本 敏[1,2], 荒川 泰彦[1,2]	1.東大ナノ量子機構, 2.東大生研, 3.QD レーザ
	11:00 - 11:15	奨 14a-D4-9	MBE法におけるin-situ 熱拡散法によるGaAsPナノワイヤの自己形成と量子ドットによる斥力効果	○VO QUOC HUY[1], 渡邉 克之[1], 影山 健生[2], 岩本 敏[1,2], 荒川 泰彦[1,2]	1.東大生研, 2.東大ナノ量子機構
	11:15 - 11:30	E 14a-D4-10	Optimization of Growth Temperature of GaAs Nucleation Layer in InAs/GaAs Quantum Dots on Ge/Si substrate by MOCVD	○Mohan Rajesh[1], Masao Nishioka[1], Yasuhiko Arakawa[1]	1.NanoQuine, The Univ. of Tokyo

	3月14日(土)　13:00 - 14:15				
	13:00 - 13:15	14p-D4-1	キャップされたInAs量子ドットの表面モホロジーの観測 ～キャップ層成長温度依存性～	○角田 雅弘[1], 車 一宏[2], 權 晋寛[2], 太田 泰友[1], 渡邉 克之[1,2], 岩本 敏[1,2], 荒川 泰彦[1,2]	1.東大ナノ量子, 2.東大生研
	13:15 - 13:30	E 14p-D4-2	MBE Growth and Analysis of InAs QDs on (411) and (221) GaAs substrates.	○(D)Eric Eugenio-Lopez[1,2], Victor Hugo Mendez-Garcia[1], Satoshi Shimomura[2]	1.CIACyT UASLP, 2.Ehime University
	13:30 - 13:45	14p-D4-3	InAsSb層上への面内超高密度InAs量子ドット(10^{12} cm^{-2})の自己形成(3)	○(M1)鮫島 一樹[1], 山口 浩一[1]	1.電通大
	13:45 - 14:00	奨 14p-D4-4	ステップ成長によるInP(311)B面基板上低密度InAs量子ドットの作製	○(M2)高熊 亨[1], 細井 響子[1], 赤羽 浩一[2], 早瀬 潤子[1]	1.慶大理工, 2.情通機構
	14:00 - 14:15	14p-D4-5	ポーラスアルミナマスクにより作製したGaAsパターン基板上へのInAs量子ドットのMBE成長	○山崎 剛典[1], 十亀 真依[1], 森下 義隆[1]	1.農工大工

15.4 III-V族窒化物結晶 / III-V-group nitride crystals　口頭講演

	3月11日(水)　8:30 - 11:45				
	8:30 - 8:45	11a-B1-1	立方晶窒化ホウ素(c-BN)薄膜のMBE成長におけるイオン照射の効果	○平間 一行[1], 谷保 芳孝[1], 狩元 慎一[1], 山本 秀樹[1]	1.NTT物性研
	8:45 - 9:00	11a-B1-2	MBE法で作製したScN薄膜のⅢ/Vフラックス比依存性	○大垣 武[1], 坂口 勲[1], 大橋 直樹[1], 羽田 肇[1]	1.物材機構
	9:00 - 9:15	11a-B1-3	RF-MBE法で作製したSm添加GaN薄膜の構造・光学的特性の評価	○(M1)出原 健太郎[1], 長谷川 繁彦[1]	1.阪大産研
	9:15 - 9:30	11a-B1-4	RFプラズマ支援分子線エピタキシー法を用いたGaNの選択成長	○(M1)薗田 彬人[1]	1.北大
	9:30 - 9:45	11a-B1-5	(-201) Ga_2O_3基板上へのAlN薄膜のRF-MBE成長	○東脇 正高[1], 中田 義昭[1], 倉又 朗人[2], 山腰 茂伸[2]	1.情通研機構, 2.タムラ製作所
	9:45 - 10:00		休憩/Break		
	10:00 - 10:15	奨 11a-B1-6	$(InN)_1/(GaN)_4$ 短周期超格子の擬似混晶化	○今井 大地[1,2,3], 草部 一秀[1,2], 王 科[1,2], 吉川 明彦[1,2,4]	1.千葉大 SMART GIR, 2.JST-ALCA, 3.JSPS PD, 4.工学院大学
	10:15 - 10:30	E 11a-B1-7	High indium content (InN)m/(GaN)n SPSs on relaxed InGaN templates	○KE WANG[1], Kazuhide Kusakabe[1], Daichi Imai[1], Akihiko Yoshikawa[1,2]	1.Chiba Univ., 2.Kogakuin Univ.
	10:30 - 10:45	11a-B1-8	PSD法により成長したp型GaNに対する接触抵抗の評価	○野口 英成[1], 荒川 靖章[1], 上野 耕平[1], 太田 実雄[1], 藤岡 洋[1,2,3]	1.東大生研, 2.JST-CREST, 3.JST-ACCEL
	10:45 - 11:00	E 11a-B1-9	GaN growth on Hf foils using nearly lattice-matched HfN barriers by pulsed sputtering deposition	○(D)Hyeryun Kim[1], Jitsuo Ohta[1], Atsushi Kobayashi[1], Kohei Ueno[1], Hiroshi Fujioka[1,2,3]	1.The Univ. of Tokyo, 2.JST-CREST, 3.JST-ACCEL
	11:00 - 11:15	11a-B1-10	PSD法による高In組成InGaN結晶成長と太陽電池の作製	○荒川 靖章[1]	1.東大生研
	11:15 - 11:30	11a-B1-11	反応性パルスDCスパッタ法により作製されたAlN膜の結晶性および表面構造に及ぼすスパッタ電力の影響	竹内 洋仁[1], ○大塚 誠[1], 福山 博之[1]	1.東北大学多元研
	11:30 - 11:45	奨 11a-B1-12	指向性スパッタリングAlN中間層を用いた Si(001)基板上単結晶(1013)GaN成長	○光成 正[1], 本田 善央[1], 天野 浩[1,2]	1.名大院工, 2.赤崎記念研究センター
	3月11日(水)　13:15 - 18:45				
	13:15 - 13:30	11p-B1-1	UHVスパッタエピタキシー法によるAlInN層の成長	○(M1)神田 超志[1], 多田 暁由[1], 小橋 勇希[1], 福井 迪[1], 水野 愛[1], 篠田 宏之[1], 六倉 信喜[1]	1.東京電機大工
	13:30 - 13:45	11p-B1-2	スパッタ法AlNテンプレート基板を用いたAlNのHVPE成長	○安井 大貴[1], 三宅 秀人[1], 平松 和政[1], 岩谷 素顕[2], 赤崎 勇[2], 天野 浩[3]	1.三重大院工, 2.名城大学, 3.名古屋大学
	13:45 - 14:00	11p-B1-3	OVPE法を用いたGaNの-c面高温成長	○谷山 雄紀[1], 高津 啓彰[1], 重田 真実[1], 隅智亮[1], 北本 啓[1], 今出 完[1], 吉村 政志[1], 伊勢村 雅士[2], 森 勇介[1]	1.阪大, 2.伊藤忠プラスチックス
	14:00 - 14:15	11p-B1-4	ハイドライド気相成長におけるSiO_2マスクの品質がGaNの選択横方向成長に及ぼす影響	○河原 慎[1], 山本 健志[1], 稲垣 卓志[1], 岡田 成仁[1], 只友 一行[1], 山根 啓輔[2]	1.山口大理工, 2.豊橋技科大電電
	14:15 - 14:30	11p-B1-5	ハイドライド気相成長法を用いて堆積させたSiNx中間層上への厚膜GaN成長	○稲垣 卓志[1], 岡村 泰仁[1], 山根 啓輔[2], 岡田 成仁[1], 只友 一行[1]	1.山口大院理工, 2.豊橋技術科学大
	14:30 - 14:45	11p-B1-6	ハイドライド気相成長法を用いた両面成長によるGaNテンプレートの反り低減	○山本 健志[1], 井原 洋[1], 山根 啓輔[2], 岡田 成仁[1], 只友 一行[1]	1.山口大院理工, 2.豊橋技術科学大
	14:45 - 15:00		休憩/Break		
	15:00 - 15:15	奨 11p-B1-7	Naフラックス結合成長法で作製したGaNバルク結晶における成長初期界面の欠陥構造解析	○(M2)浅津 宏伝[1], 竹内 正太郎[1], 今西 正幸[2], 中村 芳明[1], 今出 完[2], 森 勇介[2], 酒井 朗[1]	1.阪大院基礎工, 2.阪大院工
	15:15 - 15:30	11p-B1-8	高Ga組成Naフラックス法における結晶表面モルフォロジーの炭素濃度依存性	○小川 翔悟[1], 今西 正幸[1], 轟 夕摩[1], 村上 航介[1], 今林 弘毅[1], 松尾 大輔[1], 高澤 秀生[1], 丸山 美帆子[1], 今出 完[1], 吉村 政志[1], 森 勇介[1]	1.阪大工
	15:30 - 15:45	11p-B1-9	C添加Na-Ga融液中のCNイオンの形成・分解に関する研究	○河村 貴宏[1,2], 今林 弘毅[2], 丸山 美帆子[2], 今出 完[2], 吉村 政志[2], 森 勇介[2], 森川 良忠[2]	1.三重大院工, 2.阪大院工
	15:45 - 16:00	11p-B1-10	GaN単結晶を用いた柱状すべり面における転位増殖のモデル化	○中野 智[1], 高 冰[1], 柿本 浩一[1]	1.九大応力研
	16:00 - 16:15	奨 11p-B1-11	静滴法を用いた窒化サファイア基板のGa-Al融液に対する濡れ角測定	○安達 正芳[1], 安武 晃佑[2], 齊藤 敬高[2], 中島 邦彦[2], 杉山 正史[3], 飯田 潤二[3], 福山 博之[1]	1.東北大多元研, 2.九大院工, 3.住友金属鉱山
	16:15 - 16:30	奨 11p-B1-12	AlN溶液成長における熱力学計算を用いた成長速度の向上	○渡邉 将太[1], 永冶 仁[1], 陳 鳴宇[1], 竹内 幸久[1], 青柳 健大[1], 原田 俊太[1], 田川 美穂[1], 宇治原 徹[1]	1.名大院工
	16:30 - 16:45		休憩/Break		
招待	**16:45 - 17:00**	**11p-B1-13**	**「講演奨励賞受賞記念講演」(15分) 温度上昇に伴うAlGaN系半導体の支配的な非輻射再結合経路の変化**	**○市川 修平[1], 船戸 充[1], 岩崎 洋介[2], 川上 養一[1]**	**1.京大院工, 2.JFEミネラル株式会社**
	17:00 - 17:15	11p-B1-14	GaNにおけるキャリア・励起子エネルギー緩和過程の励起条件依存に関する数値解析	○馬 ベイ[1], 森田 健[1], 石谷 善博[1]	1.千葉大工
	17:15 - 17:30	11p-B1-15	無極性m面AlGaN/GaN量子井戸サブバンド間吸収のドーピング濃度依存性	○小谷 晃央[1,2,3], 有田 宗貴[1], 荒川 泰彦[1,2]	1.東大ナノ量子, 2.東大生研, 3.シャープ
	17:30 - 17:45	11p-B1-16	AlGaN量子井戸における励起子分子結合エネルギーの井戸幅依存性	福野 智規[1], 中村 豪仁[1], 和泉 平[1], 倉井 聡[1], 三宅 秀人[2], 平松 和政[2], ○山田 陽一[1]	1.山口大院理工, 2.三重大院工
	17:45 - 18:00	11p-B1-17	Eu, Mg共添加GaNのEu濃度が発光サイトに及ぼす影響	○(M1)鎌田 拓歩[1], 関口 寛人[1], 山根 啓輔[1], 岡田 浩[1,2], 若原 昭浩[1]	1.豊橋技科大, 2.エレクトロニクス先端融合研究所(EIIRIS)

	18:00 - 18:15	11p-B1-18	Eu, Mg共添加AlGaNのAl組成が発光サイトに与える影響	○金本 匡祥[1], 関口 寛人[1], 山根 啓輔[1], 岡田 浩[1,2], 若原 昭浩[1]	1.豊橋技科大工, 2.EIIRIS
	18:15 - 18:30	11p-B1-19	自立GaN基板上m面$Al_{1-x}In_xN$ エピタキシャル薄膜の発光特性(III)	○小島 一信[1], 池田 宏隆[2], 藤戸 健史[2], 秩父 重英[1]	1.東北大多元研, 2.三菱化学(株)
	18:30 - 18:45	奨 11p-B1-20	m面$Al_{1-x}In_xN$薄膜の分光エリプソメトリーによる評価	○(B)加賀谷 大樹[1], 山崎 芳樹[1], 池田 宏隆[2], 藤戸 健史[2], 小島 一信[1], 秩父 重英[1]	1.東北大多元研, 2.三菱化学(株)
	3月12日(木) 8:30 - 11:45				
	8:30 - 8:45	12a-B1-1	THzエリプソメトリーによるGaN単結晶の評価	○達 紘平[1], 藤井 高志[1,3], 荒木 努[1], 名西 憓之[1], 長島 健[2], 岩本 敏志[3], 佐藤 幸徳[3], 森田 直威[4], 杉江 隆一[4], 上山 智[5]	1.立命館大, 2.摂南大, 3.日邦プレシジョン, 4.東レリサーチセンター, 5.名城大
	8:45 - 9:00	奨 12a-B1-2	ホモエピタキシャル成長n型GaNのホール効果測定	○澤田 直暉[1], 成田 哲生[2], 加地 徹[2], 上杉 勉[2], 須田 淳[3]	1.京大工, 2.豊田中研, 3.京大院工
	9:00 - 9:15	12a-B1-3	GaNダイオードの放射線検出特性評価	○杉浦 睦仁[1], 久志本 真希[2], 光成 正[2], 山下 康平[2], 本田 善央[2], 天野 浩[2,3], 三村 秀典[4], 井上 翼[1], 青木 徹[4], 中野 貴之[1]	1.静大院工, 2.名大院工, 3.赤﨑リサーチセンター, 4.静大電研
	9:15 - 9:30	12a-B1-4	赤外反射分光によるGaNのキャリヤ密度深さ分布解析	○上條 隆明[1], 馬 蓓[1], 森田 健[1], 石谷 善博[1]	1.千葉大工
	9:30 - 9:45	12a-B1-5	励起子励起準位を用いたGaNの励起子ダイナミクスの解析	○竹内 和真[1], 大泉 尚之[1], 馬 蓓[1], 森田 健[1], 石谷 善博[1], 三宅 秀人[2], 平松 和政[2]	1.千葉大院工, 2.三重大院工
	9:45 - 10:00	12a-B1-6	貫通転位がEu添加GaNの発光特性に及ぼす影響	○田原 浩行[1], 関口 寛人[1], 山根 啓輔[1], 岡田 浩[1,2], 若原 昭浩[1]	1.豊橋技科大工, 2.EIIRIS
	10:00 - 10:15		休憩/Break		
	10:15 - 10:30	12a-B1-7	MOVPE法によるn^+-p構造 $In_xGa_{1-x}N$(x~0.3)光起電力素子の作製	○(PC)児玉 和樹[1], 野村 裕之[1,2], 重川 直輝[3], 山本 喜勇[1,2], 葛原 正明[1]	1.福井大, 2.JST-CREST, 3.大阪市立大
	10:30 - 10:45	奨 12a-B1-8	規則配列GaNナノコラム上InGaN単一量子井戸の発光機構	○(B)宮川 倫[1], 大音 隆男[1], 水野 祐太郎[1], 加納 達也[1], 吉田 純[1], 岸野 克巳[1,2]	1.上智大理工, 2.上智大ナノテク
	10:45 - 11:00	奨 12a-B1-9	規則配列InGaN/GaNナノコラム細線化(直径35 nm)と発光特性	○(B)吉田 純[1], 加納 達也[1], 大音 隆男[1], 水野 祐太郎[1], 宮川 倫[1], 岸野 克巳[1,2]	1.上智大理工, 2.上智ナノテク
	11:00 - 11:15	12a-B1-10	規則配列InGaN系ナノコラムにおけるダブルピーク発光の温度依存性	○(PC)大音 隆男[1], 水野 祐太郎[1], 宮川 倫[1], 加納 達也[1], 吉田 純[1], 岸野 克巳[1,2]	1.上智大理工, 2.上智大ナノテク
	11:15 - 11:30	12a-B1-11	Vピット上に形成されたポテンシャルバリアを有するInGaN系発光ダイオードの光学的特性	○杉本 浩平[1], 岡田 成仁[1], 山田 陽一[1], 只友 一行[1]	1.山口大院理工
	11:30 - 11:45	12a-B1-12	Vピット上に形成されたポテンシャルバリアを有するInGaN系発光ダイオードの電気的特性	○杉本 浩平[1], 岡田 成人[1], 山田 陽一[1], 只友 一行[1]	1.山口大院理工
	3月12日(木) 13:15 - 19:45				
招待	13:15 - 13:45	12p-B1-1	**「第5回女性研究者研究業績・人材育成賞(小舘香椎子賞)受賞記念講演」(30分) 化合物半導体を中心とした混晶薄膜ヘテロ構造の結晶成長**	**○出浦 桃子[1]**	**1.東北大学**
	13:45 - 14:00	12p-B1-2	MOVPE法によるAlN成長におけるc面サファイア微傾斜角度の影響	○鈴木 周平[1], 林 家弘[1], 三宅 秀人[1], 平松 和政[1], 福山 博之[2]	1.三重大院工, 2.東北大金工
	14:00 - 14:15	12p-B1-3	MOVPE法によるAlN成長におけるc面サファイア表面の影響	○林 家弘[1], 鈴木 周平[1], 岡田 俊祐[1], 三宅 秀人[1], 平松 和政[1]	1.三重大院工
	14:15 - 14:30	奨 12p-B1-4	窒化a面サファイア基板上へのc面AlNの有機金属気相成長	○柴岡 真実[1], 船戸 充[1], 川上 養一[1]	1.京大院工
	14:30 - 14:45	12p-B1-5	ウェットエッチングによるサファイア表面加工基板(PSS)を用いた深紫外LED用高品質AlNテンプレートの作製	○金沢 裕也[1,2], 豊田 史朗[1,2], 大島 一晟[1,2], 鎌田 憲彦[2], 鹿嶋 行雄[3], 松浦 恵里子[3], 嶋谷 聡[4], 小久保 光典[5], 田代 貴晴[5], 大川 貴史[5], 上村 隆一郎[6], 長田 大和[6], 平山 秀樹[1]	1.理化学研究所, 2.埼玉大, 3.丸文, 4.東京応化工業, 5.東芝機械, 6.アルバック
	14:45 - 15:00	E 12p-B1-6	Elimination of small-angle grain boundary in AlN grown on sapphire substrate	○(P)RYAN BANAL[1], MASATAKA IMURA[1], YASUO KOIDE[1]	1.NIMS
	15:00 - 15:15	12p-B1-7	環境にやさしい原料(Alパウダーと窒素ガス)からの厚膜AlNの気相成長	○呉 ペイツエン[1], 船戸 充[1], 川上 養一[1]	1.京大院工
	15:15 - 15:30		休憩/Break		
	15:30 - 15:45	12p-B1-8	AlN(11 $\bar{2}$2)面における表面構造および成長初期過程に関する量子論的アプローチ	○竹本 圭孝[1], 秋山 亨[1], 中村 浩次[1], 伊藤 智徳[1]	1.三重大院工
	15:45 - 16:00	12p-B1-9	AlGaN MQW内井戸層組成傾斜による電子線励起深紫外発行強度の向上	○大橋 隆宏[1], 鳥羽 隆一[1]	1.東北大院環境科学
	16:00 - 16:15	奨 12p-B1-10	MOVPE法によるSiC基板上の無極性面高Al組成AlGaN成長	○奥村 宏典[1], 谷保 芳孝[1], 山本 秀樹[1]	1.NTT物性基礎研
	16:15 - 16:30	奨 12p-B1-11	高キャリア濃度n型AlGaNの電気的特性	○武田 邦宏[1], 森 一喜[1], 山田 知明[1], 岩谷 素顕[1], 竹内 哲也[1], 上山 智[1], 赤﨑 勇[1,2]	1.名城大理工, 2.名古屋大・赤﨑記念研究センター
	16:30 - 16:45	12p-B1-12	Ga_2O_3 (-201)基板上AlGaN (0001)エピタキシャル膜の成長	○森島 嘉克[1], 平山 秀樹[2], 山下 佳弘[1], 飯塚 和幸[1], 倉又 朗人[1], 山腰 茂伸[1]	1.株式会社タムラ製作所, 2.理化学研究所
	16:45 - 17:00	12p-B1-13	深紫外LEDに向けた窒化物半導体トンネル接合の検討	○高須賀 大貴[1], 南川 大智[1], 井野 匡貴[1], 竹内 哲也[1], 岩谷 素顕[1], 上山 智[1], 天野 浩[2], 赤﨑 勇[1,3]	1.名城大理工, 2.名古屋大院工, 3.名大・赤﨑記念研究センター
	17:00 - 17:15	奨 12p-B1-14	トンネル接合を用いたモノリシック型白色LEDの検討	○加藤 貴久[1], 飯田 大輔[2], 河合 俊介[1], 上山 智[1], 竹内 哲也[1], 岩谷 素顕[1], 赤﨑 勇[1,3]	1.名城大理工, 2.東京理大, 3.名大・赤﨑記念研究センター
	17:15 - 17:30		休憩/Break		
招待	17:30 - 17:45	12p-B1-15	**「講演奨励賞受賞記念講演」(15分) MOVPE成長N極性(0001)InGaN多重量子井戸構造と発光ダイオードの構造・光学特性**	**○正直 花奈子[1], 崔 正熹[1], 谷川 智之[1,2], 木村 健司[1,2], 窪谷 茂幸[1], 花田 貴[1,2], 片山 竜二[1,2], 松岡 隆志[1,2]**	**1.東北大金研, 2.JST, CREST**
	17:45 - 18:00	奨 12p-B1-16	加圧MOVPE法を用いた(0001)面GaN上InGaN/GaN多重量子井戸の成長	○田村 彰[1], 山本 哲也[1], 本田 善央[1], 天野 浩[1,2]	1.名大院工, 2.赤﨑記念研究センター
	18:00 - 18:15	12p-B1-17	InGaN薄膜表面に形成されたピットのCLと不純物との相関	○角谷 正友[1,4], 豊満 直樹[1,2], 王 剣宇[1], 原田 善之[3], Sang Liwen[1], 関口 隆史[1], 山口 智広[2], 本田 徹[2]	1.物材機構, 2.工学院大, 3.法政大, 4.JST-ALCA
	18:15 - 18:30	12p-B1-18	GaN上に作製したGaInN単膜およびGaInN/GaN超格子のX線その場観察測定	○(B)大角 純也[1], 石原 耕史[1], 山本 泰司[1], 岩谷 素顕[1], 竹内 哲也[1], 上山 智[1], 赤﨑 勇[1,2]	1.名城大理工, 2.名古屋大学・赤﨑記念研究センター
	18:30 - 18:45	12p-B1-19	デジタル混晶SMART $(InN)_1/(GaN)_4$の低NH_3分圧MOVPEプロセス	○草部 一秀[1], 吉川 明彦[1,2]	1.千葉大C-SGIR, 2.工学院大
	18:45 - 19:00	奨 12p-B1-20	N極性(000$\bar{1}$)GaNのMOVPE選択成長における貫通転位密度の低減	○逢坂 崇[1], 谷川 智之[1,2], 木村 健司[1,2], 正直 花奈子[1], 窪谷 茂幸[1,2], 片山 竜二[1,2], 松岡 隆志[1,2], 三宅 秀人[3]	1.東北大金研, 2.JST-CREST, 3.三重大院工

	19:00 - 19:15	12p-B1-21	±c面GaNの表面熱的安定性に関する研究	○岡田 俊祐[1], 三宅 秀人[1], 平松 和政[1], 逢坂 崇[2], 谷川 智之[2], 松岡 隆志[2]	1.三重大院・工, 2.東北大・金研
	19:15 - 19:30	12p-B1-22	サファイア基板上に低温成長したGaNバッファ層のTEM評価	○松原 徹[1,2], 杉本 浩平[1], 岡田 成仁[1], 只友 一行[1]	1.山口大院理工, 2.UBE科学分析センター
	19:30 - 19:45	12p-B1-23	減圧CVDで成長した六方晶窒化ホウ素薄膜の深紫外発光特性の向上	○梅原 直己[1], 増田 敦[1], 清水 乙生[2], 光野 徹也[1], 小南 裕子[1], 原 和彦[3,4]	1.静岡大院工, 2.静岡大工, 3.静岡大創造大院, 4.静岡大電子研

15.4 III-V族窒化物結晶 / III-V-group nitride crystals　ポスター講演

3月12日(木)　16:00 - 18:00

		12p-P16-1	六角形状GaNマイクロディスクからのレーザ光放射特性の検討	○光野 徹也[1], 鈴木 翔[1], 酒井 優[2], 岸野 克巳[3], 原 和彦[1]	1.静岡大学, 2.山梨大学, 3.上智大学
		12p-P16-2	準安定相窒化ホウ素(w-BN)の電子状態計算	○太田 優一[1], 時田 幸一[1], 渡辺 洋人[1]	1.都産技研
		12p-P16-3	GaN両極性同時成長におけるV/III比依存性の検討	○久瀬 健太[1], 井上 翼[1], 中野 貴之[1]	1.静大院工
		12p-P16-4	MOCVDによるGaN基板上への低C不純物濃度のGaN単膜成長	○朴 冠錫[1,2], 池永 和正[1], 矢野 良樹[1], 徳永 裕樹[1], 三嶋 晃[2], 伴 雄三郎[2], 田渕 俊也[1], 松本 功[1]	1.大陽日酸(株), 2.大陽日酸CSE(株)
		奨・E 12p-P16-5	Low-Temperature Growth of InN Films on Si(111) Substrates by Radical-Enhanced Metal-Organic Chemical Vapor Deposition	○(PC)Yi Lu[1], Osamu Oda[1], Kazuki Iwamoto[1], Hiroki Kondo[1], Kenji Ishikawa[1], Makoto Sekine[1], Masaru Hori[1]	1.Nagoya University
		12p-P16-6	GaN(0001)面上の高In組成InGaN成長のレーザその場観察	○(B)山本 哲也[1,2], 田村 彰[1,2], 本田 善央[1,2], 天野 浩[1,2]	1.名大工, 2.赤崎記念センター
		12p-P16-7	RF-MBE法を用いてAlONバッファー層上に成長したAlNの転位密度	○畑 泰希[1], 山崎 隆弘[1], 山根 悠介[1], 前田 理也[1], 熊倉 一英[2], 山本 秀樹[2], 牧本 俊樹[1]	1.早大先進理工, 2.NTT物性基礎研
		12p-P16-8	RF-MBE法による窒化サファイア基板上アルミニウム薄膜成長	○(B)星川 侑也[1], 大澤 真弥[1], 松本 雄大[1], 山口 智広[1], 尾沼 猛儀[1,2], 本田 徹[1]	1.工学院大, 2.東京高専
		12p-P16-9	4H-SiC(0001)微傾斜基板を用いたInNドット配列の自己形成	○森 誠也[1], 高宮 健吾[1], 折原 操[1], 八木 修平[1], 土方 泰人[1], 矢口 裕之[1]	1.埼玉大院理工
		12p-P16-10	膜厚制御メサ加工基板を用いた電流制御型液相成長によるGaN横方向成長	○岩川 宗樹[1], 高倉 宏幸[1], 冨田 将史[1], 神林 大介[1], 安井 亮太[1], 水野 陽介[1], 丸山 隆浩[1], 成塚 重弥[1]	1.名城大理工
		12p-P16-11	GaNの水素雰囲気熱エッチングにより作製したAlGaNベースマイクロディスク微小光共振器	○鈴木 翔[1], 光野 徹也[1], 菊池 昭彦[2], 酒井 優[3], 岸野 克巳[2], 原 和彦[1]	1.静岡大工, 2.上智大理工, 3.山梨大医工
		12p-P16-12	GaN-SBDの定常状態における高分解光容量測定	○出来 真斗[1], 大内 朋也[1], 本田 善央[1], 天野 浩[1]	1.名古屋大
		12p-P16-13	InGaN 薄膜の分光CL マッピング像の温度依存性評価	○倉井 聡[1], 若松 歩[1], 山田 陽一[1]	1.山口大院・理工
		12p-P16-14	バイアス印加光電流およびバイアス印加PL測定によるLED評価	○(M1)宇佐美 茂佳[1,2], 天野 浩[1,2], 本田 善央[1,2]	1.名大院工, 2.赤崎記念研究センター
		12p-P16-15	焼結法による炭化タンタル被覆黒鉛材 ～バルク成長・エピ成膜用の高耐久・高信頼性保護コーティング～	○中村 大輔[1], 鈴村 彰敏[1], 重藤 啓輔[1]	1.豊田中研
		12p-P16-16	深紫外LEDにおける超格子p型AlGaN透明コンタクト層のホール拡散効果	○前田 哲利[1], 定 昌史[1], 平山 秀樹[1]	1.理研
		12p-P16-17	スパッタ法によるZnOテンプレート上へのInN層の成長	○(M2)多田 暁由[1], 小橋 勇希[1], 福井 迪[1], 神田 越志[1], 水野 愛[1], 篠田 宏之[1], 六倉 信喜[1]	1.東京電機大工
		12p-P16-18	スパッタ法によるGaNテンプレート上へのInN層の成長	○(M2)福井 迪[1], 小橋 勇希[1], 多田 暁由[1], 神田 越志[1], 水野 愛[1], 篠田 宏之[1], 六倉 信喜[1]	1.東京電機大工
		12p-P16-19	反応性プラズマ支援成膜法により形成したBN 膜の粘弾性と密着性	○野間 正男[1], 山下 満[2], 江利口 浩二[3], 長谷川 繁彦[4]	1.神港精機株式会社, 2.兵庫県立工業技術センター, 3.京大院工, 4.阪大産研

15.4 III-V族窒化物結晶 / III-V-group nitride crystals　口頭講演

3月13日(金)　8:30 - 13:00

	8:30 - 8:45	奨 13a-B1-1	GaNの欠陥によるレーザー誘起THz放射振幅の増強	○酒井 裕司[1], 川山 巌[1], 中西 英俊[2], 斗内 政吉[1]	1.阪大レーザー研, 2.SCREENホールディングス
	8:45 - 9:00	13a-B1-2	表面プラズモン共鳴のナノ構造と屈折率の依存性の検討	○丹羽 一将[1], 加藤 貴久[1], 河合 俊介[1], 飯田 大輔[2], 上山 智[1], 竹内 哲也[1], 岩谷 素顕[1], 赤崎 勇[1,3]	1.名城大理工, 2.東京理大, 3.名大・赤崎記念研究センター
	9:00 - 9:15	奨 13a-B1-3	フリップチップ加工による低熱抵抗規則配列ナノコラムLED	○林 宏暁[1], 福島 大史[1], 野間 友博[1], 水野 真[1], 今野 裕太[1], 岸野 克巳[1]	1.上智大
	9:15 - 9:30	13a-B1-4	スパッタAlN上規則配列ナノコラムLEDのフリップチップ加工	○野間 友博[1], 林 宏暁[1], 福島 大史[1], 野村 一郎[1], 岸野 克巳[1]	1.上智大理工
	9:30 - 9:45	E 13a-B1-5	Nitrogen Excess Pressure Annealing of Gallium Nitride using a Novel Heat-Beam Method	○(M1)NADIA NURSYAFIQAH[1], YUJI AWANO[1]	1.KEIO UNIV.
	9:45 - 10:00	奨 13a-B1-6	高Al組成のn-AlGaNにおけるV系電極のコンタクト特性	○森 一喜[1], 武田 邦宏[1], 草深 敏匡[1], 岩谷 素顕[1], 上山 智[1], 竹内 哲也[1], 赤崎 勇[1,2], 天野 浩[3]	1.名城大理工, 2.赤崎記念研究センター, 3.名古屋大院工
	10:00 - 10:15	13a-B1-7	高性能近紫外LEDの作製に関する検討	○弦間 彩花[1], 河合 俊介[1], 岩谷 素顕[1], 竹内 哲也[1], 上山 智[1], 赤崎 勇[1,2]	1.名城大理工, 2.名大赤崎研究記念センター
	10:15 - 10:30	奨 13a-B1-8	SiO_2ナノ周期構造を有する基板上に作製した窒化物系青色LEDの発光特性	○花井 駿[1], 北野 司[1], 岩谷 素顕[1], 竹内 哲也[1], 上山 智[1], 赤崎 勇[1,2]	1.名城大学 理工, 2.名古屋大学赤崎記念研究センター
	10:30 - 10:45		休憩/Break		
招待	**10:45 - 11:00**	**13a-B1-9**	**「講演奨励賞受賞記念講演」(15分) (001)Si基板上(1–101)InGaNストライプ光共振器の誘導放出特**	**○久志本 真希[1], 本田 善央[1], 天野 浩[1,2]**	**1.名大院工, 2.赤崎記念研究センター**
	11:00 - 11:15	13a-B1-10	Si / SiO_2 / GaN系LED基板上への微小LEDの作製	○土山 和晃[1], 宇都宮 脩[1], 山根 啓補[1], 関口 寛人[1], 岡田 浩[1,2], 若原 昭浩[1]	1.豊技大工, 2.豊技大エレクトロニクス先端融合研究所
	11:15 - 11:30	13a-B1-11	InGaN光電極を用いた水からの水素生成	○植竹 勇介[1], 荻田 太郎[1], 飯田 大輔[1], パトリック ジネ[2], 大川 和宏[1]	1.東京理科大理, 2.エア・リキード・ラボラトリーズ
	11:30 - 11:45	13a-B1-12	InGaN量子井戸を用いた青色発光トランジスタの電気的・光学的特性	○西中 淳一[1], 熊倉 一英[1], 山本 秀樹[1]	1.NTT物性研

	11:45 - 12:00	13a-B1-13	窒化物半導体発光トランジスタの光出力周波数特性	○熊倉 一英[1], 西中 淳一[1], 山本 秀樹[1]	1.NTT物性研
	12:00 - 12:15	奨 13a-B1-14	フーリエ分光法による位置制御GaNナノワイヤ量子ドットにおけるスペクトル拡散の評価	○HOLMES Mark[1], 加古 敏[2], 崔 琦鉉[1], 有田 宗貴[1], 荒川 泰彦[1,2]	1.東大ナノ量子機構, 2.東大生研
	12:15 - 12:30	13a-B1-15	GaN/AlGaN界面ゆらぎ量子ドットの構造評価	○有田 宗貴[1], 壹岐 太一[2], 荒川 泰彦[1,2]	1.東大ナノ量子機構, 2.東大生産研
	12:30 - 12:45	E 13a-B1-16	High-Q AlGaN photonic crystal nanocavities for coupling with fluctuation GaN QDs	○Sylvain Sergent[1], Munetaka Arita[1], Satoshi Kako[2], Taichi Iki[1], Satoshi Iwamoto[1,2], Yasuhiko Arakawa[1,2]	1.Nanoquine, Univ. of Tokyo, 2.IIS, Univ. of Tokyo
	12:45 - 13:00	13a-B1-17	AlGaN 薄膜中における局在中心の励起子分子発光の観測	○壹岐 太一[1], 有田 宗貴[2], 加古 敏[1,2], 荒川 泰彦[1,2]	1.東大生研, 2.東大ナノ量子
	3月13日(金) 16:15 - 18:00				
招待	**16:15 - 16:30**	**13p-B1-1**	**「講演奨励賞受賞記念講演」(15分) 位置制御GaNナノワイヤ量子ドットの巨大励起子分子束縛エネルギー**	**○チェ ギヒョン[1], ホームズ マーク[1], 加古 敏[2], 有田 宗貴[1], 荒川 泰彦[1,2]**	**1.東大ナノ量子機構, 2.東大生研**
	16:30 - 16:45	E 13p-B1-2	Momentum Space Spectroscopy of AlGaN/Air DBR Microcavities	○Renchun Tao[1], Munetaka Arita[2], Satoshi Kako[1], Kenji Kamide[2], Yasuhiko Arakawa[1,2]	1.IIS., Univ. of Tokyo, 2.NanoQuine., Univ. of Tokyo
	16:45 - 17:00	13p-B1-3	グラフェンを用いた窒化物ナノコラムの結晶成長	○今野 裕太[1], 林 宏暁[1], 岸野 克己[1]	1.上智大理工
	17:00 - 17:15	奨 13p-B1-4	水素雰囲気異方性熱エッチング(HEATE)法によるInGaN/GaN多重量子井戸ナノ構造の作製	○水谷 友哉[1], 蜂屋 諒[1], 古橋 洋樹[1], 喜多 諒[1], 菊池 昭彦[1,2]	1.上智大, 2.上智ナノテクセンター
	17:15 - 17:30	13p-B1-5	窒化物半導体における貫通転位近傍での原子偏析に関する理論的研究	○坂口 涼平[1], 秋山 亨[1], 中村 浩次[1], 伊藤 智徳[1]	1.三重大院工
	17:30 - 17:45	13p-B1-6	X線マイクロビームによるGaN基板上InGaN系デバイスの評価	○横川 俊哉[1], 桧 拓也[1], 今井 康彦[2], 木村 滋[2]	1.山口大工, 2.JASRI
	17:45 - 18:00	奨 13p-B1-7	Siサブ波長回折格子/SiO_2膜/LED構造を有する窒化物系偏光LED	○高島 祐介[1], 田邉 聖人[1], 清水 亮[1], 原口 雅宣[1,2], 直井 美貴[1,2]	1.徳島大ATS, 2.徳島大STS

15.5 IV族結晶, IV-IV族混晶 / Group IV crystals and alloys　口頭講演

	3月11日(水) 9:00 - 12:00				
	9:00 - 9:15	奨 11a-D7-1	GGA+U 法による $Si_{1-x}Sn_x$材料物性の精密予測	○長江 祐樹[1], 黒澤 昌志[1,2], 加藤 元太[1], 柴山 茂久[1,3], 中塚 理[1], 財満 鎭明[1,4]	1.名大院工, 2.学振PD, 3.学振DC, 4.名大エコトピア
	9:15 - 9:30	11a-D7-2	太陽電池用GeSnC混晶系の原子配置に関する第一原理解析	○(M2)松谷 亮[1], 末岡 浩治[1], 神山 栄治[1,2], 泉妻 宏治[2], 鹿島 一日児[2], 中塚 理[3]	1.岡山県大院情報系工, 2.グローバルウェーハズ, 3.名大院工
	9:30 - 9:45	11a-D7-3	太陽電池用GeSiSn混晶系のバンドギャップに関する第一原理計算	○(M2)須和 亮[1], 末岡 浩治[1], 神山 栄治[1,2], 泉妻 宏治[2], 鹿島 一日児[2], 中塚 理[3]	1.岡山県大院情報系工, 2.グローバルウェーハズジャパン, 3.名大院工
	9:45 - 10:00	奨 11a-D7-4	$Ge_{1-x-y}Si_xSn_y$/Geヘテロ構造におけるエネルギーバンド構造の解明	○山羽 隆[1], 加藤 公彦[1], 柴山 茂久[1,2], 浅野 孝典[1,2], 坂下 満男[1], 中塚 理[1], 財満 鎭明[1,3]	1.名大院工, 2.学振特別研究員, 3.名大エコトピア
	10:00 - 10:15	11a-D7-5	GeSn薄膜形成におけるSn析出の挙動	○塚本 貴広[1], 広瀬 信光[2], 笠松 章史[2], 三村 高志[2], 松井 敏明[2], 須田 良幸[1]	1.東京農工大院工, 2.情報通信研究機構
	10:15 - 10:30	11a-D7-6	固相成長法による高SnC組成$Ge_{1-x-y}Sn_xC_y$三元混晶薄膜の形成および結晶構造評価	○小田 裕貴[1], 山羽 隆[1], 黒澤 昌志[1,2], 竹内 和歌奈[1], 坂下 満男[1], 中塚 理[1], 財満 鎭明[1,3]	1.名大院工, 2.学振特別研究員, 3.名大エコトピア
	10:30 - 10:45		休憩/Break		
	10:45 - 11:00	奨 11a-D7-7	MOCVD法によるGe基板上での$Ge_{1-x}Sn_x$エピタキシャル成長 (2)	○須田 耕平[1], 木嶋 隆浩[1], 石原 聖也[1], 澤本 直美[1], 町田 英明[2], 石川 真人[2], 須藤 弘[2], 大下 祥雄[3], 小椋 厚志[1]	1.明治大, 2.気相成長, 3.豊田工大
	11:00 - 11:15	11a-D7-8	$Ge_{1-x}Sn_x$エピタキシャル層中の電気的活性な欠陥の挙動	○竹内 和歌奈[1], 浅野 孝典[1,2], 坂下 満男[1], 中塚 理[1], 財満 鎭明[1,3]	1.名大院工, 2.学振特別研究員, 3.名大エコトピア
	11:15 - 11:30	11a-D7-9	原子状水素供給が$Ge_{1-x}Sn_x$エピタキシャル層の結晶性に及ぼす効果	○藤浪 俊介[1], 浅野 孝典[1,2], 保崎 航也[1], 小山 剛史[1], 中塚 理[1], 岸田 英夫[1], 財満 鎭明[1,3]	1.名古屋大院工, 2.学振(DC), 3.名古屋大エコトピア
	11:30 - 11:45	奨 11a-D7-10	$Ge_{1-x}Sn_x$エピタキシャル層中の欠陥の電気的特性	○浅野 孝典[1,2], 柴山 茂久[1,2], 竹内 和歌奈[1], 坂下 満男[1], 中塚 理[1], 財満 鎭明[1,3]	1.名大院工, 2.学振DC, 3.エコトピア科学研究所
	11:45 - 12:00	11a-D7-11	熱電素子応用を目指したGeSn単結晶薄膜の熱物性評価	○黒澤 昌志[1,2], 福田 雅大[1], 高橋 恒太[1], 坂下 満男[1], 中塚 理[1], 財満 鎭明[1,3]	1.名大院工, 2.学振PD, 3.名大エコトピア
	3月11日(水) 13:30 - 17:15				
	13:30 - 13:45	11p-D7-1	絶縁基板上におけるGeSnの極低温固相成長 -高Sn濃度GeSnの形成-	○松村 亮[1,2], 佐々木 雅也[1], 知北 大典[1], 甲斐 友樹[1], 佐道 泰造[1], 宮尾 正信[1]	1.九大院システム情報, 2.学振特別研究員
	13:45 - 14:00	11p-D7-2	GeSn/ 絶縁基板の極低温種付け横方向固相成長法 (1) -種付け効果に与えるアイランド構造の影響 -	○甲斐 友樹[1], 知北 大典[1], 松村 亮[1,2], 佐道 泰造[1], 宮尾 正信[1]	1.九大院システム情報, 2.学振特別研究員
	14:00 - 14:15	奨 11p-D7-3	GeSn/ 絶縁基板の極低温種付け横方向固相成長法 (2) -Sn 濃度の横方向 分布 -	○甲斐 友樹[1], 知北 大典[1], 松村 亮[1,2], 佐道 泰造[1], 宮尾 正信[1]	1.九大院システム情報, 2.学振特別研究員
	14:15 - 14:30	11p-D7-4	GeSn/絶縁基板の極低温種付け横方向固相成長法(3) -パルスレーザーアニール・シーディングの検討-	○松村 亮[1,2], 知北 大典[1], 佐道 泰造[1], 池上 浩[1], 宮尾 正信[1]	1.九大院システム情報, 2.学振特別研究員
	14:30 - 14:45	奨 11p-D7-5	非晶質基板上ゲルマニウム薄膜の(111)面配向結晶化におけるレーザーアニール条件の検討	○高尾 透[1], 堀田 昌宏[1], 仁枝 嘉昭[1], 石河 泰明[1], 浦岡 行治[1]	1.奈良先端大
	14:45 - 15:00	奨 11p-D7-6	レーザーアニールによるGe薄膜結晶化の熱拡散シミュレーション	○仁枝 嘉昭[1], 堀田 昌宏[1], 高尾 透[1], 石河 泰明[1], 浦岡 行治[1]	1.奈良先端大
	15:00 - 15:15	11p-D7-7	非晶質SiおよびGe膜のFLA結晶化時の原子の振る舞いの差異	○松尾 直人[1], 平野 翔大[1], 部家 彰[1], 中村 祥章[2], 横森 岳彦[2], 吉岡 正樹[2]	1.兵庫県立大工, 2.ウシオ電機(株)
	15:15 - 15:30		休憩/Break		
	15:30 - 15:45	11p-D7-8	フレキシブル基板上への擬似単結晶Ge薄膜の形成	○東 英実[1], 笠原 健司[2], 工藤 康平[3], 岡本 隼人[3], 茂藤 健太[3], パク ジョンヒョク[2], 山田 晋也[1], 金島 岳[1], 宮尾 正信[2], 角田 功[3], 浜屋 宏平[1]	1.阪大基礎工, 2.九大シス情, 3.熊本高専
	15:45 - 16:00	11p-D7-9	金誘起層交換成長法で作成した擬似単結晶Geの電気伝導特性	○中野 茉莉央[1], 東 英実[1], 笠原 健司[2], 山田 晋也[1], 金島 岳[1], 浜屋 宏平[1]	1.阪大基礎工, 2.九大シス情
	16:00 - 16:15	11p-D7-10	300℃以下プロセスで作製した結晶性GeチャネルTFT	○笠原 健司[1], 永冨 雄太[2], 山本 圭介[2], 東 英実[3], 中野 茉莉央[3], 山田 晋也[3], 金島 岳[3], 中島 寛[2], 浜屋 宏平[3]	1.九大シス情, 2.九大産学連携センター, 3.阪大基礎工
	16:15 - 16:30	11p-D7-11	ガラス上Ge薄膜のAl誘起成長におけるSn添加効果	○(M1)大谷 直生[1], 都甲 薫[1], 末益 崇[1]	1.筑波大院数理物質
	16:30 - 16:45	11p-D7-12	Ge(111)薄膜を利用したガラス上Geナノワイヤの均一合成	○(B)中田 充紀[1], 都甲 薫[1], Jevasuwan Wipakorn[2], 深田 直樹[2], 末益 崇[1]	1.筑波大院 数理物質, 2.物材機構

	16:45 - 17:00	11p-D7-13	非晶質Ge薄膜のAu誘起成長に及ぼす熱処理温度の影響	○工藤 康平[1], 野満 建至[1], 岡本 隼人[1], 高倉 健一郎[1], 角田 功[1]	1.熊本高等専門学校
	17:00 - 17:15	11p-D7-14	圧縮応力を印加した非晶質Ge薄膜のAu誘起成長	○工藤 和樹[1], 酒井 崇嗣[1], 草野 欽太[1], 本山 慎一[2], 楠田 豊[2], 古田 真浩[2], 中 庸行[3], 沼田 朋子[3], 高倉 健一郎[1], 角田 功[1]	1.熊本高等専門学校, 2.サムコ, 3.堀場製作所
	3月12日(木)　10:00 - 12:00				
	10:00 - 10:15	12a-D5-1	アモルファスGe上のサブ原子層カーボンの熱処理を用いたSi(100)基板上のGe薄膜形成	○青山 拓磨[1], 伊藤 友樹[2], 畠山 真慈[2], 川島 知之[1,2], 鷲尾 勝由[1,2]	1.東北大工, 2.東北大院工
	10:15 - 10:30	奨 12a-D5-2	C/Ge/Si(100)構造におけるサブ原子層カーボンとGe成長温度のGe薄膜形成への影響	○(M2)伊藤 友樹[1], 畠山 真慈[1], 川島 知之[1], 鷲尾 勝由[1]	1.東北大院工
	10:30 - 10:45	12a-D5-3	サブ原子層カーボンを用いたGeドットのSi-C結合形成温度依存性に関する検討	○佐藤 佑紀[1], 伊藤 友樹[1], 川島 知之[1], 鷲尾 勝由[1]	1.東北大院工
	10:45 - 11:00	12a-D5-4	Arイオン注入法を用いた圧縮歪みSi/緩和$Si_{1-x}C_x$ヘテロ構造の作製	○有澤 洋[1], 星 裕介[1], 藤原 幸亮[2], 山中 淳二[2], 有元 圭介[2], 中川 清和[2], 澤野 憲太郎[3], 宇佐美 徳隆[1]	1.名大院工, 2.山梨大クリスタル研, 3.都市大総研
	11:00 - 11:15	奨 12a-D5-5	n-GeへのPデルタドーピングにおけるSi挿入によるその偏析抑制効果	○山田 道洋[1], 澤野 憲太郎[2], 植松 真司[1], 伊藤 公平[1]	1.慶大理工, 2.都市大
	11:15 - 11:30	12a-D5-6	MBEを用いたSi(100)上2段階Ge薄膜成長における表面平坦化条件の検討	○早瀬 凌[1], 伊藤 友樹[1], 川島 知之[1], 鷲尾 勝由[1]	1.東北大院工
	11:30 - 11:45	12a-D5-7	2段階成長単結晶Ge層の結晶性及び光学特性評価	○小田 克矢[1], 奥村 忠嗣[1], 葛西 淳一[1], 井戸 立身[1]	1.日立中研
	11:45 - 12:00	12a-D5-8	極薄Al_2O_3/SiO_2 BOX層を有する貼り合わせGeOI基板の熱処理による電気特性改善	○吉田 啓資[1], 中村 芳明[1], 竹内 正太郎[1], 守山 佳彦[1,2], 手塚 勉[2], 酒井 朗[1]	1.阪大院基礎工, 2.産総研グリーンナノエレクトロニクスセンター

15.5 IV族結晶, IV-IV族混晶 / Group IV crystals and alloys　ポスター講演

	3月12日(木)　16:00 - 18:00				
		12p-P17-1	金内包キノコ型ナノ構造ゲルマニウム	○青野 祐美[1], 阿部 洋[1], 宮崎 尚[1]	1.防大材料
		12p-P17-2	高空間分解能HXPESとXPSによる歪み及び組成がSiGe価電子帯に与える影響の検出	○山堀 俊太[1], 笹子 知弥[1], 米倉 瑛介[1], 澤野 憲太郎[1], 池永 英司[2], 野平 博司[1]	1.東京都市大工, 2.高輝度光科学研究センター
		12p-P17-3	イオン注入成長法で作製した圧縮歪みSi/$Si_{1-x}C_x$/Si(001)構造MOSFETの電気特性評価	○中込 諒[1], 酒井 翔一朗[1], 藤原 幸亮[1], 有元 圭介[1], 山中 淳二[1], 中川 清和[1], 宇佐美 徳隆[2], 星 裕介[2], 澤野 憲太郎[3]	1.山梨大クリスタル研, 2.名古屋大学, 3.東京都市大総研
		12p-P17-4	伸張歪みSi/緩和SiGe/Si(110)の表面モフォロジーへの成長速度の影響	○宇津山 直人[1], 佐藤 圭[1], 有元 圭介[1], 山中 淳二[1], 中川 清和[1], 宇佐美 徳隆[2], 澤野 憲太郎[3]	1.山梨大クリスタル研, 2.名古屋大, 3.東京都市大総研
		12p-P17-5	歪みSi/Si1-xCx/Si(001)ヘテロ構造の結晶性と不純物活性化過程との関係	○藤原 幸亮[1], 酒井 翔一朗[1], 小林 昭太[1], 有元 圭介[1], 山中 淳二[1], 中川 清和[1], 宇佐美 徳隆[2], 星 裕介[2], 澤野 憲太郎[3]	1.山梨大学クリスタル研, 2.名古屋大学, 3.東京都市大総研
		12p-P17-6	RFマグネトロンスパッタリング法により作製したSi_xC_{1-x}混晶薄膜の光学的・構造的特性	○(M1)楠木 厚毅[1], 原 広紀[1], 勝俣 裕[1]	1.明大理工
		12p-P17-7	Pのin-situドーピングにより作製したn型GOIの電気伝導特性	○勝俣 洋典[1], 長嶋 智典[1], 浜屋 宏平[2], 澤野 憲太郎[1]	1.東京都市大工, 2.阪大基礎工

15.6 IV族系化合物 / Group IV Compound Semiconductors　ポスター講演

	3月11日(水)　13:30 - 15:30				
		11p-P2-1	溶剤添加SiC溶液成長における炭素溶解度測定と溶剤混入量の評価	○日根 賢人[1], 太子 敏則[2]	1.信大工, 2.信大環境エネ研
		11p-P2-2	SiC溶液成長における自発形成二次元核の4H多形安定性	花房 絢乃[1], 樋口 雅之[1], ○芦田 晃嗣[1], 久津間 保徳[1], 金子 忠昭[1]	1.関学大理工
		11p-P2-3	SiC単結晶成長における溶液ドリフトと結晶形態	○(M1)加藤 貴士[1], 亀井 一人[1,2], 楠 一彦[2], 関 和明[2]	1.東北大院, 2.新日鐵住金
		11p-P2-4	自然酸化膜付Si基板上へのモノメチルシランを用いたSiC薄膜高速成長(II)	○山田 晋平[1], 成田 克[1], 中島 健介[1], 内藤 正路[2], 末光 眞希[3]	1.山形大工, 2.九工大院生命体工, 3.東北大通研
		11p-P2-5	レーザーアブレーションによるSiCナノ微粒子の作製	○椿山 亮太[1], 黒葛原 愛美[1], 宮島 顕祐[1]	1.東理大理
		11p-P2-6	ミラー電子顕微鏡およびSEM,FIB-STEMによるナノヒロック対構造の観察	○一色 俊之[1], 生頼 義久[2], 佐藤 高広[2], 福井 宗利[2]	1.京都工繊大, 2.日立ハイテク
		11p-P2-7	4H-SiCの拡張転位の電子顕微鏡解析	○佐藤 高広[1], 大津 喜宏[2], 生頼 義久[1], 一色 俊之[3], 福井 宗利[1]	1.日立ハイテクノロジーズ, 2.日立ハイテクマニファクチャ&サービス, 3.京都工芸繊維大学
		11p-P2-8	原子ステップ誘起による自己組織化単分子膜の規則配列	○田中 弥生[1], 神田 隆生[2], 江龍 修[1]	1.名工大院, 2.ポバール興業㈱
		11p-P2-9	SiC/SiO_2界面における窒素化学状態の結晶面方位依存性	○森 大輔[1], 井上 慧[1], 寺西 秀明[1], 瀧川 亜樹[1], 広瀬 隆之[1]	1.富士電機株式会社
		11p-P2-10	4H-SiC熱酸化膜への水分子吸着の影響	○佐藤 旦[1], 黒木 伸一郎[1], 石川 誠治[2], 前田 知徳[2], 瀬崎 洋[2], 吉川 公麿[1]	1.広島大学ナノデバイス, 2.フェニテックセミコン
		11p-P2-11	高温下ガンマ線照射したSiC MOSFETの耐放射線性評価	○松田 拓磨[1,2], 横関 貴史[1,2], 三友 啓[1,2], 村田 航一[1,2], 牧野 高紘[2], 阿部 浩之[2], 小野田 忍[2], 大久保 秀一[3], 田中 雄季[3], 神取 幹郎[3], 吉江 徹[3], 大島 武[2], 土方 泰斗[1]	1.埼玉大学, 2.日本原子力機構, 3.サンケン電気
		11p-P2-12	SiC-MOSFETへのガンマ線照射効果の酸化膜作製プロセスによる違い	○三友 啓[1,2], 松田 拓磨[1,2], 村田 航一[1,2], 横関 貴史[1,2], 牧野 高紘[2], 阿部 浩之[2], 小野田 忍[2], 大島 武[2], 大久保 秀一[3], 田中 雄季[3], 神取 幹朗[3], 吉江 徹[3], 土方 泰斗[1]	1.埼玉大学, 2.日本原子力機構, 3.サンケン電気
		11p-P2-13	部分的アモルファス化によるSiC/金属オーミック抵抗の低減とそのメカニズム	○(M2)ミランタ デシルワ[1], 黒木 伸一郎[1], 石川 誠治[1,2], 前田 知徳[1,2], 瀬崎 洋[1,2], 吉川 公麿[1]	1.広大 RNBS, 2.フェニテック
		11p-P2-14	レーザアニールを用いたp型4H-SiCへのオーミックコンタクト形成	○中西 洋介[1], 岡部 博明[1], 中村 勇[1], 田口 健介[1], 須賀原 和之[1], 冨田 信之[1], 山川 聡[1]	1.三菱電機 先端総研
		奨 11p-P2-15	SAB法による4H-SiC/Si HBT構造における少数キャリア注入特性	○(B)清水 彩絵[1], 西田 将太[1], 梁 剣波[1], 森本 雅史[1], 重川 直輝[1], 新井 学[2]	1.大阪市大工, 2.新日本無線(株)

15.6 IV族系化合物 / Group IV Compound Semiconductors　口頭講演

3月12日(木)　9:00 - 11:45

	9:00 - 9:15	12a-B4-1	4H-SiC溶液成長におけるSiCrAl溶媒へのSn微量添加効果	○小松 直佳[1], 三谷 武志[1,2], 高橋 徹夫[1,2], 加藤 智久[1,2], 宇治原 徹[3], 松本 祐司[4], 蔵重 和央[1,5], 奥村 元[1,2]	1.FUPET, 2.AIST, 3.名古屋大学, 4.東北大学, 5.日立化成
	9:15 - 9:30	12a-B4-2	SiC溶液成長における貫通転位変換と成長表面のマクロステップの関係	○原田 俊太[1], 肖 世玉[1], 青柳 健大[1], 村山 健太[1], 酒井 武信[1], 田川 美穂[1], 宇治原 徹[1]	1.名大院工
	9:30 - 9:45	12a-B4-3	横型CVD装置を用いたSiCエピ膜成長における界面転位の発生と抑制	○工藤 千秋[1,2], 升本 恵子[1,5], 浅水 啓州[1,3], 田村 謙太郎[1,3], 西尾 譲司[1,4], 児島 一聡[1,5], 大野 俊之[1,6]	1.FUPET, 2.パナソニック, 3.ローム, 4.東芝, 5.産総研, 6.日立
	9:45 - 10:00	12a-B4-4	微傾斜4H-SiC(0001)表面ナノ構造の周期化距離のオフ角度依存性	○福間 洸平[1], 高崎 友也[1], 梶原 隆司[1], アントン ビシコフスキー[1], 田中 悟[1]	1.九大院工
	10:00 - 10:15	12a-B4-5	低温成長による3C-SiC(111)自立基板の結晶性評価	○浅村 英俊[1], 大内 澄人[1], 生川 満久[1], 稲垣 徹[1], 川村 啓介[1]	1.エア・ウォーター総研
	10:15 - 10:30		休憩/Break		
	10:30 - 10:45	奨 12a-B4-6	12 mA/W の光電流を示す水分解用 SiC	○市川 尚澄[1]	1.名工大
	10:45 - 11:00	12a-B4-7	4H-SiC表面再結合速度における温度依存性の解析	○(B)小濱 公洋[1], 森 祐人[1], 加藤 正史[1], 市村 正也[1]	1.名工大
	11:00 - 11:15	奨 12a-B4-8	様々なドーピング密度を有するp型4H-SiCのホール効果の温度依存性	○浅田 聡志[1], 奥田 貴史[1], 木本 恒暢[1], 須田 淳[1]	1.京大院工
	11:15 - 11:30	12a-B4-9	4H-SiC中の空孔欠陥と水素の反応と、水素複合欠陥のESR評価	○棚井 創基[1], 村上 功樹[1], 奥田 貴史[2], 須田 淳[2], 木本 恒暢[2], 小杉 亮治[3], 大島 武[4], 梅田 享英[1]	1.筑波大, 2.京大, 3.産総研, 4.原研
	11:30 - 11:45	奨 12a-B4-10	超高次非線形誘電率顕微鏡法を用いた交流バイアス印加によるSiC-DMOSFET断面におけるキャリア分布のゲート電圧依存性の解析	○茅根 慎通[1], 長 康雄[1]	1.東北大

3月13日(金)　9:00 - 11:45

	9:00 - 9:15	13a-B4-1	SiC表面における酸化初期での反応過程に関する理論的検討	○伊藤 綾子[1], 秋山 亨[1], 中村 浩次[1], 伊藤 智徳[1], 影島 博之[2], 植松 真司[3], 白石 賢二[4]	1.三重大院工, 2.島根大院理工, 3.慶大理工, 4.名大院工
	9:15 - 9:30	13a-B4-2	4H-SiC/SiO_2界面における酸化反応過程に関する理論的検討	○秋山 亨[1], 伊藤 綾子[1], 中村 浩次[1], 伊藤 智徳[1], 影島 博之[2], 植松 真司[3], 白石 賢二[4]	1.三重大院工, 2.島根大院理工, 3.慶大理工, 4.名大院工
	9:30 - 9:45	13a-B4-3	4H-SiC酸化の第一原理／古典的分子動力学シミュレーション	○山崎 隆浩[1,2], 田島 暢夫[1,2], 金子 智昭[1,2], 西川 宜孝[3], 清水 達雄[4], 加藤 弘一[4], 大野 隆央[1,2,5]	1.物材機構, 2.高効率電デバコンソ, 3.みずほ情報総研, 4.東芝研究開発センター, 5.東大生産研
	9:45 - 10:00	13a-B4-4	光電子収率分光法によるSiO_2/SiC構造の電子状態計測(2)	○大田 晃生[1], 渡邉 浩成[2], グェンスァン チュン[2], 牧原 克典[2], 宮崎 誠一[2]	1.名大VBL, 2.名大院工
	10:00 - 10:15	13a-B4-5	リモートH_2プラズマ処理した4H-SiC表面の化学構造および電子状態分析	○グェンスァン チュン[1], 大田 晃生[2], 竹内 大智[1], 張 海[1], 牧原 克典[1], 宮崎 誠一[1]	1.名大院工, 2.名大VBL
	10:15 - 10:30		休憩/Break		
	10:30 - 10:45	13a-B4-6	X線反射率法によるSiO_2/SiC構造解析	○先崎 純寿[1], 下里 淳[1], 吉田 貞史[1]	1.産総研
	10:45 - 11:00	奨 13a-B4-7	カソードルミネッセンス法による熱酸化SiO_2/SiC界面欠陥の検出	○福島 悠太[1], チャンタバン アタウット[1], 永井 大介[1], 細井 卓治[1], 志村 考功[1], 渡部 平司[1]	1.阪大院工
	11:00 - 11:15	13a-B4-8	容量検出型電子スピン共鳴分光法による4H-SiC MOSFET中の結晶欠陥の測定	○(M1)鹿児山 陽平[1], 岡本 光央[2], 小杉 亮治[2], 原田 信介[2], 牧野 高紘[3], 大島 武[3], 梅田 享英[1]	1.筑波大数物, 2.産総研, 3.日本原研
	11:15 - 11:30	E 13a-B4-9	Electrically Detected Magnetic Resonance (EDMR) Study on Interface Defects in C-face 4H-SiC Metal-Oxide-Semi-conductor Field Effect Transistors	○(B)GEONWOO KIM[1], Shijie Ma[1], Ryo Arai[1], Mitsuo Okamoto[2], Shinsuke Harada[2], Takahiro Makino[3], Takeshi Ohshima[3], Takahide Umeda[1]	1.Univ. of Tsukuba, 2.AIST, 3.JAEA
	11:30 - 11:45	13a-B4-10	SiO_2/SiC MOS 構造における伝導帯端近傍の界面特性II	○竹内 和歌奈[1], 山本 建策[2], 坂下 満男[1], 金村 高司[2], 中塚 理[1], 財満 鎭明[1,3]	1.名大院工, 2.(株)デンソー, 3.名大エコトピア

3月13日(金)　16:15 - 18:30

	16:15 - 16:30	奨 13p-B4-1	種々の温度における容量の過渡応答(C-t特性)に基づくSiC MOS界面近傍の膜中トラップ密度の定量化	○藤野 雄貴[1], 菊地 リチャード平八郎[1], 喜多 浩之[1,2]	1.東大院工, 2.JSTさきがけ
	16:30 - 16:45	奨 13p-B4-2	低温酸素アニールによるSiO_2/4H-SiC(0001)界面準位密度の増減機構の理解と制御	○菊地 平八郎[1], 喜多 浩之[2]	1.東大院工, 2.JST さきがけ
	16:45 - 17:00	奨 13p-B4-3	4H-SiC面内MOSFET上のdry酸化界面における電界効果移動度と実効移動度の乖離	○平井 悠久[1], 喜多 浩之[1,2]	1.東大院工, 2.JSTさきがけ
	17:00 - 17:15	13p-B4-4	4H-SiC MOSFETにおけるチャネル移動度の面方位及びチャネル方向に対する異方性の系統的評価	○有吉 恵子[1,2], 飯島 良介[2], 原田 信介[1,3], 児島 一聡[1,3], 先崎 純寿[1,3], 田中 保宣[1,3], 高尾 和人[2], 四戸 孝[1,2]	1.FUPET, 2.東芝, 3.産総研
	17:15 - 17:30	13p-B4-5	SiCのTDDB理論	○南 眞嗣[1]	1.フェニテック
	17:30 - 17:45	奨 13p-B4-6	4H-SiC MOSFETの高温ドレインバイアス試験における故障メカニズム解析	○内田 光亮[1], 日吉 透[1], 西口 太郎[1], 山本 裕史[1], 松川 真治[1], 古米 正樹[1], 御神村 泰樹[1]	1.住友電気工業
	17:45 - 18:00	奨 13p-B4-7	NOアニールを施したSiC MOSデバイスのフラットバンド電圧安定性	○勝 義仁[1], 細井 卓治[1], 南園 悠一郎[2], 木本 恒暢[2], 志村 考功[1], 渡部 平司[1]	1.阪大院工, 2.京大院工
	18:00 - 18:15	13p-B4-8	I-V特性から見たSiC-MOSFETストレス劣化の特徴	○村上 英一[1], 清水 宥喜[1], 米村 望努[1], 原 陽平[1]	1.九産大工
	18:15 - 18:30	13p-B4-9	ゲートバイアス印加を伴うSiC MOSFETへのガンマ線照射効果	○村田 航一[1,2], 三友 啓[1,2], 松田 拓磨[1,2], 横関 貴史[1,2], 牧野 高紘[2], 阿部 浩之[2], 小野田 忍[2], 大久保 秀一[3], 田中 雄季[3], 神取 幹郎[3], 吉江 徹[3], 大島 武[2], 土方 泰斗[1]	1.埼玉大学, 2.日本原子力機構, 3.サンケン電気

3月14日(土)　9:00 - 12:30

	9:00 - 9:15	奨 14a-B4-1	量子分子動力学シミュレーションによるSiCエッチングプロセスにおける化学反応ダイナミクスの解明	○(D)伊藤 寿[1], 桑原 卓哉[1], 樋口 祐次[1], 尾澤 伸樹[1], 久保 百司[1]	1.東北大院工
	9:15 - 9:30	奨 14a-B4-2	4H-SiCの電気化学エッチングにおけるサイドエッチングの異方性	○山下 尚人[1], 佐藤 孝亮[2], 木本 恒暢[2], 須田 淳[2]	1.京大工, 2.京大院工
	9:30 - 9:45	14a-B4-3	TaC/Ta複合材を用いたSiCトレンチ基板のキャップフリーアニール	○矢吹 紀人[1], 鳥見 聡[1], 野上 暁[1], 金子 忠昭[2]	1.東洋炭素(株), 2.関西学院大理工

	9:45 - 10:00	14a-B4-4	大気圧熱プラズマジェット照射急速熱処理の冷却速度制御による4H-SiC中Pの高効率活性化	○(M2)丸山 佳祐[1], 花房 宏明[1], 林 将平[1], 村上 秀樹[1], 東 清一郎[1]	1.広大院 先端研
	10:00 - 10:15	14a-B4-5	表面に堆積したAl薄膜へのレーザ照射による4H-SiCへのp型ドーピング	○池田 晃裕[1], 角名 陸歩[1], 池上 浩[1], 浅野 種正[1]	1.九州大学
	10:15 - 10:30	14a-B4-6	液体窒素中でのSiC基板へのレーザー照射	○宮川 鈴衣奈[1], 中川 崇寛[1], 江龍 修[1]	1.名工大
	10:30 - 10:45	14a-B4-7	Ti電極とTiC電極のSiCショットキーダイオードの電気特性評価	○(B)鈴木 智之[1], 岡本 真里[2], 宗清 修[2], 角嶋 邦之[2], 片岡 好則[2], 西山 彰[2], 杉井 信之[2], 若林 整[2], 筒井 一生[2], 名取 研二[1], 岩井 洋[1]	1.東工大フロンティア研, 2.東工大総理工
	10:45 - 11:00		休憩/Break		
	11:00 - 11:15	14a-B4-8	SiO_2注入マスクを用いた6インチ基板上の高エネルギーイオン注入技術開発	○堀井 拓[1], 久保田 良輔[1], 和田 圭司[1], 田中 聡[1], 関口 剛[1], 御神村 泰樹[1]	1.住友電気工業(株)
	11:15 - 11:30	14a-B4-9	3.3 kV 4H-SiC MOSFETの作製と特性評価	○酒井 光彦[1], 内田 光亮[1], 日吉 透[1], 和田 圭司[1], 古米 正樹[1], 築野 孝[1], 御神村 泰樹[1]	1.住友電気工業
	11:30 - 11:45	奨 14a-B4-10	Investigation of SiC MOSFETs with 3C/4H Different Poly-Type Junctions	○Munetaka Noguchi[1], Toshiaki Iwamatsu[1], Naruhisa Miura[1], Shuhei Nakata[1], Satoshi Yamakawa[1]	1.Mitsubishi Electric Corp.
	11:45 - 12:00	14a-B4-11	3.3 kV級SiC-MOSFETに適用するFLR型終端構造	○海老原 洪平[1,2], 富永 貴亮[1,2], 濱田 憲治[1], 日野 史郎[1,2], 渡邊 寛[1,2], 三浦 成久[1], 中田 修平[1,2], 山川 聡[1,2]	1.三菱電機, 2.FUPET
	12:00 - 12:15	奨 14a-B4-12	超高耐圧4H-SiCパワーデバイスを目指した衝突イオン化係数の決定	○(DC)丹羽 弘樹[1], 須田 淳[1], 木本 恒暢[1]	1.京大院工
	12:15 - 12:30	14a-B4-13	新しいユニポーラ動作SiCダイオード	○谷本 智[1], 上岡 健一[1], 藤田 高弥[1], 児島 一聡[2], 牧野 俊春[3], 山崎 聡[3]	1.日産アーク・要素解析, 2.産総研・先進パワエレ, 3.産総研・エネ部門

15.7 エピタキシーの基礎 / Fundamentals of epitaxy　ポスター講演

3月13日(金)　9:30 - 11:30

		13a-P16-1	ミストCVDによるα-$(AlGa)_2O_3$混晶成長の基礎検討 ーα-Ga_2O_3と比較したα-Al_2O_3の成長速度の検討ー	○(B)高橋 幹夫[1], 畠山 匠[1], 尾沼 猛儀[1,2], 山口 智広[1], 本田 徹[1]	1.工学院大工, 2.東京高専
		13a-P16-2	GaAs MCEにおけるらせんステップ源による法線成長速度決定メカニズム	○水野 陽介[1], 冨田 将史[1], 高倉 宏幸[1], 岩川 宗樹[1], 神林 大介[1], 丸山 隆浩[1], 成塚 重弥[1]	1.名城大理工

15.7 エピタキシーの基礎 / Fundamentals of epitaxy　口頭講演

3月14日(土)　14:15 - 15:00

	14:15 - 14:30	14p-D4-6	GaAs中Mn不純物状態のSTM観察	○津久井 雅之[1], 加来 滋[1], 吉野 淳二[1]	1.東工大院理工
	14:30 - 14:45	14p-D4-7	In断続供給によるInAs量子ドット形成のSTMBE観察	○東條 孝志[1,2], 山口 浩一[2], 塚本 史郎[1]	1.阿南高専, 2.電通大
	14:45 - 15:00	14p-D4-8	InAs(001)-(8x3)ぬれ層表面の不安定性に関する検討	○伊藤 智徳[1], 秋山 亨[1], 中村 浩次[1]	1.三重大院工

15.8 結晶評価, 不純物・結晶欠陥 / Crystal evaluation, impurities and crystal defects　口頭講演

3月12日(木)　14:00 - 19:00

	14:00 - 14:15	E 12p-A18-1	Formation of polycrystalline Silicon Layer on Quartz substrate by Aluminium-induced Crystallization	○(M1)Joko Suwardy[1,2], Wipakorn Jevasuwan[1], Kaoru Toko[2], Takashi Suemasu[2], Naoki Fukata[1,2]	1.National Institute for Materials Science, 2.Univ. of Tsukuba
	14:15 - 14:30	奨 12p-A18-2	高濃度Si結晶のフォトルミネッセンススペクトルの系統的変化	○中川 啓[1,2], 田島 道夫[1,2], 豊田 裕之[2], 小椋 厚志[1]	1.明治大, 2.JAXA宇宙研
	14:30 - 14:45	12p-A18-3	Si結晶中の低濃度炭素の赤外吸収測定 (VI) 5x10^{14} cm^{-3}までのSIMS測定と標準試料	○井上 直久[1,7], 渡邉 香[2], 後藤 安則[3], 大渕 真澄[4], 関 洋文[5], 鵜野 浩行[6], 河村 裕一[7]	1.東京農工大工, 2.システムズエンジニアリング, 3.トヨタ自動車, 4.ナノサイエンス, 5.東レリサーチ, 6.住重試験検査, 7.大阪府大
	14:45 - 15:00	12p-A18-4	SiC結晶の赤外吸収(3)反射吸収	○井上 直久[1], 渡邉 香[2], 関 章憲[3], 河村 裕一[4]	1.東京農工大工, 2.システムズエンジニアリング, 3.トヨタ自動車, 4.大阪府大
	15:00 - 15:15	12p-A18-5	融液からの炭素の蒸発を利用したCZ-Siの極低炭素化技術	○永井 勇太[1], 鹿島 一日兒[1], 中川 聰子[1], 日笠 光朗[1]	1.グローバルウェーハズ・ジャパン
	15:15 - 15:30	12p-A18-6	MCZシリコン単結晶のバルクライフタイムに対する低炭素化の効果（2）	○日笠 光朗[1], 中川 聰子[1], 鹿島 一日兒[1], 永井 勇太[1]	1.グローバルウェーハズ・ジャパン
	15:30 - 15:45		休憩/Break		
	15:45 - 16:00	12p-A18-7	固液界面近傍の熱応力がSi単結晶の臨界v/G値に与える影響(II)	○末岡 浩治[1], 神山 栄治[1], 中村 浩三[1]	1.岡山県大情報工
	16:00 - 16:15	12p-A18-8	自己拡散や成長欠陥研究から求められたシリコン中の点欠陥の性質	○末澤 正志[1], 飯島 嘉明[1], 深田 直樹[2], 米永 一郎[1]	1.東北大金研, 2.物材機構
	16:15 - 16:30	12p-A18-9	シリコン中の空孔濃度に及ぼす不純物効果の検討 (II)	○中村 浩三[1], 末岡 浩治[1], 神山 栄治[1]	1.岡山県大情報工
	16:30 - 16:45	奨 12p-A18-10	水素ドナー及び格子間Si対形成に対する熱処理温度の影響	○清井 明[1], 田中 政幸[1], 川上 剛史[1], 鶴田 明三[1], 谷村 純二[1], 湊 忠玄[2], 多留谷 政良[2]	1.三菱電機先端総研, 2.三菱電機パワ電
	16:45 - 17:00	奨 12p-A18-11	シリコンウェーハ中の酸素析出物を起因とするSlip転位発生の臨界応力	○藤瀬 淳[1], 高 奉均[1], 鳥越 和尚[1], 小野 敏昭[1]	1.株式会社SUMCO
	17:00 - 17:15	奨 12p-A18-12	n型シリコンウェーハ中のFe関連準位の低温熱処理挙動	○大仲 亜由美[1], 門野 武[1], 三次 伯知[1], 栗田 一成[1]	1.SUMCO
	17:15 - 17:30		休憩/Break		
	17:30 - 17:45	12p-A18-13	炭素クラスターイオン照射によるSiウェーハの近接ゲッタリング(1) -CMOSイメージセンサのデバイス特性にゲッタリングが与える効果-	○栗田 一成[1], 門野 武[1], 李 伸[2], 朴 在勤[2]	1.株式会社SUMCO, 2.漢陽大学校
	17:45 - 18:00	奨 12p-A18-14	炭素クラスターイオン照射によるSiウェーハの近接ゲッタリング(2) -エピタキシャル成長後の水素の熱処理・拡散挙動-	○奥山 亮輔[1], 廣瀬 諒[1], 門野 武[1], 岩永 卓朗[1], 古賀 祥泰[1], 奥田 秀彦[1], 栗田 一成[1]	1.株式会社SUMCO
	18:00 - 18:15	12p-A18-15	炭素クラスターイオン照射によるSiウェーハの近接ゲッタリング(3) -エピ成長後の酸素の熱処理・拡散挙動-	○奥田 秀彦[1], 奥山 亮輔[1], 岩永 卓朗[1], 門野 武[1], 廣瀬 諒[1], 古賀 祥泰[1], 栗田 一成[1]	1.株式会社SUMCO
	18:15 - 18:30	奨 12p-A18-16	炭素クラスターイオン照射によるSiウェーハの近接ゲッタリング(4) -低温クラスター照射が照射欠陥の形成に与える影響-	○廣瀬 諒[1], 奥山 亮輔[1], 門野 武[1], 岩永 卓朗[1], 古賀 祥泰[1], 奥田 秀彦[1], 栗田 一成[1]	1.株式会社SUMCO

	18:30 - 18:45	12p-A18-17	第一原理計算によるSi単結晶中のゲッタリングサイトの探索	○白澤 渉[1], 末岡 浩治[1], 前川 和義[2], 山口 直[2]	1.岡山県大院情報系工, 2.ルネサスエレクトロニクス
	18:45 - 19:00	12p-A18-18	IV族半導体結晶におけるクラスタや混晶系の対称性を考慮した原子配置作成プログラムとその適用	○末岡 浩治[1], 松谷 亮[1], 白澤 渉[1], 神山 栄治[1,2], 泉妻 宏治[2], 鹿島 一日児[2], 中塚 理[3]	1.岡山県大情報工, 2.グローバルウェーハズ, 3.名大院工

15.8 結晶評価, 不純物・結晶欠陥 / Crystal evaluation, impurities and crystal defects　ポスター講演

3月13日(金)　9:30 - 11:30

		13a-P17-1	融液からの切り離しによるCZ Si結晶内の引き上げ速度に依存した点欠陥分布の観察	○阿部 孝夫[1], 高橋 徹[1], 白井 光雲[2]	1.信越半導体磯部研究所, 2.阪大産研
		13a-P17-2	斜入射トポグラフィーと局所ロッキングカーブ法によるAlイオン注入SiC基板の歪状態の観察	○高橋 由美子[1], 平野 馨一[1], 吉村 順一[1], 山下 良樹[1], 志村 考功[2], 長町 信治[3]	1.KEK−PF, 2.大阪院工, 3.(株)長町サイエンスラボ

16 非晶質・微結晶 / Amorphous and Microcrystalline Materials

16 非晶質・微結晶 / Amorphous and Microcrystalline Materials　ポスター講演

3月11日(水)　16:00 - 18:00

		11p-P6-1	酸化亜鉛及び硫化亜鉛の遠紫外スペクトル測定	○山田 庸介[1]	1.関学大理工
		11p-P6-2	ラマン分光法による酸化物ガラスのレーザー誘起構造変化の解析	○内田 翔平[1], 寺門 信明[1], 高橋 儀宏[1], 藤原 巧[1]	1.東北大院工
		11p-P6-3	合成粉溶融シリカガラスのArFエキシマレーザー誘起光吸収帯の熱処理特性	○(M1)丹羽 祥平[1], 野城 慎也[1], 葛生 伸[1], 山本 剛貴[1], 堀越 秀春[2]	1.福井大工, 2.東ソー・エスジーエム
		11p-P6-4	接合したシリカガラス間のOH 基の拡散	○佐藤 直哉[1], 山本 剛貴[1], 葛生 伸[1], 堀越 秀春[2], 丹羽 祥平[1]	1.福井大工, 2.東ソー・エスジーエム
		11p-P6-5	反応雰囲気気体がシリカガラスの失透に及ぼす影響(II)	○堀井 直宏[1], 桑名 秀太[1], 高野 直也[1], 葛生 伸[2], 池田 昌弘[1], 安仁屋 勝[3], 青山 義弘[1], 野村 保之[1]	1.福井高専, 2.福井大院工, 3.熊本大院自然
		11p-P6-6	水垢構造を脆弱化させる表面濡れ性の研究	○中目 万理[1], 石川 綾子[1], 松本 勘[1], 光橋 義陽[1]	1.TOTO㈱
		11p-P6-7	潜熱蓄熱に向けたガラス−結晶複合材料の開発	○村本 圭[1], 藤原 巧[1], 高橋 儀宏[1], 寺門 信明[1]	1.東北大工
		11p-P6-8	微結晶シリコン薄膜を発電層に用いたヘテロ接合型太陽電池の試作	○大住 祐矢[1], 端 純平[1], 北田 和寛[1], 吉田 憲充[1,2], 野々村 修一[1,2]	1.岐大院工, 2.岐阜大CIPS
		11p-P6-9	選択的 Si 酸化を用いた c-Si/a-Si ヘテロ接合界面(1 in)における漏れ電流抑制技術の開発	○太田 昂貴[1], 三和 寛之[1], 西田 哲[1], 牟田 浩司[1], 栗林 志頭眞[1]	1.岐大院工
		11p-P6-10	裏面コンタクト型ヘテロ接合Si結晶セルにおける裏面構造の幾何寸法設計指針の検討	○(PC)神岡 武文[1], 林 豊[1], 中村 京太郎[2], 大下 祥雄[1]	1.豊田工大, 2.明治大
		11p-P6-11	a-Si:Hパッシベーション膜の高品質化プロセスの検討	○山本 翔太[1], 岡田 祐希[1], 三和 寛之[1], 西田 哲[1], 松木 伸行[1], 牟田 浩司[1], 栗林 志頭眞[1]	1.岐阜大学院工
		11p-P6-12	TMAHによるテクスチャ付シリコン基板のライフタイム改善	○寺澤 良平[1], 兼松 雅斗[1], 武藤 芳樹[1], 西田 哲[1], 牟田 浩司[1], 栗林 志頭眞[1]	1.岐阜大院工
		11p-P6-13	結晶シリコン太陽電池のパッシベーション用アルミナ薄膜のスピンコーティング製膜	○野口 卓馬[1], ウズム アブドゥラ[1], 神田 広之[1], 伊藤 省吾[1]	1.兵県大工
		11p-P6-14	結晶シリコン太陽電池用のスピンコート・リン拡散剤の調製	○望月 脩平[1], ウズム アブドゥラ[1], 神田 広之[1], 伊藤 省吾[1]	1.兵県大工
		11p-P6-15	フラッシュランプアニールにより形成したpoly-Si膜のa-Si膜による表面パッシベーションの効果	○野澤 尚樹[1], 渡邊 大貴[1], 大平 圭介[1]	1.北陸先端大
		11p-P6-16	ポリビニルアルコールを用いたシリコン太陽電池用アルミニウムペーストの作製	○足利 泰紀[1], 野口 卓馬[1], ウズム アブドーラ[1], 松岡 敏文[2], 中西 暢[3], 福井 英人[4], 原田 富太郎[4], 伊藤 省吾[1]	1.兵県大工, 2.日本酢ビ・ポバール株式会社, 3.信越化学工業株式会社, 4.大和産業株式会社
		11p-P6-17	TiO_2ナノ粒子/SiO_2コンポジット膜を用いた太陽電池裏面反射構造II	○室岡 拓也[1], 永吉 浩[1]	1.東京高専
		11p-P6-18	シリカ粒子および液体ガラスを用いた高散乱性透明導電基板の作製	○井上 将成[1], 三浦 修平[2], 鈴木 一鋭[2], 野田 真一[2], 村上 功一[1], 野々村 修一[1,2]	1.岐大工, 2.岐大院工
		11p-P6-19	スピンコート法による結晶Si太陽電池用光反射防止膜の作製	○栗山 将[1], ウズム アブドーラ[1], 伊藤 省吾[1]	1.兵県大工
		11p-P6-20	Siナノワイヤー太陽電池の光劣化とAl_2O_3によるパッシベーション効果	○宮澤 遼太[1], 小路 智也[1], 角嶋 邦之[2], 片岡 好則[2], 西山 彰[2], 杉井 信之[2], 若林 整[2], 筒井 一生[2], 大橋 弘通[1], 名取 研二[1], 岩井 洋[1]	1.東工大フロンティア研, 2.東工大総理工
		E 11p-P6-21	The effects of Nickel additive on solar grade silica reduction process	○(DC)ABDELLAOUI IMANE[1], Kenji Itaka[2], Abd Erahmane Boucetta[2], Rabie Benioub[2], Takuya Ogasawara[2]	1.Tsukuba Univ., 2.Hirosaki Univ.
		11p-P6-22	異なるFermi準位を有するSi中Fe不純物のメスバウア分光	○伊野 裕司[1], 田中 清高[1], 坂田 和正[1], 吉田 豊[1]	1.静岡理工科大
		11p-P6-23	マルチシードキャスト法により導入した小傾角粒界における再結合速度の温度特性	○(D)小島 拓人[1], 立花 福久[1], 大下 祥雄[1], Prakash Ronit[2,3], 関口 隆史[2,3], 山口 真史[1]	1.豊田工大, 2.物材機構, 3.筑波大
		11p-P6-24	50cm角seed cast法によるSiインゴットの育成と特性評価 (III)	宮村 佳児[1], 原田 博文[1,2], イプトナー カロリン[1], プラカシュ ロニト[1], 陳 君[1], 中野 智[2], 柿本 浩一[2], ○関口 隆史[1]	1.物材機構, 2.九大応力研

16.1 基礎物性・評価 / Fundamental properties and their evaluation in disordered materials　口頭講演

3月12日(木)　9:15 - 12:30

	9:15 - 9:30	12a-A28-1	Ag微粒子を配置したGeTeにおける抵抗スイッチ現象	○今西 佑典[1], 木田 士文[1], 宮邉 徹[1], 中岡 俊裕[1]	1.上智大理工
	9:30 - 9:45	12a-A28-2	硫化銅薄膜のギャップ内準位評価	○後藤 民浩[1]	1.群馬大院理工
	9:45 - 10:00	12a-A28-3	硫黄ガス熱処理によるSnS薄膜の特性変化	○矢澤 広祐[1]	1.群大理工
	10:00 - 10:15	奨 12a-A28-4	減衰全反射型遠紫外分光装置による金属酸化物半導体粉末の測定	○田邉 一郎[1], 尾崎 幸洋[1]	1.関西学院大理工
	10:15 - 10:30	12a-A28-5	非晶質$InGaZnO_4$と$InSnZnO_4$のバンド吸収端酸素化及び水素化特性評価	○(M1)張 帥澤[1], 大野 祐樹[1], 清水 耕作[1]	1.日大生産工

	10:30 - 10:45	12a-A28-6	反射CPM法を用いた非晶質酸化物半導体薄膜トランジスタの特性不安定性解析	○竹山 裕貴[1], 大野 祐樹[1], 清水 耕作[1]	1.日大
	10:45 - 11:00		休憩/Break		
	11:00 - 11:15	12a-A28-7	原子状水素供給スパッタ法による非晶質シリコン膜の作製と 変調アドミタンス法によるp-i/i-n界面の評価	○大江 和顕[1], 岩崎 真宝[1], 清水 耕作[1]	1.日本大生産
	11:15 - 11:30	12a-A28-8	Si及びSiO_2上に製膜した非晶質Ge膜の固相結晶成長に関する検討	○黒岩 杏太[1], 磯村 雅夫[1]	1.東海大院工
	11:30 - 11:45	12a-A28-9	テルライト系ガラスを用いた超高速一括波長変換の研究 ー紫外光ポーリング条件の最適化ー	○山寺 雄太[1], 平野 拓也[1], 三田地 成幸[1]	1.東京工科大
	11:45 - 12:00	12a-A28-10	レーザー照射によるガラス表面への$BiFeO_3$形成	○熊谷 彰恵[1], 高橋 哲平[1], 高橋 儀宏[1], 寺門 信明[1], 藤原 巧[1]	1.東北大院工
	12:00 - 12:15	12a-A28-11	TiO_2結晶化ガラスにおける光触媒活性の組成及び熱処理温度依存性	○高橋 寛[1], 吉田 和貴[1], 正井 博和[2], 高橋 儀宏[1], 寺門 信明[1], 藤原 巧[1]	1.東北大院工, 2.京大化研
	12:15 - 12:30	12a-A28-12	結晶化ガラスに対する欠陥導入と光触媒活性への影響	○吉田 和貴[1], 正井 博和[2], 寺門 信明[1], 高橋 儀宏[1], 藤原 巧[1], 加藤 英樹[3], 垣花 眞人[3]	1.東北大院工, 2.京大化研, 3.東北大多元研
	3月12日(木) 14:00 - 17:15				
	14:00 - 14:15	奨 12p-A28-1	集熱・排熱デバイスへの応用に向けた$SrCuO_2$スパッタ膜の作製	○高橋 良輔[1], 寺門 信明[1], 高橋 儀宏[1], 藤原 巧[1]	1.東北大院工
	14:15 - 14:30	12p-A28-2	$(NH_4)_2SiF_6$微粒子へのリン添加－構造・発光特性－	○常盤 葵[1], 佐藤 慶介[1], 深田 直樹[2], 平栗 健二[1]	1.東京電機大学, 2.物質・材料研究機構
	14:30 - 14:45	奨 12p-A28-3	Mn^{4+}ドープ$SrGe_4O_9$相の赤色発光におけるSi置換効果	○鈴木 理恵[1], 寺門 信明[1], 高橋 儀宏[1], 藤原 巧[1]	1.東北大院工
	14:45 - 15:00	奨 12p-A28-4	Mn添加Li_2O-ZnO-GeO_2系結晶化ガラスにおける発光挙動の結晶化温度依存性	○星野 愛信[1], 高橋 儀宏[1], 寺門 信明[1], 藤原 巧[1]	1.東北大院工
	15:00 - 15:15	12p-A28-5	異なる冷却過程で作製したSrO-B_2O_3 ガラス中のSn^{2+}中心の発光	○正井 博和[1], 是枝 聡肇[2], 大窪 貴洋[3]	1.京大化研, 2.立命館大, 3.千葉大
	15:15 - 15:30	12p-A28-6	Eu^{3+}添加GdF_3-SiO_2透明結晶化ガラスのゾルゲル合成と発光特性	○早川 知克[1], 古田 眞人[1]	1.名古屋工大大学院
	15:30 - 15:45		休憩/Break		
	15:45 - 16:00	奨 12p-A28-7	浮遊法を用いた長残光$SrAl_2O_4$結晶化ガラスの合成	○篠崎 健二[1], Affatigato Mario[2], 本間 剛[1], 小松 高行[1]	1.長岡技科大, 2.コー大学
	16:00 - 16:15	12p-A28-8	リン酸鉄ナトリウムガラスのナトリウム電池用正極としての機能性	仲田 諭史[1], ○本間 剛[1], 篠崎 健二[1], 小松 高行[1]	1.長岡技科大
	16:15 - 16:30	12p-A28-9	亜鉛ビスマスリン酸塩ガラスの真空紫外反射スペクトル	○北村 直之[1], 福味 幸平[1]	1.産総研
	16:30 - 16:45	12p-A28-10	シリカ超微粒子集合体の空隙サイズの温度依存性	○小林 立人[1], 斎藤 文修[1]	1.東大総合文化
	16:45 - 17:00	12p-A28-11	仮想温度の異なるSiO_2 ガラスにおける弾性評価および構造解析	○正井 博和[1], 是枝 聡肇[2], 藤井 康裕[2], 斎藤 和也[3], 関谷 エジソン[3], 小原 真司[4]	1.京大化研, 2.立命館大, 3.豊田工大, 4.JASRI/SPring-8
	17:00 - 17:15	12p-A28-12	SiO_2中の酸素欠陥の7.6eV光吸収帯の不均一広がりとピークシフト	○梶原 浩一[1], Skuja Linrads[2], 細野 秀雄[3]	1.首都大, 2.Latvia大, 3.東工大

16.3 シリコン系太陽電池 / Bulk, thin-film and other silicon-based solar cells　口頭講演

	3月11日(水) 9:00 - 12:30				
	9:00 - 9:15	11a-C2-1	変調表面テクスチャにおける光閉じ込め効果の理論的検討	○太野垣 健[1], 岸本 裕子[1], 星 裕介[2], 宇佐美 徳隆[2]	1.京大化研, 2.名大工
	9:15 - 9:30	11a-C2-2	コロイダルリソグラフィを利用したテクスチャSi基板表面へのナノ構造形成とその太陽電池特性	○星 裕介[1], 平井 悠司[2], 宇佐美 徳隆[1]	1.名大院工, 2.千歳科技大
	9:30 - 9:45	11a-C2-3	液体ガラスを用いた反射防止膜の形成	○村上 功一[1], 三浦 修平[1], 鈴木 一鋭[1], 野田 真一[1], 井上 将成[1], 野々村 修一[1]	1.岐大院工
	9:45 - 10:00	11a-C2-4	球状シリカ粒子および液体ガラスを用いた凹凸構造付き透明導電膜基板	○野田 真一[1], 三浦 修平[1], 鈴木 一鋭[1], 井上 将成[1], 村上 功一[1], 野々村 修一[1]	1.岐大院工
	10:00 - 10:15	11a-C2-5	液体Siを用いて製膜したa-Siパッシベーション膜の耐熱性	○(M1C)過 程[1], 大平 圭介[1], 高岸 秀行[2], 下田 達也[1]	1.北陸先端大, 2.福島大
	10:15 - 10:30	奨 11a-C2-6	反応支援型ミストCVD法により低温成長した酸化アルミニウム(AlO_x)薄膜のパッシベーション応用特性	○内田 貴之[1], 川原村 敏幸[2], 藤田 静雄[1], 平松 孝浩[3], 織田 容征[3]	1.京大院工, 2.高知工大 総研, 3.東芝三菱電機産業システム
	10:30 - 10:45	11a-C2-7	新規アルミニウム源による酸化アルミニウム膜の形成と太陽電池応用	○高橋 清[1], 轟 宗一郎[2], 宮島 晋介[2]	1.日本アルキルアルミ, 2.東工大院理工
	10:45 - 11:00	11a-C2-8	a-Si:H/c-Siヘテロ界面におけるボイド構造 － 陽電子消滅データに基づく光学的評価法の適用 －	○松木 伸行[1], 上殿 明良[2], ブライアン オローク[3], 大島 永康[3]	1.岐阜大, 2.筑波大, 3.産総研
	11:00 - 11:15		休憩/Break		
	11:15 - 11:30	11a-C2-9	Cat-doping法によるa-Si膜への低温ドーピング	○瀬戸 純一[1]	1.北陸先端大
	11:30 - 11:45	11a-C2-10	低界面再結合速度を実現するCat-CVD SiN_x/a-Si積層保護膜の光学特性	○小山 晃一[1], 寺嶋 茂樹[1], 大平 圭介[1], 松村 英樹[1]	1.北陸先端大
	11:45 - 12:00	11a-C2-11	低表面再結合速度を実現したCat-CVD SiNx/a-Si積層膜の化学耐性	○寺嶋 茂樹[1], 小山 晃一[1], 大平 圭介[1], 松村 英樹[1]	1.北陸先端大
	12:00 - 12:15	E 11a-C2-12	Defect termination at the interfaces of Cat-CVD SiN_x/c-Si and SiN_x/P Cat-doped layer/c-Si structures	○(D)Cham Trinh[1,2], Koichi Koyama[1,2], Keisuke Ohdaira[1,2], Hideki Matsumura[1,2]	1.JAIST, 2.JST CREST
	12:15 - 12:30	11a-C2-13	Improvement in the passivation quality of Cat-CVD a-Si/c-Si hetero-junction interface for Si(111) and Si(100) by the formation of ultra-thin oxide layers	○(M2)Takafumi Oikawa[1], Keisuke Ohdaira[1,2], Koichi Higashimine[1,2], Hideki Matsumura[1,2]	1.JAIST, 2.JST CREST
	3月11日(水) 14:00 - 15:45				
	14:00 - 14:15	奨 11p-C2-1	シリコン窒化膜製膜時に導入される結晶欠陥層のライフタイムの算出	○(P)立花 福久[1], 小島 拓人[1], 高井 大輔[1], 小椋 厚志[2], 大下 祥雄[1]	1.豊田工大, 2.明治大学
	14:15 - 14:30	11p-C2-2	硝酸酸化SiO_2膜と加熱処理によるSi表面のパッシベーション	○中島 寛記[1], 入鹿 大地[1], 野中 啓章[1], 今村 健太郎[1], 松本 健俊[1], 小林 光[1]	1.阪大産研
	14:30 - 14:45	奨 11p-C2-3	結晶Si太陽電池表面パッシベーションにおける積層構造の検討	○(D)池野 成裕[1,5], 勝又 隆晶[1,2,4], 山下 祥弘[1], 佐藤 真一[3,4], 吉田 晴彦[3,4], 新船 幸二[3,4], 知京 豊裕[2,4], 小椋 厚志[1,4]	1.明治大学, 2.物質・材料研究機構, 3.兵庫県立大学, 4.JST-CREST, 5.学振特別研究員DC
	14:45 - 15:00	奨 11p-C2-4	金属Alの熱酸化で形成したAlOx/Si界面状態および固定電荷密度	○(D)池野 成裕[1,3], 山下 祥弘[1], 勝又 隆晶[1,2,4], 知京 豊裕[2], 小椋 厚志[1,4]	1.明治大学, 2.物材機構, 3.学振特別研究員DC, 4.JST-CREST

	15:00 - 15:15	11p-C2-5	Siヘテロ接合(SHJ)太陽電池におけるケルビンプローブ顕微鏡を用いた仕事関数測定の定量性検討	○(PC)山田 郁彦[1], 高林 紘[1], 神岡 武文[1], 立花 福久[1], 中村 京太郎[1], 大下 祥雄[1], 神谷 格[1]	1.豊田工大
	15:15 - 15:30	11p-C2-6	n/i層とp/i層が部分的に重なった裏面電極型ヘテロ接合Si太陽電池における界面欠陥密度の影響	○野毛 宏[1], 齊藤 公彦[1], 佐藤 愛子[1], 金子 哲也[2], 近藤 道雄[1,3]	1.福島大, 2.東海大工, 3.産総研
	15:30 - 15:45	奨・E 11p-C2-7	C-Si/PEDOT:PSS heterojunction solar cells with a TiO_2 AR coating	○(D)Qiming Liu[1], Tatsuya Ohki[1], Ryo Ishikawa[1], Keiji Ueno[1], Hajime Shirai[1]	1.Saitama University
	3月12日(木)　9:00 - 12:30				
	9:00 - 9:15	12a-A18-1	エレクトロルミネッセンス定量画像測定による太陽電池の開放電圧評価	○望月 敏光[1], 金 昌秀[2,3], 朱 琳[2,3], 陳 少強[4], 吉田 正裕[2,3], 高遠 秀尚[1], 秋山 英文[2,3], 金 光 義彦[3,5]	1.産総研, 2.東大物性研, 3.JST-CREST, 4.華東師範大, 5.京大化研
	9:15 - 9:30	12a-A18-2	絶対EL画像測定による太陽電池の開放電圧マッピング	○金 昌秀[1,2], 望月 敏光[3], 朱 琳[1,2], 陳 少強[4], 吉田 正裕[1,2], 高遠 秀尚[3], 秋山 英文[1,2], 金 光 義彦[2,5]	1.東大物性研, 2.JST-CREST, 3.産総研, 4.華東師範大, 5.京大化研
	9:30 - 9:45	奨 12a-A18-3	Siナノクリスタル層形成による極低反射化と多結晶Si太陽電池への応用	○入鹿 大地[1,2], 今村 健太郎[1,2], 小林 光[1,2]	1.阪大産研, 2.JST-CREST
	9:45 - 10:00	E 12a-A18-4	The Impact of Boron Diffusion Profile on n-type Silicon Solar Cells	○(PC)SIMAYI SHALAMUJIANG[1], yasuhiro Kida[1], Katsuhiko Shirasawa[1], Hidetaka Takato[1]	1.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
	10:00 - 10:15	12a-A18-5	固定ダイヤモンドワイヤーで加工した単結晶シリコンウエハの表面評価	○福田 哲生[1], 鈴木 信隆[1], 森谷 正昭[1], 白澤 勝彦[1], 高遠 秀尚[1]	1.(独)産総研
	10:15 - 10:30	12a-A18-6	切断ワイヤの摩耗と単結晶シリコンウエハの破壊強度	○小野 裕道[1], 本田 和夫[1], 福田 哲生[2], 鈴木 信隆[2], 白澤 勝彦[2], 高遠 秀尚[2]	1.福島県ハイテクプラザ, 2.(独)産総研福島再生可能エネルギー研究所
	10:30 - 10:45	12a-A18-7	Ne雰囲気スパッタSi膜(500 nm厚)への青色レーザによる結晶化	○具志堅 貴也[1], 若杉 智英[1], 岡田 竜弥[1], 野口 隆[1], 河本 直哉[2]	1.琉球大学, 2.山口大学
	10:45 - 11:00		休憩/Break		
	11:00 - 11:15	奨 12a-A18-8	太陽電池用モノライクSi中の転位発生抑制のための応力解析	○杉岡 翔太[1], 沓掛 健太朗[1,2], 出浦 桃子[1], 大野 裕[1], 米永 一郎[1]	1.東北大金研, 2.JSTさきがけ
	11:15 - 11:30	12a-A18-9	実用サイズシリコンインゴットの組織制御による転位発生抑制	○高橋 勲[1], Supawan Joonwichien[1], 平松 巧也[1], 岩田 大将[1], 松島 悟[1], 宇佐美 徳隆[1]	1.名大院工
	11:30 - 11:45	12a-A18-10	シードキャスト法における結晶Siの粒界と転位発生との関	○岩田 大将[1], 高橋 勲[1], Joonwichien Supawan[1], 宇佐美 徳隆[1]	1.名大工
	11:45 - 12:00	E 12a-A18-11	Three-dimensional analysis of dislocation multiplication in single-crystal silicon under accurate control of cooling history of temperature	○Bing Gao[1], Karolin Jiptner[2], Satoshi Nakano[1], Hirofumi Harada[2], Yoshiji Miyamura[2], Takashi Sekiguchi[2], Koichi Kakimoto[1]	1.RIAM, Kyushu Univ., 2.NIMS
	12:00 - 12:15	奨 12a-A18-12	太陽電池用多結晶Si中のサーマルドナー関連欠陥に起因する深い準位のフォトルミネッセンス	○樋口 史仁[1,2], 佐藤 邦孝[1,3], 加藤 言[1,2], 田島 道夫[1,2], 小野 春彦[1,3], 小椋 厚志[1]	1.明治大, 2.JAXA 宇宙研, 3.神奈川県産技セ
	12:15 - 12:30	12a-A18-13	硫黄を過飽和ドープしたSi単結晶の中赤外光吸収スペクトルの結晶構造依存性	○中井 達也[1], 内藤 宗幸[1], 小林 勇輝[1], 長尾 克紀[1], 青木 珠緒[1], 杉村 陽[1], 梅津 郁朗[1]	1.甲南大理工
	3月12日(木)　13:45 - 19:00				
	13:45 - 14:00	12p-C2-1	サブストレート型微結晶シリコン太陽電池における透明導電酸化物膜の影響	○齋 均[1], 前島 圭剛[2], 片山 博貴[3], 鯉田 崇[1], 松井 卓矢[1], 近藤 道雄[1], 竹内 良昭[4], 吉田 功[2]	1.産総研, 2.PVTEC, 3.Panasonic, 4.三菱重工
	14:00 - 14:15	奨 12p-C2-2	セリウムをドープした酸化インジウム膜におけるセリウム価電子状態および電気特性への水素同時ドーピング効果	○小林 英治[1], 渡部 嘉[1], 山本 哲也[2]	1.長州産業, 2.高知工科大
	14:15 - 14:30	12p-C2-3	ナノ構造体・結晶シリコン融合構造におけるGeドット積層構造とフォトニックナノ構造の独立形状制御	○(M1C)青沼 理[1], 星 裕介[1], 太野垣 健[2], 宇佐美 徳隆[1]	1.名大院工, 2.京大化研
	14:30 - 14:45	12p-C2-4	フォトニック結晶を有する極薄μc-Si太陽電池の光吸収の解析 −Ag電極プラズモン吸収の検討−	○田中 良典[1], 石崎 賢司[1], De Zoysa Menaka[1,2], 川本 洋輔[1], 梅田 尚実[1], 藤田 奨也[1], 元平 暉人[1], 野田 進[1]	1.京大院工, 2.京大白眉
	14:45 - 15:00	12p-C2-5	フォトニック結晶による極薄μc-Si太陽電池の変換効率向上 −Ag電極プラズモン吸収の抑制−	○石崎 賢司[1], De Zoysa Menaka[1,2], 田中 良典[1], 梅田 尚実[1], 川本 洋輔[1], 藤田 奨也[1], 野田 進[1]	1.京大院工, 2.京大白眉
	15:00 - 15:15	奨 12p-C2-6	ピラミッド構造への化学的転写法による極低反射Si表面と光閉じ込め	○今村 健太郎[1,2], 入鹿 大地[1,2], 野中 啓章[1,2], 小林 光[1,2]	1.阪大産研, 2.CREST-JST
	15:15 - 15:30		休憩/Break		
招待	15:30 - 15:45	12p-C2-7	**「講演奨励賞受賞記念講演」(15分)** **走査型非線形誘電率顕微鏡によるアモルファスシリコン太陽電池のpin接合の可視化**	**○廣瀬 光太郎[1], 茅根 慎通[1], 長 康雄[1]**	**1.東北大通研**
	15:45 - 16:00	奨 12p-C2-8	プラズマCVDプロセスにおける$a\text{-}Si_{1-x}C_x$:HのChemical-Orderの発現に関する量子分子動力学計算	○(D)桑原 卓哉[1], 伊藤 寿[1], 樋口 祐次[1], 尾澤 伸樹[1], 久保 百司[1]	1.東北大院工
	16:00 - 16:15	12p-C2-9	薄膜シリコン太陽電池における欠陥密度決定プロセス(I)　- ドープ膜における欠陥密度 -	○傍島 靖[1,2], 松田 彰久[1,2], 岡本 博明[1,2]	1.阪大院基礎工, 2.JST-CREST
	16:15 - 16:30	12p-C2-10	薄膜シリコン太陽電池における欠陥密度決定プロセス(II)　-pin型、nip型 太陽電池における発電特性の差異 -	○傍島 靖[1,2], 松田 彰久[1,2], 岡本 博明[1,2]	1.阪大院基礎工, 2.JST-CREST
	16:30 - 16:45	12p-C2-11	薄膜シリコン太陽電池における欠陥密度決定プロセス(III) -nip 太陽電池における発電特性の改善 -	○傍島 靖[1,2], 松田 彰久[1,2], 岡本 博明[1,2]	1.阪大院基礎工, 2.JST-CREST
	16:45 - 17:00	12p-C2-12	Conductive-AFMによる多結晶SiGe薄膜の欠陥分布の評価	○澤 祐基[1], 磯村 雅夫[1]	1.東海大院工
	17:00 - 17:15		休憩/Break		
	17:15 - 17:30	12p-C2-13	a-Si:H太陽電池における光劣化の製膜速度依存性	○松井 卓矢[1], Bidiville Adrien[1], 前島 圭剛[2], 齋 均[1], 鯉田 崇[1], 末崎 崇[2,3], 松本 光弘[2,4], 斉藤 公彦[2,5], 吉田 功[2], 近藤 道雄[1]	1.産総研, 2.PVTEC, 3.カネカ, 4.パナソニック, 5.福島大
	17:30 - 17:45	12p-C2-14	太陽光励起レーザーと組み合わせるためのシリコン光電変換素子(II)	○竹田 康彦[1], 伊藤 忠[1]	1.豊田中研
	17:45 - 18:00	12p-C2-15	FLAによるテクスチャ化ガラス上へのpoly-Si薄膜形成	○(M2)渡邊 大貴[1], 大平 圭介[1]	1.北陸先端大
	18:00 - 18:15	E 12p-C2-16	Optical modelling and simulation of Cone Shaped Si-NWs p-i-n structure for Solar Cell Application	○(P)M Khan[1], Y Ishikawa[1,3], I Kita[3], Y Kurokawa[1,2], Y Ichikawa[1], M Konagai[1,2]	1.Japan Science and Technology Agency, 2.Department of Physical Electronics, Tokyo Institute of Technology, 3.Nara Institute of Science and Technology
	18:15 - 18:30	E 12p-C2-17	Effects of surface modification on the photovoltaic performance of nanocrystalline silicon membrane cells - II	○(P)Romain Mentek[1], Daihei Hippo[1], Nobuyoshi Koshida[1]	1.Tokyo Univ. of Agri. and Tech.

	18:30 - 18:45	12p-C2-18	Siナノウォールセルの特性	○平井 政和[1], 吉葉 修平[1], 市川 幸美[1], 小長井 誠[1,2]	1.科学技術振興機構, 2.東工大院理工
	18:45 - 19:00	12p-C2-19	エネルギー障壁を制御したショットキー型Siナノワイヤ太陽電池の発電特性	○伊藤 勇磨[1], 角嶋 邦之[1], 筒井 一生[1], 若林 整[1], 片岡 好則[1], 西山 彰[1], 杉井 信之[1], 名取 研二[2], 岩井 洋[2]	1.東工大総理工, 2.東工大フロンティア研
	3月13日(金) 9:00 - 11:00				
	9:00 - 9:15	13a-C2-1	結晶Si 太陽電池モジュールにおけるインターコネクターのふるい分け試験の検討	○鈴木 聡[1,2], 棚橋 紀悟[2], 土井 卓也[3], 増田 淳[3]	1.PVTEC, 2.エスペック, 3.産総研
	9:15 - 9:30	13a-C2-2	レーザーテラヘルツエミッション顕微鏡とEL/LBIC法による多結晶Si太陽電池イメージの比較評価(II)	中西 英俊[1], ○伊藤 明[1], 川山 巌[2], 村上 博成[2], 斗内 政吉[2]	1.SCREEN, 2.阪大レーザー研
	9:30 - 9:45	13a-C2-3	レーザーテラヘルツエミッション顕微鏡による太陽電池検査実証機開発	○中西 英俊[1], 水端 稔[1], 伊藤 明[1], 川山 巌[2], 村上 博成[2], 斗内 政吉[2]	1.SCREEN, 2.阪大レーザー研
	9:45 - 10:00	13a-C2-4	結晶シリコン太陽電池モジュールにおける PID 現象と Na の拡散の関係	○城内 紗千子[1], 原 浩二郎[1], 増田 淳[1]	1.産総研
	10:00 - 10:15	13a-C2-5	結晶シリコン太陽電池における事前逆電圧印加によるPIDの抑制効果	○原 由希子[1], 増田 淳[1]	1.産総研
	10:15 - 10:30	奨 13a-C2-6	複合加速試験における太陽電池モジュールへのUV曝露の影響	○Ngo Thi Hong Trang[1], 辺田 祐志[1], 土井 卓也[2], 増田 淳[2]	1.太陽光発電技術研究組合, 2.産総研
	10:30 - 10:45	13a-C2-7	高精度屋外太陽電池評価技術	○深堀 明博[1], 武内 貴和[1], 松田 洋治[1], 菱川 善博[1]	1.産総研 太陽光発電工学研究センター
	10:45 - 11:00	奨 13a-C2-8	ナノ構造pHセンサーによる太陽電池モジュール内の微量酢酸検出	○(D)浅香 孝[1], 板山 知広[1], 長崎 秀昭[1], 岩見 健太郎[1], 山本 千津子[2], 原 由希子[2], 増田 淳[2], 梅田 倫弘[1]	1.東京農工大, 2.産総研

17 ナノカーボン / Nanocarbon Technology

17 ナノカーボン / Nanocarbon Technology　　ポスター講演

3月11日(水) 9:30 - 11:30

		11a-P6-1	IJP法で形成したCoMo触媒を用いた垂直CNTの低圧CVD成長	○林 潤一[1], 中村 基訓[1], 篁 耕司[1]	1.旭川高専
		11a-P6-2	薄膜触媒のパターニングによる高純度なカーボンナノコイルの合成	○郷原 丈弘[1], 竹井 邦晴[1], 有江 隆之[1], 秋田 成司[1]	1.大阪府大工
		11a-P6-3	無電解めっきNiB 触媒を用いた熱CVD によるナノカーボンの形成	○青笹 明彦[1], 富田 貢丞[1], 松本 勇士[1], 西出 大亮[2], 佐久間 尚志[2], 梶田 明広[2], 酒井 忠司[2], 上野 和良[1,3]	1.芝浦工大, 2.超低電圧デバイス技術研究組合, 3.SITグリーンイノベーション研究センター
		11a-P6-4	アルコールCVD法を用いた絶縁体基板上へのナノカーボンの生成	○辻本 茉里奈[1], 森迫 詩陽[1], 橘 勝[1]	1.横浜市大
		11a-P6-5	塗布を用いた絶縁基板上への直接成長グラファイト薄膜 II	○加藤 幹大[1], 西村 未来[1], 趙 新為[1]	1.東理大理
		11a-P6-6	Ir(111)/α-Al_2O_3(0001)基板を用いたグラフェンのLP-CVD成長	○(M1)齋藤 祐太[1], 島田 諒人[1], 児玉 英之[1], 澤邊 厚仁[1], 黄 晋二[1]	1.青山学院大理工
		奨 11a-P6-7	水分導入による銅触媒の結晶方位とグラフェン成長への影響	○井上 雅文[1], 安野 裕貴[1], 竹内 雅人[1], 竹井 邦晴[1], 松岡 雅也[1], 秋田 成司[1], 有江 隆之[1]	1.阪府大工
		11a-P6-8	Cu キャップ層を持つCo 触媒からの固相析出による多層グラフェン形成	○佐野 翔太[1], 北村 啓太[1], 松本 勇士[1], 酒井 忠司[2], 上野 和良[1,3]	1.芝浦工大, 2.超低電圧デバイス技術研究組合, 3.SIT グリーンイノベーション研究センター
		11a-P6-9	二軸方向電界印加状態での酸化グラフェン還元によるグラフェン作製	○(B)煙山 史人[1], 山内 繁[2], 小宮山 崇夫[1], 長南 安紀[1], 山口 博之[1], 青山 隆[1]	1.秋田県大システム科学技術, 2.秋田県大木材高度加工研究所
		11a-P6-10	赤外照射プラズマCVD法によるグラフェン膜作成法の検討	○森 成樹[1], 山内 繁[2], 小宮山 崇夫[1], 長南 安紀[1], 山口 博之[1], 青山 隆[1]	1.秋田県大システム, 2.秋田県大木高研
		11a-P6-11	有機物を用いた新しいグラフェンの作製方法 その2	○西村 未来[1], 加藤 幹大[1], 趙 新為[1]	1.東理大理
		11a-P6-12	2段階アニール析出法による高品質多層グラフェンの合成	○上田 悠貴[1], 鈴木 学[1], 山田 純平[1], 成塚 重弥[1], 丸山 隆浩[1]	1.名城大理工
		奨 11a-P6-13	酸化ニッケルを触媒とした絶縁基板上へのグラフェン直接合成	○大林 克未[1], 竹井 邦晴[1], 秋田 成司[1], 有江 隆之[1]	1.大阪府大工
		11a-P6-14	固相反応を用いた絶縁基板上へのグラフェン直接合成(III)	○杉浦 孝俊[1], 若松 裕司[1], Golap Kalita[1], 種村 眞幸[1]	1.名工大院工
		11a-P6-15	Al_2O_3 バリア層、Auキャップ層を用いた析出法における 高品質多層グラフェン生成に与えるアニール時間の効果	○山田 純平[1], 鈴木 学[1], 上田 悠貴[1], 丸山 隆浩[1], 成塚 重弥[1]	1.名城大理工
		11a-P6-16	金属融解によるCVDグラフェンの絶縁性基板上への直接転写	○井上 凌介[1], 真庭 豊[1], 宮田 耕充[1,2]	1.首都大理工, 2.JSTさきがけ
		11a-P6-17	Ni凝集を利用した転写フリープロセスによるグラフェントランジスタ作製	○水野 正也[1], 久保 俊晴[1], 三好 実人[1], 江川 孝志[1], 曽我 哲夫[1]	1.名古屋工業大学
		11a-P6-18	グラフェン一金属カルコゲナイドの面内ヘテロ原子薄膜	○白土 喜博[1], 遠藤 寛子[2], 辻 正治[1,2], 吾郷 浩樹[1,2,3]	1.九大院総理工, 2.九大先導研, 3.JSTさきがけ
		11a-P6-19	WS_2/MoS_2ヘテロ構造の2段階成長と評価	○森 勝平[1], 真庭 豊[1], 宮田 耕充[1,2]	1.首都大理工, 2.JSTさきがけ
		11a-P6-20	MoS_2合成における基板結晶性の影響	○林 賢二郎[1], 岩井 大介[1], 佐藤 信太郎[1]	1.富士通研
		奨 11a-P6-21	単層h-BN膜のCVD成長とMoS_2とのヘテロ積層膜の創製	○祝迫 佑[1], 内田 勇気[1], 辻 正治[1,2], 吾郷 浩樹[1,2,3]	1.九大院総理工, 2.九大先導研, 3.JSTさきがけ
		奨 11a-P6-22	CVDにより成膜した単層MoS_2の結晶性評価	○倉林 空[1], 長汐 晃輔[1,2]	1.東大工, 2.JST-さきがけ
		11a-P6-23	MoS_2原子層膜の共鳴ラマン評価	南野 達哉[1], 村上 俊也[2], ○木曽田 賢治[1], 伊東 千尋[2]	1.和歌山大教育, 2.和歌山大シス工
		11a-P6-24	前駆体溶液塗布膜からのMoS_2薄膜作製及びH_2アニールによる特性変化	○黒崎 祐太郎[1], 上野 啓司[1]	1.埼玉大院理工
		11a-P6-25	エピタキシャル成長した$MoSe_2$超薄膜のラマン分光	○小野満 恒二[1], Krajewska Aleksandra[1], Neufeld Ryan[1], 前田 文彦[1], 熊倉 一英[1], 山本 秀樹[1]	1.NTT物性研
		11a-P6-26	リチウムをインターカレートしたMoS_2の作製と吸湿過程	○(PC)三枝 栄子[1], 阿澄 玲子[2], 島田 悟[2], 田中 深幸[3], 清水 哲夫[3], 安藤 淳[1]	1.産総研ナノエレクトロニクス研究部門, 2.産総研電子光技術研究部門, 3.産総研ナノシステム研究部門
		11a-P6-27	機械的剥離法を用いたHfS_2原子薄膜の作製と基礎物性の評価	○石川 篤[1,2], 金澤 徹[3], 雨宮 智宏[2,3], 鶴田 健二[1], 田中 拓男[2,4], 宮本 恭幸[3]	1.岡山大院自然, 2.理研, 3.東工大院理工, 4.北大電子研

		11a-P6-28	単層カーボンナノチューブにおけるX線照射欠陥のAFMラマン評価	○村上 俊也[1], 木曽田 賢治[2], 伊東 千尋[1]	1.和大シス工, 2.和大教育
		11a-P6-29	ナノカーボン材料の電子ビーム加工の分子シミュレーション(IX)	○木田 昌吾[1], 山本 真也[1], 安田 雅昭[1], 多田 和広[2], 川田 博昭[1], 平井 義彦[1]	1.大阪府大工, 2.富山高専
		11a-P6-30	パターン形成可能なイオンゲルの作製	○関根 佳明[1], 古川 一暁[1], 鈴木 哲[1], 日比野 浩樹[1]	1.NTT物性基礎研
		11a-P6-31	ゲート制御型グラフェン光酸化に対するグラフェン形状とジュール熱の効果	○松本 守広[1], 野内 亮[1]	1.大阪府大N2RC
		奨 11a-P6-32	酸化グラフェンの VUV 光マイクロ還元とその電気特性評価	○(M2)屠 宇迪[1], 宇都宮 徹[1], 一井 崇[1], 杉村 博之[1]	1.京大院工
		11a-P6-33	真空紫外光照射により還元された酸化グラフェンのSTM観察	○(M1)中元 宏[1], 屠 宇迪[1], 楽満 啓亮[2], Om P. Khatri[3], 一井 崇[1], 宇都宮 徹[1], 杉村 博之[1]	1.京大院工, 2.京大工, 3.IIP
		奨 11a-P6-34	熱電変換を志向したカーボンナノチューブのn型分子ドーピング	○野々口 斐之[1], 中野 元博[1], 河合 壯[1]	1.奈良先端大物質
		11a-P6-35	電気二重層キャリア注入により極性制御された半導体型単層カーボンナノチューブ熱電デバイスの作製	○北村 典雅[1], 大島 侑己[1], 神田 翔平[1], 河合 英輝[1], 柳 和宏[1]	1.首都大理工
		奨 11a-P6-36	単一構造単層カーボンナノチューブ光学異性体の高純度的分離及び光学特性	○魏 小均[1], 都築 真由美[1], 平川 琢也[1], 蓬田 陽平[1], 平野 篤[1], 藤井 俊治郎[1], 田中 丈士[1], 片浦 弘道[1]	1.産総研ナノシス
		11a-P6-37	カーボンナノチューブ-アゾベンゼン複合系の作製と光学応答	○笠松 大輝[1], 小山 剛史[1], 岸田 英夫[1]	1.名大院工
		奨 11a-P6-38	Raman分光法によるカーボンナノチューブフォレストの深さごとの構造評価	○(M1)石本 光輝[1], 小路 紘史[1], 関家 一樹[1], 古田 寛[1,2], 八田 章光[1,2]	1.高知工科大院, 2.高知工科大総研ナノテク
		11a-P6-39	グラフェンのフェムト秒キャリアダイナミクスに及ぼす基板効果	○玉井 尚登[1], 山田 淳史[1], 重政 英史[1], 久津間 保徳[1], 金子 忠昭[1]	1.関学大理工
		11a-P6-40	SiC(000-1)C面上の島状グラフェンのラマンスペクトル解析	○田中 嘉人[1], 上村 奨平[1], Sanpon Vantasin[1], 久津間 保徳[1], 金子 忠昭[1], 尾崎 幸洋[1]	1.関西学院大理工
		11a-P6-41	接触抵抗改善によるグラフェンFETの高性能化	○(BC)小岩 匡[1], 岡 謙吾[1], 末光 哲也[2], 尾辻 泰一[2], 内野 俊[1]	1.東北工大, 2.東北大通研
		11a-P6-42	酸化グラフェン/シリコーン樹脂複合体の調製と物性評価	○(M1C)高橋 英史[1], 堂浦 剛[2], 林 靖彦[1], 仁科 勇太[1,3]	1.岡山大学, 2.星和電機, 3.JSTさきがけ
		11a-P6-43	MoS_2/Grapheneヘテロ構造の作製と特性評価	○佐藤 雄太[1], 大井 皓平[1], 何 柏寛[1], 田畑 博史[1], 久保 理[1], 片山 光浩[1]	1.阪大院工
		11a-P6-44	金属ナノインクによるカーボンナノチューブ紡績糸の高導電率化	○上杉 祐生[1], 大饗 俊弘[1], 楠 拓真[1], 運天 政貴[1], 吉田 弥伸[1], 西川 亘[1], 山下 善文[1], 飯島 徹[1], 林 靖彦[1]	1.岡山大院自然
		11a-P6-45	カーボンナノチューブ複合糸を用いた糸トランジスタの構造検討	○(M1)吉田 将俊[1], 大矢 剛嗣[1]	1.横国大院工
		11a-P6-46	電気物性が分離されたカーボンナノチューブを用いる酵素センサの動作機構の解明	野脇 航平[1], 星野 達也[2], ○六車 仁志[1]	1.芝浦工大院理工, 2.㈱ガステック
		11a-P6-47	カーボンナノチューブ透明導電膜のヘイズ率測定	○小野田 侑太[1], 岸 直希[1], 斎藤 毅[2], 曽我 哲夫[1]	1.名工大, 2.産総研
		11a-P6-48	カーボンナノチューブ自立膜を用いた軽量熱機関の創製	○生野 孝[1], 深野 達雄[1], 樋口 和夫[1]	1.豊田中央研究所
		11a-P6-49	グラフェンによる擬似的八木・宇田アンテナ(1)	○鈴木 哲[1], 日比野 浩樹[1]	1.NTT物性基礎研
		11a-P6-50	グラフェン黒体放射発光素子を用いた光通信	○天坂 裕也[1], 横井 智哉[1], 牧 英之[1]	1.慶大理工
		11a-P6-51	グラフェン高速広波長域光検出器開発と波長依存性	○石田 一樹[1], 牧 英之[1]	1.慶應義塾大学理工学部物理情報工学科
		11a-P6-52	ヘリウムイオンビームを用いたサスペンデッドグラフェンの微細加工	○(M1)武市 旺大[1], 兼竹 望[1], ムルガナタン マノハラン[1], 八坂 行人[1,2], シュミット マレク[1], 水田 博[1,3]	1.北陸先端大, 2.日立ハイテクサイエンス, 3.サザンプトン大
		奨 11a-P6-53	水素インターカレーションによるグラフェンナノリボンFETへのSiO_2基板の影響の除去	○(D)岩崎 拓哉[1], スン ジアン[1], 兼竹 望[1], 筑葉 拓生[1], 赤堀 誠志[1], ムルガナタン マノハラン[1], 水田 博[1,2]	1.北陸先端大, 2.サザンプトン大
		奨・E 11a-P6-54	Tuning the electronic properties of graphene nanoribbons by chemical functionalization	○(PC)Pablo Solis-Fernandez[1], Masaharu Tsuji[1], Hiroki Ago[1,2]	1.IMCE, Kyushu Univ., 2.PRESTO - JST
		11a-P6-55	有機強誘電体ゲートMoS_2-FET構造の作製	広瀬 宗一郎[1], 小林 択平[1], 中嶋 宇史[2], 新家 義裕[3], ○川江 健[3], 森本 章治[3]	1.金沢大院自然, 2.東京理科大, 3.金沢大理工
		11a-P6-56	ナノシート$Ca_2Nb_3O_{10}$をゲート絶縁膜としたMoS_2-FET構造の作製	○小林 拓平[1], 広瀬 宗一郎[1], 内田 寛[2], 新家 義裕[1], 川江 健[1], 森本 章治[1]	1.金沢大, 2.上智大

17.1 成長技術 / Growth technology　口頭講演

3月12日(木)　10:15 - 11:45

	10:15 - 10:30	12a-D6-5	真空一貫プロセスによるCNT成長用Coナノ粒子形成法の研究	○桑田 大輔[1], 竹山 隆之介[1], 中野 博貴[1], 知念 優弥[1], 星野 靖[1], 斎藤 保直[1], 中田 穣治[1]	1.神奈川大理
	10:30 - 10:45	12a-D6-6	ナノダイヤモンドからのカーボンナノチューブ成長における成長核粒子径とCNT径の相関解析	○林 明生[1], 椎名 諒[1], 有福 達治[2], 清柳 典子[2], 小林 慶裕[1]	1.大阪大工, 2.日本化薬
	10:45 - 11:00	奨 12a-D6-7	無触媒CVD成長したカーボンナノチューブの評価	○(B)平野 優[1], 稲葉 優文[1], 渋谷 恵[1], 鈴木 和真[1], 李 智宇[1], 明道 三穂[1], 平岩 篤[1], 乗松 航[2], 楠 美智子[2], 川原田 洋[1]	1.早大理工, 2.名大エコトピア研
	11:00 - 11:15	12a-D6-8	アルコールガスソース法によるRh触媒からの単層カーボンナノチューブ成長	○(M1)小澤 顕成[1], 才田 隆広[1], 成塚 重弥[1], 丸山 隆浩[1]	1.名城大理工
	11:15 - 11:30	12a-D6-9	コバルトと鉄の積層膜を触媒とした熱フィラメントCVD法による単層カーボンナノチューブの低温成長の試み	鈴木 智貴[1], 金 時蒼[1], 川井田 雄介[1], 花山 友基[1], 丸山 一樹[1], 三木 敦史[1], ○石川 豊[1]	1.日本工大工
	11:30 - 11:45	12a-D6-10	多層カーボンナノチューブと多層カーボンナノコイルの合成のための触媒担持材の検討	○飯田 哲生[1], 須田 善行[1], 滝川 浩史[1], 植仁志[2], 清水 一樹[3], 梅田 良人[4]	1.豊橋技術科学大学, 2.東海カーボン, 3.湘南合成樹脂製作所, 4.東邦ガス

	3月12日(木)　13:15 - 19:00				
招待	13:15 - 13:30	12p-D7-1	**「講演奨励賞受賞記念講演」(15分) CVD成長MoS2薄膜を用いたグラフェン/MoS2/Si太陽電池の光電変換特性**	**○壷井 佑夏[1], 王 飛久[1], 小澤 大知[1], 宮内 雄平[1], 毛利 真一郎[1], 松田 一成[1]**	**1.京大エネ研**
	13:30 - 13:45	12p-D7-2	SiC高指数面ファセット上に現れるグラフェン擬1次元構造	○林 真吾[1], 森田 康平[1], 梶原 隆司[1], ビシコフスキー アントン[1], 飯盛 拓嗣[2], 小森 文夫[2], 田中 宏和[3], 神田 昌申[3], 田中 悟[1]	1.九大院工, 2.東大物性研, 3.筑波大数理物質
	13:45 - 14:00	12p-D7-3	SiC上グラフェン成長とステップバンチングの関係	○(M2)安井 理[1], 乗松 航[1], 楠 美智子[1]	1.名古屋大工
	14:00 - 14:15	12p-D7-4	Buffer-layer-free graphene on SiC(0001) by quenching menthod	○(P)Jianfeng Bao[1], Hiroshi Iwata[2], Wataru Norimatsu[2], Michiko Kusunoki[1]	1.EcoTopia Science Institute. Nagoya University, 2.Department of Applied Chemistry. Graduate School of Engineering. Nagoya University
	14:15 - 14:30	奨 12p-D7-5	Si基板上エピタキシャルグラフェンのNi援用低温形成とリアルタイム／角度分解光電子分光によるグラフェン化機構評価	○長谷川 美佳[1], 須藤 亮太[1], 菅原 健太[1], 三本菅 正太[1], 原本 直樹[1], 寺岡 有殿[2], 吉越 章隆[2], 吹留 博一[1], 末光 眞希[1,3]	1.東北大通研, 2.原子力機構, 3.JST-CREST
	14:30 - 14:45	奨 12p-D7-6	レーザー誘起成長により形成されたSiC(0001)上グラフェンの成長過程観察	○(M1)服部 正和[1], 池上 浩[1], 中村 大輔[1], 岡田 龍雄[1], 古川 一暁[2], 高村 真琴[2], 日比野 浩樹[2]	1.九大, 2.NTT物性基礎研
	14:45 - 15:00	12p-D7-7	コンダクティブAFMによるSiC上に形成されたグラフェンの空間分布評価	○稲本 拓朗[1], 佐藤 まり子[1], 藤井 健志[1]	1.富士電機
	15:00 - 15:15	12p-D7-8	SiC単結晶薄膜ハイブリッドデバイス基板による高品質グラフェン成長	○吹留 博一[1], 秋山 昌次[2], 田島 圭一郎[1], 舩窪 一智[1], 末光 眞希[1], 小西 繁[2], 茂木 弘[2], 川合 信[2], 久保田 芳宏[2], 堀場 弘司[3], 組頭 広志[3]	1.東北大通研, 2.信越化学工業, 3.高エネ研
	15:15 - 15:30	奨 12p-D7-9	CVD法を用いた液体ガリウム触媒界面におけるグラフェン合成	○(M1)檜山 卓希[1,2], 村上 勝久[1,2], 藤田 淳一[1,2]	1.筑波大数理, 2.TIMS
	15:30 - 15:45	12p-D7-10	ガリウム蒸気触媒CVDによる絶縁基板上への大面積グラフェン合成	○村上 勝久[1,2], 田中 駿丞[1], 蛭川 彩夏[1], 檜山 卓希[1,2], 狩野 絵美[1,3], 竹口 雅樹[3], 藤田 淳一[1,2]	1.筑波大数理, 2.TIMS, 3.NIMS
	15:45 - 16:00	奨 12p-D7-11	銅ナノ粒子表面におけるグラファイト化反応過程のその場観察	○伊藤 直人[1], 村上 勝久[1], 狩野 絵美[1,2], 竹口 雅樹[2], 藤田 淳一[1]	1.筑波大数理, 2.物質・材料研究機構
	16:00 - 16:15		休憩/Break		
	16:15 - 16:30	12p-D7-12	原料分子形状が窒素ドープグラフェン構造に与える影響	○加藤 時穂[1], 今村 岳[1], 小幡 誠司[1], 斉木 幸一朗[1]	1.東大院新領域
	16:30 - 16:45	12p-D7-13	グラフェンCVD成長における酸素分圧の影響	○(DC)寺澤 知潮[1], 斉木 幸一朗[1,2]	1.東大院理, 2.東大院新領域
	16:45 - 17:00	E 12p-D7-14	Visualizing Copper Assisted Transformation of Amorphous Carbon into Graphene by Current-Induced Annealing.	○(D)Mohamad Saufi Rosmi[1,2], Mohd Zamri Mohd Yusop[1,3], Golap Kalita[1], Yazid Yaakob[1,4], Chisato Takahashi[1], Masaki Tanemura[1]	1.Nagoya Inst. of Tech., 2.Univ. Pend. Sultan Idris, 3.Univ. Tech. Malaysia, 4.Univ. Putra Malaysia
	17:00 - 17:15	E 12p-D7-15	A novel nanometer-level amorphous carbon coating method by direct pyrolysis of coronene without solvent and its application to the $LiFePO_4$ cathode for Li-ion battery	○(P)ShuJun Ye[1], Akira Hasegawa[1], Hiroaki Kumakura[1], Eiki Yasakawa[1], Akihiro Nomura[1], Yoshimi kubo[1]	1.NIMS
	17:15 - 17:30	奨 12p-D7-16	ボトムアップ・グラフェンナノリボンのエッチングフリー転写	○(PC)大伴 真名歩[1], 関根 佳明[1], 日比野 浩樹[1]	1.NTT物性基礎研
	17:30 - 17:45	奨・E 12p-D7-17	Chemical vapor deposition growth of graphene with millimeter-scale grain size	○SHENGNAN WANG[1], SATORU SUZUKI[1], MAKOTO TAKAMURA[1], HIROKI HIBINO[1]	1.NTT Basic Research Laboratories
	17:45 - 18:00	12p-D7-18	酸化グラフェンのプラズマ還元による絶縁基板上へのグラフェン直接成長	○佐藤 稔[1], 赤田 圭史[1], 寺澤 知潮[2], 小幡 誠司[1], 斉木 幸一朗[1,2]	1.東大新領域, 2.東大院理
	18:00 - 18:15	12p-D7-19	太陽炉を用いた超高温・反応性雰囲気での酸化グラフェン処理による高結晶性グラフェン形成	○石田 俊[1], 宮田 雄一郎[1], 篠田 佳彦[2], 小林 慶裕[1]	1.阪大院工, 2.若狭湾エネ研
	18:15 - 18:30	12p-D7-20	マイクロ波表面波プラズマCVDによる多数層グラフェン合成と紫外光カットによる高品質化	○市村 進[1,2], 内田 秀雄[1], 脇田 紘一[1], 林 靖彦[2], 梅野 正義[1]	1.中部大, 2.岡山大院
	18:30 - 18:45	奨 12p-D7-21	プラステックフレキシブル基板上でのグラフェン直接合成	○石橋 祐輔[1], 金井 康[1], 大野 恭秀[1,2], 前橋 兼三[1,3], 井上 恒一[1], 松本 和彦[1]	1.阪大産研, 2.徳島大, 3.東京農工大
	18:45 - 19:00	奨 12p-D7-22	量産に向けたプラズマCVDグラフェンの成長初期過程観察	○加藤 隆一[1], 南 聡史[1], 沖川 侑揮[1,2], 石原 正統[1,2], 山田 貴壽[1,2], 長谷川 雅考[1,2]	1.TASC, 2.産総研ナノチューブ応用RC
	3月14日(土)　14:30 - 15:15				
	14:30 - 14:45	14p-D7-7	BaF_2基板上のアルコールCVD グラファイティックカーボン成長	○(M1)曇 艶[1], 中村 篤志[1], 久保野 敦史[1]	1.静大院工
	14:45 - 15:00	奨 14p-D7-8	WドープNbS_2原子層の成長と評価	○佐々木 将悟[1], 真庭 豊[1], 宮田 耕充[1,2]	1.首都大理工, 2.JST さきがけ
	15:00 - 15:15	14p-D7-9	ミストアニールによる二硫化モリブデン(MoS_2)層状膜作製への挑戦	○(B)佐藤 翔太[1], 川原村 敏幸[1,2], 古田 守[2,3]	1.高知工大シス工, 2.総研, 3.環境理工

17.2 構造制御・プロセス / Structure control and process　口頭講演

	3月12日(木)　9:00 - 11:45				
	9:00 - 9:15	12a-D7-1	Cu基板表面の酸化に伴うCVD合成されたグラフェン結晶の構造変化	○Golap Kalita[1], Sharma Subash[1], Papon Remi[1], 種村 眞幸[1]	1.名工大
	9:15 - 9:30	奨 12a-D7-2	グラフェンの亀裂におけるジグザグ端の選択的な形成	○(D)藤原 美帆[1], 井上 凌介[2], 真庭 豊[2], 篠原 久典[1], 宮田 耕充[2,3]	1.名大院理, 2.首都大理工, 3.JSTさきがけ
	9:30 - 9:45	12a-D7-3	Free-standingグラフェン膜のラマン分光とTEMによる層数評価	○山崎 憲慈[1], 前原 洋祐[1], 中川 佐知子[1], 田中 由紀子[1], 河田 周二郎[1], 木村 浩一朗[1], 内田 努[1], 郷原 一寿[1]	1.北大工
	9:45 - 10:00	12a-D7-4	バイオセンサー応用に向けたグラフェン上ピレン吸着密度制御の検討	○松井 祐司[1], 根岸 良太[1], 小林 慶裕[1]	1.阪大院工
	10:00 - 10:15	12a-D7-5	窒素中性粒子ビームによる窒素ドープグラフェンの構造制御	○岡田 健[1], 寒川 誠二[1,2]	1.東北大流体研, 2.東北大WPI-AIMR
	10:15 - 10:30	12a-D7-6	ヘリウムイオンビームによるグラフェンへのナノ構造直描	○内藤 裕一[1], 飯島 智彦[1], 小川 真一[1]	1.産総研ナノエレクトニクス研究部門
	10:30 - 10:45	E 12a-D7-7	Observing graphene and graphite by nitrogen ion beam microscopy	○(P)Marek Schmidt[1], Anto Yasaka[2,1], Hiroshi Mizuta[1,3]	1.JAIST, 2.Hitachi High-Tech Science, 3.Univ. of Southampton
	10:45 - 11:00	12a-D7-8	HSQ塗布によるSiC上グラフェンのキャリア濃度変化	○(M2)小田 達也[1], 小林 慶祐[1], 有月 琢哉[1], 青木 翔[1], 永濱 拓也[1], 永瀬 雅夫[1]	1.徳島大学

	11:00 - 11:15	12a-D7-9	グラフェン／SiC界面のSiインターカレーションにおける界面構造と電子状態	○(M2)木本 真一[1], 飯盛 拓嗣[2], Anton Visikovskiy[1], 梶原 隆司[1], 小森 文夫[2], 田中 悟[1]	1.九大院工, 2.東大物性研
	11:15 - 11:30	12a-D7-10	UV/O_3処理による酸化グラフェンシートのエッチング	○清水 亮宏[1], 小幡 誠司[2], 斉木 幸一朗[1,2]	1.東大院理, 2.東大院新領域
	11:30 - 11:45	12a-D7-11	加熱金属メッシュで生成した原子状水素による酸化グラフェンの還元	○部家 彰[1], 松尾 直人[1]	1.兵庫県立大工
	3月12日(木)　9:15 - 10:15				
招待	9:15 - 9:30	12a-D6-1	**「講演奨励賞受賞記念講演」(15分) 混合界面活性剤を用いたカーボンナノチューブの単一構造分離**	**○蓬田 陽平[1], 都築 真由美[1], 魏 小均[1], 平野 篤[1], 藤井 俊治郎[1], 田中 丈士[1], 片浦 弘道[1]**	**1.産総研ナノシステム**
	9:30 - 9:45	12a-D6-2	湿式ジェットミル法を用いたカーボンナノチューブ分散液の作製および評価	○(M2)あるもわっらい あなす[1], 庄 善之[1]	1.東海大工
	9:45 - 10:00	12a-D6-3	単層カーボンナノチューブのアンジップ経時変化	○福森 稔[1], 田中 啓文[2], 田中 大輔[1], 小川 琢治[1]	1.阪大院理, 2.九工大院生命体
	10:00 - 10:15	E 12a-D6-4	Self-Assembly of Graphene- and Carbon-Nanotubes-Based Structures from Rice Husks using Microwave Plasma Irradiation	○Zhipeng Wang[1], Hironori Ogata[2], Shingo Morimoto[1], Josue Ortiz-Medina[1], Masatsugu Fujishige[1], Kenji Takeuchi[1], Hiroyuki Muramatsu[1], Takuya Hayashi[1], Mauricio Terrones[3], Yoshio Hashimoto[1], Morinobu Endo[1]	1.Shinshu Univ, 2.Hosei Univ, 3.The Pennsylvania State Univ
	3月13日(金)　18:30 - 19:00				
	18:30 - 18:45	13p-D8-10	電流計測AFMによる水素終端化シリコン基板上に固定した酸化グラフェンの局所電気特性評価	○(M1)國府 翔[1], 屠 宇迪[1], 一井 崇[1], 宇都宮 徹[1], 杉村 博之[1]	1.京大院工
	18:45 - 19:00	13p-D8-11	金(111)表面上スマネン分子のSTM計測	○藤井 慎太郎[1], Ziatdinov Maxim[1], 木口 学[1], 東林 修平[2], 櫻井 英博[3]	1.東工大院理, 2.分子研, 3.阪大院工

17.3 新機能探索・基礎物性評価 / Exploration of new functions and evaluation of basic properties　口頭講演

	3月11日(水)　16:45 - 18:00				
	16:45 - 17:00	11p-D8-1	グラフェンナノ構造における光学特性のサイズ依存性評価	○石田 周太郎[1], 田中 隆介[1], 笹木 敬司[1]	1.北大電子研
	17:00 - 17:15	11p-D8-2	テラヘルツ時間領域分光法によるグラフェン光学伝導度の基板及び温度依存性	○川野 慎也[1], 大城 誠[1], Nicole Moody[2], 川山 巌[1], Minjie Wang[2], 河野 淳一郎[2], Robert Vajtai[2], Pulickel Ajayan[2], 斗内 政吉[1]	1.阪大レーザー研, 2.ライス大学
	17:15 - 17:30	11p-D8-3	窒素ドープグラフェン上の酸素還元反応	○(M2)市川 諒英[1,2], 赤石 暁[1,2], 中村 淳[1,2]	1.電通大院先進理工, 2.JST-CREST
	17:30 - 17:45	11p-D8-4	単層酸化グラフェンに吸着したセシウムイオンの電子状態	○圓谷 志郎[1], 本田 充紀[2], 下山 巌[2], 岡本 芳浩[2], 檜本 洋[1], 矢板 毅[2], 境 誠司[1]	1.原子力機構先端基礎, 2.原子力機構量子ビーム
	17:45 - 18:00	11p-D8-5	フォノン制御したグラフェンのゼーベック係数	○安野 裕貴[1], 竹井 邦晴[1], 秋田 成司[1], 有江 隆之[1]	1.大阪府大院工
	3月13日(金)　9:00 - 11:45				
	9:00 - 9:15	13a-D8-1	電極接合に起因する二層グラフェンのバンドギャップ	○野内 亮[1]	1.大阪府立大
	9:15 - 9:30	13a-D8-2	グラフェン電界効果トランジスタにおける電極接続の影響の軽減	片倉 健太[1], 伊藤 優[1], 田中 宏和[1], 平出 璃音可[1], 大塚 洋一[1], 友利 ひかり[1,2], ○神田 晶申[1]	1.筑波大, 2.JSTさきがけ
	9:30 - 9:45	奨 13a-D8-3	コンダクタンス法による2層グラフェンのギャップ内準位解析	○金山 薫[1], 長汐 晃輔[1,2]	1.東大マテリアル, 2.JST-さきがけ
	9:45 - 10:00	13a-D8-4	グラフェン層成長により形成した多層グラフェンナノリボンの電気伝導特性	○北川 治樹[1], 根岸 良太[1], 田中 啓文[3], 福森 稔[2], 小川 琢治[2], 小林 慶裕[1]	1.阪大院工, 2.阪大院理, 3.九工大
	10:00 - 10:15	13a-D8-5	レジスト熱収縮を用いたグラフェンへの歪み印加	○高村 真琴[1], 日比野 浩樹[1]	1.NTT物性基礎研
	10:15 - 10:30	奨 13a-D8-6	グラフェン上ALD-Y_2O_3堆積におけるバッファー層への高圧酸素アニールによる容量向上	○高橋 伸尭[1], 長汐 晃輔[1,2]	1.東大院工, 2.JST-さきがけ
	10:30 - 10:45	13a-D8-7	SiC上成長擬似フリースタンディンググラフェンのconductive AFM測定	○高瀬 恵子[1], Tran Minh Tien[1,2], 古川 一暁[1], 高村 真琴[1], 日比野 浩樹[1]	1.NTT物性基礎研, 2.長岡技科大
	10:45 - 11:00	奨 13a-D8-8	AFMを用いたナノスケールでのグラフェンの弾性力評価	○猪狩 智彦[1,2], 村上 勝久[1,2], 藤田 淳一[1,2]	1.筑波大数理, 2.TIMS
	11:00 - 11:15	奨 13a-D8-9	加熱/冷却系を用いたh-BN上へのグラフェンのPMMA乾式転写	○ウワンノー ティーラユット[1], 谷口 尚[2], 渡邊賢司[2], 長汐 晃輔[1,3]	1.東大, 2.NIMS, 3.JST-さきがけ
	11:15 - 11:30	奨 13a-D8-10	ジグザグエッジ導入グラフェンの電気化学的物性	○田村 直貴[1], 笥居 高明[1], 本間 格[1]	1.東北大多元研
	11:30 - 11:45	奨 13a-D8-11	グラフェン電界効果トランジスタの光メモリ効果	○石田 昌平[1], 安野 裕貴[1], 有江 隆之[1], 竹井 邦晴[1], 竹内 雅人[1], 松岡 雅也[1], 秋田 成司[1]	1.大阪府大工
	3月13日(金)　9:30 - 11:45				
	9:30 - 9:45	13a-D7-1	ホウ素ドープ最密充填カーボンナノチューブ膜の電気伝導測定	○乗松 航[1], 小田 晃司[1], 藤田 隼人[1], 楠 美智子[2]	1.名大院工, 2.名大エコ研
	9:45 - 10:00	13a-D7-2	半導体SWNT分散薄膜のガスセンシングメカニズム	○田畑 博史[1], 松竹 直斗[1], 久保 理[1], 片山 光浩[1]	1.阪大工
	10:00 - 10:15	13a-D7-3	SWCNTフィルムの熱電物性：半導体型・金属型混合の効果	○林 大介[1], 中井 祐介[1], 客野 遥[1], 柳 和宏[1], 宮田 耕充[1,2], 真庭 豊[1], 山本 貴博[3]	1.首都大理工, 2.JSTさきがけ, 3.東京理科大学
	10:15 - 10:30	13a-D7-4	カーボンナノコイルの温度依存による物性評価	○高木 昭宏[1], 北川 淳嗣[1], 北村 翔[1], 飯田 民夫[1], 中村 康史[2], 須田 善行[2]	1.岐阜高専, 2.豊橋技科大
	10:30 - 10:45	13a-D7-5	単一のカーボンナノコイルを対象とした電気特性測定系の構築と電気特性に与える黒鉛化処理の影響	○中村 康史[1], 須田 善行[1], 滝川 浩史[1], 植仁志[2], 清水 一樹[3], 梅田 良人[4], 島 弘幸[5]	1.豊技大工, 2.東海カーボン, 3.湘南合成樹脂製作所, 4.東邦ガス, 5.山梨大医工
	10:45 - 11:00	13a-D7-6	(5,4)(6,4)(6,5)(8,6)カーボンナノチューブ酸化過程の第一原理計算	○大淵 真理[1]	1.富士通研
	11:00 - 11:15	13a-D7-7	乾燥下におけるセルロース分散カーボンナノチューブの光学遷移	○伊藤 雅浩[1], 川田 康平[1], 矢島 博文[1], 本間 芳和[1]	1.東理大理
	11:15 - 11:30	奨 13a-D7-8	単層カーボンナノチューブを用いた室温・通信波長帯域でのフォトンアンチバンチング測定	○遠藤 匠[1], 早瀬 潤子[1], 牧 英之[1]	1.慶大理工
	11:30 - 11:45	13a-D7-9	大気イオンに曝された単層ナノチューブの光学特性	○稲葉 工[1], 本間 芳和[1]	1.東理大理

3月13日(金)　16:15 - 18:30					
	16:15 - 16:30	13p-D8-1	単層WSe_2膜を用いた電気二重層発光ダイオード	○(M1)藤本 太陽[1], 蒲 江[1], Jing-Kai Huang[2], Lain-Jong Li[2], 坂上 知[1], 竹延 大志[1,3]	1.早大先進, 2.Academia Sinica, 3.早大材研
	16:30 - 16:45	E 13p-D8-2	Measuring Photo-oxidation Effect in WS_2 Nanosheets using Laser Terahertz Emission Spectroscopy	○Jofferson Gonzales[1], F.R. Bagsican[1], Iwao Kawayama[1], Hironaru Murakami[1], A. Winchester[2], S. Ghosh[2], S. Talapatra[2], Masayoshi Tonouchi[1]	1.Osaka Univ., 2.SIU-Carbondale
	16:45 - 17:00	13p-D8-3	単原子層遷移金属ダイカルコゲナイドヘテロ構造における発光特性	○(PC)毛利 真一郎[1], 小澤 大知[1], 宮内 雄平[1], 江田 剛輝[2], 松田 一成[1]	1.京大エネ研, 2.シンガポール国立大
	17:00 - 17:15	奨 13p-D8-4	原子層ヘテロ構造における光キャリアの電荷分離と緩和機構	○(DC)小澤 大知[1], Ivan Verzhbitskiy[2], Alexandra Carvalho[2], A. H. Castro Neto[2], 松田 一成[1], 江田 剛輝[2]	1.京都大エネ研, 2.シンガポール国立大
	17:15 - 17:30	13p-D8-5	グラフェン/$MoSe_2$ van der Waalsヘテロ構造における電流変調	○佐田 洋太[1], 守谷 頼[1], 矢吹 直人[1], 増渕 覚[1,2], 町田 友樹[1,2]	1.東大生産研, 2.東大ナノ量子機構
	17:30 - 17:45	13p-D8-6	グラフェン/MoS_2/金属ヘテロ構造の面直伝導におけるグラフェンの状態密度の効果	○守谷 頼[1], 山口 健洋[1], 井上 義久[1], 佐田 洋太[1], 森川 生[1], 増渕 覚[1,2], 町田 友樹[1,2]	1.東大生産研, 2.東大ナノ量子機構
	17:45 - 18:00	13p-D8-7	層状カルコゲナイドWS_2トンネルバリアの特性	○守谷 頼[1], 山口 健洋[1], 井上 義久[1], 森川 生[1], 増渕 覚[1,2], 渡邊 賢司[3], 谷口 尚[3], 町田 友樹[1,2]	1.東大生産研, 2.東大ナノ量子機構, 3.物材機構
	18:00 - 18:15	奨 13p-D8-8	h-BNのLayer-by-Layer絶縁破壊	○服部 吉晃[1], 谷口 尚[2], 渡邊 賢司[2], 長汐 晃輔[1,3]	1.東大マテ, 2.物材機構, 3.JST-さきがけ
	18:15 - 18:30	13p-D8-9	hBN 基板中の空孔のグラフェンの伝導への影響の第一原理解析	○金子 智昭[1,2], 大野 隆央[1,2,3]	1.物質・材料研究機構, 2.高効率電デバコンソ, 3.東大生産研

17.4 デバイス応用 / Device applications　口頭講演

3月12日(木)　13:15 - 16:45					
	13:15 - 13:30	12p-D6-1	電気二重層キャパシタ活性炭電極へのカーボンオニオン添加の効果	○石井 湧太[1], 青野 祐子[1], 平田 敦[1]	1.東工大院
	13:30 - 13:45	奨 12p-D6-2	SiC上カーボンナノチューブフォレストのパターニング形成のための耐超高温ZnO/Cマスク	○稲葉 優文[1], 李 智宇[1], 鈴木 和真[1], 渋谷 恵[1], 明道 三穂[1], 平野 優[1], 乗松 航[2], 楠 美智子[2], 川原田 洋[1]	1.早大先進理工, 2.名大エコトピア研
	13:45 - 14:00	奨 12p-D6-3	カーボンナノチューブ機械振動子の支持強度の振動への影響	○猪谷 健志[1], 安田 正明[1], 有江 隆之[1], 竹井 邦晴[1], 秋田 成司[1]	1.阪府大工
	14:00 - 14:15	12p-D6-4	相補型ペーパートランジスタの開発	○(B)松井 洸樹[1], 浜名 良樹[1], 大矢 剛嗣[1]	1.横国大理工
	14:15 - 14:30	奨 12p-D6-5	イオン液体による電気二重層ゲートを用いたカーボンナノチューブ単電子トランジスタの量子状態の制御	○(B)鎌田 果歩[1], 清家 康平[1], 金井 康[1], 大野 恭秀[1,2], 前橋 兼三[1,3], 井上 恒一[1], 松本 和彦[1]	1.阪大産研, 2.徳島大, 3.東京農工大
	14:30 - 14:45	奨 12p-D6-6	異種無機材料集積によるフレキシブルCMOS回路	○本田 航[1], 有江 隆之[1], 秋田 成司[1], 竹井 邦晴[1]	1.大阪府大
	14:45 - 15:00	12p-D6-7	カーボンナノチューブ複合紙による熱電発電デバイスの開発	○(B)稲垣 忠光[1], 大矢 剛嗣[1]	1.横国大理工
	15:00 - 15:15		休憩/Break		
	15:15 - 15:30	12p-D6-8	ナノダイヤモンドから成長したカーボンナノチューブ薄膜の密度・長さ制御とそのバイオセンサ応用	○加瀬 寛人[1], 根岸 良太[1], 有福 達治[2], 清柳 典子[2], 小林 慶裕[1]	1.阪大院工, 2.日本化薬(株)
	15:30 - 15:45	奨 12p-D6-9	帯電電荷によるカーボンナノチューブ機械共振の高Q値化	○安田 正明[1], 竹井 邦晴[1], 有江 隆之[1], 秋田 成司[1]	1.大阪府大工
	15:45 - 16:00	奨・E 12p-D6-10	Highly Efficient and Flexible Organic Solar Cells Using Single-Walled Carbon Nanotube Films Doped with Strong and Safe MoO_x Dopant	○(D)Il Jeon[1], Kehang Cui[1], Takaaki Chiba[1], Albert Nasibulin[2], Esko Kauppinen[2], Shigeo Maruyama[1], Yutaka Matsuo[1]	1.Univ. of Tokyo, 2.Aalto Univ.
	16:00 - 16:15	12p-D6-11	カーボンナノチューブ塗料による塗工型色素増感太陽電池の高効率化	○(B)松永 悠樹[1], 大矢 剛嗣[1]	1.横国大理工
	16:15 - 16:30	12p-D6-12	One-step電着法によるナノカーボン材料へのPt-Ruナノ粒子の担持状態および電極触媒特性評価	○吉竹 晴彦[1], 早瀬 勝平[1], 王 志朋[2], 緒方 啓典[1]	1.法政大院理工, 2.信州大工
	16:30 - 16:45	12p-D6-13	イオン照射によるナノカーボン材料の欠陥構造の制御およびOne-step電着法によるPtナノ粒子の担持状態の解析	○早瀬 勝平[1], 吉竹 晴彦[1], 西村 智朗[2], 王 志朋[3], 緒方 啓典[1,4]	1.法政大院, 2.法政大イオン研, 3.信州大, 4.法政大学ﾏｲｸﾛ・ﾅﾉﾃｸ研
3月14日(土)　9:00 - 12:00					
	9:00 - 9:15	14a-D7-1	高品質エピタキシャルグラフェンを用いたGFETの特性評価	○須藤 亮太[1], 舘野 泰範[2], 吹留 博一[1], 末光 眞希[1]	1.東北大通研, 2.住友電工伝デ研
	9:15 - 9:30	奨 14a-D7-2	SiNゲートスタックによる高キャリア移動度グラフェンチャネルFET	○玉虫 元[1], 菅原 健太[1], Mastura binti Hussin[1], 末光 哲也[1], 須藤 亮太[1], 吹留 博一[1], 末光 眞希[1], 尾辻 泰一[1]	1.東北大 通研
	9:30 - 9:45	14a-D7-3	グラフェン/シリコンショットキー接合太陽電池	○アディカリ スディープ[1], 内田 秀雄[1], 安林 幹翁[1], 河原 敏男[1], 梅野 正義[1]	1.中部大
	9:45 - 10:00	奨 14a-D7-4	グラフェン光検出器の高感度化に向けた構造検討	○嶋谷 政彰[1], 小川 新平[1], 藤澤 大介[1], 金井 康[2], 大野 恭秀[2], 前橋 兼三[2], 松本 和彦[2]	1.三菱電機, 2.阪大産研
	10:00 - 10:15	14a-D7-5	グラフェンによる擬似的八木・宇田アンテナ(2)	○鈴木 哲[1], 日比野 浩樹[1]	1.NTT物性基礎研
	10:15 - 10:30	14a-D7-6	グラフェントンネルトランジスタの第一原理解析	○(M1C)鈴木 俊英[1], ハマム アーメド[1], ムルガナタン マノハラン[1], 水田 博[1,2]	1.北陸先端大, 2.サザンプトン大
	10:30 - 10:45	14a-D7-7	トップゲート型サスペンデッドグラフェンNEMSスイッチの特性評価	○(M2)筑葉 拓生[1], ムルガナタン マノハラン[1], 水田 博[1,2]	1.北陸先端大, 2.サザンプトン大
	10:45 - 11:00	14a-D7-8	グラフェンカンチレバー型NEMSスイッチの作製と評価	○(M2)兼竹 望[1,2], ムルガナタン マノハラン[1,2], 水田 博[1,2]	1.北陸先端大, 2.サザンプトン大
	11:00 - 11:15	奨 14a-D7-9	三脚構造分子をリンカーとしたアプタマー修飾グラフェンFETを用いたIgE検出	○(B)林 亮太[1], 麻植 丈史[1], 生田 昂[1], 金井 康[1], 大野 恭秀[1,2], 前橋 兼三[1,3], 井上 恒一[1], 田代 彩[1], 家 裕隆[1], 安蘇 芳雄[1], 松本 和彦[1]	1.阪大産研, 2.徳島大, 3.農工大
	11:15 - 11:30	14a-D7-10	グラフェン電界効果トランジスターにおけるフェリチン吸着の効果	○Mulyana Yana[1], 上沼 睦典[1], 岡本 尚文[1], 石河 泰明[1], 山下 一郎[1], 浦岡 行治[1]	1.奈良先端大
	11:30 - 11:45	E 14a-D7-11	Role of the electric field in the carbon dioxide molecule adsorption on graphene: Density functional theory simulation	○Manoharan Muruganathan[1], Hiroshi Mizuta[1,2]	1.JAIST, 2.Univ. of Southampton
	11:45 - 12:00	14a-D7-12	Pdナノドットで修飾したグラフェンナノリボンを用いた水素センサ	○竹内 豪[1], 星野 伸介[1], 宮田 耕[1], 高橋 綱己[1,2], 内田 建[1,2]	1.慶應大理工 電子工, 2.JST CREST

3月14日(土)　13:00 - 14:30					
	13:00 - 13:15	14p-D7-1	酸処理法によるシリコン酸化膜上グラフェンの歪とドーピング除去	増田 祥也[1], ○佐野 正人[1]	1.山形大院理工
	13:15 - 13:30	14p-D7-2	グラフェン／金属電極複合構造の電気伝導特性	○實宝 秀幸[1,2], 岡田 晋[2], 大淵 真理[1]	1.富士通研, 2.筑波大
	13:30 - 13:45	奨 14p-D7-3	Au/Cr/MoS2 系におけるCr 薄膜化によるコンタクト抵抗特性の改善	○佐野 宏亮[1], 高橋 綱己[1,2], 内田 建[1,2]	1.慶應大理工 電子工, 2.JST CREST
	13:45 - 14:00	14p-D7-4	HfO_2絶縁膜を用いたMoS_2 FETにおける実効移動度の評価	○二之宮 成樹[1], 森 貴洋[2], 内田 紀行[2], 久保 利隆[2], 渡辺 英一郎[3], 津谷 大樹[3], 森山 悟士[3], 田中 正俊[1], 安藤 淳[2]	1.横国大院工, 2.産総研, 3.物材機構
	14:00 - 14:15	14p-D7-5	MoS_2チャネルに対する水分子吸着の影響	○小林 拓平[1], 広瀬 宗一郎[1], 新家 義裕[1], 川江 健[1], 森本 章治[1]	1.金沢大
	14:15 - 14:30	14p-D7-6	薄膜HfS_2 FET	○金澤 徹[1], 雨宮 智宏[1,3], 石川 篤[2,3], 鶴田 健二[2], 田中 拓男[3,4], 宮本 恭幸[1]	1.東工大院理工, 2.岡山大院自然, 3.理研, 4.北大電子研

合同セッションK ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス / Joint Session K

合同セッションK ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス / Joint Session K　ポスター講演

3月13日(金)　9:30 - 11:30					
		13a-P18-1	触媒反応生成高エネルギーH_2O ビームのエネルギー状態	○叶内 慎吾[1], 中村 友紀[1], 玉山 泰宏[1], 安井 寛治[1]	1.長岡技科大工
		13a-P18-2	MnドーピングがZnOホモエピタキシャル薄膜成長過程に与える影響	○岩崎 裕徳[1], 野瀬 幸則[1], 吉村 武[1], 芦田 淳[1], 藤村 紀文[1]	1.大阪府立大院工
		13a-P18-3	水素導入による酸化亜鉛の電気特性変化	伊藤 弘樹[1], ○安部 功二[1]	1.名古屋工業大
		13a-P18-4	ZnOサブミクロンロッドの光学的特性	○鈴木 聡[1], 木田 正紀[1], 古川 俊介[1], 星野 慧一[1]	1.木更津高専
		E 13a-P18-5	Physical Property Evaluation of ZnO Thin Film Fabricated by Low-temperature process for Flexible Transparent Devices	○(M2)Hiraku Watanabe[1], Adie Bin Mohd Khafe[1], Hiroshi Yamuchi[1], Shigekazu Kuniyoshi[1], Masatoshi Sakai[1], Masaaki Iizuka[2], Kazuhiro Kudo[1]	1.Grad. Sch. Chiba. Univ., 2.Chiba Univ.
		13a-P18-6	マルチプラズマイオンプレーティングに向けた低シート抵抗ZnO透明導電膜の連続合成装置の開発	○佐藤 直幸[1], 大木 浩[2], 根矢 和次[2], 佐藤 達志[2]	1.茨城大院理工, 2.株式会社ビームトロン
		13a-P18-7	スパッタリング法によるAZO膜の電気特性に与える投入電力の影響	○正力 幹也[1], 井上 創太[1], 菊池 大樹[1], 杉浦 怜[1], 舩木 修平[1], 山田 容士[1]	1.島大総理工
		13a-P18-8	高密度Zn-O_2混合プラズマ中におけるZnO導電膜の透明度遷移領域の観察	○野中 翔太[1], 竹田 直樹[1], 佐藤 直幸[1], 池畑 隆[1]	1.茨城大院理工
		奨 13a-P18-9	塗布法による酸化亜鉛ナノ粒子層pn接合の作製と評価	○糸原 大貴[1], 篠原 風人[1], 吉田 俊幸[1], 藤田 恭久[1]	1.島根大院総理工
		奨 13a-P18-10	n型酸化亜鉛発光層を用いた酸化亜鉛ナノ粒子塗布型紫外線発光ダイオードの作製	○清山 拓史[1], 平儀野 雄斗[1], 阿部 耕介[2], 橋本 英樹[2], リン ジェイ[3], 吉田 俊幸[1], 藤田 恭久[1]	1.島根大院総理, 2.島根大総理, 3.島根大戦略的研究C
		13a-P18-11	ガリウムアセチルアセトナートを用いた酸化ガリウムのMOCVD成長	高橋 映成[1], ○安田 隆[1], 中込 真二[1], 國分 義弘[1]	1.石巻専修大理工
		13a-P18-12	ミストエピタキシー法によるα型酸化ガリウムの横方向選択成長(ELO)	○高塚 章夫[1], 織田 真也[1], 金子 健太郎[2], 藤田 静雄[2], 人羅 俊実[1]	1.株式会社FLOSFIA, 2.京大院工
		13a-P18-13	ワイドギャップ半導体β-Ga_2O_3単結晶のテラヘルツ波反射測定によるキャリア密度評価	○齋藤 伸吾[1], 尾沼 猛儀[1,2,3], 佐々木 公平[1,4], 倉又 朗人[4], 関根 徳彦[1], 笠松 章史[1], 東脇 正高[1]	1.情通機構, 2.東京高専, 3.工学院大, 4.タムラ製作所
		13a-P18-14	ミストCVDによって作製したコランダム型酸化インジウム(α-In_2O_3)の特性評価	○(B)須和 祐太[1], 川原村 敏幸[1], 小島 一信[2], 秩父 重英[2]	1.高知工大シス工, 2.東北大多元研
		13a-P18-15	サファイア上にミストCVD成長させたα-Fe_2O_3(0001)薄膜のCAICISSによる表面構造解析	○尾坂 駿[1], 丹波 大樹[1], 高橋 一暉[1], 織田 真也[2,3], 金子 健太郎[2], 田畑 博史[1], 久保 理[1], 藤田 静雄[2], 片山 光浩[1]	1.阪大院工, 2.京大院工, 3.FLOSFIA(株)
		13a-P18-16	GaとH$_2$Oを原料とする大気圧化学気相堆積法によるβ-Ga_2O_3薄膜及びナノ構造の成長	○寺迫 智昭[1], 一ノ谷 光[2], 宮田 晃[2], 矢木 正和[3]	1.愛媛大院理工, 2.愛媛大工, 3.香川高専
		13a-P18-17	ヘテロ接合を用いたDLTS法によるIGZO薄膜のトラップ準位の評価（2）	○小坂 修司[1], 横田 嘉宏[1], 岡田 廣[1]	1.コベルコ科研
		奨 13a-P18-18	滴下法により形成したZnOナノ粒子層のMES-FET応用のための基礎的検討	○篠原 風人[1], 糸原 大貴[1], 吉田 俊幸[1], 藤田 恭久[1]	1.島根大院総理
		13a-P18-19	SiN:Fゲート絶縁膜を用いた高信頼性a-InGaZnO薄膜トランジスタの界面における結合状態の解析	○(DC)山崎 はるか[1], 石河 泰明[1], 藤井 茉美[1], 高橋 英治[2], 安東 靖典[2], 浦岡 行治[1]	1.奈良先端大, 2.日新電機
		13a-P18-20	In-Ga-Zn-O薄膜トランジスタにおけるパッシベーション膜の効果 ～フッ素含有酸化シリコン・酸化シリコン/窒化シリコン積層パッシベーション～	○辰岡 玄悟[1], Jingxin Jiang[1], Dapeng Wang[1,2], 古田 守[1,2]	1.高知工大環境理工, 2.高知工大総研
		13a-P18-21	プラズマ処理によるIGZO TFTのソース・ドレイン領域形成 ～ガス種と基板バイアスが抵抗率およびその熱的安定性に及ぼす効果～	○曲 勇作[1], Dapeng Wang[1,2], 古田 守[1,2]	1.高知工大環境, 2.高知工大総研
		13a-P18-22	In-Ga-Zn-O薄膜トランジスタにおけるソース・ドレイン電極プラズマエッチングダメージと実効チャネル長への影響	○是友 大地[1], 戸田 達也[1], ワン ダーパン[1,2], 古田 守[1,2]	1.高知工大環境理工, 2.高知工大総研

合同セッションK ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス / Joint Session K　口頭講演

3月11日(水)　9:30 - 11:45					
	9:30 - 9:45	11a-D1-1	酸化亜鉛透明導電膜を感ガス材とした高速高出力電流水素センサー	○山本 哲也[1], 野本 淳一[1], 牧野 久雄[1], 岸本 誠一[2]	1.高知工科大総研, 2.高知高専機械工学科
	9:45 - 10:00	11a-D1-2	2段階アニールによるNb:TiO_2透明導電膜作製プロセスウィンドウの拡大	○中尾 祥一郎[1,2], 廣瀬 靖[1,2,3], 長谷川 哲也[1,2,3]	1.KAST, 2.CREST, 3.東大理
	10:00 - 10:15	11a-D1-3	ポリカーボネート基板上V添加ZnO薄膜の低温成膜と評価	○鈴木 智也[1], 千葉 博[2], 安倍 大[2], 川島 知之[1,2], 鷲尾 勝由[1,2]	1.東北大工, 2.東北大院工
	10:15 - 10:30	11a-D1-4	AZO透明導電膜における表面テクスチャ構造の制御と最適化	○山中 俊憲[1], 宇於崎 涼介[1], 宮田 俊弘[1], 南 内嗣[1]	1.金沢工大 OEDS R&D センター
	10:30 - 10:45		休憩/Break		
	10:45 - 11:00	11a-D1-5	多結晶AZO透明導電膜のキャリア輸送現象に対する結晶粒界の影響	○宇於崎 涼介[1], 山中 俊憲[1], 宮田 俊弘[1], 南 内嗣[1]	1.金沢工大 OEDS R&D センター

	11:00 - 11:15	11a-D1-6	ZnO膜中にドープしたEuドナーと水素の働き	○赤沢 方省[1]	1.NTT DIC
	11:15 - 11:30	11a-D1-7	Tight-Binding量子分子動力学法を用いたアモルファスIGZOの構造計算	○森田 晋也[1], 伊藤 寿[2], 樋口 祐次[2], 尾澤 伸樹[2], 久保 百司[2]	1.(株)神戸製鋼所, 2.東北大工
	11:30 - 11:45	11a-D1-8	ESRを用いたIGZO薄膜の評価	○野中 裕介[1], 黒澤 陽一[1], 小松 良寛[1], 石原 典隆[1], 太田 将志[1], 中島 基[1], 廣橋 拓也[1], 高橋 正弘[1], 生内 俊光[2], 保坂 泰靖[2], 肥塚 純一[2], 山崎 舜平[1]	1.半エネ研, 2.AFD Inc.
	3月11日(水)　13:15 - 17:45				
招待	**13:15 - 13:30**	**11p-D1-1**	**「講演奨励賞受賞記念講演」(15分) クリティカルレイヤーを用いたスパッタAl添加ZnO透明電導電膜のキャリア輸送制御 (II)**	**○野本 淳一[1], 牧野 久雄[1], 山本 哲也[1]**	**1.高知工科大総研**
	13:30 - 13:45	11p-D1-2	c軸配向結晶性IGZO FETの微細化に伴うフォノン散乱の影響	○松田 慎平[1], 菊地 彫[1], 山根 靖正[1], 岡崎 豊[1], 山崎 舜平[1]	1.半エネ研
	13:45 - 14:00	11p-D1-3	窒素添加InGaZnO膜の熱処理に対する電気特性評価	○中野 慎太郎[1], 前田 雄也[1], 大黒 達也[2], 百瀬 寿代[2], 諸岡 哲[2], 神例 信貴[3], 鈴木 幸治[4]	1.(株)東芝 研究開発センター, 2.(株)東芝 セミコンダクター&ストレージ社, 3.(株)東芝 生産技術センター, 4.東芝リサーチコンサルティング(株)
	14:00 - 14:15	奨 11p-D1-4	IGZO薄膜中の酸素空孔によるPLとドナー準位	○(M1C)陳 東京[1], 森本 貴明[1,2], 福田 伸子[3], 大木 義路[1,4]	1.早大先進理工, 2.学振DC2, 3.産総研FLEC, 4.早大材研
	14:15 - 14:30	11p-D1-5	酸化物半導体を低温溶液プロセスで作製する際のマイクロ波及び真空紫外光照射効果の確認	○(PC)鄭 恵貞[1], 小倉 晋太郎[1], 吉田 学[1], 牛島 洋史[1], 福田 伸子[1], 植村 聖[1]	1.産総研
	14:30 - 14:45	11p-D1-6	光ゾル-ゲルプロセスによるIZO半導体薄膜の作製とTFT特性	○小笹 健仁[1], 鄭 恵貞[1], 植村 聖[1], 吉田 学[1], 星野 聡[1]	1.産総研FLEC
	14:45 - 15:00	奨 11p-D1-7	溶液プロセスによる非晶質InZnO薄膜トランジスタ特性に対する湿式酸素アニールの影響	○長田 至弘[1], 石河 泰明[1], 藤井 茉美[1], 浦岡 行治[1]	1.奈良先端大
	15:00 - 15:15	奨 11p-D1-8	塗布型a-InZnO薄膜トランジスタに向けた銀ナノペーストの印刷適性	○(DC)浦川 哲[1], 石河 泰明[1], 長田 至弘[1], 藤井 茉実[1], 堀田 昌宏[1], 浦岡 行治[1]	1.奈良先端大
	15:15 - 15:30		休憩/Break		
	15:30 - 15:45	11p-D1-9	水素の影響による酸化亜鉛スズ(ZnSnO:ZTO)薄膜トランジスタの電気特性変化	○(M1C)竹之内 良太[1], 戸田 達也[1], 石井 林太郎[3], 高橋 広己[3], 王 大鵬[1,2], 古田 守[1,2]	1.高知工大, 2.総研, 3.三井金属鉱業株式会社
	15:45 - 16:00	奨 11p-D1-10	ゾルゲル成膜した酸化亜鉛薄膜の乾燥温度依存性とTFT特性	○川上 祐貴[1], 大東 隆文[1], 尾形 健一[1], 前元 利彦[1], 佐々 誠彦[1]	1.大工大ナノ材研センタ
	16:00 - 16:15	11p-D1-11	酸化亜鉛系電界効果トランジスターを用いたグルコースセンサーの作製と評価	○(M1)池谷 謙[1], 小池 一歩[1], 広藤 裕一[1], 前元 利彦[1], 佐々 誠彦[1], 矢野 満明[1]	1.大阪工大ナノ材研センタ
	16:15 - 16:30	11p-D1-12	アモルファスInWO TFTの微量Zn添加効果	○(P)木津 たきお[1], 宮永 美紀[2], 粟田 英章[2], 生田目 俊秀[1], 塚越 一仁[1]	1.物材機構, 2.住友電気工業
	16:30 - 16:45	11p-D1-13	アモルファス酸化インジウム薄膜トランジスタにおける電荷密度および移動度の添加元素依存性	○三苫 伸彦[1], 相川 慎也[1], 欧阳 威[1], 高 旭[1], 木津 たきお[1], 林 孟芳[1], 藤原 明比古[2], 生田目 俊秀[1], 塚越 一仁[1]	1.物材機構 WPI-MANA, 2.SPring-8
	16:45 - 17:00	11p-D1-14	大型スパッタカソードにおけるIGZO 膜の均一性向上	○大久保 裕夫[1], 磯部 辰徳[1], 新井 真[1], 清田 淳也[1], 齋藤 一也[1]	1.アルバック
	17:00 - 17:15	奨 11p-D1-15	非晶質InGaZnO抵抗変化メモリにおける電極材料依存性	○門 圭佑[1], 山内 祥光[1], 鍋坂 恭平[1], 藤井 茉美[1], 石河 泰明[1], 浦岡 行治[1]	1.奈良先端大
	17:15 - 17:30	奨・E 11p-D1-16	Analysis of Oxygen vacancies in the Interface of amorphous InGaZnO / Siloxane passivation film by X-ray photoelectron spectroscopy	○(M2)Chaiyanan Kulchaisit[1], Haruka Yamazaki[1], Juan Paolo Bermundo[1], Mami Fujii[1], Masahiro Horita[1], Yasuaki Ishikawa[1], Yukiharu Uraoka[1]	1.Nara Inst. of Sci. and Tech.
	17:30 - 17:45	奨・E 11p-D1-17	Low temperature excimer laser annealing of a-InGaZnO thin-film transistors passivated by hybrid organic-inorganic passivation layer	○(D)Juan Paolo Bermundo[1], Yasuaki Ishikawa[1], Mami Fujii[1], Michiel van der Zwan[2], Hiroshi Ikenoue[3], Ryoichi Ishihara[2], Toshiaki Nonaka[4], Yukiharu Uraoka[1]	1.Nara Inst. of Sci. and Tech., 2.Delft Univ. of Tech., 3.Kyushu Univ., 4.AZ Elect. Mat.
	3月12日(木)　9:00 - 12:15				
	9:00 - 9:15	12a-D1-1	高速回転式ミストCVD法により形成したZnO薄膜	○田之上 博信[1], 和田 祥平[1], 横山 裕太郎[1], 谷口 卓矢[1], 山本 真也[1], 中村 昭平[1], 中 良弘[1,3], 永岡 昭二[2,3], 中村 有水[1,3]	1.熊大工, 2.熊本県産技センター, 3.熊本有機センター
	9:15 - 9:30	奨 12a-D1-2	高周波熱プラズマ法による窒素ドープ酸化亜鉛ナノ粒子の生成	○(DC)平儀野 雄斗[1], 田中 暁巳[2], 竹内 浩[2], 竹内 啓[2], 藤田 恭久[1]	1.島根大院総理, 2.竹内電機
	9:30 - 9:45	奨 12a-D1-3	MOCVD法を用いて成長したNドープZnO膜のアニール効果	○中浦 拓也[1,3], 原田 善之[3], 王 剣宇[1], 長田 貴弘[1], 関口 隆史[1], 知京 豊裕[1], 鈴木 撰[2], 石垣 隆正[3], 角谷 正友[1]	1.NIMS., 2.COMMET, 3.法政大
	9:45 - 10:00	12a-D1-4	反応性プラズマ蒸着法によって作製したGa添加ZnO薄膜における構造特性への酸素ガス流量及びGa添加量の効果	○寺迫 智昭[1], 野本 淳一[2], 牧野 久雄[2], 白方 祥[1], 山本 哲也[2]	1.愛媛大院理工, 2.高知工科大総研
	10:00 - 10:15	12a-D1-5	c面サファイア上V添加ZnO極薄膜配向性の成膜温度依存性	○渡部 晃弘[1], 千葉 博[2], 川島 知之[1,2], 鷲尾 勝由[1,2]	1.東北大工, 2.東北大院工
	10:15 - 10:30	12a-D1-6	c面とa面サファイア基板上V添加ZnO薄膜配向性の成膜温度依存性	○千葉 博[1], 渡部 晃弘[2], 川島 知之[1], 鷲尾 勝由[1]	1.東北大院工, 2.東北大工
	10:30 - 10:45		休憩/Break		
	10:45 - 11:00	12a-D1-7	UHVスパッタ法により成長したZnO層の大気アニール処理	○(M1)松久 健司[1], 佐久間 大樹[1], 三好 佑弥[1], 水野 愛[1], 篠田 宏之[1], 六倉 信喜[1]	1.東京電機大工
	11:00 - 11:15	12a-D1-8	窒素添加結晶化法によるc面サファイア基板上へのZnO膜の作製：歪み緩和におけるバッファー層結晶粒密度の影響	井手 智章[1], 松島 宏一[1], 清水 僚太[1], 山下 大輔[1], 徐 鉉雄[1], 古閑 一憲[1], 白谷 正治[1], ○板垣 奈穂[1,2]	1.九州大学, 2.JSTさきがけ
	11:15 - 11:30	奨 12a-D1-9	水熱合成ZnOターゲットを用いたZnO薄膜のヘリコン波励起プラズマスパッタエピタキシー(3)：浅い不純物に関する考察	○山崎 芳樹[1], 古澤 健太郎[1], 岩橋 咲弥[1], 小島 一信[1], 秩父 重英[1]	1.東北大多元研
	11:30 - 11:45	奨 12a-D1-10	水熱合成ZnOターゲットを用いたZnO薄膜のヘリコン波励起プラズマスパッタエピタキシー(4)：遷移金属不純物に関する考察	○(B)岩橋 咲弥[1], 山崎 芳樹[1], 小島 一信[1], 古澤 健太郎[1], 上殿 明良[2], 秩父 重英[1]	1.東北大多元研, 2.筑波大物理工
	11:45 - 12:00	奨 12a-D1-11	$Mg_xZn_{1-x}O$/ZnOヘテロ構造における面内Mg分布の評価と制御	○打田 正輝[1], ジョセフ フォルソン[1], 瀬川 勇三郎[2], 小塚 裕介[1], 塚崎 敦[3,4], 川崎 雅司[1,2]	1.東大院工, 2.理研CEMS, 3.東北大金研, 4.JSTさきがけ
	12:00 - 12:15	12a-D1-12	Pt/$Mg_xZn_{1-x}O$/n^+-ZnOショットキーフォトダイオードの分光感度特性	○遠藤 治之[1], 佐藤 秀幸[2], Belmoubarik Mohamed[2], 高橋 強[1], 野崎 友大[2], 佐橋 政司[2], 柏葉 安兵衛[3]	1.岩手県工技センタ, 2.東北大工, 3.岩手大

	3月13日(金)　16:15 - 19:15				
	16:15 - 16:30	13p-D1-1	α-Ga_2O_3 バルク単結晶の作製と構造評価	○金子 健太郎[1,2], 織田 真也[1,2], 藤田 静雄[1], 人羅 俊実[2]	1.京大院工, 2.株式会社FLOSFIA
	16:30 - 16:45	奨 13p-D1-2	水素・窒素気流中におけるβ-Ga_2O_3の熱的安定性の熱力学的検討	○富樫 理恵[1], 野村 一城[1], 江口 千尋[1], 蕗澤 孝紘[1], 後藤 健[2], 村上 尚[1], 熊谷 義直[1], 倉又 朗人[2], 山腰 茂伸[2], 纐纈 明伯[1]	1.東京農工大院工, 2.タムラ製作所
	16:45 - 17:00	13p-D1-3	β-Ga_2O_3基板の結晶欠陥評価(2)	○永井 哲也[1], 野網 健悟[1], 中居 克彦[1], 二木 登史郎[1]	1.日鉄住金テクノロジー
	17:00 - 17:15	奨 13p-D1-4	ミストCVD法により成長したSnドープGa_2O_3薄膜の電気特性評価	○赤岩 和明[1], 李 三東[1], 金子 健太郎[1], 藤田 静雄[1]	1.京大院工
	17:15 - 17:30	13p-D1-5	大気圧プラズマCVD法を用いた(-201)β -Ga_2O_3薄膜のホモエピタキシャル成長	○木口 拓也[1], 野瀬 幸則[1], 上原 剛[2], 藤村 紀文[1]	1.大阪府立 大学院, 2.積水インテグレーテッドリサーチ
	17:30 - 17:45		休憩/Break		
	17:45 - 18:00	奨 13p-D1-6	ハライド気相成長法によるβ-Ga_2O_3基板上ホモエピタキシャル成長	○野村 一城[1], 後藤 健[2], 佐々木 公平[2,3], 河原 克明[1], ティユ クァン トゥ[4], 富樫 理恵[1], 村上 尚[1], 熊谷 義直[1], 東脇 正高[3], 倉又 朗人[2], 山腰 茂伸[2], Bo Monemar[4,5], 纐纈 明伯[1]	1.東京農工大院工, 2.タムラ製作所, 3.情報通信研究機構, 4.東京農工大GIRO, 5.Linköping Univ.
	18:00 - 18:15	奨 13p-D1-7	酸素ラジカル支援PLD法による酸化ガリウム系混晶薄膜の成長	○若林 諒[1], 服部 真依[1], 大島 孝仁[1], 佐々木 公平[2], 増井 建和[2], 倉又 朗人[2], 山腰 茂伸[2], 吉松 公平[1], 大友 明[1,3]	1.東工大院理工, 2.タムラ製作所, 3.元素戦略
	18:15 - 18:30	奨 13p-D1-8	β-$(Al_xGa_{1-x})_2O_3$/β-Ga_2O_3 ヘテロ接合のバンドオフセット評価	○服部 真依[1], 若林 諒[1], 大島 孝仁[1], 佐々木 公平[2], 増井 建和[2], 倉又 朗人[2], 山腰 茂伸[2], 堀場 弘司[3,4], 組頭 広志[3,4], 吉松 公平[1], 大友 明[1,4]	1.東工大院理工, 2.タムラ製作所, 3.高エネ研, 4.東工大元素戦略
	18:30 - 18:45	奨 13p-D1-9	PLD法を用いたβ-Ga_2O_3エピタキシャル薄膜成長のNiOバッファー層導入による低温化	○福田 大二[1], 塩尻 大士[1], 山内 涼輔[1], 土嶺 信男[2], 金子 智[1,3], 松田 晃史[1], 吉本 護[1]	1.東工大, 2.(株)豊島製作所, 3.神奈川県産技センター
	18:45 - 19:00	13p-D1-10	β-Ga_2O_3薄膜を用いたMFIS構造の作製	○近藤 勇樹[1], 尾澤 秋弘[1], 野村 圭介[1], 川江 健[1], 森本 章治[1]	1.金沢大学
	19:00 - 19:15	13p-D1-11	β-Ga_2O_3のMBE成長における積層欠陥発生の面方位依存性	○佐々木 公平[1], 倉又 朗人[1], 山腰 茂伸[1]	1.タムラ製作所
	3月14日(土)　9:00 - 11:30				
	9:00 - 9:15	14a-D1-1	極性ZnO単結晶表面の偏光依存硬X線光電子分光	○大澤 健男[1], 上田 茂典[1], 鈴木 基寛[2], 大橋 直樹[1]	1.物材機構, 2.JASRI/SPring-8
	9:15 - 9:30	奨 14a-D1-2	高周波マグネトロンスパッタリング法によるZnO薄膜の極性制御	○(M1)角田 啓[1,2], 大澤 健男[2], 大橋 直樹[2], 石垣 隆正[1]	1.法政大学大学院, 2.物質・材料研究機構
	9:30 - 9:45	14a-D1-3	ZnOの結晶対称性の破れと偏光励起の相関	○松井 裕章[1], 蓮池 紀幸[2], 播磨 弘[2], 田畑 仁[1]	1.東大工, 2.京都工繊大
	9:45 - 10:00	14a-D1-4	雰囲気の違いによるZnO単結晶基板の光導電特性	○阿部 貴美[1], 鎌田 修平[1], 高橋 修三[1], 中川 玲[1], 千葉 鉄也[1], 中川 美智子[1], 千葉 茂樹[1], 柏葉 安宏[2], 大坊 真洋[1], 新倉 郁生[1], 柏葉 安兵衛[1], 長田 洋[1]	1.岩手大学, 2.仙台高専
	10:00 - 10:15		休憩/Break		
	10:15 - 10:30	14a-D1-5	r 面サファイア基板を用いたWO_3 薄膜のMBE 成長	○松尾 昌幸[1], 村山 喬之[1], 原田 義之[1], 小池 一歩[1], 佐々 誠彦[1], 矢野 満明[1], 稲葉 克彦[2], 小林 信太郎[2]	1.大阪工大ナノ材研センタ, 2.リガク X 線研究所
	10:30 - 10:45	14a-D1-6	ゾル-ゲル法により成長したNiOエピタキシャル膜の格子歪	○國分 義弘[1], 目黒 康裕[1], 中込 真二[1]	1.石巻専修大理工
	10:45 - 11:00	14a-D1-7	MOCVD法によるc面サファイア基板上Cu_2O薄膜の結晶成長-二段階成長の検討-	○寺村 瑞樹[1], 谷口 凱[1], 田口 健太朗[1], 藤原 一樹[1], 石川 博康[1]	1.芝浦工大
	11:00 - 11:15	14a-D1-8	分子プレカーサー水溶液を用いたミストCVD法によるZnO薄膜製作	○(M1)後藤 良介[1], 澁木 勇人[1], 田沼 圭亮[1], 畠山 匠[1], 永井 裕己[1], 山口 智広[1], 佐藤 光史[1], 本田 徹[1]	1.工学院大学
	11:15 - 11:30	14a-D1-9	ミストCVD法におけるZnS薄膜の成長機構	山崎 佑一郎[1], ○宇野 和行[1], 田中 一郎[1]	1.和大システム工

コードシェアセッション / Code-sharing session

	3.5 レーザー装置・材料, 3.14 光制御デバイス・光ファイバーのコードシェアセッション　口頭講演				
	3月13日(金)　9:00 - 11:15				
招待	9:00 - 9:15	13a-A13-1	**「講演奨励賞受賞記念講演」(15分) 中赤外(9-12μm)光渦レーザーにおける符号制御**	**○堀川 マイケル知樹[1], 尾川 あずさ[1], 古城 健司[1], 宮本 克彦[1], 尾松 孝茂[1,2]**	**1.千葉大融合, 2.JST-CREST**
	9:15 - 9:30	奨・E 13a-A13-2	Widely tunable optical vortex parametric laser	○(D)ABULIKEMU AIZITIAILI[1], Taximaiti Yusufu[1,2], Katsuhiko Miyamoto[1], Takashige Omatsu[1,2]	1.Chiba Univ, 2.JST-CREST
	9:30 - 9:45	13a-A13-3	マイクロチップレーザー励起中赤外光パラメトリック発生の検討	○石月 秀貴[1], 平等 拓範[1]	1.分子研
	9:45 - 10:00	奨 13a-A13-4	CsLiB6O10結晶を用いた非同軸位相整合方式の高効率 355nm 紫外光発生	○(D)曲 晨[1], 吉村 政志[1], 高橋 義典[1], 森 勇介[1]	1.阪大院工
	10:00 - 10:15	奨 13a-A13-5	金属/液体電極を用いた電圧印加による$MgO:LiNbO_3$周期分極反転構造の作製と緑色光第二高調波発生	○沖野 行佑[1], 栖原 敏明[1]	1.阪大院工
	10:15 - 10:30	奨 13a-A13-6	接合イオンスライス$LiNbO_3$結晶におけるプロトン交換増速エッチングによるリッジ光導波路の作製	○田中 圭祐[1], 栖原 敏明[1]	1.阪大院工
	10:30 - 10:45	奨 13a-A13-7	MgO(8mol%)添加c-$LiTaO_3$アニールプロトン交換導波路の作製	○岡 寿治[1], 栖原 敏明[1]	1.阪大院工
	10:45 - 11:00	13a-A13-8	AlGaAs/AlOx 高屈折率差U字導波路における第二高調波発生の位相整合特性	○中村 勇貴[1], 松下 智紀[1], 近藤 高志[1]	1.東大工
	11:00 - 11:15	奨 13a-A13-9	周期空間反転AlGaAsのAs_2を用いたMBE成長	○楢崎 亮太[1], 松下 智紀[1], 近藤 高志[1]	1.東大工

3.11 フォトニック構造・現象, 13.7 超薄膜・量子ナノ構造のコードシェアセッション　口頭講演

3月12日(木)　9:00 - 12:30

	9:00 - 9:15	奨 12a-A10-1	有機ヒ素を用いたMOVPE法によるフォトニック結晶の埋め込み成長	○河崎 正人[1,3], 吉田 昌宏[1], 石崎 賢司[1], Menaka De Zoysa[1,2], 北村 恭子[1,2], 野田 進[1]	1.京大院工, 2.京大白眉, 3.三菱電機先端総研
	9:15 - 9:30	12a-A10-2	$(Sc, Er)_2O_3$薄膜におけるサイト選択励起でのエネルギー移動とアップコンバージョン	○川上 欣洋[1], 俵 毅彦[2,3], 尾身 博雄[2,3], 鍛治 怜奈[1], 足立 智[1]	1.北大院工, 2.NTT物性基礎研, 3.NTTナノフォトニクスセンタ
	9:30 - 9:45	12a-A10-3	(ErSc)2O3 薄膜におけるアップコンバージョン発光とフォトニックバンドギャップによる抑制	○俵 毅彦[1,2], Thomas McManus[1,3], 川上 欣洋[4], 尾身 博雄[1,2], Adel Najar[1], 鍛治 怜奈[4], 足立 智[4], 後藤 秀樹[1]	1.NTT物性研, 2.NTTナノフォトニクスセンタ, 3.バース大, 4.北大
	9:45 - 10:00	奨 12a-A10-4	InP(311)B基板上InAs量子ドットからの単一光子発生とその温度特性	○(M2)細井 響子[1], 高熊 亨[1], 黒澤 裕之[3], 中島 秀朗[3], 赤羽 浩一[2], 熊野 英和[3], 末宗 幾夫[3], 早瀬 潤子[3]	1.慶大理工, 2.情通機構, 3.北大電子研
	10:00 - 10:15	12a-A10-5	(111)A 面上量子ドットにおける励起子微細構造分裂の高精度評価	○中島 秀朗[1], 熊野 英和[1], 劉 祥明[2], 間野 高明[2], 黒田 隆[2], 末宗 幾夫[1]	1.北大電子研, 2.物材機構
	10:15 - 10:30	E 12a-A10-6	Entangled photon emission at temperatures up to 60 K from droplet epitaxial quantum dots	○(P)Xiangming Liu[1], Takashi Kuroda[1], Takaaki Mano[1], Hideaki Nakajima[2], Hidekazu Kumano[2], Ikuo Suemune[2], Yoshiki Sakuma[1], Kazuaki Sakoda[1]	1.NIMS, 2.RIES Hokkaido Univ.
	10:30 - 10:45	12a-A10-7	量子ドット-ナノ共振器強結合系における光散逸経路間干渉	○太田 泰友[1], 太田 竜一[2], 熊谷 直人[1], 岩本 敏[1,2], 荒川 泰彦[1,2]	1.東大ナノ量子機構, 2.東大生研
	10:45 - 11:00	奨 12a-A10-8	走査型電子顕微鏡による量子ドットの位置検出とナノ共振器との結合状態評価	○車 一宏[1], 太田 泰友[2], 高宮 大策[1], 角田 雅弘[2], 岩本 敏[1,2], 荒川 泰彦[1,2]	1.東大生研, 2.東大ナノ量子機構
	11:00 - 11:15		休憩/Break		
	11:15 - 11:30	12a-A10-9	ウエハ接合界面での光損失を低減した量子ドット結合共振器の作製	○北田 貴弘[1], 原山 千穂[1], 太田 寛人[1], 前川 知久[1], 盧 翔孟[1], 熊谷 直人[1], 井須 俊郎[1]	1.徳島大院フロンティア
	11:30 - 11:45	12a-A10-10	一次元フォノニック結晶導波路におけるフォノン伝搬のバンド構造依存性	○畑中 大樹[1], ドデル アモリ[1], マブーブ イムラン[1], 小野満 恒二[1], 山口 浩司[1]	1.NTT物性研
	11:45 - 12:00	奨 12a-A10-11	多モード干渉を利用した表面プラズモンポラリトン交差導波路	○太田 雅[1], 福原 誠史[1], 住村 あさひ[1], 伊藤 基[1], 相原 卓磨[1], 石井 佑弥[1], 福田 光男[1]	1.豊技大
	12:00 - 12:15	奨 12a-A10-12	グラフェン装荷型プラズモニクス導波路における光吸収の増強	○(M1)常川 雅人[1,2], 小野 真証[1,3], 納富 雅也[1,2,3]	1.NTT物性研, 2.東工大理工, 3.NTTナノフォトニクスセンタ
	12:15 - 12:30	奨 12a-A10-13	プラズモニック導波路のSi細線導波路への結合	○小野 真証[1,2], Hao Xu[1,2], 倉持 栄一[1,2], 野崎 謙悟[1,2], 谷山 秀昭[1,2], 常川 雅人[2,3], 納富 雅也[1,2,3]	1.NTTナノフォトニクスセンタ, 2.NTT物性科学基礎研, 3.東工大理工

6.6 プローブ顕微鏡, 12.2 評価・基礎物性のコードシェアセッション　口頭講演

3月13日(金)　9:00 - 12:00

	9:00 - 9:15	奨 13a-D14-1	多段階光強度のLM-STSによるP3HT:PCBM系有機薄膜太陽電池の局所測定	○落合 貴大[1,2], 安田 剛[3], 加藤 洋和[1], 小林 祐貴[1], 吉田 昭二[1], 武内 修[1], 重川 秀実[1]	1.筑波大数理物質, 2.タカノ(株), 3.物質・材料研究機構
	9:15 - 9:30	奨 13a-D14-2	動作中の有機トランジスタにおける過渡的キャリア分布のナノスケール可視化	○山岸 裕史[1], 木村 知玄[1], 小林 圭[1,2], 野田 啓[3], 山田 啓文[1]	1.京大院工, 2.京大白眉セ, 3.慶應大理工
	9:30 - 9:45	13a-D14-3	時間分解静電気力顕微鏡による有機半導体グレインへの電荷注入・排出過程の可視化	○木村 知玄[1], 山岸 裕史[1], 小林 圭[1,2], 山田 啓文[1]	1.京大工, 2.京大白眉セ
	9:45 - 10:00	奨 13a-D14-4	探針増強ラマン散乱分光測定における金属探針の温度評価と熱拡散手法	○(DC)望月 誠仁[1], 小口 真弘[1], 角井 杏帆[1], 矢野 隆章[1], 原 正彦[1], 林 智広[1]	1.東工大総理工
	10:00 - 10:15	13a-D14-5	液中FM-AFMによる免疫グロブリンM(IgM)の抗原結合評価	○黄 雲飛[1], 木南 裕陽[1], 小林 圭[1,2], 山田 啓文[1]	1.京大工, 2.京大白眉セ
	10:15 - 10:30	奨 13a-D14-6	自己検知型カンチレバーを用いた液中における単一吸着細胞の剥離力測定	○橋本 重孝[1], 安達 誠[1], 岩田 太[1,2]	1.静岡大院工, 2.静岡大電研
	10:30 - 10:45		休憩/Break		
招待	**10:45 - 11:00**	**13a-D14-7**	**「講演奨励賞受賞記念講演」(15分) ポルフィリン-TbIIIダブルデッカー型単分子磁石のSTMによるパターニングと近藤状態の評価**	**○猪瀬 朋子[1], 田中 大輔[1], Liu Jie[2], 梶原 美珠[2], 米田 忠弘[2], 小川 琢治[1]**	**1.阪大院理, 2.東北大多元研**
	11:00 - 11:15	奨 13a-D14-8	単一分子伝導における分子形状効果の3次元計測	○片山 智貴[1], 中村 美紀[1], 吉田 昭二[1], 武内 修[1], 重川 秀実[1]	1.筑波大数理
	11:15 - 11:30	奨 13a-D14-9	CuPc追加蒸着によるPCBMの配列構造の変化	○(M1)桝井 茜[1], 坂上 弘之[1], 高萩 隆行[1], 鈴木 仁[1]	1.広島大院先端研
	11:30 - 11:45	奨 13a-D14-10	力検出による近接場光の高分解能観測	○山西 絢介[1], 徳山 貴士[1], 内藤 賀公[1], 李 艶君[1], 菅原 康弘[1]	1.阪大院工
	11:45 - 12:00	13a-D14-11	電気化学FM-AFMを用いたイオン液体／ルブレン(001)界面における探針誘起ナノリソグラフィー	○坂東 賢一[1], 原 援又[1], 森野 裕介[1], 岡田 悠悟[2], 今西 哲士[1], 横田 泰之[1], 植村 隆文[2], 竹谷 純一[2], 福井 賢一[1]	1.阪大院基礎工, 2.東大院新領域

13.10 化合物太陽電池, 15.2 II-VI族結晶および多元系結晶のコードシェアセッション　口頭講演

3月12日(木)　13:30 - 17:45

	13:30 - 13:45	12p-A26-1	ZnTe基板上へのClドープCdTe薄膜のMBE成長	○(M1)寺沢 俊貴[1], 田中 徹[1], 斉藤 勝彦[1], 郭 其新[1], 西尾 光弘[1]	1.佐賀大院工
	13:45 - 14:00	12p-A26-2	MBEによる高不整合材料ZnCdTeO薄膜の成長	○(B)岡野 友紀[1], 溝口 耕輔[1], 寺沢 俊貴[1], 田中 徹[1], 斉藤 勝彦[1], 郭 其新[1], 西尾 光弘[1]	1.佐賀大学
	14:00 - 14:15	奨 12p-A26-3	PLD法による透明p型導電性BaCuSF膜の作製とCdTe太陽電池への応用	○川邉 利幸[1], 榊間 博[1], 小川 洋平[2], 細野 藍響[2], 岡本 保[2], 和田 隆博[1]	1.龍谷大理工, 2.木更津高専
	14:15 - 14:30	12p-A26-4	グラフェン透明導電膜の薄膜化合物太陽電池応用	○石川 亮佑[1], 大矢 智也[1], 野本 隆宏[1], 坪井 望[1]	1.新潟大工
	14:30 - 14:45	12p-A26-5	Se蒸気圧制御によるCZTSナノ粒子薄膜のSe化	○梅嶋 悠人[1], 井狩 華奈美[1], 上村 一生[1], 張 険峰[2], 小林 正和[1,3]	1.早大先進理工, 2.早大ICSEP, 3.早大材研
	14:45 - 15:00	12p-A26-6	ゾルゲル硫化法によるCu_2ZnSnS_4薄膜の作製におけるUV/O_3処理の効果 II	○宮沢 勇斗[1], 田中 久仁彦[1], 打木 久雄[1]	1.長岡技大
	15:00 - 15:15	12p-A26-7	ミスト CVD 法による Cu_2ZnSnS_4 薄膜の作製と評価	○渡辺 勇一郎[1], 池之上 卓己[1], 三宅 正男[1], 平藤 哲司[1]	1.京大院エネ科

	15:15 - 15:30	奨 12p-A26-8	ナフテン酸銅, ナフテン酸亜鉛およびオクチル酸スズとジメチルセレンを用いた$Cu_2ZnSnSe_4$薄膜の作製	○山田 諒太[1], 田橋 正浩[1], 高橋 誠[1], 吉野 賢二[2], 後藤 英雄[1]	1.中部大学, 2.宮崎大学
	15:30 - 15:45		休憩/Break		
	15:45 - 16:00	12p-A26-9	Cu_2ZnSnS_4ナノ粒子の液相合成におけるCu^{2+}還元過程	○(M1)森下 一喜[1], 須藤 裕之[1], 神谷 格[1]	1.豊田工大
	16:00 - 16:15	12p-A26-10	Cu_2ZnSnS_4ナノ粒子を用いた塗布型太陽電池の作製	○杉本 寛太[1], 桑名 潤[1], 後藤 仁憲[1], 陶山 直樹[1], 張 毅聞[2], 黒川 康良[1], 山田 明[1,3]	1.東工大院理工, 2.凸版印刷, 3.東工大PVREC
	16:15 - 16:30	12p-A26-11	HAXPESによる窓層/CdS層/CZTS層界面のバンド構造評価	○田島 伸[1], 片岡 恵太[1], 梅原 密太郎[1], 高橋 直子[1], 木本 康司[1], 北住 幸介[1], 磯村 典武[1]	1.豊田中研
	16:30 - 16:45	12p-A26-12	$Zn_{1-x}Mg_xO/Cu_2ZnSn(S, Se)_4$界面のバンド接続の in-situ 評価	○諏訪原 裕貴[1]	1.鹿児島大
	16:45 - 17:00	E 12p-A26-13	Photocarrier dynamics in $Cu_2ZnSn(S_xSe_{1-x})_4$ single crystals: Composition dependence	○(PC)Le Quang Phuong[1,2], Makoto Okano[1], Genki Yamashita[3], Masaya Nagai[3], Masaaki Ashida[3], Akira Nagaoka[1,4], Kenji Yoshino[4], Yoshihiko Kanemitsu[1,2]	1.Kyoto Univ., 2.JST-CREST, 3.Osaka Univ., 4.Univ. of Miyazaki
	17:00 - 17:15	E 12p-A26-14	Suppression of nonradiative recombination centers in Cu_2ZnSnS_4 single crystals by sodium doping	○(PC)Le Quang Phuong[1,2], Makoto Okano[1], Genki Yamashita[3], Masaya Nagai[3], Masaaki Ashida[3], Akira Nagaoka[1,4], Kenji Yoshino[4], Yoshihiko Kanemitsu[1,2]	1.Kyoto Univ., 2.JST-CREST, 3.Osaka Univ., 4.Univ. of Miyazaki
	17:15 - 17:30	12p-A26-15	電子線照射によるCu_2ZnSnS_4太陽電池の電気的・光学的特性への影響	○相原 理[1], 坂倉 秀徳[1], 片桐 裕則[2], 杉山 睦[1]	1.東京理科大 理工/総研, 2.長岡高専
	17:30 - 17:45	奨 12p-A26-16	ケステライト化合物$Cu_2ZnSn(S_x, Se_{1-x})_4$単結晶中の固有散乱メカニズム	○永岡 章[1,5], Scarpulla Michael[2], 柿本 浩一[3], 吉野 賢二[4], 野瀬 嘉太郎[1]	1.京大院工, 2.米ユタ大, 3.九大応力研, 4.宮崎大工, 5.学振特別研究員PD
	3月13日(金) 9:00 - 12:15				
	9:00 - 9:15	奨 13a-A17-1	近接昇華法を用いたサファイア基板上のAg(Ga,Al)Te_2混晶作製	○宇留野 彩[1], 薄井 綾香[1], 竹田 裕二[1], 井上 朋大[1], 小林 正和[1,2]	1.早大先進理工, 2.早大材研
	9:15 - 9:30	13a-A17-2	$CuInSe_2$-In_2Se_3系化合物の結晶構造と光学的性質	○(PC)前田 毅[1], 宮 イゲン[1], 和田 隆博[1]	1.龍谷大理工
	9:30 - 9:45	奨 13a-A17-3	$CuGaSe_2$-ZnSe系化合物の結晶構造と光学的性質	○山田 悠斗[1], 前田 毅[1], 竹井 康二[1], 和田 隆博[1]	1.龍谷大理工
	9:45 - 10:00	13a-A17-4	Znのサイト選択ドーピングによるp形CIGS薄膜の作製	○白方 祥[1], 吉田 正吾[1], 岸田 貴志[1], 弓達 新治[1], 宮田 晃[1]	1.愛媛大 工
	10:00 - 10:15	13a-A17-5	CIGS薄膜のその場PL測定	○深井 尋史[1], 池村 賢一郎[2], 井口 和也[2], エル リ カオ ザッカーリ[1], カトリ イズール[1], 松山 勇[1], 山口 博[1], 中田 時夫[1]	1.東京理科大総研, 2.浜松ホトニクス
	10:15 - 10:30	13a-A17-6	$CuIn_{1-x}Ga_xSe_2$ における光キャリアの緩和及び拡散ダイナミクス	○岡野 真人[1], 櫻井 岳暁[2], 秋本 克洋[2], 柴田 肇[3], 仁木 栄[3], 金光 義彦[1,4]	1.京大化研, 2.筑波大数物研, 3.産総研・太陽光発電工学研究センター, 4.JST-CREST
	10:30 - 10:45	E 13a-A17-7	Microstructure Characteristics of Cu(In, Ga)Se_2 Thin Films Investigated by TEM	○(PC)HyungSeok Kim[1,4], T. Ohkubo[1], K. Hono[1], K. Yoshida[2], T. Nakada[3]	1.NIMS, 2.Osaka Univ., 3.Tokyo Univ. of Sci., 4.LG Electronics
	10:45 - 11:00	13a-A17-8	Lift-off法を用いたsuperstrate型Cu(In,Ga)Se_2薄膜太陽電池におけるPEDOT:PSS裏面電極の検討	○新澤 雄高[1], 新井 裕之[1], 廣庭 大輔[1], 峯元 高志[1]	1.立命館大学
	11:00 - 11:15	13a-A17-9	裏面パッシベーション効果を利用したCIGS太陽電池特性	○崔 誠佑[1], 上川 由紀子[1], 西永 慈郎[1], 山田 昭政[1], 柴田 肇[1], 仁木 栄[1]	1.産総研
	11:15 - 11:30	E 13a-A17-10	Effect of KF-PDT on MBE-Grown Cu$(In_{1-x},Ga_x)Se_2$ Thin Film	○(PC)Ishwor Khatri[1], Hirofumi Fukai[1], Isamu Matsuyama[1], Hiroshi Yamaguchi[1], Tokio Nakada[1]	1.Tokyo University of Science
	11:30 - 11:45	13a-A17-11	Photovoltages and Their Dependence on Incident Light Wavelengths on CIGS Solar Cells Investigated by P-KFM	○(D)Hyeondeuk Yong[1], Takashi Minemoto[3], Takuji Takahashi[1,2]	1.IIS, The Univ. of Tokyo, 2.INQIE, The Univ. of Tokyo, 3.Coll. of Sci. and Eng., Ritsumeikan Univ.
	11:45 - 12:00	13a-A17-12	CIGS上でのケルビンプローブフォース顕微鏡及び静電引力顕微鏡による表面電位分布と静電引力スペクトルの観測	○石井 智章[1], 峯元 高志[3], 高橋 琢二[1,2]	1.東大生研, 2.東大ナノ量子機構, 3.立命館大理工
招待	**12:00 - 12:15**	**13a-A17-13**	**「講演奨励賞受賞記念講演」(15分) Cu(In,Ga)Se2薄膜太陽電池の 価電子帯制御による界面再結合抑制効果の理論的及び実験的検証**	**○西村 昂人[1], 平井 義晃[1], 黒川 康良[1], 山田 明[1,2]**	**1.東工大院理工, 2.太陽光発電システム研究センター**

13.10 化合物太陽電池, 15.2 II-VI族結晶および多元系結晶のコードシェアセッション　ポスター講演

3月13日(金) 16:30 - 18:30

		13p-P19-1	電着法によるFeSe薄膜の作製と物性評価II	○(M1)長屋 智紀[1], 高橋 誠[1], 鈴木 崇也[1], 田橋 正浩[1], 大木戸 貞夫[1]	1.中部大学
		13p-P19-2	酸性溶液中で硫黄源の仕込み量がSnS膜に与える影響	○石川 佑[1], 宮﨑 尚[1], 岡本 庸一[1], 守本 純[1]	1.防衛大材料
		13p-P19-3	硫化法を用いたSnS薄膜における組成比が電気特性に与える影響	○三上 俊太郎[1], 横井 翼[1], 鷲見 浩貴[1], 相原 理[1], 永易 京[1], 久富 一真[1], 杉山 睦[1]	1.東京理科大学理工学部/総合研究機構
		奨 13p-P19-4	GeS_2とS蒸気反応を用いたCu_2GeS_3薄膜太陽電池の作製	○知野 広太郎[1], 豊永 詞[1], 金井 綾香[1], 荒木 秀明[1,2]	1.長岡高専, 2.科学技術振興機構, さきがけ
		13p-P19-5	スプレー熱分解法によるCu_2ZnSnS_4薄膜太陽電池の作製	○(B)藤川 祥太朗[1], ヒエップ グエン ティ[1], ウィルマン セプティナ[1], 原田 隆史[1], 池田 茂[1], 松村 道雄[1]	1.阪大太陽エネルギー化学研セ
		13p-P19-6	2段階同時蒸着法による$Cu_2ZnSnSe_4$薄膜作製の検討	○村上 秀憲[1], 大塚 健介[1], 弓達 新治[1], 宮田 晃[1], 白方 祥[1]	1.愛媛大工
		13p-P19-7	$Cu_2ZnSn(S,Se)_4$ナノ粒子を用いた塗布薄膜の焼成条件による影響	○鈴木 俊正[1], 鈴木 吏[2], 堀 茂雄[2], 野々村 修一[2]	1.JFCC, 2.岐阜大学
		13p-P19-8	時間の経過による三次元構造Cu_2ZnSnS_4太陽電池の特性変化	○田中 久仁彦[1], 長橋 由樹[1], 石山 貴道[1], 森谷 克彦[2], 打木 久雄[1]	1.長岡技大, 2.鶴岡高専
		13p-P19-9	分子線エピタキシー法による$CuGaS_2$薄膜の作製と評価 ～$(NH_4)_2S_x$による過剰Cu_xSのエッチング～	○倉掛 真弥[1], 岡 優貴[1], 松下 将也[1], 山田 秀明[1], 阿部 友紀[1], 市野 邦男[1]	1.鳥大院工
		13p-P19-10	MEE法を用いて成長したGaAs(001)基板上CIS-CGS構造の評価	○豊田 康揮[1], 佐藤 知嵩[1], 谷口 龍希[1], サティア パマ[1], 堀越 佳治[1], 牧本 俊樹[1]	1.早稲田大学
		13p-P19-11	大気中におけるCIGS太陽電池の効率劣化の検証	○西永 慈郎[1], 上川 由紀子[1], 崔 誠佑[1], 柴田 肇[1], 仁木 栄[1]	1.産総研
		13p-P19-12	二波長蛍光分光法および光容量分光法を用いた鉛ハライド系ペロブスカイト太陽電池の欠陥準位評価	○中澤 紀祥[1], 櫻井 岳暁[1], M.M. Islam[1], 秋本 克洋[1], 尾込 裕平[2], 早瀬 修二[2]	1.筑波大, 2.九工大

		13p-P19-13	ペロブスカイト太陽電池に用いる多孔質酸化チタン層の昇温脱離分析	○(B)宝山 修士[1], ハシーヤ カリマ アディリ[1], 原田 隆史[1], 池田 茂[1], 伊藤 省吾[2], 松村 道雄[1]	1.大阪大基礎工, 2.兵庫県立大工
		13p-P19-14	量子ドット増感型太陽電池の量子ドット生成法に対するフォトキャリア取り出し効率の比較	○家山 昂[1], 尾崎 信彦[1], 大渕 隆文[2], 福田 直晃[2], 加藤 美奈子[3], 滝谷 俊夫[3]	1.和歌山大シス工, 2.京都大, 3.日立造船(株)
		13p-P19-15	AR膜によるInGaP/GaAs/Si 3接合セル中サブセル特性の制御	○重川 直輝[1], 梁 剣波[1]	1.大阪市大工
		13p-P19-16	多接合太陽電池応用に向けたGaAs/Ge表面活性化接合技術の検討	○山下 大之[1], 河野 元紀[1], 渡辺 健太郎[1], 杉山 正和[1], 須賀 唯知[1], 中野 義昭[1]	1.東大工
		13p-P19-17	GaAs:N δドープ超格子を有する太陽電池の二段階光吸収	○鈴木 智也[1], 八木 修平[1], 土方 泰斗[1], 岡田 至崇[2], 矢口 裕之[1]	1.埼玉大理工, 2.東大先端研
		E 13p-P19-18	GaNAs quantum structures embedded in GaAs p-i-n for Intermediate Band Solar Cell with zero valance band offset	○Martin Elborg[1], Takeshi Noda[1], Liyuan Han[1]	1.NIMS, Tsukuba
		13p-P19-19	面内高密度InAs量子ドット層における光伝導特性	○(B)秋元 直己[1], 内田 俊介[1], 山口 浩一[1]	1.電通大
		13p-P19-20	ECRプラズマ作製によるCu/Cu_2O型PVセルの特性に与える水素プラズマ前処理の効果	○奈良 拓馬[1], 菊地 悠介[1], 佐藤 直幸[1], 池畑 隆[1]	1.茨城大院理工
		13p-P19-21	ECRプラズマ作製によるCu/Cu_2O型PVセルの大気曝露特性	○長谷川 基輝[1], 菊地 悠介[1], 佐藤 直幸[1], 池畑 隆[1]	1.茨城大院理工
		13p-P19-22	Free-standing InP Nanowire Array and Their Optical Properties Toward Resource-Saving Solar Cells	○(M1)muyi Chen[1], Eiji Nakai[1], katsuhiro Tomioka[1,2], takashi Fukui[1]	1.Graduate school of IST and RCIQE Hokkaido Univ.,, 2.JST-PRESTO

President's Reception for Overseas Participants

It's free! Network with JSAP

Researchers and students from overseas attending the 62nd JSAP Spring Meeting at Tokai University are invited to join the directors of the JSAP to share and exchange ideas about the activities of the Japan Society of Applied Physics.

This unique and informal gathering will include light refreshments and be held at a cafeteria "Log House" on the campus of Tokai University from 18:00 to 20:00 on Friday, 13 March 2015.

The Reception will be an excellent opportunity for overseas researchers to network and directly express their opinions to JSAP directors about the annual conferences, publications, and other activities of the JSAP.

Date : Friday, March 13　18:00-20:00
Location : Cafeteria "Log House",
Shonan Campus, Tokai Univ.
Fee : Free　* No reservation is required

Campus Map



のっしゅ 理科教室

理科工作の展示をしています
ぜひ，お立ち寄りください

日程：平成２７年３月１１日（水）～１３日（金）
場所：展示会場内（体育館：Ｐ会場）







応用物理学教育の振興・普及啓発のため
応物賞金２１募金にご協力ください！

応用物理学会　特別企画

応物キャリア相談会 2015春



応用物理学（理学・物理学・工学・バイオ系含）関連の
学生およびポスドクのための相談会です



ポスターデザイン:
はやのん理系漫画制作室

今回の出展機関（順不同）

- (株)東芝
- ソニー(株)
- 日本電気(株)
- 三菱電機(株)
- シャープ(株)
- NTT R&D
- 日本アイ・ビー・エム(株)東京基礎研究所
- (株)SUMCO
- サンディスク(株)
- (株)テクノプロ
- 名古屋大学ビジネス人材育成センター
- 物質・材料研究機構
- 産業技術総合研究所
- 科学技術振興機構
- 応用物理学会APSG

日時:
2015年3月13日(金)
11:30~13:45/16:15~18:30

場所: 東海大学湘南キャンパス（神奈川県平塚市北金目4-1-1）
展示会場（総合体育館）
（第62回応用物理学会春季学術講演会 会場）
参加申し込み: 特に必要なし
参加費: 無料（ただし参加登録費をお支払いいただいた学術講演会参加者に限る）

主催: 公益社団法人 応用物理学会
問い合わせ先: 応用物理学会事務局　岡本　(Tel:03-5802-0861　soka@jsap.or.jp)
https://www.jsap.or.jp/career/
こちらのサイトから事前に「面談シート」をダウンロードすることができます.

応用物理学会 Student Chapter

突然ですがこんな疑問ありませんか…？

- SCの活動って何をするの？
- どんなことなら予算が出るの？
- 他のSCは何をやってるの？



その疑問、解決しましょう！！

第4回学生研究者交流会

2015年3月11日　@東海大 湘南キャンパス

対象　学部生・院生・ポスドク
（先生や企業の方もどうぞ！）

無料・当日参加OK！

申し込み　2月28日〆切

お名前・所属・連絡先を明記した上で
下記のアドレスへメールをお送りください
（wujwu2015@gmail.com）

---

①　15:30 ～ 17:30
交流会 @A10会場

- 各SCからの活動報告会
- 座談会

②　19:00 ～
懇親会 @コム・スクエア

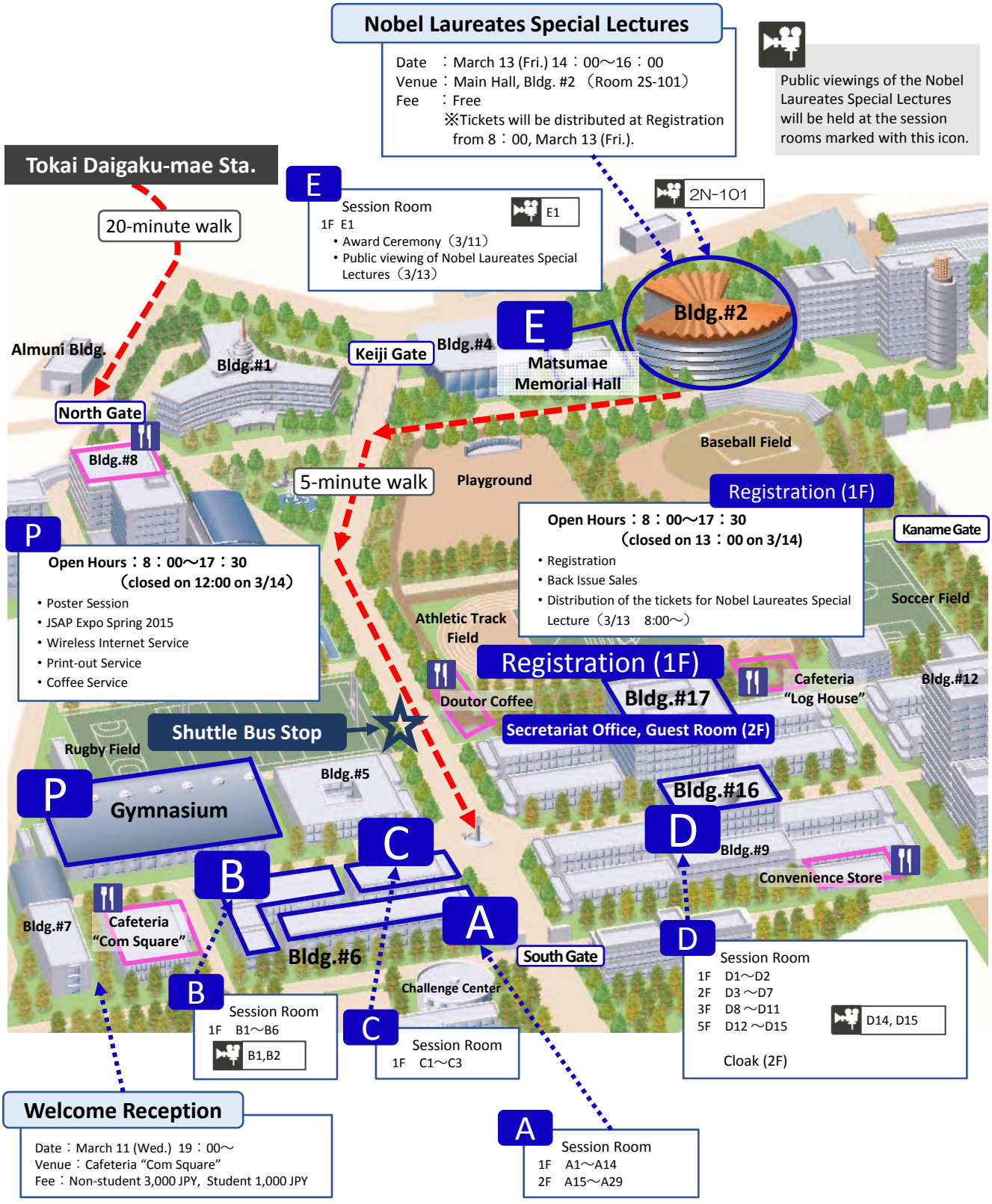
＊交流会・講演会の両参加者は無料です
＊定員がございます



東海大 湘南キャンパス構内図

主催：公益社団法人　応用物理学会
企画・運営：応用物理学会スチューデントチャプター
連絡先：早大・日女大SC 長久保咲絵 eikas.n@optnet.jwu.ac.jp

Campus Map



For inquiries during the meeting
Secretariat Office TEL: +81-463-59-8303

The 62nd JSAP Spring Meeting

Nobel Laureates Special Lectures

March 13 (Fri.) 14:00 ～ 16:00
Main Hall, Bldg. #2 （Room 2S-101）,
Shonan Campus, Tokai University

Special lectures by Profs. Isamu Akasaki, Hiroshi Amano, and Shuji Nakamura, 2014 Nobel Laureates in Physics will be held at the 62nd JSAP Spring Meeting.



Prof. Isamu Akasaki
(Meijo University)



Prof. Hiroshi Amano
（Nagoya University）



Prof. Shuji Nakamura
（UC Santa Barbara）

Program

14：00 Opening
14：05 Congratulatory Message from JSAP President
14：15 Special Lecture by Prof. Isamu Akasaki
14：45 Special Lecture by Prof. Hiroshi Amano
15：15 Special Lecture by Prof. Shuji Nakamura

***The lectures will be given in Japanese and no translation will be provided.**

Fee

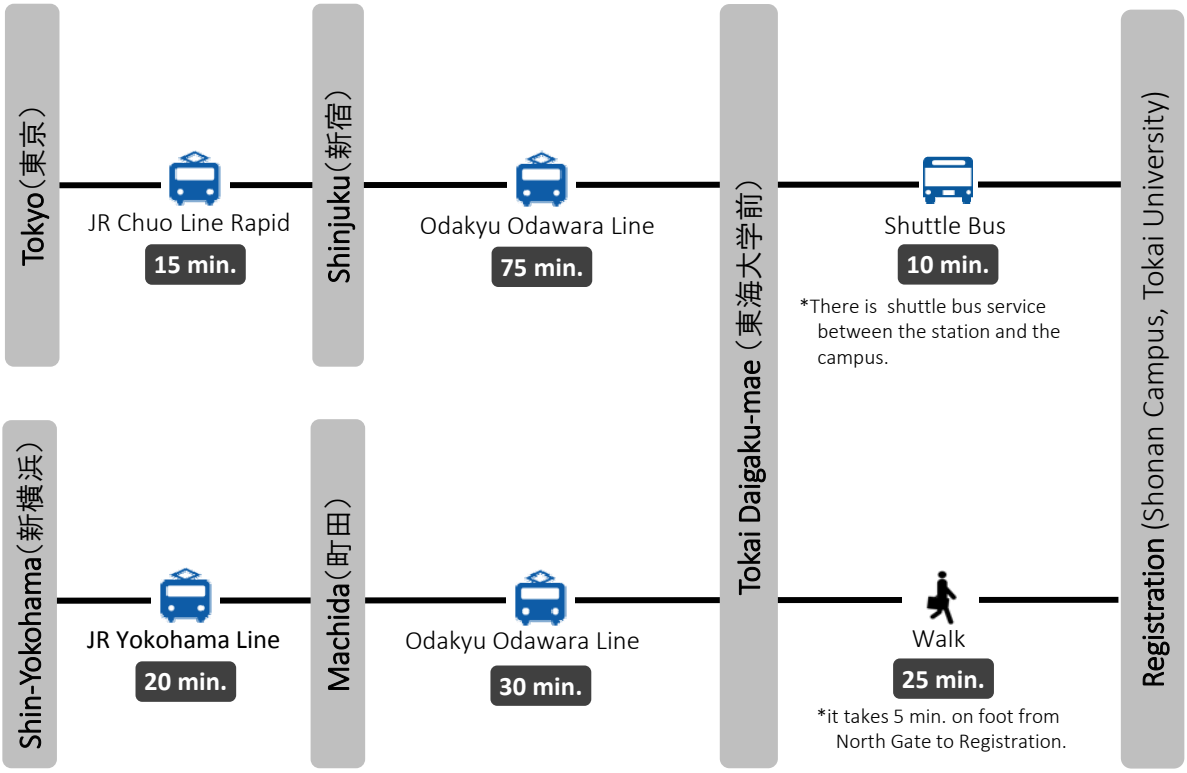
Free *Registration will be required to attend the regular sessions in the 62nd JSAP Spring Meeting.

How to Attend

1. Online Entry Deadline: 12:00 pm February 13 (Fri.)
   Please check the official website (http://meeting.jsap.or.jp/) for more details.
2. Onsite Ticket Distribution（Only for The 62nd JSAP Meeting Registrants)
   Tickets will be distributed at the Registration (1F Bldg. #17, Shonan Campus, Tokai Univ.) from 8：00 am, March 13 (Fri.) *limited 1300 seats. first-come and first-served basis

※Public viewings of the lectures will be held at some session rooms.

Access



There is no parking space available on the campus. Please use the public transportation.
Please avoid street parking as a courtesy to the neighbors.

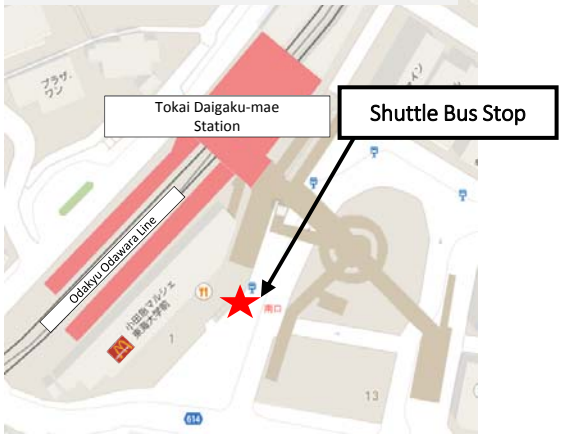
Shuttle Bus Services

There is shuttle bus service between Tokai Daigaku-mae Station to the campus (near Registration).

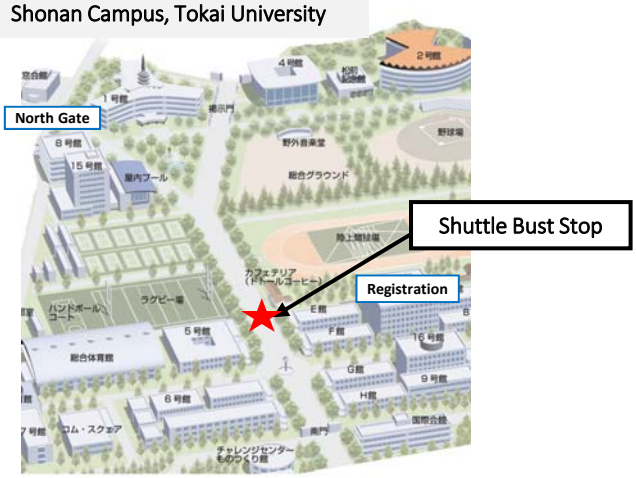
Fare **One-way: 250 JPY** **Round-trip: 400 JPY** *We do NOT accept payment by prepaid IC card.

***Payment should be made when getting on/off inside the campus. If you wish to buy round-trip tickets, please ask the staff at the bus stop inside the campus.**
*Bus ticket office will be set up near the shuttle bus stop inside the campus. There will be no ticket office at Tokai Daigaku-mae Station.
*Please bring small changes with you in advance.
*Congestion will be expected during peak hours.
*There is route bus services between Tokai Daigaku-mae Station to the North Gate of the campus. (One-way: 180 JPY)

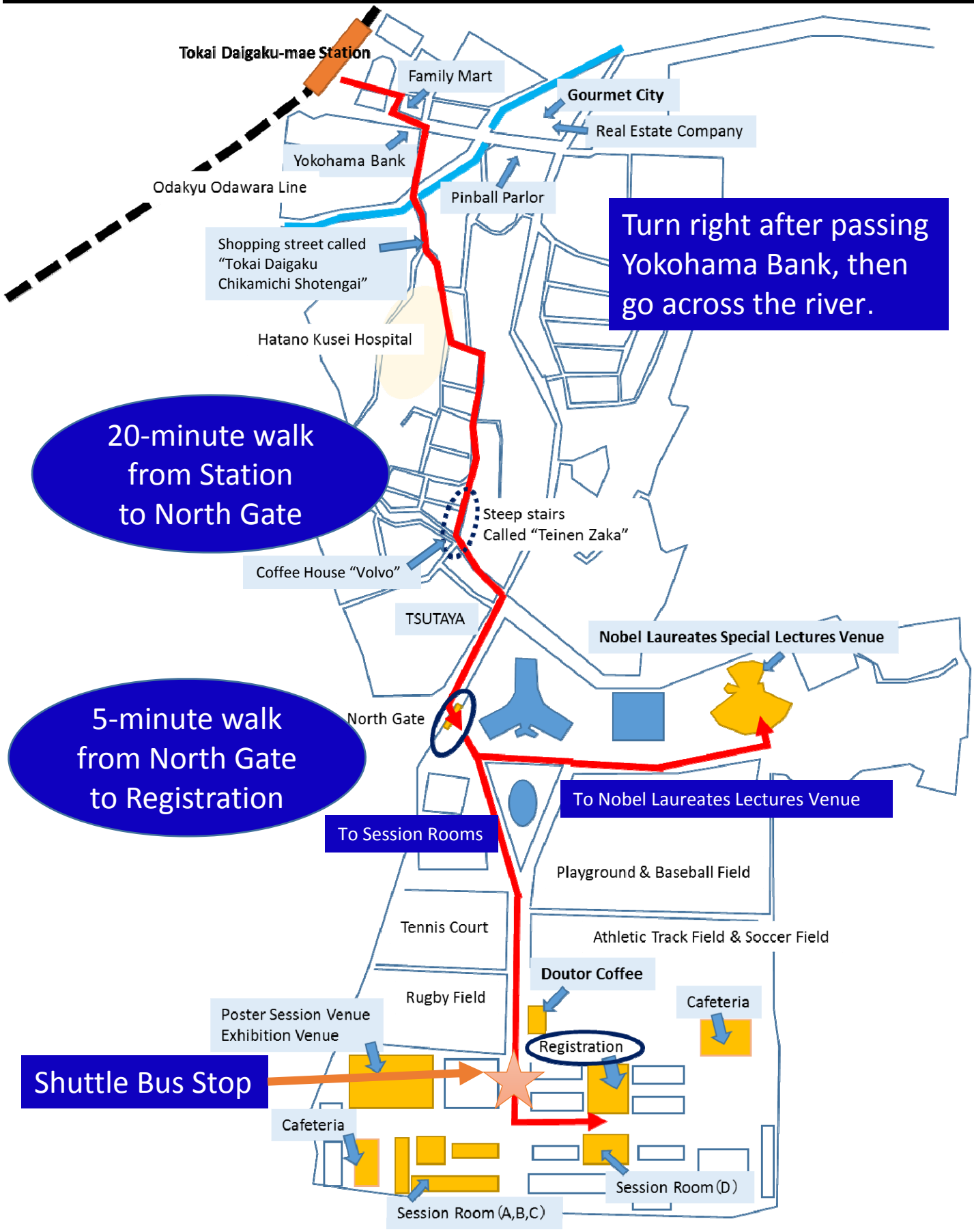
Tokai Daigakumae Station（South Exit）



Shonan Campus, Tokai University



Map

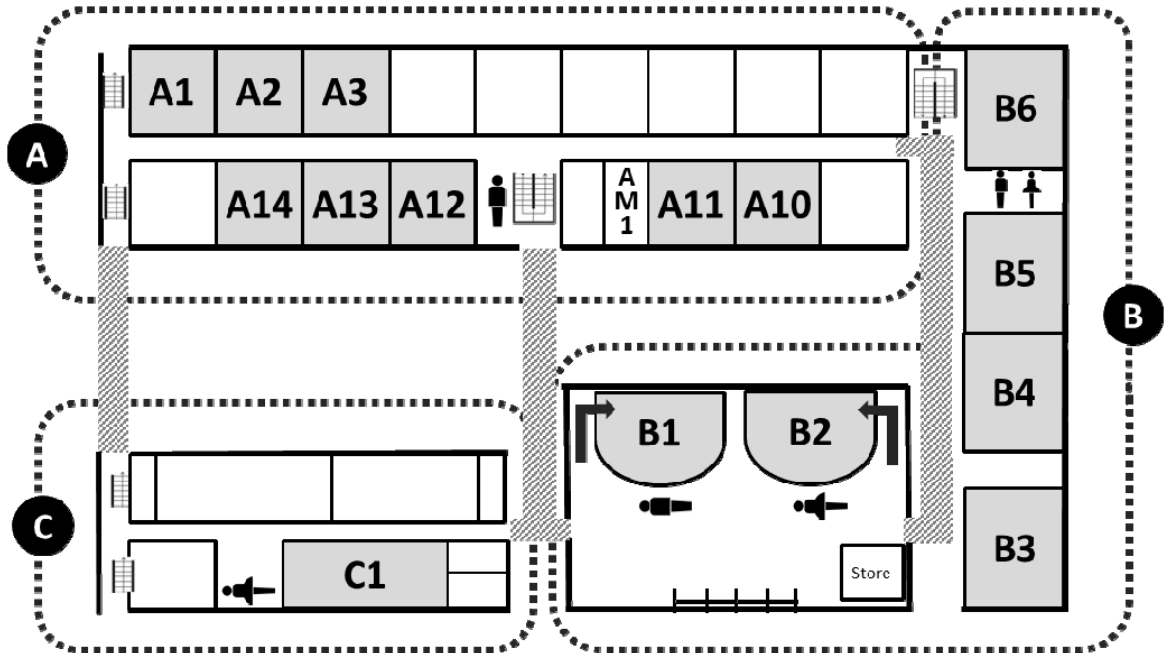

Tokai Daigaku-mae Station
Family Mart
Gourmet City
Real Estate Company
Yokohama Bank
Odakyu Odawara Line
Pinball Parlor
Turn right after passing Yokohama Bank, then go across the river.
Shopping street called "Tokai Daigaku Chikamichi Shotengai"
Hatano Kusei Hospital
20-minute walk from Station to North Gate
Steep stairs Called "Teinen Zaka"
Coffee House "Volvo"
TSUTAYA
Nobel Laureates Special Lectures Venue
5-minute walk from North Gate to Registration
North Gate
To Nobel Laureates Lectures Venue
To Session Rooms
Playground & Baseball Field
Tennis Court
Athletic Track Field & Soccer Field
Doutor Coffee
Cafeteria
Rugby Field
Poster Session Venue
Exhibition Venue
Registration
Shuttle Bus Stop
Cafeteria
Session Room (D)
Session Room (A,B,C)

Floor Plan

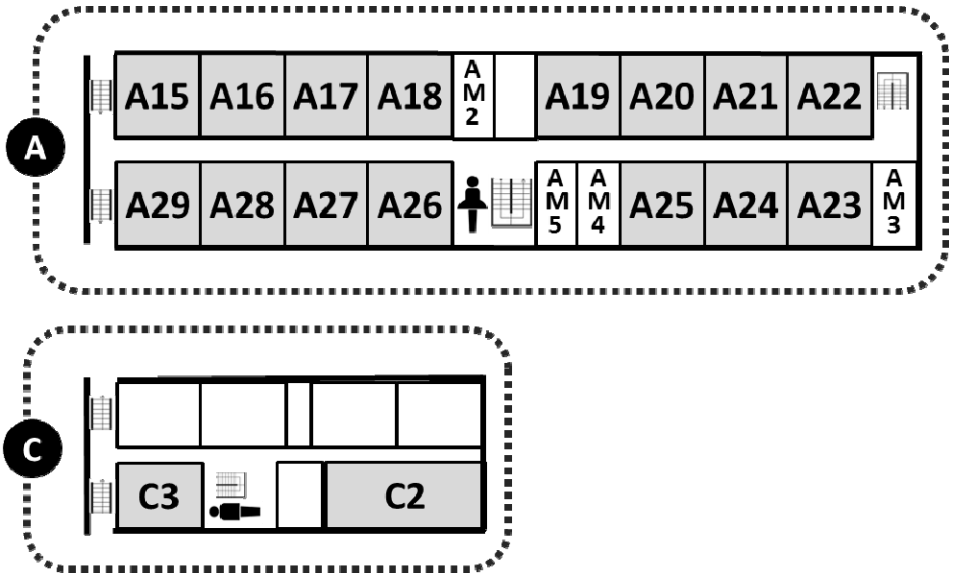
6 号館

1F

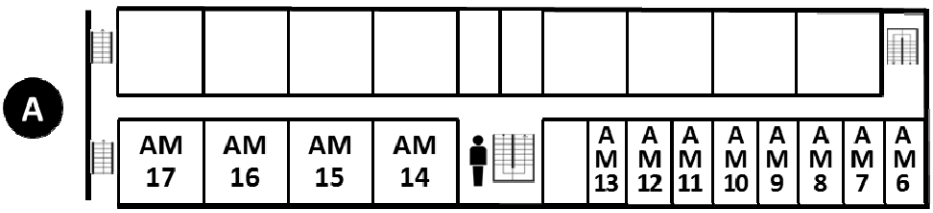
roofed corridor



2F

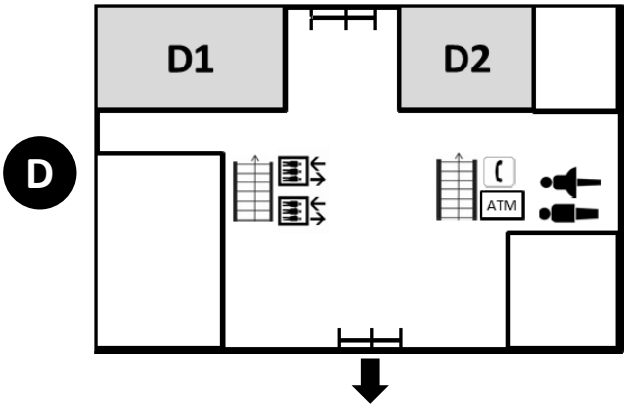


3F

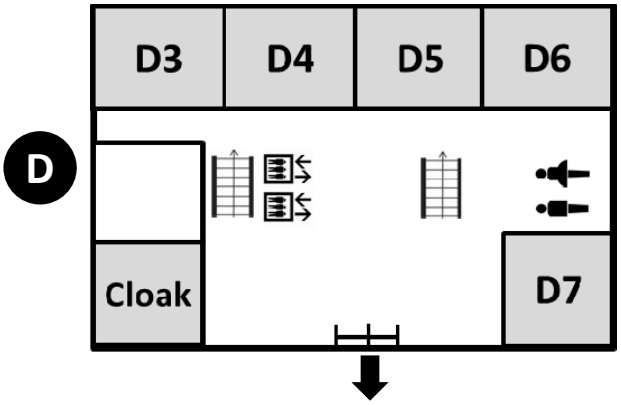


Floor Plan

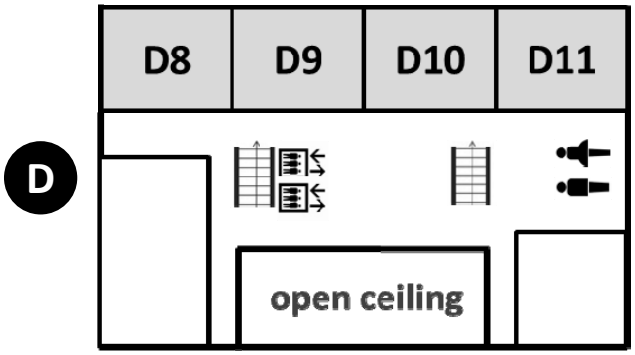
1F



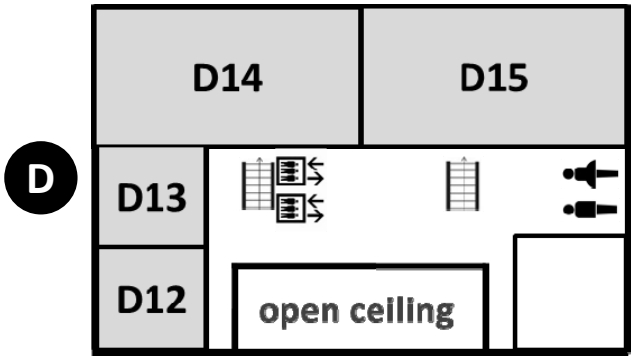
2F 16号館



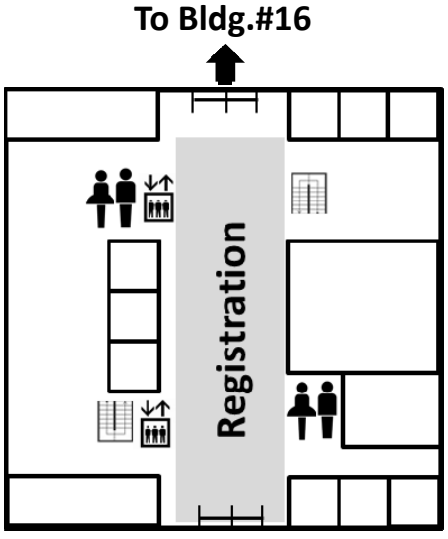
3F



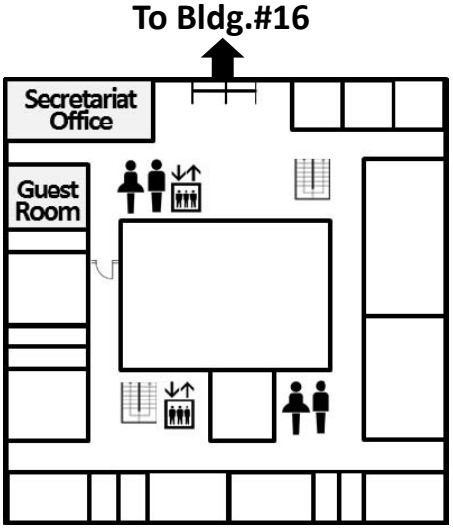
5F



1F



2F 17号館



General Information

Registration

Location: 1F Lobby, Bldg. 17
Hours: March 11 (Wed.)-13 (Fri.); 8:00 am-5:30 pm
March 14 (Sat.); 8:00 am- 1:00 pm

Registration Fee

Category	Advanced	Onsite
JSAP Regular Member/ JSAP Sub Member	8,000 JPY	12,000 JPY
Student (Member/Non-member)	3,000 JPY	5,000 JPY
JSAP Senior Member*	4,000 JPY	7 ,000 JPY
JSAP's Partner Society **Member	8,000 JPY	12,000 JPY
Non-member	15,000 JPY	20,000 JPY

*JSAP members of over 60 years age without a regular job. Need application to become Senior Member.
**JSAP's Partner Societies : APS(American Physical Society), EOS (European Optical Society), EPS(European Physical Society), IOP(Institute of Physics), KPS(Korean Physical Society), OSA(Optical Society of America), OSK(Optical Society of Korea), PESJ (Physics Education Society of Japan), PSROC(The Physical Society of Republic of China), SFP(Société Française de Physique), SPIE (International Society for Optical Engineering), TPS(Taiwan Photonics Society)

Wireless Internet Service

Wireless internet service is available for free. No PC is available at the site. Please bring your own laptops.

Location: Poster Session Venue <Gymnasium>
Hours: March 11 (Wed.)-13 (Fri.); 10:00 am-6:00 pm
March 14 (Sat.); 10:00 am- 12:00 pm

Cloak Room Service

Location: Room 16-201, 2F, Bldg. D
Hours: March 11 (Wed.); 8:00 am-7:00 pm
March 12 (Thu.)-13 (Fri.); 8:00 am-7:30 pm
March 14 (Sat.); 8:00 am- 4:00 pm
Fee: 300 JPY per luggage

Notes: Please keep the valuables with you. We may not able to accept your luggage due to the limited space of the room.

Lost and Found

To check whether a lost item has been turned in, please come to the Secretariat Office (2F, Bldg. 17).
After the conference, please contact at the JSAP Secretariat (meeting@jsap.or.jp)

Print-out Service

Conference abstracts included in the abstract DVD-ROM can be printed out at Poster Session Venue. Please note that you cannot print out your personal documents.

No photo taking is allowed during the session.

All participants must wear their meeting badges at all times.

Presentation Guidelines

Oral Presentations

1. Presentation Time

Oral presentations are assigned 15 minutes. (presentation for 10 minutes, Q&A for 5 minutes).
Staff will inform you of the time with a bell.

1st Bell：10 min. (including 5 min. for Q&A remaining)
2nd Bell：5 min. remaining (end of your talk)
3rd Bell： End of your presentation time

2. Presentation Method

Oral presentations will given using a PC projector. JSAP will prepare a laptop PC and a LCD projector at each session room.
Please bring your presentation files (ppt) in USB devices or CD-ROMs.
(Software specifications)
- OS: Windows 7 Pro.
- **Microsoft Power Point 2013**
- Windows Media Player Ver. 10 *Other video players are not installed on the PC.

(Presentation file)
- Please use the standard fonts of Windows 7.
- Presentation files should be named as follows; your program number_your family name.
  Ex.) 11p-A2-5_Smith.ppt

(Preparation at the session room)
- Please copy your presentation file to the desktop in the presence of our staff member during the break before the session starts.

<u>For those who bring their own PC</u>
- Please turn on your computer prior to your presentation and make sure that you can quickly project the screen when your turn comes.
- Time to set up the equipment is included in your presentation time. Please prepare will in advance for the smooth flow of the session.
- We will prepare the connector as shown right. If your laptop does not have this connection, please bring the converter by yourself.



Poster Presentation

1. Preparation

JSAP will prepare display panels (180cm(H)×90cm(W) with each program number posted on. Pushpins will be available at each panel. Do not use glue or tape.

2. Hours

	AM	PM1	PM2
Preparation	9:10～9:30	13:10～13:30	15:40～16:00
Session	9:30～11:30	13:30～15:30	16:00～18:00
Poster Removal	11:30～11:40	15:30～15:40	18:00～18:10

***PM2 session on March 13 is scheduled from 16:30 to 18:30.**
***Core time: First half for those with an odd program number. Latter half for those with an even program number.**

Short Oral Presentation

Presenters have 2 minutes to present the summary of their study before their poster presentations.
There will be no discussion time allotted. Speakers must end their presentation immediately after the attention bell.

Welcome Reception

Enjoy the cold beer and great food while networking with your colleagues and other meeting participants!



Date: 7:00 pm- March 11 (Wed.), 2015
Venue: Cafeteria "Com Square", Shonan Campus, Tokai University
（Kitakaname 4-1-1, Hiratsuka, Kanagawa, 259-1292）
Fee: Non-student 3,000 JPY (tax included) Student 1,000 JPY (tax included)

How to Participate

1. Please register on the page below.
2. Online payment is not available. Please pay the fee at the "Welcome Reception" desk at the Registration by 5:00pm, March 11 (Wed.). We only accept cash.

**Onsite registration is available only if there are still seats left after the deadline.

Register at: http://meeting.jsap.or.jp/eng/socialgathering.html

Registration Deadline： March 1 (Sun.), 2015

Special Events

Awards Presentations

Date: March 11 (Wed.)
Location: Room E1 (Matsumae Memorial Hall 1F)

11:00 am - 12:00 pm	The 37th Young Scientist Presentation Award
3：15 pm - 3：45 pm	JSAP Outstanding Achievement Award
4：00 pm - 5：15 pm	JSAP Research Achievement Award
5:30 pm – 6:30 pm	JSAP Honorary Members

Nobel Laureates Special Lectures

Date: March 13 (Fri.) 2:00 pm -4:00 pm
Location: Room 2S-101 (Main Hall, Bldg. #2)
Fee: Free

***The lectures will be given in Japanese and no translation will be provided.**

President's Reception for Overseas Researchers

Researchers from overseas attending the meeting are invited to join the directors of the JSAP to share and exchange ideas about the activities of the JSAP.

Date: March 13 (Fri.) 6:00 pm – 8:00 pm
Location: Cafeteria "Log House", Shonan Campus, Tokai University
Fee: Free (No reservation is required.)

Nursery Services

JSAP offers free nursery services with qualified staff for the participants with children.

Hours: March 11 (Wed.) -13 (Fri.) 8:30 am – 7:30 pm
March 14 (Sat.) 8:30 am- 4:00 pm

<u>Advanced reservation is required.</u>

Apply at: http://meeting.jsap.or.jp/eng/nursery

Application Deadline： March 2 (Mon.), 2015

Schedule by Category I

Category	March 11 (Wed.)		March 12 (Thu.)		March 13 (Fri.)		March 14 (Sat.)	
Section	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM
1 Interdisciplinary Physics and Related Areas of Science and Technology								
1.1 Interdisciplinary and General Physics				P1 13:30 - 15:30		D12 16:30 - 19:00		
1.2 Education						P1 16:30 - 18:30		
1.3 Novel technologies and interdisciplinary engineering		D13 13:15 - 17:00		P2 13:30 - 15:30				
1.4 Energy conversion and storage	P1 9:30 - 11:30		D12 9:00 - 12:45					
1.5 Resources and environment	D12 10:00 - 11:30			P3 13:30 - 15:30				
1.6 Instrumentation, measurement and Metrology					P1 9:30 - 11:30		D12 9:00 - 11:15	D12 13:00 - 14:15
1.7 Ultrasonic	P2 9:30 - 11:30	D12 13:15 - 17:15						
2 Ionizing Radiation								
2.1 Radiation physics and Detector fundamentals			P1 9:30 - 11:30		A19 9:00 - 12:15	A19 14:00 - 16:00		
2.2 Detection systems		A19 16:15 - 18:00	P2 9:30 - 11:30			A19 16:15 - 19:00	A19 9:00 - 12:15	
2.3 Application, radiation generators, new technology	A19 9:00 - 11:45	A19 14:00 - 16:00	P3 9:30 - 11:30					
3 Optics and Photonics # Code-sharing session 3.5 and 3.14, 3.11 and 13.7 (See also "Code-sharing session")								
3.0 Optics and Photonics English Session					A15 9:00 - 11:15			
3.1 Basic optics and frontier of optics					P2 9:30 - 11:30		A12 9:00 - 12:00	A12 13:00 - 14:15
3.2 Equipment optics and materials				A13 14:00 - 17:15	P3 9:30 - 11:30			
3.3 Information photonics and image engineering					P4 9:30 - 11:30	A11 16:30 - 17:30	A11 9:00 - 12:15	A11 13:15 - 14:30
3.4 Biomedical optics			P4 9:30 - 11:30				A10 9:30 - 11:45	A10 13:00 - 14:30
3.5 Laser system and materials			P5 9:30 - 11:30			A13 16:30 - 18:45	A13 9:30 - 12:00	
3.6 Ultrashort-pulse and high-intensity lasers			A15 9:45 - 12:30	A15 14:00 - 17:45	P5 9:30 - 11:30	A15 16:30 - 19:00	A15 9:15 - 12:00	A15 13:00 - 15:00
3.7 Laser processing	A11 9:30 - 12:30	A11 14:00 - 18:00	A11 9:30 - 11:30		A11 9:30 - 12:30	P2 16:30 - 18:30		
3.8 Optical measurement, instrumentation, and sensor	A14 9:00 - 12:30	A14 14:00 - 18:00			P6 9:30 - 11:30		A14 9:00 - 11:30	A14 13:00 - 15:00
3.9 Terahertz technologies		P1 16:00 - 18:00	A14 9:15 - 12:15	A14 13:30 - 17:00	A14 9:00 - 12:15	A14 16:15 - 19:00		
3.10 Optical quantum physics and technologies	A17 9:15 - 12:00	A17 14:00 - 16:45	P6 9:30 - 11:30					
3.11 Photonic structures and phenomena	P3 9:30 - 11:30			A10 14:00 - 18:45	A10 9:00 - 12:15	A10 16:30 - 18:45		
3.12 Nanoscale optical science and near-field optics	A12 9:00 - 12:30	A12 14:00 - 18:00	A12 9:00 - 12:15		A12 9:00 - 12:30	P3 16:30 - 18:30		
3.13 Semiconductor optical devices			A17 9:00 - 13:00	A17 14:00 - 19:00		P4 16:30 - 18:30		
3.14 Optical control devices and optical fibers	A13 9:15 - 12:30	A13 14:00 - 16:45	A13 9:00 - 11:45		P7 9:30 - 11:30			
3.15 Silicon photonics		A16 14:00 - 17:00	A16 9:30 - 12:30	A16 14:00 - 17:30	P8 9:30 - 11:30			
6 Thin Films and Surfaces # Code-sharing session 6.6 and 12.2 (See also "Code-sharing session")								
6.1 Ferroelectric thin films		P3 16:00 - 18:00			A21 9:00 - 12:30	A21 16:15 - 18:30	A21 9:00 - 12:00	
6.2 Carbon-based thin films	P4 9:30 - 11:30	C1 13:15 - 18:00	C1 9:00 - 11:45	C1 13:15 - 19:00				
6.3 Oxide electronics	D10 9:00 - 11:45	D10 13:15 - 17:45	D10 9:00 - 11:45		D10 9:00 - 11:45	P5 16:30 - 18:30 D10 16:30 - 19:00	D10 9:30 - 11:45	D10 13:00 - 14:45
6.4 Thin films and New materials	D8 9:00 - 11:45		D8 9:00 - 11:45	D8 13:15 - 18:30		P6 16:30 - 18:30		
6.5 Surface Physics, Vacuum	D9 9:00 - 12:00			D13 13:15 - 17:00		P7 16:30 - 18:30		
6.6 Probe Microscopy			D9 10:00 - 11:45	P4 13:30 - 15:30		D9 16:30 - 19:30	D9 9:00 - 12:00	D9 13:00 - 15:00

How to Read a Table

March 11 (Wed.)		March 12 (Thu.)		March 13 (Fri.)		March 14 (Sat.)	
AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM
P3 9:30 - 11:30			A10 14:00 - 18:45	B1 9:00 - 12:15	B2 16:30 - 18:45	D9 9:00 - 12:00	D9 13:00 - 15:00
Poster presentation			Session Room	Session Time			

Schedule by Category II

Category	March 11 (Wed.)		March 12 (Thu.)		March 13 (Fri.)		March 14 (Sat.)	
Section	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM
7 Beam Technology and Nanofabrication								
7.1 X-ray technologies	P5 9:30 - 11:30	A26 13:15 - 17:30						
7.2 Applications and technologies of electron beams			P7 9:30 - 11:30	A11 13:30 - 19:00				
7.3 Micro/Nano patterning and fabrication	B2 9:00 - 11:45	B2 13:15 - 16:30	P8 9:30 - 11:30					
7.4 Buried interface sciences with quantum beam						P8 16:30 - 18:30	A16 9:00 - 12:00	
7.5 Atomic/molecular beams and beam-related new technologies					A16 10:30 - 12:00	P9 16:30 - 18:30		
7.6 Ion beams						P10 16:30 - 18:30	C1 9:00 - 12:00	C1 13:00 - 15:00
8 Plasma Electronics								
8.0 Plasma Electronics English Session			D14 9:00 - 10:45		P9 9:30 - 11:30			
8.1 Plasma production and control				P9 16:00 - 18:00		A28 16:30 - 19:00	A28 9:00 - 11:45	
8.2 Plasma measurements and diagnostics		A27 14:00 - 18:00			P10 9:30 - 11:30			
8.3 Plasma deposition of thin film and surface treatment				P10 16:00 - 18:00	A27 9:00 - 12:30			
8.4 Plasma etching					P11 9:30 - 11:30		A27 9:00 - 13:00	
8.5 8.5 Plasma nanotechnology					P12 9:30 - 11:30	A27 16:30 - 18:45		
8.6 Plasma life sciences				P11 16:00 - 18:00	A28 9:00 - 12:15			
8.7 Plasma phenomena, emerging area of plasmas and their new applications		A28 14:00 - 18:00				P11 16:30 - 18:30		
8.8 Plasma Electronics Invited Lecture			D14 11:00 - 11:30					
Plasma Electronics Award Ceremony			D14 11:30 - 11:45					
9 Applied Materials Science								
9.1 Dielectrics, ferroelectrics		P4 16:00 - 18:00	B5 9:00 - 12:30					
9.2 Nanowires and Nanoparticles			A20 9:30 - 12:15	A20 14:00 - 18:30		P12 16:30 - 18:30		
9.3 Nanoelectronics						P13 16:30 - 18:30	A20 9:00 - 11:45	A20 13:00 - 14:45
9.4 Thermoelectric conversion			A22 9:00 - 12:30	A22 14:00 - 18:00	A22 9:00 - 12:30	P14 16:30 - 18:30		
9.5 New functional materials and new phenomena	A20 10:00 - 11:45	A20 14:00 - 16:30		P5 13:30 - 15:30				
10 Spintronics and Magnetics								
10.1 Emerging materials in spintronics and magnetics (excluding semiconductors)		D11 15:45 - 18:30	D11 9:00 - 11:45					
		P5 13:30 - 15:30						
10.2 Spin torque, spin current, circuits, and measurement technologies				D11 13:15 - 18:30				
10.3 Giant magnetoresistance (GMR), tunnel magnetoresistance (TMR) and magnetic recording technologies						D11 16:15 - 18:15		D11 13:00 - 15:00
10.4 Semiconductors, organic, optical, and quantum spintronics							D2 9:00 - 12:00	D2 13:00 - 15:00
10.5 Application of magnetic field							D11 9:00 - 12:00	
11 Superconductivity								
11.1 Fundamental properties		A2 14:00 - 16:45	P9 9:30 - 11:30	A2 13:30 - 18:00				
11.2 Thin and thick superconducting films, coated conductors and film crystal growth				A1 14:00 - 17:30		A1 12:00 - 19:00		
11.3 Critical Current, Superconducting Power Applications		A1 14:00 - 18:00						
11.4 Analog applications and their related technologies				A3 14:00 - 17:00			A3 9:00 - 12:00	
11.5 Junction and circuit fabrication processs, digital applications						A2 16:15 - 17:30	A2 9:00 - 12:00	

Schedule by Category III

Category	March 11 (Wed.)		March 12 (Thu.)		March 13 (Fri.)		March 14 (Sat.)	
Section	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM
12 Organic Molecules and Bioelectronics # Code-sharing session 6.6 and 12.2 (See also "Code-sharing session")								
12.1 Fabrications and Structure Controls	D2 9:00 - 12:00	D2 13:15 - 18:00	D2 9:00 - 11:30		P13 9:30 - 11:30			
12.2 Characterization and Materials Physics				P6 13:30 - 15:30		D14 16:30 - 19:00	D14 9:00 - 12:00	D14 13:00 - 15:00
12.3 Functional Materials and Novel Devices	D4 9:00 - 11:45	D4 13:15 - 17:45	D4 9:00 - 11:30	D4 13:15 - 17:45	D4 9:00 - 11:00	P15 16:30 - 18:30		
12.4 Organic light-emitting devices and organic transistors	D3 9:30 - 11:45	D3 13:15 - 18:00	D3 9:00 - 11:45	P12 16:00 - 18:00	D3 9:00 - 11:45		D3 9:15 - 12:00	D3 13:00 - 15:00
12.5 Organic solar cells	D15 9:00 - 11:45	D15 13:15 - 18:00	D15 9:00 - 11:30	P7 13:30 - 15:30	D15 9:00 - 12:00	D15 16:30 - 19:00	D15 9:00 - 12:00	D15 13:00 - 15:00
12.6 Nanobiotechnology	D5 9:30 - 11:45	D5 13:15 - 18:00	P10 9:30 - 11:30		D5 9:30 - 11:45	D5 16:30 - 19:00		
12.7 Biomedical Engineering and Biochips	D6 9:00 - 11:45	D6 13:15 - 18:00	P11 9:30 - 11:30		D6 9:00 - 11:45	D6 16:15 - 19:15	D6 9:00 - 12:00	
13 Semiconductors # Code-sharing session 3.11 and 13.7, 13.10 and 15.2 (See also "Code-sharing session")								
13.1 Fundamental properties, surface and interface, and simulations of Si related materials	A27 9:00 - 12:30		A27 10:00 - 12:30	A27 14:00 - 18:00		P16 16:30 - 18:30		
13.2 Exploratory Materials, Physical Properties, Devices				P8 13:30 - 15:30	A25 9:00 - 12:30	A25 16:15 - 19:15	A25 9:00 - 12:00	A25 13:00 - 14:00
13.3 Insulator technology			P12 9:30 - 11:30		A24 9:00 - 12:30		A24 9:00 - 12:15	
13.4 Si wafer processing /MEMS/Integration technology	A29 9:00 - 12:30	A29 14:00 - 17:30	A29 9:00 - 12:00		P14 9:30 - 11:30		A29 9:00 - 12:00	A29 13:00 - 15:00
13.5 Semiconductor devices and related techologies	A23 9:00 - 12:15	A23 14:00 - 17:30	P13 9:30 - 11:30	A23 14:00 - 17:30	A23 9:00 - 12:30	A23 16:15 - 19:00		
13.6 Semiconductor English Session			A23 9:00 - 12:15					
13.7 Quantum properties and fabrications of nanoscale structures and devices	A10 9:15 - 12:30			A24 14:00 - 15:45 P13 16:00 - 18:00				
13.8 Compound and power electron devices and process technology	A21 9:00 - 12:00	A21 14:00 - 17:15	A21 9:00 - 12:30	A21 14:00 - 17:30		P17 16:30 - 18:30		
13.9 Optical properties and light-emitting devices	A25 9:30 - 12:15	A25 13:30 - 17:30	A25 9:00 - 12:30	A25 14:00 - 17:00		P18 16:30 - 18:30		
13.10 Compound solar cells			A26 10:00 - 12:00		A26 9:30 - 12:15		A26 9:30 - 12:00	
15 Crystal Engineering # Code-sharing session 13.10 and 15.2 (See also "Code-sharing session")								
15.1 Bulk crystal growth			D13 9:30 - 11:45	P14 16:00 - 18:00			D13 10:00 - 12:00	
15.2 II-VI and related compounds				P15 16:00 - 18:00		A17 16:15 - 19:15		
15.3 III-V-group epitaxial crystals					P15 9:30 - 11:30	D4 16:15 - 19:00	D4 9:00 - 11:30	D4 13:00 - 14:15
15.4 III-V-group nitride crystals	B1 8:30 - 11:45	B1 13:15 - 18:45	B1 8:30 - 11:45	B1 13:15 - 19:45 P16 16:00 - 18:00	B1 8:30 - 13:00	B1 16:15 - 18:00		
15.5 Group IV crystals and alloys	D7 9:00 - 12:00	D7 13:30 - 17:15	D5 10:00 - 12:00	P17 16:00 - 18:00				
15.6 Group IV Compound Semiconductors		P2 13:30 - 15:30	B4 9:00 - 11:45		B4 9:00 - 11:45	B4 16:15 - 18:30	B4 9:00 - 12:30	
15.7 Fundamentals of epitaxy					P16 9:30 - 11:30			D4 14:15 - 15:00
15.8 Crystal evaluation, impurities and crystal defects				A18 14:00 - 19:00	P17 9:30 - 11:30			
16 Amorphous and Microcrystalline Materials								
16.1 Fundamental properties and their evaluation in disordered materials		P6 16:00 - 18:00	A28 9:15 - 12:30	A28 14:00 - 17:15				
16.3 Bulk, thin-film and other silicon-based solar cells	C2 9:00 - 12:30	C2 14:00 - 15:45 P6 16:00 - 18:00	A18 9:00 - 12:30	C2 13:45 - 19:00	C2 9:00 - 11:00			
17 Nanocarbon Technology								
17.1 Growth technology	P6 9:30 - 11:30		D6 10:15 - 11:45	D7 13:15 - 19:00				D7 14:30 - 15:15
17.2 Structure control and process			D7 9:00 - 11:45 D6 9:15 - 10:15			D8 18:30 - 19:00		
17.3 Exploration of new functions and evaluation of basic properties		D8 16:45 - 18:00			D8 9:00 - 11:45 D7 9:30 - 11:45	D8 16:15 - 18:30		
17.4 Device applications				D6 13:15 - 16:45			D7 9:00 - 12:00	D7 13:00 - 14:30
Joint Session K								
Joint Session K	D1 9:30 - 11:45	D1 13:15 - 17:45	D1 9:00 - 12:15		P18 9:30 - 11:30	D1 16:15 - 19:15	D1 9:00 - 11:30	

Schedule by Category IV

Category	March 11 (Wed.)		March 12 (Thu.)		March 13 (Fri.)		March 14 (Sat.)	
Section	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM
Special symposium								
Women in Applied Physics - Part Ⅲ: Bioelectronics -					B3 9:00 - 12:00			
PHONON ENGINEERING: material science, theory/simulation and measurement technologies for Nano-scale thermal management and device innovation							B2 8:45 - 15:00	
Science Square in Shonan Campus of Tokai University Part 1 symposium							F1 9:00 - 10:50	
Science Square in Shonan Campus of Tokai University Part 2 Science Square and Science Shows							E1 11:00 - 15:00	
Smart Energy Revolution form KANAGAWA				E1 13:00 - 16:45				
Kickoff Symposium for Group of Research and Joint-Effort on Industry-Academia Partnership				B2 13:30 - 17:30				
Symposium								
Quantum Photonics: Toward a new paradigm of quantum information technology		B4 13:30 - 17:15						
Fabrication and characterization of nano-structures prepared with advanced shadowing deposition systems		D9 13:15 - 17:00						
Advanced CMOS Technology and Its Future Scope		B5 13:15 - 17:30						
Ionizing radiation optics				A19 14:00 - 17:15				
Advanced and Practical 3D Fabrication Techniques Using Lasers				B6 13:30 - 18:00				
Polarity-reversed optical device handling quantum photons				D2 13:15 - 17:00				
Theory and Practice of Nanoelectron-photon Interaction via Dissipation and Fluctuations				A12 14:00 - 17:45				
Optical sensing utilized in space and earth observations				B3 13:30 - 16:15				
Guidelines for Development of Ferroelectric Materials in the Following Generation				B5 13:30 - 17:30				
New functionality of oxides generated by spin-orbit interaction				D10 13:15 - 18:30				
Recent development of titanium dioxide				D9 13:15 - 17:30				
The latest trend of the lithography technology				C3 13:15 - 15:30				
Synthesizing methods for fine particles and their latest applications				D14 13:30 - 18:45				
Visualization and application of biointerfaces				D5 13:15 - 17:15				
How should we behave as future scientists? - Innovative value creation of integration technology by young generations -				A29 13:00 - 17:00				
Sensing Technologies for the Future of Automobile Society~The Prospect and Challenge of Autonomous Driving System~				D15 14:00 - 17:15				
Valence-electron metamorphology in oxide semiconductors				D1 13:15 - 18:30				
Progress of power semiconductors, toward wide bandgap materials beyond silicon				B4 13:15 - 18:15				
Research forefront of shock wave and high & micro-gravity application science					D13 9:00 - 13:00			
A vision of future spintronics ~What is the next in spintronics?					B6 9:00 - 12:30			
Memorial Symposium for Prof. K. Kitazawa and Prof. H. Maeda					B2 9:00 - 11:45	B2 16:15 - 18:45		
Growth and characterization of bulk crystalline silicon for photovoltaic application						C2 13:15 - 18:15		
Materials science of singularity in nitride semiconductors-Growth, processing and electronic application-							B1 8:30 - 11:45	B1 12:45 - 15:00
State of the art technology in electron and focused-ion-beam apparatuses		B3 13:15 - 17:15						
Feasibility of integration of perovskite semiconductors into multinary compounds solar cells	B6 9:00 - 11:45	B6 13:15 - 17:00						
Code-sharing session								
3.5 Laser system and materials and 3.14 Optical control devices and optical fibers					A13 9:00 - 11:15			
3.11 Photonic structures and 13.7 Quantum properties and fabrications of nanoscale structures and devices			A10 9:00 - 12:30					
6.6 Probe Microscopy and 12.2 Characterization and Materials Physics					D14 9:00 - 12:00			
13.10 Compound solar cells and 15.2 II-VI and related compounds				A26 13:30 - 17:45	A17 9:00 - 12:15	P19 16:30 - 18:30		

Schedule by Room 1

Room		Cap.	March 11 (Wed.)		March 12 (Thu.)		March 13 (Fri.)		March 14 (Sat.)	
			AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM
A	**A1** 6A-105	114		11.3 Critical Current, Superconducting Power Applications		11.2 Thin and thick superconducting films, coated conductors and film crystal growth		11.2 Thin and thick superconducting films, coated conductors and film crystal growth		
	A2 6A-106	114		11.1 Fundamental properties		11.1 Fundamental properties		11.5 Junction and circuit fabrication procresss, digital applications	11.5 Junction and circuit fabrication procresss, digital applications	
	A3 6A-107	114				11.4 Analog applications and their related technologies			11.4 Analog applications and their related technologies	
	A10 6A-115	105	13.7 Quantum properties and fabrications of nanoscale structures and devices		3.11/13.7 codesharing session	3.11 Photonic structures and phenomena	3.11 Photonic structures and phenomena	3.11 Photonic structures and phenomena	3.4 Biomedical optics	3.4 Biomedical optics
	A11 6A-116	105	3.7 Laser processing	3.7 Laser processing	3.7 Laser processing	7.2 Applications and technologies of electron beams	3.7 Laser processing	3.3 Information photonics and image engineering	3.3 Information photonics and image engineering	3.3 Information photonics and image engineering
	A12 6A-101	105	3.12 Nanoscale optical science and near-field optics	3.12 Nanoscale optical science and near-field optics	3.12 Nanoscale optical science and near-field optics	Theory and Practice of Nanoelectron-photon Interaction via Dissipation and Fluctuations	3.12 Nanoscale optical science and near-field optics		3.1 Basic optics and frontier of optics	3.1 Basic optics and frontier of optics
	A13 6A-102	105	3.14 Optical control devices and optical fibers	3.14 Optical control devices and optical fibers	3.14 Optical control devices and optical fibers	3.2 Equipment optics and materials	3.5/3.14 codesharing session	3.5 Laser system and materials	3.5 Laser system and materials	
	A14 6A-103	105	3.8 Optical measurement, instrumentation, and sensor	3.8 Optical measurement, instrumentation, and sensor	3.9 Terahertz technologies	3.9 Terahertz technologies	3.9 Terahertz technologies	3.9 Terahertz technologies	3.8 Optical measurement, instrumentation, and sensor	3.8 Optical measurement, instrumentation, and sensor
	A15 6A-205	114			3.6 Ultrashort-pulse and high-intensity lasers	3.6 Ultrashort-pulse and high-intensity lasers	3.0 Optics and Photonics English Session	3.6 Ultrashort-pulse and high-intensity lasers	3.6 Ultrashort-pulse and high-intensity lasers	3.6 Ultrashort-pulse and high-intensity lasers
	A16 6A-206	114		3.15 Silicon photonics	3.15 Silicon photonics	3.15 Silicon photonics	7.5 Atomic/molecular beams and beam-related new technologies		7.4 Buried interface sciences with quantum beams	
	A17 6A-207	114	3.10 Optical quantum physics and technologies	3.10 Optical quantum physics and technologies	3.13 Semiconductor optical devices	3.13 Semiconductor optical devices	13.10/15.2 codesharing session	15.2 II-VI and related compounds		
	A18 6A-208	114			16.3 Bulk, thin-film and other silicon-based solar cells	15.8 Crystal evaluation, impurities and crystal defects				
	A19 6A-211	114	2.3 Application, radiation generators, new technology	2.3 Application, radiation generators, new technology 2.2 Detection systems		Ionizing radiation optics	2.1 Radiation physics and Detector fundamentals	2.1 Radiation physics and Detector fundamentals 2.2 Detection systems	2.2 Detection systems	
	A20 6A-212	114	9.5 New functional materials and new phenomena	9.5 New functional materials and new phenomena	9.2 Nanowires and Nanoparticles	9.2 Nanowires and Nanoparticles			9.3 Nanoelectronics	9.3 Nanoelectronics
	A21 6A-213	114	13.8 Compound and power electron devices and process technology	13.8 Compound and power electron devices and process technology	13.8 Compound and power electron devices and process technology	13.8 Compound and power electron devices and process technology	6.1 Ferroelectric thin films	6.1 Ferroelectric thin films	6.1 Ferroelectric thin films	
	A22 6A-214	114			9.4 Thermoelectric conversion	9.4 Thermoelectric conversion	9.4 Thermoelectric conversion			
	A23 6A-216	105	13.5 Semiconductor devices and related techologies	13.5 Semiconductor devices and related techologies	13.6 Semiconductor English Session	13.5 Semiconductor devices and related techologies	13.5 Semiconductor devices and related techologies	13.5 Semiconductor devices and related techologies		
	A24 6A-217	105				13.7 Quantum properties and fabrications of nanoscale structures and devices	13.3 Insulator technology		13.3 Insulator technology	
	A25 6A-218	105	13.9 Optical properties and light-emitting devices	13.9 Optical properties and light-emitting devices	13.9 Optical properties and light-emitting devices	13.9 Optical properties and light-emitting devices	13.2 Exploratory Materials, Physical Properties, Devices	13.2 Exploratory Materials, Physical Properties, Devices	13.2 Exploratory Materials, Physical Properties, Devices	13.2 Exploratory Materials, Physical Properties, Devices
	A26 6A-201	105		7.1 X-ray technologies	13.10 Compound solar cells	13.10 Compound solar cells, 15.2 II-VI and related compounds	13.10 Compound solar cells		13.10 Compound solar cells	
	A27 6A-202	105	13.1 Fundamental properties, surface and interface, and simulations of Si related materials	8.2 Plasma measurements and diagnostics	13.1 Fundamental properties, surface and interface, and simulations of Si related materials	13.1 Fundamental properties, surface and interface, and simulations of Si related materials	8.3 Plasma deposition of thin film and surface treatment	8.5 Plasma nanotechnology	8.4 Plasma etching	
	A28 6A-203	105		8.7 Plasma phenomena, emerging area of plasmas and their new applications	16.1 Fundamental properties and their evaluation in disordered materials	16.1 Fundamental properties and their evaluation in disordered materials	8.6 Plasma life sciences	8.1 Plasma production and control	8.1 Plasma production and control	

Schedule by Room 2

Room		Cap.	March 11 (Wed.)		March 12 (Thu.)		March 13 (Fri.)		March 14 (Sat.)	
			AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM
A	**A29** 6A-204	105	13.4 Si wafer processing /MEMS/ Integration technology	13.4 Si wafer processing /MEMS/ Integration technology	13.4 Si wafer processing /MEMS/ Integration technology	How should we behave as future scientists? - Innovative value creation of integration technology by young generations -			13.4 Si wafer processing /MEMS/ Integration technology	13.4 Si wafer processing /MEMS/ Integration technology
B	**B1** 6B-101	340	15.4 III-V-group nitride crystals	15.4 III-V-group nitride crystals	15.4 III-V-group nitride crystals	15.4 III-V-group nitride crystals	15.4 III-V-group nitride crystals	15.4 III-V-group nitride crystals	Materials science of singularity in nitride semiconductors-Growth, processing and electronic application-	Materials science of singularity in nitride semiconductors-Growth, processing and electronic application-
	B2 6B-102	340	7.3 Micro/Nano patterning and fabrication	7.3 Micro/Nano patterning and fabrication		Kickoff Symposium for Group of Research and Joint-Effort on Industry-Academia Partnership	Memorial Symposium for Prof. K. Kitazawa and Prof. H. Maeda	Memorial Symposium for Prof. K. Kitazawa and Prof. H. Maeda	PHONON ENGINEERING: material science, theory/simulation and measurement technologies for Nano-scale thermal management and device innovation	
	B3 6B-103	190		State of the art technology in electron and focused-ion-beam apparatuses		Optical sensing utilized in space and earth observations	Women in Applied Physics - Part III: Bioelectronics -			
	B4 6B-104	190		Quantum Photonics: Toward a new paradigm of quantum information technology	15.6 Group IV Compound Semiconductors	Progress of power semiconductors, toward wide band-gap materials beyond silicon	15.6 Group IV Compound Semiconductors	15.6 Group IV Compound Semiconductors	15.6 Group IV Compound Semiconductors	
	B5 6B-105	190		Advanced CMOS Technology and Its Future Scope	9.1 Dielectrics, ferroelectrics	Guidelines for Development of Ferroelectric Materials in the Following Generation				
	B6 6B-106	190	Feasibility of integration of perovskite semiconductors into multinary compounds solar cells	Feasibility of integration of perovskite semiconductors into multinary compounds solar cells		Advanced and Practical 3D Fabrication Techniques Using Lasers	A vision of future spintronics ~What is the next in spintronics?			
C	**C1** 6C-104	180		6.2 Carbon-based thin films	6.2 Carbon-based thin films	6.2 Carbon-based thin films			7.6 Ion beams	7.6 Ion beams
	C2 6C-207	171	16.3 Bulk, thin-film and other silicon-based solar cells	16.3 Bulk, thin-film and other silicon-based solar cells		16.3 Bulk, thin-film and other silicon-based solar cells	16.3 Bulk, thin-film and other silicon-based solar cells	Growth and characterization of bulk crystalline silicon for photovoltaic application		
	C3 6C-201	117				The latest trend of the lithography technology				
D	**D1** 16-101	165	Joint Session K	Joint Session K	Joint Session K	Valence-electron metamorphology in oxide semiconductors		Joint Session K	Joint Session K	
	D2 16-102	121	12.1 Fabrications and Structure Controls	12.1 Fabrications and Structure Controls	12.1 Fabrications and Structure Controls	Polarity-reversed optical device handling quantum photons			10.4 Semiconductors, organic, optical, and quantum spintronics	10.4 Semiconductors, organic, optical, and quantum spintronics
	D3 16-203	121	12.4 Organic light-emitting devices and organic transistors	12.4 Organic light-emitting devices and organic transistors	12.4 Organic light-emitting devices and organic transistors		12.4 Organic light-emitting devices and organic transistors		12.4 Organic light-emitting devices and organic transistors	12.4 Organic light-emitting devices and organic transistors
	D4 16-204	121	12.3 Functional Materials and Novel Devices	12.3 Functional Materials and Novel Devices	12.3 Functional Materials and Novel Devices	12.3 Functional Materials and Novel Devices	12.3 Functional Materials and Novel Devices	15.3 III-V-group epitaxial crystals	15.3 III-V-group epitaxial crystals	15.3 III-V-group epitaxial crystals 15.7 Fundamentals of epitaxy
	D5 16-205	121	12.6 Nanobiotechnology	12.6 Nanobiotechnology	15.5 Group IV crystals and alloys	Visualization and application of biointerfaces	12.6 Nanobiotechnology	12.6 Nanobiotechnology		
	D6 16-206	121	12.7 Biomedical Engineering and Biochips	12.7 Biomedical Engineering and Biochips	17.2 Structure control and process 17.1 Growth technology	17.4 Device applications	12.7 Biomedical Engineering and Biochips	12.7 Biomedical Engineering and Biochips	12.7 Biomedical Engineering and Biochips	
	D7 16-207	121	15.5 Group IV crystals and alloys	15.5 Group IV crystals and alloys	17.2 Structure control and process	17.1 Growth technology	17.3 Exploration of new functions and evaluation of basic properties		17.4 Device applications	17.4 Device applications 17.1 Growth technology
	D8 16-303	121	6.4 Thin films and New materials	17.3 Exploration of new functions and evaluation of basic properties	6.4 Thin films and New materials	6.4 Thin films and New materials	17.3 Exploration of new functions and evaluation of basic properties	17.3 Exploration of new functions and evaluation of basic properties 17.2 Structure control and process		

Schedule by Room 3

Room		Cap.	March 11 (Wed.)		March 12 (Thu.)		March 13 (Fri.)		March 14 (Sat.)	
			AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM
D	**D9** 16-304	121	6.5 Surface Physics, Vacuum	Fabrication and characterization of nano-structures prepared with advanced shadowing deposition systems	6.6 Probe Microscopy	Recent development of titanium dioxide		6.6 Probe Microscopy	6.6 Probe Microscopy	6.6 Probe Microscopy
	D10 16-305	121	6.3 Oxide electronics	6.3 Oxide electronics	6.3 Oxide electronics	New functionality of oxides generated by spin-orbit interaction	6.3 Oxide electronics	6.3 Oxide electronics	6.3 Oxide electronics	6.3 Oxide electronics
	D11 16-306	121		10.1 Emerging materials in spintronics and magnetics (excluding semiconductors)	10.1 Emerging materials in spintronics and magnetics (excluding semiconductors)	10.2 Spin torque, spin current, circuits, and measurement technologies		10.3 Giant magnetoresistance (GMR), tunnel magnetoresistance (TMR) and magnetic recording technologies	10.5 Application of magnetic field	10.3 Giant magnetoresistance (GMR), tunnel magnetoresistance (TMR) and magnetic recording technologies
	D12 16-501	77	1.5 Resources and environment	1.7 Ultrasonic	1.4 Energy conversion and storage			1.1 Interdisciplinary and General Physics	1.6 Instrumentation, measurement and Metrology	1.6 Instrumentation, measurement and Metrology
	D13 16-502	99		1.3 Novel technologies and interdisciplinary engineering	15.1 Bulk crystal growth	6.5 Surface Physics, Vacuum	Research forefront of shock wave and high & micro-gravity application science		15.1 Bulk crystal growth	
	D14 16-503	286			8.0 Plasma Electronics English Session 8.8 Plasma Electronics Invited Lecture Plasma Electronics Award Ceremony	Synthesizing methods for fine particles and their latest applications	6.6/12.2 codesharing session	12.2 Characterization and Materials Physics	12.2 Characterization and Materials Physics	12.2 Characterization and Materials Physics
	D15 16-504	286	12.5 Organic solar cells	12.5 Organic solar cells	12.5 Organic solar cells	Sensing Technologies for the Future of Automobile Society ~ The Prospect and Challenge of Autonomous Driving System ~	12.5 Organic solar cells	12.5 Organic solar cells	12.5 Organic solar cells	12.5 Organic solar cells
E	**E1** Matsumae Memorial Hall	490	Award Ceremony	Outstanding Achievement Award Lecture Award Ceremony		Smart Energy Revolution form KANAGAWA			Science Square in Shonan Campus of Tokai University Part 2 Science Square and Science Shows	
F	**F1** 2N-101	1000							Science Square in Shonan Campus of Tokai University Part 1 symposium	
P（Gymnasium）	**P1 ~ P19**	Poster Session	1.4 Energy conversion and storage 1.7 Ultrasonic 3.11 Photonic structures and phenomena 6.2 Carbon-based thin films 7.1 X-ray technologies 17 Nanocarbon Technology	[1:30 pm - 3:30 pm] 10 Spintronics and Magnetics 15.6 Group IV Compound Semiconductors [4:00 pm - 6:00 pm] 3.9 Terahertz technologies 6.1 Ferroelectric thin films 9.1 Dielectrics, ferroelectrics 16 Amorphous and Microcrystalline Materials	2.1 Radiation physics and Detector fundamentals 2.2 Detection systems 2.3 Application, radiation generators, new technology 3.4 Biomedical optics 3.5 Laser system and materials 3.10 Optical quantum physics and technologies 7.2 Applications and technologies of electron beams 7.3 Micro/Nano patterning and fabrication 11 Superconductivity 12.6 Nanobiotechnology 12.7 Biomedical Engineering and Biochips 13.3 Insulator technology 13.5 Semiconductor devices and related techologies	[1:30 pm - 3:30 pm] 1.1 Interdisciplinary and General Physics 1.3 Novel technologies and interdisciplinary engineering 1.5 Resources and environment 6.6 Probe Microscopy 9.5 New functional materials and new phenomena 12.2 Characterization and Materials Physics 12.5 Organic solar cells 13.2 Exploratory Materials, Physical Properties, Devices [4:00 pm - 6:00 pm] 8.1 Plasma production and control 8.3 Plasma deposition of thin film and surface treatment 8.6 Plasma life sciences 12.4 Organic light-emitting devices and organic transistors 13.7 Quantum properties and fabrications of nanoscale structures and devices 15.1 Bulk crystal growth 15.2 II-VI and related compounds 15.4 III-V-group nitride crystals 15.5 Group IV crystals and alloys	1.6 Instrumentation, measurement and Metrology 3.1 Basic optics and frontier of optics 3.2 Equipment optics and materials 3.3 Information photonics and image engineering 3.6 Ultrashort-pulse and high-intensity lasers 3.8 Optical measurement, instrumentation, and sensor 3.14 Optical control devices and optical fibers 3.15 Silicon photonics 8.0 Plasma Electronics English Session 8.2 Plasma measurements and diagnostics 8.4 Plasma etching 8.5 Plasma nanotechnology 12.1 Fabrications and Structure Controls 13.4 Si wafer processing /MEMS/ Integration technology 15.3 III-V-group epitaxial crystals 15.7 Fundamentals of epitaxy 15.8 Crystal evaluation, impurities and crystal defects 21 Joint Session K	[4:30 pm - 6:30 pm] 1.2 Education 3.7 Laser processing 3.12 Nanoscale optical science and near-field optics 3.13 Semiconductor optical devices 6.3 Oxide electronics 6.4 Thin films and New materials 6.5 Surface Physics, Vacuum 7.4 Buried interface sciences with quantum beams 7.5 Atomic/molecular beams and beam-related new technologies 7.6 Ion beams 8.7 Plasma phenomena, emerging area of plasmas and their new applications 9.2 Nanowires and Nanoparticles 9.3 Nanoelectronics 9.4 Thermoelectric conversion 12.3 Functional Materials and Novel Devices 13.1 Fundamental properties, surface and interface, and simulations of Si related materials 13.8 Compound and power electron devices and process technology 13.9 Optical properties and light-emitting devices 13.10 Compound solar cells, 15.2 II-VI and related compounds		

Invited Lecture of Overseas Researchers

Date	Hours	Room	Title	Speaker
3/12 (Thu.)	11:00～11:30	A11	Intracellular molecular manipulation by femtosecond laser triggering	Hao He (Shanghai Jiaotong Univ.)

English Sessions

English presentations are scheduled in the following sessions.

3.0	Optics and Photonics English Session			
	3/13 (Fri.)	9:00～11:15	Oral Session	Room A15
8.0	Plasma Electronics English Session			
	3/12 (Thu.)	9:00～10:45	Oral Session	Room D14
	3/13 (Fri.)	9:30～11:30	Poster Session	Venue P
10	Spintronics and Magnetics			
	3/11 (Wed.)	13:30～15:30	Poster Session	Venue P
10.1	Emerging materials in spintronics and magnetics (excluding semiconductors)			
	3/11 (Wed.)	15:45～18:30	Oral Session	Room D11
	3/12 (Thu.)	9:00～11:45	Oral Session	Room D11
10.2	Spin torque, spin current, circuits, and measurement technologies			
	3/12 (Thu.)	13:15～18:30	Oral Session	Room D11
10.3	Giant magnetoresistance (GMR), tunnel magnetoresistance (TMR) and magnetic recording technologies			
	3/13 (Fri.)	16:15～18:15	Oral Session	Room D11
	3/14 (Sat.)	13:00～15:00	Oral Session	Room D11
10.4	Semiconductors, organic, optical, and quantum spintronics			
	3/14 (Sat.)	9:00～15:00	Oral Session	Room D2
10.5	Application of magnetic field			
	3/14 (Sat.)	9:00～12:00	Oral Session	Room D11
13.5	Semiconductor English Session			
	3/12 (Thu.)	9:00～12:15	Oral Session	Room A23

Luncheon Seminars

Luncheon seminars sponsored by our exhibitors are scheduled during the meeting.

Date	Hours	Room	Seat	Sponsor
3/11 (Wed)	12:15 pm- 1:00 pm	B1	200	The Japan Society of Applied Physics (APEX/JJAP)
		B3	100	CRESTEC CORPORATION
3/12 (Thu.)	12:15 pm- 1:00 pm	B3	100	ELIONIX INC.
		B4	100	WITec
		B1	100	Springer Japan
		B6	100	National Institute for Materials Science (NIMS)
3/13 (Fri.)	12:15 pm- 1:00 pm	B5	100	Thermo Riko / Astech

How to Participate

Tickets for the luncheon seminars will be distributed upon presentation of your meeting badge.
Location: “Luncheon Seminars” desk at the Registration.
Hours: 8:00 am- 11:00 am on the day of the event
***first-come and first-served basis**

Please make sure to come to the seminar room before 12:10 pm and receive the lunch in exchange of the ticket.
The exchange ticket will become invalid at 12:10 pm.
Those without the ticket can wait for cancellation. Please come to the venue by 12:10 pm.

JSAP EXPO Spring 2015

The exhibit is open to everyone. Visit the exhibition showcasing latest products and technical solutions!
Complementary coffee is available at the venue.

Location: Gymnasium
Hours: March 11 (Wed.) – 13 (Fri.); 10:00 am – 6:00 pm
March 14 (Sat.); 10:00 am – 12:00 pm
Number of Exhibitors: 180 companies (expected)

List of Exhibitors (as of February 9, 2015)

AdvanceSoft Corporation, ADVANTEST CORPORATION, AILIN VACUUM CO., LTD., AIP Publishing LLC, Air Water Inc., ALD Japan, ALS Technology Co., Ltd, APF, Inc., APOLLOWAVE Corporation, ARIOS inc., Arroz Corporation, ARTRAY CO., LTD., Asahi Spectra Co., Ltd., Asahi Techno Solutions Inc., Astech Corporation, BEAMSENSE Co., LTD, Biemtron Co., Ltd. / Richimore International, Corp. , Bruker AXS K.K., Bunkoukeiki Co., Ltd., Coherent Japan, Inc., Comet Inc., Cornes Technologies Limited, CRESTEC CORPORATION, Crosslight Software Inc. Japan Branch, Crystal Optics Inc., Cybernet Systems Co., Ltd., DEFTOP CORPORATION, DIAVAC LIMITED, Digital Data Management Corporation, EIKO Corporation, ELMINET CORPORATION, EpiQuest, Inc., EpiTech Inc., Evans Analytical Group Nano Science Coporation, Filgen, Inc., FORESIGHT TECHNO CO., LTD., Foundation for Promotion of Material Science and Technology of Japan, FUJIFILM Global Graphic Systems Co., Ltd. , FUJITSU LIMITED, GREEN TEC CORPORATION, Hakuto Co., Ltd., Hamamatsu Photonics K.K., HiSOL, INC., HORIBA, Ltd., HTL Co. Japan Ltd., Hulinks Inc., IOP Publishing, IRC, Inc., J.A.Woollam Japan Corp., Japan High Tech Co., Ltd., Japan Laser Corporation, JASCO Corporation, JECC TORISHA Co., Ltd., JEOL Ltd., JSW AFTY Corporation, Kantum Electronics Co., Ltd., KASHIYAMA INDUSTRIES, LTD., Keisoku Engineering System, Co., Ltd., Kenix, Keysight Technologies, KIMMON KOHA Co., Ltd., Kinokuniya Company Ltd., KITANO SEIKI CO., LTD., KITZ SCT, Kogakugiken Corp., Kohzu Precision Co., Ltd., Kojundo Chemical Lab. Co., Ltd., KOKEN LTD., KOSAKA LABORATORY LTD., Lasertec Corporation, LightStone Corp., LINTEC CO., LTD. , LUFT LIMITED, MECC CO., LTD, MEIDENSHA CORPORATION, Micro Support Co., Ltd., MO SANGYO CO., LTD., Momentive Performance Materials Japan LLC, MUSASHI ENGINEERING, INC., MUSASHINO DENSHI, INC., Mutumi Corporation, Nagase Techno-Engineering Co.,Ltd., NANOFACTOR Co., Ltd., Nanometrics Japan Ltd., Nanophoton Corporation, NanoSystem Solutions, Inc., Nanotechnology Platform Japan, NAPSON CORPORATION, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), National Institute of Radiological Sciences, NEOARK CORPORATION, NF Corporation Co., Ltd., NIHON EXCEED CORPORATION, NIHON KOSHUHA CO., LTD., Nippon Automatic Control Co., Nippon Roper, K.K., Ocean Photonics, Inc., OPHIR JAPAN LTD., OPTIMA CORPORATION, Opto Science, Inc., Opto Sirius Corporation, OS TECH CO., LTD., OSAKA VACUUM, LTD., Otsuka Electronics Co., Ltd., Oxford Instruments KK, OXIDE Corporation, P&C LTD., Park Systems Japan Inc., PASCAL CO., LTD., PHOTON Design Corporation, PI-CRYSTAL.inc., PMT CORPORATION, PNEUM Co., Ltd., Prolinx Corporation, Quantum Design Japan, Inc., Rayture Systems Co., Ltd., R-DEC Co., Ltd., Rigaku Corporation, RIKEN KEIKI CO., LTD., Riko International Co., LTD. / Micro Tec. Co., LTD., ROCKGATE Corporation, SAES Getters S.p.A., Japan Branch, SAKAGUCHI E.H VOC CORP., SAKIGAKE-Semiconductor Co., Ltd., SAMCO Inc., SANKEI CO., LTD., SANYU ELECTRON CO., LTD., SCETI K.K, Schrödinger K.K., SCIVAX Corporation, SEED Lab., Corporation, SEIBU GIKEN CO., LTD. , Semilab Japan KK, Sensofar Japan LTD., Sevensix Inc., SIGMA TECH Co., Ltd., Sigma-Aldrich Japan G.K., Solpit Industry, SOMA OPTICS, LTD., Spectra Design Ltd., Spectra Quest Lab. Inc. , Spectris Co.,Ltd. PANalytical Division, SPLEAD Corporation, Springer, SUGA Co., Ltd., Syouei System Co. Ltd., SystemBrain, SYSTEMHOUSE SUNRISE Inc., Systems Engineering Inc., Taiei Electric Co., TAIYO NIPPON SANSO Corporation, TAMURA CORPORATION, TANAKA PRECIOUS METALS, Tec Corporation, Technohands Co., Ltd., Technology Link, Ltd., Technoport Co., Ltd., TEGA Science, Inc., THAMWAY CO., LTD., The Japan Science and Technology Agency (JST) , The Japan Society of Applied Physics, THERMO RIKO CO., LTD., Thermocera Japan Ltd., TNS Systems LLC, TokushuDenshiKairo Inc., TOKYO INSTRUMENTS, INC., TOMOE Engineering Co., Ltd., Toshima Manufacturing Co., Ltd., TOYAMA CO., Ltd., TOYO Corporation, ULVAC CRYOGENICS INC. , UNISOKU Co., Ltd., VAT Ltd., Vector Semiconductor CO., LTD., VG Scienta, VIC International Co., ltd., Watty Corporation, WITec K.K., Zurich Instruments Ltd.

5th JSAP Photo Contests *(Science as Art)*

Vote your favorite and win a prize!

Location: Gymnasium
Hours: March 11 (Wed.) – 13 (Fri.); 10:00 am – 6:00 pm
March 14 (Sat.); 10:00 am – 12:00 pm

Stamp Rally

Get 2 signatures from exhibitors and win a prize!

■Application for International Postdoctoral Membership

International Postdoctoral Membership is new membership type for a member without Japanese nationality who received a doctoral degree from a Japanese university and will belong/ belong to overseas institutions. .
With the annual membership fee of 3,000 JPY, International Postdoctoral Members are eligible to subscribe for free to the JSAP's online English journal (APEX /JJAP) instead of JSAP's Japanese membership journal (OYO BUTURI).
The valid period of the membership is for three years including the year of returning to their home country.
Please fill out the application form and bring it to information desk at registration or send by post, fax or by email as a scanned document to the following.

Membership Services, The Japan Society of Applied Physics
Yushima Urban Bldg. 7F, 2-31-22 Yushima, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0034
TEL: +81-3-5802-0862 FAX: +81-3-5802-6250
Email: membership@jsap.or.jp

(Paragraph 5, Article 2 of the Detailed Rules of The Japan Society of Applied Physics)
As a general rule, if a Member without Japanese nationality who received a doctoral degree from a Japanese university and belongs to an overseas institution applies in accordance with prescribed procedures based on nomination of an educator at the Japanese university, he/she will, upon review by the international committee, be approved as an International Postdoctoral Member. International Postdoctoral Members may gratuitously view only Applied Physics Express (APEX) and the Japanese Journal of Applied Physics (JJAP), English journals, instead of Japanese journals. The period of this provision shall be for three years, including the year of returning to the home country.

The Japan Society of Applied Physics
International Postdoctoral Member Application Form

Date:

I, hereby, declare that I have the qualification prescribed paragraph 5, Article 2 of the Detailed Rules of the Japan Society of Applied Physics, and apply to become an International Postdoctoral Member.

Applicant Information
Name:
Membership Number:
University:
Expected Graduation Year:
Affiliation after Graduation:
Start Date of Subscription to APEX/JJAP: (Month/Year)
Research Area:

Endorser
Academic Supervisor's Name: _____
(Signature)

Membership Number: